

第 16 回応用物理学学会業績賞受賞記念講演 / 16th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture

第 16 回応用物理学学会業績賞受賞記念講演 / 16th JSAP Outstanding Achievement Award Lecture

3/20(Sun.) 10:00 - 10:45 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場

10:00 招 20a-W541-1 【第 16 回応用物理学学会業績賞 (研究業績) 受賞記念講演】 ○香取 秀俊^{1,2}
(45 分)

1. 東京大学, 2. 理研

光格子時計の発明と展開

3/20(Sun.) 10:45 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場

10:45 招 20a-KD-6 【第 16 回応用物理学学会業績賞 (研究業績) 受賞記念講演】 ○堀池 靖浩¹
(45 分)

1. 筑波大学

半導体ドライエッチング技術の先駆的研究開発と産業展

開への貢献

特別シンポジウム / Special Symposium

科学と産業の凋落と再興: 応用物理と未来社会 / Decline and Revival of Science and Industry: Applied Physics and Future Society

3/19(Sat.) 13:00 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場

13:00 招 19p-KD-1 開会の辞

保立 和夫¹、河田 聡²

1. 東京大学大学院工学系研究科教授, 2. 大阪大学工学研究科教授

13:10 招 19p-KD-2 日本の大学の研究競争力はなぜ弱くなったのか?

○豊田 長康¹

1. 鈴鹿医療科学大学学長

13:50 招 19p-KD-3 電子立国は、なぜ凋落したか

○西村 吉雄¹

1. 技術ジャーナリスト

14:30 招 19p-KD-4 大学とアカデミアへの要望/自主性こそ鍵

○田中 一宜¹

1. 科学技術振興機構研究開発戦略センター特任フェロー

15:10 招 19p-KD-5 日本の大学・公的研究機関からのグローバルベンチャー

○土谷 大¹

1. 九州大学客員准教授

創出にむけて

15:50 休憩/Break

16:10 招 19p-KD-6 総合討論

○河田 聡¹、豊田 長康²、西村 吉雄³、田中 一宜⁴、土谷 大⁵

1. 大阪大学工学研究科教授, 2. 鈴鹿医療科学大学学長, 3. 技術ジャーナリスト, 4. 科学技術振興機構研究開発戦略センター特任フェロー, 5. 九州大学客員准教授

17:10 招 19p-KD-7 閉会の辞

○中野 義昭¹

1. 東京大学大学院工学系研究科教授

産学協働シンポジウム - 未来創生に向けて - / SANGAKUKYODO Symposium - Creating New Bottles for New Wine -

3/19(Sat.) 13:30 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場

13:30 招 19p-S222-1 開催の挨拶

○末光 眞希¹

1. 東北大

13:35 招 19p-S222-2 変革の時代: 技術者はデザイン力を持って

○澤谷 由里子¹

1. 東京工科大

14:05 招 19p-S222-3 人間 + 機械の未来

○暦本 純一^{1,2}

1. ソニーコンピュータサイエンス研究所, 2. 東大

14:35 招 19p-S222-4 トヨタの環境チャレンジ

○小木曾 聡¹

1. アドヴィックス

15:05 休憩/Break

15:20 招 19p-S222-5 今求められる大学発イノベーション

○坂本 修一¹

1. 文部科学省

15:40 招 19p-S222-6 国家財政と科学技術イノベーション

○片山 健太郎¹

1. 財務省

16:00 招 19p-S222-7 IoT 世界におけるトリリオン・センサと MEMS

○神永 晋¹

1. SK グローバルアドバイザーズ

16:30 招 19p-S222-8 パネルディスカッション「未来創生に必要な環境づくり」

○堂免 恵¹、澤谷 由里子²、坂本 修一³、片山 健太郎⁴、暦本 純一^{5,6}、小木曾 聡⁷、神永 晋⁸

1. 湧志創造, 2. 東京工科大, 3. 文部科学省, 4. 財務省, 5. ソニーコンピュータサイエンス研究所, 6. 東大, 7. アドヴィックス, 8. SK グローバルアドバイザーズ

17:25 招 19p-S222-9 閉会の挨拶

○堂免 恵¹

1. 湧志創造

応用物理分野で活躍する女性達 - 第 4 回 プラズマと応用技術編 - / Women in Applied Physics - Part4: Plasma Electronics -

3/21(Mon.) 13:00 - 17:50 口頭講演 (Oral Presentation) H101 会場

13:00 招 21p-H101-1 はじめに

○増田 淳¹

1. 産総研

13:05 招 21p-H101-2 会長挨拶

○保立 和夫¹

1. 東大

13:15 招 21p-H101-3 物理/工学/フォトンクスにおける女性の活躍

○伊賀 健一¹

1. 東工大

14:15 招 21p-H101-4 プラズマを応用したポリマー表面処理技術とバイオデバイス創製

○高井 まどか¹

1. 東大院工

14:40 招 21p-H101-5 プラズマ表面改質による生体材料の高機能化

○大矢根 綾子¹

1. 産総研

15:05 休憩/Break

15:15 招 21p-H101-6 プラズマプロセスを用いたチタンおよびその合金の生体適合性向上

○稗田 純子¹、リザ シャヒラ¹、赤坂 大樹¹、大竹 尚登¹、堤 祐介²、永井 亜希子²、瑞 隆夫²、松尾 誠³、岩本 喜直³

1. 東工大, 2. 東医歯大, 3. iMott

15:40 招 21p-H101-7 プラズマ誘起気泡によるバイオメディカル応用

○山西 陽子¹

1. 芝浦工大

16:05 招 21p-H101-8 DLTS 法による半導体材料へのプラズマエッチングダメージ評価

○竹内 和歌奈¹、クスマンダリ¹、坂下 満男¹、中塚 理¹、徳田 豊²、財満 鎮明^{1,3}

1. 名古屋大院工, 2. 愛知工大, 3. 名古屋大未来研

16:30 招 21p-H101-9 次世代電力機器開発に向けた高電界現象の理解とその制御

○熊田 亜紀子¹

1. 東大工

16:55 休憩/Break

17:00 招 21p-H101-10 パネルディスカッション

○為近 恵美¹、伊賀 健一²、高井 まどか³、中島 寛⁴、根本 香絵⁵

1. NTT-AT, 2. 東工大, 3. 東大, 4. NTT 物性研, 5. NII

「Internet of Things を俯瞰する」 - 応用物理から実装技術、アプリ、ビッグデータまで - / Overlooking "IoT" - From Applied Physics to Electronics Packaging, IoT Application, and Big Data -

3/21(Mon.) 13:00 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) W9 会場

13:00 招 21p-W9-1 はじめに

○森田 行則¹

1. 産総研

13:10 招 21p-W9-2 IoT の現状

○徳田 英幸¹

1. 慶応大

14:00 招 21p-W9-3 IoT とデバイス実装

○折井 靖光¹

1. IBM

14:50 招 21p-W9-4 IoT と環境発電

○竹内 敬治¹

1. NTT

15:40 休憩/Break

15:50 招 21p-W9-5 IoT とセンサ

○田中 秀治¹

1. 東北大

16:40 招 21p-W9-6 IoT と次世代人工知能技術

○本村 陽一¹

1. 産総研

17:30 招 21p-W9-7 IoT と半導体テクノロジー

○西山 彰¹

1. 東芝

18:20 招 21p-W9-8 おわりに

○若林 整¹

1. 東工大

『フォノンエンジニアリングの広がり』 ~ ナノスケール熱制御がもたらす、新しい熱伝導・断熱・蓄熱・変換技術の基礎と応用

/ PHONON ENGINEERING AND ITS WIDENING APPLICATIONS: nano-scale physics and new thermal management solutions for heat transfer, insulator, storage and conversion

3/22(Tue.) 9:00 - 11:55 口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場

9:00 招 22a-KD-1 開会の挨拶

○塩見 淳一郎¹

1. 東大工

9:10 招 22a-KD-2 来賓ご挨拶

○守屋 直文¹

1. 内閣府

9:15 招 22a-KD-3 自動車における熱マネジメント

○乾 究¹

1. トヨタ自動車

9:40 招 22a-KD-4 ナノスケールデバイスのための電子輸送とフォノン輸送

伊藤 直人¹、○栗野 祐二¹

1. 慶大理工

のセルフコンシステント・モンテカルロ・シミュレーション技術

10:05 招 22a-KD-5 CNT を用いた熱伝導材料の開発とその応用

○阿多 誠介¹、嶋 賢治¹

1. 産総研

10:30 休憩/Break

10:40	招 E 22a-KD-6	Development of high performance aerogel thermal insulation materials comparable to vacuum panels	○ Rudder Wu ¹ , Raymond Virtudazo ¹ , Takao Mori ¹	1.NIMS
11:05	招 22a-KD-7	熱伝導度に異常な温度依存性を示す材料を利用した熱流ダイオードの開発	○竹内 恒博 ¹	1. 豊田工大
11:30	招 22a-KD-8	マイクロ機械共振器による電氣的フォノン制御	○山口 浩司 ¹	1.NTT 物性科学基礎研
3/22(Tue.) 12:45 - 15:00	口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場			
12:45	招 22p-KD-1	ナノスケール熱伝導率センシング：フォノンスペクトロスコピー	○長坂 雄次 ¹	1. 慶大理工
13:10	招 22p-KD-2	単一ナノ材料の伝熱特性計測デバイスの量産技術の開発と展望	○児玉 高志 ¹	1. 東大
13:35	招 22p-KD-3	フォノンをリアルタイム可視化するフェムト秒動画撮像法	○合田 圭介 ^{1,2}	1. 東大, 2.UCLA
14:00	招 22p-KD-4	第一原理フォノン伝導計算：その最前線とポスト「京」/マテリアルズインフォマティクス時代への展望	○只野 央将 ¹ , 常行 真司 ¹	1. 東大
14:25	招 22p-KD-5	長期的に熱エネルギー保存できる蓄熱セラミックス	○大越 慎一 ¹	1. 東大
14:50	22p-KD-6	閉会の挨拶	○野村 政宏 ¹	1. 東大

分科企画シンポジウム / Symposium

1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology

S.1 エネルギーマネジメント：小規模システムの事例に学ぶ再生可能エネルギーの導入ポテンシャル

/ Energy management - possibility of renewable energy installation learning from small systems -

3/19(Sat.) 13:30 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) W641 会場

13:30	招 19p-W641-1	再生可能エネルギーとネガワットの導入に対応した次世代エネルギーマネジメントシステム手法の開発	○林 泰弘 ¹	1. 早大理工 JST CREST
14:00	招 19p-W641-2	宮古島市における島嶼型スマートコミュニティの取り組み	○三上 暁 ¹	1. 宮企エコ
14:30	招 19p-W641-3	供給制約・需要制約下における地域エネルギーシステム：種子島の事例	○菊池 康紀 ^{1,2,3}	1. 東大総括プロ, 2. 九大 I2CNER, 3. 千葉大環境センター
15:00	休憩 / Break			
15:15	招 19p-W641-4	デジタルグリッドがもたらす IoT (Internet of Energy and Things)	○阿部 力也 ^{1,2}	1. 東大技術経営, 2. 東大総括寄付講座
15:45	19p-W641-5	水溶液電解法による二酸化炭素還元	○松本 純 ¹ , 武藤 昭博 ¹ , 武田 大 ¹ , 杉山 正和 ² , 藤井 克司 ²	1. 千代田化工, 2. 東大
16:00	招 19p-W641-6	各種熱駆動ケミカルヒートポンプによる未利用・再生可能エネルギーマネジメントシステム	○小倉 裕直 ¹	1. 千葉大院工
16:30	招 19p-W641-7	総合討論	○杉山 正和 ¹	1. 東大

3 光・フォトンクス / Optics and Photonics

S.2 偏光計測制御の新展開 / New developments in polarization measurement and control

3/19(Sat.) 13:30 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場

13:30	招 19p-S621-1	イントロダクトリトック：偏光計測制御の新展開	○岡 和彦 ¹ , 大谷 幸利 ² , 和田 篤 ³	1. 北大, 2. 宇都宮大, 3. 防衛大
13:45	招 E 19p-S621-2	Berry Phase, Polarization, and Point Spread Function in High Etendue Optical Systems	○Russell A Chipman ^{1,2}	1.Univ. of Arizona, 2.Utsunomiya Univ.
14:15	招 19p-S621-3	統計的波動場の偏光とコヒーレンスの制御	○武田 光夫 ¹	1. 宇都宮大 CORE
14:45	招 E 19p-S621-4	Polarization of Skylight	○Joseph A Shaw ¹ , Laura M Dahl ¹ , Nathan J Pust ¹	1.Montana State Univ.
15:15	休憩 / Break			
15:30	招 19p-S621-5	偏光の干渉とホログラフィー	○黒田 和男 ¹	1. 宇大オプト
16:00	招 19p-S621-6	偏光イメージングカメラを用いたシングルショット位相シフトデジタルホログラフィーとシングルショット偏光デジタルホログラフィー	○栗辻 安浩 ¹	1. 京都工繊大
16:30	19p-S621-7	チャープパルスを用いた直線偏光の偏光方位の超高速回転	○永井 美祐 ¹ , 坂本 盛嗣 ^{2,3} , 山根 啓作 ² , 森田 隆二 ² , 岡 和彦 ²	1. 北大工, 2. 北大院工, 3. 長岡技科大
16:45	奨 19p-S621-8	6 個の光強度検出器を用いたストークス偏光計	○(DC) 柴田 秀平 ¹ , 川畑 州一 ² , 大谷 幸利 ¹	1. 宇大工, 2. 東京工芸大
17:00	E 19p-S621-9	A partial Mueller matrix polarimeter using two photoelastic modulator and polarizer pairs	○(B)Nia Natasha Tipol ¹ , Shuichi Kawabata ² , Yukitoshi Otani ¹	1.Utsunomiya Univ. for Utsunomiya University, 2.Tokyo Polytechnic Univ. for Tokyo Polytechnic University

11 超伝導 / Superconductivity

S.3 銅酸化物超伝導体発見 30 周年記念シンポジウム / 30th Anniversary Symposium on the Discovery of Cuprate Superconductors

3/19(Sat.) 13:15 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) H101 会場

13:15	招 19p-H101-1	銅酸化物高温超伝導体の理解の現状—実験的側面を中心に—	○前田 京剛 ¹	1. 東大総合文化
13:45	招 19p-H101-2	高温超伝導：これまで、これから。	○福山 秀敏 ¹	1. 東京理科大学総研院
14:30	招 E 19p-H101-3	HTS conductors for high field magnets in the next 10 years	○David Christopher Larbalestier ¹	1.Florida State U
15:15	休憩 / Break			
15:30	招 19p-H101-4	高度に結晶配向制御された銅酸化物系高温超伝導線材～RE123 線材を中心に～	○飯島 康裕 ¹	1. フジクラ
16:00	19p-H101-5	ナノ粒子 APC 導入 REBCO 薄膜の磁束ピンニング特性	○松本 要 ¹ , 西原 匡弥 ¹ , 堀出 朋哉 ¹	1. 九工大工
16:15	招 19p-H101-6	高温超伝導材料のエレクトロニクス応用の進展と今後の展望	○田辺 圭一 ¹	1. 超電導工研
16:45	19p-H101-7	高温超伝導体 Bi2212 テラヘルツ光源の多機能化	○掛谷 一弘 ¹ , エララビ アセム ¹ , 温 一凡 ¹ , 土居 卓司 ¹ , 辻本 学 ^{1,2}	1. 京大院工, 2. 筑波大数理物質
17:00	19p-H101-8	高温超伝導線材技術の船舶脱磁への応用	○廣田 恵 ¹	1. 艦磁研
17:15	19p-H101-9	25T 無冷媒超伝導マグネットの初期性能試験	○淡路 智 ¹ , 小黒 英俊 ¹ , 渡辺 和雄 ¹ , 宮崎 寛史 ² , 戸坂 泰造 ² , 花井 哲 ² , 井岡 茂 ²	1. 東北大金研, 2. 東芝

12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics

S.4 日韓の有機エレクトロニクス研究：現状と次の飛躍に向けて / Recent Progress of Organic Electronics in Japan and Korea: For the Next Jump

3/19(Sat.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W521 会場

13:45	招 E 19p-W521-1	Trends in Evaluation of Bulk and Interface Electronic Structures of Organic Semiconductors	○Hisao Ishii ^{1,2,3}	1.CFS, Chiba U., 2.AIS, Chiba U., 3.MCRC, Chiba U.
14:15	招 E 19p-W521-2	Manipulation of Carrier Injection Barriers of Multilayer Graphene Electrode for OLED	○Yongsup Park ¹ , Min-Jae Maeng ¹ , Ji-Hoon Kim ¹ , Jong-Am Hong ¹ , Joohyun Hwang ² , Hong Kyw Choi ² , Jaehyun Moon ² , Jeong-Ik Lee ²	1.Kyung Hee U., Korea, 2.ETRI, Korea
14:45	招 E 19p-W521-3	High-performance organic transistors and printed LSIs	○Jun Takeya ¹	1.the Univ. of Tokyo

15:15	招 E 19p-W521-4	Highly flexible low voltage electronic devices based on ultrathin polymer dielectrics	○ Seunghyup Yoo ¹ , Hanul Moon ¹ , Hyejeong Sung ¹ , Seungwon Lee ¹ , Mincheol Kim ¹ , Sung Gap Im ¹	1.KAIST
15:45		休憩 / Break		
16:00	招 E 19p-W521-5	Recent Progress of Degradation Analysis of Organic Light Emitting Diodes	○ Hideyuki Murata ¹	1.JAIST
16:30	招 E 19p-W521-6	High Efficiency Organic-Inorganic Hybrid Perovskite Light-Emitting Diodes	Himchan Cho ¹ , Su-Hun Jeong ¹ , Min-Ho Park ¹ , Young-Hoon Kim ¹ , Christoph Wolf ¹ , Chang-Lyoul Lee ² , Jin Hyuck Heo ³ , Aditya Sadhanala ⁴ , NoSung Myoung ² , Seunghyup Yoo ⁵ , Sang Hyuk Im ³ , Richard H. Friend ⁴ , ○ Tae-Woo Lee ^{1,6}	1.Dept. of Mat. Sci.&Eng., POSTECH, 2.Gwangju Inst. of Sci.&Tech.(GIST), 3.Kyung Hee Univ., 4.Univ. of Cambridge, 5.Korea Adv. Inst.of Sci.&Tech.(KAIST), 6.Dept. of Chem.Eng. Div. of Adv. Mat. Sci., Sch. of Environ. Sci.&Eng. POSTECH
17:00	招 E 19p-W521-7	Recent progress and future of organic photovoltaic cells	○ Masahiro Hiramoto ¹	1.IMS
17:30	招 E 19p-W521-8	Environment Sensitive LSPR of Ag Nanodot Arrays Incorporated Polymer Solar Cells	Seyeong Song ¹ , Jungwoo Heo ² , Tae Kyung Lee ¹ , Hye Rim Yeom ¹ , Soojin Park ^{2,1} , Bright Walker ¹ , Sang Kyu Kwak ^{1,3} , ○ Jin Young Kim ^{1,2}	1.Dept. of Energy Eng., Sch. of Energy&Chem. Eng., Ulsan Nat. Inst. of Sci.&Tech., 2.Dept. of Phys., Ulsan Nat. Inst. of Sci.&Tech., 3.Center for Multidimensional Carbon Materials, Inst. for Basic Sci.

13 半導体 / Semiconductors

S.5 化合物薄膜太陽電池の高効率化技術の現在と未来 / Efficiency improvement for thin film compound semiconductor solar cells in the present and future

3/19(Sat) 13:15 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場				
13:15	招 19p-W541-1	Cu ₂ ZnSnS ₄ (CZTS) 太陽電池の高効率化に関する検討	○田島 伸 ¹	1. 豊田中研
13:45	招 19p-W541-2	Cu ₂ ZnSn(S, Se) ₄ 薄膜の CdS 層製膜前における表面処理の効果	○西永 慈郎 ¹ 、反保 衆志 ¹ 、酒井 紀行 ² 、加藤 拓也 ² 、杉本 広紀 ² 、柴田 肇 ¹ 、仁木 栄 ¹	1.産総研, 2. ソーラーフロンティア
14:00	奨 19p-W541-3	バンド傾斜構造による Cu ₂ Sn _{1-x} Ge _x (CTGS) 太陽電池の高効率化	○梅原 密太郎 ¹ 、田島 伸 ¹ 、竹田 康彦 ¹ 、元廣 友美 ¹	1. 豊田中研
14:15	招 19p-W541-4	CIGS 系化合物薄膜太陽電池の高効率化技術の現在と未来	○柴田 肇 ¹	1. 産総研
14:45	E 19p-W541-5	Effect of Additional Indium Deposition after Cu(In,Ga)Se ₂ Thin Film Growth for Potassium Fluoride Post-deposition Treatment	○ Ishwor Khatri ¹ , Mutsumi Sugiyama ¹ , Tokio Nakada ¹	1.Tokyo University of Science
15:00	奨 19p-W541-6	Zn _{1-x} Mg _x O バッファー層による Cu(In,Ga)S ₂ 薄膜太陽電池の変換効率改善	○廣井 啓 ^{1,2,3} 、岩田 恭彰 ^{1,2} 、杉本 広紀 ^{1,2} 、山田 明 ³	1. ソーラーフロンティア, 2. 昭和シェル石油, 3. 東工大 院理工
15:15	招 19p-W541-7	スマートスタック異種多接合太陽電池	○菅谷 武芳 ¹ 、牧田 紀久夫 ¹ 、水野 英範 ¹ 、大島 隆治 ¹ 、太野垣 健 ¹	1.産総研
15:45	奨 19p-W541-8	In ₂ O ₃ /Sn/Cu(In,Ga)Se ₂ の ohmic-like 接合の形成による superstrate 型 Cu(In,Ga)Se ₂ 太陽電池の作製	○新井 裕之 ¹ 、新澤 雄高 ¹ 、立野 俊史 ¹ 、峯元 高志 ¹	1. 立命館大
16:00		休憩 / Break		
16:15	招 19p-W541-9	III-V 族多接合型太陽電池の動向について	○高本 達也 ¹ 、鷲尾 英俊 ¹ 、十楚 博行 ¹	1. シャープ
16:45	招 19p-W541-10	量子ドット中間バンド太陽電池の高効率化メカニズム	○岡田 至崇 ¹ 、庄司 靖 ¹ 、玉置 亮 ¹ 、吉田 勝尚 ¹ 、曾我部 東馬 ¹	1. 東大先端研
17:15	奨 19p-W541-11	量子ドット太陽電池の高効率化に向けたキャップ層厚みによる室温サブレベル間吸収制御	○古川 弘文 ^{1,2,3} 、渡邊 克之 ^{1,2} 、小谷 晃央 ^{1,2,3} 、岩本 敏 ^{1,2} 、和泉 真 ³ 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子機構, 2. 東大生研, 3. シャープ (株)
17:30	招 19p-W541-12	GaN/Ga ₂ O ₃ 基板および GaN 基板に成長した InGaN/GaN MQW 太陽電池特性	○渡邊 則之 ¹ 、満原 学 ¹ 、重川 直輝 ²	1.NTT 先デ研, 2. 大阪市大
17:45	招 19p-W541-13	CdTe 太陽電池の最近の展望	○岡本 保 ¹	1. 木更津高専
18:15	招 19p-W541-14	ペロブスカイト太陽電池高効率化のための材料開発	○若宮 淳志 ^{1,2} 、西村 秀隆 ¹ 、中池 由美 ¹ 、嶋崎 愛 ¹ 、村田 靖次郎 ¹	1. 京大化研, 2.JST- さきがけ

13 半導体 / Semiconductors

15 結晶工学 / Crystal Engineering

16 非晶質・微結晶 / Amorphous and Microcrystalline Materials

S.6 発光イメージングが切り拓く半導体結晶・デバイス評価の明るい未来 / Blazing frontier of luminescence imaging for characterization of semiconductor crystals and devices

3/19(Sat) 13:30 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) S011 会場				
13:30	招 19p-S011-1	イントロダクトリートーク ~発光イメージングから見えるもの~	○香掛 健太郎 ¹	1. 東北大金研
13:45	招 19p-S011-2	太陽電池の絶対エレクトロルミネッセンス画像計測法と応用	○秋山 英文 ¹	1. 東大物性研
14:15	奨 19p-S011-3	PL イメージングを用いた強制汚染およびゲッターリングによる多結晶 Si 中の鉄およびニッケルの影響評価	○鈴木 涼太 ¹ 、池野 成裕 ^{1,2} 、小島 拓人 ¹ 、大下 祥雄 ³ 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大理工, 2. 学振特別研究員, 3. 豊田工大
14:30	招 19p-S011-4	フォトルミネッセンス・マッピング法による CIGS 太陽電池の評価	○白方 祥 ¹	1. 愛媛大工
15:00	招 19p-S011-5	EL 測定を用いた GaAs 太陽電池の構造評価と効率向上	○井上 智之 ¹ 、トープラサートボン カシディット ¹ 、デラマレー アモリ ^{1,2} 、渡辺 健太郎 ^{1,2} 、ギルモージェンフランソワ ² 、杉山 正和 ^{1,2} 、中野 義昭 ^{1,2}	1. 東大工, 2. ネクスト PV
15:15		休憩 / Break		
15:30	招 19p-S011-6	PL イメージングによる 4H-SiC 結晶欠陥の評価	○土田 秀一 ¹ 、鎌田 功穂 ¹ 、田沼 良平 ¹ 、長野 正裕 ¹	1. 電中研
16:00	招 19p-S011-7	4H-SiC MOSFET 中の単一表面欠陥の共焦点顕微鏡観察	○梅田 享英 ¹ 、阿部 裕太 ¹ 、Y.-W. Zhu ¹ 、岡本 光央 ¹ 、小杉 亮治 ² 、原田 信介 ² 、春山 盛善 ³ 、小野田 忍 ³ 、大島 武 ³	1. 筑波大数物, 2. 産総研, 3. 原子力機構
16:15	招 19p-S011-8	時間空間分解カソードルミネッセンスによる III 族窒化物半導体の評価	○秩父 重英 ¹ 、山崎 芳樹 ¹ 、小島 一信 ¹	1. 東北大多元研
16:45	招 19p-S011-9	InGaN 薄膜の分光 CL マッピング像の温度依存性評価 (2)	○倉井 聡 ¹ 、黒飛 雄樹 ¹ 、山田 陽一 ¹	1. 山口大院理工
17:00	招 19p-S011-10	近接場過渡レンズ法による InGaN 単一量子井戸におけるキャリアダイナミクスの評価	○塚本 真大 ¹ 、石井 良太 ¹ 、船戸 充 ¹ 、川上 養一 ¹	1. 京大院工
17:15	招 19p-S011-11	Nanoprobe-CL 法による半導体ナノ結晶の顕微物性評価	○渡辺 健太郎 ^{1,2}	1. 阪大院基礎工, 2. 物材機構

13 半導体 / Semiconductors

S.24 IoT アプリケーションと、それを支えるキーテクノロジー / IoT Application and Key Technologies

3/19(Sat) 13:30 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
13:30	招 19p-W631-1	IoT を支えるデジタルものづくりのエコシステム	○川原 圭博 ¹	1. 東大情理
14:00	招 19p-W631-2	IoT 時代の LSI 回路技術の役割と期待	○森村 浩季 ¹ 、大嶋 尚一 ¹ 、松永 賢一 ¹ 、ムサ アハマド ¹ 、近藤 利彦 ¹	1. 日本電信電話

14:30	招 19p-W631-3	IoT 応用を目指した MEMS 振動発電素子	○年吉 洋 ¹	1. 東大
15:00	招 19p-W631-4	IoT における低電力 LSI デバイス (SOTB) の最新技術	○山口 泰男 ¹ 、新川田 裕樹 ¹ 、蒲原 史朗 ¹ 、犬石 昌秀 ¹	1. ルネサスエレクトロニクス
15:30		休憩 / Break		
15:45	招 19p-W631-5	IoT とデジタルトランスフォーメーション	○森川 博之 ¹	1. 東大
16:15	招 19p-W631-6	センサがもたらす IoT 化と環境計測	○松本 佳宣 ¹	1. 慶大理工
16:45	招 19p-W631-7	センサネットワークに適した無線通信規格 Wi-SUN について	○山田 亮太 ¹	1. オムロン
17:15	招 19p-W631-8	Cognitive Computing に向けた Neuromorphic device	○山道 新太郎 ¹	1. 日本 IBM
17 ナノカーボン / Nanocarbon Technology				
S.8 日韓ジョイントシンポジウム: 機能性 2 次元材料の現状と新展開 / Recent progress and future prospects of functional 2-dimensional materials				
3/19(Sat.) 9:45 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) S221 会場				
9:45	E 19a-S221-1	Opening Address	○ Eisuke Tokumitsu ¹ , Yongmin Kim ²	1. JAIST, 2. Dankook Univ.
10:00	招 E 19a-S221-2	Application of Layered Chalcogenide Materials to Atomic Layer Electronics	○ Keiji Ueno ¹	1. Saitama Univ.
10:30	招 E 19a-S221-3	Electronic and optical properties of monoclinic MoTe ₂	○ Heejun Yang ¹ , Suyeon Cho ² , Jaeyoon Baik ³ , K. J. Chang ³ , Kazu Suenaga ⁴ , Sung Wng Kim ¹ , Young Hee Lee ²	1. Department of Energy Science, Sungkyunkwan University (SKKU), 2. IBS Center for Integrated Nanostructure Physics (CINAP), Sungkyunkwan University (SKKU), 3. Department of Physics, KAIST, 4. National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), 5. Pohang Accelerator Laboratory, POSTECH
11:00	招 E 19a-S221-4	Valley physics in 2D crystals of transition metal dichalcogenides	○ Yijin Zhang ¹ , Yoshihiro Iwasa ^{1,2}	1. Univ. Tokyo, 2. RIKEN
11:30	招 E 19a-S221-5	Selective deformation of monolayer MoS ₂ by illuminating laser and magnetotransport of 2D materials probed up to 60 T	○ Sung Ho Jhang ¹ , Sung Won Kim ¹ , Jeong Hyeon Na ¹	1. Konkuk Univ.
3/19(Sat.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) S221 会場				
13:45	招 E 19p-S221-1	Atomically thin hetero-structural semiconductors	○ Kazuhito Tsukagoshi ¹	1. NIMS
14:15	招 E 19p-S221-2	Oxidation of 2-Dimensional Semiconductors and Its Implication towards Applications	○ Sunmin Ryu ¹	1. POSTECH
14:45	招 E 19p-S221-3	CVD growth of atomically-thin transition metal dichalcogenides and their heterostructures	○ Yasumitsu Miyata ^{1,2}	1. Tokyo Metropolitan Univ., 2. JST-PRESTO
15:15	招 E 19p-S221-4	Two-dimensional van der Waals Heterostructures for Advanced Electronics	○ Gwan-Hyoung Lee ¹	1. Yonsei Univ.
15:45		休憩 / Break		
16:00	招 E 19p-S221-5	Surface engineering of two-dimensional atomic crystals for performance enhancement and its application	○ Young-Jun Yu ¹	1. Electronics and Telecommunications Research Institute (ETRI)
16:30	奨 E 19p-S221-6	Single-Layer WS ₂ Phototransistor with Multi-Layer Graphene Electrodes on a Flexible Parylene Substrate	○ (D) Adha Sukma Aji ¹ , Toshiaki Shiiba ¹ , Kenjiro Fukuda ^{2,3} , Hiroki Ago ^{1,3,4}	1. Graduate School of Engineering Sciences, Kyushu Univ., 2. Thin-Film Device Laboratory, RIKEN, 3. PRESTO-JST, 4. Institute for Materials Chemistry and Engineering, Kyushu Univ.
16:45	奨 E 19p-S221-7	Defect position analysis in MoS ₂ FETs by random telegraphic signals	○ Nan Fang ¹ , Kosuke Nagashio ¹ , Akira Toriumi ¹	1. Tokyo Univ.
17:00	招 E 19p-S221-8	Research development of materials and innovative devices using atomically thin 2D functional films for ubiquitous sensing	○ Atsushi Ando ¹	1. AIST
1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology				
S.9 科学教育コンテストを活用した次世代人材育成 / Human Resources Development of Next Generation Using Science Education Competition				
3/20(Sun.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) W621 会場				
9:00	招 20a-W621-1	物理チャレンジ教育活動と国際物理オリンピックへの日本参加	○毛塚 博史 ¹	1. 東京工科大
9:30	招 20a-W621-2	物理チャレンジと物理教育: 出場経験者としての視点から	○植松 祐輝 ¹	1. 京大院理
10:00	招 20a-W621-3	国際生物学オリンピックに向けた学生指導の経緯から～いかにして代表生徒を指導したか～	○石井 規雄 ¹	1. 日本生物学オリンピック (JBO) 教育支援部
10:30	招 20a-W621-4	中学生のための理数探究イベント「ふくい理数グランプリ」	○三崎 光昭 ¹	1. 福井県教育庁義務教育課
11:00	招 20a-W621-5	次世代人材育成における科学技術コンテストの役割	○河崎 泰介 ¹	1. 科学技術振興機構
11:30	招 20a-W621-6	アドバイザーの立場から見た高校生のための理数探究イベント「ふくい理数グランプリ」	○葛生 伸 ¹	1. 福井大院工
2 放射線 / Ionizing Radiation				
S.10 医学分野における RI 利用の現状と展望 / Present and future use of radioisotopes in medical science				
3/20(Sun.) 13:30 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) W9 会場				
13:30	招 20p-W9-1	コンプトンカメラを用いた医学分野における RI イメージングの研究	○酒井 真理 ¹	1. 群馬大医
14:00	招 20p-W9-2	PET 解析技術の開発	○渡部 浩司 ¹	1. 東北大サイクロ
14:30	招 20p-W9-3	モンテカルロシミュレーションを用いた RI 内用療法における細胞生存率の見積もり	○平野 祥之 ¹ 、長谷川 純崇 ²	1. 群馬大重粒子, 2. 放医研分イメ
15:00		休憩 / Break		
15:15	招 20p-W9-4	診断・治療に用いる放射性核種の製造	○永津 弘太郎 ¹	1. 放医研
15:45	招 20p-W9-5	アイソトープ治療に対する α 放射体からのアプローチ	○鷲山 幸信 ¹	1. 金沢大保健
16:15	招 20p-W9-6	新しい β ⁻ 放出核種を用いた治療用放射性薬剤の開発	○飯田 靖彦 ^{1,3} 、藤澤 豊 ¹ 、渡邊 智 ² 、石岡 典子 ² 、橋本 和幸 ² 、永井 泰樹 ² 、山口 藍子 ³ 、花岡 宏史 ³ 、医療大樋口 徹也 ³ 、遠藤 啓吾 ^{3,4}	1. 鈴鹿医療大薬, 2. 原子力機構, 3. 群馬大院医, 4. 京都

3 光・フォトリソ / Optics and Photonics

S.11 液中レーザープロセス技術の展開 / Progress in studies on laser-processing employing liquid media

3/20(Sun.) 13:15 - 18:45			口頭講演 (Oral Presentation) W321 会場	
13:15	招 20p-W321-1	液中レーザープロセスの研究展開 - 物理プロセスと化学プロセスの融合 -	○越崎 直人 ¹	1. 北大院工
13:45	招 20p-W321-2	高速度レーザーストロボビデオ撮影による液中レーザーアブレーションの可視化観察	○伊藤 義郎 ¹ 、田辺 里枝 ¹	1. 長岡技術科大学院
14:15	20p-W321-3	液体窒素中でのレーザーアブレーションによるサイアロンを用いたナノ粒子の作製と評価	○富谷 統一郎 ¹ 、王 浩浩 ¹ 、武田 隆史 ² 、広崎 尚登 ² 、佐々木 浩一 ³ 、矢野 哲司 ¹ 、小田原 修 ¹ 、和田 裕之 ¹	1. 東工大, 2. 物材機構, 3. 北大
14:30	20p-W321-4	液中レーザーアブレーションによる金属微粒子生成現象の観察: レーザー照射回数の影響	○倉田 修吾 ¹ 、角谷 悟 ¹ 、田辺 里枝 ¹ 、伊藤 義郎 ¹	1. 長岡技術大
14:45	休憩 / Break			
15:00	招 20p-W321-5	溶液中への高強度レーザー照射による金属・合金ナノ粒子合成とその特性	○中村 貴宏 ¹ 、佐藤 俊一 ¹	1. 東北大多元研
15:30	招 20p-W321-6	レーザープロセスによるナノ粒子生成と光電デバイスへの活用	○齋藤 健一 ^{1,2}	1. 広島大自然セ, 2. 広島大院理
16:00	招 20p-W321-7	多孔質 Si の液中レーザー照射によるナノ結晶 Si 粒子の高効率生成と発光色制御	○中村 俊博 ¹ 、袁 澤 ² 、安達 定雄 ¹	1. 群馬大院理工, 2. 筑波大院理物質系
16:30	20p-W321-8	液中レーザー照射による亜鉛フタロシアニンナノ粒子の作製と評価	○五十嵐 傑 ¹ 、朝日 剛 ² 、小田原 修 ¹ 、和田 裕之 ¹	1. 東工大総理工, 2. 愛媛大院理工
16:45	20p-W321-9	スズ・亜鉛合金をターゲットに用いた液中レーザーアブレーションによるナノ材料の創成	○尾藤 秀甫 ¹ 、近藤 崇博 ¹ 、本田 光裕 ² 、クリニッチ セルゲイ ¹ 、岩森 暁 ¹	1. 東海大, 2. 名工大
17:00	休憩 / Break			
17:15	招 20p-W321-10	気-液界面レーザーアブレーションによるサブナノ、シングルナノクラスター創製	○西 哲平 ¹ 、鈴木 教友 ¹ 、秋元 祐介 ¹ 、高橋 直子 ¹ 、北住 幸介 ¹ 、梶谷 修司 ¹ 、渡邊 佳英 ¹	1. 豊田中研
17:45	招 20p-W321-11	フェムト秒レーザー誘起プラズマによる液体からの親水性炭素ナノ粒子の生成	○ハッ橋 知幸 ¹	1. 阪大院理
18:15	20p-W321-12	液中レーザー融合法により作製した銀サブミクロン球状粒子の内部構造と照射時間による影響	○中村 貴宏 ¹ 、真柄 英之 ¹ 、榊 祥太 ² 、越崎 直人 ² 、佐藤 俊一 ¹	1. 東北大多元研, 2. 北大院工
18:30	20p-W321-13	ピコ秒パルスレーザーを用いた液中レーザー融合法による球状粒子生成	○住岡 耕平 ¹ 、越崎 直人 ¹ 、齋藤 健一 ^{2,3} 、坂本 全 ¹ 、教 ³	1. 北大工, 2. 広大自然セ, 3. 広大院理

6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces

S.13 真空・減圧プロセスにおける気体の流れの解析 / Gas Flow Analysis in Vacuum and Low-Pressure Processing

3/20(Sun.) 14:00 - 17:30			口頭講演 (Oral Presentation) W621 会場	
14:00	招 20p-W621-1	真空・減圧プロセスにおける気体の流れの解析 イントロダクトリートーク	○吉田 肇 ¹ 、板倉 明子 ²	1. 産総研, 2. 物材機構
14:15	招 20p-W621-2	気体分子流の基礎理論と数値解析	○松田 七美男 ¹	1. 東京電機大
14:45	招 20p-W621-3	モンテカルロ法による加速器ビームダクト内の圧力分布計算例	○谷本 育律 ¹	1. 高エネ研
15:15	招 20p-W621-4	熱 CVD 過程のモデル化	○秋山 泰伸 ¹	1. 東海大工
15:45	休憩 / Break			
16:00	招 20p-W621-5	粒子法による希薄気体流れとプラズマシミュレーション	○和田 隆生 ¹ 、佐橋 一裕 ¹ 、塩谷 明美 ¹	1.(株)ウェーブフロント
16:30	招 20p-W621-6	プラズマプロセスにおけるシミュレーション	○松永 史彦 ¹	1. ペガサスソフトウェア
17:00	招 20p-W621-7	スパッタリングシステム内における圧力分布、および圧力変化の実測	○田尻 修一 ¹ 、大西 孝則 ¹ 、岡野 夕紀子 ¹ 、小川 倉一 ² 、美馬 宏司 ³	1. 岡野製作所, 2. 小川創研, 3. 大阪市立大学

6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces

S.14 機能性酸化物探索の新展開 ~ more oxide, beyond oxide ~ / Frontiers of new functional oxides -more oxide, beyond oxide-

3/20(Sun.) 13:15 - 17:30			口頭講演 (Oral Presentation) H111 会場	
13:15	招 20p-H111-1	酸化物薄膜の成膜に向けたミスト CVD 技術の進展	○藤田 静雄 ¹ 、金子 健太郎 ¹	1. 京大院工
14:00	招 20p-H111-2	ガスソース MBE 高品質酸化物薄膜で拓く酸化物エレクトロニクス	○高橋 圭 ^{1,2} 、松原 雄也 ^{1,3} 、村田 智城 ³ 、Bahramy Mohammad ^{1,3} 、小塚 裕介 ³ 、Maryenko Denis ¹ 、Falson Joseph ³ 、塚崎 敦 ⁴ 、十倉 好紀 ^{1,3} 、川崎 雅司 ^{1,3}	1. 理研 CEMS, 2.JST さきがけ, 3. 東工大, 4. 東北大金
14:30	20p-H111-3	放射光 X 線回折を利用した酸化物ヘテロ構造中の酸素八面体傾斜の評価	○菅 大介 ¹ 、若林 裕助 ² 、田尻 寛男 ³ 、島川 祐一 ^{1,4}	1. 京大化研, 2. 阪大基礎工, 3.JASRI/SPring-8, 4.JST-CREST
14:45	20p-H111-4	ツイストした三角格子層からなる新層状酸化物薄膜の作製	○大羽 健太 ¹ 、○打田 正輝 ¹ 、大内 祐貴 ¹ 、小塚 裕介 ¹ 、川崎 雅司 ^{1,2}	1. 東工大, 2. 理研 CEMS
15:00	休憩 / Break			
15:15	招 20p-H111-5	鉄系超伝導体の薄膜成長	○生田 博志 ¹	1. 名工大
16:00	招 20p-H111-6	トポクティブ反応を用いた複合アニオン酸化物エビタキシー	○近松 彰 ¹	1. 東大院理
16:30	20p-H111-7	Fe ₃ O ₄ 薄膜の酸化還元反応を利用した全固体磁気特性制御デバイス	○土屋 敬志 ^{1,2} 、寺部 一弥 ² 、尾地 真典 ¹ 、樋口 透 ¹ 、長田 実 ² 、山下 良之 ² 、上田 茂典 ² 、青野 正和 ²	1. 東京理大理, 2. 物材機構
16:45	20p-H111-8	可視光応答型光触媒材料としてのチタン酸化物の理論提案	○(PC) 青木 祐太 ¹ 、齋藤 晋 ¹	1. 東工大理
17:00	招 20p-H111-9	半導体の物性予測と物質探索 - 先端計算科学からのアプローチ	○大場 史康 ^{1,2}	1. 東工大応セラ研・MCES, 2. 物材機構 MI2I

6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces

9 応用物性 / Applied Materials Science

S.15 誘電体・強誘電体材料評価・解析技術の最先端 / State-of-the-art characterization technique of dielectric and ferroelectric materials

3/20(Sun.) 13:45 - 18:15			口頭講演 (Oral Presentation) W641 会場	
13:45	招 20p-W641-1	高信頼性強誘電体メモリ (FRAM) の進展	○彦坂 幸信 ¹	1. 富士通セミコンダクター株
14:15	招 20p-W641-2	先進 STEM 法による材料局所電磁場の実空間観察	○柴田 直哉 ¹	1. 東大総研
14:45	招 20p-W641-3	ラマン散乱分光法による誘電体の物性評価	○谷口 博基 ¹	1. 名大理
15:15	招 20p-W641-4	X 線回折を用いた誘電体・強誘電体材料の評価	○森岡 仁 ¹	1. プルカー AXS
15:45	休憩 / Break			
16:00	招 20p-W641-5	ニオブ酸リチウム強誘電体の欠陥制御 - 可視光下光起電力の増強へ向けて -	○犬塚 淳 ¹ 、高橋 秀輔 ¹ 、吉田 光汰 ¹ 、井上 亮太郎 ² 、野口 祐二 ¹ 、宮山 勝 ¹	1. 東大院工, 2. 日大医
16:15	招 20p-W641-6	第一原理計算による誘電体 / 圧電体材料の解析	○岩崎 蒼志紀 ¹	1. 太陽誘電
16:45	招 20p-W641-7	電気特性評価のための最新 AFM 測定モード	○石井 孝治 ¹	1. オックスフォード・インスト
17:15	招 20p-W641-8	誘電体材料の信頼性評価法	○安藤 陽 ¹	1. 村田製作所

17:45 招 20p-W641-9 薄膜材料の正・逆圧電特性評価 ○神野 伊策¹、辻浦 裕一¹、黒川 文弥¹、肥田 博隆¹ 1. 神戸大工
1

8 プラズマエレクトロニクス / Plasma Electronics

S.16 宇宙科学・工学とプラズマプロセス / Plasma Processing in Space Science and Engineering

3/20(Sun.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場

13:45 招 20p-KD-2 宇宙科学・工学とプラズマ ○白谷 正治¹、古閑 一憲¹ 1. 九大シス情
14:00 招 20p-KD-3 イオンエンジンによる小惑星探査機 ○細田 聡史¹、西山 和孝¹、月崎 竜童¹、國中 均¹ 1. 宇宙航空研究開発機構
14:30 招 20p-KD-4 超小型宇宙探査機のためのプラズマ推進機 ○鷹尾 祥典¹ 1. 横国大
15:00 招 20p-KD-5 大電力電気推進 ○田原 弘一¹ 1. 大阪工大機械
15:30 招 20p-KD-6 高密度ヘリコンプラズマ生成とプラズマ推進 ○篠原 俊二郎¹ 1. 農工大工
16:00 休憩 / Break
16:15 招 20p-KD-7 ジオスペース探査衛星による放射線帯観測計画について ○高島 健¹、三谷 烈史¹、篠原 育¹、三好 由純² 1. 宇宙研, 2. 名大
～プラズマ波動・粒子同時観測～
16:45 招 20p-KD-8 宇宙用化合物薄膜太陽電池の開発 ○今泉 充¹、高本 達也²、大島 武³ 1. 宇宙機構, 2. シャープ, 3. 原子力機構
17:15 招 20p-KD-9 無重力条件下での炭素ナノ材料のアーク合成 ○三重野 哲¹ 1. 静岡大創造科学技術

10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics

S.17 様々なスピン計測技術を用いたスピントロニクス材料開発の最前線 / Researches on spintronic materials and phenomena using advanced spin-resolved measurements

3/20(Sun.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場

13:45 招 20p-W241-1 スピン分解光電子分光による高スピン偏極材料の電子状態の研究 ○木村 昭夫¹ 1. 広大院理
14:15 招 20p-W241-2 強磁性ナノ構造におけるスピン依存量子干渉 ○岡 博文¹ 1. 東北大多元研
14:45 招 20p-W241-3 高輝度・高スピン偏極低エネルギー電子顕微鏡による磁区構造の動的観察 ○安江 常夫¹、鈴木 雅彦¹、越川 孝範¹ 1. 阪電通大エレ研
15:15 休憩 / Break
15:30 招 20p-W241-4 放射光軟X線磁気円二色性によるスピントロニクス材料研究 ○中村 哲也¹、鈴木 基寛¹ 1. 高輝度セ
16:00 招 20p-W241-5 光誘起超高速スピンドYNAMIKSの検出と制御 ○岡本 博¹、宮本 辰也¹、貴田 徳明¹ 1. 東大新領域
16:30 招 20p-W241-6 メスバウアー分光法を用いたスピントロニクス材料の研究 ○壬生 攻¹ 1. 名工大工

12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics

S.18 計算材料科学の新潮流 - 有機分子・バイオエレクトロニクスを中心に - / New trends in computational materials science - Molecular electronics and bioelectronics

3/20(Sun.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場

13:45 招 20p-W631-1 イントロダクトリートーク：計算材料科学の新潮流 - 有機分子・バイオエレクトロニクスを中心に - ○下位 幸弘¹ 1. 産総研 CD-FMat
14:00 招 20p-W631-2 情報統合型物質・材料研究：解析型研究から開拓型研究へ ○寺倉 清之¹ 1. 物・材機構
14:30 招 20p-W631-3 有機無機界面のハイブリッド量子古典法による大規模シミュレーション ○尾形 修司¹ 1. 名工大院
15:00 招 20p-W631-4 錯体/半導体複合型 CO₂ 還元触媒における電子移動の理論計算 ○旭 良司¹、陣内 亮典¹、白井 総一¹、Akimov A.V.²、Prezhdo O.V.² 1. 豊田中研, 2. 南カリフォルニア大
15:30 招 20p-W631-5 有機半導体に対する変形効果の計算機シミュレーション ○島田 敏宏¹、山川 貴恵¹、柳瀬 隆¹、長浜 太郎¹ 1. 北大工
15:45 休憩 / Break
16:00 招 20p-W631-6 小児マヒウイルスカプシドの全原子分子動力学シミュレーション ○岡崎 進¹ 1. 名大院工
16:30 招 20p-W631-7 理論化学、計算化学に基づいた有機デバイス材料開発 ○志津 功将¹、鈴木 不律¹、安達 千波矢^{2,3,4}、梶 弘典¹ 1. 京大化研, 2. 九大 OPERA, 3. 九大 WPI-I2CNER, 4. JST-ERATO
17:00 招 20p-W631-8 第一原理的な " デバイス機能 " の理論予測とその材料設計への応用～非平衡輸送特性を中心に～ ○浅井 美博¹ 1. 産総研 CD-FMat

13 半導体 / Semiconductors

S.7 理系学生のキャリア設計指針 ～これからの第一歩を決めるために～ / Compass for career design of science students - where to make the first step to your ideal future? -

3/20(Sun.) 13:45 - 16:30 口頭講演 (Oral Presentation) W611 会場

13:45 招 20p-W611-1 新たなデバイスへのアプローチ ○久本 大^{1,2} 1. 日立, 2. 東工大院
14:00 招 20p-W611-2 私のキャリア観 - 今と昔の自己分析 ○小路 智也¹ 1. 旭化成エレクトロニクス
14:15 招 20p-W611-3 研究から IT ベンチャーへ ○木下 治紀¹ 1. 東工大院理工
14:30 招 20p-W611-4 応用から基礎、化学から生物学へ～自らの興味を追い求め続けた高専生の一例～ ○西村 亮祐¹ 1. 東北大院生命
14:45 招 20p-W611-5 エレクトロニクス分野におけるキャリア形成について ○小林 正治¹ 1. 東大生研
～海外留学・就職の経験を踏まえて～
15:00 休憩 / Break
15:15 招 20p-W611-6 技術と経営をつなぐ ○吉澤 正樹¹ 1. 経営共創基盤
15:30 招 20p-W611-7 研究者としての夢に向けて - 海外 PhD という選択肢 - ○成田 海¹ 1. 東工大院
15:45 招 20p-W611-8 理系工学部材料系の就職活動における思考過程 ○石貝 創¹ 1. 奈良先端大
16:00 招 20p-W611-9 大企業からベンチャーへ～理系キャリア選択の一例～ ○五十嵐 美樹¹ 1. エルピクセル
16:15 招 20p-W611-10 世界一をみさせ ○池田 修二¹ 1. ティーアイソリューションズ 株

3 光・フォトンクス / Optics and Photonics

S.12 社会実装を見据えたテラヘルツ新技術の展開 / Innovation and social implement of THz technologies

3/21(Mon.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) H135 会場

13:30 招 21p-H135-1 イントロ THz 技術の社会実装への課題 ○寶迫 巖¹ 1. 情報通信研究機構
13:45 招 21p-H135-2 LiNbO₃ 結晶を用いたテラヘルツ光技術の進展 ○川瀬 晃道^{1,2} 1. 名大工, 2. 理研
14:15 招 21p-H135-3 テラヘルツ量子カスケードレーザーの進展と今後の展望 ○平山 秀樹^{1,2}、寺嶋 亘^{1,2}、林 宗洋¹ 1. RAP, 2. 理研
14:45 招 21p-H135-4 共鳴トンネルダイオードによる室温テラヘルツ発振器と応用に向けた高機能化 ○浅田 雅洋¹ 1. 東工大総理工
15:15 招 21p-H135-5 差周波発生テラヘルツ量子カスケードレーザー光源の超広帯域動作 ○藤田 和上¹、伊藤 昭生¹、日高 正洋¹、道垣内 龍男¹、枝村 忠孝¹、山西 正道¹ 1. 浜ホト中研
15:30 休憩 / Break
15:45 招 21p-H135-6 テラヘルツ波による細胞研究への可能性 ○小川 雄一¹、白神 慧一郎¹、鈴木 哲仁¹ 1. 京大院農
16:15 招 21p-H135-7 励起光状態変化によるテラヘルツ波検出技術および導波路導入による高効率化 ○水津 光司¹、水野 光貴¹、木村 優基¹、南部 広樹¹、秋葉 拓也¹、宮本 克彦²、尾松 孝茂²、諸橋 功³、小川 洋³、中島 慎也³、関根 徳彦³、寶迫 巖³ 1. 千葉工大工, 2. 千葉大融合, 3. NICT
16:45 招 21p-H135-8 テラヘルツ時間領域分光法によるタンパク質低振動ダイナミクスの水和および温度依存性 ○山本 直樹¹、太田 薫²、田村 厚夫¹、○富永 圭介^{1,2} 1. 神戸大理学研究科, 2. 神戸大学分子フォト
17:15 招 21p-H135-9 テラヘルツ分光を利用したゴム加硫反応イメージング ○平川 靖之¹、延塚 彩夏¹、神野 拓也¹、権藤 豊彦¹ 1. 久留米高専
1

17:30	21p-H135-10	アレイ放射器から発せられるインコヒーレントサブテラヘルツ波を用いた煙霧環境でのアクティブイメージング	○清水 直文 ¹ 、沖永 誠治 ² 、松山 賢 ²	1.NTT 先デ研, 2.東理大 火災科学研究所
17:45	招 21p-H135-11	クロージング: シンポジウム閉会にあたって	○南出 泰丞 ¹	1. 理研
12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics				
S.19 有機薄膜太陽電池の現状と今後の展望 / Present Situation and Future Prospects of Organic Solar Cells				
3/21(Mon.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場				
13:30	招 21p-W531-1	有機半導体の pn 制御と有機太陽電池への応用	○平本 昌宏 ¹	1. 分子研
14:00	招 21p-W531-2	高分子太陽電池の機構解明と高効率化	○大北 英生 ¹ 、辨天 宏明 ¹ 、伊藤 紳三郎 ¹	1. 京大院工
14:30	招 21p-W531-3	有機薄膜太陽電池の光電変換機構の理論研究	○田村 宏之 ¹	1. 東北大
15:00		休憩 / Break		
15:15	招 21p-W531-4	高分子薄膜太陽電池のドナー/アクセプター界面構造制御	○但馬 敬介 ^{1,2}	1. 理研 CEMS, 2.JST-PRESTO
15:45	招 21p-W531-5	電子ドナー性と電子アクセプター性共役高分子で創る高効率全高分子型薄膜太陽電池	○辨天 宏明 ¹ 、森 大輔 ¹ 、大北 英生 ¹ 、伊藤 紳三郎 ¹	1. 京大院工
16:15	招 21p-W531-6	有機 CT 結晶を用いる高電圧有機太陽電池への挑戦	○吉田 司 ¹ 、中山 健一 ¹ 、増原 陽人 ¹ 、松井 淳 ¹ 、儘田 正史 ¹ 、ホワイト マシュー ² 、スタッドラー フィリップ ³ 、シャーバー マーカス ³ 、ユムサック チデム ³ 、サリチフチ ニヤジ ³	1. 山形大院理工, 2. パーモント大, 3. リンツ大
16:45		休憩 / Break		
17:00	招 21p-W531-7	有機薄膜太陽電池の高効率化に向けた半導体ポリマーの設計	○尾坂 格 ¹	1. 理研 CEMS
17:30	招 21p-W531-8	多様な用途に適用できる有機薄膜太陽電池	○都島 颯司 ¹ 、斉藤 三長 ¹ 、早瀬 留美子 ¹	1. 東芝研究開発センター
16 非晶質・微結晶 / Amorphous and Microcrystalline Materials				
S.20 次世代高効率・低コスト結晶シリコン太陽電池 / Advanced high efficiency and low cost crystal silicon solar cells				
3/21(Mon.) 13:00 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場				
13:00	招 21p-KD-1	太陽光発電開発戦略 "NEDO PV Challenges" と新プロジェクト "高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発" の概要について	○山田 宏之 ¹	1.NEDO
13:30	招 21p-KD-2	先端複合技術型シリコン太陽電池に必要なとされる技術	○大下 祥雄 ¹ 、小椋 厚志 ² 、中村 京太郎 ²	1. 豊田工大, 2. 明治大
14:00	招 21p-KD-3	CZ シリコン単結晶における軽元素とバルクライフタイムの関係	○柿本 浩一 ¹ 、宮村 佳児 ¹ 、原田 博文 ¹ 、中野 智 ¹ 、高 冰 ¹	1. 九大応力研
14:30	招 21p-KD-4	結晶シリコン太陽電池におけるウェーハとプロセスの相性	○小椋 厚志 ¹ 、小島 拓人 ¹ 、中村 京太郎 ¹ 、田島 道夫 ¹ 、大下 祥雄 ² 、西島 英一 ³ 、正田 勲 ³ 、飯田 伸仁 ³ 、橋昇二 ³	1. 明大理工, 2. 豊田工大, 3. 株式会社トクヤマ
15:00		休憩 / Break		
15:15	21p-KD-5	ボトムに単結晶 Si を用いたスマートスタック多接合セル	○水野 英範 ² 、牧田 紀久夫 ¹ 、菅谷 武芳 ¹ 、太野 垣 健 ¹ 、望月 敏光 ^{1,2} 、高遠 秀尚 ^{1,2}	1. 産総研, 2. 福島再エネ研
15:30	21p-KD-6	裏面エミッタ型結晶シリコン太陽電池における基板比抵抗の影響	○綿引 達郎 ¹ 、小林 裕美子 ¹ 、森岡 孝之 ¹ 、西村 慎也 ¹ 、新延 大介 ¹ 、西村 邦彦 ¹ 、時岡 秀忠 ¹ 、山向 幹雄 ¹	1. 三菱電機
15:45	招 21p-KD-7	高性能結晶シリコン太陽電池の実現に向けた新規ヘテロ接合用材料と高品質シリコン結晶に関する研究	○宇佐美 徳隆 ¹ 、高橋 勲 ¹ 、黒川 康良 ¹ 、中塚 理 ¹	1. 名大院工
16:15	招 21p-KD-8	高効率銅電極ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池	○足立 大輔 ¹ 、山本 憲治 ¹	1. カネカ
16:45	招 21p-KD-9	めっき電極を適用したメタルラップスルー型バックコンタクトヘテロ接合太陽電池	○石村 史陽 ¹ 、李文君 ¹ 、小林 英治 ¹ 、橋本 公一 ¹ 、佐藤 誠治 ¹ 、渡部 嘉 ¹ 、Evert Bende ² 、Gianluca Coletti ²	1. 長州産業株式会社, 2.ECN
合同セッション K / Joint Session K				
S.21 金属酸化物薄膜の成膜装置 / Advanced Fabrication System for Metal Oxide Thin Films				
3/21(Mon.) 13:30 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場				
13:30	招 21p-S222-1	成膜技術の革新が支えた酸化物エレクトロニクスの発展とその未来	○川崎 雅司 ^{1,2}	1. 東大工, 2. 理研 CEMS
14:00	招 21p-S222-2	スパッタリング併用有機金属気相堆積法と希土類添加 ZnO への応用	○藤原 康文 ¹	1. 阪大院工
14:30	招 21p-S222-3	ECR プラズマスパッタ法による金属酸化物薄膜形成	○赤沢 方省 ¹	1.NTT DIC
15:00	招 21p-S222-4	ドイツにおけるスパッタ技術の最新動向	○鈴木 巧一 ¹	1. サーフェックトランスナショナル
15:30	招 21p-S222-5	反応性プラズマ蒸着 (RPD) 装置	○木下 公男 ¹ 、前原 誠 ¹ 、酒見 俊之 ¹ 、北見 尚久 ¹	1. 住友重機械工業
16:00		休憩 / Break		
16:15	招 21p-S222-6	常圧非平衡プラズマを用いた新規な酸化物薄膜の化学気相成長プロセス	○藤村 紀文 ¹ 、野瀬 幸則 ¹ 、木口 拓也 ¹ 、上原 剛 ² 、吉村 武 ¹ 、芦田 淳 ¹	1. 大阪府立大 工, 2. 積水化学工業(株) R&D
16:45	招 21p-S222-7	ゾル・ゲル法による酸化物半導体混晶および積層構造の作製	○安田 隆 ¹	1. 石専大理工
17:15	招 21p-S222-8	原子層堆積法で作製した金属酸化物薄膜の電子デバイスへの展開	○生田目 俊秀 ¹	1. 物材機構
17:45	招 21p-S222-9	分子線エビタキシー法を用いた酸化物系ヘテロ構造の作製と物性	○塚崎 敦 ^{1,2}	1. 東北大金研, 2.JST さきがけ
3 光・フォトリソ / Optics and Photonics				
S.22 「cavity-QED, circuit-QED の進展」～様々な系で何をどこまでできるようになったのか? ～ / Cavity & circuit-QED: frontier research at the leading edge				
3/22(Tue.) 9:00 - 13:00 口頭講演 (Oral Presentation) H101 会場				
9:00	招 22a-H101-1	ナノ光ファイバー共振器が可能にする Cavity-QED 系の新展開	○加藤 真也 ¹	1. 早大理工
9:30	招 22a-H101-2	半導体量子ドットによる circuit-QED	○樋田 啓 ¹	1.NTT 物性研
10:00	22a-H101-3	超伝導量子ビット集団とマイクロ波キャビティのコヒーレントな結合	○松崎 雄一郎 ¹ 、角柳 孝輔 ¹ 、コランタン デブレ ¹ 、ネイル ランバート ² 、石田 夏子 ² 、樋田 啓 ¹ 、仙場 浩一 ³ 、ウィリアム ムンロ ¹ 、山口 浩司 ¹ 、齊藤 志郎 ¹	1.NTT 物性基礎研, 2. 理研, 3. 情報通信研究機構
10:15	招 22a-H101-4	超伝導人工原子・調和振動子 超強結合系	○布施 智子 ¹ 、吉原 文樹 ¹ 、Sahel Ashhab ² 、角柳 孝輔 ³ 、齋藤 志郎 ³ 、仙場 浩一 ¹	1. 情報通信研究機構, 2.Qatar Environment and Energy Research Institute, 3.NTT 物性基礎研
10:45		休憩 / Break		
11:00	招 22a-H101-5	人工 A 型原子を用いたマイクロ波単一光子検出	○猪股 邦宏 ¹ 、Lin Zhirong ¹ 、越野 和樹 ² 、山本 剛 ³ 、中村 泰信 ⁴	1. 理研創発物性, 2. 東京医歯大, 3.NEC スマエネ研, 4. 東大先端研
11:30	招 22a-H101-6	Circuit-QED とスピン: 量子メモリから超高感度磁気共鳴まで	○久保 結丸 ^{1,2} 、Grezes Cecile ¹ 、Bienfait Audrey ¹ 、磯谷 順一 ³ 、Vion Denis ¹ 、Esteve Daniel ¹ 、Bertet Patrice ¹	1. サクレール研究所, 2. 沖縄科技大, 3. 筑波大情報メディア研

12:00	奨	22a-H101-7	散逸のある補助系と結合したスピン系におけるスクイズドスピン状態の生成	○(PC)湯川 英美 ¹ 、Dooley Shane ¹ 、松崎 雄一郎 ² 、Knee George ² 、Munro William J. ² 、根本 香絵 ¹	1.情報研, 2.NTT 物性基礎研
12:15	奨	22a-H101-8	ダイヤモンド NV 中心における量子メディア変換	○(B)黒岩 良太 ¹ 、関口 雄平 ¹ 、新倉 菜恵子 ¹ 、小坂 英男 ¹	1.横国大院工
12:30	招	22a-H101-9	まとめと将来展望	○齊藤 志郎 ¹	1.NTT 物性基礎研

公募シンポジウム / Symposium

3 光・フォトリニクス / Optics and Photonics

S.23 テラヘルツ・赤外線領域強電磁場による極限非線形現象の光科学と応用展望

/ Science and Application of Extreme Nonlinear Phenomena Induced by Intense Terahertz and Infrared Electromagnetic Field

3/19(Sat.) 13:00 - 16:00 口頭講演 (Oral Presentation) H135 会場					
13:00		19p-H135-1	はじめに	○永井 正也 ¹	1.阪大基礎工
13:15	招	19p-H135-2	単一サイクル赤外光による強相関有機金属の瞬時強電場効果	○岩井 伸一郎 ¹	1.東北大理
13:45	招	19p-H135-3	BIBO 結晶を用いた超広帯域赤外 OPCPA 光源の開発とアト秒・サブサイクル分光への展開	○板谷 治郎 ¹	1.東大物性研
14:15		19p-H135-4	中赤外超短パルス増強場による光電界電子放出	○芦原 聡 ¹ 、草 史野 ^{1,2} 、竹上 明伸 ^{1,2}	1.東大生研, 2.農工大院工
14:30	休憩 / Break				
14:45	招	19p-H135-5	原子スケールナノギャップ電極間に発生する強電界テラヘルツ電磁波とナノ構造のキャリアダイナミクス	○平川 一彦 ^{1,2} 、吉田 健治 ¹ 、杜 少卿 ¹ 、張 亜 ¹	1.東大生研, 2.東大ナノ量子機構
15:15	招	19p-H135-6	高強度 THz パルスによる電気・磁気光学応答の超高速制御	○廣理 英基 ^{1,2}	1.京大 iCeMS, 2.JST さきがけ
15:45	奨	19p-H135-7	スピンドイナミクスと磁気秩序の高強度テラヘルツ磁場による制御	○栗原 貴之 ¹ 、末元 徹 ¹ 、中嶋 誠 ²	1.東大物性研, 2.阪大レーザー研

1 応用物理学一般 / Interdisciplinary Physics and Related Areas of Science and Technology

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

1.1 応用物理一般・学際領域 / Interdisciplinary and General Physics

3/20(Sun.) 10:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S322 会場					
10:15	奨	20a-S322-1	撥水性希土類酸化物の作製と評価	○谷本 怜美 ¹ 、磯部 敏宏 ¹ 、松下 祥子 ¹ 、中島 章 ¹	1.東工大
10:30		20a-S322-2	多孔質ガラスを用いた固体液体複合材料の作製とその動的撥水性	○横山 広大 ¹ 、酒井 宗寿 ² 、磯部 敏宏 ¹ 、松下 祥子 ¹ 、中島 章 ¹	1.東工大理工工, 2.山口東理大先材研
10:45		20a-S322-3	蛍光色素注入による植物蒸散流速の光学計測法の開発	○大嶋 一輝 ¹ 、長崎 秀昭 ¹ 、岩見 健太郎 ¹ 、梅田 倫弘 ¹	1.農工大工
11:00		20a-S322-4	人工知能融合超高速化量子分子動力学法の開発とトライボプロセスへの応用	○小原 幸子 ¹ 、佐藤 愛美 ¹ 、佐藤 絵美 ¹ 、稲葉 賢二 ¹ 、石澤 由紀江 ¹ 、宮野 正之 ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、畠山 望 ¹ 、宮本 明 ¹	1.東北大学
11:15	E	20a-S322-5	Understanding the Difference in Cohesive Energies between Alpha and Beta Tin	○Sergei Manzhos ¹ 、Fleur Legrain ¹ 、Oleksandr Malyi ² 、Clas Persson ²	1.Ntl Uni of Singapore, 2.Uni of Oslo
11:30		20a-S322-6	2次元画像からの散乱評価 [III]; 多面体からの光学散乱 (2)	○川口 昭夫 ¹ 、二宮 洋文 ²	1.京大原子研, 2.二宮宝石 (株)
11:45	奨	20a-S322-7	円形に配列した尖端図形による運動錯視	○(MIC)大槻 一博 ¹ 、面谷 信 ¹	1.東海大工
12:00		20a-S322-8	ヴァイオリンの f 孔開口部形状と空気共鳴 A0 モードの周波数シフトに関する実験的検討	○松谷 晃宏 ¹	1.東工大半導体 MEMS
3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場					
	奨	21a-P1-1	回転スクリーンを用いた体積型立体表示 - スクリーン透過性と立体像の視認性との関係 -	○(M1)鈴木 慎之介 ¹ 、藤川 知栄美 ¹ 、面谷 信 ¹	1.東海大工
		21a-P1-2	ラマン分光法と密度汎関数法を用いた THF-CH のゲスト - ホスト相互作用の研究	○加藤 雅洋 ¹ 、高嶋 明人 ¹ 、西尾 泉 ¹	1.青学大理工
		21a-P1-3	アルゴン雰囲気中での加熱による ta-C 薄膜損傷のラマン分光観察	○神津 知己 ¹ 、山口 誠 ² 、川口 雅弘 ³	1.レニショー, 2.秋田大学, 3.都立産技研
		21a-P1-4	中和反応による界面張力不安定性が引き起こす液滴の自発変化と運動	○原田 優吾 ¹ 、作田 浩輝 ¹ 、吉川 研一 ¹	1.同志社大
	E	21a-P1-5	Defects in Alpha and Gamma Nylon6: a Density Functional Tight Binding Study	○Sergei Manzhos ¹ 、Saeid Arabnejad ¹	1.Ntl Uni of Singapore

1.2 教育 / Education

3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2 会場					
		21a-P2-1	ワイヤループを用いたタッチレーザーの教材への応用 II	○山口 静夫 ¹	1.九共大総研
		21a-P2-2	自律型ロボット体験学習用カリキュラムの構築と実践的検証	○谷野 順平 ¹ 、中野 寛之 ¹ 、佐伯 平二 ¹	1.愛知工業大学
	奨	21a-P2-3	Puppy の動作特性における路面材料依存性	○(B)中口 陽介 ¹ 、坂田 結菜 ¹ 、木村 岳 ¹ 、広田 悠輝 ¹ 、野口 央照 ¹ 、田中 武 ¹	1.広工大
		21a-P2-4	光全反射概念形成教材の開発とアウトリーチ活動報告	○荒川 真由美 ¹ 、中野 寛之 ¹ 、佐伯 平二 ¹	1.愛工大工
		21a-P2-5	講習会用プログラム乾板の作製方法	○平谷 雄二 ¹	1.広国大工
		21a-P2-6	ホロコソッドランプを用いた光電効果実験 (VI)	○大向 隆三 ¹ 、布施 陽子 ¹ 、松本 龍馬 ¹ 、近藤 一史 ¹	1.埼玉大教育
		21a-P2-7	LED ライトを用いたヤングの干渉実験 (IV)	○大向 隆三 ¹ 、小林 浩太 ¹ 、関川 留都 ¹ 、近藤 一史 ¹	1.埼玉大教育
		21a-P2-8	レーザー折投影法によるタッチパネル透明電極のパターン解析	○栗山 健二 ¹ 、鈴木 三男 ²	1.静岡大工, 2.福島高専
		21a-P2-9	基本的な論理回路を使った 4 色 LED ストロブスコープ	○高和 宏行 ^{1,2} 、古川 貴大 ¹ 、木本 隆之 ¹ 、阿部 昌浩 ¹	1.麻布実教, 2.ユニオプト
		21a-P2-10	FFT を用いた学生用振動実験の試作	○鈴木 三男 ¹ 、増田 健二 ²	1.福島高専, 2.静大工
		21a-P2-11	工学実験への導入を目指した MOSFET の作製	○(B)富田 昌吾 ¹ 、辻 琢人 ¹ 、長岡 史郎 ² 、大谷 真弘 ³	1.鈴鹿工業高等専門学校, 2.香川高等専門学校, 3.奈良工業高等専門学校
		21a-P2-12	Si 太陽電池製作を利用した半導体教育の実践	○和田 直樹 ¹ 、塩貝 一樹 ¹ 、若原 昭浩 ²	1.新居浜高専, 2.豊橋技科大
		21a-P2-13	シリコン太陽電池教材の開発	○藤田 智常 ¹ 、多田 彬史 ¹ 、○内海 淳志 ¹	1.舞鶴高専
		21a-P2-14	セルオートマトンを用いた半導体シミュレータ (3)	○大豆生田 利章 ¹	1.群馬高専
		21a-P2-15	マンガを用いた電気回路教材の開発	○大豆生田 利章 ¹ 、小林 美桜 ¹	1.群馬高専
	奨	21a-P2-16	TCAD を用いた初歩的な SiC パワー半導体プロセスの教育システムの構築	○(B)高濱 滉太 ¹ 、広田 悠輝 ¹ 、中口 陽介 ¹ 、足立 拓磨 ¹ 、向井 浩二 ¹ 、田中 武 ¹	1.広工大

奨	21a-P2-17	TCAD を用いた Si へのイオン注入とアニール効果	○(B) 広田 悠輝 ¹ 、中口 陽介 ¹ 、足立 拓磨 ¹ 、高濱 澁太 ¹ 、向井 浩二 ¹ 、田中 武 ¹	1. 広島工大
奨	21a-P2-18	TCAD を用いた Si へのイオン注入の角度依存性	○(B) 足立 拓磨 ¹ 、広田 悠輝 ¹ 、中口 陽介 ¹ 、高濱 澁太 ¹ 、向井 浩二 ¹ 、田中 武 ¹	1. 広島工大
	21a-P2-19	高電界中のランプ火炎の演示実験	○塚林 功 ² 、関 一 ¹ 、佐藤 杉弥 ² 、服部 邦彦 ²	1. いろは理工工房, 2. 日本工大
	21a-P2-20	発光ダイオードの高効率性を理解させる実験教材の開発	○長島 礼人 ¹ 、大塚 健太 ¹	1. 山梨大教育
	21a-P2-21	LED 光センサを利用した力学実験における加速度の速度依存性	○河野 託也 ¹ 、本田 直輝 ¹ 、後野 昭次 ¹	1. 豊田高専
	21a-P2-22	事前・事後学習時間を確保する物理学の講義の試み	○寺田 貢 ¹	1. 福岡大理
	21a-P2-23	コンピュータを用いた能動的学習による物理学実験	○西脇 洋一 ¹ 、米岡 裕美 ¹ 、赤羽 明 ¹	1. 埼玉医大
	21a-P2-24	Moodle を用いた物理実験学習支援システムの構築と e-learning 教材の開発	○門倉 和貴 ¹ 、藤城 武彦 ¹ 、田中 良一 ¹ 、鈴木 恒則 ¹ 、遠藤 順一 ¹	1. 東海大理
	21a-P2-25	小学校教諭のための理科実験テキスト	○上月 具拳 ¹ 、山中 仁昭 ² 、間島 利也 ¹ 、寺重 隆視 ¹ 、出木原 裕順 ¹	1. 広島国際大, 2. 海上保安大
	21a-P2-26	二酸化炭素の透過と空気の浮力に関する理科探究教材の研究	○(M1) 佐藤 直哉 ¹ 、葛生 伸 ¹	1. 福井大院工
	21a-P2-27	学生プロジェクトによる理科実験授業におけるタブレット端末の電子黒板としての活用	○手島 駿 ¹ 、長谷川 誠 ¹	1. 千歳科大
奨	21a-P2-28	夕焼け実験装置における散乱光スペクトルの測定	○(B) 徳光 聖茄 ¹ 、長谷川 誠 ¹	1. 千歳科大
	21a-P2-29	白色 LED を用いた簡易型波長多重光通信実験セットと科学イベントでの使用	○萩原 潤樹 ¹ 、○長谷川 誠 ¹	1. 千歳科大
	21a-P2-30	3D ビンホールカメラ教材の学習指導案の最適化	○白井 勇祐 ¹ 、渡部 ゆうき ¹ 、小栗 和也 ¹	1. 東海大教養
	21a-P2-31	手鏡を用いた虚像を学ぶ授業プログラム	○千葉 芳明 ¹ 、西條 敏剛 ² 、本田 亮 ³	1. 宮城教大, 2. 宮城白石高, 3. 鳴門教大
	21a-P2-32	光速度不変原理の破綻 I	○土田 成能 ¹	1. ダベンチ研
	21a-P2-33	スキャニメーションを利用した理科教材に関する研究	○黒川 聖菜 ¹ 、渡邊 聖也 ¹ 、小栗 和也 ¹	1. 東海大教養
	21a-P2-34	拡張現実技術を活用した物理教材の開発	○林 和彦 ¹ 、福野 秀一 ¹ 、盛田 篤矢 ¹ 、正留 世紀 ¹ 、馬越 達也 ¹	1. 呉高専
	21a-P2-35	高専生による専門英語を用いた理化学実験教室	○柳生 義人 ¹ 、西口 廣志 ¹ 、石貫 文子 ¹ 、中尾 充宏 ¹	1. 佐世保高専
	21a-P2-36	薬剤師養成における物理教育 - 新学習指導要領を考慮した -	○渡部 智希 ¹	1. 北海道薬大
	21a-P2-37	電子機能ブロックの開発 (3)	○白井 敏男 ¹ 、安達 愛華 ¹ 、二山 愛理 ¹ 、棚瀬 勇介 ¹ 、松本 拓也 ¹	1. 岐阜高専
	21a-P2-38	無関心層への防災啓発のための教材開発	○野村 詩織 ¹	1. 京都大工
	21a-P2-39	順序依存性を有する偏光色教材	○松崎 俊樹 ¹ 、○原田 建治 ¹ 、菅原 詩織 ¹ 、酒井 大輔 ¹	1. 北見工大
	21a-P2-40	電気の流れやすさを学ぶ体験型教材の作製	○覃 黄毅 ¹ 、○酒井 大輔 ¹ 、菅原 詩織 ¹ 、原田 建治 ¹	1. 北見工大
	21a-P2-41	電気系複合シミュレータの開発	○今岡 聖也 ¹ 、外谷 昭洋 ¹	1. 呉高専
	21a-P2-42	化学技術者としてのコンピテンシー育成に向けた取り組み	○丸山 隆浩 ¹ 、坂東 俊治 ¹ 、坂 えり子 ¹ 、大脇 健史 ¹ 、永田 央 ¹ 、藤田 典史 ¹ 、小澤 理樹 ¹ 、田中 正剛 ¹ 、池邊 由美子 ¹ 、才田 隆広 ¹	1. 名城大理工
	21a-P2-43	創造理工学実験におけるマグネシウム酸化実験の導入	○鈴木 建司 ¹ 、伊藤 智幹 ¹ 、岡島 茂樹 ¹ 、柴田 祥一 ¹ 、佐藤 元泰 ¹ 、伊藤 響 ¹ 、阪田 泉 ¹ 、中山 和也 ¹ 、井筒 潤 ¹ 、大嶋 晃敏 ¹ 、伊藤 幸雄 ¹	1. 中部大工
	21a-P2-44	表面分析用イオン源の試作	○山田 健二 ¹ 、寺岡 佑起 ¹ 、玉山 泰宏 ² 、安井 寛治 ¹	1. 石川高専, 2. 長岡技科大
	21a-P2-45	温泉水を用いた ²¹⁰ Pb の半減期の教材化	○足利 裕人 ¹	1. 公立鳥取環境大
	21a-P2-46	可変周波数 Twin T 発振回路	○蟹江 壽 ¹ 、山口 富治 ²	1. 理大基礎工, 2. 電機大院工
	21a-P2-47	情報カードを用いた理科教材開発	○吉原 夕貴 ¹ 、小栗 和也 ¹	1. 東海大教養
	21a-P2-48	GPS ロガーを搭載したペットボトルロケット実験を含む学習指導案の作成	○片山 太我 ¹ 、今井 脩人 ¹ 、小栗 和也 ¹	1. 東海大教養
	21a-P2-49	不思議歯車を用いた天文学、技術史、機械工学教材の開発	○前川 仁 ¹ 、渡辺 美和子 ²	1. 産総研, 2. 渡辺教具製作所
	21a-P2-50	手回し発電機のハンドル回転エネルギーの測定器	○出口 幹雄 ¹	1. 新居浜高専
	21a-P2-51	永久磁石の“片側磁極”を用いたホール効果	○安森 偉郎 ¹ 、岡田 工 ² 、崔 一煥 ²	1. 東海大教育研, 2. 東海大チャレンジセンター
	21a-P2-52	天然膨張黒鉛シートを正極とした金属空気電池の作製とエネルギー教育への利用 II	○岡野 寛 ¹ 、福岡 蓮己 ¹ 、平川 巨紀 ¹ 、村川 星斗 ¹ 、栗原 健太 ² 、三崎 伸也 ² 、細川 敏弘 ² 、幸 哲也 ²	1. 香川高専, 2. 東洋炭素㈱
1.3 新技術・複合新領域 / Novel technologies and interdisciplinary engineering				
3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場				
	21a-P3-1	複数固定ガスセンサによる気体の発生源推定	○遠藤 元 ¹ 、西島 喜明 ¹	1. 横国大院工
	21a-P3-2	酸化マンガンナノシートのガスセンサ応答特性	○都倉 勇貴 ¹ 、松井 洋 ² 、緒明 佑哉 ^{1,2} 、今井 宏明 ^{1,2} 、松本 佳宣 ^{1,2} 、白鳥 世明 ^{1,2}	1. 慶大理工, 2. 慶大院理工
	21a-P3-3	銀イオンを担持した交互積層膜のガスセンサへの応用	○森山 友加里 ¹ 、柘植 洋祐 ² 、白鳥 世明 ^{1,2}	1. 慶大理工, 2. 慶大院理工
	21a-P3-4	水素ガスで動作するスイッチング素子の検証	○赤丸 悟士 ¹ 、原 正憲 ¹ 、松山 政夫 ¹	1. 富山大水素研セ
	21a-P3-5	3D プリンターをつかった Ne-Fe-B 系界面構造のモデリング	○山崎 淳 ¹ 、古宇田 光 ¹ 、合田 義弘 ²	1. 東大物性研, 2. 東工大総合理工
E	21a-P3-6	Investigation on the sensing mechanism and feasibility of ITO based liquid sensor	○(M2)Seok-hwan Lee ¹ , Jiho Chang ^{1,2} , Jung-Yeul Jung ³ , Moonjin Lee ⁴	1. OST. KMOU., 2. Electronic Material Engineering. KMOU., 3. Offshore Plant Industries. KRISO., 4. Maritime Safety Research. KRISO.
	21a-P3-7	ポリマー製フォトニック結晶を用いた非標識光学バイオセンサーの開発とアミロイドβの検出	○遠藤 達郎 ¹ 、長島 優 ² 、岩田 淳 ²	1. 阪府大院工, 2. 東大院医
	21a-P3-8	ネマティック液晶複屈折の光学干渉法による定量化	○伊藤 誠弥 ¹ 、丸山 耕一 ¹ 、木村 宗弘 ²	1. 秋田工業高等専門学校, 2. 長岡技術科学大学
	21a-P3-9	改良型動的 Shirley 法による XPS スペクトル解析の安定化	○田中 博美 ¹ 、西澤 佑吾 ¹ 、松本 凌 ^{2,3} 、吉川 英樹 ² 、田沼 繁夫 ² 、吉原 一紘 ⁴	1. 米子高専, 2. 物材機構, 3. 筑波大院, 4. シエンタ オミクロン
	21a-P3-10	ニッケルをドーブしたポリピロール膜の電気化学的挙動と特性	○松橋 広大 ¹ 、丸山 耕一 ¹	1. 秋田工業高等専門学校
	21a-P3-11	Deep-RIE により形成されたトレンチ側面の化学組成に関するプラズマ発光分光分析からの考察	○西岡 國生 ¹ 、佐藤 美那 ¹ 、○松谷 晃宏 ¹	1. 東工大半導体 MEMS
	21a-P3-12	液体定在波を利用した微生物細胞の流路レス凝集法におけるマイクロ開いアレイを用いた大きさによる篩い分けと単一分離	○松谷 晃宏 ¹ 、高田 綾子 ²	1. 東工大半導体 MEMS, 2. 東工大バイオ技術

3/21(Mon.) 13:45 - 16:15		口頭講演 (Oral Presentation) S322 会場	
13:45	21p-S322-1	マテリアルキュレーション：材料情報の活用による材料探索例 4	○吉武 道子 ¹ 1. 物質・材料研究機構
14:00	21p-S322-2	マテリアルキュレーションのための物性関連図検索システム	○吉武 道子 ¹ 1. 物質・材料研究機構
14:15	21p-S322-3	フェーズフィールドシミュレーションによる Al-Cu 合金凝固組織の組成依存性	○荻本 泰史 ¹ 、佐藤 圭輔 ¹ 1. 富士電機
14:30	21p-S322-4	超高速量子分子動力学法のための人工知能融合第一原理パラメータ決定	○佐藤 愛美 ¹ 、稲葉 賢二 ¹ 、石澤 由紀江 ¹ 、小原 幸子 ¹ 、佐藤 絵美 ¹ 、宮野 正之 ¹ 、ポノー バトリック ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、畠山 望 ¹ 、張山 昌論 ¹ 、宮本 明 ¹ 1. 東北大
14:45	21p-S322-5	衝撃処理された酸化ユーロピウム粉末の発光特性	○岸村 浩明 ¹ 、松永 拓也 ¹ 、森 俊輔 ¹ 、濱田 翔 ¹ 、有賀 敦 ¹ 、松本 仁 ¹ 1. 防衛大材料
15:00	休憩 / Break		
15:15	奨 21p-S322-6	インクジェットシステムを利用した微小球ゲルの高速生成	○(PC) 下河 有司 ¹ 、美谷 周二朗 ¹ 、酒井 啓司 ¹ 1. 東大生研
15:30	奨 21p-S322-7	イットリウム鉄ガーネット様膜の 1 液式低温成膜プロセスの開発	○川島 拓也 ¹ 、水戸 慎一郎 ¹ 、笹野 順司 ² 1. 東京高専, 2. 豊橋技科大
15:45	奨 21p-S322-8	TiN を用いた Pt 超薄膜水素センサの熱的安定性改善	○井並 祥太 ¹ 、古川 遼 ² 、堺 健司 ¹ 、紀和 利彦 ¹ 、塚田 啓二 ¹ 1. 岡山大自然, 2. 岡山大工
16:00	21p-S322-9	Pt ナノドットを用いた抵抗変化型水素センサの検出特性	○星野 伸介 ¹ 、竹内 豪 ¹ 、高橋 綱己 ^{1,2} 、内田 建 ^{1,2} 1. 慶應大理工, 2. JST CREST
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境 / Energy conversion, storage, resources and environment			
3/21(Mon.) 9:00 - 12:30		口頭講演 (Oral Presentation) S322 会場	
9:00	E 21a-S322-1	Adsorption of Benzene and Borderline / Group B Heavy Metals by Poly (butadiene-co-acrylic acid) Gel	○(M2) Brian Adala Omondi ¹ , Hiroataka Okabe ¹ , Yoshiaki Hidaka ¹ , Kazuhiro Hara ¹ 1. Kyushu University
9:15	21a-S322-2	ホルミウムレーザーを利用した二酸化炭素リサイクルシステムの開発	○佐藤 篤 ¹ 、那須 祥彦 ¹ 、佐々木 正史 ¹ 、丸尾 容子 ¹ 1. 東北工大
9:30	21a-S322-3	ウェアラブル発電システムの発電による下肢筋活動に与える影響	○斉藤 純 ¹ 1. サレジオ高専
9:45	E 21a-S322-4	Excellent Surface Passivation of Crystalline Silicon by Atomic Layer Deposition Al ₂ Mg _x O _y Thin Films	○HYUNJU LEE ¹ , Takefumi Kamioka ¹ , Dongyan Zhang ¹ , Naotaka Iwata ¹ , Yoshio Ohshita ¹ 1. Toyota Technol. Inst.
10:00	21a-S322-5	PbI ₂ ペロブスカイト太陽電池のインピーダンス分光法	○柳田 真利 ¹ 、白井 康裕 ¹ 、宮野 健次郎 ¹ 1. 物質・材料機構 GREEN
10:15	21a-S322-6	砂丘地に設置した太陽電池の表面に付着する砂塵汚れの分析	○五百井 拓哉 ¹ 、田川 公太郎 ¹ 、三保谷 拓史 ² 1. 鳥取大地, 2. シャープ
10:30	21a-S322-7	Si 粒子の酸化挙動と酸化抑制方法	○新井田 誠 ¹ 、巽 宏平 ¹ 1. 早大情シス
10:45	休憩 / Break		
11:00	奨 21a-S322-8	I ₂ -K ₂ CO ₃ 系熱化学的水素製造サイクルの基本反応の検討	○内藤 剛大 ¹ 、寺井 隆幸 ¹ 、武山 雅樹 ² 、近藤 和吉 ² 1. 東京大工, 2. (株) デンソー
11:15	21a-S322-9	冷却過程の異なるナノポーラスカーボンの水素吸蔵特性	○菅間 由紀乃 ¹ 、朱 傑 ¹ 、石橋 佳国 ¹ 、津田 欣典 ^{1,2} 、小松 啓志 ¹ 、齋藤 秀俊 ¹ 1. 長岡技術科学大学, 2. ヒューズ・テクノネット
11:30	21a-S322-10	人工知能融合超高速化量子分子動力学法の開発と蓄電池プロセスへの応用	○宮野 正之 ¹ 、佐藤 愛美 ¹ 、小原 幸子 ¹ 、石澤 由紀江 ¹ 、佐藤 絵美 ¹ 、稲葉 賢二 ¹ 、ポノー バトリック ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、畠山 望 ¹ 、張山 昌論 ¹ 、宮本 明 ¹ 、幸塚 寛 ² 、小山 章 ² 、江田 信夫 ² 、長井 龍 ² 、太田 瑠 ² 1. 東北大, 2. LIBTEC
11:45	21a-S322-11	サブサーフェス磁気イメージングシステムによる多層蓄電池内の非破壊電流密度分布計測に関する研究	○野本 和誠 ¹ 、松田 聖樹 ¹ 、稲垣 明里 ¹ 、美馬 勇輝 ¹ 、木村 憲明 ^{2,3} 、木村 建次郎 ^{1,3} 1. 神戸大, 2. IGS, 3. JST 先端計測
12:00	奨 21a-S322-12	高速充放電リチウムイオン電池に向けた強誘電体-活物質複合正極	○吉川 祐未 ¹ 、寺西 貴志 ¹ 、林 秀考 ¹ 、岸本 昭 ¹ 1. 岡大院自然
12:15	E 21a-S322-13	Alpha-Sn versus Beta-Sn Anodes for Li-, Na-, and Mg-ion Batteries: a First-Principles Study Including the Effect of Phonons	○Sergei Manzhos ¹ , Fleur Legrain ¹ , Oleksandr Malyi ² , Clas Persson ² 1. Ntl Uni of Singapore, 2. Uni of Oslo
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場	
	22a-P1-1	Si ナノ構造 / カーボンナノチューブ複合材料作製法の検討	○(M1) 亀田 直哉 ¹ 、山浦 大地 ¹ 、伊藤 和希 ¹ 、若林 慶 ¹ 、荻野 俊郎 ¹ 1. 横国大院
	22a-P1-2	AgPd@Pd/TiO ₂ 触媒を用いた硝酸分解による水素生成における UV-Vis 光照射の効果	○嶋本 大祐 ¹ 、服部 真史 ² 、吾郷 浩樹 ³ 、○辻 正治 ⁴ 1. 九大総理工, 2. 東工大フロンティア, 3. 九大先導研, 4. 九大炭素センター
	22a-P1-3	NLO 膜を用いた透明太陽電池の開発と機能性窓への応用	○森田 廣 ¹ 、市岡 大志 ¹ 、桐田 直志 ¹ 、吉田 博行 ¹ 1. 山口東京理大工
	22a-P1-4	全固体リチウムイオン二次電池のひずみイメージング	○松下 友紀 ¹ 、繁田 亜門 ¹ 、内田 勇介 ¹ 、高田 啓二 ¹ 1. 関西大院理工
	22a-P1-5	リチウムイオン二次電池シリコン負極のひずみイメージング	○大坂 隆馬 ¹ 、松下 友紀 ¹ 、佛願 建太 ¹ 、高田 啓二 ¹ 1. 関西大院理工
	22a-P1-6	リチウムイオン二次電池正極活物質 LiCoO ₂ エピタキシャル膜の評価	○(B) 中山 慶祐 ¹ 、大坂 隆馬 ¹ 、佛願 建太 ¹ 、高田 啓二 ¹ 、一杉 太郎 ² 、白木 将 ² 1. 関西大システム理工, 2. 東北大 AIMR
	22a-P1-7	メタンの低温水蒸気改質の実験的研究 続 (2)	○(M1) 北川 聖 ¹ 、高橋 克己 ¹ 、小原 宏之 ¹ 1. 玉川大学 TSCP
	22a-P1-8	CNT を用いた微生物燃料電池の試作 続 (2)	○(M2) 倉嶋 一壘 ¹ 、高橋 克己 ¹ 、小原 宏之 ¹ 1. 玉川大学 TSCP
	22a-P1-9	水素供給電解セルのための触媒電析に関する一実験	○鈴木 智久 ¹ 1. 玉川大学 TSCP
	22a-P1-10	偏光を用いた燃料電池用電解質膜の劣化解析	○堀内 孝祐 ¹ 、松田 敏彦 ¹ 1. 株式会社 KRI
	22a-P1-11	レーザープラズマを用いたアルミナ還元における物質の凝固点差によるアルミニウム回収法	○(M1) 明国 亮 ¹ 、佐藤 裕亮 ¹ 、松井 信 ¹ 、小紫 公也 ² 、荒川 義博 ² 1. 静岡大, 2. 東京大
	E 22a-P1-12	Removal of Metal Ions from Aqueous Solutions using Carboxymethyl Cellulose /Sodium Styrene Sulfonate Hydrogels prepared by Radiation Grafting	○(M2) Tran Thu Hong ¹ , Hiroataka Okabe ¹ , Yoshiaki Hidaka ¹ , Kazuhiro Hara ¹ 1. Kyushu University
	22a-P1-13	ローレンツ力を利用した海水・油分離装置内の海水流れと流路断面形状の関係	○横尾 太郎 ¹ 、赤澤 輝彦 ¹ 、岩本 雄二 ¹ 、梅田 民樹 ¹ 1. 神戸大
	22a-P1-14	GPS を利用した簡便なゴミ排出量調査方法の検討	○林 雅悠 ¹ 、石垣 藍 ¹ 、小栗 和也 ¹ 1. 東海大教養

1.5 計測技術・計測標準 / Instrumentation, measurement and Metrology				
3/19(Sat.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) S322 会場				
13:45	奨	19p-S322-1	ストロンチウム原子の時計遷移の絶対周波数測定 -SI 秒との比較における不確かさの低減-	○田邊 健彦 ¹ 、赤松 大輔 ¹ 、小林 拓実 ¹ 、高見澤 昭文 ¹ 、柳町 真也 ¹ 、池上 健 ¹ 、鈴木 智也 ¹ 、稲場 肇 ¹ 、大久保 章 ¹ 、安田 正美 ¹ 、洪 鋒雷 ^{1,2} 、大苗 敦 ¹ 、保坂 一元 ¹
14:00		19p-S322-2	2 台の電気的冷却方式低温サファイア発振器間の周波数安定度測定	○池上 健 ¹ 、渡部 謙一 ¹ 、柳町 真也 ¹ 、高見澤 昭文 ¹ 、平野 育 ¹ 、萩本 憲 ¹ 、ハートネット ジョン ²
14:15	奨	19p-S322-3	核磁気共鳴計測用の微小サンプル管の形状設計	○樋沢 拓真 ¹ 、高橋 雅人 ² 、岩瀬 英治 ¹
14:30		19p-S322-4	1 M Ω 集積化量子ホール素子の開発	○大江 武彦 ¹ 、Sucheta Gorwadkar ¹ 、板谷 太郎 ¹ 、金子 晋久 ¹
14:45	奨	19p-S322-5	多種ガス用微量水分発生装置におけるガス流量制御の長期安定性	○天野 みなみ ¹ 、阿部 恒 ¹
15:00		19p-S322-6	黒体輻射による超高温域の熱力学温度測定	○山口 祐 ¹ 、笹嶋 尚彦 ¹ 、山田 善郎 ¹
15:15		19p-S322-7	質量同時測定型液中粒子計数装置による液中粒子数濃度標準開発	○坂口 孝幸 ¹
15:30	奨	19p-S322-8	非接触な潜傷検査技術 - 熱応力誘起光散乱法によるガラス基板表面の潜傷検出 -	○坂田 義太郎 ¹ 、寺崎 正 ¹ 、野中 一洋 ¹
15:45			休憩 / Break	
16:00		19p-S322-9	植物から大気中に放出されるイオン電荷の測定	○一木 博文 ¹ 、高橋 芳弘 ¹ 、二神 光次 ² 、川口 俊郎 ² 、三島 正章 ²
16:15		19p-S322-10	温度安定型水晶振動子出力への湿度の影響低減	○鈴木 淳 ¹
16:30	奨	19p-S322-11	水晶振動子 / 微小液滴界面制御による粘性計測	○(D) 深田 健太 ¹ 、白鳥 世明 ¹
16:45		19p-S322-12	液中で振動するステンレス球を使った粘度と密度の同時計測	○西田 順一 ¹ 、坂井 佑 ¹ 、東 圭 ¹ 、岩倉 行志 ¹
17:00		19p-S322-13	2 連回転電場を用いた新方式質量分析器の開発	○堀田 昌直 ¹ 、野島 雅 ² 、胡桃 聡 ³ 、鈴木 薫 ³ 、足立 達哉 ⁴ 、草柳 高志 ⁴ 、盛谷 浩右 ⁵ 、寺崎 正 ¹ 、藤尾 侑輝 ¹
17:15		19p-S322-14	接着状態の応力発光可視化に関する研究	○(同) オフィスタンデム、2. 東京理科大学総研、3. 日本大学理工、4.(株) アンペール、5. 兵庫県立大学工研
3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場				
		21a-P4-1	蛍光温度センサ用 Mn 添加スピネルの赤色発光強度の検討	○勝亦 徹 ¹ 、青木 美奈 ¹ 、折原 友香 ¹ 、長山 聖 ¹ 、見富 大真 ¹ 、相沢 宏明 ¹ 、小室 修二 ¹
		21a-P4-2	磁気記録ヘッドの磁気誘起ひずみイメージング	○佛願 建太 ¹ 、大坂 隆馬 ¹ 、松下 友紀 ¹ 、高田 啓二 ¹
		21a-P4-3	磁気テープの磁場誘起ひずみイメージング	○奥野 幸穂 ¹ 、高田 啓二 ¹ 、大坂 隆馬 ¹ 、溝尾 研人 ¹ 、安原 希 ¹
		21a-P4-4	電気泳動堆積法による TiO ₂ マイクロパターンの作製と光触媒活性評価方法への応用	○日置 亜也子 ¹ 、村上 修一 ¹ 、佐藤 和郎 ¹ 、物部 浩達 ²
		21a-P4-5	静電気分布を用いた材料表面の水分吸着に関する検討	○菊永 和也 ¹ 、江頭 正浩 ¹ 、山下 博史 ¹ 、寺崎 正 ¹
1.6 超音波 / Ultrasonics				
3/20(Sun.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) S322 会場				
13:45	招	20p-S322-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15 分) 極性反転構造の ZnO 及び ScAlN 圧電薄膜の形成と弾性波デバイス応用	○森 剛志 ¹ 、鈴木 雅視 ² 、柳谷 隆彦 ²
14:00	奨	20p-S322-2	超音波速度変化による脂肪肝診断のための簡易プローブ	○(M1) 堀 誠 ¹ 、真野 和音 ¹ 、谷川 昇平 ¹ 、横田 大輝 ¹ 、青谷 悠平 ¹ 、熊谷 勇汰 ¹ 、和田 健司 ¹ 、松中 敏行 ¹ 、堀中 博道 ¹ 、森川 浩安 ²
14:15	奨	20p-S322-3	RF 加温による超音波速度変化イメージング法を用いた血管不安定プラーク診断装置	○(M1) 横田 大輝 ¹ 、真野 和音 ¹ 、谷川 昇平 ¹ 、堀 誠 ¹ 、青谷 悠平 ¹ 、熊谷 勇汰 ¹ 、松山 哲也 ¹ 、和田 健司 ¹ 、松中 敏行 ¹ 、堀中 博道 ¹ 、森川 浩安 ²
14:30		20p-S322-4	海綿骨の骨梁形状が超音波二波伝搬現象に与える影響	○(B) 中西 翔子 ¹ 、八軒 卓磨 ¹ 、井本 有紀 ¹ 、松川 真美 ¹
14:45	奨	20p-S322-5	骨中のコラーゲン架橋が音速異方性に与える影響	○井本 有紀 ¹ 、高柳 真司 ¹ 、太田 哲男 ¹ 、松川 真美 ¹
15:00		20p-S322-6	プラスチック光ファイバの複合材料への超音波溶着	○(M1) 島田 俊平 ¹ 、田中 宏樹 ¹ 、長谷部 和彦 ¹ 、林 寧生 ¹ 、越智 寛 ² 、松井 孝洋 ² 、西崎 到 ³ 、松本 幸大 ⁴ 、田中 洋介 ⁵ 、中村 一史 ⁶ 、水野 洋輔 ¹ 、中村 健太郎 ¹
15:15		20p-S322-7	超音波振動によるネマティック液晶の 2 次元配向制御	○(B) 清水 裕貴 ¹ 、谷口 聡紀 ¹ 、江本 顕雄 ¹ 、小山 大介 ¹ 、中村 健太郎 ² 、松川 真美 ¹
15:30		20p-S322-8	溶存気体成分 (空気 / 二酸化炭素) に依存した超音波粒子凝集体と音響キャピテーション気泡との関係	○矢内 沙祐里 ¹ 、村松 浩也 ¹ 、齋藤 隆之 ¹
15:45	奨	20p-S322-9	前方光散乱を用いた微小液滴径のオンサイト測定	○早川 大智 ¹ 、美谷 周二朗 ¹ 、酒井 啓司 ¹
16:00			休憩 / Break	
16:15	奨	20p-S322-10	UHF 帯 MEMS 無線水晶振動子バイオセンサによる夾雑物中のマーカー蛋白質の無標識検出	○(M1) 岩田 有弘 ¹ 、鳥居 宏臣 ¹ 、萩 博次 ¹ 、平尾 雅彦 ¹
16:30		20p-S322-11	パースト波アンダーサンプリング回路の開発と SAW 微量水分計への適用	○辻 俊宏 ¹ 、大泉 透 ² 、竹田 宣生 ² 、赤尾 慎吾 ² 、塚原 祐輔 ² 、山中 一司 ²
16:45		20p-S322-12	高音速薄膜装置によるリーキー弾性表面波の低損失化 - LiTaO ₃ 基板への適用 -	○垣尾 省司 ¹ 、勝谷 信介 ¹ 、保坂 桂子 ¹
17:00		20p-S322-13	非同期光パルスプローブ法による GHz 帯任意周波数表面音響波の時間分解二次元イメージング	○松田 理 ¹ 、野野 浩史 ¹ 、加藤 駿 ¹ 、兼子 翔吾 ¹ 、メジル シルヴァン ¹ 、友田 基信 ¹ 、ライト オリバー ¹
17:15		20p-S322-14	直線集束ビーム超音波材料解析システムを用いた X-cut ランガサイト型単結晶の方位決定の実験的検討	○大橋 雄二 ¹ 、横田 有為 ² 、工藤 哲男 ¹ 、庄子 育宏 ¹ 、鎌田 圭 ³ 、黒澤 俊介 ³ 、吉川 彰 ^{1,2,3}
17:30	奨	20p-S322-15	高抵抗 GaN の高温における共振超音波スペクトロスコピーの開発と圧電性の評価	○(M1) 足立 寛太 ¹ 、萩 博次 ¹ 、長久保 白 ¹ 、中村 暢伴 ¹ 、平尾 雅彦 ¹ 、今出 完 ² 、吉村 政志 ² 、森 勇介 ²
17:45	奨	20p-S322-16	深さ方向に分解能を持つ音速計測法の開発: 共焦点ピコ秒超音波法	○関口 修 ¹ 、中村 暢伴 ¹ 、萩 博次 ¹ 、平尾 雅彦 ¹

18:00	奨 20p-S322-17	【注目講演】アンテナ発振非接触圧電センサによる薄膜の形態変化モニタリング手法の開発	○白岩 裕一郎 ¹ 、橋里 駿 ¹ 、中村 暢伴 ¹ 、荻 博次 ¹ 、1. 阪大基礎工 平尾 雅彦 ¹
3/21(Mon.) 9:30 - 11:30	ポスター講演 (Poster Presentation) P5 会場		
	21a-P5-1	反射型横波弾性表面波センサのための計測システム開発と環境計測応用	○(M2) 増田 智仁 ¹ 、近藤 淳 ^{1,2} 1. 静岡大院, 2. 静岡大創造院
	21a-P5-2	横波弾性表面波デバイスを用いた直接メタノール燃料電池用センサ	○多田 恭輔 ¹ 、近藤 淳 ¹ 1. 静岡大工
	21a-P5-3	横波弾性表面波を用いた液体中の微粒子測定	○小林 沙耶 ¹ 1. 静岡大工
E	21a-P5-4	Femtosecond laser-induced acoustic wave emission from gold nano-colloidal suspensions; shape dependence	○Frances Camille Masim ¹ , Hao-Li Liu ² , Koji Hatanaka ^{1,2} 1. Academia Sinica, 2. Chang Gung Univ.
	21a-P5-5	音響キャビテーションを伴う音場のシャドウグラフ計測	○(D) 黒山 喬夫 ¹ 、水谷 孝一 ² 、若槻 尚斗 ² 、海老原 格 ² 、大淵 武史 ³ 1. 筑波大・シス情工, 2. 筑波大・シス情系, 3. 防衛大・応物
	21a-P5-6	純水を用いた単一気泡ソルミネッセンスの発光測定システムの検討	○(M1) 山田 量子 ¹ 、松井 信 ¹ 1. 静岡大

2 放射線 / Ionizing Radiation

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

3/21(Mon.) 16:00 - 18:00	ポスター講演 (Poster Presentation) P12 会場		
奨	21p-P12-1	シリコングリッドを用いた画像検出器用シンチレータの開発	○田端 健人 ¹ 、西澤 潤一 ¹ 、増澤 智昭 ¹ 、青木 徹 ¹ 1. 静大院情
	21p-P12-2	BNCTのための熱外中性子束強度モニターの基本設計	○(B) 柏木 佑介 ¹ 、関 興彩 ¹ 、真鍋 正伸 ¹ 、佐藤 文信 ¹ 、村田 勲 ¹ 1. 阪大院工
	21p-P12-3	BNCTのための T/N 比リアルタイム計測装置用検出素子の検討	○(B) 大屋 瞭介 ¹ 、皿上 順英 ¹ 、真鍋 正伸 ¹ 、佐藤 文信 ¹ 、村田 勲 ¹ 1. 阪大院工
	21p-P12-4	パルス中性子透過分光撮影のための画像取得システムの開発とその応用	○田中 健太 ¹ 、石塚 健 ¹ 、持木 幸一 ¹ 、石川 裕卓 ² 、1. 都市大工, 2. 北大理工, 3. 名大工 佐藤 博隆 ² 、加美山 隆 ² 、鬼柳 善明 ³
奨	21p-P12-5	サブ mm 等方分解能を目指した PET 検出器 X' tal Cube の結晶弁別能の改善	○新田 宗孝 ^{1,2} 、稲玉 直子 ² 、錦戸 文彦 ² 、吉田 英治 ² 、1. 千葉大理, 2. 放医研 田島 英朗 ² 、河合 秀幸 ¹ 、山谷 泰賀 ²
	21p-P12-6	TES型マイクロカロリメータ用低発熱型 SQUID の特性評価	○吉田 早耶香 ¹ 、前畑 京介 ¹ 、善本 翔太 ¹ 、満田 和久 ² 、酒井 和宏 ² 1. 九大工, 2. JAXA
	21p-P12-7	77 K における GAGG 結晶の γ 線に対するシンチレーション応答測定	○都留 由紀子 ¹ 、前畑 京介 ¹ 、木佐 優太 ¹ 、鎌田 圭 ¹ 、2. 庄予 育宏 ³ 、吉川 彰 ^{2,3} 1. 九大工, 2. 東北大, 3. (株) C & A
	21p-P12-8	リバース型アバランシェフォトダイオードのシングルイベント効果のシミュレーション研究 (II)	○(M1) 松田 光平 ¹ 、片寄 祐作 ¹ 、大島 武 ² 、小野 田 忍 ² 、牧野 高純 ² 1. 横国大工, 2. 原子力機構
	21p-P12-9	シンチレーション飛跡検出器による治療用重粒子線の線質計測	○石田 祥大 ^{1,2} 、松藤 成弘 ^{2,1} 、陳 志凌 ² 、河野 俊之 ¹ 、古場 祐介 ² 1. 東工大総理工, 2. 放医研
	21p-P12-10	単結晶 CdTe への Ar プラズマと UV オゾンによる表面処理効果	○(M1) 柿本 祐輔 ¹ 、岸原 弘之 ² 、市岡 聖菜 ² 、徳田 敏 ² 、吉牟田 利典 ² 、佐藤 敏幸 ^{1,2} 1. 奈良先端科学技術大学院大学, 2. (株) 島津製作所
	21p-P12-11	CdS 半導体結晶シンチレータの放射線応答評価	○柳田 健之 ¹ 、越水 正典 ² 、岡田 豪 ¹ 1. 奈良先端, 2. 東北大工
	21p-P12-12	中性子計測用 Ce:LuLiF ₃ 共結晶のシンチレーション特性の固化速度依存性	○柳田 健之 ¹ 、福田 健太郎 ² 、藤本 裕 ³ 、河口 範明 ⁴ 、渡辺 賢一 ⁵ 、岡田 豪 ¹ 、瓜谷 章 ⁵ 1. 奈良先端大, 2. トクヤマ, 3. 東北大工, 4. A&T, 5. 名大工
	21p-P12-13	ガンマ線用 Ce:LuLiF ₃ のシンチレーション特性	○柳田 健之 ¹ 、藤本 裕 ² 、福田 健太郎 ² 、岡田 豪 ¹ 1. 奈良先端大, 2. 東北大工, 3. トクヤマ
	21p-P12-14	Sm 添加 CsBr によるラジオフォトルミネッセンス	○岡田 豪 ¹ 、藤本 裕 ² 、田中 宏典 ² 、Kasap Safa ³ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大, 2. 東北大, 3. サスカ大 (加)
	21p-P12-15	Sm 添加 ZnO-P ₂ O ₅ ガラス中で生じる放射線誘起現象とそれを用いた放射線計測への検討	○岡田 豪 ¹ 、正井 博和 ² 、鳥本 彩 ² 、Kasap Safa ³ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大, 2. 京大化研, 3. サスカ大 (加)
	21p-P12-16	Dy 添加 NaPO ₃ -Al(PO ₃) ₃ ガラスのシンチレーション特性評価	○(M1) 久良 智明 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 、藤本 裕 ² 、正井 博和 ³ 1. 奈良先端大, 2. 東北大工, 3. 京大化研
	21p-P12-17	銀添加 Li ₃ PO ₄ -Al(PO ₃) ₃ ガラスの RPL 特性	○(M1) 辰巳 浩規 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 、正井 博和 ² 1. 奈良先端科学技術大学院大学, 2. 京都大学化学研究所
	21p-P12-18	無添加 ZnSe 半導体結晶のシンチレーション特性	○(M1) 辰巳 浩規 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端科学技術大学院大学
	21p-P12-19	無添加 ZrO ₂ のシンチレーション特性とドシメーター特性	○(M1) 辰巳 浩規 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端科学技術大学院大学
	21p-P12-20	イットリア安定化ジルコニア結晶のシンチレーションおよびドシメーター特性評価	○中内 大介 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大物質
	21p-P12-21	Ce 添加 SrAl ₂ O ₇ 単結晶のシンチレーション特性評価	○中内 大介 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、越水 正典 ² 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大物質, 2. 東北大工
E	21p-P12-22	Scintillation and optical properties of Cr-doped Al ₂ O ₃ crystal and ceramic	○(M1) Nurul Athirah ¹ , Masaki Mori ¹ , Go Okada ¹ , Takayuki Yanagida ¹ 1. NAIST
	21p-P12-23	Sn 添加 YAG の光物性およびシンチレーション特性	○(M1) 森 正樹 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、正井 博和 ² 、越水 正典 ³ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大, 2. 京大化研, 3. 東北大院工
	21p-P12-24	Nd-Ce 共添加 Lu ₃ Al ₅ O ₁₂ 単結晶のシンチレーション特性における Ce ³⁺ 濃度依存性	○(M1) 大矢 智久 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大
	21p-P12-25	SPS によって作製した透明セラミック CaO のドシメーター特性	○加藤 匠 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大
	21p-P12-26	Y 添加透明セラミック MgO のドシメーター特性	○加藤 匠 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大
	21p-P12-27	透明セラミック BaF ₂ のシンチレータ特性	○加藤 匠 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大
	21p-P12-28	BaF ₂ 添加 AlN セラミックスのシンチレーションおよびドシメーター特性	○(M1) 小島 香織 ¹ 、岡田 豪 ¹ 、福田 健太郎 ² 、柳田 健之 ¹ 1. 奈良先端大, 2. (株) トクヤマ
	21p-P12-29	希土類元素をドーブした CaF ₂ 蛍光体の PL, TSL および OSL 特性	○南戸 秀仁 ¹ 、中川 涼太 ¹ 、平澤 一樹 ¹ 、竹井 義法 ¹ 、岡田 豪 ² 、柳田 健之 ² 、藤本 裕 ³ 、福田 健太郎 ⁴ 、代田テックノル 柳田 由香 ⁵ 、山本 幸佳 ⁵ 1. 金沢工大, 2. 奈良先端大, 3. 東北大, 4. トクヤマ, 5. 千
	21p-P12-30	ZnO-P ₂ O ₅ ガラス中の Sn ²⁺ 発光に与える 2 価酸化物の置換効果	○正井 博和 ¹ 、上田 悠貴 ¹ 、岡田 豪 ² 、柳田 健之 ² 1. 京大化研, 2. 奈良先端大
	21p-P12-31	Cu ⁺ 及び Ce ³⁺ 添加 Na ₂ O-Al ₂ O ₃ -B ₂ O ₃ ガラスのドシメーター特性	○藤本 裕 ¹ 、矢幅 拓真 ¹ 、田中 宏典 ¹ 、柳田 健之 ² 、越水 正典 ¹ 、浅井 圭介 ¹ 1. 東北大院工, 2. 奈良先端
	21p-P12-32	Ce 添加 YLiF ₄ 結晶の熱蛍光及び輝尽蛍光特性	○藤本 裕 ¹ 、柳田 健之 ² 、田中 宏典 ¹ 、福田 健太郎 ¹ 、越水 正典 ¹ 、浅井 圭介 ¹ 1. 東北大院工, 2. 奈良先端, 3. トクヤマ
	21p-P12-33	TlCdCl ₃ 結晶の光学及びシンチレーション特性	○藤本 裕 ¹ 、佐伯 啓一郎 ¹ 、田中 宏典 ¹ 、柳田 健之 ¹ 、越水 正典 ¹ 、浅井 圭介 ¹ 1. 東北大院工, 2. 奈良先端
	21p-P12-34	アルカリ金属含有リン酸塩ガラスのラジオフォトルミネッセンス特性	○(M1) 田中 宏典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、佐伯 啓一郎 ¹ 、矢幅 拓真 ¹ 、浅井 圭介 ¹ 1. 東北大院工, 2. 奈良先端大

21p-P12-35	Rb リン酸塩ガラスのラジオフォトルミネッセンス特性	○(M1) 田中 宏典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、佐伯 啓一郎 ¹ 、矢幅 拓真 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 奈良先端大
21p-P12-36	Cs リン酸塩ガラスのラジオフォトルミネッセンス特性	○(M1) 田中 宏典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、佐伯 啓一郎 ¹ 、矢幅 拓真 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 奈良先端大
21p-P12-37	CsCaCl ₃ 焼結体の輝尽蛍光特性	○(B) 野田 沙矢佳 ¹ 、佐伯 啓一郎 ¹ 、越水 正典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹ 、柳田 健之 ²	1. 東北大工, 2. 奈良先端大
21p-P12-38	NaCl および CsI の焼結体におけるドシメータ特性	○(B) 野田 沙矢佳 ¹ 、佐伯 啓一郎 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、越水 正典 ¹ 、浅井 圭介 ¹ 、柳田 健之 ²	1. 東北大工, 2. 奈良先端大
21p-P12-39	Tl 添加 CsCl 結晶の蛍光及びシンチレーション特性	○酒井 卓巳 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大工, 2. 奈良先端大
21p-P12-40	CsCaCl ₃ :Pb の蛍光及びシンチレーション特性	○(M1) 佐伯 啓一郎 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 奈良先端大
21p-P12-41	水溶液法によるホウ酸系結晶の作製とそのシンチレーション特性の解析	○塚本 貴之 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 奈良先端大
21p-P12-42	重金属ナノ粒子を含有したプラスチックシンチレータの X 線検出特性線	○(B) 樋山 史幸 ¹ 、野口 多紀朗 ¹ 、越水 正典 ¹ 、岸本 俊二 ² 、春木 理恵 ² 、錦戸 文彦 ³ 、柳田 健之 ⁴ 、藤本 裕 ¹ 、相田 努 ¹ 、高見 誠一 ¹ 、阿尻 雅史 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大, 2. 高エネ研, 3. 放医研, 4. 奈良先端大
21p-P12-43	ニュートリノレス二重β崩壊検出を企図したα電子系有機修飾 MoO ₃ ナノ粒子装荷液体シンチレータの開発	○(M2) 滝川 奨 ¹ 、野口 多紀朗 ¹ 、相田 努 ¹ 、高見 誠一 ¹ 、阿尻 雅文 ¹ 、越水 正典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大
21p-P12-44	フォトクロミズムを示すスピロピランの X 線照射による異性化学挙動	○(B) 浅井 康平 ¹	1. 東北大院工
21p-P12-45	YBa ₂ Cu ₃ O _x への X 線照射による特性変化の観測	○(B) 黒田 勇樹 ¹ 、越水 正典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工
21p-P12-46	γ線照射した絶縁材料の抵抗特性	○一木 博文 ¹ 、緒方 将人 ¹ 、松岡 剛志 ¹ 、二神 光次 ¹ 、川口 俊郎 ² 、三島 正章 ²	1. 九産大工, 2. 財) 光線研究所
21p-P12-47	TlBr 結晶の蛍光およびシンチレーション特性	○越水 正典 ¹ 、人見 啓太郎 ¹ 、柳田 健之 ² 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 奈良先端大
21p-P12-48	Ce:LiCaAlF ₆ におけるエネルギー移動過程の温度依存性	○越水 正典 ¹ 、佐伯 啓一郎 ¹ 、山下 真一 ² 、柳田 健之 ³ 、福田 健太郎 ⁴ 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 東大院工, 3. 奈良先端大, 4. トクヤマ
21p-P12-49	ピコ秒過渡吸収分光による Ce:Gd ₂ SiO ₅ (GSO) 中でのホスト励起状態の解析	○越水 正典 ¹ 、山下 真一 ² 、室屋 裕佐 ³ 、柳田 健之 ⁴ 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工, 2. 東大院工, 3. 阪大産研, 4. 奈良先端大
21p-P12-50	垂直磁気異方性 CoFeB-MgO 磁気トンネル接合の高速中性子耐性評価 (III)	○成田 克 ¹ 、高橋 豊 ¹ 、原田 正英 ² 、大井 元貴 ² 、川 健一 ² 、小林 大輔 ³ 、廣瀬 和之 ³ 、佐藤 英夫 ^{4,5} 、池田 正二 ^{4,5} 、遠藤 哲郎 ^{4,5,6} 、大野 英男 ^{4,5,7,8}	1. 山形大工, 2. 原子力機構 J-PARC, 3. JAXA 宇宙研, 4. 東大 CIES, 5. 東北大 CSIS, 6. 東北大工, 7. 東北大通研 LNS, 8. 東北大 WPI-AIMR
21p-P12-51	固体燃料ロケット推進薬における酸化剤粒子の規則配列	○(B) 上垣 那津世 ¹ 、細見 直正 ¹ 、大竹 可那 ² 、岩崎 祥大 ³ 、松本 幸太郎 ⁴ 、羽生 宏人 ⁴ 、山口 聡一郎 ¹	1. 関西大シス理, 2. 関西大院理, 3. 総研大物, 4. JAXA
21p-P12-52	固体燃料ロケット推進薬における X 線 CT の統計的分析法	○(M1) 大竹 可那 ¹ 、細見 直正 ² 、上垣 那津世 ² 、岩崎 祥大 ³ 、松本 幸太郎 ⁴ 、羽生 宏人 ⁴ 、山口 聡一郎 ²	1. 関西大院理, 2. 関西大シス理, 3. 総研大物, 4. JAXA
21p-P12-53	生体内多核種同時イメージング検出器の基礎検討	○(M1) 丁 性元 ¹ 、吉原有里 ¹ 、島添 健次 ¹ 、高橋 浩之 ¹ 、杉田 亮平 ² 、広瀬 農 ²	1. 東京大工, 2. 東京大農
21p-P12-54	RANS におけるフォトンカウンティング法の適応	○田中 健太 ¹ 、石塚 健 ¹ 、堀 拓馬 ¹ 、持木 幸一 ¹ 、竹谷 篤 ² 、大竹 淑恵 ²	1. 都市大院工, 2. 理研光量子
21p-P12-55	大強度パルス相対論的電子ビーム照射による NaCl 単結晶の点欠陥生成と温度上昇	○鳥羽 瞭太 ¹ 、菊池 崇志 ² 、今田 剛 ^{1,3} 、末松 久幸 ¹ 、中山 忠親 ¹ 、鈴木 常生 ¹ 、新原 皓一 ¹	1. 長岡技術科学大学 極限エネルギー密度工学研究センター, 2. 長岡技術科学大学, 3. 新潟工科大学
2.1 放射線物理一般・検出器基礎 / Radiation physics and Detector fundamentals			
3/21(Mon.) 10:30 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) W810 会場			
10:30	21a-W810-1	アルカリ金属元素を共添加した Eu:SrI ₂ 結晶におけるシンチレーション特性	○(M2) 伊藤 友樹 ¹ 、横田 有為 ² 、黒澤 俊介 ² 、吉川 彰 ^{1,2,4} 、Kral Robert ³ 、鎌田 圭 ^{2,4} 、Jan Pejchal ³ 、大橋 雄二 ¹ 、C&A
10:45	21a-W810-2	Ce 賦活 (Gd, La) ₂ SiO ₇ シンチレータの温度特性	○堀合 毅彦 ¹ 、黒澤 俊介 ² 、村上 力輝斗 ¹ 、山路 晃広 ¹ 、庄子 育宏 ^{1,3} 、大橋 雄二 ¹ 、鎌田 圭 ^{2,3} 、横田 有為 ² 、吉川 彰 ^{1,2,3}
11:00	21a-W810-3	Mg 共添加 Ce:Lu ₃ (Ga,Al) ₅ O ₁₂ シンチレータの作製とシンチレーション特性評価	山口 大聡 ¹ 、○鎌田 圭 ^{2,3} 、庄子 育宏 ^{3,1} 、黒澤 俊介 ¹ 、横田 有為 ² 、大橋 雄二 ¹ 、吉川 彰 ^{1,2,3}
11:15	奨 21a-W810-4	Cs ₂ HfCl ₆ 及び Cs ₂ ZrCl ₆ シンチレータの特性比較	○(M1) 佐伯 啓一郎 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、越水 正典 ¹ 、柳田 健之 ² 、浅井 圭介 ¹
11:30	奨 21a-W810-5	多光子蛍光計測及び LA-ICPMS による Ce ³⁺ :LiCaAlF ₆ 単結晶の評価	○(B) 田中 美帆 ¹ 、遠山 浩平 ¹ 、小野 晋吾 ¹ 、高柳 順 ² 、福田 健太郎 ³ 、横納 好岐 ⁴ 、平田 岳史 ⁴
11:45	奨 21a-W810-6	Ce ³⁺ ドープバリウムホウ酸塩ガラスの発光特性調査	○鳥本 彩 ¹ 、正井 博和 ¹ 、岡田 豪 ² 、柳田 健之 ²
12:00	奨 21a-W810-7	Peak-to-Charge Discrimination (PQD) 法による GSO:Ce(0.4, 1.0, 1.5mol%) を用いた時定数分解能の評価	○小川原 亮 ¹ 、石川 正純 ¹
12:15	21a-W810-8	プラスチックシンチレーションカウンター試作器	○古田 悦子 ¹ 、岩崎 紀子 ¹
3/21(Mon.) 13:45 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) W810 会場			
13:45	招 21p-W810-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 【注目講演】マイクロビーム放射線治療に用いる高線量・高空間分解能 X 線計測を目的とした線量計測技術の開発	○岡田 豪 ¹ 、上田 純平 ² 、田部 勢津久 ² 、Edgar Andy ³ 、Belev George ⁴ 、柳田 健之 ¹ 、Kasap Safa ⁵
14:00	21p-W810-2	電離箱のパルス信号に及ぼす測定妨害核種の超高頻度入射の効果	○松原 章浩 ¹ 、藤田 奈津子 ¹ 、三宅 正恭 ² 、西澤 章光 ²
14:15	21p-W810-3	重イオンと気体標的の衝突による負イオン生成	○渡邊 桃 ¹ 、松尾 崇 ² 、河野 俊之 ¹ 、大野 由美子 ³ 、渡邊 紳一 ² 、村上 健 ⁴
14:30	21p-W810-4	α線に対する単結晶 CVD ダイアモンド放射線検出器の Fano 因子評価	○嶋岡 毅敏 ¹ 、金子 純一 ¹ 、佐藤 優樹 ² 、坪田 雅功 ¹ 、新名 宏明 ¹ 、茶谷 原昭義 ³ 、渡邊 幸志 ³ 、梅澤 仁 ³ 、李野 由明 ³
14:45	21p-W810-5	3 × 3 ピクセル電極を有する TlBr 検出器の製作	○人見 啓太郎 ¹ 、長野 宣道 ¹ 、小野寺 敏幸 ² 、伊藤 辰也 ¹ 、金 聖潤 ¹ 、石井 慶造 ¹

15:00	21p-W810-6	垂直 TMZ 法を用いた TiBr 結晶の育成及び TiBr 検出器の評価	○小野寺 敏幸 ¹ 、人見 啓太郎 ² 、庄司 忠良 ¹	1. 東北工大、2. 東北大
15:15	21p-W810-7	Tl 電極の臭化タリウム半導体検出器の温度特性	○松村 基広 ¹ 、山崎 淳 ¹ 、渡辺 賢一 ¹ 、瓜谷 章 ¹ 、長野 宣道 ² 、人見 啓太郎 ²	1. 名古屋大、2. 東北大
15:30	21p-W810-8	澆液化プロセスによる TiBr 結晶の育成	○能勢 真伍 ¹ 、郷家 正迪 ¹ 、田邊 健治 ¹ 、常盤 和靖 ¹ 、櫻木 史郎 ²	1. 東理大基礎工、2. ユニオンマテリアル

2.2 検出器開発 / Detection systems

3/19(Sat.) 10:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) W810 会場				
10:00	19a-W810-1	低抵抗率基板を用いた Gated Silicon Drift Detector の厚膜化と受光面積の拡大	○竹下 明伸 ¹ 、櫻井 俊伍 ¹ 、小田 裕也 ¹ 、福島 慎也 ¹ 、石川 翔平 ¹ 、日高 淳輝 ¹ 、松浦 秀治 ¹	1. 大阪電通大
10:15	19a-W810-2	厚膜化 Gated Silicon Drift Detector の有効面積の拡大	○石川 翔平 ¹ 、福島 慎也 ¹ 、櫻井 俊伍 ¹ 、小田 祐也 ¹ 、竹下 明伸 ¹ 、日高 淳輝 ¹ 、松浦 秀治 ¹	1. 大阪電通大
10:30	19a-W810-3	マルチボード型 CdTe ピクセル検出器開発	○豊川 秀訓 ¹ 、佐治 超爾 ¹ 、川瀬 守弘 ¹ 、呉 樹奎 ¹ 、古川 行人 ¹ 、梶原 堅太郎 ¹ 、佐藤 真直 ¹ 、広野 等子 ² 、菅浦 敬久 ³ 、城 鮎美 ³ 、末永 敦士 ⁴ 、池田 博一 ⁵	1. JASRI/Spring-8, 2. ボン大学, 3. 原子力機構, 4. 豊和産, 5. JSAS/JAXA
10:45	19a-W810-4	Tl ₂ Si ₄ 放射線検出器の開発	○高橋 司 ¹ 、渡辺 俊一郎 ¹ 、渡邊 肇 ¹ 、野島 太郎 ¹ 、小野寺 敏幸 ²	1. 三井金属鉱業、2. 東北工大
11:00	19a-W810-5	整流性電極を用いた Tl ₂ Si ₄ 放射線検出器の特性向上	○渡辺 俊一郎 ¹ 、野島 太郎 ¹ 、渡邊 肇 ¹ 、高橋 司 ¹ 、小野寺 敏幸 ²	1. 三井金属鉱業、2. 東北工大
11:15	奨 19a-W810-6	超薄窓型単結晶ダイヤモンド荷電粒子検出器の開発 (2)	○加田 渉 ¹ 、神谷 富裕 ² 、Grijl Veljko ³ 、Skukan Natko ³ 、Sudić Ivan ³ 、Pomorski Michal ⁴ 、牧野 高紘 ² 、安藤 裕士 ^{1,2} 、神林 佑哉 ^{1,2} 、小野田 忍 ² 、花泉 修 ¹ 、Jaksić Milko ³ 、大島 武 ²	1. 群馬大理工、2. 原子力機構、3. RBI、4. CEA- LIST
11:30	奨 19a-W810-7	ビスマス吸収体を用いたガンマ線検出用 TES 型マイクロカロリメータの開発	○首藤 祐輝 ¹ 、伊豫本 直子 ¹ 、吉峰 郁洋 ¹ 、前畑 京介 ¹ 、高野 彬 ¹ 、善本 翔太 ¹ 、満田 和久 ² 、永吉 賢一郎 ² 、林 佑 ² 、村松 はるか ²	1. 九大理工、2. 宇宙科学研究所
11:45	19a-W810-8	マイクロ波読出しによる TES 模擬信号の測定	○入松川 知也 ^{1,2} 、平山 文紀 ² 、佐々木 仁 ² 、佐藤 昭 ² 、山森 弘毅 ² 、永沢 秀一 ² 、福田 大治 ² 、日高 陸夫 ² 、佐藤 泰 ² 、神代 暁 ² 、大野 雅史 ¹ 、高橋 浩之 ¹	1. 東大工、2. 産総研
12:00	19a-W810-9	TES 型 X 線マイクロカロリメータの多色 X 線に対する性能評価	○村松 はるか ¹ 、林 佑 ¹ 、中島 祐貴 ¹ 、前久 景星 ¹ 、満田 和久 ¹ 、山崎 典子 ¹	1. 宇宙研
12:15	19a-W810-10	TES 型マイクロカロリメータによる ²⁴¹ Cm 線源の L X 線スペクトル計測	○前畑 京介 ¹ 、杉本 哲也 ¹ 、伊豫本 直子 ¹ 、石橋 健二 ¹ 、中村 圭佑 ² 、森下 祐樹 ² 、高崎 浩司 ² 、満田 和久 ³	1. 九大理工、2. JAEA、3. JAXA
3/19(Sat.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W810 会場				
13:45	奨 19p-W810-1	比例モード Si-APD を用いた HfO ₂ ナノ粒子添加プラスチックシンチレータ搭載 X 線シンチレーション検出器	○井上 圭介 ¹ 、岸本 俊二 ² 、春木 理恵 ² 、越水 正典 ³ 、平田 智之 ³ 、錦戸 文彦 ⁴	1. 総研大、2. KEK / 物構研、3. 東北大、4. 放医研
14:00	19p-W810-2	CsI の自己放射化による中性子線量当量の評価	○(M2) 栗原 凌佑 ¹ 、木下 博之 ¹ 、本田 宗一郎 ¹ 、納富 昭弘 ¹ 、若林 源一郎 ² 、福永 淳一 ³ 、梅津 芳幸 ³ 、中村 泰彦 ³ 、大賀 才路 ³ 、中村 和正 ⁴	1. 九大医保、2. 近大原研、3. 九大病院、4. 浜松医科大
14:15	19p-W810-3	MPPC 読み出しによる LiCAF ラバーシートの中性子検出性能評価	○松村 徹 ¹ 、新川 孝男 ¹ 、岡本 直也 ¹	1. 防衛大応物
14:30	19p-W810-4	分子イメージング応用に向けた高解像度型コンプトンカメラの開発	○(DC) 岸本 彩 ¹ 、片岡 淳 ¹ 、末岡 晃紀 ¹ 、小出 絢子 ¹ 、大須賀 慎二 ²	1. 早大理工、2. 浜松ホトニクス
14:45	奨 19p-W810-5	2 光子同時計測コンプトンイメージング手法の開発	○吉原 有里 ¹ 、中村 泰明 ¹ 、島添 健次 ¹ 、高橋 浩之 ¹	1. 東大工
15:00	19p-W810-6	波長弁別型 DOI 検出器およびカラー SiPM の開発	○島添 健次 ¹ 、高橋 浩之 ¹ 、渡辺 賢一 ² 、Wiest Florian ³	1. 東大工、2. 名古屋大、3. KETEK
15:15	19p-W810-7	MPPC を用いた高精度時間計測法の開発と ToF-PET への応用	○(M2) 辻川 貴之 ¹ 、片岡 淳 ¹ 、藤田 卓也 ¹ 、池田 博一 ²	1. 早大理工、2. JAXA
15:30	E 19p-W810-8	Development of pixel X/gamma detector based on SiPMs and ToT-ASIC	○(D) Alina Lipovec ¹ 、Tian Yang ¹ 、Kenji Shimazoe ¹ 、Hiroyuki Takahashi ¹	1. The Univ. of Tokyo
15:45	休憩 / Break			
16:00	奨 19p-W810-9	MPPC を用いた低被ばくかつ多色 X 線 CT の提案と実証	○森田 隼人 ¹ 、大島 翼 ¹ 、片岡 淳 ¹	1. 早大理工
16:15	19p-W810-10	Scintillating Glass GEM による高解像 X 線イメージングと CT	○藤原 健 ¹ 、三津谷 有貴 ² 、高橋 浩之 ² 、豊川 弘之 ¹	1. 産総研、2. 東大工
16:30	19p-W810-11	顕微マッピング測定を用いた損傷構造の分析	○上田 隆裕 ¹ 、楠本 多聞 ¹ 、小田 啓二 ¹ 、金崎 真聡 ¹ 、北村 尚 ² 、小平 聡 ² 、山内 知也 ¹	1. 神大院海事、2. 放医研
16:45	奨 19p-W810-12	PADC 検出器中電子線トラックの構造分析	○(D) 楠本 多聞 ¹ 、森 豊 ² 、金崎 真聡 ¹ 、小田 啓二 ¹ 、菅田 義英 ³ 、藤乘 幸子 ³ 、山内 知也 ¹	1. 神大院海事、2. 神戸大研究基盤セ、3. 阪大産研
17:00	19p-W810-13	高閾値検出器としてのポリエチレンテレフタレートの特異性研究 (2)	○上野 琢也 ¹ 、楠本 多聞 ¹ 、小田 啓二 ¹ 、金崎 正聡 ¹ 、北村 尚 ² 、小平 聡 ² 、山内 知也 ¹	1. 神大院海事、2. 放医研
17:15	19p-W810-14	PADC 検出器中イオントラックに生成されるヒドロキシル基の研究	○亀田 結貴 ¹ 、楠本 多聞 ¹ 、池永 龍之介 ¹ 、安田 修一郎 ¹ 、小田 啓二 ¹ 、北村 尚 ² 、小平 聡 ² 、山内 知也 ¹	1. 神大院海事、2. 放医研
17:30	19p-W810-15	2 インチ径 SrI ₂ (Eu) 単結晶の育成と特性評価	○庄子 育宏 ^{1,3} 、黒澤 俊介 ² 、横田 有為 ² 、早坂 将輝 ³ 、長門 和久 ³ 、鎌田 圭 ^{2,3} 、酒井 昭宏 ⁴ 、太田 朗生 ⁴ 、柳田 由香 ⁴ 、大橋 雄二 ¹ 、竹内 宣博 ⁴ 、吉川 彰 ^{1,2,3}	1. 東北大金研、2. 東北大 NICHe、3. ㈱ C&A、4. 千代田テクノ
17:45	19p-W810-16	2 インチ径 Eu 添加 SrI ₂ 単結晶のシンチレーション特性評価とその応用	○黒澤 俊介 ¹ 、庄子 育宏 ^{2,3} 、酒井 昭宏 ⁴ 、横田 有為 ⁴ 、早坂 将輝 ³ 、長門 和久 ³ 、太田 朗生 ⁴ 、柳田 由香 ⁴ 、千代田テクノ	1. 東北大 NICHe、2. 東北大金研、3. (株)C&A、4. (株)大橋 雄二 ² 、鎌田 圭 ^{1,3} 、竹内 宣博 ⁴ 、吉川 彰 ^{1,2,3}

2.3 放射線応用・発生装置・新技術 / Application, radiation generators, new technology

3/20(Sun.) 9:00 - 10:45 口頭講演 (Oral Presentation) W810 会場				
9:00	20a-W810-1	数 100keV 小型イオンマイクロビーム装置で形成されたビーム径の縮小化 (II)	○石井 保行 ¹ 、大久保 猛 ¹	1. 原子力機構高崎
9:15	20a-W810-2	原子炉ベース低速度陽電子ビームラインの輝度増強部の設計・テスト	○(M2) 葛谷 佳広 ¹ 、大島 永康 ² 、徐 虬 ¹ 、佐藤 紘一 ³ 、木野村 淳 ¹ 、藪内 敦 ¹	1. 京大原子炉、2. 産総研、3. 鹿児島大
9:30	20a-W810-3	エネルギー分解コンピュータ断層撮影法による尿路結石の組成識別	○(M2) 井上 福太郎 ¹ 、神野 郁夫 ¹	1. 京大工学研究科
9:45	20a-W810-4	高精度陽子線治療に向けた陽電子放出核種生成断面積の推定	○増田 孝充 ¹ 、片岡 淳 ¹ 、岸本 彩 ¹ 、多屋 隆紀 ¹ 、高部 美帆 ¹ 、嶋達志 ² 、山本 誠一 ³ 、稲庭 拓 ⁴	1. 早大理工、2. 阪大 RCNP、3. 名大医、4. 放医研

10:00	20a-W810-5	多種帯状シンチレータ板を用いたエネルギー分解 X 線コンピュータ断層撮影法	○濱口 拓 ¹ 、神野 都夫 ¹ 、堀田 一海 ² 、中村 正明 ³ 、安達 隆二 ³	1. 京大院工, 2.MCHC-RDSC, 3. 三菱化学
10:15	奨 20a-W810-6	transXend 検出器固有の応答関数を用いた X 線エネルギー分布取得法の検討	○(M1)丸山 能央 ¹ 、濱口 拓 ¹ 、神野 都夫 ¹	1. 京大院工
10:30	奨 20a-W810-7	エネルギー分解 CT における散乱 X 線の影響評価	○(D) 蔡 典修 ¹ 、神野 都夫 ¹	1. 京大院工
3/22(Tue.) 9:00 - 12:15	口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場			
9:00	22a-W833-1	有人宇宙船内における最適な遮蔽材料と遮蔽厚の検討 (II)	○島田 健 ¹ 、永松 愛子 ² 、佐藤 達彦 ³ 、明石 小百合 ¹ 、西 啓輔 ¹ 、武田 和雄 ⁴	1.AES, 2.JAXA, 3.JAEA, 4.RIST
9:15	22a-W833-2	月着陸探査に向けた能動型蛍光 X 線分光計	○草野 広樹 ¹ 、長谷部 信行 ¹ 、長岡 央 ¹ 、柴村 英道 ¹ 、天野 嘉春 ¹ 、太田 亨 ² 、Fagan Timothy J. ² 、久野 治義 ¹	1. 早大理工研, 2. 早大教育
9:30	22a-W833-3	月着陸探査に向けた焦電結晶 X 線源の開発	○(D) 内藤 雅之 ¹ 、溝根 美穂 ¹ 、草野 広樹 ¹ 、柴村 英道 ¹ 、長岡 央 ¹ 、久野 治義 ¹ 、長谷部 信行 ¹	1. 早大
9:45	22a-W833-4	アクティブ X 線検出器の動作モニタリングのための探査ローバー用多機能遠隔広視野視覚センサシステムの開発	○西山 裕之 ¹ 、清水 創太 ² 、内藤 雅之 ¹ 、草野 広樹 ¹ 、長岡 央 ¹ 、長谷部 信行 ¹	1. 早稲田大学, 2. 慶應義塾大学
10:00	22a-W833-5	火星衛星探査に向けたガンマ線・中性子分光計	○草野 広樹 ¹ 、長谷部 信行 ¹ 、長岡 央 ¹ 、柴村 英道 ¹ 、天野 嘉春 ¹ 、太田 亨 ² 、Fagan Timothy J. ² 、久野 治義 ¹	1. 早大理工研, 2. 早大教育
10:15	22a-W833-6	火星衛星から発生するガンマ線数値シミュレーション	○(D) 内藤 雅之 ¹ 、吉田 康平 ¹ 、石井 隼也 ¹ 、青木 大輔 ¹ 、長岡 央 ¹ 、草野 広樹 ¹ 、長谷部 信行 ¹	1. 早大理工
10:30	22a-W833-7	火星衛星表面から放出される中性子強度の水素濃度依存性	○(B) 石井 隼也 ¹ 、長谷部 信行 ^{1,2} 、草野 広樹 ² 、長岡 央 ¹ 、内藤 雅之 ¹ 、吉田 康平 ¹ 、青木 大輔 ¹	1. 早大理工, 2. 早大理工
10:45	休憩 / Break			
11:00	22a-W833-8	頭部用 RF コイル一体型 PET 装置の 2 次試作機を用いた性能評価	○錦戸 文彦 ¹ 、菅 幹生 ² 、藤原 理伯 ² 、清水 啓司 ³ 、小島 隆行 ¹ 、田島 英朗 ¹ 、吉田 英治 ¹ 、山谷 泰賀 ¹	1. 放医研, 2. 千葉大, 3. 浜松ホトニクス
11:15	22a-W833-9	重粒子線照射野イメージングのための single-ring OpenPET 実証機開発	○山谷 泰賀 ¹ 、吉田 英治 ¹ 、田島 英朗 ¹ 、錦戸 文彦 ¹ 、Mohammadi Akram ¹ 、脇坂 秀克 ¹ 、稲庭 拓 ¹ 、北川 敦志 ¹	1. 放医研
11:30	22a-W833-10	低エネルギー光子測定による治療用炭素ビーム軌道上の空洞検出のシミュレーションによる評価	○山口 充孝 ¹ 、長尾 悠人 ¹ 、菅井 裕之 ² 、酒井 真理 ¹ 、河地 有木 ¹ 、佐藤 隆博 ¹ 、神谷 富裕 ¹ 、藤巻 秀 ¹ 、荒川 和夫 ^{1,2} 、鳴海 一雅 ¹	1. 原子力機構, 2. 群馬大
11:45	22a-W833-11	蛍光イオントラップを用いた重イオン計測と放射線生物学への応用	○小平 聡 ¹ 、小西 輝昭 ¹ 、小林 亜利紗 ¹ 、蔵野 美恵 ¹ 、子 ¹ 、Axselrod Mark ²	1. 放医研, 2. Landauer Inc.
12:00	22a-W833-12	18 MeV 単色中性子標準場の開発	○松本 哲郎 ¹ 、増田 明彦 ¹ 、原野 英樹 ¹	1. 産総研分析計測
3/22(Tue.) 13:15 - 15:00	口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場			
13:15	22p-W833-1	LiTaO ₃ 単結晶による発生 X 線の平均温度変化率依存性	○花元 克巳 ¹ 、片岡 隆浩 ¹ 、山岡 聖典 ¹	1. 岡山大院保
13:30	22p-W833-2	テラプルトップ加速器を用いた後方散乱 X 線イメージング	○豊川 弘之 ¹ 、藤原 健 ¹ 、萬代 新一 ² 、伊佐 英範 ² 、瓜谷 章 ³ 、渡辺 賢一 ³ 、山崎 淳 ³ 、遠山 貴之 ³ 、大橋 和也 ³ 、井上 彬 ⁴ 、夏井 拓也 ⁴ 、吉田 光宏 ⁴	1. 産総研, 2. B E A M X, 3. 名大工, 4. KEK- 総研大
13:45	22p-W833-3	中性子捕捉療法における患者の放射化のモンテカルロシミュレーションによる検討	○松本 政雄 ^{1,2} 、高階 正彰 ^{1,2} 、小宮山 里帆 ²	1. 阪大院医, 2. 阪大医
14:00	22p-W833-4	【注目講演】超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発 (1) 全体概要	○井口 哲夫 ¹ 、大原 利成 ² 、西澤 典彦 ¹ 、富田 英生 ¹ 、山中 真仁 ¹ 、SONNENSCHNEIN Volker ¹ 、金 磊 ¹ 、佐藤 淳史 ² 、大森 茜 ² 、井手野 晃 ²	1. 名大院工, 2. 積水メディカル
14:15	22p-W833-5	超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発 (2) 新規医薬品開発における微量放射性炭素同位体分析および分析サンプル前処理・導入系の開発	○大原 利成 ¹ 、佐藤 淳史 ¹ 、大森 茜 ¹ 、井手野 晃 ¹ 、西澤 典彦 ² 、金 磊 ² 、山中 真仁 ² 、Sonnenschein Volker ² 、富田 英生 ² 、井口 哲夫 ²	1. 積水メディカル, 2. 名古屋大
14:30	22p-W833-6	超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発 (3) 中赤外域光周波数コム光源の開発	○西澤 典彦 ¹ 、金 磊 ¹ 、山中 真仁 ¹ 、Sonnenschein Volker ¹ 、富田 英生 ¹ 、佐藤 淳史 ² 、大森 茜 ² 、井手野 晃 ² 、大原 利成 ² 、井口 哲夫 ¹	1. 名大院工, 2. 積水メディカル (株)
14:45	22p-W833-7	超高感度迅速放射性炭素同位体分析装置の開発 (4) 中赤外 ¹³ C- キャビティリングダウン分光システムの開発	○富田 英生 ¹ 、SONNENSCHNEIN Volker ¹ 、寺林 稜 ¹ 、平 ¹ 、緩詰 聡士 ¹ 、弘津 高夫 ¹ 、佐藤 淳史 ² 、金 磊 ¹ 、山中 真仁 ¹ 、西澤 典彦 ¹ 、大森 茜 ² 、井手野 晃 ² 、大原 利成 ² 、井口 哲夫 ¹	1. 名大院工, 2. 積水メディカル (株)

3 光・フォトリクス / Optics and Photonics

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

3.1 光学基礎・光学新領域 / Basic optics and frontier of optics

3/19(Sat.) 13:15 - 17:15	口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場			
13:15	19p-H116-1	高次方位偏光ビームを用いた差引イメージングによる高空間分解能レーザー顕微鏡	○松永 大地 ¹ 、小澤 祐市 ¹ 、佐藤 俊一 ¹	1. 東北大多元研
13:30	奨 E 19p-H116-2	Generation of third-harmonic vortex beams by near-infrared femtosecond laser pulse filamentation in air	○(P)Yuchieh Lin ¹ , Yasuo Nabekawa ¹ , Katsumi Midorikawa ¹	1. Attosecond Science Research Team, RIKEN Center for Advanced Photonics
13:45	19p-H116-3	空間変調光注入同期による面発光レーザーのトポロジカルチャージ制御	○西坂 拓馬 ¹ 、○重松 恭平 ¹ 、山根 啓作 ^{1,2} 、森田 隆二 ^{1,2} 、淡路 祥成 ³ 、戸田 泰則 ^{1,2}	1. 北大院工, 2. JST CREST, 3. NICT
14:00	19p-H116-4	コロナ放電による光渦誘起表面レリーフのガラス転写	○増田 圭吾 ¹ 、Guzhaliyi Juman ¹ 、吉田 一貴 ¹ 、中野 翔吾 ¹ 、酒井 大輔 ² 、原田 健治 ² 、宮本 克彦 ¹ 、尾松 孝茂 ¹	1. 千葉大工, 2. 北見工大
14:15	19p-H116-5	光渦によって形成される単結晶性シリコンニードルのパルス幅依存性	○藤原 穂波 ¹	1. 千葉大院融合
14:30	19p-H116-6	光渦によるインク液滴の飛翔制御	○白石 福太郎 ¹ 、中村 優里 ¹ 、高橋 冬都 ¹ 、藤原 穂波 ¹ 、泉澤 魁 ¹ 、宮本 克彦 ¹ 、鈴木 一己 ² 、吉野 正樹 ¹ 、尾松 孝茂 ¹	1. 千葉大学大学院, 2. リコー CTP 事業部, 3. リコー 画像エンジン開発
14:45	休憩 / Break			
15:00	19p-H116-7	軸対称偏光子を用いたトラップ粒子の回転制御	○小原 威吹 ¹ 、坂本 盛嗣 ^{1,2} 、山根 啓作 ¹ 、森田 隆二 ¹ 、岡 和彦 ¹	1. 北大院工, 2. 長岡技科大
15:15	19p-H116-8	熱プラズモニック・マランゴニ対流を用いた微小粒子取束	○名村 今日子 ¹ 、Pilgrim Gregory A. ^{1,2} 、中嶋 薫 ¹ 、鈴木 基史 ¹	1. 京大院・工, 2. 学振外国人特別研究員
15:30	奨 E 19p-H116-9	Effect of Surface Wettability on Marangoni Flows Generated by Localized Plasmon Resonance	○(PC)Gregory A Pilgrim ^{1,2} , Yudi Tu ¹ , Toru Utsunomiya ¹ , Takashi Ichii ¹ , Hiroyuki Sugimura ¹	1. Kyoto Univ., 2. JSPS International Research Fellow

15:45	19p-H116-10	白色光照射によるグラフェン粉末混入 ZnO ランダム構造における発振モード変化	○煮雪 亮 ¹ 、藤原 英樹 ¹ 、笹木 敬司 ¹	1. 北大電子研
16:00	19p-H116-11	六角形状 GaN マイクロディスク内に発現するウィスパーリングギャラリーモードを用いたバイオセンサの検討	○光野 徹也 ¹ 、酒井 優 ² 、岸野 克巳 ³ 、原 和彦 ¹	1. 静岡大工, 2. 山梨大医工, 3. 上智大理工
16:15	奨 19p-H116-12	気泡含有ガラス微小球による縮退の解けた WGM の発現	○(D) 熊谷 博 ¹ 、Giuseppe Palma ² 、Francesco Prudenzano ² 、岸 哲生 ¹ 、矢野 哲司 ¹	1. 東工大院, 2. パーリ工科大学
16:30		休憩 / Break		
16:45	奨 19p-H116-13	電子線照射によるウルトラファインバブルの高分解能イメージング	○(M1) 原 直波 ¹ 、福田 真大 ¹ 、居波 涉 ^{1,2} 、川田 善正 ^{1,2} 、小林 秀彰 ³ 、前田 重雄 ³ 、藤田 俊弘 ³	1. 静岡大工, 2. 静岡大電研, 3. IDEC 株式会社
17:00	奨 19p-H116-14	Mathematica による異方性・分散性 FDTD 法プログラミング	○(DC) 貝原 輝則 ¹ 、有馬 卓司 ¹ 、清水 大雅 ¹	1. 東京農工大工
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場		
	20p-P1-1	ブッシュ型 NLO 色素の無電界ポーリング現象における分子サイズ依存性	○北川 顕磨 ¹ 、鳴海 哲夫 ¹ 、間瀬 暢之 ¹ 、川田 善正 ¹ 、杉田 篤史 ¹	1. 静大院工
	20p-P1-2	金ナノロッド / 非線形光学ポリマー複合型微小非線形光学素子の励起光照射条件に対する熱耐性	○松井 達也 ¹ 、小野 篤史 ¹ 、川田 善正 ¹ 、杉田 篤史 ¹	1. 静大院工
	20p-P1-3	一次元金ナノロッド配列系の散乱分光	○二橋 俊介 ¹ 、小野 篤史 ¹ 、川田 善正 ¹ 、杉田 篤史 ¹	1. 静大院工
	20p-P1-4	金ナノ三角柱における局在表面プラズモン共鳴条件下での第二高調波発生現象	○(B) 余語 宏文 ¹ 、二橋 俊介 ² 、小野 篤史 ² 、川田 善正 ² 、杉田 篤史 ²	1. 静大工, 2. 静大院工
	20p-P1-5	光発熱効果により生成されたプラズモニック・バブルの安定性評価	○上田 一輝 ^{1,2} 、西村 勇姿 ² 、山本 陽二郎 ³ 、床波 志保 ⁴ 、飯田 琢也 ^{1,2}	1. 阪府大生命環境, 2. 阪府大院理, 3. グリーンケム, 4. 阪府大院工
	20p-P1-6	量子化ラゲールガウスビームの偏光干渉による位相分布の観察	○小川 賀代 ¹ 、井澤 瑠美 ¹ 、齊藤 彩 ¹ 、田辺 綾乃 ² 、栗原 誠 ² 、橋本 信幸 ²	1. 日本女子大理工, 2. シチズンホールディングス(株)開発部
	20p-P1-7	収差存在下における高次径偏光ビームの集光特性の検討	○小澤 祐市 ^{1,2} 、佐藤 俊一 ¹	1. 東北大多元研, 2. JST さきがけ
3.2 材料・機器光学 / Equipment optics and materials				
3/21(Mon.) 9:00 - 12:30		口頭講演 (Oral Presentation) H135 会場		
9:00	21a-H135-1	カチオン開環重合モノマーを用いた光重合性ナノ微粒子・ポリマーコンポジットの体積ホログラフィック記録特性	○小野 孝典 ¹ 、富田 康生 ¹	1. 電気通信大学大学院先進理工学専攻
9:15	21a-H135-2	フッ素含有ハーパーブランポリマーを用いたナノ微粒子・ポリマーコンポジットの体積ホログラフィック記録特性	○武内 慎介 ¹ 、富田 康生 ¹ 、西村 直也 ² 、大土井 啓祐 ²	1. 電通大 先進理工, 2. 日産化学
9:30	21a-H135-3	高 T _g メタクリレート系 EO ポリマーの高温安定性	○大友 明 ¹ 、青木 勲 ¹ 、山田 千由美 ¹ 、山田 俊樹 ¹	1. 情通機構
9:45	21a-H135-4	無添加 AlN 結晶におけるフォトリフラクティブホログラムの保持時間	○(M1) 久保 雄紀 ¹ 、藤村 隆史 ^{1,2}	1. 宇大院工, 2. 宇大 CORE
10:00	21a-H135-5	(Rb,Cs) ₂ SiF ₆ Mn ²⁺ 蛍光体の合成と発光特性	○町田 憲一 ¹ 、西本 聖久 ¹ 、半澤 弘昌 ¹	1. 大阪大院工
10:15	21a-H135-6	プラズモニック光集積回路に向けた金属薄膜上への二次非線形配向多結晶 ZnO 薄膜の作製と評価	○藤原 裕大 ¹ 、北尾 明大 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大院工
10:30	21a-H135-7	ゴニオ・スタージェム型散乱計の開発 VI	○川手 悦男 ¹	1. (有)トラス
10:45		休憩 / Break		
11:00	21a-H135-8	アゾポリマー薄膜における光誘起表面レリーフ形成の偏光依存性	○茨田 大輔 ^{1,2,3} 、福田 隆史 ³	1. 宇大院工, 2. 宇大 CORE, 3. 産総研電子光技術
11:15	21a-H135-9	一軸異方性を有する光応答性液晶媒体への高次軸対称偏光による 3 次元ベクトル記録	○坂本 盛嗣 ¹ 、Tran Minh Tien ¹ 、野田 浩平 ¹ 、佐々木 友之 ¹ 、川月 喜弘 ² 、小野 浩司 ¹	1. 長岡技科大, 2. 兵庫県立大
11:30	21a-H135-10	液晶レンズの応答特性 (III)	千田 誠 ¹ 、田村 賢介 ¹ 、河村 希典 ¹ 、佐藤 進 ²	1. 秋大院工, 2. 液晶レンズ研究所
11:45	奨 21a-H135-11	光配向パターンニングしたコレステリック液晶を用いた反射型偏光子	○(DC) 小橋 淳二 ¹ 、吉田 浩之 ^{1,2} 、尾崎 雅則 ¹	1. 阪大院工, 2. JSP さきがけ
12:00	奨 21a-H135-12	パターン配向制御によるコレステリック液晶からの反射光拡散	○毛利 文律 ¹ 、小橋 淳二 ¹ 、吉田 浩之 ^{1,2} 、尾崎 雅則 ¹	1. 阪大院工, 2. JST さきがけ
12:15	奨 21a-H135-13	高分子ネットワーク色素ドープ液晶フィルムの光応答挙動評価	○片山 絵梨香 ¹ 、王 静 ¹ 、穴戸 厚 ^{1,2}	1. 東工大資源研, 2. JST さきがけ
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P2 会場		
	22a-P2-1	積層液晶マイクロレンズアレイの光拡散の増大効果	○梁瀬 智 ¹ 、内田 勝 ¹ 、王 濱 ¹	1. 秋田産技センター
	22a-P2-2	偏光無依存型液晶レンズを用いた多焦点画像からの特徴抽出	田村 賢介 ¹ 、河村 希典 ¹ 、佐藤 進 ²	1. 秋大院工, 2. 液晶レンズ研究所
	22a-P2-3	液晶 / 色素セルの端面から放射される蛍光のスペクトルの変化	○小澤 慎太郎 ¹ 、板屋 竣介 ¹ 、太田 正倫 ¹ 、Nada Dianah Binti M Azmi ¹ 、藤枝 一郎 ¹	1. 立命館大理工
	22a-P2-4	TN 配向の液晶 / 色素セルの蛍光の放射パターン	○太田 正倫 ¹ 、板屋 竣介 ¹ 、Nada Dianah Binti M Azmi ¹ 、小澤 慎太郎 ¹ 、藤枝 一郎 ¹	1. 立命館大理工
	22a-P2-5	CaMoO ₄ :Yb ³⁺ /Er ³⁺ アップコンバージョン蛍光体の特性評価	○大山 溪人 ¹ 、野中 俊宏 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
	22a-P2-6	酸化ツリウムを用いたアップコンバージョン蛍光体の青色発光特性評価	○小漆間 拓人 ¹ 、大山 溪人 ¹ 、菖蒲 勇 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
	22a-P2-7	LaOF:Yb ³⁺ /Er ³⁺ アップコンバージョン蛍光体の特性評価	○大山 溪人 ¹ 、野中 俊宏 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
	奨 22a-P2-8	水熱合成による SnO ₂ Nanowhisker 薄膜	○(M1) 竹中 一生 ¹ 、吉川 亮平 ² 、白鳥 世明 ^{1,2}	1. 慶大院理工, 2. 慶大理工
	22a-P2-9	シリコンのアルカリエッチングを利用した赤外用ワイヤグリッド偏光子の作製	○山田 逸成 ¹ 、吉田 黎 ¹	1. 滋賀県立大工
	22a-P2-10	フォトメカニカル機能をもつキラルなサリチリデンフェニルエチルアミン結晶の光学的性質	○高鍋 彰文 ¹ 、田中 真人 ² 、上本 紘平 ³ 、植草 秀裕 ³ 、森 直 ⁴ 、小島 秀子 ⁵ 、朝日 透 ^{1,5}	1. 早大院先進理工, 2. 産総研, 3. 東工大理工, 4. 阪大院工, 5. 早大ナノ・ライフ
	22a-P2-11	半導体レーザと集積化した導波路型三原色合波器の検討	中尾 慧 ¹ 、辻野 謙太 ¹ 、横川 修一 ¹ 、田中 彩恵 ¹ 、林口 翔子 ¹ 、○勝山 俊夫 ^{1,2}	1. 福井大院工, 2. 福井大産学官連携本部
	22a-P2-12	塗布法による ZnS:Mn 無機 EL 素子の作製	○久保田 崇文 ¹ 、相澤 柊斗 ¹ 、三浦 登 ¹	1. 明治大理工学研究所電気工学専攻
3.3 情報フォトニクス・画像工学 / Information photonics and image engineering				
3/21(Mon.) 11:00 - 12:30		口頭講演 (Oral Presentation) S224 会場		
11:00	21a-S224-1	半導体レーザと位相型プログラムを用いた植物栽培の提案	○井上 達晶 ¹ 、松本 祐二 ¹ 、高木 康博 ¹	1. 農大院工
11:15	21a-S224-2	2 層矩形ミラーアレイ (WARM) による遠赤外線を用いた局所暖房	○(B) 岡本 智行 ^{1,2} 、小貫 健太 ^{1,2} 、小野瀬 翔 ^{1,2} 、糸井川 高穂 ¹ 、山本 裕紹 ^{1,2}	1. 宇大工, 2. 宇大オプト
11:30	21a-S224-3	再帰反射を用いた空中結像 (AIRR) による全周型空中ディスプレイ	○(B) 小野瀬 翔 ¹ 、山本 裕紹 ¹	1. 宇都宮大学

11:45	21a-S224-4	サブ回折限界パターンを用いた画像暗号化技術	○(M2)相野 匡彦 ¹ 、小倉 裕介 ¹ 、谷田 純 ¹	1. 阪大院情
12:00	21a-S224-5	高速LEDディスプレイ上での時空間スクランプリングによる暗号化	○(M1)高橋 昌史 ¹ 、山本 裕紹 ^{1,2}	1. 宇大院工, 2.JST, CREST
12:15	21a-S224-6	セキュリティ素子応用に向けたパターンニングされたネマチック液晶のシュリーレン組織パターンの評価	○中山 敬三 ¹ 、大坪 順次 ²	1. 近畿大理工, 2. 静岡大院工
3/21(Mon.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) S224 会場				
13:45	奨 21p-S224-1	近似計算を導入した光線形識別器と応用	○池田 佳奈美 ¹ 、谷口 泰史 ¹ 、渡邊 恵理子 ¹	1. 電通大
14:00	奨 21p-S224-2	インクジェットプリンターを用いた高解像度ボリュームディスプレイのフルカラー化	○鈴木 智孝 ¹ 、平山 竜士 ¹ 、成瀬 誠 ² 、中山 弘敬 ¹ 、角江 崇 ¹ 、伊藤 智義 ¹ 、下馬場 朋禄 ¹ 、白木 厚子 ¹	1. 千葉大学, 2. 情報通信研究機構
14:15	21p-S224-3	フォトクロミック材料を用いたボリュームディスプレイにおける濃淡表現	○(B)川島 史也 ¹ 、平山 竜士 ¹ 、成瀬 誠 ² 、白木 厚子 ¹ 、中山 弘敬 ¹ 、角江 崇 ¹ 、下馬場 朋禄 ¹ 、伊藤 智義 ¹	1. 千葉大工, 2. 情報通信研究機構
14:30	奨 21p-S224-4	多色ボリュームディスプレイのためのフォトクロミック材料混合体	○(DC)平山 竜士 ¹ 、成瀬 誠 ² 、白木 厚子 ¹ 、中山 弘敬 ¹ 、角江 崇 ¹ 、下馬場 朋禄 ¹ 、伊藤 智義 ¹	1. 千葉大, 2. 情通機構
14:45	奨 21p-S224-5	パブルボリュームディスプレイ	○熊谷 幸汰 ¹ 、早崎 芳夫 ¹	1. 宇都宮大学オブティクス教育研究センター
15:00		休憩 / Break		
15:30	招 E 21p-S224-6	[Invited lecture of overseas researcher] (45min.) Multiple scattering and imaging in turbid media	○Jacopo Bertolotti ¹	1.Univ. of Exeter
16:15	奨 21p-S224-7	単一のハイパースペクトル画像を用いた反射成分と多重蛍光成分の分離およびアンミキシング	○大原 直之 ¹ 、Zheng Yinqiang ² 、佐藤 いまり ^{1,2} 、山口 雅浩 ¹	1. 東工大, 2. 国立情報学研
16:30	21p-S224-8	量子化誤差低減アルゴリズムに基づくシングルショットタイコグラフィ	○福井 美音 ¹ 、小倉 裕介 ¹ 、谷田 純 ¹	1. 阪大院情
16:45	奨 21p-S224-9	ランダムマスクによるシングルショット広視野回折イメージング	○江上 力貴 ¹ 、堀崎 遼一 ¹ 、谷田 純 ¹	1. 阪大院情
17:00	21p-S224-10	アダマール変換イメージングにおける撮像系の開発	○仁田 功一 ¹ 、林 真二 ¹ 、的場 修 ¹	1. 神戸大院システム情報
17:15		休憩 / Break		
17:30	奨 21p-S224-11	2チャンネル回転シリング干渉計を用いた位相ソフトインコヒーレントフーリエホログラフィ	○渡辺 果歩 ¹ 、野村 孝徳 ¹	1. 和歌山大院システム工
17:45	奨 21p-S224-12	CGHのための観察位置変化を考慮したスペックルノイズ評価法	○芳賀 祐太 ¹ 、中村 友哉 ¹ 、山口 雅浩 ¹	1. 東工大総理工
18:00	奨 21p-S224-13	ドーパント分布の光制御技術を活用したZnO空間光変調器による屈折率変調に関する検証	○中島 俊亮 ¹ 、堅直也 ¹ 、川添 忠 ² 、野村 航 ³ 、大津 元一 ^{2,4}	1. 九大シス情, 2.NPEO, 3. 九大LP分シ, 4. 東工大
18:15	21p-S224-14	SNR均等化による多値光メモリのビット数評価と2層化への検討	森本 遥陽 ¹ 、仁田 功一 ¹ 、的場 修 ¹	1. 神戸大院シス情
18:30	21p-S224-15	単一光子意思決定の理論：幾何学及び圏論による構造分析	○成瀬 誠 ¹ 、堀 裕和 ² 、青野 真士 ^{3,4} 、Huant Serge ⁵ 、金 成主 ⁶	1. 情通機構, 2. 山梨大, 3. 東工大, 4.JST さきがけ, 5.Inst. NEEL, CNRS and Univ. Joseph Fourier, 6. 物材機構
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場				
22a-P3-1		可視光像と赤外光像の融合	○石黒 将平 ¹ 、早崎 芳夫 ¹	1. 宇都宮大オプト
22a-P3-2		NEMSを用いたブラズモン変調器の開発	○加地 崇洋 ¹ 、岡本 敏弘 ¹ 、原口 雅宣 ¹	1. 徳島大院
22a-P3-3		液晶ホログラムメモリへの角度多重記録におけるレーザ露光条件の改善	○前田 雄大 ¹ 、荻原 昭文 ¹ 、渡邊 実 ²	1. 神戸高専, 2. 静岡大工
22a-P3-4		コレステリック液晶へのモノマー添加による選択反射波長の温度依存性	○荻原 昭文 ¹ 、垣内田 洋 ²	1. 神戸高専, 2. 産総研
22a-P3-5		スペックル法を用いたカラーデジタルホログラフィック顕微鏡における分光透過率の推定	タン チンチェン ¹ 、得能 友太 ¹ 、○船水 英希 ¹ 、相津 佳永 ¹	1. 室工大院
22a-P3-6		デジタルホログラフィック顕微鏡による赤血球沈降の3次元観測	園田 光太郎 ¹ 、○船水 英希 ¹ 、相津 佳永 ¹	1. 室工大院
22a-P3-7		デジタルフレネルホログラフィにおける高分解像再生法とその適用限界	○原田 康浩 ¹ 、長津 和也 ¹ 、小湊 佳尚 ¹	1. 北見工大
22a-P3-8		ホログラフィック蛍光マッピングにおける空間分割照合	○阿部 怜佑 ¹ 、岩永 将司 ² 、宮川 一志 ³ 、早崎 芳夫 ¹	1. 宇大オプト, 2. 宇大農, 3. 宇大バイオ
22a-P3-9		円筒形ホログラムと多角形ホログラムの高速計算法の性能比較	○山東 悠介 ¹ 、茨田 大輔 ^{1,2} 、谷田 豊彦 ¹	1. 宇大 CORE, 2. 宇大院工, 3. 大阪府産技研
22a-P3-10		LN結晶を用いたホログラム記録の入射偏光依存性	○陳 軍 ¹ 、珍田 由 ¹ 、小野 敦也 ¹ 、石井 行弘 ^{2,3}	1. 東京工芸大工, 2. 東京理科大応物, 3. 理研
22a-P3-11		1次元回折格子を埋め込んだ回転ディスクからの焦点誤差信号の生成実験	○(BC)高木 燦 ¹ 、澤田 拓哉 ^{1,2} 、藤田 輝雄 ¹	1. 福井工大, 2. 漆遊館
22a-P3-12		プレグレッシブ位相共役技術による空間モードの選択的抽出	○佐久間 大樹 ¹ 、岡本 淳 ¹ 、小田 友和 ¹ 、後藤 優太 ¹ 、野澤 仁 ¹ 、富田 章久 ¹	1. 北大院情報科学
22a-P3-13		直交ミラーアレイとミラーによる空中像の二重表示	○(DC)久次米 亮介 ¹ 、水科 晴樹 ¹ 、水科 晴樹 ¹ 、山本 裕紹 ^{1,2}	1. 徳島大学, 2. 宇都宮大学
22a-P3-14		2枚の非対称位相板を用いるWFC光学系の深度拡大特性	○(B)水町 祐貴 ¹ 、小松 進一 ¹	1. 早大先進理工
22a-P3-15		3次元位相板とタンジェント位相板の弱位相板領域における深度拡大特性の比較	○町田 恭晃 ¹ 、小松 進一 ¹	1. 早大先進理工
22a-P3-16		コンプレキシブフレネルホログラフィのGPUによる高速化	○(D)遠藤 優 ¹ 、下馬場 朋禄 ¹ 、角江 崇 ¹ 、伊藤 智 ¹	1. 千葉大
3.4 生体・医用光学 / Biomedical optics				
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2 会場				
20p-P2-1		簡易型複屈折光学顕微鏡による試料の観察	○大久保 進也 ¹	1. 沼津高専
20p-P2-2		光コヒーレントモグラフィによる皮膚表面形状の計測および光線追跡計算への適用	水沼 孝太 ¹ 、永森 祐太郎 ¹ 、船水 英希 ¹ 、西館 泉 ²	1. 室工大院, 2. 東京農工大
20p-P2-3		モンテカルロ法を用いた9層構造皮膚モデルにおける光伝搬の深さと広がりに関する解析	湯浅 友典 ¹ 、○相津 佳永 ¹	1. 室工大院, 2. 釧路高専
20p-P2-4		2波長ファイバ照射によるスペックル血流・血液濃度変化の同時計測に関する検討	湯浅 友典 ¹ 、○相津 佳永 ¹	1. 室工大院, 2. 旭川高専
20p-P2-5		RGB画像からのWiener推定による皮膚分光反射率とハイパースペクトルイメージングデータとの比較	○相津 佳永 ¹	1. 室工大院, 2. 東京農工大
20p-P2-6		皮膚ファントムにおける皮膚と皮丘の再現に関する検討	佐藤 心海 ¹ 、○船水 英希 ¹ 、西館 泉 ² 、湯浅 友典 ¹ 、相津 佳永 ¹	1. 室工大院, 2. 釧路高専, 3. 東京農工大
20p-P2-7		生きた細胞に対する短波長可視レーザー光の毒性評価	永森 祐太郎 ¹ 、前田 貴章 ² 、○湯浅 友典 ¹ 、船水 英希 ¹ 、西館 泉 ² 、相津 佳永 ¹	1. 室工大院, 2. 釧路高専, 3. 東京農工大
20p-P2-8		8mmショートマルチモードファイバーによる生体試料の反射画像測定	○難波 慎太郎 ¹ 、川原 翔平 ¹ 、松山 哲也 ¹ 、和田 健司 ¹ 、堀中 博道 ¹ 、川喜多 愛 ² 、村田 香織 ² 、杉本 憲治 ²	1. 阪府大院工, 2. 阪府大院生
			○庄司 光 ¹ 、西館 泉 ² 、佐藤 学 ¹	1. 山工大, 2. 東京農工大

20p-P2-9	超解像蛍光顕微鏡 (SOFI) による大腸菌細胞骨格の観察	佐藤 瑞樹 ¹ 、○堀内 友貴 ¹ 、堀田 純一 ¹	1. 山形大理工
20p-P2-10	Born 近似に基づく乳癌診断マイクロ波 CT の再構成法	○(B) 細見 直正 ¹ 、寺西 大 ² 、浅川 誠 ¹ 、山口 聡一 ¹	1. 関西大シス理、2. 広島工大 朗 ¹
20p-P2-11	色相イメージングを用いた医療用マイクロ波 CT	○(B) 藤田 梯仁 ¹ 、細見 直正 ¹ 、坪井 亮太 ¹ 、福西 達也 ¹ 、寺西 大 ² 、浅川 誠 ¹ 、山口 聡一 ¹	1. 関西大、2. 広島工大
奨 20p-P2-12	超音響顕微鏡高感度化のための円錐台リング型トランスデューサの開発	○山本 壮里 ¹ 、宇野 友貴 ¹ 、高橋 英嗣 ¹ 、山岡 禎久 ¹	1. 佐賀大理工
20p-P2-13	市販の光測定機器による光合成測定に関する検討	○永瀬 裕基 ¹ 、遠見 隆秀 ¹ 、木部 慎太郎 ¹ 、本田 天 ¹	1. 九工大情真 ¹ 、井上 耕太郎 ¹ 、李 旻哲 ¹ 、小西 直樹 ¹
20p-P2-14	多光子三次元構造化照明顕微鏡	○戸田 圭亮 ^{1,2} 、磯部 圭佑 ^{1,3} 、河野 弘幸 ¹ 、宮脇 敦史 ¹ 、緑川 克美 ^{1,2}	1. 理研、2. 埼玉大理工、3. JST さきがけ
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S422 会場			
13:45	21p-S422-1 直線偏光レーザー透過特性と生体組織の配向特性との関係	○橋新 裕一 ¹ 、佐野 秀 ¹	1. 近畿大理工
14:00	21p-S422-2 半無限平面体からの偏光の後方散乱: モンテカルロ・シミュレーション	○大槻 莊一 ¹	1. 産総研健康工学
14:15	E 21p-S422-3 Simulation of the change in power and chromatic aberration of the aging human eye	○(D) Mark Coughlan ¹ , Toshifumi Mihashi ² , Alexander Goncharov ¹	1. National Univ. of Ireland, Galway, 2. Tokyo Inst. of Technology
14:30	21p-S422-4 超音波によるルミノール化学発光の増強効果を利用した光散乱媒質内イメージング	○佐藤 彰洋 ¹ 、菊地 直斗 ¹ 、青木 孝輔 ¹ 、小林 和訓 ¹ 、小林 正樹 ¹	1. 東北工大
14:45	21p-S422-5 ヒト皮膚由来のバイオフォトンの同時多波長スペクトルパターン分析	○岩佐 琥偉 ¹ 、佐藤 佑哉 ¹ 、及川 大揮 ¹ 、小林 正樹 ¹	1. 東北工大
15:00	21p-S422-6 ヒト皮膚容積脈波画像に基づく心拍変動の解析	青木 佑太 ¹ 、○西館 泉 ¹ 、中野 和也 ² 、新関 久一 ³ 、相津 佳永 ⁴	1. 東京農工大院、2. 東京理科大、3. 山形大学院、4. 室工大
15:15	休憩 / Break		
15:30	21p-S422-7 SHG(第二高調波発生)顕微鏡の小型化	○厚田 耕佑 ¹ 、長谷 栄治 ¹ 、南川 丈夫 ¹ 、吉木 啓介 ² 、安井 武史 ¹	1. 徳島大、2. 兵庫県立大
15:45	21p-S422-8 【注目講演】周波数分割多重化された蛍光共焦点顕微鏡法の高速度	○三上 秀治 ¹ 、小林 博文 ¹ 、Syed Hamad ¹ 、王 艺森 ¹ 、小関 泰之 ² 、合田 圭介 ^{1,3,4}	1. 東大理、2. 東工大、3. UCLA、4. JST
16:00	21p-S422-9 利得スイッチング駆動半導体レーザーを用いた誘導ラマン顕微鏡による生細胞イメージング	○徳永 京也 ¹ 、房 宜激 ² 、横山 弘之 ² 、小関 泰之 ¹	1. 東大院工、2. 東北大 NICHe
16:15	奨 E 21p-S422-10 Bio-Imaging of Cancer Cells Using Polymer-Stabilized Platinum Nanoclusters as Fluorescent Probes	○(D) XIN HUANG ¹ , HIDEKAZU ISHITOBI ^{1,2} , YASUSHI INOUE ^{1,2,3}	1. FBS, Osaka Univ., 2. Appl. Phys., Osaka Univ., 3. PARC, Osaka Univ.
16:30	奨 21p-S422-11 電子線励起アシスト光学顕微鏡による非染色細胞構造の高分解能観察	○(DC) 福田 真大 ¹ 、益田 有里子 ¹ 、居波 涉 ² 、川田 善正 ²	1. 静大院工、2. 静大電子研
16:45	奨 21p-S422-12 高速波長走査レーザーを用いた全指紋領域の広帯域高速スペクトル誘導ラマン散乱イメージング	○青木 拓也 ¹ 、福島 修一郎 ¹ 、古川 太一 ² 、橋本 守 ¹	1. 阪大基、2. 阪大ナノ
17:00	休憩 / Break		
17:15	奨 21p-S422-13 非侵襲血糖モニタに向けた差分光音響数値モデルの検討	○田中 雄次郎 ¹ 、田島 卓郎 ¹ 、瀬山 倫子 ¹ 、小泉 弘 ¹	1. NTT 先デ研
17:30	奨 E 21p-S422-14 Multifunctional ZnS:Mn/NaGdF ₂ :Yb:Er nanostructure for multimodal bio-imaging	○Thangaraju Dheivasiganam ¹ , Yuriko Masuda ² , Mohamed Mathar Sahib Ibrahim Khaleelullah ² , Wataru Inami ^{1,2} , Yoshimasa Kawata ^{1,2} , Tadanobu Koyama ¹ , Yasuhiro Hayakawa ^{1,2}	1. RIE Shizuoka Univ, 2. GSST Shizuoka Univ
17:45	21p-S422-15 【注目講演】多波長走査型干渉顕微鏡による生体内部の en-face 断層振動計測	○崔 森悦 ^{1,3} 、佐藤 敬太 ¹ 、任 書晃 ^{2,3} 、日比野 浩 ^{2,3}	1. 新潟大工、2. 新潟大医、3. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構、AMED-CREST
18:00	21p-S422-16 ショートマルチモードファイバプローブを用いた FF OCT による生体試料観察	○齋藤 大輔 ¹ 、西館 泉 ² 、佐藤 学 ¹	1. 山形大理工、2. 東京農工大
18:15	奨 21p-S422-17 波長 1.7μm 帯超高分解能フルレンジスペクトルドメイン OCT	○川越 寛之 ¹ 、山中 真仁 ¹ 、巻田 修一 ² 、安野 嘉晃 ² 、西澤 典彦 ¹	1. 名大院工、2. 筑波大 COG
18:30	奨 21p-S422-18 OCT 散乱・吸収計測における Beer-Lambert 則の定量評価	○吾郷 友樹 ¹ 、横田 涼子 ² 、岩井 俊昭 ¹	1. 東京農工大 BASE、2. 東京農工大工
18:45	奨 21p-S422-19 スペクトル領域 OCT を用いたファントム内色素の吸収量分光計測	○勝吉 優士 ¹ 、岩井 俊昭 ²	1. 東京農工大工、2. 東京農工大 BASE

CS.1.3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session

3/21(Mon.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) S611 会場			
9:00	21a-S611-1 常温接合 Nd:YAG/ダイヤモンド複合構造レーザーの熱履歴評価	○(B) 山口 頌木 ¹ 、奥山 洋平 ¹ 、市川 裕允 ¹ 、庄司 一郎 ¹	1. 中央大理工
9:15	21a-S611-2 レーザーセラミックス接合技術の開発 - 真空熱処理による Yb:YAG セラミックスの光学特性の劣化 -	○持田 哲郎 ¹ 、藤岡 加奈 ¹ 、時田 茂樹 ¹ 、藤本 靖 ¹ 、宮永 憲明 ¹ 、河仲 準二 ¹	1. 阪大レーザー研
9:30	21a-S611-3 常温接合を用いたレーザー結晶と銅との直接接合	○安達 亮次 ¹ 、松井 鵬樹 ¹ 、庄司 一郎 ¹	1. 中央大理工
9:45	21a-S611-4 水晶を用いた高強度光励起波長変換の検討	○石月 秀貴 ¹ 、平等 拓範 ¹	1. 分子研
10:00	21a-S611-5 波長変換材料 LaBGeO ₅ の 2 次非線形光学定数精密測定	○本多 勇介 ¹ 、河崎 進太 ¹ 、庄司 一郎 ¹	1. 中央大理工
10:15	21a-S611-6 電圧印加による LaBGeO ₅ 周期分極反転構造作製の基礎検討	○沖野 行佑 ¹ 、栖原 敏明 ¹	1. 阪大院工
10:30	21a-S611-7 MgO(8mol%) 添加 c-LiTaO ₃ 周期分極反転構造による 355nm 紫外光和周波発生	○岡 寿治 ¹ 、栖原 敏明 ¹	1. 阪大院工
10:45	奨 21a-S611-8 周期空間反転 GaAs ホモ接合ダイオードの作製	○鈴木 涼介 ¹ 、松下 智紀 ^{1,2} 、近藤 高志 ^{1,2}	1. 東大工、2. 東大先端研
11:00	21a-S611-9 定比組成 LiNbO ₃ の電気光学定数精密測定	○中野 翔太 ¹ 、秋山 和己 ¹ 、庄司 一郎 ¹	1. 中央大理工
11:15	21a-S611-10 圧力印加による高 Q 値結晶 WGM 共振器の周波数制御及び 2 次高調波発生	○(DC) 吉岐 航 ^{1,2} 、Werner Christoph ² 、Breunig Ingo ² 、Buse Karsten ²	1. 慶應理工、2. フライブルグ大

3.5 レーザー装置・材料 / Laser system and materials

3/20(Sun.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) S224 会場			
13:45	奨 E 20p-S224-1 Passively Q-switched Nd:YVO ₄ Microchip Laser for Giant Pulse Generation	○Arvydas Kausas ¹ , Takunori Taira ¹	1. Inst. for Molecular Science
14:00	E 20p-S224-2 Giant-Pulse Width Tunable System based on Composite Nd:YAG/Cr:YAG Ceramic Microchip Laser	○Hwan Hong Lim ¹ , Takunori Taira ¹	1. IMS
14:15	E 20p-S224-3 High-gain amplification of a microchip laser beam	Vincent Yahia ¹ , ○Takunori Taira ¹	1. IMS
14:30	奨 20p-S224-4 Cr ³⁺ イオン ¹ T ₁ 準位励起による Nd/Cr:YAG 材料の蛍光特性 II	○(M1) 山田 隼弘 ¹ 、本田 能之 ² 、本越 伸二 ³ 、實野 孝久 ² 、藤岡 加奈 ² 、吉田 実 ¹ 、河仲 準二 ²	1. 近大理工、2. 阪大レーザー研、3. レーザー総研

14:45	20p-S224-5	安定化 CW レーザー用低熱膨張セラミックス光共振器の長期安定性	○伊藤 功 ^{1,2} 、小林 洋平 ^{1,2}	1. 東大物性研, 2. JST-ERATO
15:00	20p-S224-6	低温 (< -10°C) 動作 Q スイッチ Tm,Ho:YLF レーザーの開発	○草刈 星貴 ¹ 、佐藤 篤 ^{1,2} 、浅井 和弘 ¹ 、石井 昌憲 ² 、水谷 耕平 ² 、落合 啓 ²	1. 東北工大院工, 2. NICT
15:15	20p-S224-7	高出力超短パルス OPCPA システムの開発 - 希ガス充填中空ファイバによる広帯域種光発生 -	○(B) 吉井 健登 ^{1,3} 、郭 晓杨 ² 、伊山 功一 ^{3,4} 、時田 茂樹 ³ 、吉田 実 ¹ 、川嶋 利幸 ⁴ 、西岡 一 ⁵ 、河仲 準 ^{2,3}	1. 近畿大学, 2. 京都大学, 3. 阪大レーザー研, 4. 浜松ホトニクス, 5. 電気通信大学
15:30	20p-S224-8	可変オンソフト LPFG を用いたファイバレーザーの波長可変実験	○(B) 百々 晋平 ¹ 、小野 唯吾 ¹ 、坂田 肇 ¹	1. 静大工
15:45	奨 20p-S224-9	波長 1610 nm 狭線幅単一偏光 Er:Yb 全ファイバー MOPA の開発	○藤田 慧祐 ¹ 、戸倉川 正樹 ¹	1. 電通大 レーザー研
16:00	奨 20p-S224-10	半導体可飽和吸収体鏡を用いた波長可変モード同期 Tm ファイバレーザーの開発	○益子 裕 ¹ 、藤田 慧祐 ¹ 、戸倉川 正樹 ¹	1. 電通大レーザー研
16:15		休憩 / Break		
16:30	20p-S224-11	分割パルスファイバー増幅器の開発	○(M1) 岩田 興治 ¹ 、チュナマン ヘンリック ¹ 、白川 晃 ¹	1. 電通大レーザー研
16:45	20p-S224-12	ファイバラマン増幅器励起用高出力 1120 nm ファイバー光源の開発	○(M1) 道端 優 ¹ 、陳 明晨 ¹ 、白川 晃 ¹	1. 電通大レーザー研
17:00	奨 20p-S224-13	利得スイッチング半導体レーザーパルスの光増幅における自然放出光ノイズの低減とその高精度評価	○茶木 智大 ^{1,2} 、房 宜激 ^{1,2} 、山田 博仁 ^{1,2} 、横山 弘之 ^{1,2}	1. 東北大院工, 2. 東北大未来研
17:15	20p-S224-14	全光ファイバ構成フォトニック結晶ファイバ増幅による 1 μm 帯ビコ秒光パルスの増幅	○千葉 仁美 ¹ 、房 宜激 ^{1,2} 、横山 弘之 ^{1,2}	1. 東北大未来研 (NICHe), 2. 東北大院工
17:30	20p-S224-15	径偏光ビームの光ファイバ増幅器における液晶型可変波長板の偏光補償効果	○光主 幸紀 ¹ 、小澤 祐市 ¹ 、佐藤 俊一 ¹	1. 東北大多元研
17:45	20p-S224-16	光渦励起ラマンレーザー	○西潟 由博 ¹ 、宮本 裕司 ¹ 、宮本 克彦 ¹ 、尾松 孝茂 ¹	1. 千葉大院
18:00	奨 E 20p-S224-17	Widely tunable optical vortex laser with extended cavity configuration	○(D) ABULIKEMU AIZITIALI ¹ , Mamuti Roukuya ¹ , Yusufu Taximaiti ¹ , Katsuhiko Miyamoto ¹ , Takashige Omatsu ¹	1. Chiba Univ.
18:15	20p-S224-18	波長可変外中赤外 (6-17 μm) 光渦の発生	○安藤 花葉 ¹ 、堀川 マイケル知樹 ¹ 、尾川 あずさ ¹ 、宮本 克彦 ¹ 、尾松 孝茂 ¹	1. 千葉大工
18:30	20p-S224-19	ミュオン水素原子超微細構造エネルギー測定のための中赤外レーザーの開発	○相川 脩 ^{1,2,3} 、湯本 正樹 ² 、齋藤 徳人 ² 、岩崎 雅彦 ^{1,3} 、和田 智之 ²	1. 理研仁科, 2. 理研光量子, 3. 東工大理工
3/21(Mon.) 11:46 - 12:06		ショート付ポスター講演 (Short Oral Presentation) S611 会場		
11:46	21a-S611-11	A model development for quantitative analysis of CW regime, multi-pass amplifier system characteristics including optical losses	○Haik Chosrowjan ¹ , Toshiyuki Kitamura ¹ , Seiji Taniguchi ¹ , Masayuki Fujita ¹ , Yasukazu Izawa ¹	1. Inst. for Laser Tech
11:48	21a-S611-12	全導波路型 Talbot 共振器内第 2 高調波発生によるレーザーアレイの同位相化	○廣澤 賢一 ^{1,2} 、正田 史生 ¹ 、柳澤 隆行 ¹ 、神成 文彦 ²	1. 三菱電機情報総研, 2. 慶大理工
11:50	21a-S611-13	青色 LD 直接励起 可視 Pr ³⁺ :YLF レーザ	○飯島 功大 ¹ 、狩山 了介 ¹ 、田中 裕樹 ¹ 、清田 恭章 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
11:52	21a-S611-14	緑・青色 InGaN 半導体レーザーの波長多重励起による Ti:sapphire モード同期レーザー	○澤田 亮太 ¹ 、田中 裕樹 ¹ 、狩山 了介 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
11:54	21a-S611-15	Yb 材料におけるゼロフォノン線での緩和発振の初期挙動に関する考察	○佐藤 庸一 ¹ 、平等 拓範 ¹	1. 分子研
11:56	21a-S611-16	ミリ波信号発生のための 2 モード発振 マイクロチップレーザーのモード間同期の特性評価	○(MIC) 佐藤 圭祐 ¹ 、渡邊 昌良 ² 、齋藤 伸吾 ³ 、兵頭 政春 ¹	1. 金沢大, 2. 電通大, 3. 情報通信研究機構
11:58	21a-S611-17	円柱状の色素溶液における誘導放出光のモード間競合	橋本 拓也 ¹ 、○齊藤 光徳 ¹	1. 龍谷大理工
12:00	21a-S611-18	特殊コアを有するフォトニック結晶ファイバの開発	○八尾 顕 ^{1,2} 、阪口 雄基 ² 、平石 隆之 ³ 、影林 由郎 ³ 、藤本 靖 ² 、中野 人志 ¹	1. 近大理工, 2. 阪大レーザー研, 3. ウシオ電機
12:02	E 21a-S611-19	Influence of Pumping Noise on Thulium-doped Fiber Lasers	○(D) YU WANG ¹ , Sze Set ¹ , Shinji Yamashita ¹	1. The Univ. of Tokyo
12:04	21a-S611-20	パルスライマン α 光の高効率発生	○大石 裕 ^{1,2} 、宮崎 洗治 ¹ 、齊藤 徳人 ¹ 、Oleg Louchev ¹ 、中村 惇平 ² 、三宅 康博 ² 、和田 智之 ¹ 、岩崎 雅彦 ¹	1. 理研, 2. 高エネ研
3/21(Mon.) 16:00 - 18:00		ショート付ポスター講演 (Poster Presentation) P13 会場		
	21p-P13-1	A model development for quantitative analysis of CW regime, multi-pass amplifier system characteristics including optical losses	○Haik Chosrowjan ¹ , Toshiyuki Kitamura ¹ , Seiji Taniguchi ¹ , Masayuki Fujita ¹ , Yasukazu Izawa ¹	1. Inst. for Laser Tech
	21p-P13-2	全導波路型 Talbot 共振器内第 2 高調波発生によるレーザーアレイの同位相化	○廣澤 賢一 ^{1,2} 、正田 史生 ¹ 、柳澤 隆行 ¹ 、神成 文彦 ²	1. 三菱電機情報総研, 2. 慶大理工
	21p-P13-3	青色 LD 直接励起 可視 Pr ³⁺ :YLF レーザ	○飯島 功大 ¹ 、狩山 了介 ¹ 、田中 裕樹 ¹ 、清田 恭章 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
	21p-P13-4	緑・青色 InGaN 半導体レーザーの波長多重励起による Ti:sapphire モード同期レーザー	○澤田 亮太 ¹ 、田中 裕樹 ¹ 、狩山 了介 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
	21p-P13-5	Yb 材料におけるゼロフォノン線での緩和発振の初期挙動に関する考察	○佐藤 庸一 ¹ 、平等 拓範 ¹	1. 分子研
	21p-P13-6	ミリ波信号発生のための 2 モード発振 マイクロチップレーザーのモード間同期の特性評価	○(MIC) 佐藤 圭祐 ¹ 、渡邊 昌良 ² 、齋藤 伸吾 ³ 、兵頭 政春 ¹	1. 金沢大, 2. 電通大, 3. 情報通信研究機構
	21p-P13-7	円柱状の色素溶液における誘導放出光のモード間競合	橋本 拓也 ¹ 、○齊藤 光徳 ¹	1. 龍谷大理工
	21p-P13-8	特殊コアを有するフォトニック結晶ファイバの開発	○八尾 顕 ^{1,2} 、阪口 雄基 ² 、平石 隆之 ³ 、影林 由郎 ³ 、藤本 靖 ² 、中野 人志 ¹	1. 近大理工, 2. 阪大レーザー研, 3. ウシオ電機
	E 21p-P13-9	Influence of Pumping Noise on Thulium-doped Fiber Lasers	○(D) YU WANG ¹ , Sze Set ¹ , Shinji Yamashita ¹	1. The Univ. of Tokyo
	21p-P13-10	パルスライマン α 光の高効率発生	○大石 裕 ^{1,2} 、宮崎 洗治 ¹ 、齊藤 徳人 ¹ 、Oleg Louchev ¹ 、中村 惇平 ² 、三宅 康博 ² 、和田 智之 ¹ 、岩崎 雅彦 ¹	1. 理研, 2. 高エネ研

3.6 超高速・高強度レーザー / Ultrashort-pulse and high-intensity lasers			
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場			
20p-P3-1		時空間分解偏光解析から明らかとなった励起子コヒーレントダイナミクスにおける回転対称性破れ	○重松 恭平 ¹ 、鈴木 雅人 ¹ 、山根 啓作 ¹ 、森田 隆二 ¹ 、戸田 泰則 ¹
20p-P3-2		単一ト秒パルス用回折限集光システムの開発 3	○田丸 裕基 ^{1,2} 、森 哲 ³ 、澤田 和寛 ^{1,4} 、Fu Yuxi ¹ 、高橋 栄治 ¹ 、須田 亮 ² 、神成 文彦 ⁴ 、緑川 克美 ¹ 、豊田 光紀 ³
20p-P3-3		アイドラー光パルス圧縮法を用いた高強度フェムト秒レーザー装置の開発 (1)- モノリシック型ガラスブロックを用いたチャープパルス増幅 -	○赤羽 温 ¹ 、山川 考一 ¹
20p-P3-4		グラフエン転写シリコン導波路からのスーパーコンティニューム光発生	○(M2) 後藤 貴大 ^{1,2} 、石澤 淳 ¹ 、高 磊 ^{3,4} 、土澤 泰 ^{3,4} 、1.NTT 物性研、2. 東京電機大、3.NTT NPC、4.NTT 先松田 信幸 ^{1,3} 、日達 研一 ¹ 、西川 正 ² 、山田 浩治 ^{3,4} 、デ研 寒川 哲臣 ¹ 、後藤 秀樹 ¹
20p-P3-5		デュアルピッチ PPLN 導波路による CEO 周波数安定化の低パルスエネルギー閾値化	○原 一鳳 ^{1,3} 、日達 研一 ¹ 、忠永 修 ² 、石澤 淳 ¹ 、西 1.NTT 物性研、2.NTT 先デ研、3. 東京電機大学 川 正 ³ 、寒川 哲臣 ¹ 、後藤 秀樹 ¹
20p-P3-6		WGM 微小共振器における CW-CCW 結合の光カーコム発生への影響	○(B) 藤井 瞬 ¹ 、加藤 拓巳 ¹ 、吉岐 航 ¹ 、陣内 哲倫 ¹ 、慶大 ¹ 、小島 知也 ¹ 、岡部 悠介 ¹ 、田邊 孝純 ¹
E 20p-P3-7		Tunable mid-infrared optical frequency comb source based on supercontinuum at 1um wavelength range	○LEI JIN ¹ 、MASAHITO YAMANAKA ¹ 、VOLKER SONNENSCHNEIN ¹ 、HIDEKI TOMITA ¹ 、TETSUO IGUCHI ¹ 、ATSUSHI SATO ² 、AKANE OMORI ² 、AKIRA IDENO ² 、TOSHINARI OH-HARA ² 、NORIHICO NISHIZAWA ¹
20p-P3-8		赤外共鳴ナノアンテナを利用した表面増強赤外非線形分光 II	○草 史野 ^{1,2} 、竹上 明伸 ^{1,2} 、森近 一貴 ² 、田山 純平 ¹ 、農工大院工、2. 東大生研
20p-P3-9		ダイヤモンド光学フォノンのコヒーレント制御	○佐々木 寛弥 ^{1,2} 、大矢 数馬 ^{1,2} 、高橋 弘史 ³ 、今泉 拓也 ^{1,2} 、北島 正弘 ^{1,2} 、荻沼 洋輔 ^{1,2} 、鹿野 豊 ^{1,4,5} 、中村 一隆 ^{1,2}
E 20p-P3-10		1.2MW-peak-power sub-picosecond optical pulse source based on a gain-switched laser diode	○YICHENG FANG ^{1,2} 、Tomohiro Chaki ^{1,2} 、Hirohito Yamada ^{1,2} 、Hiroyuki Yokoyama ^{1,2}
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S622 会場			
9:00	E 21a-S622-1	Probing two-electron dynamics of helium in time domain via fluorescence channel	○(P)Vinh Hoai Trinh ¹ 、Eiji Takahashi ¹ 、Katsumi Midorikawa ¹
9:15	E 21a-S622-2	Strong x-ray induced resonant Auger decay from core-excited states	○Souvik Chatterjee ¹ 、○Takashi Nakajima ¹
9:30	21a-S622-3	非対称な系への Multi-resolution MCTDHF の適用 2	○澤田 亮人 ¹ 、佐藤 健 ¹ 、石川 顕一 ¹
9:45	21a-S622-4	時間分解光電子分光による CO ₂ の真空紫外域光解離ダイナミクス (2): Ab initio 計算	○足立 俊輔 ¹ 、Sergy Grebenshchikov ² 、佐藤 元樹 ¹ 、鈴木 俊法 ¹
10:00	21a-S622-5	高強度レーザーによる薄膜からの陽子発生	○匂坂 明人 ¹ 、小倉 浩一 ¹ 、錦野 将元 ¹ 、Pirozhkov Alexander S. ¹ 、河内 哲哉 ¹ 、西内 満美子 ¹ 、今 亮 ¹ 、神門 正城 ¹ 、近藤 公伯 ¹ 、有川 安信 ² 、小島 完興 ² 、Morace Alessio ² 、戸崎 翔太 ² 、余語 覚文 ² 、中井 光男 ² 、西村 博明 ²
10:15	E 21a-S622-6	High-Order Harmonics from Relativistic Electron Spikes: Statistical Analysis	○Alexander S. Pirozhkov ¹ 、Timur Zh. Esirkepov ¹ 、Tatiana A. Pikuz ² 、Anatoly Ya. Faenov ² 、Koichi Ogura ¹ 、Yukio Hayashi ¹ 、Hideyuki Kotaki ¹ 、Eugene N. Ragozin ³ 、David Neely ⁴ 、Hiromitsu Kiriayama ¹ 、James K. Koga ¹ 、Yuji Fukuda ¹ 、Akito Sagisaka ¹ 、Masaharu Nishikino ¹ 、Takashi Imazono ¹ 、Noboru Hasegawa ¹ 、Tetsuya Kawachi ¹ 、Hiroyuki Daido ¹ 、Yoshiaki Kato ⁵ 、Sergei V. Bulanov ¹ 、Kiminori Kondo ¹ 、Masaki Kando ¹
10:30	休憩 / Break		
10:45	招 21a-S622-7	【講演奨励賞受賞記念講演】(15 分) 広帯域光パラメトリック増幅器による二波長同時増幅を利用した位相安定な高強度中赤外光パルスの発生と、その電場波形の測定	○金島 圭佑 ¹ 、石井 順久 ¹ 、竹内 健悟 ¹ 、板谷 治郎 ¹
11:00	E 21a-S622-8	Carrier envelope phase stabilization using orthogonally polarized reference pulse	○Yuxi FU ¹ 、Eiji J. TAKAHASHI ¹ 、Yuuki TAMARU ¹ 、Katsumi MIDORIKAWA ¹
11:15	21a-S622-9	数パルスアト秒パルス照射による水素分子イオンのサブ 10fs 解離経路制御	古川 裕介 ^{1,2} 、沖野 友哉 ¹ 、○鍋川 康夫 ¹ 、アマニ イランル ¹ 、高橋 栄治 ¹ 、山内 薫 ³ 、緑川 克美 ¹
11:30	21a-S622-10	1.4- シクロヘキサジエンにおける水素原子の脱離ダイナミクス	○(M1) 荒木 孝太郎 ^{1,2} 、天宅 建晴 ^{1,3} 、跡部 龍之介 ^{1,3} 、関川 太郎 ^{1,3} 、原測 祐 ^{2,3} 、佐藤 壮太 ^{2,3} 、武次 徹也 ^{2,3}
11:45	21a-S622-11	高次高調波発生とイオンイメージングを併用して評価したフェムト秒 2 波長レーザーパルスによる CO 分子の非断熱的な配向度	○峰本 紳一郎 ¹ 、梅本 澁嗣 ² 、住谷 達哉 ² 、小松原 航 ² 、酒井 広文 ¹
12:00	21a-S622-12	ファン共鳴におけるコヒーレントフォノンの初期位相シフトの観測	○加藤 景子 ¹ 、長谷川 祐哉 ^{1,2} 、小栗 克弥 ¹ 、西川 正 ² 、後藤 秀樹 ¹
3/21(Mon.) 13:45 - 19:15 口頭講演 (Oral Presentation) S622 会場			
13:45	奨 21p-S622-1	外部複素スケーリングを用いたコンパクトな強レーザー場第一原理計算	○(M1) 織茂 悠貴 ¹ 、佐藤 健 ¹ 、澤田 亮人 ¹ 、石川 顕一 ¹
14:00	奨 21p-S622-2	アト秒パルスによるネオン原子のイオン化の第一原理シミュレーション	○岩津 広大 ¹ 、佐藤 健 ² 、石川 顕一 ²
14:15	奨 21p-S622-3	高強度フェムト秒レーザー照射によりシリコンへ励起された表面プラズモンポラリトンの観測	○(M1) 萩谷 将人 ¹ 、宮地 悟代 ¹
14:30	奨 21p-S622-4	直線偏光パルスによる非等方的なコヒーレントフォノンの制御	○牧野 孝太郎 ¹ 、齊藤 雄太 ¹ 、Fons Paul ¹ 、Kolobov Alexander V. ¹ 、中野 隆志 ¹ 、富永 淳二 ¹ 、長谷 宗明 ²

14:45	奨 21p-S622-5	トポロジカル絶縁体 Sb_2Te_3 の光励起キャリアダイナミクス	○則松 桂 ^{1,2,3,4} 、羽田 真毅 ^{5,6} 、田中 誠一 ⁷ 、山本 宗平 ^{1,3} 、石川 忠彦 ⁷ 、恩田 健 ^{6,7} 、笹川 崇男 ^{1,3} 、中村 一隆 ^{1,3,4}	1. 東工大応セラ研, 2.JSPS, 3. 東工大総理工, 4.JST-CREST, 5. 岡山工, 6.JST- さきがけ, 7. 東工大理工
15:00	21p-S622-6	半導体電子系ベータヘルツ応答検出に向けた単一アト秒量子干渉法の提案	○小栗 克弥 ¹ 、増子 拓紀 ¹ 、山口 量彦 ^{1,2} 、須田 亮 ² 、後藤 秀樹 ¹	1.NTT 物性基礎研, 2. 東京理科大学
15:15	21p-S622-7	GaN 半導体を用いたベータヘルツ光学動作	○増子 拓紀 ¹ 、小栗 克弥 ¹ 、山口 量彦 ² 、須田 亮 ² 、後藤 秀樹 ¹	1.NTT 物性基礎研, 2. 東京理科大学
15:30		休憩 /Break		
15:45	招 21p-S622-8	【光・フォトリクス分科内招待講演】(15分) 双方向発振デュアルコムリングレーザー	○(M1) 中村 将 ^{1,2,3,4} 、井手口 拓郎 ¹ 、小林 洋平 ² 、合 田 圭介 ^{1,3,4}	1. 東大理, 2. 東大物性研, 3.UCLA, 4.JST
16:00	奨 21p-S622-9	時間分解デュアルコム分光法の開発と固体光物性研究への応用	○浅原 彰文 ^{1,2} 、西山 明子 ^{1,2,3} 、吉田 悟 ^{1,2} 、近藤 健一 ¹ 、中嶋 善品 ^{1,2} 、美濃島 薫 ^{1,2}	1. 電通大, 2.JST, ERATO 知的光シンセサイザ, 3.JSPS
16:15	奨 21p-S622-10	単層カーボンナノチューブを用いた全偏波保持ファイバレーザー光周波数コム光源の開発	○富樫 泉洗 ¹ 、長池 健 ¹ 、金 磊 ¹ 、榊原 陽一 ² 、面 田 恵美子 ² 、片浦 弘道 ² 、西澤 典彦 ¹	1. 名大工, 2. 産総研
16:30	奨 21p-S622-11	Er 添加超短パルスファイバレーザーを用いたコヒーレント広帯域光周波数コム光源の開発	○新家 俊輝 ¹ 、野村 佳孝 ¹ 、金 磊 ¹ 、小関 泰之 ² 、西澤 典彦 ¹	1. 名大工, 2. 東大工
16:45	21p-S622-12	音響光学変調器を用いたオフセット周波数のないファイバコム	○中村 圭佑 ^{1,2} 、大久保 章 ^{1,2} 、マルテ シュラム ^{1,2} 、穀山 渉 ¹ 、稲場 肇 ^{1,2}	1. 産総研, 2.JST, ERATO 知的光シンセサイザ
17:00	21p-S622-13	位相変調器ベース光コムを用いた広周波数可変な低位相雑音ミリ波発生	○石澤 淳 ¹ 、西川 正 ² 、後藤 貴大 ^{1,2} 、日達 研一 ¹ 、寒川 哲田 ¹ 、後藤 秀樹 ¹	1.NTT 物性研, 2. 東京電機大
17:15		休憩 /Break		
17:30	奨 21p-S622-14	1f-2f 干渉法を用いた高線り返しモード同期 Yb ファイバレーザーの位相制御	○安井 英顕 ^{1,2} 、徐 博 ^{1,2} 、中嶋 善品 ^{1,2} 、張 志剛 ³ 、美濃島 薫 ^{1,2}	1. 電通大, 2.JST, ERATO 知的光シンセサイザ, 3. 中国北京大学
17:45	奨 21p-S622-15	CW レーザーで制御した Fabry-Perot 共振器を用いた光コムモードフィルタリング	○(M1) 吉田 悟 ^{1,2} 、西山 明子 ^{1,2,3} 、中嶋 善品 ^{1,2} 、美濃島 薫 ^{1,2}	1. 電通大, 2.JST, ERATO 知的光シンセサイザ, 3.JSPS
18:00	奨 21p-S622-16	極紫外アト秒パルスの赤外電場によるストリーク計測	○齋藤 成之 ¹ 、石井 順久 ¹ 、金井 輝人 ¹ 、渡部 俊太郎 ² 、板谷 治郎 ¹	1. 東大物性研, 2. 東理大
18:15	21p-S622-17	高出力光シンセサイザの開発	○田丸 裕基 ^{1,2} 、高橋 栄治 ¹ 、Fu Yuxi ¹ 、Mücke Oliver D. ³ 、Kärtner Frantz X. ³ 、須田 亮 ² 、緑川 克美 ¹	1. 理研, 2. 東理大理工, 3.DESY-CFEL
18:30	21p-S622-18	希ガス封入中空ファイバ及び石英薄板を用いた超広帯域フェムト秒光パルスの発生	○(B) 植田 隆太 ¹ 、肥田 遼平 ¹ 、鈴木 敬和 ¹ 、伊佐 文宏 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
18:45	21p-S622-19	2 波長同期フェムト秒チャープパルスファイバ増幅システム	○吉富 大 ¹ 、鳥塚 健二 ¹	1. 産総研
19:00	21p-S622-20	拡張ストークスパラメータにおける拡張偏光度スペクトルを用いた光波の空間回転対称性解析の検討	○(D) 鈴木 雅人 ¹ 、山根 啓作 ¹ 、岡 和彦 ¹ 、戸田 泰則 ¹ 、森田 隆二 ¹	1. 北大理工
CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオ・プロセスとセンシングの融合に向けて」/ 3.7/12.6/12.7 Code-sharing session				
13:45	招 21p-W331-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) フェムト秒レーザーアブレーションを用いた成長機構転換によるタンパク質結晶の高品質化	○富永 勇佑 ¹ 、丸山 美帆子 ¹ 、吉村 政志 ¹ 、杉山 成 ² 、安達 宏昭 ^{1,3} 、塚本 勝男 ¹ 、松村 浩由 ^{3,4} 、高野 和文 ^{3,5} 、村上 聡 ^{3,6} 、井上 豪 ^{1,3} 、吉川 洋史 ^{1,7} 、森勇介 ^{1,3}	1. 阪大院工, 2. 阪大院環, 3. 創晶, 4. 立命大生科, 5. 京府大院生環, 6. 東工大院生理工, 7. 埼大理工
14:00	奨 21p-W331-2	フォトニック結晶ナノレーザーでの電気化学センシング	○渡部 工 ¹ 、古田 祐樹 ¹ 、高橋 大智 ¹ 、長谷川 湧 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大・院工
14:15	奨 21p-W331-3	マイクロ流路内における生分解性粒子支援フェムト秒レーザー外來分子導入	○石井 敦浩 ¹ 、有安 和優 ¹ 、三橋 龍樹 ¹ 、Dag Heinemann ² 、Alexander Heisterkamp ^{2,3} 、寺川 光洋 ¹	1. 慶大院理工, 2. レーザーセンターハノーバー, 3. ライプニッツ大学ハノーバー
14:30	奨 21p-W331-4	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での微小物体の高速ソーティング	○山川 健 ^{1,4} 、萩原 宏規 ^{1,4} 、飯野 敬矩 ^{1,4} 、田中 直樹 ^{2,4} 、芝田 悠大 ^{2,4} 、野沢 泰祐 ^{2,4} 、磯崎 瑛宏 ^{2,4} 、Dino Di Carlo ^{3,4} 、合田 圭介 ^{2,3,4} 、細川 陽一郎 ^{1,4}	1. 奈良先端大物質, 2. 東大院理, 3.UCLA, 4.JST
14:45	21p-W331-5	レーザ走査光触媒リソグラフィを活用した液中細胞パターンニング	○(M1) 藤城 翔偉 ¹ 、関根 浩平 ¹ 、河野 翔 ¹ 、池田 丈 ² 、黒田 章夫 ² 、山本 英明 ³ 、谷井 孝至 ¹	1. 早大理工, 2. 広大先端研, 3. 東北大学際研
15:00	21p-W331-6	マイクロ流路作製のための LPP EUV 光による PDMS の加工	○浦井 ひかり ¹ 、小川 瑞生 ¹ 、深見 慎太郎 ¹ 、鳥居 周一 ¹ 、牧村 哲也 ¹ 、中村 大輔 ² 、高橋 昭彦 ² 、岡田 龍雄 ² 、新納 弘之 ³	1. 筑波大院数理, 2. 九大院シス情, 3. 産総研
15:15		休憩 /Break		
15:30	21p-W331-7	金属ナノ粒子を用いたレーザー直接描画法による 3 次元マイクロ構造体の形成	○渡辺 明 ¹ 、蔡 金光 ¹	1. 東北大多元研
15:45	21p-W331-8	Bull's eye 構造のプラズモニクチップを用いた蛍光標識ナノ粒子の蛍光顕微鏡観察	○泉 章太 ¹ 、細川 千絵 ² 、富麻 真奈 ¹ 、田和 圭子 ¹	1. 関西学院大理工, 2. 産総研
16:00	21p-W331-9	遺伝変異フェリチンによる離散金ナノ粒子アレイ作製技術の構築	○信澤 和行 ¹ 、岡本 尚文 ² 、Chong Karen Siew Ling ³ 、山下 一郎 ^{1,2}	1. 阪大院工, 2. 奈良先端大物質, 3.IMRE A*STAR
16:15	21p-W331-10	汎用グリーンレーザーによるフッ素ポリマーの微細加工技術開発および水棲微生物観察用バイオチップ作製	○根本 佳祐 ¹ 、小川 達也 ¹ 、花田 修賢 ^{1,2}	1. 弘前大理工, 2. 理研
16:30	21p-W331-11	集光フェムト秒レーザーを用いた単一細胞刺激による神経細胞ネットワークの活動特性	○中川 裕太 ^{1,2} 、工藤 卓 ² 、田口 隆久 ³ 、細川 千絵 ¹	1. 産総研, 2. 関西学院大理工, 3. 情通機構
16:45	21p-W331-12	物理ストレスを受けたミトコンドリアの力印加共焦点顕微鏡による活性酸素応答測定	○本田 諭志 ¹ 、李 永波 ¹ 、上田 雅 ¹ 、長崎 秀昭 ¹ 、岩見 健太郎 ¹ 、太田 善浩 ¹ 、梅田 倫弘 ¹	1. 農工大
17:00		休憩 /Break		
17:15	21p-W331-13	Measurement of Reactive Species for the Development of Plasma-on-Chip	○呉 準席 ^{1,2} 、小島 信也 ³ 、八田 章光 ^{1,2} 、佐々木 実 ³ 、熊谷 慎也 ³	1.Kochi Univ. Technol., 2.Center Nanotechnol., 3.Toyota Technol. Inst.
17:30	21p-W331-14	可視光照射によるバイオセンシング用銀ナノ構造基板の作製	○吉川 裕之 ¹ 、沈 正君 ¹ 、廣納 麻美 ¹ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大院工
17:45	21p-W331-15	神経細胞表面のグルタミン酸受容体分子の初期集合状態に依存した光捕捉過程	○前澤 安代 ¹ 、岸本 龍典 ^{1,2} 、工藤 卓 ² 、田口 隆久 ³ 、細川 千絵 ^{1,2}	1. 産総研 バイオメディカル, 2. 関西学院大理工, 3. 情通機構 脳情報
18:00	21p-W331-16	界面レーザー捕捉による局所的タンパク濃度上昇・結晶化促進の顕微分光	○三浦 篤志 ^{1,2} 、吉松 泉 ² 、喜多村 昇 ^{1,2}	1. 北大院理, 2. 北大院総化
18:15	21p-W331-17	光発熱集合効果を用いた高速細菌数測定法の原理構築	○山本 靖之 ^{1,2} 、清水 恵美 ² 、西村 勇姿 ¹ 、床波 志保 ² 、飯田 琢也 ¹	1. 阪府大院理, 2. 阪府大院工

18:30	21p-W331-18	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ 中での単一細胞の高速操作：操作性の流速およびレー ザー強度依存性	○萩原 宏規 ^{1,4} 、山川 健 ^{1,4} 、飯野 敬矩 ^{1,4} 、田中 直樹 ^{2,4} 、1. 奈良先端大物質、2. 東大院理、3. UCLA、4. JST 芝田 悠大 ^{2,4} 、野沢 泰佑 ^{2,4} 、磯崎 瑛宏 ^{2,4} 、Dino Di Carlo ^{3,4} 、合田 圭介 ^{2,3,4} 、細川 陽一郎 ^{1,4}	
18:45	21p-W331-19	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたオープンチップ 中の高速流体からの細胞分取	○飯野 敬矩 ^{1,3} 、山川 健 ^{1,3} 、萩原 宏規 ^{1,3} 、佐久間 臣耶 ^{2,3} 、早川 健 ^{2,3} 、益田 泰輔 ^{2,3} 、新井 史人 ^{2,3} 、細 川 陽一郎 ^{1,3}	1. 奈良先端大物質創成、2. 名大院工、3. JST

3.7 レーザープロセッシング / Laser processing

3/19(Sat.) 13:30 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) W321 会場				
13:30	19p-W321-1	Real-time observation of phase-change in an organic film using a mid-infrared free-electron laser IV	Sandeep Kumar Maurya ¹ , Keisuke Mizobata ¹ , ○ Takashi Nakajima ¹ , Heishun Zen ¹ , Toshiteru Kii ¹ , Hideaki Ohgaki ¹	1. Kyoto Univ.
13:45	19p-W321-2	光散乱を用いた結晶性高分子薄膜の構造変化検出の可能 性について	○(M1) 宇都 裕貴 ¹ 、溝端 圭介 ¹ 、Maurya Sandeep ¹ 、中嶋 隆 ¹	1. 京大エネ研
14:00	19p-W321-3	レーザービーム透過法によるレーザー誘起気泡の観測	○作花 哲夫 ¹ 、田村 文香 ¹ 、松本 歩 ¹ 、本多 恭也 ¹ 、 西 直哉 ¹ 、天野 健一 ¹ 、深見 一弘 ¹ 、中嶋 隆 ²	1. 京大工、2. 京大エネ理工研
14:15	E 19p-W321-4	Evaluation of pulsed QCW laser irradiation on concrete in upward direction	○(P) Nguyen PhiLong ¹ , Hiroyuki Daido ¹ , Yukihiro Matsunaga ¹ , Tomonori Yamada ¹ , Akihiko Nishimura ¹ , Tetsuya Kawachi ¹	1. JAEA
14:30	休憩 / Break			
14:45	19p-W321-5	炭素繊維強化プラスチックのパルスレーザー加工におけ る波長・パルス幅依存性	○大河 弘志 ¹ 、染川 智弘 ² 、藤田 雅之 ^{2,3} 、松谷 貴田 ¹ 、 前田 佳伸 ¹ 、宮永 憲明 ³	1. 近大理工、2. レーザー総研、3. 阪大レーザー研
15:00	19p-W321-6	燃焼を考慮したCFRPのレーザー加工に関する3Dシミュ レーション	○大久保 友雅 ¹ 、佐藤 雄二 ² 、塚本 雅裕 ²	1. 東京工科大、2. 阪大接合研
15:15	19p-W321-7	PCF 増幅 150W 級ナノ秒パルスファイバーレーザーを用 いた CFRP の高品質加工	○(PC) 佐藤 雄二 ¹ 、塚本 雅裕 ¹ 、松岡 史浩 ² 、大 久保 友雅 ³	1. 阪大接合研、2. 阪大院工、3. 東京工科大
15:30	19p-W321-8	レーザー粉末床溶融法における Ti 合金粉末の溶融凝固 プロセスのハイスピードビデオカメラ観察及び造形物の組 織観察	○山下 顕資 ¹ 、塚本 雅裕 ² 、佐藤 雄二 ² 、升野 振一 郎 ² 、山下 順広 ³ 、阿部 信行 ²	1. 阪大院工、2. 阪大接合研、3. 石川県工試
15:45	19p-W321-9	パルスステールエネルギー制御 CO ₂ レーザーによる合成石 英ガラスの加工特性	○山本 拓哉 ¹ 、宇野 和行 ¹ 、秋津 哲也 ¹ 、實野 孝久 ²	1. 山梨大工、2. 阪大レーザー研
16:00	休憩 / Break			
16:15	19p-W321-10	真空紫外レーザーによるシリコンゴム表面への微細周 期構造の形成 (2)	○ウィスヌ バンブディ セティオ ¹ 、大越 昌幸 ¹ 、山 下 嗣人 ²	1. 防衛学校、2. 関東学院大学
16:30	19p-W321-11	高圧ガス中レーザー蒸発法による Sn 内包多角形状炭素 粒子の形成	○下垣 光明 ¹ 、小塩 明 ¹ 、小海 文夫 ¹	1. 三重大院工
16:45	19p-W321-12	Si/Ge ターゲットの高圧ガス中レーザー蒸発法による一 次元ナノ構造体の形成	○平岩 昂 ¹ 、小崎 拓也 ¹ 、森下 翔太 ¹ 、久保田 捷 ¹ 、 小塩 明 ¹ 、小海 文夫 ¹	1. 三重大院工
17:00	19p-W321-13	ダブルパルスレーザーアブレーションによる TiO ₂ と Ni のブルーム衝突過程	○(B) 片山 慶太 ¹ 、浜岡 克佳 ¹ 、青木 珠緒 ¹ 、福岡 寛 ³ 、 吉田 岳人 ² 、杉村 陽 ¹ 、梅津 郁朗 ¹	1. 甲南理工、2. 阿南高専、3. 奈良高専
17:15	19p-W321-14	ダブルレーザーアブレーション法におけるブルーム衝突 に対する励起時間の影響	○(M2) 浜岡 克佳 ¹ 、福岡 寛 ² 、杉村 彰 ¹ 、梅津 郁 朗 ¹	1. 甲南大理工、2. 奈良高専
3/20(Sun.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) W321 会場				
9:00	奨 20a-W321-1	ガラス内部へのフェムト秒レーザー加工の照射時間と溶融 痕サイズの関係	○松本 葵 ¹ 、栗田 一佳 ¹ 、玉木 隆幸 ¹ 、八幡 恵輔 ² 、 大村 悦二 ³	1. 奈良高専、2. 三星ダイヤモンド、3. 大阪大学
9:15	奨 20a-W321-2	フェムト秒レーザー照射による酸化チタン光触媒の光触 媒機能を誘起する波長領域の変化	○山縣 秀人 ¹	1. 近大理工
9:30	奨 20a-W321-3	レーザー誘起前方転写法への円環ビームの適用	○大町 弘毅 ¹ 、中村 貴宏 ¹ 、佐藤 俊一 ¹	1. 東北多元研
9:45	奨 E 20a-W321-4	A Universal Photochemical Approach to Ultra-Small, Well-Dispersed Nanoparticle/Reduced Graphene Oxide Hybrids with Enhanced Nonlinear Optical Properties	○(P) Dezh Tan ¹ , Kazunari Matsuda ¹ , Jianrong Qiu ²	1. Kyoto Univ., 2. Zhejiang Univ.
10:00	奨 20a-W321-5	レーザー駆動 EUV 光による物質アブレーションにおけ るイオンエネルギーと価数診断	○(M1) 出口 亮 ¹ 、田中 のぞみ ¹ 、和田 直 ¹ 、砂原 淳 ² 、 余語 覚文 ¹ 、西村 博明 ¹	1. 阪大レーザー研、2. レーザー総研
10:15	休憩 / Break			
10:30	奨 20a-W321-6	エキシマレーザーアニーリングによるパルファ層誘起 β -Ga ₂ O ₃ 薄膜の低温固相エピタキシャル結晶化	○内田 啓貴 ¹ 、塩尻 大士 ¹ 、福田 大二 ¹ 、土嶺 信男 ¹ 、 小山 浩司 ³ 、金子 智 ¹ 、松田 晃史 ¹ 、吉本 護 ¹	1. 東京工業大学、2. (株) 豊島製作所、3. (株) 並木精密 宝石、4. 神奈川県産技セ
10:45	奨 20a-W321-7	KrF エキシマレーザー照射によって形成された SiC(0001) 上グラフェンの成長過程の解明	○(M2) 服部 正和 ¹ 、池上 浩 ¹ 、中村 大輔 ¹ 、岡田 龍雄 ¹	1. 九州大学
11:00	奨 20a-W321-8	レーザー干渉パターンニングを利用した水熱合成法により 合成した周期構造酸化亜鉛マイクロ結晶の特性評価	○山崎 正瑛 ¹ 、下垣 哲也 ¹ 、小田 晃司 ¹ 、 Iyamperumal Palani ² 、中村 大輔 ¹ 、東島 三洋 ¹ 、中 田 芳樹 ³ 、池上 浩 ¹ 、Nilesh Vasa ⁴ 、岡田 龍雄 ¹	1. 九大シス情、2. インド工科大学インドール校、3. 阪大 レーザー研、4. インド工科大学マドラス校
11:15	奨 20a-W321-9	パルス幅依存性から考えられる液中レーザー溶融法サブ ミクロン球状粒子生成過程	○榑 祥太 ¹ 、越崎 直人 ¹ 、池上 浩 ² 、石川 善恵 ³ 、 辻 剛志 ⁴	1. 北大院工、2. 九大院工、3. 産総研、4. 島根大院工
11:30	奨 20a-W321-10	金属酸化物ナノ材料を用いたエタノールガスセンサー開 発	○佐藤 至弘 ¹ 、近藤 崇博 ¹ 、セルゲイ クリニッチ ¹ 、 岩森 暁 ¹	1. 東海大
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W321 会場				
9:00	21a-W321-1	単結晶ダイヤモンドへの超短パルスレーザー加工とダイ ナミクス	○坂倉 政明 ¹ 、岡田 拓郎 ² 、Bharadwaj Vibhav ³ 、 Sotillo Belén ³ 、Eaton Shane ³ 、Ramponi Roberta ³ 、 Serpengüzeli Ali ⁴ 、Gökay Ulaş ⁴ 、下間 靖彦 ² 、三浦 清貴 ²	1. 京大産連、2. 京大院工、3. ミラノ工科大、4. コチ大
9:15	21a-W321-2	ガラス材料間の超短光パルスマイクロ接合法における接 合領域と接合強度の関係探索	○玉木 隆幸 ¹ 、乾 永弥 ¹ 、松本 葵 ¹ 、渡邊 歴 ²	1. 奈良高専、2. 立命館大学
9:30	21a-W321-3	フェムト秒レーザー制御パラメータのガラス内加工精度に 及ぼす影響	○北島 魁人 ¹ 、土田 英一 ¹	1. 小山高専
9:45	21a-W321-4	1.5 μm フェムト秒ベッセルビームによる Si 貫通穴の形 成	He Fei ^{1,2} 、Cheng Ya ² 、○杉岡 幸次 ¹	1. 理研、2. SIOM
10:00	E 21a-W321-5	Microspatially modulating hydrophilic/hydrophobic property on glass surface using femtosecond laser direct writing	○Jian Xu ¹ , Mingjie Liu ² , Katsumi Midorikawa ¹ , Koji Sugioka ¹	1. RIKEN, Japan, 2. Beihang Univ., China
10:15	21a-W321-6	フェムト秒レーザー還元直接描画法による Cu-Ni 微細パ ターニング	○溝尻 瑞枝 ¹ 、櫻井 淳平 ¹ 、秦 誠一 ¹	1. 名大院工

10:30		休憩 / Break		
10:45	21a-W321-7	短パルスレーザー照射による水素吸蔵合金の表面改質効果	○阿部 浩之 ¹ 、下村 拓也 ² 、菅浦 敏久 ³ 、徳平 真之介 ⁴ 、原宮下 敦巳 ¹ 、西村 昭彦 ² 、大道 博行 ² 、内田 裕久 ⁴	1. 原子力機構量子高崎, 2. 原子力機構レーザー研, 3. 原子力機構量子播磨, 4. 東海大院応用理学
11:00	21a-W321-8	イットリア安定化ジルコニアセラミックスに形成されたフェムト秒レーザー誘起周期構造形成の Puls 幅依存性	○欠端 雅之 ¹ 、屋代 英彦 ¹ 、大矢根 綾子 ² 、伊藤 敦夫 ³ 、鳥塚 健二 ¹	1. 産総研 電子光技術, 2. 産総研 ナノ材料, 3. 産総研健康工学
11:15	21a-W321-9	ホログラフィックライン整形ベクトルビームを用いたナノ周期構造の作製	○長谷川 智士 ¹ 、早崎 芳夫 ¹	1. 宇都宮大オブティクス
11:30	21a-W321-10	回折光学素子対により集光されたフェムト秒レーザーパルス幅の評価	○中野 秀俊 ¹ 、佐藤 慎 ¹ 、竹田 州 ¹ 、尼子 淳 ¹	1. 東洋大理工
11:45	21a-W321-11	フェムト秒レーザー誘起衝撃力による植物細胞の細胞壁と細胞膜の高速形状変化	○吹田 啓介 ¹ 、片桐 大輔 ¹ 、飯野 敬矩 ¹ 、米田 新 ² 、出村 拓 ² 、細川 陽一郎 ¹	1. 奈良先端大物質, 2. 奈良先端大バイオ
12:00	21a-W321-12	フェムト秒レーザー誘起衝撃力と AFM によるゼブラフィッシュ胚の硬さ評価	○南野 大樹 ¹ 、宮本 敏男 ¹ 、山田 壮平 ² 、別所 康全 ² 、松井 貴輝 ² 、飯野 敬矩 ¹ 、細川 陽一郎 ¹	1. 奈良先端大物質, 2. 奈良先端大バイオ
3/21(Mon.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P14 会場				
	21p-P14-1	数サイクルレーザーパルスによる固体表面へのナノ加工	○宮地 悟代 ¹	1. 東京農工大
	21p-P14-2	フェムト秒レーザーを用いた劈開による基板切り出し手法の検討	○岡本 淳祐 ¹ 、○宮川 鈴衣奈 ¹ 、江龍 修 ¹	1. 名工大
	21p-P14-3	超短レーザーパルス直挿 Pr: フッ化物導波路レーザー作製	○佐藤 琢哉 ¹ 、山中 雄介 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
	21p-P14-4	フェムト秒 Ti:Sapphire レーザの第二高調波直挿による Nd:YLF 導波路レーザー	○佐藤 琢哉 ¹ 、山中 雄介 ¹ 、廣澤 賢一 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
	21p-P14-5	フェムト秒レーザー照射による乳酸・グリコール酸重合合体からの蛍光分子放出	○梅本 大河 ¹ 、柴田 明道 ² 、矢田 周平 ² 、有安 和優 ² 、寺川 光洋 ^{1,2}	1. 慶大理工, 2. 慶大院理工
	E 21p-P14-6	Incorporation of zinc-containing nanoparticles prepared via laser ablation into polymer nanosheets toward wound dressing application	○Hafzan Qayyum Muhammad ¹ , Takuya Komachi ¹ , Mitsuhiro Honda ² , Takahiro Kondo ¹ , Yosuke Okamura ¹ , Sergei Kulinich ¹ , Satoru Iwamori ¹	1. Tokai Univ., 2. Nagoya Inst. Tech.
	21p-P14-7	ホログラフィックデュアル偏光フェムト秒レーザー加工システムを用いたレーザースイーパー	○阿部 哲也 ¹ 、長谷川 智士 ¹ 、高橋 秀知 ² 、太田 道春 ³ 、早崎 芳夫 ¹	1. 宇都宮大オブト, 2. アイシン精機, 3. イムラアメリカ
3.8 光計測技術・機器 / Optical measurement, instrumentation, and sensor				
3/20(Sun.) 13:15 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場				
13:15	20p-H116-1	干渉縞包絡線変位検出手法の比較	○韋 冬 ¹ 、明田川 正人 ¹	1. 長岡技術機械
13:30	20p-H116-2	カー係数測定用 QP 法の解析一絶対符号の決定	○滝澤 國治 ¹ 、金 蓮花 ²	1. 浜松ホトニクス中研, 2. 山梨大学工
13:45	奨 20p-H116-3	チャープした超短パルスのスペクトル干渉を用いた距離イメージング法の開発	○加藤 峰士 ^{1,2} 、内田 めぐみ ¹ 、中嶋 善晶 ^{1,2} 、美濃 島 薫 ^{1,2}	1. 電通大, 2. JST, ERATO 知的光シンセサイザ
14:00	20p-H116-4	Si-APD 二光子吸収応答による距離計測 - 変調信号の位相掃引による短時間高精度計測	○(M1) 山田 祥規 ¹ 、根本 昌弥 ¹ 、田中 洋介 ¹ 、黒川 隆志 ¹	1. 農工大工
14:15	奨 20p-H116-5	ダイヤモンド中電子スピンの光検出磁気共鳴イメージング	○岡崎 陸 ¹ 、藤田 留士郎 ¹ 、渡邊 幸志 ² 、赤羽 浩一 ³ 、門内 靖明 ¹ 、伊藤 公平 ¹ 、早瀬 潤子 ¹	1. 慶大理工, 2. 産総研, 3. 情報通信研究機構
14:30	奨 20p-H116-6	超音波アシスト分光イメージングによる懸濁液計測 - 超音波合成波を用いた浮遊粒子の並進移動マニピュレーション	○王 从涛 ¹ 、野郷 孝介 ¹ 、森 敬太 ¹ 、石丸 伊知郎 ¹	1. 香川大工
14:45	奨 20p-H116-7	導波モードセンサによる硫酸銅めっき液中添加剤量監視	○佐藤 洗太郎 ¹ 、大木 義路 ^{1,2} 、藤巻 真 ³	1. 早大先進理工, 2. 早大材研, 3. 産総研
15:00	奨 20p-H116-8	不可視情報の光学的識別における評価指標の最適化	○佐竹 優貴 ¹ 、若生 一広 ¹	1. 仙台高専
15:15	奨 20p-H116-9	波長 / ID 空間変換および共焦点スリットを用いたフルフィールド・スキャンレス共焦点レーザー顕微鏡の開発	○宮本 周治 ¹ 、長谷 栄治 ^{1,2} 、南川 丈夫 ^{1,2} 、山本 裕紹 ^{2,3} 、安井 武史 ^{1,2}	1. 徳島大学, 2. JST-ERATO 美濃島知的光シンセサイザプロジェクト, 3. 宇都宮大学
15:30	奨 20p-H116-10	光コム 2 色干渉計による空気屈折率の経験式精度を超える自己補正	○宮野 皓貴 ^{1,2} 、Guanhao Wu ³ 、牧野 智大 ¹ 、美濃 島 薫 ^{1,2}	1. 電通大, 2. JST, ERATO 知的光シンセサイザ, 3. 中国清華大学
15:45	奨 20p-H116-11	光周波数コムモード同期と周波数安定化に向けたグラフェン / III-V ハイブリッド変調器	○(DC) 林 佑介 ¹ 、Chien-Chung Lee ² 、Kevin Silverman ³ 、Ari Feldman ³ 、Todd Harvey ³ 、Richard Mirin ³ 、西山 伸彦 ¹ 、荒井 滋久 ⁴ 、Thomas Schibli ^{3,5,6}	1. 東工大電電, 2. Dept. Physics, U. Colorado Boulder, 3. NIST, 4. 東工大 QNERC, 5. JILA, 6. Dept. Electrical Computer and Energy, U. Colorado Boulder
16:00		休憩 / Break		
16:15	20p-H116-12	フェムト秒パルスの高感度タイミングジッター検出方法を適用した光コム干渉計の開発	○中嶋 善晶 ^{1,2} 、Schibli Thomas ³ 、美濃 島 薫 ^{1,2}	1. 電通大, 2. JST, ERATO 知的光シンセサイザプロジェクト, 3. コロラド大
16:30	20p-H116-13	スキャンレス光周波数コム分散計測システムの検討	○(MIC) 春日 海秀 ¹ 、宮本 貴幸 ¹ 、塩田 達俊 ¹	1. 埼玉大理工
16:45	20p-H116-14	BOCDA における高速ランダムアクセスの性能向上	○河野 裕太 ^{1,2} 、岸 真人 ^{1,2} 、保立 和夫 ^{1,2}	1. 東大, 2. 保立研
17:00	20p-H116-15	BOCDA 法を用いた空間分解能 3.6mm での PLC 内ブリルアン周波数シフトの分布測定	○(M2) 三浦 信一 ¹ 、岸 真人 ¹ 、保立 和夫 ¹	1. 東大
17:15	20p-H116-16	ブリルアンダイナミックグレーティングを用いた光相関領域法による温度・歪の分離分布測定の高空間分解能化に関する研究	○(MIC) 笹井 健生 ¹ 、岸 真人 ¹ 、保立 和夫 ¹	1. 東大工
17:30	E 20p-H116-17	Distributed Measurement of Brillouin Dynamic Grating in Brillouin Optical Correlation Domain Reflectometry	○(DC) YUGUO YAO ¹ , MASATO KISHI ¹ , KAZUO HOTATE ¹	1. The Univ. of Tokyo
17:45	20p-H116-18	酸素 A バンドを利用したクロロフィル蛍光の分光画像計測: 水田への応用	○栗山 健二 ¹ 、眞子 直弘 ² 、本間 香貴 ³ 、久世 宏明 ²	1. 静岡大工, 2. 千葉大 CEReS, 3. 東北大農
18:00	20p-H116-19	生体断層計測用 GHz 帯 Er 添加高調波能動モード同期ファイバーレーザーの製作	○羽田 圭志 ¹ 、崔 森悦 ^{2,5} 、任 書晃 ^{3,5} 、日比野 浩 ^{3,5} 、黒川 隆志 ⁴	1. 新潟大院自然研, 2. 新潟大工, 3. 新潟大医, 4. 東京農工大工, 5. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構, AMED-CREST
18:15	20p-H116-20	高周波位相変調を用いた高速振動変位の精密測定	○土屋 光輝 ¹ 、木村 亮祐 ¹ 、伊藤 孝優 ¹ 、田中 洋介 ¹ 、黒川 隆志 ¹	1. 農工大工
18:30	20p-H116-21	薄明視野顕微鏡法を用いた金ナノ粒子の 3 次元マッピング	○後藤 和史 ¹ 、○早崎 芳夫 ¹	1. 宇大オブティクス
3/21(Mon.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場				
9:00	奨 21a-H116-1	SF-STAMP 光学系を用いたマルチスペクトラルイメージング	○(B) 肥田 遼平 ¹ 、鈴木 敬和 ¹ 、伊佐 文宏 ¹ 、植田 隆太 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
9:15	21a-H116-2	In ⁺ イオン光周波数標準のための深紫外コヒーレント光源	○李 瑛 ¹ 、大坪 望 ¹ 、松原 健祐 ¹ 、井戸 哲也 ¹ 、早坂 和弘 ¹	1. 情通機構
9:30	21a-H116-3	位相操作型干渉計を用いた超高速フーリエ変換コヒーレントラマン分光	○榊 祐介 ¹ 、玉光 未侖 ¹ 、中村 将 ¹ 、ゴバラ クリシュナ ボダガトラバリ ¹ 、井手口 拓郎 ¹ 、合田 圭介 ^{1,2,3}	1. 東大理工, 2. UCLA, 3. JST
9:45	21a-H116-4	超高速広帯域フーリエ変換 CARS 分光	○(M2) 橋本 和樹 ¹ 、高橋 めぐみ ¹ 、井手口 拓郎 ¹ 、合田 圭介 ^{1,2,3}	1. 東大理工, 2. UCLA, 3. JST

10:00	21a-H116-5	白色光励起による多波長多段階反応過程の観測：フーリエ変換型2次元透過吸収分光システムの開発	安西 宇宙 ¹ , Joshi Neeraj Kumar ¹ , 冬木 正紀 ² , ○ 1. 神戸大, 2. 畿央大 和田 昭英 ¹
10:15	21a-H116-6	光周波数領域における時系列の位相雑音計測	○穀山 渉 ¹ , 大久保 章 ¹ , 和田 雅人 ¹ , 中村 圭佑 ¹ , 1. 産総研 計量標準 稲場 肇 ¹
10:30	奨 21a-H116-7	スキャンレスデュアルコム分光イメージング法の提案	○澁谷 九輝 ^{1,3} , 松本 拓磨 ¹ , 水谷 康弘 ^{2,3} , 岩田 哲 ¹ , 1. 徳島大, 2. 大阪大, 3. JST-ERATO 美濃島知的光シン セサイザプロジェクト ○渡邊 直登 ^{1,3} , 安井 武史 ^{1,3}
10:45	21a-H116-8	光周波数コムを用いた ⁸⁵ Rb 原子のリドベグ励起用基準光源の開発 II	○渡邊 直登 ¹ , 中 信長 ¹ , 竹村 直貴 ¹ , 海上 智行 ¹ , 1. 電通大レーザー 田村 光 ¹ , 武者 満 ¹ , 中川 賢一 ¹
11:00	21a-H116-9	デュアルコム分光法による Rb 原子の高分解能分光	○西山 明子 ^{1,2,3} , 浅原 彰文 ^{1,2} , 吉田 悟 ^{1,2} , 中嶋 善 ¹ , 1. 電通大, 2. JST, ERATO 知的光シンセサイザ, 3. JSPS 晶 ^{1,2} , 美濃島 薫 ^{1,2}
11:15	21a-H116-10	天体の視線速度観測用高分散分光器の波長校正用光周波数コムの開発 -間隔 20 GHz、波長 380 - 500 nm の広帯域光周波数コム の発生 -	○大久保 章 ^{1,5} , 中村 圭佑 ^{1,5} , シュラム マルテ ^{1,5} , 1. 産総研, 2. 横国大, 3. 国立天文台, 4. 電通大, 5. JST, 山本 宏樹 ^{2,5} , 石川 純 ¹ , 洪 鋒雷 ^{1,2,5} , 大苗 敦 ^{1,5} , ERATO 美濃島 薫 ^{1,4,5} , 筒井 寛典 ^{3,5} , 神戸 栄治 ^{3,5} , 泉浦 秀 行 ^{3,5} , 稲場 肇 ^{1,5}
11:30	奨 21a-H116-11	次元変換光コムを用いたスキャンレス・フルフィールド共焦点顕微鏡の開発(2) ~ 2次元波長分散光学系の構築 ~	○長谷 栄治 ^{1,2} , 宮本 周治 ¹ , 謝 宜達 ^{1,2} , 南川 丈夫 ¹ , 1. 徳島大, 2. JST-ERATO 美濃島 IOS, 3. 宇都宮大 1,2, 山本 裕紹 ^{3,2} , 安井 武史 ^{1,2}
3/21(Mon.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場			
13:15	21p-H116-1	広視野ヘテロダイン干渉振動計測法による一括平面振動計測	○崔 森悦 ^{1,4} , 丸山 悠太 ² , 鈴木 孝昌 ² , 小浦 方 格 ³ , 1. 新大工, 2. 新大自然研, 3. 新大産学地域連携推進機構, 4. 国立研究開発法人日本医療研究開発機構, AMED- CREST
13:30	21p-H116-2	白色干渉計を用いた薄膜メトロロジーの開発	○吉野 紘和 ¹ , Mansfield Daniel ² , Smith Roger ¹ , 1. Loughborough Univ., 2. Taylor Hobson Walls Michael ¹
13:45	21p-H116-3	離散的な円偏光変調方式による円二色性顕微鏡システム	○成島 哲也 ^{1,2} , 岡本 裕巳 ¹ , 1. 分子研・総研大, 2. J S T きがけ
14:00	21p-H116-4	2波長デジタル超解像干渉顕微鏡	○中嶋 澄 ¹ , 石川 慎二 ¹ , 早崎 芳夫 ¹ , 1. 宇都宮大学オプト
14:15	奨 21p-H116-5	波長掃引型 OCT を用いた多層構造試料の空間分解スペクトル計測	○(MIC) 大仁田 竜馬 ¹ , 塩田 達俊 ¹ , 1. 埼玉大大学院
14:30	21p-H116-6	エリプソメトリーによる3次元形状計測のための偏光照明法	小川 広暉 ¹ , ○津留 俊英 ¹ , 1. 山形大地教
14:45	21p-H116-7	SC 光源と多波長逆伝搬法を用いた高分解能断層形状計測	○安部 和樹 ¹ , 武隈 雄也 ¹ , 崔 森悦 ² , 佐々木 修己 ² , 新田 勇 ¹ , 小浦 方 格 ³ , 1. 新潟大院自然研, 2. 新潟大工, 3. 新潟大産学地域連携 推進機構
15:00	奨 21p-H116-8	VIPA を用いた周波数領域シングルショットイメージング	○(M1) 宮岡 拓実 ¹ , 塩田 達俊 ¹ , 1. 埼玉大理工
15:15	奨 21p-H116-9	UAV(無人飛行機: Unmanned Air Vehicle) に搭載するワンショット フーリエ分光イメージングの表面反射光除去と光源色補正方式の提案	○岡田 瑞穂 ¹ , 西藤 翼 ¹ , 森 敬太 ¹ , 中田 翔 ¹ , 石 丸 伊知郎 ¹ , 1. 香川大工
15:30	奨 21p-H116-10	プラスチック光ファイバ中のモード間干渉を用いた歪・温度センシング: アニールによる室温での温度感度の向上	○(B) 河 智仁 ¹ , 沼田 剛毅 ¹ , 林 寧生 ¹ , 水野 洋輔 ¹ , 1. 東工大精研 1, 中村 健太郎 ¹
15:45	E 21p-H116-11	Dual photoelastic modulator and rotating wave plate based Mueller matrix polarimeter to measure the optical properties of scattering media	○(DC) Pradipta Mukherjee ² , David I. Serrano-Garcia ¹ , Yukitoshi Otani ^{2,1} , 1. Utsunomiya Univ. Center for Optical Research and Education, 2. Utsunomiya Univ. Dept. Of Optical Engineering
16:00	E 21p-H116-12	Mueller matrix imaging polarimeter with non-ideal retarder calibration	○(D) Bhattacharyya Kaustav ¹ , Yukitoshi Otani ^{1,2} , David I. Serrano Garcia ² , 1. Utsunomiya Univ. Dept. of Optical Eng., 2. Utsunomiya Univ. Center for Optical Research and Education (CORE)
16:15	休憩 / Break		
16:30	E 21p-H116-13	Monitoring ultra short-term growth dynamics of plants under the influence of zinc using a highly sensitive interferometric technique, SIT	○(D) Kanchana Muthumali DeSilva Kokke ¹ , Hirofumi Kadono ¹ , 1. Saitama University
16:45	21p-H116-14	バイオスペックル OCT による水ストレス下の植物反応の計測	○中島 貴 ¹ , 門野 博史 ¹ , 1. 埼玉大理工
17:00	21p-H116-15	散乱光受光型水面センシングシステム構成法の検討	相原 弘和 ¹ , 増田 浩次 ¹ , 後藤 春可 ¹ , ○北村 心 ¹ , 1. 鳥根大総合理工
17:15	21p-H116-16	偏光子を用いたフェムト秒ダブルパルス LIBS の信号増強効果	○染川 智弘 ¹ , 大塚 昌孝 ² , 前田 佳伸 ² , 藤田 雅之 ^{1,3} , 1. レーザー総研, 2. 近大理工, 3. 阪大レーザー研
17:30	21p-H116-17	デジタルコヒーレント技術を用いた FMCW 反射光計測	○永田 翼 ¹ , 白畑 卓磨 ¹ , Set S.Y. ¹ , 山下 真司 ¹ , 1. 東大先端研
17:45	奨 21p-H116-18	楕円ガウスビーム照射における光放射圧を利用した環境微粒子カウンター	○(M1) 田井 祐一郎 ¹ , 岩井 俊昭 ¹ , 1. 東京農工大 BASE
18:00	21p-H116-19	LIFS-LIDAR による大気エアロゾル観測および解析	○富田 孝幸 ¹ , 塚田 祥大 ¹ , 久保田 智貴 ¹ , 菅沼田 光 ¹ , 1. 信州大学 齊藤 保典 ¹
18:15	21p-H116-20	カリウムファラデーフィルタを用いた気温測定実験	○阿保 真 ¹ , 有賀 幸輝 ¹ , Pham Le Hoai Phong ¹ , 1. 首都大院シスデザ
18:30	21p-H116-21	CO ₂ 分布計測用ライダーのための 1.6 μ mOPA 光源の性能評価	○柴田 泰邦 ¹ , 長澤 親生 ¹ , 阿保 真 ¹ , 1. 首都大院シスデザ
18:45	21p-H116-22	Tm ファイバーレーザー励起 Ho:YLF レーザーの開発	○水谷 耕平 ¹ , 石井 昌憲 ¹ , 青木 誠 ¹ , 浅井 和弘 ² , 1. 情通機構, 2. 東北工大 佐藤 篤 ²
3/21(Mon.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P15 会場			
	21p-P15-1	幾何光学と波動光学の連成解析によるウェハ厚さ計測の誤差特性	○小貫 哲平 ¹ , 尾島 裕隆 ¹ , 清水 淳 ¹ , 周 立波 ¹ , 1. 茨大工
	21p-P15-2	多層構造を有する試料における各層の偏光特性の分別	○金 蓮花 ¹ , 小林 大地 ¹ , 近藤 英一 ¹ , 高和 宏行 ² , 1. 山梨大工, 2. ユニオプト (株), 3. 名大工 ジェローズ ベルナル ³
	21p-P15-3	高分解能イメージングエリプソメーターの開発	○金 蓮花 ¹ , 佐野 和夫 ² , 藤尾 勲 ² , 上原 誠 ² , 1. 山梨大工, 2. (株) 目白ゲノッセン
	21p-P15-4	デジタルコヒーレント受信を用いた SS-OCT の Full-range 測定	○白畑 卓磨 ¹ , 山下 真司 ¹ , 1. 東京大学
	21p-P15-5	ダウンサンプリング位相シフト干渉法を用いた振動分布計測	○梅木 遼 ¹ , 鈴木 孝昌 ¹ , 1. 新潟大院自然研
	21p-P15-6	± 45° TN 液晶セルを用いた複屈折計測システムの検討 (II)	○(M2) 竹内 亨 ¹ , 本間 道則 ¹ , 伊東 良太 ¹ , 藤田 直子 ² , 岡野 桂樹 ² , 村田 純 ² , 尾崎 紀昭 ² , 村口 元 ² , 能勢 敏明 ¹

21p-P15-7	TN セルのシア特性と微分干渉観察応用の検討	○石坂 尚聖 ¹ 、本間 道則 ¹ 、伊東 良太 ¹ 、岡野 圭樹 ² 、1. 秋田県大システム、2. 秋田県大応用生物 藤田 直子 ² 、村田 純 ² 、村口 元 ² 、尾崎 紀昭 ² 、能 勢 敏明 ¹	
奨 21p-P15-8	デュアル光コム分光エリブソメトリー	○南川 丈夫 ^{1,2} 、謝 宜達 ^{1,2} 、澁谷 九輝 ^{1,2} 、兼岡 良樹 ¹ 、1. 徳島大院 STS、2. JST-ERATO、3. 産総研、4. 阪大院工 大久保 章 ^{2,3} 、稲場 肇 ^{2,3} 、水谷 康弘 ^{2,4} 、安井 武史 ^{1,2} 、 岩田 哲郎 ^{1,2}	
奨 21p-P15-9	波長制御型 CRDS によるガス中微量水分計測	○橋口 幸治 ¹ 、Lisak Daniel ² 、阿部 恒 ¹	1. 産総研、2. ニコラス・コベルニクス大学
E 21p-P15-10	Development of Cavity Ring-Down Spectroscopy for Carbon Isotope Analysis of Biomedical Samples (2)	○(P)Volker Thomas Sonnenschein ¹ 、Ryohei Terabayashi ¹ 、Takahiro Hirotsu ¹ 、Satoshi Yuruzume ¹ 、 Noriyoshi Hayashi ¹ 、Hideki Tomita ¹ 、Lei Jin ¹ 、 Masahito Yamanaka ¹ 、Norihiro Nishizawa ¹ 、Atsushi Sato ² 、Akane Omori ² 、Akira Ideno ² 、Toshinari Oh- hara ² 、Tetsuo Iguchi ¹	1. Nagoya Univ.、2. Sekisui Medical
21p-P15-11	ラフな表面による回折散乱光の偏光特性	○金 蓮花 ¹ 、田口 拓馬 ¹ 、近藤 英一 ¹	1. 山梨大
21p-P15-12	可視光 OCT と FDTD シミュレーションによる半導体光 デバイス微細加工における新規非破壊膜厚測定法	○西 剛史 ¹ 、尾崎 信彦 ¹ 、及川 陽一 ² 、宮地 邦男 ² 、1. 和歌山大システム、2. シンクランド、3. 物質・材料研究 大里 啓孝 ³ 、渡辺 英一郎 ³ 、池田 直樹 ³ 、杉本 喜正 機構	
21p-P15-13	赤外線加熱と赤外線カメラを用いた透明体の三次元形状 計測	○石井 靖弘 ¹ 、廣瀬 知弘 ¹ 、北山 綱次 ¹	1. 豊田中研
21p-P15-14	SC 光を用いた表面プラズモン共鳴分光エリブソメータ	○兼岡 良樹 ¹ 、安井 武史 ¹ 、岩田 哲郎 ¹	1. 徳島大
21p-P15-15	面発光型半導体レーザーを用いた FMCW レーザレ ダ	○覚間 誠一 ¹	1. 北大院工
21p-P15-16	熱拡散方向に基づいた接合部可視化手法の開発	○光田 浩樹 ¹ 、中尾 敏之 ¹ 、渡辺 正浩 ¹ 、芹川 滋 ² 、1. 日立研開、2. 日立ハイテクファイナシステムズ 熊沢 豊 ² 、加藤 洋史 ²	
21p-P15-17	可視光波長帯におけるシリコンフォトダイオードの応答 非直線性の波長依存特	○田辺 稔 ¹ 、雨宮 邦招 ¹ 、沼田 孝之 ¹ 、福田 大治 ¹	1. 産総研
21p-P15-18	ポンプ・プローブ光の変調位相差の掃引により相関ピー ク位置を掃引する BOCDA 法	○平野 真樹 ¹ 、岸 真人 ¹ 、保立 和夫 ¹	1. 東大工
21p-P15-19	ポンプ・プローブ法とナノ秒連続光法のギャップを埋め る新過渡吸収測定手法 RIPT 法の開発	○中川 達央 ¹ 、岡本 基士 ¹ 、花田 啓明 ¹ 、小山 久美 子 ¹ 、加藤 隆二 ²	1. ユニソク分光、2. 日大工
21p-P15-20	パラジウム表面上共鳴格子型水素センサのグースヘン シェンシフト計測による高感度化の検討	○水谷 彰夫 ¹ 、佐藤 慶英 ¹ 、菊田 久雄 ¹	1. 阪府大工
21p-P15-21	球面レンズと非点収差レンズを交互に配列されたマイク ロレンズアレイを用いた広ダイナミックレンジ Shack- Hartmann 波面センサー	○伊藤 絢美 ¹ 、最田 裕介 ¹ 、神藤 宏伸 ¹ 、野村 孝徳 ¹	1. 和歌山大システム工 1
21p-P15-22	サブピクセルシフト巡回型アダマール変換イメージング におけるデコンボリューション	○鉄野 翔太 ¹ 、澁谷 九輝 ¹ 、岩田 哲郎 ¹	1. 徳島大
21p-P15-23	水中におけるレーザー光の波面ゆらぎの数値シミュレ ーション	○伊藤 周 ¹ 、池端 悠一郎 ²	1. 金沢高専、2. 金沢工大

3.9 テラヘルツ全般 / Terahertz technologies

3/20(Sun.) 9:00 - 12:15			
口頭講演 (Oral Presentation) H135 会場			
9:00	20a-H135-1	ホーンアンテナによる共鳴トンネルダイオードのテラヘ ルト波受信感度向上	○落合 孝典 ¹ 、田切 孝夫 ¹ 、向井 俊和 ²
9:15	奨 20a-H135-2	トランジスタを用いた二乗検波器の感度特性	○関口 恭介 ¹ 、松永 直也 ¹ 、金谷 晴一 ¹ 、浅野 種正 ¹
9:30	E 20a-H135-3	Room temperature, very sensitive terahertz bolometer using doubly clamped mechanical oscillators	○(PC)Ya Zhang ¹ 、Yasuyuki Watanabe ¹ 、Suguru Hosono ¹ 、Naomi Nagai ¹ 、Kazuhiko Hirakawa ^{1,2}
9:45	20a-H135-4	TDTR 法を用いたテラヘルツ検出用 GaAs MEMS 両持 ち梁構造の評価	○細野 優 ¹ 、張 亜 ¹ 、メーア ジェレミー ¹ 、長井 奈 緒美 ¹ 、肥後 昭男 ² 、中野 義昭 ³ 、野村 政宏 ^{1,4} 、平 川 一彦 ^{1,4}
10:00	奨 20a-H135-5	集積型 光-THz 信号直接変換素子の作製	○安井 章雄 ¹ 、山崎 理司 ¹ 、雨宮 智宏 ² 、古澤 健太 郎 ³ 、原 紳介 ³ 、渡邊 一世 ³ 、関根 徳彦 ³ 、西山 伸 彦 ¹ 、笠松 章史 ³ 、荒井 滋久 ^{1,2}
10:15	20a-H135-6	テラヘルツ波のヘテロダイナミック EO サンプリング検出信号 の空間分布特性	○安本 拓朗 ¹ 、都築 聡 ¹ 、北原 英明 ¹ 、山本 晃司 ¹ 、1. 福井大遠赤セ、2. ニジニブゴロド大 古屋 岳 ¹ 、バクノフ マイケル ² 、谷 正彦 ¹
10:30	休憩 / Break		
10:45	20a-H135-7	1.5 μ m 帯励起 GaAs 光伝導アンテナのためのグレーティ ング電極設計	○島谷 省伍 ¹ 、吉川 遼 ¹ 、角屋 豊 ¹ 、西田 宗弘 ¹
11:00	20a-H135-8	Er ドープ InAs 量子ドット層のキャリア緩和時間から評 価した光電流周波数特性	○熊谷 直人 ¹ 、村雲 圭佑 ¹ 、盧 翔孟 ¹ 、北田 貴弘 ¹ 、1. 徳島大院フロンティア 井須 俊郎 ¹
11:15	奨 E 20a-H135-9	Vibron-assisted transport in single Ce@C ₆₀ molecule transistors	○(D)Shaoqing Du ¹ 、Kenji Yoshida ¹ 、Ya Zhang ¹ 、 Kazuhiko Hirakawa ^{1,2}
11:30	奨 20a-H135-10	p 型 Ga _{0.5} In _{0.5} P における複数種 LO 単位と電子遷移系の 量子干渉効果	○(D)坂本 裕則 ¹ 、馬 蓓 ¹ 、森田 健 ¹ 、石谷 善博 ¹
11:45	20a-H135-11	イソニアジド単結晶成長とテラヘルツ偏光分光スペクト ル測定による分子振動解析	○佐々木 哲朗 ¹ 、大塚 誠 ² 、坂本 知昭 ³
12:00	20a-H135-12	トリプトファンの鏡像異性体およびラセミ体のテラヘル ツ吸収スペクトル測定	○田中 彬裕 ¹ 、岡野 真人 ¹ 、渡邊 紳一 ¹
3/20(Sun.) 13:30 - 17:45			
口頭講演 (Oral Presentation) H135 会場			
13:30	招 20p-H135-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 高 Q 値フォトニック結晶共振器によるテラヘルツセンシ ングの高感度化	○岡本 和馬 ¹ 、久武 信太郎 ¹ 、富士田 誠之 ¹ 、永妻 忠夫 ¹
13:45	20p-H135-2	積層型メタルスリットアレイの擬似誘電体的性質	○坂口 浩一郎 ¹ 、山口 祐生 ¹ 、橋本 雅文 ¹ 、高野 恵 介 ² 、福嶋 丈浩 ¹ 、中嶋 誠 ² 、徳田 安紀 ¹
14:00	20p-H135-3	キラリティ切替可能な MEMS スパイラルメタマテリア ル THz 応答解析	○菅 哲朗 ¹ 、磯崎 英宏 ¹ 、根本 夏紀 ¹ 、神田 夏輝 ² 、1. 東京大学、2. 理化学研究所 小西 邦昭 ¹ 、高橋 英俊 ¹ 、五神 真 ¹ 、松本 潔 ¹ 、下 山 勲 ¹
14:15	奨 20p-H135-4	金属対称ベアカットワイヤーによる 0.5 THz 帯ゼロ近傍 屈折率無反射 2 次元メタマテリアル	○木村 辰也 ¹ 、安田 淳一 ² 、鈴木 健仁 ^{1,2}

14:30	E 20p-H135-5	Double Layer SRR Device for Terahertz-wave Imaging System	○(P)Zhengli Han ¹ , Seigo Ohno ² , Yu Tokizane ¹ , Kouji Nawata ¹ , Mio Koyama ¹ , Takashi Notake ¹ , Yuma Takida ¹ , Shinichiro Hayashi ¹ , Hiroaki Minamide ¹	1.Riken, 2.Tohoku University
14:45	20p-H135-6	銀薄膜を用いたテラヘルツ帯用金属薄膜サブ波長格子構造偏光子	○村木 兼吾 ¹ 、白石 和男 ¹ 、依田 秀彦 ¹ 、大野 泰司 ¹	1.宇都宮大工
15:00	20p-H135-7	モアレ型メタ表面に モアレ型メタ表面に 基づく 基づく 螺旋位相板の数値的検討	○大野 誠吾 ¹ 、石原 照也 ¹	1.東北大院理
15:15		休憩 /Break		
15:30	招 20p-H135-8	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 高出力 THz 波発生に向けた MgO:LiNbO ₃ 結晶のパラメトリック利得の測定	○瀧田 佑馬 ¹ 、四方 潤一 ² 、縄田 耕二 ¹ 、時実 悠 ¹ 、韓 正利 ¹ 、小山 美緒 ¹ 、野竹 孝志 ¹ 、林 伸一郎 ¹ 、南出 泰聖 ¹	1. 理研, 2. 日大
15:45	20p-H135-9	接触型回折格子デバイスによるテラヘルツ光発生機構の解明	○坪内 雅明 ¹ 、永島 圭介 ¹ 、吉田 美美子 ¹ 、越智 義浩 ¹ 、岡山 桃子 ¹	1. 原子力機構
16:00	奨 20p-H135-10	光注入型テラヘルツ波パラメトリック発生器の2波長発生	○(D) 村手 宏輔 ¹ 、今山 和樹 ¹ 、林 伸一郎 ²¹ 、川 瀬 晃道 ¹²	1. 名大院工, 2. 理研
16:15	20p-H135-11	1.5 μm 帯励起用 InGaAs 光伝導層の成長条件依存性	○加茂 喜彦 ¹ 、伊田 孝寛 ¹ 、栗田 暢之 ¹	1. パイオニア
16:30	奨 20p-H135-12	1.5 μm 帯励起光伝導アンテナのテラヘルツ波発生・検出特性	○栗田 暢之 ¹ 、伊田 孝寛 ¹ 、加茂 喜彦 ¹	1. パイオニア
16:45	20p-H135-13	1.5 μm パルス照射による有機電気光学ポリマーからの THz 波発生	○梶 貴博 ¹ 、山田 俊樹 ¹ 、齋藤 伸吾 ¹ 、諸橋 功 ¹ 、富成 征弘 ¹ 、青木 勲 ¹ 、田中 秀吉 ¹ 、大友 明 ¹	1. 情通機構
17:00	20p-H135-14	共鳴トンネルダイオードテラヘルツ周波数可変発振器を用いた分光分析実験	○北川 成一郎 ¹ 、水野 麻弥 ² 、齋藤 伸吾 ² 、荻野 康太 ¹ 、鈴木 左文 ¹ 、浅田 雅洋 ¹	1. 東工大, 2. 情報通信研究機構
17:15	20p-H135-15	周期的静電場-テラヘルツ変換用金属導波管のテラヘルツ波伝搬特性	伊藤 亮祐 ¹ 、伊藤 圭介 ¹ 、齋 熊斌 ¹ 、○ペイ 鐘石 ¹	1. 名工大
17:30	E 20p-H135-16	THz quantum cascade lasers toward high output power operation	○TSUNGTSE LIN ¹ , WATARU TERASHIMA ¹ , HIDEKI HIRAYAMA ¹	1. RIKEN
3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6 会場				
	21a-P6-1	テラヘルツ時間領域分光法を用いた反射測定による誘電体基板材料の積層構造測定	○(M1) 東島 侑矢 ¹ 、長 敬三 ¹ 、久保田 貴之 ¹ 、水 津 光司 ¹ 、須藤 博樹 ¹ 、中林 寛暁 ¹	1. 千葉工大
	21a-P6-2	テラヘルツ時間領域分光法による LiNbO ₃ 単結晶の焦電性の評価に関する研究	○清水 悠平 ¹ 、佐藤 祐喜 ¹ 、吉門 進三 ¹	1. 同大理工
	21a-P6-3	スパイラルアンテナを用いた THz-TDS によるイメージングでのナイフエッジ位置の信号値オーバーシュートの利用	○森川 治 ¹ 、山本 晃司 ² 、谷 正彦 ² 、栗原 一嘉 ² 、桑島 史欣 ³	1. 海保大, 2. 福井大, 3. 福井工大
	21a-P6-4	テラヘルツ帯ゼロバイアス検波用レクタナの集積一体構造設計	○徳岡 岳海 ¹ 、齊藤 光史 ¹ 、須原 理彦 ¹	1. 首都大院理工
	21a-P6-5	テラヘルツ時間領域分光法によるヒト皮膚真皮層の水の状態の評価	○矢野 かおり ¹ 、服部 利明 ¹	1. 筑波大学数理
	21a-P6-6	テラヘルツ及びラマン分光を用いたフォノン及び分子振動解析による酸化チタン (IV) の UV 活性化とキノロン系合成抗菌剤の UV 劣化の評価	○坂本 知昭 ¹ 、佐々木 哲朗 ² 、香取 典子 ¹ 、合田 幸広 ¹	1. 国立衛研, 2. 静岡大電研
	21a-P6-7	負の屈折率媒質を用いた Cherenkov 自由電子レーザー	○李 大治 ¹ 、高野 恵介 ² 、中嶋 誠 ² 、宮本 修治 ³	1. レーザー総研, 2. 阪大レーザー研, 3. 兵庫県立大高度研
	21a-P6-8	金属 V 溝構造におけるテラヘルツ波の超集束: 境界条件の近似解析	○栗原 一嘉 ¹ 、山本 晃司 ² 、桑島 史欣 ³ 、森川 治 ⁴ 、谷 正彦 ²	1. 福井大教育地域, 2. 福井大遠赤セ, 3. 福井工大, 4. 海保大
奨	21a-P6-9	高感度なカットスルー金属スリットアレー型テラヘルツ波帯偏光子の広帯域化	○古謝 望 ¹ 、富樫 隆久 ¹ 、永井 正也 ² 、鈴木 健仁 ¹	1. 茨城大工, 2. 阪大基礎工
奨	21a-P6-10	金属対称ベアカットワイヤーによる 1.0 THz 帯負の屈折率 2 次元メタマテリアル	○安田 淳一 ¹ 、木村 辰也 ² 、鈴木 健仁 ¹²	1. 茨城大工, 2. 茨城大院理工
奨	21a-P6-11	金属非対称ベアカットワイヤーによる 0.7 THz 帯負の屈折率 2 次元メタマテリアル	○近藤 諭 ¹ 、木村 辰也 ² 、鈴木 健仁 ¹²	1. 茨城大工, 2. 茨城大院理工
	21a-P6-12	半導体メサ集積ボウタイアンテナ対の 300GHz 帯無線伝送設計の解析	○石黒 裕也 ¹ 、山倉 裕和 ¹ 、須原 理彦 ¹	1. 首都大理工
	21a-P6-13	低損失厚膜アンテナ電極による共鳴トンネルダイオードテラヘルツ発振器の周波数向上	○(M2) 前川 猛 ¹ 、金谷 英敏 ¹ 、鈴木 左文 ² 、浅田 雅洋 ¹	1. 東工大 総理工, 2. 東工大 理工
	21a-P6-14	密度行列法を用いた GaN 系 2 ウェル THz-QCL 構造の最適化	○安田 浩朗 ¹	1. 情報通信研究機構
奨	21a-P6-15	光導波路導入によるテラヘルツ・エバネッセント波分光法の高効率化	○(M1) 木村 優基 ¹ 、水野 光貴 ¹ 、南部 広樹 ¹ 、水津 光司 ¹ 、諸橋 功 ² 、小川 洋 ² 、中島 慎也 ² 、関根 徳彦 ² 、寶迫 巖 ²	1. 千葉工大, 2. NICT
	21a-P6-16	高出力超短パルス励起による PPLN からの周波数チャープ THz 波発生	○浜崎 淳一 ¹ 、小川 洋 ¹ 、関根 徳彦 ¹ 、笠松 章史 ¹ 、寶迫 巖 ¹	1. 情報通信研究機構
	21a-P6-17	非対称二重格子ゲート・プラズモニック THz 波検出器のアレイ化と超半球シリコンレンズ集積による受光効率向上	○谷口 弘樹 ¹ 、糟谷 文月 ¹ 、渡辺 隆之 ¹ 、末光 哲也 ¹ 、尾辻 泰一 ¹ 、瀧田 佑馬 ² 、伊藤 弘昌 ² 、南出 泰聖 ² 、石橋 忠夫 ³ 、清水 誠 ⁴ 、佐藤 昭 ¹	1. 東北大, 2. 理研, 3. NTT エレクトロニクステクノ, 4. NTT エレクトロニクス
3/22(Tue.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) H135 会場				
9:00	奨 22a-H135-1	テラヘルツ波ケミカル顕微鏡を用いた微量溶液 pH 計測	○濱田 輝 ¹ 、秋宗 広祐 ¹ 、周 益 ¹ 、紀和 利彦 ¹ 、塚田 啓二 ¹ 、塚田 啓二 ¹	1. 岡山大工
9:15	22a-H135-2	THz パッシブポロイスキヤナによる衣服下隠匿物の物質識別法の研究	○廣本 宣久 ¹ 、森 孝二 ² 、佐藤 準一 ²	1. 静岡大創造院, 2. 海洋総合開発
9:30	22a-H135-3	偏波独立型 0.3THz 高速テラヘルツイメージング	○(M1) 齋 熊斌 ¹ 、荻戸 立夫 ² 、遠藤 政男 ³ 、裴 鐘石 ¹	1. 名工大, 2. 富山大, 3. 豊橋技科大
9:45	22a-H135-4	is-TPGを用いた THz-CT によるプラスチック部品の計測	○(M1) 杉山 裕也 ¹ 、トリバティ サロジ ¹ 、村手 宏輔 ¹ 、今山 和樹 ¹ 、川瀬 晃道 ¹²	1. 名大工, 2. 理研
10:00	奨 22a-H135-5	光注入型 THz 波パラメトリック発生 / 検出を用いた遮蔽物越しの分光イメージング	○(M1) 加藤 三樹矢 ¹ 、村手 宏輔 ¹ 、今山 和樹 ¹ 、トリバティ サロジ ¹ 、川瀬 晃道 ¹²	1. 名大院工, 2. 理研
10:15	22a-H135-6	THz 量子カスケードレーザーと 2 次元非冷却マイクロボロメータを用いたテラヘルツデジタルホログラフィ	○小川 貴之 ¹ 、南川 丈夫 ¹² 、安井 武史 ¹² 、山本 裕紹 ²³	1. 徳島大学, 2. JST-ERATO, 3. 宇都宮大学

10:30	奨 E 22a-H135-7	Experimental Evaluation of Terajet Produced by a Dielectric Cuboid in the THz Region	○ HaiHuy NguyenPham ¹ , Shintaro Hisatake ¹ , I. V. Minin ² , O. V. Minin ² , Tadao Nagatsuma ¹	1.Osaka Univ., 2.Tomsk State Univ.
10:45		休憩 /Break		
11:00	奨 22a-H135-8	円偏光 THz パルスを用いた非接触 AC ホール測定	○ (M2) 森本 智英 ¹ 、山下 元氣 ¹ 、永井 正也 ¹ 、芦田 昌明 ¹	1. 阪大基礎工
11:15	奨 22a-H135-9	光誘起キャリアによるテラヘルツ光の相対論的ドップラー反射	○ (PC) 河野 七瀬 ¹ 、板倉 隆二 ¹ 、坪内 雅明 ¹	1. 原子力機構関西研
11:30	22a-H135-10	高精度テラヘルツ偏光測定装置を用いたゴムの光弾性計測	○ 岡野 真人 ¹ 、渡邊 紳一 ¹	1. 慶大理工
11:45	22a-H135-11	【注目講演】有機分子結晶の THz-FEL アブレーションの励起周波数依存性	○ 永井 正也 ¹ 、芦田 昌明 ¹ 、川瀬 啓悟 ² 、入澤 明典 ² 、磯山 悟朗 ² 、冬木 正紀 ³ 、青木 順 ⁴ 、豊田 岐聡 ⁴	1. 阪大院基礎工, 2. 阪大産研, 3. 畿央大, 4. 阪大院理
12:00	22a-H135-12	デュアル THz コム計測のための 2 波長モード同期 Er ファイバーレーザー	○ 胡 国庆 ¹ 、水口 達也 ² 、南川 丈夫 ^{2,3} 、鄭 鋒 ¹ 、○ 安井 武史 ^{2,3}	1. 北京航空航大, 2. 徳島大, 3.JST-ERATO
12:15	22a-H135-13	非制御フェムト秒レーザー励起フォトキャリア THz コムを用いた CW-THz 波のリアルタイム絶対周波数計測	○ 水口 達也 ¹ 、林 健太 ¹ 、南川 丈夫 ^{1,2} 、安井 武史 ^{1,2}	1. 徳島大, 2.JST-ERATO
3.10 光子量子物理・技術 / Optical quantum physics and technologies				
3/20(Sun.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場				
10:00	招 20a-W541-1	【第 16 回応用物理学学会業績賞 (研究業績) 受賞記念講演】	○ 香取 秀俊 ^{1,2}	1. 東京大学, 2. 理研
		(45 分) 光格子時計の発明と展開		
10:45	招 20a-W541-2	【講演奨励賞受賞記念講演】 (15 分) 量子中継技術に向けたダイヤモンド NV 中心の研究	○ 三島 将太 ¹ 、田中 統太 ¹ 、黒岩 良太 ¹ 、荒木 建人 ¹ 、新倉 菜恵子 ¹ 、小坂 英男 ¹	1. 横国大院工
11:00	20a-W541-3	冷却 Rb 原子集団を用いた通信波長光子のアンチバンチングの観測	○ 小林 俊輝 ¹ 、松本 賢一郎 ¹ 、生田 力三 ¹ 、三木 茂斗 ³ 、山下 太郎 ² 、寺井 弘高 ² 、山本 俊 ¹ 、小芦 雅研 ¹ 、向井 哲哉 ⁴ 、井元 信之 ¹	1. 阪大基礎工, 2. 情通機構, 3. 東工大, 4.NTT 物性基礎
11:15	E 20a-W541-4	InSb Nanowire Double Quantum Dots Coupled to a Superconducting Microwave Cavity	○ (PC) Rui Wang ¹ , Russell S. Deacon ^{1,2} , D. Car ³ , E. P. A. M. Bakkers ³ , Koji Ishibashi ^{1,2}	1.RIKEN, 2.RIKEN-CEMS, 3.Eindhoven Univ.
11:30	20a-W541-5	超伝導量子ビットを用いた伝搬マイクロ波単一光子の量子非破壊測定	○ 河野 信吾 ¹ 、増山 雄太 ¹ 、田淵 豊 ¹ 、石川 豊史 ¹ 、野口 篤史 ¹ 、山崎 歴舟 ¹ 、宇佐見 康二 ¹ 、中村 泰信 ^{1,2}	1. 東大先端研, 2. 理研 CEMS
11:45	20a-W541-6	光子偏光・電子スピン量子もつれ相関の生成に向けた光子-電子の同時検出実験	○ 黒山 和幸 ¹ 、Marcus Larsson ¹ 、藤田 高史 ¹ 、松尾 貞茂 ¹ 、Sascha R.Valentine ² 、Arne Ludwig ² 、Andreas Wieck ² 、大岩 顕 ³ 、樽茶 清悟 ^{1,4}	1. 東大工, 2.Ruhr-Univ Bochum, 3. 阪大産研, 4. 理研 CEMS
3/20(Sun.) 13:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場				
13:45	招 20p-W541-1	【第 17 回光・量子エレクトロニクス業績賞 (宅間宏賞) 受賞記念講演】 (30 分) 量子光学、量子情報、量子非線形光学などの実験的研究	○ 竹内 繁樹 ¹	1. 京都大学
14:15	奨 20p-W541-2	光子対数識別と多重化を組み合わせた伝令付き単一光子源	○ (M1) 清原 孝行 ¹ 、岡本 亮 ¹ 、竹内 繁樹 ¹	1. 京大院工
14:30	E 20p-W541-3	Spectral correlation measurement in Hong-Ou-Mandel interference between two independent sources	○ Ruibo Jin ¹ , Thomas Gerrits ² , Mikio Fujiwara ¹ , Ryota Wakabayashi ^{1,3} , Taro Yamashita ¹ , Shigehito Miki ¹ , Hirotaka Tera ¹ , Ryosuke Shimizu ¹ , Masahiro Takeoka ¹ , Masahide Sasaki ¹	1.NICT, 2.NIST, 3.Waseda University, 4.UEC
14:45	20p-W541-4	雑音のある reciprocal 通信路を介したエンタングルメント配送実験	○ 生田 力三 ¹ 、野崎 正太 ¹ 、山本 俊 ¹ 、小芦 雅斗 ² 、井元 信之 ¹	1. 阪大基礎工, 2. 東大工
15:00	20p-W541-5	サブ・ガイガーモード動作 Si APD 単一光子検出器	○ 辻野 賢治 ¹ 、山口 俊夫 ¹ 、松本 みどり ¹ 、木下 順二 ¹	1. 東京女子医大
15:15	20p-W541-6	正弦電圧ゲート動作 InGaAs/InP-APD による単一光子検出効率 53 % の実現	○ (M2) 多田 彬子 ¹ 、行方 直人 ¹ 、井上 修一郎 ¹	1. 日大量科研
15:30		休憩 /Break		
15:45	20p-W541-7	Bennett 1992 の盗聴量解析	○ 中村 敏幸 ¹ 、中田 賢佑 ¹ 、小川 和久 ¹ 、岡本 淳 ¹ 、富田 章久 ¹	1. 北海道大院情報科学研究科
16:00	20p-W541-8	量子もつれ中継による測定装置無依存 DPS 量子鍵配送の提案	○ 井上 恭 ¹	1. 阪大工
16:15	20p-W541-9	周波数上に位相符号化する DPS 量子鍵配送方式	○ (D) 大川 洋平 ¹ 、大村 史倫 ¹ 、安武 裕輔 ^{1,2} 、深津 晋 ¹	1. 東大院総合, 2.JST さきがけ
16:30	20p-W541-10	フォトニック結晶ファイバを用いたスクイズド状態の大規模並行生成に関する数値解析	○ (M2) 保坂 有杜 ¹ 、川森 泰貴 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
16:45	20p-W541-11	ファイバ入射パルスの最適化制御による周波数モード間直交位相もつれ生成	○ (B) 川森 泰貴 ¹ 、保坂 有杜 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
17:00	奨 20p-W541-12	量子測定理論のイメージング科学への応用	○ 鹿野 豊 ^{1,2,3} 、小林 弘和 ⁴	1. 分子研, 2. チャップマン大, 3. 東工大応セラ研, 4. 高知工科大
17:15		休憩 /Break		
17:30	奨 20p-W541-13	レーザーカオス発生用光集積回路とビットシフト回転法を用いた物理乱数生成	○ 宇賀神 上総 ¹ 、寺島 悠太 ¹ 、内田 淳史 ¹ 、原山 卓久 ^{2,3} 、吉村 和之 ²	1. 埼玉大, 2.NTT CS 基礎研, 3. 早稲田大
17:45	20p-W541-14	半導体レーザーカオスと金属導波路を用いた THz 波の発生実験	○ 岸端 俊宏 ¹ 、赤峰 佑介 ¹ 、岩尾 憲幸 ¹ 、大井 真夏 ¹ 、坂上 直哉 ¹ 、白崎 拓郎 ¹ 、合田 沙里 ¹ 、桑島 史欣 ¹ 、谷 正彦 ² 、栗原 一嘉 ² 、山本 晃司 ² 、中島 誠 ³	1. 福井工大, 2. 福井大, 3. 阪大
18:00	奨 20p-W541-15	光結合されたレーザを有する光集積回路を用いた低周波不規則振動におけるカオス同期実験	○ 小原 翔馬 ¹ 、宇賀神 上総 ¹ 、カルサクリアン・ダール・ボスコ・アンドレアス ¹ 、内田 淳史 ¹ 、原山 卓久 ^{2,3} 、吉村 和之 ²	1. 埼玉大, 2.NTT CS 研, 3. 早大
18:15	20p-W541-16	スター型結合半導体レーザにおけるカオス同期ダイナミクス	○ 松本 卓也 ¹ 、大坪 順次 ¹	1. 静大院工
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象_13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session				
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場				
13:45	21p-S621-1	リング状共振器を用いたスピン・光軌道角運動量変換	○ 岩本 敏 ^{1,2} 、太田 泰友 ² 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
14:00	21p-S621-2	超高速波長変換素子に向けた InAs 量子ドットを有する GaAs/AlAs 多層膜三結合共振器	○ 盧 翔孟 ¹ 、熊谷 直人 ¹ 、北田 貴弘 ¹ 、井須 俊郎 ¹	1. 徳島大フロンティア
14:15	奨 21p-S621-3	量子ドット・ナノ共振器強結合系における時間分解発光測定	○ 車 一宏 ¹ 、太田 泰友 ² 、角田 雅弘 ² 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構

14:30	21p-S621-4	3 連結合光ナノ共振器における光ラビ振動の動的反転操作の実証	○鴻池 遼太郎 ^{1,2} 、仲代 匡宏 ¹ 、田中 良典 ¹ 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員
14:45	奨 21p-S621-5	量子ドット集合体におけるチャープパルスを用いたロバストなフォトンエコー生成	○(M1) 佐藤 嘉高 ¹ 、青沼 直登 ¹ 、赤羽 浩一 ² 、早 瀬 潤子 ¹	1. 慶大理工, 2. 情報通信研究機構
15:00	21p-S621-6	結合共振器から生じる二波長レーザー光の時間的コヒーレンスの評価	○北田 貴弘 ¹ 、太田 寛人 ¹ 、原山 千穂 ¹ 、盧 翔益 ¹ 、熊谷 直人 ¹ 、井須 俊郎 ¹	1. 徳島大院フロンティア
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 E 21p-S621-7	Modulation of Dynamic Nuclear Spin Polarization in Single InAs/GaAs Quantum Dots by Photonic Bandgap Effect	○(D)CheeFai Fong ¹ , Yasutomo Ota ² , Satoshi Iwamoto ^{1,2} , Yasuhiko Arakawa ^{1,2}	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.Nanoquine
15:45	21p-S621-8	GaAs 中の窒素発光中心から発生した光子の量子干渉	○(D)張 遼 ¹ 、池沢 道男 ¹ 、佐久間 芳樹 ² 、迫田 和 彰 ² 、舛本 泰章 ¹	1. 筑波大物理, 2. 物質・材料研究機構
16:00	21p-S621-9	ピラー型微細形状を有する QDinF を用いた高純度単一光子状態の生成	○村上 大輔 ¹ 、小田島 聡 ² 、中島 秀郎 ³ 、熊野 英和 ¹ 、菅倉 弘理 ⁴	1. 北大院工, 2. 八戸工大, 3. 北大電子研, 4. 北大創成
16:15	21p-S621-10	量子エミッターを含む結合ナノ共振器系のダイナミクスの解析	○上出 健仁 ¹ 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子機構, 2. 東大生研
16:30	21p-S621-11	転写プリント法による数原子層黒リンフォトニック結晶ナノ共振器結合系の作製	○太田 泰友 ¹ 、守谷 頼 ² 、矢吹 直人 ² 、荒井 美穂 ² 、角田 雅弘 ¹ 、岩本 敏 ^{1,2} 、町田 友樹 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子, 2. 東大生研
16:45	21p-S621-12	転写プリント法を用いた量子ドットを有するプラズモニックマイクロリング共振器の作製と光学特性評価	○玉田 晃均 ¹ 、太田 泰友 ² 、車 一宏 ¹ 、Jinfa Ho ² 、渡邊 克之 ² 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
17:00		休憩 / Break		
17:15	21p-S621-13	動的熱輻射制御に伴う光源温度及び輻射パワーの過渡応答特性	○井上 卓也 ^{1,2} 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員 DC
17:30	奨 21p-S621-14	2 波長切替型中赤外熱輻射光源の設計	○紀 安き ¹ 、井上 卓也 ^{1,2} 、De Zoysa Menaka ^{1,3} 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員 DC, 3. 京大白眉
17:45	21p-S621-15	電気機械フォノン導波路を用いた周波数多重化演算の可能な論理ゲート素子	○畑中 大樹 ¹ 、ダラス トム ¹ 、マブーブ イムラン ¹ 、小野満 恒二 ¹ 、山口 浩司 ¹	1.NTT 物性研
18:00	奨 21p-S621-16	GaN/AlGaN 多重量子井戸とフォトニック結晶に基づく中波長赤外熱輻射光源の開発	○(D)Kang Daniel Dongyeon ¹ 、井上 卓也 ^{1,2} 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京都大学, 2. 学振特別研究員 DC
18:15	21p-S621-17	MgO 基板上的狭帯域近赤外 Si フォトニック結晶熱輻射光源の開発	○末光 真大 ¹ 、堤 達紀 ² 、浅野 卓 ² 、De Zoysa Menaka ^{2,3} 、野田 進 ²	1. 大阪ガス, 2. 京大院工, 3. 京大白眉
18:30	21p-S621-18	埋込ヘテロ構造共振器を用いたフォトニック結晶 PT 対称結合共振器導波路の解析	○高田 健太 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2}	1.NTT 物性研, 2.NTT NPC
18:45	21p-S621-19	コヒーレント状態と個数状態を用いたハイブリッド解析手法の微小共振器ラマン効果への応用	○乾 善貴 ¹ 、浅野 卓 ¹ 、高橋 和 ² 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 阪府大院
3.11 フォトニック構造・現象 / Photonic structures and phenomena				
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場				
	20p-P4-1	Q 値向上時のフォトニックヘテロ共振器シリコンラマンレーザーの特性	○乾 善貴 ¹ 、高橋 和 ² 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 阪府大院
E	20p-P4-2	Coupled-wave analysis for photonic-crystal surface-emitting lasers II - Optical loss in photonic crystals with external reflection -	○(D)JOHN GELLETA ^{1,2} , HITOSHI KITAGAWA ^{1,2} , SUSUMU NODA ^{1,2}	1.Kyoto Univ., 2.ACCEL JST
	20p-P4-3	フォトニック結晶レーザー特性に与える格子点の形状・材質の影響の考察 II	○(M1) 中川 翔太 ¹ 、北川 均 ¹ 、田中 良典 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工
	20p-P4-4	傾斜した空孔を有するフォトニック結晶構造の作製 - 円偏光ビームの射出に向けて -	前川 享平 ¹ 、○西本 昌哉 ^{1,2} 、安田 大貴 ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、北村 恭子 ^{1,3} 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員, 3. 京都工繊大
	20p-P4-5	広い波長範囲で高効率動作可能な単一光子源実現に向けたフォトニック結晶導波路の設計	○朴 主言 ¹ 、太田 泰友 ² 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
	20p-P4-6	低屈折率なシリカを用いた高 Q 値 zipper 共振器の作製	○鐵本 智大 ¹ 、熊崎 基 ¹ 、古澤 健太郎 ² 、関根 徳彦 ² 、笠松 章史 ² 、田邊 孝純 ¹	1. 慶大理工, 2. 情報通信研究機構
奨	20p-P4-7	低屈折率媒質埋込み型高 Q 値ダブルスロット光ナノ共振器の設計	○仲代 匡宏 ¹ 、鴻池 遼太郎 ^{1,2} 、田中 良典 ¹ 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員
奨	20p-P4-8	$\lambda^2/2000$ 断面積スロット導波路への高効率モード変換の実現	○小野 真証 ^{1,2} 、谷山 秀昭 ^{1,2} 、Hao Xu ^{1,2} 、常川 雅人 ^{2,3} 、倉持 栄一 ^{1,2} 、野崎 謙悟 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2,3}	1.NTT ナノフォトニクスセンタ, 2.NTT 物性科学基礎研, 3. 東工大理工
	20p-P4-9	金ナノフィン周期構造と微小機械振動子を用いた近赤外光波長測定方法に関する研究	○前田 悦男 ¹ 、米谷 玲皇 ¹	1. 東京大学
	20p-P4-10	金テーパー構造におけるフェムト秒プラズモン集光特性の向上に向けた数値モデル計算	○(B) 片野 利佳 ¹ 、正木 雄太 ¹ 、小島 康裕 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶應義塾大学
	20p-P4-11	広帯域発光量子ドットを埋込んだ直列ヘテロ接合型フォトニック結晶導波路による超小型近赤外多波長光源	○内田 翔 ¹ 、尾崎 信彦 ¹ 、小田 久哉 ² 、池田 直樹 ³ 、杉本 喜正 ³	1. 和歌山大シス工, 2. 千歳科技大光科学, 3. 物材機構
	20p-P4-12	広帯域発光量子ドットを埋込んだ直列ヘテロ接合型フォトニック結晶導波路からの発光特性	○小田 久哉 ¹ 、山中 明生 ¹ 、内田 翔 ² 、尾崎 信彦 ² 、池田 直樹 ³ 、杉本 喜正 ³	1. 千歳科技大, 2. 和歌山大, 3. 物質材料研究機構
	20p-P4-13	シリカクラッドフォトニック結晶導波路を用いた四光波混合による 40 Gbps 信号の波長変換	○田村 卓也 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大院工
	20p-P4-14	フォトニック結晶導波路におけるスローライト誘起ドップラーシフト (III) --- ドップラーシフトと断熱的波長変換の関係	○近藤 圭祐 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大院工
	20p-P4-15	熱輻射制御による半透明体の輻射輸送促進	○津田 慎一郎 ¹ 、清水 信 ¹ 、井口 史匡 ¹ 、湯上 浩雄 ¹	1. 東北大工
	20p-P4-16	Si ロッド型熱輻射光源への透明酸化物コーティングの光学的影響	○堤 達紀 ¹ 、末光 真大 ² 、浅野 卓 ¹ 、De Zoysa Menaka ^{1,3} 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 大阪ガス, 3. 京大白眉
	20p-P4-17	マイクロリング型遅延走査器とフォトニック結晶二光子吸収フォトダイオードを用いたオンチップ光相関計	○板垣 健佑 ¹ 、衣笠 駿 ¹ 、伊藤 寛之 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大院工・院工
	20p-P4-18	フォトニック結晶を導入した超薄膜単結晶シリコン太陽電池の検討	○(M2) 藤田 奨也 ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、田中 良典 ¹ 、De Zoysa Menaka ^{1,2} 、川本 洋輔 ¹ 、元平 暉人 ¹ 、長谷川 創 ¹ 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 京大白眉
奨	20p-P4-19	複数層一括融着による 3 次元フォトニック結晶作製の検討 (II)	○北野 圭輔 ^{1,2} 、石崎 賢司 ¹ 、権平 皓 ^{1,2} 、野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員

3/21(Mon.) 9:00 - 12:15			口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場
9:00	21a-S621-1	三角形ダブルホール格子点をもつフォトニック結晶レーザの作製 (III)	○渡邊 明佳 ¹ 、廣瀬 和義 ¹ 、杉山 貴浩 ¹ 、北川 均 ² 、1. 浜ホト、2. 京大院工 野田 進 ²
9:15	21a-S621-2	共振器共鳴励起を用いた量子ドット-フォトニック結晶ナノ共振器系の高自然放出係数レーザ発振	○太田 泰友 ¹ 、高宮 大策 ² 、角田 雅弘 ¹ 、渡邊 克之 ¹ 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
9:30	21a-S621-3	フォトニック結晶レーザの面積化のための格子点構造の設計	○田中 良典 ¹ 、北川 均 ¹ 、中川 翔太 ¹ 、野田 進 ¹
9:45	E 21a-S621-4	Temperature performance of plasmonic quantum dot nanowire laser	○Jinfa Ho ¹ 、Jun Tatebayashi ¹ 、Sylvain Sergent ¹ 、Chee Fai Fong ¹ 、Satoshi Iwamoto ^{1,2} 、Yasuhiko Arakawa ^{1,2}
10:00	奨 21a-S621-5	TBA-MOVPEを用いたフォトニック結晶構造の形成 (III)	○(M1) 吉田 昌宏 ¹ 、河崎 正人 ³ 、De Zoysa Menaka ^{1,2} 、初田 蘭子 ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、田中 良典 ¹ 、北川 均 ¹ 、野田 進 ¹
10:15	21a-S621-6	ナノ共振器シリコンラマンレーザの時間領域測定	○(M2) 山下 大喜 ¹ 、高橋 和 ¹ 、浅野 卓 ² 、野田 進 ²
10:30	21a-S621-7	ナノ共振器シリコンラマンレーザの周波数差、Q値の統計的評価	○(B) 栗原 潤 ¹ 、山下 大喜 ¹ 、高橋 和 ¹ 、野田 進 ²
10:45	21a-S621-8	ナノグレイティング蛍光体の共鳴モードを利用した指向性・偏光発光	○稲田 安寿 ¹ 、橋谷 享 ¹ 、新田 充 ¹ 、富田 昇吾 ¹ 、平澤 拓 ¹
11:00	21a-S621-9	フォトニック結晶レーザにおける面内相互引き込み現象に関する検討	○小林 大河 ¹ 、Menaka De Zoysa ^{1,2} 、吉田 昌宏 ¹ 、河崎 正人 ³ 、初田 蘭子 ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、田中 良典 ¹ 、北川 均 ¹ 、野田 進 ¹
11:15	21a-S621-10	2次元ビーム走査可能なフォトニック結晶レーザの検討 (III)	○安田 大貴 ¹ 、西後 淳貴 ¹ 、北村 恭子 ^{1,2} 、野田 進 ¹
11:30	奨 21a-S621-11	半導体三次元カイラルフォトニック結晶における共振器モードの観測	○高橋 駿 ¹ 、太田 泰友 ¹ 、田尻 武義 ² 、館林 潤 ¹ 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
11:45	奨 21a-S621-12	3次元フォトニック結晶における立体交差水平導波路のクロストークの解析 (II)	○(DC) 権平 皓 ^{1,2} 、石崎 賢司 ¹ 、北野 圭輔 ^{1,2} 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹
12:00	21a-S621-13	プレート差込型積層方式による大面積プレート三次元フォトニック結晶ナノ共振器の作製と評価	○田尻 武義 ¹ 、高橋 駿 ² 、太田 泰友 ² 、館林 潤 ² 、渡邊 克之 ² 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
3/22(Tue.) 9:00 - 12:15			口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場
9:00	22a-S621-1	光バースゲート論理に基づく光演算回路	○新家 昭彦 ^{1,2} 、石原 亨 ³ 、井上 弘士 ⁴ 、野崎 謙悟 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2}
9:15	22a-S621-2	オンチップ光相関計による連続的な相関波形の観測	○衣笠 駿 ¹ 、馬場 俊彦 ¹
9:30	22a-S621-3	表面にフォトニック結晶を形成した μ c-Si太陽電池の理論解析-非対称形状導入の検討-	○長谷川 創 ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、田中 良典 ¹ 、元平 暉人 ¹ 、川本 洋輔 ¹ 、De Zoysa Menaka ^{1,2} 、藤田 奨也 ¹ 、野田 進 ¹
9:45	22a-S621-4	結合L2共振器による曲線導波路とチャンネルドロップフィルタ	○倉持 栄一 ^{1,2} 、野崎 謙悟 ^{1,2} 、新家 昭彦 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2}
10:00	奨 22a-S621-5	二光子吸収フォトダイオードアレイを用いた光相関計	○近藤 圭祐 ¹ 、馬場 俊彦 ¹
10:15	22a-S621-6	フォトニック結晶におけるランダム性の影響とその制御による利用	○大岡 勇太 ¹ 、スル アシキンダウド ¹ 、鐵本 智大 ¹ 、田邊 孝純 ¹
10:30	22a-S621-7	pnダイオード付フォトニック結晶導波路を用いた自由キャリア引き抜きによる動的レッドシフト	○近藤 圭祐 ¹ 、馬場 俊彦 ¹
10:45	22a-S621-8	高Q値光ナノ共振器及びその結合系の電氣的動的制御に向けた実験的検討	○(M2) 中川 遥之 ¹ 、鴻池 遼太郎 ¹ 、仲代 匡宏 ¹ 、浅野 卓 ¹ 、田中 良典 ¹ 、野田 進 ¹
11:00	奨 22a-S621-9	シリカフォノニック結晶共振器を用いた光弾性変調動作の実現	○金 仁基 ¹ 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
11:15	奨 22a-S621-10	高Q値SiCフォトニック結晶ナノ共振器における第二高調波発生	○山口 祐樹 ¹ 、田 昇愚 ¹ 、宋 奉植 ^{1,2} 、浅野 卓 ¹ 、野田 進 ¹
11:30	22a-S621-11	六角形プラズモニク・ナノホール・アレイのホール径制御とセンシング性能	○(MIC) 大野 峻澄 ¹ 、ヴァデル カール ¹ 、史 蹟 ² 、中村 吉男 ² 、松下 祥子 ² 、三宮 工 ¹
11:45	22a-S621-12	高効率ビーム偏向メタ表面の線形全光スイッチングの検討	○北 翔太 ^{1,2} 、高田 健太 ^{1,2} 、小野 真証 ^{1,2} 、野崎 謙悟 ^{1,2} 、倉持 栄一 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2}
12:00	奨 22a-S621-13	エピタキシャルAu/Ag薄膜を用いたメタマテリアルの高性能化	○(MIC) 小岩 匡 ¹ 、A Fedotov Vassili ² 、Ou Jun-Yu ² 、内野 俊 ¹
3/22(Tue.) 13:15 - 14:30			口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場
13:15	E 22p-S621-1	Design of nanowire-induced nanocavities in grooved SiN photonic crystals for the ultra-violet and visible range	○Sylvain SERGENT ^{1,2} 、Masato Takiguchi ^{1,2} 、Hideaki Taniyama ^{1,2} 、Akihiko Shinya ^{1,2} 、Eiichi Kuramochi ^{1,2} 、Masaya Notomi ^{1,2}
13:30	22p-S621-2	イオン液体の位置選択的注入によるフォトニック結晶モードギャップ共振器形成	○横尾 篤 ^{1,2} 、Kowalczyk Dorota ² 、滝口 雅人 ^{1,2} 、倉持 栄一 ^{1,2} 、谷山 秀昭 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2}
13:45	22p-S621-3	【注目講演】フォトリングラフィで作製したQ値100万を超えるシリコンフォトニック結晶ナノ共振器	○芦田 紘平 ¹ 、岡野 誠 ² 、大塚 実 ² 、関 三好 ² 、横山 信幸 ² 、越野 圭二 ² 、森 雅彦 ² 、高橋 和 ¹
14:00	22p-S621-4	グラフエン装荷フォトニック結晶によるオンデマンドナノ共振器の検討	○千葉 永 ^{1,2} 、納富 雅也 ^{1,2,3}
14:15	22p-S621-5	Siフォトニック結晶ナノ共振器におけるQ値の温度依存性	○浅野 卓 ¹ 、高橋 和 ² 、越智 賢明 ¹ 、岸元 克浩 ¹ 、野田 進 ¹
3.12 ナノ領域光学 / 近接場光学 / Nanoscale optical science and near-field optics			
3/19(Sat.) 9:00 - 12:30			口頭講演 (Oral Presentation) S622 会場
9:00	19a-S622-1	パンプ型THz近接場顕微鏡における信号温度依存性の観察	○林 冠廷 ¹ 、小宮山 進 ² 、金 鮮美 ¹ 、河村 賢一 ³ 、梶原 優介 ¹
9:15	19a-S622-2	電流によりグラフエン表面に誘起される電磁エバネッセント波パンプ・テラヘルツ近接場顕微鏡による可視化	○(PC) 根間 裕史 ¹ 、林 冠廷 ¹ 、金 鮮美 ¹ 、菅原 健太 ³ 、尾辻 泰一 ³ 、小宮山 進 ² 、梶原 優介 ¹
9:30	E 19a-S622-3	Excitation and strong electrical modulation of plasmons in Graphene with the use of a 2-dimensional inverted pyramid array diffraction grating	○(D) Nikolaos Matthaikakis ^{1,2} 、Hiroshi Mizuta ^{2,1} 、Martin D.B Charlton ¹
9:45	奨 19a-S622-4	エバネッセント光原子ファネルへの擬似ベッセル中空光ビームの高効率結合	○堀田 一真 ¹ 、萩原 顕 ¹ 、伊藤 治彦 ¹

10:00	奨	19a-S622-5	radial 偏光を用いた表面プラズモン増強原子ファネル	○高橋 幸佑 ¹ 、笠間 敬太 ¹ 、伊藤 治彦 ¹	1. 東工大総理工
10:15	奨	19a-S622-6	3D プリント造形表面プラズモン原子ファネル	○横山 雄大 ¹ 、野中 大地 ¹ 、伊藤 治彦 ¹	1. 東工大総理工
10:30	奨	19a-S622-7	高感度原子センシングのための表面プラズモン誘起ナノスリット	○鈴木 匠 ¹ 、中原 優 ¹ 、伊藤 治彦 ¹	1. 東工大総理工
10:45			休憩 / Break		
11:00		19a-S622-8	大出力を目指した大型 pn ホモ接合 Si 赤外レーザー	○田中 肇 ¹ 、川添 忠 ² 、大津 元一 ^{1,2}	1. 東大工, 2.NPO ナノフォト
11:15	奨	19a-S622-9	ドレスト光子を用いた光増幅型のシリコン青・紫外光検出器の感度評価	○(M2)池川 晶貴 ¹ 、川添 忠 ² 、大津 元一 ¹	1. 東大院工, 2.NPO ナノフォト
11:30		19a-S622-10	Sb をイオン注入した Si 赤外発光素子の開発	○唐澤 賢志 ¹ 、川添 忠 ² 、大津 元一 ³	1. セイコーインスツル, 2.NPO ナノフォト, 3. 東大院工
11:45	奨	19a-S622-11	ドレスト光子フォノンを用いた GaP LED の加工条件依存性と 2 準位 2 状態モデルによる解析	○(D)金 俊亨 ¹ 、川添 忠 ² 、大津 元一 ¹	1. 東大院工, 2.NPO ナノフォト
12:00		19a-S622-12	SiC 磁気光学電流変換素子とその強磁性特性評価	○川添 忠 ¹ 、大津 元一 ²	1.NPO ナノフォト, 2. 東大工
12:15		19a-S622-13	非放射場と放射場を対等に扱う単一感受率による光学の理論 V	○坂野 斎 ¹	1. 山梨大工
3/19(Sat.) 14:00 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) S622 会場					
14:00		19p-S622-1	ナノフォトニックドロップレットのビジュアル応用に向けた検討	○(PC)野村 航 ¹ 、豎 直也 ²	1. 九大 LP 分シ, 2. 九大シス情
14:15		19p-S622-2	金ナノロッド-シリコン量子ドット複合体の発光特性	○(D)杉本 泰 ¹ 、藤井 稔 ¹ 、Tianhong Chen ² 、Ren Wang ² 、Bjoern M. Reinhard ² 、Luca Dal Negro ²	1. 神戸大院工, 2. ボストン大学
14:30		19p-S622-3	金ナノ粒子-シリコン量子ドットバイオコンジュゲートの発光特性評価	○井上 飛鳥 ¹ 、杉本 泰 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大院工
14:45		19p-S622-4	Film-coupled nanoparticle 構造によるシリコンナノ結晶の発光特性	○八嶋 志保 ¹ 、杉本 泰 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神大院工
15:00	奨	19p-S622-5	金属コート AFM テップによる単一量子ドットの光子統計制御	○内貴 博之 ¹ 、高田 広樹 ¹ 、小泉 範高 ¹ 、増尾 貞弘 ¹	1. 関西学院大理工
15:15		19p-S622-6	局在プラズモン結合 Er ドープガラス微小共振器を用いた高効率 2 光子励起蛍光	○小野寺 俊平 ¹ 、任 芳 ¹ 、高島 秀聡 ¹ 、藤原 英樹 ¹ 、1. 北大電子研 笹木 敬司 ¹	
15:30		19p-S622-7	金ナノキャップ構造による希土類ドープアップコンバージョンナノ粒子の発光増強	○籾本 樹生 ¹ 、山本 薫 ¹ 、高階 寛之 ¹ 、今北 健二 ¹ 、1. 神戸大院工 藤井 稔 ¹	
15:45		19p-S622-8	金属コアシェル構造による希土類ドープ複合ナノ粒子のアップコンバージョン発光増強	○高階 寛之 ¹ 、山本 薫 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大院工
16:00			休憩 / Break		
16:15	奨	19p-S622-9	Si/SiO ₂ ナノ粒子における Fano 共鳴と指向性散乱	○土本 悠太 ¹ 、矢野 隆章 ^{1,2} 、林 智広 ^{1,2} 、原 正彦 ^{1,2}	1. 東工大, 2. 理研
16:30		19p-S622-10	シリカ / 金属界面エネルギー差を利用したナノカップの作製とそのプラズモンセンシング	○龍野 俊直 ¹ 、岡本 隆之 ² 、江崎 智太郎 ¹ 、磯部 敏 宏 ¹ 、中島 章 ¹ 、松下 祥子 ¹	1. 東工大理工, 2. 理研
16:45		19p-S622-11	光熱変形光メモリーのための金属ナノ構造の熱解析	○(M1)小山 高大 ¹ 、藤村 隆史 ^{1,2}	1. 宇大院工, 2. 宇大 CORE
17:00		19p-S622-12	カソードルミネッセンスによる Ag 粒子のプラズモン放射角依存	○(M1)ソーラ ザック ¹ 、山本 直紀 ¹ 、三宮 工 ¹	1. 東工大
17:15	奨	19p-S622-13	カソードルミネッセンスイメージングを用いた金属ナノ構造体における局在表面プラズモンモードの解析	○(M1)野久保 大貴 ¹ 、小野 篤史 ^{1,2} 、居波 涉 ^{1,2} 、川田 善正 ^{1,2}	1. 静岡大院工, 2. 静岡大電研
17:30		19p-S622-14	1 分子 SERS 分光法で追うプラズモニック光化学反応の実験	○(PC)山本 裕子 ^{1,2} 、茅野 優也 ¹ 、伊藤 民武 ³ 、中西 俊介 ¹	1. 香川大工, 2. 学振 RPD, 3. 産総研四国
17:45		19p-S622-15	単一銀ナノワイヤー 2 量体間隙の一次元 SERS ホットスポット観察	○伊藤 民武 ¹ 、山本 裕子 ^{2,3} 、脇田 慎一 ¹ 、ジャヤ デワン バラチャンドラン ⁴	1. 産総研健工, 2. 学振 RPD, 3. 香大工, 4. 滋賀県大工
18:00		19p-S622-16	先端増強ラマンにおけるプラズモンプローブの金属グレインに関する考察	○田口 敦清 ¹ 、河田 聡 ¹	1. 阪大工
3/20(Sun.) 9:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S622 会場					
9:15		20a-S622-1	測定再現性 1.8 nm を実現する走査型近接場顕微鏡計測技術	○立崎 武弘 ¹ 、張 開鋒 ² 、山川 市朗 ² 、谷口 伸一 ²	1. 東海大工, 2. 日立研開
9:30		20a-S622-2	プラズモンナノフォーカスによる白色光源の生成と近接場光学顕微鏡応用	○(B)田中 美咲 ¹	1. 大阪大学工
9:45		20a-S622-3	近接場走査顕微鏡のための高効率プラズモン薄膜光導波路	○張 開鋒 ¹ 、中田 俊彦 ¹ 、馬場 修一 ¹ 、山川 市朗 ¹ 、1. 日立研開 谷口 伸一 ¹	
10:00	奨	20a-S622-4	近接場反射顕微鏡分光法の開発と金属ナノ構造体の分光特性の究明	○溝端 秀聡 ¹ 、井村 考平 ¹	1. 早大理工
10:15	奨	20a-S622-5	長方形金ナノ構造体におけるプラズモン場の偏光状態マッピング	○(DC)橋谷田 俊 ^{1,2} 、成島 哲也 ^{1,2,3} 、岡本 裕己 ^{1,2}	1. 総研大, 2. 分子研, 3.JST さきがけ
10:30			休憩 / Break		
10:45		20a-S622-6	金ナノディスクにおける多極子プラズモンの位相緩和過程の時間領域観測	○西山 嘉男 ¹ 、岡本 裕己 ^{1,2}	1. 分子研, 2. 総研大
11:00		20a-S622-7	フェムト秒時間領域における高次分散に起因する表面プラズモン波束の変形の解析	○中村 圭佑 ¹ 、久保 敦 ¹	1. 筑波大物
11:15		20a-S622-8	1.55 μm 帯フェムト秒表面プラズモンの二光子蛍光顕微鏡観察	○村上 亮輔 ¹ 、池沢 道男 ¹ 、久保 敦 ¹	1. 筑波大物理
11:30		20a-S622-9	ZnO における長距離伝搬赤外表面プラズモン波の生成	○松井 裕章 ¹ 、池羽田 晶文 ² 、田畑 仁 ¹	1. 東大工, 2. 農研機構
11:45	奨	20a-S622-10	多モード干渉を用いた表面プラズモン合成分波器	○住村 あさひ ¹ 、中山 昂太郎 ¹ 、太田 雅 ¹ 、福原 誠 ¹ 、1. 豊技大 史 ¹ 、石井 佑弥 ¹ 、福田 光男 ¹	
12:00	奨	20a-S622-11	多モード干渉を用いたプラズモニック論理演算回路	○太田 雅 ¹ 、住村 あさひ ¹ 、福原 誠史 ¹ 、伊藤 基 ¹ 、1. 豊技大 石井 佑弥 ¹ 、福田 光男 ¹	
3/20(Sun.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S622 会場					
13:45	奨	20p-S622-1	MEMS 技術による表面プラズモン異常透過現象の励起波長連続可変制御	○本間 浩章 ^{1,2} 、高橋 一浩 ¹ 、石田 誠 ¹ 、澤田 和明 ¹	1. 豊橋技科大, 2. 特別研究員 DC2
14:00	奨	20p-S622-2	金属ギャップ光アンテナを用いたサブ波長構造化の実現	○畠田 英明 ¹ 、宮田 将司 ¹ 、高原 淳一 ^{1,2}	1. 阪大院工, 2. 阪大フォトリソセンター
14:15		20p-S622-3	帯電ナノ微粒子の自発的配列を用いた表面プラズモン共鳴構造化	○米山 貴之 ¹ 、青木 画奈 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大工
14:30		20p-S622-4	光の干渉を利用したプラズモニックナノ粒子の非対称散乱挙動の制御	○齋藤 晃一郎 ¹ 、立間 徹 ¹	1. 東大生研
14:45		20p-S622-5	異なる分子長径のジチオールで作製した銀ナノ粒子凝集体の吸光特性	○野口 勇弥 ¹ 、鈴木 仁 ¹ 、高萩 隆行 ¹ 、坂上 弘之 ¹	1. 広島大学

15:00	20p-S622-6	里芋の葉をテンプレートに使ったメタマテリアル	○杉町 悠太 ¹ 、海老原 佑亮 ¹ 、乗木 貴広 ² 、下条 雅幸 ² 、梶川 浩太郎 ¹	1. 東工大総理工工, 2. 芝浦工大工
15:15		休憩 / Break		
15:30	20p-S622-7	金ナノホール列による Tamm プラズモン結晶	○西田 宗弘 ¹ 、横溝 純平 ¹	1. 広大先端研
15:45	20p-S622-8	メタ表面における分子内光学遷移過程の人工的選択	○岩長 祐伸 ¹ 、崔 峯碩 ¹ 、宮崎 英樹 ¹ 、杉本 喜正 ¹	1. 物材機構
16:00	20p-S622-9	陽極酸化ポーラスアルミナにもとづいた微細同軸ナノケーブルアレーの形成と光学特性	○山岸 翔一 ¹ 、近藤 敏彰 ¹ 、柳下 崇 ¹ 、益田 秀樹 ¹	1. 首都大都市環境
16:15	20p-S622-10	太陽熱発電のための NiW アブソーバ・エミッタの開発	○(B) 鍵本 優大 ¹ 、那 順 ² 、岩見 健太郎 ² 、梅田 倫 弦 ²	1. 農工大工, 2. 農工大院工
16:30	20p-S622-11	プラズモニク結晶の欠陥モード制御	○酒井 恭輔 ¹ 、大村 竜矢 ¹ 、菅原 翔太郎 ¹ 、笹木 敬司 ¹	1. 北大電子研
16:45	20p-S622-12	SiC 表面フォノンポラリトンによる光アンテナ電界増強度の測定	○國近 祐太 ¹ 、宮田 純一 ¹ 、山本 悠人 ¹ 、川野 貴裕 ¹ 、笠原 健一 ¹ 、池田 直樹 ² 、大里 啓孝 ² 、杉本 喜正 ²	1. 立命館大理工, 2. 物質・材料研究機構
17:00		休憩 / Break		
17:15	20p-S622-13	ナノロッドアレイによる赤外域での電場増強と表面増強赤外吸収 (II)	○竹上 明伸 ^{1,2} 、草 史野 ^{1,2} 、芦原 聡 ²	1. 農工大院工, 2. 東大生研
17:30	奨 20p-S622-14	赤外メタマテリアルの構造対称性制御によるファノ共鳴励起	○(B) 原 修平 ¹ 、石川 篤 ^{1,2} 、田中 拓男 ^{2,3} 、鶴田 健二 ¹	1. 岡大工, 2. 理研, 3. 東工大
17:45	20p-S622-15	ナノフォーカスした表面プラズモンポラリトンによるピコ秒機械振動の増強光検出	○友田 基信 ^{1,2} 、Xiang Chen ² 、Oluwaseyi Balogun ²	1. 北大院工, 2. ノースウエスタン大
18:00	20p-S622-16	Ge ドープシリカ薄膜を誘電体層とする金属-誘電体-金属構造からの第二次高調波発生	○(M1) 姜 秉俊 ¹	1. 神戸大工
18:15	奨 20p-S622-17	アルミニウムの遠紫外表面プラズモン特性の屈折率依存性	○田邊 一郎 ¹ 、田中 嘉人 ² 、領木 貴之 ¹ 、渡利 幸治 ¹ 、後藤 剛喜 ¹ 、黄川田 昌和 ³ 、居波 涉 ³ 、川田 善正 ³ 、尾崎 幸洋 ¹	1. 関学理工, 2. 東大生研, 3. 静大院工
18:30	20p-S622-18	イオン液体を用いて合成したアルミニウムナノ粒子の Si 基板への固定化	○望月 俊成 ¹ 、長崎 秀昭 ¹ 、岩見 健太郎 ¹ 、牧 禎 ¹ 、田口 敦清 ² 、大野 弘幸 ¹ 、梅田 倫弘 ¹	1. 農工大工, 2. 阪大工
18:45	20p-S622-19	アルミニウム、インジウム、タンタルを用いた深紫外プラズモニクス	○西田 知旬 ¹ 、川元 駿 ¹ 、王 胖胖 ^{1,2} 、龍崎 奏 ¹ 、岡本 晃一 ¹ 、玉田 薫 ¹	1. 九大先導研, 2. 九大分子シスセ
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場		
	21p-P1-1	ナノサイズ円偏光生成のためのアパーチャーレスプローブの提案	○蔡 永福 ¹ 、石橋 隆幸 ¹	1. 長岡技科大
	奨 21p-P1-2	二探針走査型近接場光学顕微鏡を用いた超高速表面プラズモンの時間波形計測	○(M1) 小島 康裕 ¹ 、正木 雄太 ¹ 、神成 文彦 ¹	1. 慶大理工
	奨 21p-P1-3	フェムト秒表面プラズモン波束による平面型ナノキャビティの共鳴励起	○大竹 祐香 ¹ 、久保 敦 ¹ 、笠谷 岳士 ² 、宮崎 英樹 ²	1. 筑波大物理, 2. 物・材機構
	21p-P1-4	Si 上に形成した金ナノ円盤が示す表面電位差の照射依存性	○(B) 江崎 智太郎 ¹ 、松谷 晃宏 ² 、西岡 國生 ² 、庄 司 大 ² 、佐藤 美那 ² 、岡本 隆之 ³ 、磯部 敏宏 ¹ 、中島 章 ¹ 、松下 祥子 ¹	1. 東工大理工, 2. 東工大 MEMS, 3. 理研
	21p-P1-5	光磁界のみで励起された金スプリットリング共振器の磁気応答シミュレーション	○(M1) 松本 涼太 ¹ 、岡本 敏弘 ¹ 、原口 雅宣 ¹	1. 徳島大工
	21p-P1-6	サブ波長構造を有する Au 2 次元回折格子の作製と光学特性評価	○山田 泰士 ¹ 、元垣内 敦司 ^{1,3} 、三宅 秀人 ^{2,3} 、平松 和政 ^{1,3}	1. 三重大院工, 2. 三重大院地域イノベ, 3. 三重大極限ナノエレセンター
	21p-P1-7	プラズモニクブラッググレーティングの作製	○岡本 浩行 ¹ 、日下 晃佑 ¹ 、山口 堅三 ² 、鏡原 照正 ² 、原口 雅宣 ³ 、岡本 敏弘 ³	1. 阿南高専, 2. 香川大工, 3. 徳島大院
	21p-P1-8	ナノ周期構造中の固有モード共鳴を用いた高感度屈折率検出	○高島 祐介 ¹ 、原口 雅宣 ^{1,2} 、直井 美貴 ^{1,2}	1. 徳島大 ATS, 2. 徳島大 STS
	21p-P1-9	2 層型ワイヤグリッド偏光子の空間制御と光学特性評価	○(M1) 中嶋 智康 ¹ 、元垣内 敦司 ^{1,3} 、三宅 秀人 ^{2,3} 、平松 和政 ^{1,3}	1. 三重大院工, 2. 三重大院地域イノベ, 3. 三重大極限ナノエレセンター
	21p-P1-10	二重反射構造ポリマー導波路型クレッチマン配置表面プラズモン共鳴センサの二波長測定による高感度化と広測定域化	○黒田 康彰 ¹ 、丹所 祐貴 ¹ 、松島 裕一 ² 、石川 浩一 ¹ 、宇高 勝之 ¹	1. 早大理工, 2. GCS 機構
	21p-P1-11	金ナノロッドのプラズモン共鳴が二酸化バナジウムの相変化に及ぼす効果	○久保 若奈 ^{1,3} 、小形 陽介 ^{1,2} 、田中 拓男 ^{1,2,4}	1. 理研, 2. 学習院大, 3. 農工大, 4. 東工大
	21p-P1-12	SiC 上グラフェンに堆積した金ナノ粒子の SERS 効果	○松村 尚知 ¹ 、柳谷 伸一郎 ¹ 、古部 昭広 ¹ 、岸川 博紀 ¹ 、後藤 信夫 ¹ 、永瀬 雅夫 ¹	1. 徳島大工
	21p-P1-13	アゾポリマーナノ粒子の生成と光変形効果	○河合 慶太 ¹ 、豊田 慎也 ¹ 、新保 一成 ¹ 、大平 泰生 ¹	1. 新潟大学
	21p-P1-14	任意の電場を考慮した赤外吸収分光の理論計算手法の開発	○岩佐 豪 ^{1,2} 、竹中 将斗 ¹ 、武次 徹也 ^{1,2}	1. 北大理, 2. 京大 ESICB
	21p-P1-15	CuGaS ₂ /ZnS 系量子ドットの特性評価	○杉村 健太郎 ¹ 、長久保 準基 ² 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工, 2. アルバック
3.13 半導体光デバイス / Semiconductor optical devices				
3/20(Sun.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) S321 会場				
9:00	E 20a-S321-1	Temperature dependence of dark current characteristics of InAs/GaSb type-II superlattice photodiode	○Sundararajan Balasekaran ¹ 、Kouhei Miura ¹ 、Ken-ichi Machinaga ¹ 、Daisuke Kimura ¹ 、Takahiko Kawahara ¹ 、Masaki Migita ¹ 、Hiroshi Obi ¹ 、Nitta Toshiyuki ¹ 、Hiroshi Inada ¹ 、Yasuhiro Iguchi ¹ 、Tsukuru Katsuyama ¹	1. Transmission Devices Laboratory, Sumitomo Electric Industries, Ltd., Yokohama, Japan
9:15	20a-S321-2	電荷敏感型赤外光子検出器 (CSIP) における光カブラの研究	○金 鮮美 ¹ 、小宮山 進 ² 、林 冠廷 ¹ 、パトラシ ミカイル ³ 、梶原 優介 ¹	1. 東大生研, 2. 東大総工, 3. 情通研
9:30	20a-S321-3	フォトニク結晶構造を導入した薄膜型光検出器の検討	○顧 之チン ¹ 、井上 大輔 ¹ 、平谷 拓生 ¹ 、雨宮 智宏 ¹ 、西山 伸彦 ¹ 、荒井 滋久 ¹	1. 東工大
9:45	20a-S321-4	プロトン注入量子構造混晶化を用いた VCSEL の特性評価	○森脇 翔平 ¹ 、齋藤 季 ¹ 、宮本 智之 ¹	1. 東工大精研
10:00	20a-S321-5	Talbot 効果による面発光レーザーアレイ位相同期の波長分布の影響解析	○(M1) 小森 雄貴 ¹ 、宮本 智之 ¹	1. 東工大精密工学研究所
10:15	20a-S321-6	光無線給電に向けたトンネル接合破壊型 VCSEL アレイに関する検討	○押田 将平 ¹ 、須原 壮 ¹ 、宮本 智之 ¹	1. 東工大精研
10:30	20a-S321-7	面発光レーザーの単一モード出力増大に向けたスローライト SOA の増幅特性	○中濱 正統 ¹ 、顧 曉冬 ¹ 、坂口 孝浩 ¹ 、松谷 晃宏 ² 、小山 二三夫 ¹	1. 東工大 精研, 2. 東工大 技術部

10:45	20a-S321-8	VCSEL 構造を用いた高出力ソリッドステートビームスキャナ	○中濱 正統 ¹ 、顧 曉冬 ¹ 、坂口 孝浩 ¹ 、松谷 晃宏 ² 、1. 東工大精研、2. 東工大技術部 小山 二三夫 ¹
11:00	20a-S321-9	サブ波長格子を用いたアサーマル波長可変面発光レーザーの製作	○井上 俊也 ¹ 、中濱 正統 ¹ 、松谷 晃宏 ¹ 、坂口 孝浩 ¹ 、1. 東工大 1、小山 二三夫 ¹
11:15	奨 20a-S321-10	横方向結合共振器を用いた面発光レーザーの横モード制御	○小林 拓貴 ^{1,2} 、中濱 正統 ^{1,2} 、小山 二三夫 ^{1,2}
3/20(Sun.) 13:45 - 18:00	口頭講演 (Oral Presentation) S321 会場		
13:45	20p-S321-1	AIN 基板上深紫外 LED 光出力に対するチップ形状依存性の検討	○谷口 学 ^{1,3} 、Guo-Dong Hao ¹ 、中屋 晃成 ¹ 、溜 直樹 ² 、1. 情報通信研究機構、2.(株)トクヤマ、3. 神戸大院工、 井上 振一郎 ^{1,3,4} 、4.JST さきがけ
14:00	E 20p-S321-2	Analysis of Electrode Structure and Process for High-Power AlGaIn-based Deep-Ultraviolet Light-Emitting Diodes	○Guodong HAO ¹ 、Manabu Taniguchi ¹ 、Naoki Tamari ^{1,2} 、Shin-ichiro Inoue ^{1,3}
14:15	20p-S321-3	ウェハ接合により形成した結合共振器構造による二波長面発光レーザーの特性	○(M1) 太田 寛人 ¹ 、西村 信耶 ¹ 、渡邊 健吉 ¹ 、盧 翔孟 ¹ 、熊谷 直人 ¹ 、北田 貴弘 ¹ 、井須 俊郎 ¹
14:30	E 20p-S321-4	Enhanced Brightness from Ge Nanostructures Sensitized by CdTe/PbS QDs	○(P) Satish Laxman Shinde ¹ 、Li-Wei Nein ¹ 、S. Ishii ¹ 、T. Nagao ¹
14:45	20p-S321-5	ドット密度高密度化効果による障壁層薄膜化と量子ドットレーザーの高速変調動作実現	○影山 健生 ¹ 、ヴォクオック フィ ² 、渡邊 克之 ² 、1. 東大ナノ量子、2. 東大生研、3.QD レーザ 武政 敬三 ³ 、菅原 充 ³ 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
15:00	20p-S321-6	光周波数コムを用いた歪補償多重積層 InAsQD-SOA のパルス応答特性評価	○松本 敦 ¹ 、赤羽 浩一 ¹ 、坂本 高秀 ¹ 、梅沢 俊臣 ¹ 、1. 情通機構 菅野 敦史 ¹ 、山本 直克 ¹
15:15	20p-S321-7	方解石エタロンフィルタによる 2 波長レーザーの周波数間隔変化	○乾 勝貴 ¹ 、赤羽 浩一 ² 、山本 直克 ² 、菅野 敦史 ² 、1. 青学大、2.NICT 川西 哲也 ² 、外林 秀之 ¹
15:30	休憩 / Break		
15:45	奨 20p-S321-8	Si 基板上 GaInAsP/InP 薄膜 DFB レーザの高変調効率動作	○(D) 井上 大輔 ¹ 、平谷 拓生 ¹ 、福田 快 ¹ 、富安 高 ¹ 、1. 東工大電気電子、2. 東工大量子ナノ 弘 ¹ 、雨宮 智宏 ² 、西山 伸彦 ¹ 、荒井 滋久 ^{1,2}
16:00	奨 20p-S321-9	Si 基板上 GaInAsP/InP 薄膜 DFB レーザの初期信頼性	○福田 快 ¹ 、井上 大輔 ¹ 、平谷 拓生 ¹ 、雨宮 智宏 ² 、1. 東工大電気電子、2. 東工大量子ナノ 西山 伸彦 ¹ 、荒井 滋久 ^{1,2}
16:15	奨 20p-S321-10	表面回折格子を有する半導体薄膜 DBR レーザの光出力特性	○(DC) 平谷 拓生 ¹ 、井上 大輔 ¹ 、富安 高弘 ¹ 、福 田 快 ¹ 、瓜生 達也 ¹ 、雨宮 智宏 ² 、西山 伸彦 ¹ 、荒井 滋久 ^{1,2}
16:30	20p-S321-11	直接貼付 InP/Si 基板上 GaInAsP-InP ダブルヘテロレーザーの低温発振特性	○西山 哲央 ¹ 、松本 恵一 ¹ 、岸川 純也 ¹ 、鋤柄 俊樹 ¹ 、1. 上智大理工 大貫 雄也 ¹ 、鎌田 直樹 ¹ 、菅家 智一 ¹ 、下村 和彦 ¹
16:45	20p-S321-12	メタモルフィック成長を用いた中赤外帯域 type- I 型レーザーの構造検討	○(B) 吉元 圭太 ¹ 、今村 優雅 ¹ 、荒井 昌和 ¹
17:00	20p-S321-13	2 次元共振器半導体レーザーによる高速ビームスイッチ動作の提案	○福嶋 丈浩 ¹ 、坂口 浩一郎 ¹ 、徳田 安紀 ¹
17:15	20p-S321-14	EAM ゲートアレイを用いた分配選択型光スイッチモジュールの特性向上	○村中 勇介 ¹ 、瀬川 徹 ¹ 、小木曾 義弘 ¹ 、藤井 拓郎 ¹ 、1.NTT 先デ研 1、高橋 亮 ¹
17:30	20p-S321-15	マイクロリング共振器装荷型マッハ・ツェンダー 2x2 光スイッチの高速化に関する検討	○川口 直輝 ¹ 、堀 健人 ¹ 、荒川 太郎 ¹ 、國分 泰雄 ¹
17:45	20p-S321-16	InP 垂直結合型 2 次元光フェーズドアレイ素子設計	○福田 将治 ¹ 、小松 憲人 ¹ 、種村 拓夫 ¹ 、中野 義昭 ¹ 、1. 東大院工 1
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30	ポスター講演 (Poster Presentation) P2 会場		
21p-P2-1	21p-P2-1	半導体ナノ粒子分散 SiO ₂ 膜の形成と評価	○出村 洋智 ¹ 、Alexander Ulyashin ² 、永吉 浩 ¹
21p-P2-2	21p-P2-2	グラフェンのキャリア緩和過程のフェムト秒近赤外過渡吸収分光と温度依存性	○山田 淳史 ¹ 、久津間 保徳 ¹ 、金子 忠昭 ¹ 、玉井 尚 登 ¹
21p-P2-3	21p-P2-3	イオン注入を用いた多重積層量子ドット構造の混晶化の検討	○(B) 松井 信衛 ¹ 、武井 勇樹 ¹ 、松本 敦 ² 、赤羽 浩 ¹ 、1. 早大理工、2. 情報通信研究機構、3. 早大 GCS 機構 一 ² 、松島 裕一 ³ 、石川 浩 ¹ 、宇高 勝之 ¹
21p-P2-4	21p-P2-4	イオン注入と熱処理による多重積層量子ドット組成混晶の集積素子への応用の検討	○武井 勇樹 ¹ 、松井 信衛 ¹ 、松本 敦 ² 、赤羽 浩一 ² 、1. 早大理工、2. 情報通信研究機構、3. 早大 GCS 機構 松島 裕一 ³ 、石川 浩 ¹ 、宇高 勝之 ¹
E 21p-P2-5	21p-P2-5	Numerical Investigation on Electrically Pumped Metallic Cavity Lasers	○Chuanqing Yu ¹ 、Baifu Zhang ¹ 、Koh Chieda ¹ 、1.the Univ. of Tokyo Takuo Tanemura ¹ 、Yoshiaki Nakano ¹
21p-P2-6	21p-P2-6	分布反射器集積中赤外量子カスケードレーザーの開発	○古永 弘幸 ¹ 、橋本 順一 ¹ 、森 大樹 ¹ 、辻 幸洋 ¹ 、1. 住友電工 村田 誠 ¹ 、江川 満 ¹ 、猪口 康博 ¹ 、勝山 造 ¹
21p-P2-7	21p-P2-7	赤外イメージングによる量子ドットアレイセンサの評価	○黄 晨暉 ¹ 、田中 朋 ¹ 、各務 惣太 ^{1,3} 、角田 雅弘 ³ 、1.NEC スマエネ研、2.NEC もの統本、3. 東大ナノ量子 渡邊 克之 ⁴ 、井上 晴 ² 、難波 兼二 ² 、五十嵐 悠一 ^{1,3} 、機構、4. 東大生研 田能村 昌弘 ¹ 、南部 芳弘 ^{1,3} 、山本 剛 ^{1,3} 、萬 伸一 ^{1,3} 、 荒川 泰彦 ^{3,4}

CS.1 3.5 レーザー装置・材料と3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session

3/21(Mon.) 9:00 - 11:30	口頭講演 (Oral Presentation) S611 会場		
9:00	21a-S611-1	常温接合 Nd:YAG/ダイヤモンド複合構造レーザーの熱複屈折評価	○(B) 山口 頌木 ¹ 、奥山 洋平 ¹ 、市川 裕允 ¹ 、庄司 一郎 ¹ 、1. 中央大理工 一部 ¹
9:15	21a-S611-2	レーザーセラミックス接合技術の開発 - 真空熱処理による Yb:YAG セラミックスの光学特性の劣化 -	○持田 哲郎 ¹ 、藤岡 加奈 ¹ 、時田 茂樹 ¹ 、藤本 靖 ¹ 、1. 阪大レーザー研 宮永 憲明 ¹ 、河仲 準二 ¹
9:30	21a-S611-3	常温接合を用いたレーザー結晶と銅との直接接合	○安達 亮次 ¹ 、松井 鶴樹 ¹ 、庄司 一郎 ¹
9:45	21a-S611-4	水晶を用いた高強度光励起波長変換の検討	○石月 秀貴 ¹ 、平等 拓範 ¹
10:00	21a-S611-5	波長変換材料 LaBGeO ₅ の 2 次元非線形光学定数精密測定	○本多 勇介 ¹ 、河崎 進太 ¹ 、庄司 一郎 ¹
10:15	21a-S611-6	電圧印加による LaBGeO ₅ 周期分極反転構造作製の基礎検討	○沖野 行佑 ¹ 、梶原 敏明 ¹
10:30	21a-S611-7	MgO(8mol%) 添加 c-LiTaO ₃ 周期分極反転構造による 355nm 紫外光和周波発生	○岡 寿治 ¹ 、梶原 敏明 ¹
10:45	奨 21a-S611-8	周期空間反転 GaAs ホモ接合ダイオードの作製	○鈴木 涼介 ¹ 、松下 智紀 ^{1,2} 、近藤 高志 ^{1,2}
11:00	21a-S611-9	定比組成 LiNbO ₃ の電気光学定数精密測定	○中野 翔太 ¹ 、秋山 和己 ¹ 、庄司 一郎 ¹
11:15	21a-S611-10	圧力印加による高 Q 値結晶 WGM 共振器の周波数制御及び 2 次高調波発生	○(DC) 吉岐 航 ^{1,2} 、Werner Christoph ² 、Breunig Ingo ² 、Buse Karsten ²

3.14 光制御デバイス・光ファイバー / Optical control devices and optical fibers

3/20(Sun.) 13:30 - 15:30	ポスター講演 (Poster Presentation) P5 会場		
20p-P5-1	20p-P5-1	高効率 PPLN リッジ導波路波長変換デバイスの作製	○岸本 直 ^{1,2} 、小川 洋 ² 、関根 徳彦 ² 、笠松 章史 ² 、1. 沖電気工業、2. 情通機構 村井 仁 ¹
20p-P5-2	20p-P5-2	KTN 結晶を用いた光偏向の繰り返し再現特性	○佐々木 雄三 ¹ 、坂本 尊 ¹ 、上野 雅浩 ¹ 、豊田 誠治 ¹ 、1.NTT DIC 1、山口 城治 ¹

20p-P5-3	空間電荷を利用した $KTa_{1-x}Nb_2O_7$ の光弾性係数 p_{11} , p_{12} の測定	○今井 欽之 ¹ 、川村 宗範 ¹ 、阪本 匡 ¹	1.NTT デバイスイノベーションセンター
20p-P5-4	高出力 LED と太陽電池から成るパワーダイスターを用いたモーター制御	○岡本 研正 ¹	1.LBC コーポレーション
20p-P5-5	三原色合波器のための導波路型反射鏡の検討	田中 彩恵 ¹ 、中尾 慧 ¹ 、横川 修一 ¹ 、林口 翔子 ¹ 、 ○勝山 俊夫 ^{1,2} 、中島 清美 ³ 、池田 直樹 ³ 、杉本 喜正 ³	1. 福井大院工, 2. 福井大産学官連携本部, 3. 物材機構
20p-P5-6	三原色合波器のためのスポットサイズ変換器の検討	林口 翔子 ¹ 、田中 彩恵 ¹ 、横川 修一 ¹ 、中尾 慧 ¹ 、 ○勝山 俊夫 ^{1,2}	1. 福井大院工, 2. 福井大産学官連携本部
20p-P5-7	厚膜レジスト SU-8 を用いたスポットサイズコンバータ	○千日 拓馬 ¹ 、中島 悠人 ¹ 、雨宮 嘉照 ¹ 、田部井 哲夫 ¹ 、横山 新 ¹	1. 広大なノデバイス
20p-P5-8	磁気光学材料と Si 光共振器を用いた光スイッチ	○野田 和希 ¹ 、雨宮 嘉照 ¹ 、田部井 哲夫 ¹ 、横山 新 ¹	1. 広島大ナノデバイス
20p-P5-9	自己形成型プラスチック導波路の屈折率分布制御と伝搬損失の改善	○(M2) 平川 遼 ¹ 、山下 兼一 ¹ 、三谷 真利奈 ² 、石 樽 崇明 ²	1. 京工織大院工芸, 2. 慶應大院理工
20p-P5-10	中赤外用銀薄膜サブ波長多重格子構造偏光子	○樋口 翔吾 ¹ 、柿沼 洋 ¹ 、白石 和男 ¹ 、依田 秀彦 ¹ 、大野 泰司 ¹	1. 宇都宮大工
20p-P5-11	電気粘性流体中の音速測定: 光ファイバ型電界分布センシングの実現に向けて	○水野 洋輔 ¹ 、邱 惟 ¹ 、皆川 和成 ¹ 、林 寧生 ¹ 、中 村 健太郎 ¹	1. 東工大精研
20p-P5-12	エレクトロスプレー法を用いた POF アルカンセンサの改善	○(B) 中村 耀 ¹ 、鈴木 裕 ¹ 、森澤 正之 ¹	1. 山梨大院工
20p-P5-13	長距離光ファイバーを用いた高分解能温度センシング	○(M1) 田中 天翔 ¹ 、松倉 聖 ¹ 、石黒 敦己 ¹ 、和田 健司 ¹ 、松山 哲也 ¹ 、堀中 博道 ¹	1. 阪府大院・工
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S321 会場			
9:00	招 21a-S321-1 【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 超高速 BOCDR 法による実時間歪・温度分布測定	○水野 洋輔 ¹ 、林 寧生 ¹ 、福田 英幸 ¹ 、中村 健太郎 ¹	1. 東工大精研
9:15	21a-S321-2 熱湯を用いたプラスチック光ファイバのテーパ加工	○(M1) 氏原 大希 ¹ 、林 寧生 ¹ 、水野 洋輔 ¹ 、中村 健太郎 ¹	1. 東工大精研
9:30	21a-S321-3 参照光路を撤廃した簡素化 OADR	○関 誠 ¹ 、林 寧生 ¹ 、水野 洋輔 ¹ 、中村 健太郎 ¹	1. 東工大精研
9:45	21a-S321-4 偏波保持型 FBG ファブリック・ペロー干渉計と半導体レーザーの注入電流変調を用いた温度とひずみの同時計測	○和田 篤 ¹ 、田中 哲 ¹ 、高橋 信明 ¹	1. 防衛大
10:00	21a-S321-5 GI 数モードファイバ内 LPFG の広帯域モード変換に基づく透過型バンドパスフィルタ	○(M1) 木船 拓也 ¹ 、坂田 肇 ¹	1. 静岡大工
10:15	休憩 / Break		
10:30	21a-S321-6 GaInAsP/InP 導波路型 TE-TM モード変換器の波長特性の評価	○増山 圭 ¹ 、庄司 雄哉 ¹ 、水本 哲弥 ¹	1. 東工大
10:45	21a-S321-7 光方向性結合器における結合モード理論とモード間干渉の比較	○波多腰 玄一 ¹ 、伊賀 健一 ²	1. 早稲田大, 2. 東工大
11:00	21a-S321-8 微小リング共振器と導波路間の結合状態評価	○(M1) 小野 裕介 ¹ 、石野 雅章 ² 、岡本 亮 ¹ 、横山 士吉 ^{2,3} 、竹内 繁樹 ¹	1. 京大院工, 2. 九大院総理工, 3. 九大先導研
11:15	21a-S321-9 高次直列量子井戸マイクロリング波長選択フィルタの損失を考慮した伝搬行列法による設計と解析	○早坂 伸之 ¹ 、荒川 太郎 ¹ 、國分 泰雄 ¹	1. 横国大院工
11:30	奨 21a-S321-10 共振器集積導波モード共鳴フィルタの時間応答	○井上 純一 ¹ 、奥田 弘樹 ¹ 、裏 升吾 ¹	1. 京都工織大
11:45	奨 21a-S321-11 スローライト導波路アレイを用いた二次元ビーム掃引	○森 裕之 ¹ 、顧 曉冬 ¹ 、松谷 晃宏 ² 、小山 二三夫 ¹	1. 東工大精研, 2. 半導体プロセス技術センター
12:00	奨 21a-S321-12 液晶弾性とフリンジ電界が微小画素の光変調に及ぼす影響	○磯前 慶友 ¹ 、柴田 陽生 ¹ 、石鍋 隆宏 ¹ 、藤掛 英夫 ¹	1. 東北大院工
3/21(Mon.) 13:45 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) S321 会場			
13:45	21p-S321-1 積分球を使った有機発光素子の PL 測定	○乾 貴大 ¹ 、溝口 雄太 ¹ 、米田 拓也 ¹ 、笠原 健一 ¹ 、池田 直樹 ² 、大里 啓孝 ² 、杉本 喜正 ²	1. 立命館大理工, 2. 物質・材料研究機構
14:00	21p-S321-2 Metafilm: メタマテリアルを内包した有機薄膜フィルム	○雨宮 智宏 ^{1,3} 、金澤 徹 ¹ 、浦上 達宣 ² 、石川 篤 ^{3,4} 、北條 直也 ¹ 、安井 章雄 ¹ 、西山 伸彦 ¹ 、田中 拓男 ³ 、荒井 滋久 ¹	1. 東工大, 2. 三井化学, 3. 理研, 4. 岡大
14:15	21p-S321-3 有機薄膜集積回路	○雨宮 智宏 ¹ 、金澤 徹 ¹ 、平谷 拓生 ¹ 、顧 之琛 ¹ 、北條 直也 ¹ 、久能 雄輝 ¹ 、浦上 達宣 ² 、荒井 滋久 ¹	1. 東工大, 2. 三井化学
14:30	21p-S321-4 EO ポリマー装荷型ブラズモン変調器に向けたブラズモンスロット導波路の作製と評価	○北條 直也 ¹ 、雨宮 智宏 ¹ 、山田 千由美 ² 、山田 俊樹 ² 、西山 伸彦 ¹ 、大友 明 ² 、荒井 滋久 ¹	1. 東工大, 2. 情報通信機構
14:45	21p-S321-5 ドワン電子増強型 FTC 系 EO ポリマー変調モジュールの信頼性評価	○高野 真悟 ¹ 、石川 佳澄 ¹ 、伊藤 孝知 ¹ 、本谷 将之 ¹ 、日隈 薫 ¹ 、市川 潤一郎 ¹ 、横山 士吉 ² 、前田 大輔 ³ 、小澤 雅昭 ³ 、大友 明 ⁴	1. 住友大阪セメント, 2. 九大先導研, 3. 日産化学工業, 4. 情報通信研究機構
15:00	21p-S321-6 偏光操作を用いる光 2 トーン信号生成における安定性の向上	○千葉 明人 ¹ 、赤松 洋介 ¹ 、高田 和正 ¹	1. 群馬大院工
15:15	休憩 / Break		
15:30	21p-S321-7 アクティブ Y 分岐付き MZ 変調器の動作安定性	○市川 潤一郎 ¹ 、日隈 薫 ¹ 、山口 祐也 ² 、中島 啓幾 ² 、川西 哲也 ^{2,3}	1. 住友大阪セメント, 2. 早大理工, 3. 情通機構
15:45	21p-S321-8 低誘電率基板を用いた 60GHz 帯アンテナ電極電気光学変調器	池田 隆志 ¹ 、○井上 敏之 ¹ 、村田 博司 ¹ 、塩見 英久 ¹ 、岡村 康行 ¹ 、木谷 聡志 ² 、中林 誠 ² 、村田 和夫 ⁴ 、未成 信宏 ¹ 、○村田 博司 ¹ 、岡村 康行 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 住友電工プリントサーキット, 3. 住友電工フッポリマー, 4. 住友電工
16:00	21p-S321-9 メタサーフェス構造を用いた 100 GHz 帯電気光学無線 - 光変換デバイス		1. 阪大院基礎工
16:15	奨 21p-S321-10 マルチ QPM 素子による多重周波数混合を用いた複数搬送波発生	○中村 一貴 ¹ 、フン チャンナ ¹ 、遊部 雅生 ¹ 、梅木 毅何 ² 、竹ノ内 弘和 ²	1. 東海大工, 2.NTT 先端集積デバイス研
16:30	21p-S321-11 2 周期分極反転導波路型 Type-II 擬似位相整合ポストセレクションフリー偏波エンタングル光子対発生デバイスの量子干渉実験	○(M2) 渡辺 雄太 ¹ 、柘原 敏明 ¹	1. 阪大院工
3.15 シリコンフォトニクス / Silicon photonics			
3/20(Sun.) 10:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場			
10:00	奨 20a-S621-1 強磁性金属と誘電体界面における Otto 配置下の表面プラズモン励起の評価	○矢後 佳貴 ¹ 、安藤 健朗 ¹ 、森田 滯 ¹ 、清水 大雅 ¹	1. 農工大工
10:15	20a-S621-2 有機金属堆積法によるガラスおよびシリコン基板上への $Bi_2Y_1Fe_2O_{12}$ 薄膜の作製と評価	○細田 昌志 ¹ 、佐藤 譲 ¹ 、ダニシュ アブドゥルワヒド ¹ 、清水 大雅 ¹	1. 農工大工

10:30	20a-S621-3	スロット導波路の温度無依存性の検討	○兩宮 嘉照 ¹ 、サナ アムリタ クマル ¹ 、谷口 智哉 ¹ 、1. 広島大 横山 脩平 ¹ 、野田 和希 ¹ 、千日 拓馬 ¹ 、横山 新 ¹	
10:45	20a-S621-4	積層型 Si 方向性結合器の設計と作製	○山本 悠介 ¹ 、貝原 輝則 ¹ 、清水 大雅 ¹	1. 農工大
11:00		休憩 / Break		
11:15	20a-S621-5	マッハツェンダー干渉計内リング共振器構造による導波路型波長選択スイッチの特性解析	○三浦 謙悟 ¹ 、庄司 雄哉 ¹ 、水本 哲弥 ¹	1. 東工大
11:30	20a-S621-6	多層光回路に向けた層間伝送用トライデント型結合器の提案と実証	○(M1) 伊東 憲人 ¹ 、久能 雄輝 ¹ 、林 佑介 ¹ 、鈴木 純一 ¹ 、兩宮 智宏 ¹ 、西山 伸彦 ¹ 、荒井 滋久 ¹	1. 東工大
11:45	奨 20a-S621-7	ArF 液浸露光技術を用いた高効率 Si 細線グレーティングカプラ	○蘇武 洋平 ¹ 、鄭 錫煥 ¹ 、田中 有 ¹ 、森戸 健 ¹	1. 光電子融合基盤技術研究所
12:00	20a-S621-8	フリップチップ実装によるシリコン基板上多波長光源	○羽鳥 伸明 ¹ 、栗原 充 ¹ 、西沢 元亨 ¹ 、田中 有 ¹ 、森戸 健 ¹ 、蔵田 和彦 ¹	1. PETRA
3/20(Sun.) 13:45 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場				
13:45	E 20p-S621-1	Direct Modulation (6 Gbps) in Quantum Dot Lasers on Silicon	○YuanHsuan Jhang ¹ , Reio Mochida ² , Katsuaki Tanabe ^{2,3} , Keizo Takemasa ⁴ , Mitsuru Sugawara ⁴ , Satoshi Iwamoto ^{1,2} , Yasuhiko Arakawa ^{1,2}	1. IIS, The Univ. Tokyo, 2. NanoQuine, The Univ. Tokyo, 3. Kyoto Univ., 4. QD Laser, Inc
14:00	奨 20p-S621-2	Ge 導波路の光伝搬特性の偏光依存性	○奥村 忠嗣 ¹ 、小田 克矢 ¹ 、葛西 淳一 ¹ 、佐川 みずず ¹ 、諏訪 雄二 ¹	1. 日立研開
14:15	20p-S621-3	成長後アニールによる高濃度 n 型 Ge の発光増強	○(M1) 東垂水 直樹 ¹ 、和田 一実 ¹ 、石川 靖彦 ¹	1. 東大工
14:30	20p-S621-4	横方向エピタキシャル成長による Ge 導波路の結晶性改善	○小田 克矢 ¹ 、奥村 忠嗣 ¹ 、葛西 淳一 ¹ 、加古 敏 ² 、岩本 敏 ² 、荒川 泰彦 ²	1. 日立研開, 2. 東大生研・先端研
14:45	20p-S621-5	SiO ₂ 上横方向成長を用いた極低貫通転位密度 Ge 薄膜	○八子 基樹 ¹ 、和田 一実 ¹	1. 東大院工
15:00		休憩 / Break		
15:15	20p-S621-6	レーザーアニールを用いた Si 上 Ge pin フォトダイオードの高性能化 (2)	○永友 翔 ¹ 、菊田 真也 ² 、星野 聡彦 ² 、石川 靖彦 ¹	1. 東大院工, 2. 東京エレクトロン
15:30	20p-S621-7	Ge/SiGe ヘテロ接合アバランシェフォトダイオードの作製	○宮坂 祐司 ¹ 、開 達郎 ² 、岡崎 功太 ² 、土澤 泰 ² 、山本 剛 ² 、和田 一実 ¹ 、石川 靖彦 ¹	1. 東大工, 2. NTT 先端集積デバイス研
15:45	20p-S621-8	バットジョイント横 PIN 型 Ge 受光器の高速度動作特性	○下山 峰史 ¹ 、奥村 滋一 ¹ 、小野 英輝 ¹ 、今井 雅彦 ¹ 、田中 有 ¹ 、森戸 健 ¹	1. PETRA
16:00	20p-S621-9	伸張歪ゲルマニウムにおける共鳴電子ラマン遷移	○(M2) 松下 智昭 ¹ 、安武 裕輔 ^{1,2} 、揖場 聡 ³ 、齋藤 秀和 ³ 、湯浅 新治 ³ 、深津 晋 ¹	1. 東大院総合 (駒場), 2. JST さきがけ, 3. 産業技術総合研究所
16:15		休憩 / Break		
16:30	E 20p-S621-10	Theoretical analysis of optical gain in Ge _{1-x} Sn _x /Ge quantum well on Ge-on-Si substrates	○Guo-En Chang ¹	1. Nat. Chung Cheng Univ.
16:45	奨 20p-S621-11	ストレスライナーによる Ge 細線への一軸引張歪み印加とバンドギャップ変調	○田中 章吾 ¹ 、岡 博史 ¹ 、富永 幸平 ¹ 、天本 隆史 ¹ 、小山 真広 ¹ 、細井 卓治 ¹ 、志村 孝功 ¹ 、渡部 平司 ¹	1. 大阪大学
17:00	E 20p-S621-12	GeSn/Ge multiple-quantum-well short-wave infrared photoconductors on silicon	Shao-Wei Chen ¹ , Chia-Ho Tsai ¹ , Mao-Cheng Weng ¹	1. Nat. Chung Cheng Univ.
17:15	E 20p-S621-13	Photoluminescence from Ge _{0.92} Sn _{0.08} /Ge multiple-quantum-well on silicon substrates	Li-Chou Sun ¹ , ○Guo-En Chang ¹	1. Nat. Chung Cheng Univ.
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) S611 会場				
13:30	21p-S611-1	Si フォトニック結晶変調器における鋸歯形 p/n 接合	○寺田 陽祐 ¹ 、建部 知紀 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大院工
13:45	21p-S611-2	Si フォトニック結晶変調器の p-n 接合のドーピング濃度最適化	○(B) 建部 知紀 ¹ 、寺田 陽祐 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大
14:00	E 21p-S611-3	High-efficiency silicon optical modulator based on silicon-nitride-loaded SOI waveguide	○Guangwei Cong ¹ , Yuriko Maegami ¹ , Morifumi Ohno ¹ , Makoto Okano ¹ , Koji Yamada ¹	1. AIST
14:15	21p-S611-4	III-V CMOS フォトニクス・プラットフォーム上 空乏型 InGaAsP 光変調器の検討	○関根 尚希 ¹ 、韓 在勲 ^{1,2} 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 真一 ^{1,2}	1. 東大工, 2. JST-CREST
14:30	21p-S611-5	Si フォトニック結晶マッハツェンダー変調器における広い波長範囲での周波数応答調査	○鎌倉 陽介 ¹ 、寺田 陽祐 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大院工
14:45	21p-S611-6	Si フォトニック結晶 QPSK 変調器の零バイアス低電圧動作	○(M1) 北條 恵子 ¹ 、寺田 陽祐 ¹ 、鎌倉 陽介 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大工
15:00	奨 21p-S611-7	歪 SiGe を用いた MOS 型光変調器の変調帯域改善に関する検討	○(D) 韓 在勲 ^{1,2,3} 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 信一 ^{1,2}	1. 東大院工, 2. JST-CREST, 3. 学振特別研究員
15:15	21p-S611-8	in-situ B ドーピングした歪 SiGe 層を用いた Si 光変調器の検討	○藤方 潤一 ¹ 、野口 将高 ¹ 、韓 在勲 ² 、高橋 重樹 ¹ 、中村 隆宏 ¹ 、竹中 充 ²	1. PETRA, 2. 東大工
3/21(Mon.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P16 会場				
	21p-P16-1	最小限の膜厚ステップ領域を使用した AWG のロス低減構造	○岡山 秀彰 ^{1,2} 、太繩 陽介 ^{1,2} 、八重樫 浩樹 ^{1,2} 、佐々木 浩紀 ^{1,2}	1. 沖電気, 2. PETRA
	21p-P16-2	曲線型方向性結合器を用いたリング共振器偏光無依存性の検討	○横井 裕人 ¹ 、三橋 頼人 ¹ 、松島 裕一 ² 、石川 浩 ¹ 、宇高 勝之 ¹	1. 早大理工, 2. GCS 機構
	21p-P16-3	方向性結合器による高ダイナミックレンジ偏波スプリッタの設計	○中瀬 大志 ¹ 、丸山 武男 ¹	1. 金沢大
	E 21p-P16-4	Label Free Biosensor Based on Photonic Crystal Resonator	○(DC) Amrita Kumar Sana ¹ , Yoshiteru Amemiya ¹ , Shin Yokoyama ¹	1. Hiroshima Univ.
	E 21p-P16-5	Preparation and Characterization of Bi substituted gadolinium iron garnet (Bi _x Gd _{3-x} Fe ₅ O ₁₂ films with x=1 to 2.5 by Enhanced Metal Organic Decomposition method	○(D) AbdulWahid Danish ¹ , Jo Sato ¹ , Masashi Hosoda ¹ , Hiromasa Shimizu ¹	1. TUAT
	21p-P16-6	光変調器応用に向けたグラフェンスロット導波路の試作	○佐々木 和哉 ^{1,2} 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 信一 ^{1,2}	1. 東大院工, 2. JST-CREST
	21p-P16-7	シリコン MMI 導波路型 2 × 2 光スイッチの検討	○藤原 裕士 ¹ 、嶋田 裕介 ¹ 、石川 敦 ¹ 、松本 敦 ² 、松島 裕一 ³ 、石川 浩 ¹ 、宇高 勝之 ¹	1. 早大理工, 2. 情報通信研究機構, 3. 早大 GCS 機構
	21p-P16-8	直接貼付 InP/Si 基板上 InAs 量子ドットの成長	○(B) 鎌田 直樹 ¹ 、鋤柄 俊樹 ¹ 、西山 哲央 ¹ 、大貫 雄也 ¹ 、松本 恵一 ¹ 、下村 和彦 ¹	1. 上智理工
	21p-P16-9	ポリマー介在層付 Si 基板上への InP チップヘテロ接合の検討	○永井 秀樹 ¹ 、デン ボ ¹ 、松島 裕一 ² 、石川 浩 ¹ 、宇高 勝之 ¹	1. 早大理工, 2. 早大 GCS
	21p-P16-10	直接貼付 InP/Si 基板上結晶成長膜の接合強度および PL 強度の圧力依存性評価	○(B) 大貫 雄也 ¹ 、松本 恵一 ¹ 、岸川 純也 ¹ 、西山 哲央 ¹ 、鎌田 直樹 ¹ 、下村 和彦 ¹	1. 上智大理工
	21p-P16-11	円形マイクロブリッジ構造による GOI の二軸引っ張り歪み増強	○松下 奨 ¹ 、徐 学俊 ¹ 、澤野 憲太郎 ¹ 、丸泉 琢也 ¹	1. 都市大総研
	21p-P16-12	Ge 量子ドット /Si 界面への P デルタドーピングが発光特性とドット形成に与える影響	○渡邊 幸樹 ¹ 、徐 学俊 ¹ 、澤野 憲太郎 ¹ 、丸泉 琢也 ¹	1. 都市大総研

3.16 Optics and Photonics English Session			
3/19(Sat.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場			
9:00	E 19a-H116-1	Above MW Peak Power at 1 kHz from Microchip 266 nm Laser	Lihe Zheng ¹ , ○ Takunori Taira ¹ 1.Inst. for Mol. Sci.
9:15	奨 E 19a-H116-2	An all-optical method for determining temperature at the nanoscale via tip-enhanced THz-Raman spectroscopy	○ (P)Maria Balois ¹ , Norihiko Hayazawa ^{1,2} , Francesca Celine Catalan ² , Satoshi Kawata ³ , Takuo Tanaka ¹ , Taka-aki Yano ⁴ , Tomohiro Hayashi ⁴ 1.Innovative Photon Manipulation Research Team - RIKEN, 2.Surface and Interface Science Laboratory - RIKEN, 3.Osaka University, 4.Tokyo Institute of Technology
9:30	E 19a-H116-3	Spatiotemporal link in optical frequency comb for sub-micron axial resolution imaging of a meter-order depth object	○ (PC)Quang Duc Pham ¹ , Yoshio Hayasaki ¹ 1.Utsunomiya Univ.
9:45	奨 E 19a-H116-4	High-throughput optofluidic microparticle analyzer based on time-stretch imaging	○ (P)Cheng Lei ^{1,2} , Masashi Ugawa ¹ , Taisuke Nozawa ¹ , Dino Di Carlo ³ , Yasuyuki Ozeki ¹ , Keisuke Goda ^{1,3,4} 1.Univ. of Tokyo, 2.Tsinghua Univ., 3.UCLA, 4.JST
10:00	E 19a-H116-5	Terahertz Plasmonic Waveguides based on Metallic Rod Arrays	○ Borwen You ¹ , Ja-Yu Lu ² , Toshiaki Hattori ¹ 1.Univ. of Tsukuba, Japan, 2.NCKU, Taiwan
10:15	E 19a-H116-6	Self-sustained oscillation in nano-spring coupled optomechanical oscillator	○ (P)Feng Tian ^{1,2} , Hisashi Sumikura ^{1,2} , Eiichi Kuramochi ^{1,2} , Hideaki Taniyama ^{1,2} , Masato Takiguchi ^{1,2} , Masaya Notomi ^{1,2} 1.NTT Nanophotonics Center, 2.NTT Basic Research Laboratories
10:30	E 19a-H116-7	Twist Polarizer Metamaterial for Mid-Infrared Spectral Range	○ (D)Ihar Faniayeu ¹ , Vygantas Mizeikis ¹ 1.Shizuoka Univ.
10:45	E 19a-H116-8	Bidirectional metamaterial perfect absorbers	○ (P)Nguyen Thanh Tung ^{1,2} , Takuo Tanaka ¹ 1.Metamaterials Lab, RIKEN, Japan, 2.Vietnam Academy of Science and Technology, Vietnam
11:00	奨 E 19a-H116-9	Aluminum Infrared Perfect Absorbers for Wavelength Selective Devices	○ (P)Thang DAO ^{1,2} , Satoshi Ishii ^{1,2} , Kai Chen ^{1,2} , Takahiro Yokoyama ^{1,2} , Toshihide Nabatame ^{1,2} , Tadaaki Nagao ^{1,2,3} 1.International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA), National Institute for Materials Science (NIMS), 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan, 2.CREST, Japan Science and Technology Agency, 4-1-8 Honcho, Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan, 3.Department of Condensed Matter Physics, Graduate School of Science, Hokkaido University, Sapporo 060-0810, Japan
11:15	奨 19a-H116-10	Sunlight absorption with resonant silicon nanoparticles	○石井 智 ^{1,2} , チェン カイ ^{1,2} , スガヴァネシュワラム ^{1,2} , ダオ タン ^{1,2} , 長尾 忠昭 ^{1,2} 1. 物材機構, 2.JST-CERST
11:30	E 19a-H116-11	An all-optical three terminal device based on photo-excitation of magnetization	○ Hiro Munekata ¹ , Katsunori Takahashi ¹ , Kenta Iizuka ¹ , Yamato Iwasaki ¹ 1.ISEL Tokyo Tech.
11:45	奨 E 19a-H116-12	BOCDR assisted by the slope of Brillouin scattering spectrum	○ (M1)Heeyoung Lee ¹ , Neisei Hayashi ¹ , Yosuke Mizuno ¹ , Kentaro Nakamura ¹ 1.Tokyo Tech
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6 会場			
	E 20p-P6-1	Lanthanide ions for suppression of molecular photodamages under DUV biological imaging: pH dependency	○ (M2C)YauChuen YIU ¹ , Yasuaki KUMAMOTO ² , Atsushi TAGUCHI ¹ , Satoshi KAWATA ¹ 1.Department of Applied Physics, Osaka Univ., 2.Department of Pathology and Cell Regulation, Kyoto Prefectural Univ. of Medicine
	E 20p-P6-2	Performance analysis of optical frequency comb profilometry with a single pixel camera based on ghost imaging	○ (M1)Makhtar Nabila ¹ , Quang Duc Pham ¹ , Yasuhiro Mizutani ² , Yoshio Hayasaki ¹ 1.Utsunomiya Univ., 2.Osaka Univ.
	E 20p-P6-3	Effect of pump wavelength on Brillouin gain spectra in optical fibers	○ (M1)Heeyoung Lee ¹ , Neisei Hayashi ¹ , Yosuke Mizuno ¹ , Kentaro Nakamura ¹ 1.Tokyo Tech

6 薄膜・表面 / Thin Films and Surfaces

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

6.1 強誘電体薄膜 / Ferroelectric thin films

3/20(Sun.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場			
	20a-P1-1	極低温下における PZT 薄膜のリーク電流特性	○ (M1) 島 希 ¹ , 佐々木 敏夫 ² , 橋爪 洋一郎 ¹ , 中嶋 宇史 ¹ , 岡村 総一郎 ¹ 1. 東理大理, 2. 東北大金研
	20a-P1-2	チタン酸ジルコニウム酸鉛薄膜の強誘電分域のひずみイメージング	○ (B) 一番ヶ瀬 友哉 ¹ , 高田 啓二 ¹ 1. 関西大理工
	20a-P1-3	コンビナトリアルスパッタ法を用いた PMN-PZ-PT 薄膜の組成依存性評価	○寺元 卓也 ¹ , 黒川 文弥 ¹ , 辻浦 裕一 ¹ , 肥田 博隆 ¹ , 神野 伊策 ¹ 1. 神戸大工
	20a-P1-4	強誘電体インクジェット成膜に用いる吐出液の検討	松岡 勇汰 ¹ , ○山口 正樹 ^{1,2} , 増田 陽一郎 ³ 1. 芝浦工大, 2. 芝浦工大 RCGI, 3. 八戸工大
	20a-P1-5	BIT 系非鉛圧電材料のスパッタ薄膜形成と特性評価	○水嶋 英明 ¹ , 米久保 莊 ¹ , 工藤 賢一 ¹ , 西野 入隆 ² , 奥富 衛 ² , 児玉 泰史 ² , 水越 健輔 ² , 平林 明 ² 1. 長野県工技セ, 2. セラテックジャパン
	20a-P1-6	ラマン分光法を用いた BaTiO ₃ の酸素欠陥の評価	○福島 浩晃 ¹ , 岡 廣隆 ¹ , 神津 知己 ¹ , 舟窪 浩 ² , 内田 寛 ³ , 森分 博紀 ⁴ , 島 宏美 ¹ , 西田 謙 ¹ 1. 防衛大, 2. 東工大, 3. 上智大, 4. ファインセラミックセンター
	20a-P1-7	一軸延伸による強誘電性高分子の表面構造および残留分極値の変化	○福田 圭佑 ¹ , 宝田 隼 ¹ , 古川 昭雄 ¹ 1. 東理大理理工
	20a-P1-8	β -Ga ₂ O ₃ 単結晶基板上への (Hf,Zr)O ₂ 薄膜の成長	○高野 賢志 ¹ , 小前 智也 ¹ , 木口 拓也 ¹ , 野瀬 幸則 ¹ , 吉村 武 ¹ , 芦田 淳 ¹ , 藤村 紀文 ¹ 1. 大阪府大
	20a-P1-9	圧電型触覚センサのための BiFeO ₃ 薄膜の作製と評価	○河野 壯 ¹ , 三原 雅人 ¹ , 田辺 任 ¹ , 安部 隆 ¹ , 奥山 雅則 ² , 寒川 雅之 ¹ 1. 新潟工大, 2. 大阪工大
	20a-P1-10	靴における圧電発電の検討	○柿原 凌汰 ¹ , 苅谷 健人 ¹ , 松下 裕司 ¹ , 吉村 武 ¹ , 藤村 紀文 ¹ 1. 大阪府大院工
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W641 会場			
9:00	21a-W641-1	ナノシート界面層を利用した配向性 PZT 厚膜の作製	宮崎 竜斗 ¹ , ノノ瀬 大地 ² , 金 鑑雄 ³ , 島 宏美 ³ , 赤間 章裕 ⁴ , 木口 賢紀 ⁴ , 西田 謙 ³ , 金野 豊彦 ⁴ , 舟窪 浩 ² , ○内田 寛 ¹ 1. 上智大理工, 2. 東工大物創, 3. 防衛大, 4. 東北大金研
9:15	21a-W641-2	正方晶 / 菱面体晶 Pb(Zr _x Ti _{1-x})O ₃ 人工超格子薄膜における圧電応答の層厚依存性	○山田 智明 ^{1,2} , 海老原 洋平 ¹ , 坂田 修身 ^{3,4} , 森岡 仁 ⁵ , 木口 賢紀 ⁶ , 清水 莊雄 ⁴ , 舟窪 浩 ⁴ , 吉野 正人 ¹ , 長崎 正雅 ¹ 1. 名古屋大, 2.JST さきがけ, 3. 物質・材料研究機構, 4. 東工大, 5.BruckerAXS, 6. 東北大
9:30	奨 21a-W641-3	電界印加による面内分極軸優先配向 Pb(Zr,Ti)O ₃ 薄膜のドメイン構造変化	○一ノ瀬 大地 ¹ , 江原 祥隆 ¹ , 清水 莊雄 ¹ , 坂田 修身 ^{2,3} , 山田 智明 ^{4,5} , 舟窪 浩 ¹ 1. 東工大, 2.NIMS, 3.Spring-8, 4. 名大, 5.PRESTO

9:45	21a-W641-4	PZT 圧電薄膜の正圧電特性経時変化	○西 崇仁 ¹ 、辻浦 裕一 ¹ 、黒川 文弥 ¹ 、肥田 博隆 ¹ 、1. 神大工 神野 伊策 ¹
10:00	21a-W641-5	積層圧電薄膜の作製およびその実効的圧電特性評価	○山本 稜祐 ¹ 、黒川 文弥 ¹ 、辻浦 裕一 ¹ 、肥田 博隆 ¹ 、1. 神大工、2. 産総研 ¹ 、神野 伊策 ¹ 、牧本 なつみ ² 、小林 健 ²
10:15	21a-W641-6	化学溶液法によるピエゾ MEMS デバイス向け PZT 薄膜形成	○河原 正美 ¹ 、KIM SEUNG-HYUN ² 1.(株)高純度化学研、2.Brown 大
10:30	21a-W641-7	パルスポーリングが基板上および MEMS カンテレーバ 上 PZT 薄膜の圧電特性に与える影響	○小林 健 ¹ 、牧本 なつみ ¹ 1. 産総研
10:45		休憩 / Break	
11:00	奨 21a-W641-8	強誘電体薄膜のドメインダイナミクスと負のキャパシタ ンスの第一原理計算	○笠松 秀輔 ¹ 、渡邊 聡 ² 、Han Seungwu ³ 、Hwang Cheol Seong ³ 1. 東大物性研、2. 東大院工、3. ソウル大
11:15	21a-W641-9	SNDM 線形誘電率ナノイメージングにおける空間分解能 の数値解析	○平永 良臣 ¹ 、茅根 慎通 ¹ 、長 康雄 ¹ 1. 東北大通研
11:30	E 21a-W641-10	Hysteresis of the Electrostatic Potential of (GeTe) ₂ Sb ₂ Te ₃ Superlattice Grains Measured by Scanning Probe Spectroscopy	○Leonid Bolotov ¹ 、Tetsuya Tada ¹ 、Yuta Saito ¹ 、Junji Tominaga ¹ 1.AIST
11:45	奨 21a-W641-11	PLD 法による正方晶 (Bi,K)TiO ₃ エピタキシャル膜作製 と圧電特性評価	○根本 祐一 ¹ 、一ノ瀬 大地 ¹ 、清水 荘雄 ² 、内田 寛 3、舟窪 浩 ^{1,2} 1. 東工大総理工、2. 東工大元素、3. 上智大理工
12:00	21a-W641-12	Bi ₂ ZnTiO ₆ 薄膜の結晶構造とその誘電特性	○富永 健 ¹ 、北條 元 ¹ 、東 正樹 ¹ 1. 東工大 応セラ
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00		口頭講演 (Oral Presentation) W641 会場	
13:45	招 21p-W641-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 高濃度マンガンを置換二オプ酸リチウム薄膜の可視光起電 力特性評価	○犬塚 淳 ¹ 、高橋 秀輔 ¹ 、井上 亮太郎 ² 、野口 祐二 1、宮山 勝 ¹ 1. 東大院工、2. 日大医
14:00	21p-W641-2	(111)SrTiO ₃ 基板上への (Ba,La)SnO ₃ 薄膜の作製と特性 評価	○三浦 光平 ¹ 、山下 紘誉 ¹ 、小前 智也 ¹ 、吉村 武 ¹ 、1. 阪府大工 芦田 淳 ¹ 、藤村 紀文 ¹
14:15	奨 21p-W641-3	{110} 一軸配向ペロブスカイト型酸化物薄膜の作製と結晶 構造解析	○(B) 佐藤 智也 ¹ 、木村 純一 ² 、一ノ瀬 大地 ² 、三 村 和仙 ² 、舟窪 浩 ² 、内山 潔 ¹
14:30	21p-W641-4	電子強誘電体 YbFe ₂ O ₄ 薄膜の電子状態とその光吸収特性 への影響	○榎本 涼 ¹ 、吉村 武 ¹ 、芦田 淳 ¹ 、藤村 紀文 ¹ 1. 阪府大工
14:45	奨 21p-W641-5	BaTiO ₃ /SrRuO ₃ 光電変換デバイスの作製と特性評価	○朽名 和俊 ¹ 、松尾 拓紀 ¹ 、北中 佑樹 ¹ 、野口 祐二 1、宮山 勝 ¹ 1. 東大院工
15:00	21p-W641-6	Ba _{1-x} Ca _x TiO ₃ /ZnO ヘテロ接合の作製とバンド配置の解析	○後田 敦史 ¹ 、山田 裕明 ¹ 、小前 智也 ¹ 、吉村 武 ¹ 、1. 阪府大院工 藤村 紀文 ¹
15:15	21p-W641-7	チタン酸ジルコン酸バリウムナノキューブの合成とその 誘電特性	○三村 憲一 ¹ 、馬 強 ¹ 、加藤 一実 ¹ 1. 産総研
15:30		休憩 / Break	
15:45	奨 21p-W641-8	固相成長による配向制御した HfO ₂ 基強誘電体薄膜の作 製と特性評価	○三村 和仙 ¹ 、片山 きりは ¹ 、清水 荘雄 ² 、内田 寛 ³ 、1. 東工大総理工、2. 東工大元素、3. 上智大理工、4. 東北 木口 賢紀 ⁴ 、赤間 章裕 ⁴ 、今野 豊彦 ⁴ 、坂田 修身 ⁵ 、大金研、5.NIMS 舟窪 浩 ^{1,2}
16:00	奨 21p-W641-9	走査型非線形誘電率顕微鏡における強誘電性 Y:HfO ₂ 薄 膜のドメイン反転	○陳 舟 ¹ 、平永 良臣 ¹ 、清水 荘雄 ² 、片山 きりは ² 、1. 東北大通研、2. 東工大 三村 和仙 ² 、舟窪 浩 ² 、長 康雄 ¹
16:15	奨 21p-W641-10	k-Al ₂ O ₃ 型 Me _x Fe _{2-x} O ₃ エピタキシャル薄膜の構造と強誘 電性 (I)	○浜岸 容丞 ¹ 、安井 伸太郎 ¹ 、谷山 智康 ¹ 、清水 荘雄 ² 、1. 東工大応セラ研、2. 東工大元素戦略、3.JFCC、4. 東北 小西 綾子 ³ 、森分 博紀 ³ 、白石 貴久 ⁴ 、赤間 章裕 ⁴ 、大金研 木口 賢紀 ⁴ 、伊藤 満 ¹
16:30	21p-W641-11	k-Al ₂ O ₃ 型 Me _x Fe _{2-x} O ₃ エピタキシャル薄膜の構造と強誘 電性 (II)	○浜岸 容丞 ¹ 、安井 伸太郎 ¹ 、谷山 智康 ¹ 、清水 荘雄 ² 、1. 東工大応セラ研、2. 東工大元素戦略、3.JFCC、4. 東北 小西 綾子 ³ 、森分 博紀 ³ 、白石 貴久 ⁴ 、赤間 章裕 ⁴ 、大金研 木口 賢紀 ⁴ 、伊藤 満 ¹
16:45	21p-W641-12	巨大 c/a 相 Ga 置換 BiFeO ₃ 薄膜の作製と配向制御	○清水 啓佑 ¹ 、北條 元 ¹ 、東 正樹 ¹ 1. 東工大応セラ研
17:00	21p-W641-13	ITO/ シリカガラス基板上への BiFeO ₃ および ZnO/ BiFeO ₃ 薄膜の作製とその光起特性	○片山 丈嗣 ¹ 、林 幸老朗 ¹ 、○坂本 渉 ¹ 、余語 利信 ¹ 1. 名大未来研
17:15		休憩 / Break	
17:30	奨 21p-W641-14	BiFeO ₃ 系強誘電体薄膜の可視光下光起電力 -Gap-State Engineering による材料設計 -	○(DC) 松尾 拓紀 ¹ 、北中 佑樹 ¹ 、野口 祐二 ¹ 、宮 山 勝 ¹ 1. 東大院工
17:45	奨 21p-W641-15	正圧電応答における強誘電ドメインの寄与の解析	○菊谷 健人 ¹ 、荒牧 正明 ¹ 、吉村 武 ¹ 、藤村 紀文 ¹ 1. 阪府大院工
18:00	奨 21p-W641-16	遷移金属元素をドーブした単一ドメイン BiFeO ₃ 薄膜の 異常光起電力効果 (II)	○(M1) 高山 幸太 ¹ 、中嶋 誠二 ¹ 、藤沢 浩訓 ¹ 、清 水 勝 ¹ 1. 兵庫県立大学
18:15	21p-W641-17	室温マルチフェロイクス BiFeO ₃ 単結晶の磁気ドメイン の特性	○伊藤 利充 ¹ 、尾崎 康子 ¹ 、富岡 泰秀 ¹ 、徳永 将史 ¹ 1. 産総研、2. 東大物性研 2
18:30	E 21p-W641-18	Growth and electrical properties of BiFeO ₃ -(Bi _{1/2} Na _{1/2}) TiO ₃ thin films	○(D)JINHONG CHOI ¹ 、Takeshi Yoshimura ¹ 、 Norifumi Fujimura ¹ 1.Osaka Pref. Univ.
18:45	21p-W641-19	振動発電応用に向けた BiFeO ₃ 厚膜の作製	○荒牧 正明 ¹ 、菊谷 健人 ¹ 、吉村 武 ¹ 、村上 修一 ² 、1. 阪府院工、2. 阪府産技研 藤村 紀文 ¹
6.2 カーボン系薄膜 / Carbon-based thin films			
3/19(Sat.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H103 会場			
13:15	奨 19p-H103-1	CVD ダイヤモンドの成長モード制御による高配向 NV セ ンターの高密度化	○小澤 勇斗 ^{1,2} 、田原 康佐 ^{1,2} 、石綿 整 ^{1,2} 、岩崎 孝之 ^{1,2} 、1. 東工大、2.CREST 波多野 睦子 ^{1,2}
13:30	19p-H103-2	NV センターの形成効率の熱処理温度依存性	○(M2) 春山 盛善 ^{1,2} 、小野田 忍 ² 、立見 和雅 ¹ 、寺 1. 群馬大理工、2. 原子力機構、3. 物材機構、4. 筑波大学 地 徳之 ³ 、磯谷 順一 ⁴ 、加田 渉 ¹ 、大島 武 ² 、花泉 修 ¹
13:45	奨 19p-H103-3	高配向 NV センター デルタドープ薄膜の形成	○石綿 整 ^{1,2} 、田原 康佐 ^{1,2} 、小澤 勇斗 ^{1,2} 、岩崎 孝之 ^{1,2} 、1. 東工大、2.CREST 波多野 睦子 ^{1,2}
14:00	奨 19p-H103-4	ダイヤモンド粒子中に形成した GeV センターの発光特性	○島本 祐輔 ¹ 、岩崎 孝之 ^{1,2} 、須藤 健瑠 ^{1,2} 、波多野 睦子 ^{1,2} 、小田 俊理 ^{1,3} 1. 東工大、2.CREST、3. 東工大量子ナノエレ研セ
14:15	奨 19p-H103-5	NV センターを用いたダイヤモンドデバイス内部電界の 検出	○(M2) 成木 航 ^{1,3} 、岩崎 孝之 ^{1,3} 、田原 康佐 ^{1,3} 、加 1. 東工大、2. 産総研、3.CREST 藤 宙光 ^{2,3} 、牧野 俊晴 ^{2,3} 、小倉 政彦 ^{2,3} 、竹内 大輔 ^{2,3} 、 山崎 聡 ^{3,2} 、波多野 睦子 ^{1,3}
14:30	19p-H103-6	nin 構造を用いたダイヤモンド NV 中心の電荷状態制御	○村井 拓哉 ¹ 、牧野 俊晴 ^{2,3} 、加藤 宙光 ^{2,3} 、土井 悠生 ¹ 、1. 阪大基礎工、2. 産総研、3.CREST、4. 東工大、5. 東京 鈴木 義茂 ¹ 、波多野 睦子 ^{3,4} 、山崎 聡 ^{2,3} 、清水 麻希 理科大、6. 京大化研 3,5、水落 憲和 ^{1,3,6}

14:45	19p-H103-7	ダイヤモンド nin 接合における NV センタの電荷状態の制御	○清水 麻希 ^{1,2} 、牧野 俊晴 ^{2,3} 、Amici Renato Goes ⁴ 、岩崎 孝之 ^{2,4} 、長谷川 淳一 ⁴ 、田原 康佐 ⁴ 、成木 航 ⁴ 、加藤 宙光 ³ 、竹内 大輔 ³ 、山崎 聡 ^{2,3} 、波多野 睦子 ^{2,4}	1. 東理大理, 2. CREST, 3. 産総研, 4. 東工大
15:00	奨 19p-H103-8	表面終端による浅い NV センターの電荷状態	○(B)加藤 かなみ ¹ 、山野 颯 ¹ 、蔭浦 泰資 ¹ 、瀬下 裕志 ¹ 、稲葉 優文 ¹ 、東又 格 ¹ 、小池 悟大 ¹ 、谷井 孝至 ¹ 、磯谷 順一 ² 、寺地 徳之 ³ 、小野田 忍 ⁴ 、春山 盛善 ⁵ 、加田 涉 ⁵ 、花泉 修 ⁵ 、川原田 洋 ¹	1. 早稲田大学, 2. 筑波大学, 3. 物質・材料研究機構, 4. 日本原子力研究開発機構, 5. 群馬大学
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 19p-H103-9	磁気センサー応用に向けた単一の NV センターの作製と状態の評価	○(B)山野 颯 ¹ 、加藤 かなみ ¹ 、蔭浦 泰資 ¹ 、稲葉 優文 ¹ 、東又 格 ¹ 、小池 悟大 ¹ 、春山 盛善 ^{2,4} 、谷井 孝至 ¹ 、小野田 忍 ² 、寺地 徳之 ³ 、加田 涉 ⁴ 、花泉 修 ⁴ 、磯谷 順一 ⁵ 、川原田 洋 ¹	1. 早稲田大, 2. 原子力機構, 3. 物材機構, 4. 群馬大, 5. 筑波大
15:45	19p-H103-10	ダイヤモンド中の NV センタを用いた静磁場イメージング	○水野 皓介 ¹ 、田原 康佐 ^{1,3} 、成木 航 ^{1,3} 、岩崎 孝之 ¹ 、関口 武治 ² 、原田 慶恵 ^{2,3} 、波多野 睦子 ^{1,3}	1. 東工大, 2. 京都大, 3. JST-CREST
16:00	奨 19p-H103-11	高配向・高密度 NV センタアンサンブルを用いた交流磁場測定	○(D)田原 康佐 ^{1,2} 、小澤 勇斗 ^{1,2} 、岩崎 孝之 ^{1,2} 、波多野 睦子 ^{1,2}	1. 東工大, 2. JST-CREST
16:15	19p-H103-12	ダイヤモンドの NV センターを用いる超高感度 NMR	○磯谷 順一 ¹ 、角谷 均 ² 、Scheuer Jochen ³ 、Schwartz Ilai ³ 、Chen Qiong ³ 、Schulze-Suenninghausden David ¹ 、Carl Patrick ⁵ 、Hoefer Peter ⁵ 、Retzker Alexander ⁶ 、Luy Burkhard ⁴ 、Plenio Martin ³ 、Naydenov Boris ³ 、Jelezko Jelezko ³	1. 筑波大, 2. 住友電工, 3. ウルム大, 4. カールスルーエ大, 5. プルカー, 6. ヘプライ大
16:30		休憩 / Break		
16:45	奨 19p-H103-13	高耐圧・高電流密度を有するノーマリオフ C-H ダイヤモンド MOSFET	○(B)工藤 拓也 ¹ 、北林 祐哉 ¹ 、山田 哲也 ¹ 、許 徳琛 ¹ 、齋藤 俊輝 ¹ 、松村 大輔 ¹ 、林 佑哉 ¹ 、瀬下 裕志 ¹ 、平岩 篤 ¹ 、川原田 洋 ¹	1. 早大理工
17:00	奨 19p-H103-14	C-H 多結晶ダイヤモンド MOSFET への高電圧印加による電流特性変化	○(M1)牛 俊雄 ¹ 、許 徳琛 ¹ 、山田 哲也 ¹ 、北林 祐哉 ¹ 、齋藤 俊輝 ¹ 、柴田 将暢 ¹ 、松村 大輔 ¹ 、工藤 拓也 ¹ 、稲葉 優文 ¹ 、平岩 篤 ¹ 、川原田 洋 ¹	1. 早大理工
17:15	奨 19p-H103-15	縦型構造トレンチチャネル C-H ダイヤモンド MOSFET(II)	○(B)牟田 翼 ¹ 、齋藤 俊輝 ¹ 、工藤 拓也 ¹ 、北林 祐哉 ¹ 、松村 大輔 ¹ 、牛 俊雄 ¹ 、稲葉 優文 ¹ 、平岩 篤 ¹ 、川原田 洋 ¹	1. 早大理工
17:30	奨 19p-H103-16	ゲート型ダイヤモンド電解質溶液ゲート FET の電流電圧特性	○(B)五十嵐 圭為 ¹ 、檜村 卓朗 ¹ 、モフドスクリ シャイリ ¹ 、稲葉 優文 ¹ 、新谷 幸弘 ^{1,2} 、平岩 篤 ¹ 、川原田 洋 ¹	1. 早大理工, 2. 横河電機
17:45	19p-H103-17	強誘電体をゲート絶縁膜としたダイヤモンド表面チャネル型 FET 構造の作製(2)	柄谷 涼太 ¹ 、古市 浩幹 ¹ 、馬場 一気 ¹ 、森 陽介 ¹ 、中嶋 宇史 ² 、徳田 規夫 ¹ 、○川江 健 ¹	1. 金沢大, 2. 東京理科大
18:00	E 19p-H103-18	High-k TiO ₂ Films Deposition on Hydrogenated-diamond	○Jiangwei LIU ¹ 、Meiyong Liao ¹ 、Masataka Imura ¹ 、Banal Ryan ¹ 、Yasuo Koide ¹	1. NIMS
18:15	19p-H103-19	ダイヤモンド表面の SO ₂ ホルダービングの実時間測定	○(PC)花田 賢志 ¹ 、嘉数 誠 ¹	1. 佐賀大
18:30	19p-H103-20	シンクロトロン X 線トポグラフィによる低欠陥密度高温高压合成ダイヤモンド(111)単結晶の積層欠陥観察	○榎谷 聡士 ¹ 、森林 明也 ¹ 、花田 賢志 ¹ 、角谷 均 ² 、嘉数 誠 ¹	1. 佐賀大院工, 2. 住友電工アドバンスマテリアル研究所
18:45	奨 19p-H103-21	シンクロトロン X 線トポグラフィによる低欠陥密度高温高压合成(110)ダイヤモンド単結晶の積層欠陥の部分転位観察	○榎谷 聡士 ¹ 、森林 朋也 ¹ 、花田 賢志 ¹ 、角谷 均 ² 、嘉数 誠 ¹	1. 佐賀大院工, 2. 住友電工アドバンスマテリアル研究所
3/20(Sun.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) H103 会場				
9:00	E 20a-H103-1	Diamond growth perturbed by high TMB partial pressures	○(PC)Alexandre FIORI ¹ 、Tokuyuki TERAJI ¹	1. NIMS
9:15	20a-H103-2	ヘテロエピタキシャルダイヤモンド下地を用いたホウ素添加ダイヤモンド成長および電気化学測定	○伊藤 誠人 ¹ 、児玉 英之 ¹ 、渡辺 剛志 ² 、栄長 泰明 ² 、鈴木 一博 ² 、澤邊 厚仁 ¹	1. 青学大理工, 2. 慶應大理工, 3. トウラスエンジニアリング
9:30	20a-H103-3	ホウ素添加ナノ多結晶ダイヤの開発と基礎特性	○池田 和寛 ¹ 、角谷 均 ¹	1. 住友電気工業株式会社
9:45	20a-H103-4	{111} リンドープダイヤモンド薄膜成長のオフ角依存性 II	○小泉 聡 ¹ 、山本 卓 ¹ 、大谷 亮太 ¹ 、Janssens Stoffel ¹	1. 物材機構
10:00	20a-H103-5	固体挿入プラズマ CVD 法による Bi を含む新規炭素系物質の合成	○(D)田村 貴大 ¹ 、柳瀬 隆 ² 、長浜 太郎 ² 、島田 敏宏 ²	1. 北大院総化, 2. 北大院工
10:15	20a-H103-6	大面積ダイヤモンド基板上への合成における Ar 導入効果	○山田 英明 ¹ 、茶谷原 昭義 ¹ 、李野 由明 ¹	1. 産総研
10:30	20a-H103-7	酸素添加条件で成長したホモエピタキシャルダイヤモンド(100)薄膜中の欠陥評価	○寺地 徳之 ¹ 、渡邊 賢司 ¹	1. 物材機構
10:45		休憩 / Break		
11:00	奨 20a-H103-8	格子状核発生領域を用いたダイヤモンドのヘテロエピタキシャル成長 II	○市川 公善 ¹ 、児玉 英之 ¹ 、鈴木 一博 ² 、澤邊 厚仁 ¹	1. 青学大理工, 2. トウラスエンジニアリング
11:15	奨 20a-H103-9	高密度プラズマによる 3C-SiC/Si 上のダイヤモンド核配向性の向上	○矢板 潤也 ^{1,2} 、岩崎 孝之 ^{1,2,3} 、Natal Meralys ⁴ 、Saddow Stephen ⁴ 、波多野 睦子 ^{1,2,3}	1. 東京工業大学, 2. CREST, 3. ALCA, 4. 南フロリダ大学
11:30	奨 20a-H103-10	パルスバイアス核形成法を用いた 3C-SiC(111)/Si(111)上への高配向ダイヤモンドの合成	○須藤 建福 ^{1,2} 、矢板 潤也 ^{1,2} 、岩崎 孝之 ^{1,2,3} 、波多野 睦子 ^{1,2,3}	1. 東工大院, 2. CREST, 3. ALCA
11:45	奨 20a-H103-11	同軸型アークプラズマ堆積法により作製した窒素添加超ナノ微結晶ダイヤモンド / アモルファスカarbon混相膜の微細構造評価	○(DC)儀間 弘樹 ¹ 、アプデルラーマン ゼクリア ^{1,2} 、吉武 剛 ¹	1. 九大, 2. アスワン大
3/20(Sun.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H103 会場				
13:15	20p-H103-1	ダイヤモンド同位体超格子における詳細な格子振動	○坂東 優樹 ¹ 、齋藤 晋 ¹	1. 東工大理
13:30	奨 20p-H103-2	ボロンドープダイヤモンド超伝導量子干渉計の作製に向けたジョセフソン接合の直流、交流ジョセフソン効果の観測	○日出幸 昌邦 ¹ 、蔭浦 泰資 ¹ 、柴田 将暢 ¹ 、北林 祐哉 ¹ 、笹間 陽介 ² 、山口 尚秀 ² 、高野 義彦 ² 、川原田 洋 ¹	1. 早大理工, 2. 物材機構
13:45	20p-H103-3	バイポーラモード動作ノーマリオフダイヤモンド JFET の高温特性	○岩崎 孝之 ^{1,2,3} 、加藤 宙光 ^{3,4} 、牧野 俊晴 ^{3,4} 、小倉 政彦 ^{3,4} 、竹内 大輔 ^{3,4} 、山崎 聡 ^{3,4} 、波多野 睦子 ^{1,2,3}	1. 東工大, 2. ALCA, 3. CREST, 4. 産総研
14:00	20p-H103-4	縦型ダイヤモンド JFET の作製	○諏訪 泰介 ¹ 、岩崎 孝之 ^{1,2,3} 、加藤 宙光 ^{3,4} 、牧野 俊晴 ^{3,4} 、小倉 政彦 ^{3,4} 、竹内 大輔 ^{3,4} 、山崎 聡 ^{3,4} 、波多野 睦子 ^{1,2,3}	1. 東工大, 2. ALCA, 3. CREST, 4. 産総研

14:15	E 20p-H103-5	Reverse-Recovery in Diamond PIN diodes	○(PC)Aboulaye Traore ¹ , Akira Nakajima ¹ , Toshiharu Makino ^{1,2} , Daisuke Kuwabara ^{1,2,3} , Hiromitsu Kato ^{1,2} , Satoshi Yamasaki ^{1,2,3}	1.AIST, 2.CREST/AIST, 3.Univ. of Tsukuba
14:30	E 20p-H103-6	Energy Dissipation in Single Crystal Diamond Mechanical Resonators	○Meiyong Liao ¹ , Masaya Toda ² , Liwen Sang ¹ , Masataka Imura ¹ , Shunich Hishita ¹ , Shuji Tanaka ² , Yasuo Koide ¹	1.NIMS, 2.Tohoku Uni.
14:45		休憩/Break		
15:00	奨 20p-H103-7	NEXAFS 法と固体 NMR 法による DLC 膜の sp ³ /(sp ³ +sp ²) 比率の定量分析	○(D)周小龍 ¹ 、Tunmee Sarayut ¹ 、鈴木 常生 ¹ 、河原 成元 ¹ 、神田 一浩 ² 、Phothongkam Pat ³ 、中島 秀樹 ³ 、小松 啓志 ¹ 、齋藤 秀俊 ¹	1.長岡技科大、2.兵庫県立大、3. 泰国シンクロトン光研究所
15:15	20p-H103-8	熱 CVD アモルファスカーボンの低温成膜技術	○渡邊 要介 ¹	1.東京エレクトロン
15:30	奨 20p-H103-9	ta-C/ダイヤモンド膜のカロテスト摩耗試験	○(M1)今井 貴大 ¹ 、藤井 裕真 ¹ 、山野 将史 ¹ 、針谷 達 ¹ 、須田 善行 ¹ 、滝川 浩史 ¹ 、神谷 雅男 ² 、瀧 真 ³ 、長谷川 祐史 ³ 、辻 信広 ³	1.豊橋技科大、2.伊藤光学工業、3. オンワード技研
15:45	20p-H103-10	DLC 膜のはく離評価への AE 法の適応	○大花 継頼 ¹ 、間野 大樹 ¹ 、中村 拳子 ²	1.産総研製造技術 RI、2.産総研先進コーティング RC
16:00	奨 20p-H103-11	軟 X 線照射による Si 含有水素化 DLC 膜の膜改質	○(MIC)田中 祥太郎 ¹ 、長谷川 孝行 ^{1,2} 、岡田 真 ¹ 、松井 真二 ¹ 、神田 一浩 ¹	1.兵衛大高度研、2.合同会社シンクロトンアナリシス LLC
16:15	奨 20p-H103-12	フッ素化 DLC 薄膜表面への軟 X 線照射による機能性変化	○(MIC)高松 大樹 ^{1,2} 、新部 正人 ^{1,2} 、神田 一浩 ^{1,2}	1.兵庫県大工、2.高度研
16:30	20p-H103-13	ナノ構造アモルファスカーボン膜を用いた水分離膜	○北野 宏樹 ^{1,2} 、Josue Ortiz-Medina ² 、Aaron Morelos-Gomez ² 、林 卓也 ^{2,3} 、竹内 健司 ^{2,3} 、藤重 雅嗣 ³ 、山口 晃生 ^{1,2} 、遠藤 守信 ^{2,3}	1.北川工業株式会社、2.信州大学 アクア・イノベーション拠点 (COD)、3.信州大学 カーボン科研
16:45	奨 20p-H103-14	水溶性犠牲層溶解法で作製した自立スーパー DLC 薄膜へのレーザ照射	○針谷 達 ¹ 、宮本 優 ¹ 、山野 将史 ¹ 、須田 善行 ¹ 、滝川 浩史 ¹ 、河野 剛士 ¹ 、神谷 雅男 ² 、瀧 真 ³ 、長谷川 祐史 ³ 、辻 信広 ³ 、西内 満美子 ⁴ 、榊 泰直 ⁴ 、近藤 公伯 ⁴ 、金子 智 ⁵	1.豊橋技科大、2.伊藤光学、3. オンワード技研、4.原子力機構、5. 神奈川産技センター
17:00		休憩/Break		
17:15	奨 20p-H103-15	トリメチルボラジンからの a-BCN 膜の作製	○河越 奈沙 ¹ 、山本 哲也 ² 、中野 雅之 ³ 、岩本 喜直 ¹ 、松尾 誠 ¹ 、稗田 純子 ¹ 、大竹 尚登 ¹ 、赤坂 大樹 ¹	1.東工大、2.日本触媒、3.東京高専、4.i-Motto
17:30	20p-H103-16	大気圧窒素プラズマを用いた窒化炭素の合成、評価	○財部 健一 ¹ 、平井 正明 ¹ 、藤野 拓真 ¹ 、安井 望 ¹	1.岡山理科大
17:45	20p-H103-17	グラファイト 状窒化炭素薄膜の合成温度による影響	○羽瀨 仁恵 ¹ 、藤田 詩織 ¹ 、堀江 弘将 ¹ 、滝川 浩史 ¹	1.岐阜高専、2.豊橋技科大
18:00	20p-H103-18	光電子分光法を用いた N-doped a-C の電荷状態の解析	○(D)村田 悠馬 ¹ 、市原 文彦 ¹ 、中山 廉平 ¹ 、小野 洋 ¹ 、チュウ チャオキョン ² 、桑原 大介 ¹ 、田中 勝己 ¹	1.電通大先進理工、2.電通大国際交流
18:15	20p-H103-19	Al 膜上に堆積した SiO ₂ /a-CN _x :H 多層膜からの電界電子放出	○木下 治久 ¹ 、村山 翼 ¹ 、松本 健 ¹	1.静大院工
18:30	奨 20p-H103-20	スパッタ法により作製したアモルファス窒化炭素薄膜における投入電力の影響とその光誘起変形	○原田 人萌 ¹ 、青野 祐美 ¹ 、北沢 信章 ¹ 、渡邊 芳久 ¹	1.防大材料
18:45	20p-H103-21	ポリマー状炭素粉末の水吸着特性	○久保 暢也 ¹ 、荒川 悟 ¹ 、サラユット トゥンミー ¹ 、周小龍 ¹ 、小松 啓志 ¹ 、齋藤 秀俊 ¹	1.長岡技科大
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場		
	21p-P3-1	水素終端ダイヤモンド (001) 表面の金オーミック電極の障壁高さ	○河野 省三 ¹ 、寺地 徳之 ² 、竹内 大輔 ³ 、小倉 政彦 ³ 、児玉 英之 ¹ 、澤邊 厚仁 ¹	1.青学大理工、2.物材機構、3.産総研
	21p-P3-2	水素終端ダイヤモンド表面伝導層上の金オーミック電極の電気的特性	○河野 省三 ¹ 、稲葉 優文 ² 、平岩 篤 ¹ 、川原田 洋 ^{1,2}	1.早大ナノ・ライフ、2.早大理工
	21p-P3-3	分散化した高濃度ホウ素ドーピング縮退 CVD ダイヤモンド多層膜構造のマクロスコピックな半導体特性	○田淵 智大 ¹ 、毎田 修 ¹ 、伊藤 利道 ¹	1.阪大工
	21p-P3-4	微細構造を有する CVD ダイヤモンド検出器の keV 電子の検出特性	○清水 彰人 ¹ 、毎田 修 ¹ 、伊藤 利道 ¹	1.阪大工
	21p-P3-5	n 型ダイヤモンド薄膜およびダイヤモンドデバイスの耐 X 線・γ 線特性	○大谷 亮太 ¹ 、廖 梅勇 ¹ 、上野 克宜 ² 、佐々木 敬介 ² 、田所 孝広 ² 、坪田 雅功 ³ 、金子 純一 ³ 、小泉 聡 ¹	1.物材機構、2.日立製作所、3.北大
	21p-P3-6	高温高圧合成ナノ多結晶ダイヤモンドの基礎物性評価	○石川 晃啓 ¹ 、濱田 幸佑 ¹ 、石川 史太郎 ¹ 、松下 正 ¹ 、大藤 弘明 ² 、新名 亨 ² 、入船 徹男 ²	1.愛媛大学院理工、2.愛媛大学 GRC
	21p-P3-7	マイクロ波プラズマ CVD 法による DLC 積層 Si 基板上での多結晶ダイヤモンド成長	○品川 友宏 ¹ 、古畑 武夫 ¹ 、山林 弘也 ¹ 、仲村 恵右 ¹ 、山田 英明 ² 、山向 幹雄 ¹	1.三菱電機、2.産総研
	21p-P3-8	マイクロ波プラズマ CVD 法による多結晶ダイヤモンド成長における Si 基板上への Si 薄膜の挿入	○古畑 武夫 ¹ 、品川 友宏 ¹ 、山林 弘也 ¹ 、仲村 恵右 ¹ 、山田 英明 ² 、山向 幹雄 ¹	1.三菱電機、2.産総研
	奨 21p-P3-9	光電子分光法による B ドープ超ナノ微結晶ダイヤモンド / 水素化アモルファスカーボン混相膜のショットキー障壁高さ評価	○(DC)花田 尊徳 ¹ 、大曲 新矢 ² 、竹市 悟志 ¹ 、吉武 剛 ¹	1.九大総理工、2.産総研
	奨 21p-P3-10	ホウ素ドーピング超ナノ微結晶ダイヤモンド / 水素化アモルファスカーボン混相膜の欠陥構造の評価	○片宗 優貴 ¹ 、竹市 悟志 ² 、吉武 剛 ²	1.九工大、2.九大
	21p-P3-11	ダイヤモンドバウダへの銀コーティング (4)	○井山 年明 ¹ 、大島 龍司 ¹ 、飯塚 完司 ¹	1.日工大
	21p-P3-12	墨スパッタ膜の構造とガス吸着特性	○須田 順子 ¹ 、古田 憲吾 ¹ 、杉本 岩雄 ¹ 、高橋 和彦 ²	1.東京工科大学 CS 学部、2.同志社大学理工
	21p-P3-13	フッ素化非晶質炭素薄膜の極低温合成および物性評価	○齋藤 登之 ¹ 、年森 隆明 ¹ 、小林 直樹 ¹ 、佐藤 哲也 ¹	1.山梨大学
	21p-P3-14	有機液体中での炭素薄膜の成長に及ぼす硫黄の添加効果	○(M1)白石 理沙 ¹ 、白石 美佳 ¹ 、佐藤 凌 ² 、安藤 佳祐 ² 、安藤 寿浩 ³ 、小室 修二 ² 、蒲生西谷 美香 ²	1.東洋大院理工、2.東洋大理工、3.物材機構
	21p-P3-15	アモルファス窒化炭素薄膜の作製 II	○内島 一哉 ¹ 、佐竹 聖樹 ² 、澤島 淳二 ³ 、中村 重之 ⁴ 、財部 健一 ⁵ 、福井 一俊 ⁶ 、池田 和聡 ⁶ 、伊藤 國雄 ¹ 、山理大、6. 福井大工	1.龍谷大学、2.明石高専、3.茨城高専、4.津山高専、5. 岡山理科大、6. 福井大工
	21p-P3-16	DC マグネトロンスパッタリング法によって作製した CN 膜の特性評価	○野々村 秋人 ¹ 、伊藤 國雄 ¹ 、山本 伸一 ¹	1.龍谷大学
	21p-P3-17	MgO 上に堆積させたアモルファス窒化炭素膜の発光特性	○磯川 裕哉 ¹ 、佐竹 聖樹 ² 、澤島 淳二 ³ 、中村 重之 ⁴ 、財部 健一 ⁵ 、福井 一俊 ⁶ 、池田 和聡 ⁶ 、伊藤 國雄 ¹ 、山本 伸一 ¹	1.龍谷大理工、2.明石高専、3.茨城高専、4.津山高専、5. 岡山理科大、6. 福井大工

21p-P3-18	セルロースナノペーパー上に堆積したアモルファス窒化炭素薄膜の光誘起変形	○青野 祐美 ¹ 、浅井 慎之介 ¹ 、小田原 啄 ¹ 、原田 人 ¹ 、防衛大材料、2. 阪大産研 萌 ¹ 、能木 雅也 ²	
21p-P3-19	有機化合物/N ₂ 混合気体放電を用いた高素含有 a-CN _x H 膜の生成—薄膜の構造解析	○平松 拳也 ¹ 、齋藤 秀俊 ¹ 、伊藤 治彦 ¹	1. 長岡技大工
21p-P3-20	下地層上に堆積させたアモルファス窒化炭素膜の発光特性	○磯川 裕哉 ¹ 、佐竹 聖樹 ² 、澤島 淳二 ³ 、中村 重之 ⁴ 、1. 龍谷大理工、2. 明石高専、3. 茨城高専、4. 津山高専、財部 健一 ⁵ 、福井 一俊 ⁶ 、池田 和聡 ⁶ 、伊藤 國雄 ¹ 、5. 岡山理大、6. 福井大工 山本 伸一 ¹	
21p-P3-21	RF スパッタリング法によって作製した BCN 薄膜の発光特性	○内島 一哉 ¹ 、佐竹 聖樹 ² 、澤島 淳二 ³ 、中村 重之 ⁴ 、1. 龍谷大理工、2. 明石高専、3. 茨城高専、4. 津山高専、財部 健一 ⁵ 、福井 一俊 ⁶ 、池田 和聡 ⁶ 、伊藤 國雄 ¹ 、5. 岡山理大、6. 福井大工 山本 伸一 ¹	
6.3 酸化物エレクトロニクス / Oxide electronics			
3/19(Sat.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) H111 会場			
9:00	招 19a-H111-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 高品質 γ -Ti ₂ O ₃ 薄膜の合成と超伝導特性	○吉松 公平 ¹ 、坂田 修生 ^{2,3} 、大友 彰 ^{1,3}
9:15	奨 19a-H111-2	TiO ₂ , Ti ₂ O ₃ , γ -Ti ₂ O ₃ 共晶薄膜の超伝導	○(M1) 黒川 輝 ¹ 、吉松 公平 ¹ 、大友 明 ^{1,2}
9:30	奨 19a-H111-3	Cs ₂ WO ₆ エピタキシャル薄膜の作製と超伝導特性の変調	○相馬 拓人 ¹ 、吉松 公平 ¹ 、大友 明 ^{1,2}
9:45	奨 19a-H111-4	YO エピタキシャル薄膜の電気輸送特性と光学特性	○(D) 神永 健一 ^{1,2} 、清良輔 ^{1,2} 、林 好一 ³ 、八方 直久 ⁴ 、田尻 寛男 ⁵ 、岡 大地 ² 、福村 知昭 ² 、長谷川 哲也 ¹
10:00	奨 19a-H111-5	反応性 RF スパッタ法で作製した CuCrO ₂ 薄膜の光透過性と構造物性	○千葉 博 ¹ 、川島 知之 ¹ 、鷲尾 勝由 ¹
10:15	奨 19a-H111-6	チタン酸ストロンチウムの光励起電気伝導特性	○大澤 尚幸 ¹ 、高橋 竜太 ¹ 、Lippmaa Mikko ¹
10:30	奨 19a-H111-7	反強磁性絶縁体 CaFeO ₃ および LaFeO ₃ を用いた [(CaFeO _x) _n /(LaFeO ₃) _n] _m (m=14 for n=3,5,7 and (n, m)=(1,98),(3,33),(5,20)) 人工超格子における磁気特性の膜厚及び界面数依存性	○大橋 祥平 ¹ 、大島 佳祐 ¹ 、松山 裕貴 ¹ 、稲葉 隆哲 ¹ 、渡部 雄太 ¹ 、王 春 ¹ 、張 琦 ¹ 、宋 華平 ¹ 、橋本 拓也 ² 、高瀬 浩一 ¹ 、永田 知子 ¹ 、山本 寛 ¹ 、岩田 展幸 ¹
10:45	奨 19a-H111-8	ペロブスカイト型 SrNbO ₃ N エピタキシャル薄膜の巨大正磁気抵抗	○岡 大地 ¹ 、廣瀬 靖 ^{2,3} 、中尾 祥一郎 ³ 、福村 知昭 ¹ 、長谷川 哲也 ^{2,3}
11:00	奨 19a-H111-9	ドメイン構造と酸素量の変調による LaCuO ₃ 薄膜の輸送特性制御	○(D) 小野塚 智也 ¹ 、近松 彰 ¹ 、廣瀬 靖 ^{1,2} 、長谷川 哲也 ^{1,2}
11:15	奨 19a-H111-10	Co/Pt/r 面及び c 面配向 Cr ₂ O ₃ 積層膜の作製及び評価	○(M1) 隅田 貴士 ¹ 、橋本 浩佑 ¹ 、福井 慎二郎 ¹ 、永田 知子 ¹ 、山本 寛 ¹ 、岩田 展幸 ¹
11:30	奨 19a-H111-11	表面処理条件の異なる YAlO ₃ (001) 基板上に成膜した Cr ₂ O ₃ 薄膜の結晶構造解析および磁気特性	○(M1) 橋本 浩佑 ¹ 、隅田 貴士 ¹ 、福井 慎二郎 ¹ 、永田 知子 ¹ 、山本 寛 ¹ 、岩田 展幸 ¹
11:45	奨 19a-H111-12	高電界効果移動度を有する BaSnO ₃ 薄膜電界効果トランジスタ	○(M2) 西原 和貴 ¹ 、藤原 宏平 ¹ 、塩貝 純一 ¹ 、塚崎 敦 ^{1,2}
12:00	奨 19a-H111-13	FeSe 電気二重層トランジスタにおける超伝導転移温度の酸化物基板依存性	○塩貝 純一 ¹ 、伊藤 恭太 ¹ 、三橋 駿貴 ¹ 、野島 勉 ¹ 、塚崎 敦 ^{1,2}
3/19(Sat.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H111 会場			
13:15	奨 19p-H111-1	高周波基板バイアススパッタ法における高エネルギーイオン照射による VO ₂ 薄膜の転移特性制御	○(D) スルーハニス ビンティアズハン ¹ 、沖村 邦雄 ¹ 、大坪 嘉之 ² 、木村 真一 ² 、ムスタファ ザグリウイ ³ 、坂井 稜 ³
13:30	奨 19p-H111-2	基板上 VO ₂ 薄膜の転移応力制御によるマイクロクラックの削減と転移の急峻化	○(M2) 大森 康平 ¹ 、矢嶋 超彬 ¹ 、西村 知紀 ¹ 、島海 明 ¹
13:45	奨 19p-H111-3	極微細 VO ₂ ヘテロナノウォール細線の作製と金属-絶縁体転移特性	○(M1) 坪田 智司 ¹ 、服部 梓 ^{1,2} 、田中 秀和 ¹
14:00	19p-H111-4	二次元電子ガスの磁気イメージングのための超高分解能レーザー励起光電子顕微鏡	○谷内 敏之 ^{1,2} 、両角 海里 ¹ 、元結 啓仁 ¹ 、Rodel Tobias ³ 、Fortuna Franck ³ 、Santander-Syro Andrés ³ 、辛 埴 ^{1,2}
14:15	奨 19p-H111-5	SrTiO ₃ 表面の 2 次元電子ガスにおける強磁性ドメインの面方位依存性	○両角 海里 ¹ 、元結 啓仁 ¹ 、谷内 敏之 ^{1,2} 、Tobias C. Rodel ³ 、Franck Fortuna ³ 、Andrés F. Santander-S ³ 、辛 埴 ^{1,2}
14:30	奨 19p-H111-6	端面制御した La _{0.67} Sr _{0.33} MnO ₃ エピタキシャル薄膜を用いた酸素還元反応触媒活性評価	○西村 幸恵 ¹ 、菅 大介 ¹ 、島川 祐一 ^{1,2}
14:45	奨 19p-H111-7	固体電解質中の Li イオン濃度分布: 電圧印加下その場測定	○杉山 一生 ¹ 、齋藤 正裕 ² 、青木 靖二 ² 、大塚 祐二 ² 、清水 亮太 ³ 、一杉 太郎 ³
15:00	奨 19p-H111-8	Li(Ni _{0.5} Mn _{1.5})O ₄ 全固体リチウム電池における電解質/電極界面イオン伝導	○(PC) 河底 秀幸 ¹ 、白木 将 ¹ 、鈴木 竜 ¹ 、清水 亮太 ¹ 、一杉 太郎 ^{1,2}
15:15	19p-H111-9	TiO ₂ /SiO ₂ 界面への電気化学的水素ドーブ	○矢嶋 超彬 ¹ 、西村 知紀 ¹ 、島海 明 ¹
15:30	奨 E 19p-H111-10	Hydrogen Induced Colossal Resistance Switching in Perovskite Nickelates	○Jikun Chen ^{1,2,3} 、Jian Shi ^{1,4} 、You Zhou ¹ 、Yong Wu ² 、Yong Jiang ² 、Xun Shi ² 、Lidong Chen ⁵ 、Takeaki Yajima ³ 、Tomonori Nishimura ³ 、Akira Toriumi ³ 、Shriram Ramanathan ¹
15:45	奨 19p-H111-11	漏液しないアルカリ電解液による導電性-磁性代替デバイスの省電力化	○鈴木 雄喜 ¹ 、片瀬 貴義 ² 、太田 裕道 ²
16:00	休憩/Break		
16:15	19p-H111-12	PLD で成膜した Li ₃ PO ₄ 固体電解質/LiCoO ₂ 電極界面のイオン伝導	○白木 将 ¹ 、鈴木 竜 ¹ 、河底 秀幸 ¹ 、清水 亮太 ¹ 、白澤 徹郎 ² 、一杉 太郎 ^{1,3}
16:30	19p-H111-13	第一原理計算により求めた定圧化でのアモルファス Li ₃ BO ₃ 電解質構造と Li 拡散の理論解析	○池田 稔 ¹ 、大野 隆央 ^{1,2}
16:45	19p-H111-14	イオン拡散における充満効果	○福住 勇矢 ¹ 、小林 航 ^{1,2} 、守友 浩 ^{1,2,3}
17:00	19p-H111-15	Ta ₂ O ₅ 固体電解質薄膜へのプロトン注入と膜質評価	○今井 阿由子 ¹ 、古谷 早苗 ¹ 、住吉 研 ¹
17:15	19p-H111-16	蓄電池プロセスのためのマルチスケール・マルチフィジックス計算化学手法の開発	○畠山 望 ¹ 、長山 千恵子 ¹ 、鈴木 悦子 ¹ 、宮野 正之 ¹ 、大串 巧太郎 ¹ 、ポノー バトリック ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、宮本 明 ¹ 、幸 琢寛 ² 、小山 章 ² 、江田 信夫 ² 、長井 龍 ² 、太田 璋 ²
17:30	19p-H111-17	P2 型 Na ₂ Co _{1-x} Mn _x O ₂ 固溶体の EXAFS 解析	○(M1) 赤間 翔太 ¹ 、天羽 薫 ² 、小林 航 ^{1,2,4} 、丹羽 秀治 ^{1,3,4} 、守友 浩 ^{1,3,4}

17:45	19p-H111-18	O3型 Na ₂ Co _{1-y} Fe _y O ₂ 固溶体の EXAFS 解析	○小川 航 ^{1,2,4} 、天羽 薫 ³ 、赤間 翔太 ¹ 、丹羽 秀治 ^{1,2,4} 、守友 浩 ^{1,2,4}	1. 筑波大数理物質科学研究科, 2. 筑波大数理物質系, 3. 筑波大理工学群, 4. 筑波大数理物質融合科学セ
18:00	19p-H111-19	マンガンブルー類似体のリチウムイオン二次電池負極挙動	○柴田 恭幸 ¹ 、浦瀬 翔太 ¹ 、守友 浩 ^{1,2}	1. 筑波大数理, 2. 筑波大 CiRiSE
18:15	19p-H111-20	pH制御による電気化学製膜 Cu ₂ Oの電気特性制御	○辻 玄貴 ¹ 、滝口 雄貴 ¹ 、宮島 晋介 ¹	1. 東大院理工
18:30	19p-H111-21	Cu ₂ O系へテロ接合太陽電池のn形半導体層の成膜技術の検討	○宇於崎 涼介 ¹ 、渡辺 恭輔 ¹ 、西 祐希 ¹ 、宮田 俊弘 ¹ 、南内嗣 ¹	1. 金沢工大 OEDS R&D センター
18:45	19p-H111-22	Zn _{1-x} Ge _x O多元系酸化物薄膜をn形層に用いるp形Cu ₂ O系へテロ接合太陽電池	○西 祐希 ¹ 、山崎 丞路 ¹ 、宮田 俊弘 ¹ 、南内嗣 ¹	1. 金沢工大 OEDS R&D センター
3/20(Sun.) 9:15 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H111 会場				
9:15	20a-H111-1	溶液を基板に滴下した光化学堆積法による AlO _x 薄膜作製	○佐藤 駿太 ¹ 、市村 正也 ¹	1. 名工大
9:30	20a-H111-2	スプレー法による酸化アルミニウム薄膜の作製	○高田 直也、安部 功二 ¹ 、長沼 健斗 ¹	1. 名工大
9:45	20a-H111-3	大気開放型 CVD による酸化亜鉛ウィスカの成膜	○角田 直輝 ¹ 、小松 啓志 ² 、菊田 剛史 ² 、齋藤 秀俊 ¹	1. 米子高専, 2. 長岡技科大
10:00	20a-H111-4	HfO ₂ /SiO ₂ /Si 構造における保持電荷量の評価	○(M1)野口 和馬 ¹ 、廣森 湧太郎 ¹ 、宮武 真嗣 ¹ 、奈良 安雄 ¹	1. 兵庫県立大
10:15	20a-H111-5	電界効果による強相関酸化物 SrVO ₃ 薄膜の金属-絶縁体転移相図	○大友 圭輔 ¹ 、佐藤 洋平 ¹ 、上野 和紀 ¹	1. 東大院総合
10:30	20a-H111-6	界面双極子を用いた水溶液/酸化物界面バンド端位置の制御	○疋田 育之 ¹ 、西尾 和記 ² 、Linsey Seitz ² 、Pongkarn Chakhranon ² 、立川 卓 ^{2,3} 、Thomas Jaramillo ^{1,2} 、Harold Hwang ^{1,2}	1. SLAC, 2. スタンフォード大, 3. 東大新領域
10:45	20a-H111-7	面方位制御 La _{1/3} Sr _{2/3} FeO ₃ 薄膜における電荷不均化の膜厚依存性	○簗原 誠人 ¹ 、北村 未歩 ¹ 、和達 大樹 ² 、組頭 広志 ¹	1. 高エネ研, 2. 東大物性研
11:00	20a-H111-8	Fe ₃ O ₄ 薄膜の Solid-state dewetting の AFM 観察	○正能 大起 ¹ 、高橋 竜太 ¹ 、小沼 碧海 ² 、丸山 伸伍 ² 、松本 祐司 ² 、Jahangir Solmaz ³ 、Nagarajan Valanoor ³ 、Lippmaa Mik ¹	1. 東大物性研, 2. 東北大院工, 3. UNSW
11:15	20a-H111-9	PLD 法で作製した Y ₃ Fe ₅ O ₁₂ 薄膜における格子歪とスピンの波相関	○山原 弘靖 ¹ 、村田 哲也 ¹ 、那須 英和 ¹ 、関 宗俊 ¹ 、田畑 仁 ¹	1. 東大院工
11:30	20a-H111-10	スピン波応用に向けた R サイト置換ガーネット薄膜の作製と磁性評価	○村田 哲也 ¹ 、那須 英和 ¹ 、山原 弘靖 ¹ 、関 宗俊 ¹ 、田畑 仁 ¹	1. 東大院工
3/21(Mon.) 9:15 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) H111 会場				
9:15	21a-H111-1	Rutile-TiO ₂ 単結晶光生成キャリアダイナミクスにおける結晶軸依存性	○佐藤 夏子 ¹ 、五十嵐 樹莉 ¹ 、井口 歩武 ¹ 、井出 寛子 ¹ 、下迫 直樹 ¹ 、坂間 弘 ¹ 、江馬 一弘 ¹ 、樺田 英之 ¹	1. 上智大理工
9:30	21a-H111-2	可視光応答性光触媒 NbON(100) 薄膜のエピタキシャル成長と残留キャリア密度の低減	○菊地 諒介 ¹ 、中村 透 ¹ 、田村 聡 ¹ 、村瀬 英昭 ¹ 、羽藤 一仁 ¹	1. パナソニック
9:45	21a-H111-3	パルスレーザー堆積 / 非接触原子間力顕微鏡複合装置の開発とアナターゼ型 TiO ₂ (001) 表面の高分解能測定	○勝部 大樹 ¹ 、山下 隼人 ¹ 、阿保 智 ¹ 、若家 富士男 ¹ 、阿部 真之 ¹	1. 阪大院基礎工
10:00	21a-H111-4	深紫外線センサの応用に向けた Ni _{1-x} Mg _x O 膜の酸素空孔が及ぼす吸収スペクトルへの影響とバンドギャップの評価	○西谷 拓樹 ¹ 、太田 晃平 ¹ 、北野 総佑 ¹ 、濱野 亮介 ¹ 、稲田 貢 ¹ 、清水 智弘 ¹ 、新宮原 正三 ¹ 、幸塚 広光 ¹ 、齋藤 正 ¹	1. 関西大学
10:15	21a-H111-5	金属ナノ粒子-酸化物界面におけるマイクロ波吸収	○佐藤 友香 ¹ 、米谷 真人 ¹ 、椿 俊太郎 ¹ 、鈴木 榮一 ¹ 、和田 雄二 ¹	1. 東大院理工
10:30	21a-H111-6	グラフェン上への配向性 ZnO ナノロッドの直接合成	○(BC)徳田 冬樹 ¹ 、本田 光裕 ¹ 、奥村 竜二 ¹ 、川 洋 ¹	1. 名工大
10:45	21a-H111-7	(Zn _{1-x} Ni _x)O 混合体のバルク相分離構造解析及びエピタキシャル相分離薄膜成長	○(M1)李 明宇 ¹ 、中川原 修 ² 、服部 梓 ¹ 、田中 秀和 ¹	1. 阪大産研, 2. 株式会社村田製作所
11:00	21a-H111-8	単結晶酸化物ナノワイヤのナノ熱物性を活用した分子センサ	Meng Gang ¹ 、長島 一樹 ¹ 、金井 真樹 ¹ 、柳田 剛 ¹	1. 九大先導研
11:15	21a-H111-9	VO ₂ フリースタンディングナノ細線の作製と電気伝導特性評価	○樋口 敬之 ¹ 、神吉 輝夫 ¹ 、Luca Pellegrino ² 、Nicola Manca ⁴ 、Daniele Marré ^{2,3} 、田中 秀和 ¹	1. 阪大産研, 2. CNR-SPIN, 3. Genova Univ., 4. Delft Univ. of tech
11:30	21a-H111-10	TiO ₂ (001) 基板の単結晶 VO ₂ 薄膜の Hall 測定による電荷輸送特性評価	○近成 将 ¹ 、神吉 輝夫 ¹ 、田中 秀和 ¹	1. 阪大産研
11:45	21a-H111-11	有機極性分子の表面修飾による VO ₂ 薄膜の金属-絶縁体相転移制御	○塩谷 広樹 ¹ 、庄子 良晃 ² 、清水 規矢 ² 、中野 匡規 ¹ 、福島 孝典 ² 、岩佐 義宏 ^{1,3}	1. 東大工, 2. 東工大資源研, 3. 理研 CEMS
3/21(Mon.) 13:00 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) H111 会場				
13:00	奨 21p-H111-1	Cu ₂ /WO ₃ 平面型抵抗変化メモリの TEM その場観察	○武藤 恵 ¹ 、米坂 瞭太 ¹ 、福地 厚 ¹ 、有田 正志 ¹ 、高橋 庸夫 ¹	1. 北大院情報
13:15	奨 21p-H111-2	二層絶縁層を有する MoO ₃ /Al ₂ O ₃ 抵抗変化型メモリ動作の TEM その場観察	○平田 周一郎 ¹ 、高橋 謙仁 ¹ 、福地 厚 ¹ 、有田 正志 ¹ 、高橋 庸夫 ¹	1. 北大院情報
13:30	奨 21p-H111-3	抵抗変化型メモリのアナログ的抵抗可変特性	○曹 民圭 ¹ 、勝村 玲音 ¹ 、福地 厚 ¹ 、有田 正志 ¹ 、高橋 庸夫 ¹ 、安藤 秀幸 ² 、森江 隆 ²	1. 北大・院情報, 2. 九工大・生命体工
13:45	奨 21p-H111-4	Ta ₂ O ₅ を用いた抵抗変化型メモリの多値・アナログメモリ動作	○勝村 玲音 ¹ 、Grönroos Mika ¹ 、福地 厚 ¹ 、有田 正志 ¹ 、高橋 庸夫 ¹ 、安藤 秀幸 ² 、森江 隆 ²	1. 北大・院情報, 2. 九工大・生命体工
14:00	奨 21p-H111-5	スパッタ堆積 SiO ₂ 膜の抵抗変化現象に対するキャリアエネルギーの影響	○山口 凛太郎 ¹ 、佐藤 伸吾 ¹ 、大村 泰久 ¹	1. 関西大
14:15	奨 21p-H111-6	酸素欠陥型抵抗変化メモリにおける欠陥導入層の材料選択	○中川 良祐 ¹ 、福地 厚 ¹ 、有田 正志 ¹ 、高橋 庸夫 ¹	1. 北大院情報
14:30	21p-H111-7	RF スパッタ法による BaTiO ₃ 薄膜の抵抗変化型メモリ特性の検討	○前島 壮 ¹ 、橋本 修平 ¹ 、杉江 敏幸 ¹ 、張 子洋 ¹ 、山下 馨 ¹ 、野田 実 ¹	1. 京工織芸
14:45	奨 21p-H111-8	Layer-by-Layer 焼成雰囲気における BaTiO ₃ 薄膜の抵抗変化型メモリ特性向上の研究	○杉江 敏幸 ¹ 、橋本 修平 ¹ 、前島 壮 ¹ 、張 子洋 ¹ 、野田 実 ¹ 、山下 馨 ¹	1. 京工織芸
15:00	奨 21p-H111-9	スパッタ堆積 SiO ₂ 膜の抵抗変化現象の特徴	○赤野 拓哉 ¹ 、山口 凛太郎 ¹ 、佐藤 伸吾 ¹ 、大村 泰久 ¹	1. 関西大
15:15	奨 21p-H111-10	抵抗変化メモリ (ReRAM) の導電性パス生成機構の検討 ~ NiO の様々な表面状態に対する電子状態解析 ~	○(DC)森山 拓洋 ^{1,4} 、山崎 隆浩 ² 、大野 隆央 ^{2,3} 、岸田 悟 ^{1,4} 、木下 健太郎 ^{1,4}	1. 鳥取大工, 2. 物材機構, 3. 東大生産研, 4. TiFREC
15:30	奨 21p-H111-11	スパッタ堆積 TiO ₂ 膜の抵抗変化現象に関する考察	○川嶋 望 ¹ 、佐藤 伸吾 ¹ 、大村 泰久 ¹	1. 関西大
15:45	奨 21p-H111-12	ルチル型 TiO ₂ 単結晶の酸素空孔分布制御と抵抗変化特性	○下谷 将人 ¹ 、竹内 正太郎 ¹ 、酒井 朗 ¹	1. 阪大院基礎工

16:00	奨 21p-H111-13	酸素ラジカルを用いて作製した TiO ₂ スパッタ薄膜の局所構造と I-V 特性	○(M1)川村 欣也 ¹ 、樋口 透 ¹ 、鈴木 直哉 ¹ 、土屋 敬志 ¹ 、小林 正起 ² 、組頭 広志 ² 、寺部 一弥 ³	1.東理大理, 2.高エネ研, 3.物材機構
16:15		休憩 / Break		
16:30	21p-H111-14	熱アニールによる HfO ₂ 膜変化の導電 AFM 観察	○三沢 源人 ¹ 、島 久 ¹ 、内藤 泰久 ¹ 、秋永 広幸 ¹	1.産総研
16:45	21p-H111-15	Electronic mechanism for resistive switching	○Hannes Raebiger ^{1,2} , Claudio Padilha ^{2,1} , Alexandre R. Rocha ³ , Gustavo M. Dalpian ²	1.Yokohama Natl. Univ., 2.UFABC, 3.UNESP
17:00	21p-H111-16	Ge 核 / Si 上への Fe ₃ O ₄ ナノドットエピタキシャル成長における Ge 核サイズの効果	○(D)石部 貴史 ¹ 、前田 佳輝 ¹ 、松井 秀紀 ¹ 、渡辺 健太郎 ¹ 、成瀬 延康 ² 、中村 芳明 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 北海道大学
17:15	21p-H111-17	Si 基板上への 鉄酸化物ナノドットの固相エピタキシャル成長とその電気特性評価	○前田 佳輝 ¹ 、黒川 翼 ¹ 、石部 貴史 ¹ 、渡辺 健太郎 ¹ 、成瀬 延康 ² 、中村 芳明 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 北海道大学
17:30	21p-H111-18	Cu/Ta ₂ O ₅ 界面の酸化還元反応と抵抗スイッチ動作の湿度依存性	○鶴岡 徹 ¹ 、マスカン セドリック ¹ 、長谷川 剛 ² 、青野 正和 ¹	1.物材機構, 2.早稲田大
17:45	21p-H111-19	Pt/Nb:STO ショットキー接合における障壁変調とメモリ特性の関係	○塩見 俊樹 ¹ 、萩原 祐仁 ¹ 、岸田 悟 ^{1,2} 、木下 健太郎 ^{1,2}	1.鳥取大工, 2.TiFREC
18:00	21p-H111-20	陰イオン拡散型抵抗変化メモリの荷電状態に基づいた信頼性の検討	○木村 康平 ¹ 、大観 光徳 ^{1,2} 、岸田 悟 ^{1,2,3} 、木下 健太郎 ^{1,2,3}	1.鳥取大工, 2.鳥取大学工学部附属電子ディスプレイ研究センター, 3.鳥取大学工学部附属先端融合研究センター
18:15	21p-H111-21	ReRAM における抵抗変化ドライブングフォースとしての Soret 拡散の検討	○木下 健太郎 ^{1,2,3} 、小石 遼介 ¹ 、森山 拓洋 ^{1,2} 、河野 公紀 ¹ 、宮下 英俊 ^{1,2} 、李 相錫 ^{1,2} 、岸田 悟 ^{1,2}	1.鳥取大工, 2.TiFREC, 3.TEDREC
18:30	21p-H111-22	Ti 系薄膜および Ti ナノドットを埋め込んだ SiO ₂ 膜の抵抗変化特性評価	○加藤 祐介 ¹ 、大田 晃生 ¹ 、牧原 克典 ¹ 、宮崎 誠一 ¹	1.名大院工
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場		
奨 22a-P4-1		酸化亜鉛を用いた透明セルフスイッチングナノダイオードの作製と評価	○孫 屹 ¹ 、芦田 浩平 ¹ 、松田 宗平 ¹ 、小山 政俊 ¹ 、前元 利彦 ¹ 、佐々 誠彦 ¹ 、葛西 誠也 ²	1. 阪工大ナノ材研, 2. 北大量集センター
奨 E 22a-P4-2		One-pot room temperature synthesis of yellow-orange TiO ₂ : high photocatalytic activity under visible light	○(M2)Yufeng Wang ¹ , Shintaro Takahashi ¹ , Ken-ichi Saitow ^{2,1}	1.Graduate school of science, Hiroshima Univ., 2.N-BARD, Hiroshima Univ.
奨 22a-P4-3		Au/Cu ₂ O/(Cu,Ni ₃ Si) _n O _m /n-Si 構造の抵抗変化型不揮発性メモリ	○岩佐 太陽 ¹ 、塚本 貴広 ¹ 、須田 良幸 ¹	1. 東京農工大院工
奨 22a-P4-4		強相関電子系 Ca _{1-x} La _x MnO ₃ における C 型軌道整列状態の形成	○(M2)後藤 崇将 ¹ 、小山 泰正 ^{1,2}	1.早大基幹, 2.早大材研
奨 E 22a-P4-5		Influence of Seed Layer to Change the Size of Zinc Oxide Nanorods	○(D)Albertus Bramantyo ¹ , Masayuki Okuya ¹ , Kenji Murakami ¹ , Nji Raden Poespawati ² , Arief Udhiarto ²	1.Shizuoka University, 2.Univ. of Indonesia
22a-P4-6		ルチル型二酸化ルテニウム薄膜における電気輸送特性の膜厚依存性	○香澤 大 ^{1,2} 、岡 大地 ² 、福村 知昭 ² 、長谷川 哲也 ^{1,3}	1. 東大院理, 2. 東北大院理, 3.KAST
22a-P4-7		Nd:YAG レーザーの第 4 次高調波を用いた PLD 法による SrTiO ₃ 薄膜の結晶成長とアニール効果	○富士原 巧 ¹ 、横田 晃伸 ¹ 、中村 基訓 ¹ 、吉本 健一 ¹ 、笠 耕司 ¹	1. 旭川高専
22a-P4-8		Proposal of Integrated Sensitized Solar Cell Films Based on Sputtered ZnO Thin Films	○Jassim Alshaalah ¹ 、牧原 健二 ¹ 、吉村 徹三 ¹	1. 東京工科大
22a-P4-9		酸素欠陥を持つ Pt/TiO _{2-d} /Pt スパッタ薄膜の低温成膜と構造・電気特性	高柳 真 ¹ 、川村 欣也 ¹ 、土屋 敬志 ¹ 、寺部 一弥 ² 、樋口 透 ¹	1.東理大理, 2.物材機構
22a-P4-10		価数を制御した VO ₂ 薄膜の金属-絶縁体転移	丹野 友博 ¹ 、末次 高明 ¹ 、土屋 敬志 ¹ 、小林 正起 ² 、樋口 透 ¹ 、組頭 広志 ²	1.東理大理, 2.高エネ研
22a-P4-11		Nd _{1-x} R _x FeO _{3-d} 薄膜の結晶・電子構造と電気特性	並木 航 ¹ 、鈴木 直哉 ¹ 、中野 拓也 ¹ 、土屋 敬志 ¹ 、小林 正起 ² 、組頭 広志 ² 、樋口 透 ¹	1.東理大理, 2.高エネ研
22a-P4-12		原子層堆積法による酸化ビスマスの成長	○平林 三寛 ¹ 、田中 優 ¹ 、小松 周平 ¹	1. 上智大理工
22a-P4-13		ZnO/Pt 障壁を用いた赤外線ボロメータ素子	○張 朝傑 ¹ 、関根 大貴 ¹ 、宝田 隼 ¹ 、古川 昭雄 ¹	1.東理大院理工
22a-P4-14		導電性 ITO 層上に成長した M2 相 VO ₂ 薄膜の IMT 特性及び自励発振特性	○モハメッド ミヤシュルズ ¹ 、佐藤 賢太 ¹ 、按田 祐輔 ¹ 、椎名 庸介 ¹ 、沖村 邦雄 ¹ 、坂井 穰 ²	1. 東海大院理工, 2. ツール大 GREMAN
22a-P4-15		SrTiO ₃ /LaTiO ₃ 界面の二次元磁気輸送特性	○李 智進 ¹ 、高橋 竜太 ¹ 、リップマー ミック ¹	1. 東大物性研
22a-P4-16		マグネリ相チタン酸化物単結晶の作製条件と特性の評価	○上岡 隼人 ¹ 、水越 貴彦 ¹ 、加藤 明久 ¹ 、七井 靖 ¹	1. 日大文理
22a-P4-17		(Ti,Co)O ₂ スパッタ薄膜の磁性への電界効果	○山田 義春 ¹ 、佐藤 和郎 ¹	1. 阪府産技研
22a-P4-18		可視光で充電できる酸化チタン-ポリアニリン複合膜	○(M1) 税所 健 ¹ 、安永 達也 ¹ 、松山 智彦 ¹ 、前田 大輝 ¹ 、野見山 輝明 ¹ 、堀江 雄二 ¹	1. 鹿児島大院理工
22a-P4-19		金属有機化合物分解法による GaN 表面への NiO 粒子の形成	○(M1) 喜田 弘文 ¹ 、伊藤 圭亮 ¹ 、熊崎 祐介 ¹ 、佐藤 威友 ¹	1. 北大量集セ
22a-P4-20		酸化鉄ナノ構造体を用いた擬似太陽光による気相メタノール光触媒分解	○太田 貴洋 ¹ 、野田 啓 ¹	1. 慶應大理工
22a-P4-21		可視光透過型太陽電池に向けた GZO 薄膜の作製と評価	○永沼 裕文 ¹ 、金 相澈 ¹ 、佐藤 和弥 ¹ 、趙 新為 ¹ 、小室 修二 ²	1. 東理大理, 2. 東洋大理工
22a-P4-22		ITO 陽極からの正孔注入特性改善のための ITO バッファの検討	○星 陽一 ¹ 、濱口 大地 ¹ 、小林 信一 ¹ 、澤田 豊 ¹ 、内田 孝幸 ¹	1. 東京工芸大学
E 22a-P4-23		The impact of Nb doping on the resistance switching of SrTiO ₃	○JUN CHEN ¹ , Jianyong Li ² , Shun Ito ³ , Xianjia Luo ¹ , Takashi Sekiguchi ¹	1.NIMS, 2.JST, 3.Tohoku Unvi
22a-P4-24		3D-nanoESCA による La ₂ Ti ₃ MS ₂ O ₇ (M=Cu, Ag) のピンポイント電子状態解析	○坂井 延寿 ¹ 、永村 直佳 ² 、Liu Jingyuan ¹ 、久富 隆史 ¹ 、山田 太郎 ¹ 、尾嶋 正治 ¹ 、堂免 一成 ¹	1. 東大院工, 2.NIMS
22a-P4-25		可視光透過型太陽電池に向けた NiO:Li 薄膜の作製と評価 II	○佐藤 和弥 ¹ 、金 相澈 ¹ 、永沼 裕文 ¹ 、小室 修二 ² 、趙 新為 ¹	1. 東理大理, 2. 東洋大理工
22a-P4-26		MOD 法を用いた TiO ₂ 薄膜による光触媒活性の評価	○小漆間 拓人 ¹ 、馬場 稔也 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
22a-P4-27		多孔質酸化チタン薄膜の水素処理効果	○市川 裕 ¹ 、久保木 尊愛 ¹ 、永吉 浩 ¹	1. 東京高専
6.4 薄膜新材料 / Thin films and New materials				
3/21(Mon.) 9:00 - 11:45		口頭講演 (Oral Presentation) H103 会場		
9:00	21a-H103-1	TEOS 導入による MOCVD 法 CeO ₂ 薄膜の結晶化抑制	○古矢 智也 ¹ 、松村 隆志 ¹ 、菊地 健介 ¹ 、鈴木 雄大 ¹ 、鈴木 撰 ² 、石橋 啓次 ² 、山本 康博 ¹	1.法政大理工, 2.(株) コメント
9:15	21a-H103-2	RF スパッタ法により形成した Pr+Ce 酸化物膜の結晶性評価	○熊谷 健大 ¹ 、山口 航太 ¹ 、高畑 潤一郎 ¹ 、鈴木 撰 ² 、石橋 啓次 ² 、山本 康博 ¹	1.法政大理工, 2.(株) コメント
9:30	21a-H103-3	スパッタ法により形成した Al ₂ O ₃ 添加 CeO ₂ 薄膜の電気特性評価	○小西 順也 ¹ 、大澤 隆志 ¹ 、田中 章裕 ¹ 、牧石 拓巳 ¹ 、鈴木 撰 ² 、石橋 啓次 ² 、李 成奇 ² 、高橋 健一郎 ² 、山本 康博 ¹	1.法政大理工, 2. ㈱ コメント
9:45	21a-H103-4	PLD 法により Sr ₂ SiO ₄ ターゲットから作製した Sr ₂ SiO ₄ 薄膜の膜中固定電荷のアニール時間依存性	○谷脇 将太 ¹ 、今西 啓司 ¹ 、馬野 光博 ¹ 、吉田 晴彦 ¹ 、新船 幸二 ¹ 、佐藤 真一 ¹ 、堀田 育志 ¹	1. 兵庫県立大学
10:00		休憩 / Break		

10:15	奨 21a-H103-5	一軸加圧下熱処理による非晶質酸化モリブデン薄膜の固相結晶化	○難波 諒太郎 ¹ 、野沢 靖久 ¹ 、譚 ボオン ¹ 、土嶺 信 ¹ 、東工大、2.(株)豊島製作所、3. 神奈川県産技センター ² 、金子 智 ^{3,1} 、松田 晃史 ¹ 、吉本 護 ¹	1. 東工大、2.(株)豊島製作所、3. 神奈川県産技センター ² 、金子 智 ^{3,1} 、松田 晃史 ¹ 、吉本 護 ¹
10:30	奨 21a-H103-6	ベチーニ法で作製した粉末による Bi 過剰 Bi _{1-x} FeO ₃ ターゲットを用いた BiFeO ₃ 薄膜の作製と評価	○王 春 ¹ 、大島 佳祐 ¹ 、稲葉 隆哲 ¹ 、宋 華平 ¹ 、渡部 雄太 ¹ 、永田 知子 ¹ 、橋本 拓也 ² 、高瀬 浩一 ¹ 、山本 寛 ¹ 、岩田 展幸 ¹	1. 日大理工、2. 日大文理
10:45	奨 21a-H103-7	塗布照射法における酸化スズ膜結晶化過程のナノ秒温度計測	○(M1) 勝木 司 ¹ 、中島 智彦 ² 、土屋 哲男 ² 、湯本 敦史 ¹ 、篠田 健太郎 ²	1. 芝浦工大理工、2. 産総研
11:00	奨 21a-H103-8	深紫外 LED のための ITO/Ga ₂ O ₃ 多層膜透明電極の検討	○(M1) 桑原 奈津子 ¹ 、安田 俊輝 ¹ 、勝野 翔太 ¹ 、小出 典克 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、上山 智 ¹ 、赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工、2. 名古屋大・赤崎記念研究センター
11:15	奨 21a-H103-9	Eu ドープ NiO エピタキシャル薄膜の室温作製と特性評価	○高野 詩織 ¹ 、福田 大二 ¹ 、塩尻 大士 ¹ 、秋山 賢輔 ^{1,2} 、金子 智 ^{1,2} 、松田 晃史 ¹ 、吉本 護 ¹	1. 東工大、2. 神奈川県産技センター
11:30	奨 21a-H103-10	ソフト化学的 Li 挿入によるアナターゼ型 TaON へのキャリアドーブ	○鈴木 温 ^{1,2} 、廣瀬 靖 ^{1,2} 、中尾 祥一郎 ² 、中川 貴文 ¹ 、岡田 洋史 ¹ 、松尾 豊 ¹ 、長谷川 哲也 ^{1,2}	1. 東大院理、2.KAST
3/21(Mon.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H103 会場 English Session				
13:15	奨 E 21p-H103-1	Flux-mediated epitaxy growth of ferroelectric relaxor Bi-based for high-temperature functional capacitors	○ Rabie BENIOUB ¹ , Heddadj Sidi mohamed ¹ , Itaka Kenji ²	1.Hirosaki Univ., 2.Hirosaki Univ. NJRISE
13:30	奨 E 21p-H103-2	Measures for mitigating environmental degradation of Two Dimensional Hafnium Disulfide Field Effect Transistors	○(M2)Wikrant Upadhyaya ¹ , Toru kanazawa ¹ , Yasuyuki Miyamoto ¹	1.TokyoTech
13:45	奨 E 21p-H103-3	Laser modification of TiO ₂ thin films for applications in photovoltaics.	○(DC)Dauksta Edvins ^{1,2} , Mizeikis Vygantas ¹ , Medvids Arturs ² , Murakami Kenji ¹	1.Shizuoka Univ., 2.Riga Technical Univ.
14:00	E 21p-H103-4	Thickness dependence of epitaxially grown cobalt ferrite (111) thin films on sapphire (0001) substrate using RF sputtering	○(D)Ritesh Patel ¹ , Takeshi Tainosho ¹ , Yuki Hisamatsu ¹ , Sonia Sharmin ¹ , Hideto Yanagihara ¹ , Eiji Kita ¹	1.Institute of Applied Physics, University of Tsukuba
14:15	E 21p-H103-5	Influence of NO doping on the properties of ZnO thin films on a-plane sapphire grown by catalytic-reaction-assisted chemical vapor deposition	○ Kanji Yasui ¹ , Koudai Watanabe ¹ , Ryouichi Tajima ¹ , Yuki Ishidzuka ¹ , Yuki Ohashi ¹ , Yasuhiro Tamayama ¹	1.Nagaoka Univ. Technol.
14:30	E 21p-H103-6	Controlling material ratio and gradient of mixed lead halide films for tandem solar cell fabrication	○(D)Collin Chandler Stecker ¹ , Luis K. Ono ¹ , Yabing Qi ¹	1.OIST
14:45	E 21p-H103-7	An effective approach to synthesize monolayer tungsten disulfide crystals using tungsten hexachloride	○(D)Amutha Thangaraja ¹ , Sachin Shinde ¹ , Golap Kalita ¹ , Masaki Tanemura ¹	1.Nagoya Inst.Technol.
15:00	休憩 / Break			
15:15	21p-H103-8	SrTiO ₃ (110) 上に成膜した BiFeO ₃ 薄膜及び人工超格子の結晶構造解析及び電気的磁気的特性	○松山 裕貴 ¹ 、稲葉 隆哲 ¹ 、大島 佳祐 ¹ 、王 春 ¹ 、張 琦 ¹ 、渡部 雄太 ¹ 、宋 華平 ¹ 、橋本 拓也 ² 、永田 知子 ¹ 、山本 寛 ¹ 、岩田 展幸 ¹	1. 日大理工、2. 日大文理
15:30	21p-H103-9	H ₂ O 添加成膜した In-Ga-O 半導体薄膜の特性	○西村 英一郎 ¹ 、森本 敏夫 ¹ 、中山 徳行 ¹ 、松村 文彦 ¹ 、白木 真葉 ¹ 、清水 耕作 ² 、大野 祐樹 ² 、田中 聡 ²	1. 住友金属鉱山株式会社、2. 日本大学
15:45	21p-H103-10	HfO ₂ /SiO ₂ /Si 構造における C-V 特性のアニール温度依存性	○(M1) 上岡 聡史 ¹ 、三宅 省三 ¹ 、堀田 育志 ¹ 、新船 幸二 ¹ 、佐藤 真一 ¹	1. 兵庫県立大学
16:00	21p-H103-11	プローブパコンパチ非破壊電気コンタクトプローブ	○吉武 道子 ¹ 、柳生 進二郎 ¹ 、知京 豊裕 ¹	1. 物質・材料研究機構
16:15	21p-H103-12	【注目講演】水素前方散乱測定を用いた BaH ₂ のヒドリドイオン電界応答観察水素前方散乱測定を用いた BaH ₂ のヒドリドイオン電界応答観察	○大口 裕之 ^{1,2,3} 、齋藤 正裕 ⁴ 、佐藤 豊人 ⁵ 、桑野 博喜 ¹ 、折茂 慎一 ^{5,6} 、一杉 太郎 ^{6,7}	1. 東北大院工、2. 東北大 μ SIC、3. 東北大 NiChE、4. 東レリサーチセンター、5. 東北大金研、6. 東北大 AIMR、7. 東工大
16:30	21p-H103-13	Ce ₂ O ₃ /Bi エピタキシャル薄膜における金属絶縁体転移	○柴田 峻佑 ¹ 、清 良輔 ^{1,2} 、福村 知昭 ² 、長谷川 哲也 ¹	1. 東大院理、2. 東北大院理
16:45	21p-H103-14	(100) 配向 ScN 薄膜の光・電気特性	○大垣 武 ¹ 、坂口 勲 ¹ 、大橋 直樹 ¹ 、羽田 肇 ¹	1. 物材機構
17:00	休憩 / Break			
17:15	21p-H103-15	オンデマンド赤外線透過率・導電率同時代替デバイスの作製	○片瀬 貴義 ¹ 、遠藤 賢司 ² 、太田 裕道 ¹	1. 北大電子研、2. 北大院情報科学
17:30	21p-H103-16	VO ₂ 薄膜のサーモクロミズムによる熱ふく射の波長制御	○室井 直人 ¹ 、名村 今日子 ¹ 、鈴木 基史 ¹	1. 京大院工
17:45	21p-H103-17	TiO ₂ 光学薄膜の結晶構造と機械的特性 (II)	○竹上 真司 ¹ 、椎名 超智 ¹ 、室谷 裕志 ¹ 、勝俣 力 ²	1. 東海大工、2.(株)バルメツ
18:00	21p-H103-18	複合成膜装置によるアクリル基板上へ形成した光学薄膜の密着性	○田島 直弥 ¹ 、室谷 裕志 ¹ 、松本 繁治 ² 、本多 博光 ²	1. 東海大工、2.(株)シンクロン
18:15	21p-H103-19	ニオブとチタンの複合酸化物光学薄膜における光学特性の評価 (2)	○宮川 とも子 ¹ 、室谷 裕志 ¹	1. 東海大工
18:30	21p-H103-20	CeO ₂ 光学薄膜の成膜手法の検討 (II)	○成田 彩希 ¹ 、室谷 裕志 ¹ 、天野 辰次 ² 、岡 茂樹 ²	1. 東海大工、2.(株)ニデック
18:45	21p-H103-21	エレクトロクロミック特性を有するニッケル化合物の水蒸気を原料とした高速反応性スパッタリング	○奈良井 哲 ¹ 、若松 央暉 ² 、山内 駿 ² 、釘宮 敏洋 ¹ 、阿部 良夫 ²	1. 神戸製鋼所、2. 北見工大
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5 会場				
	22a-P5-1	hcp 構造を有する Ni 膜の成長と熱処理の影響	○池之上 卓己 ¹ 、上野 仁希 ¹ 、小森 祥央 ² 、掛谷 弘 ² 、三宅 正男 ¹ 、平藤 哲司 ¹	1. 京大院エネ科、2. 京大院工
	22a-P5-2	SmFe ₇ 及び SmFe ₇ N _x エピタキシャル薄膜の結晶磁気異方性	○楠森 毅 ¹ 、藤田 麻哉 ¹ 、尾崎 公洋 ¹	1. 産総研中部
	22a-P5-3	パラジウム基板 (001) 上のニッケル超薄膜の磁性	○(M1) 有本 昌平 ¹ 、クリューガー ビーター ¹	1. 千葉大院
	22a-P5-4	[(CaFeOx)n/(LaFeO3)n]m {m=14 for n=3,5,7 and (m,n)=(98,1),(33,3),(20,5)} 人工超格子の精密な堆積量制御手法の開発及び結晶構造解析	○大橋 祥平 ¹ 、大島 佳祐 ¹ 、松山 裕貴 ¹ 、稲葉 隆哲 ¹ 、渡部 雄太 ¹ 、王 春 ¹ 、張 琦 ¹ 、宋 華平 ¹ 、橋本 拓也 ² 、高瀬 浩一 ¹ 、永田 知子 ¹ 、山本 寛 ¹ 、岩田 展幸 ¹	1. 日大理工、2. 日大文理
	22a-P5-5	MoSi ₂ -Si 複合体薄膜の電気伝導機構	○下園 宏祐 ¹ 、木谷 遼介 ¹ 、佐藤 祐喜 ¹ 、吉門 進三 ¹	1. 同志社大理工
	22a-P5-6	オクタデシルホスホン酸の自己組織化単分子膜の作製と評価	○馬場 稔也 ¹ 、ニエ ヘンヨン ² 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工、2.Univ. of Western Ontario
	22a-P5-7	交流インピーダンス法による酸化物薄膜の伝導性評価	○(B) 山口 雅仁 ¹ 、井上 貴明 ¹ 、佐藤 智也 ¹ 、内山 潔 ¹	1. 鶴岡高専
	22a-P5-8	スピコンコートによる LaNiO ₃ 薄膜の微構造制御	○(B) 熊谷 佳郎 ¹ 、内山 潔 ¹	1. 鶴岡高専
	22a-P5-9	大気開放型 CVD 法による Nb:TiO ₂ /SUS304 構造体の合成	○菊田 剛史 ¹ 、小林 望 ¹ 、小松 啓志 ¹ 、齋藤 秀俊 ¹	1. 長岡技科大
	22a-P5-10	RF マグネトロンスパッタリング法による BiVO ₄ 薄膜作製	○馬場 稔也 ¹ 、小漆間 拓人 ¹ 、西谷 幹彦 ² 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工、2. 大阪大学

22a-P5-11	II型Siクラスレート薄膜におけるフッ化水素酸処理および物性評価	○浦野 和俊 ¹ 、上原 康暉 ¹ 、浅野 友紀 ¹ 、大橋 史隆 ¹ 、岐大工 ¹ 、久米 徹二 ¹ 、伴 隆幸 ¹ 、野々村 修一 ¹	
22a-P5-12	TiO ₂ を複合化したCu ₂ O光電極の水還元反応の安定性評価	○西川 雅美 ¹ 、福田 真之 ¹ 、野坂 芳雄 ¹ 、中島 智彦 ¹ 、長岡技大、2.産総研 ² 、土屋 哲男 ² 、齊藤 信雄 ¹	
22a-P5-13	RFスパッタ法を用いたIGZO薄膜の作製とTFT応用	○(B)高橋 崇典 ¹ 、門脇 圭佑 ¹ 、佐藤 智也 ¹ 、井上 貴明 ¹ 、熊谷 佳郎 ¹ 、宝賀 剛 ¹ 、内山 潔 ¹	1. 鶴岡高専
22a-P5-14	スパッタリングを用いて作製したMn添加ZnO薄膜の評価	○箕輪 直輝 ¹ 、那須 菜穂 ¹ 、張 宇 ¹ 、趙 新為 ¹	1. 東理大理
22a-P5-15	超音波噴霧法によるシリコン酸化膜の低温成膜	○香取 重尊 ¹ 、平松 考樹 ¹ 、永幡 正憲 ¹ 、織田 真也 ¹ 、人羅 俊実 ²	1. 津山高専、2. 株式会社FLOSFIA
22a-P5-16	非熱平衡二次元プラズマを利用した酸化スズ薄膜の形成	○堀水 懸登 ¹ 、金指 翔大 ¹ 、増田 優貴 ¹ 、奥谷 昌之 ^{1,2}	1. 静岡大院工、2. 静岡大グリーン研
22a-P5-17	エアロゾルデポジション法による多孔質酸化物膜の作製	○(B)井上 貴明 ¹ 、志藤 泰紀 ¹ 、佐藤 智也 ¹ 、明渡 純 ² 、内山 潔 ¹	1. 鶴岡高専、2. 産総研
22a-P5-18	キレートフレーム法で合成したY ₂ O ₃ 膜とEr ₂ O ₃ 膜の断面観察	○淡 森彦 ¹ 、中村 淳 ^{1,2} 、小松 啓志 ¹ 、齋藤 秀俊 ¹	1. 長岡技科大、2. 中部キレスト
3/22(Tue.) 13:00 - 15:00 口頭講演 (Oral Presentation) H103 会場			
13:00	22p-H103-1 SOI基板を用いたSi(100)上の複合面方位CeO ₂ 領域間の完全分離	○井上 知泰 ¹ 、信田 重成 ¹	1. いわき明星大科学技術
13:15	22p-H103-2 強磁場スパッタ法によるマンガン窒化物薄膜の作製	○松本 利希 ¹ 、川口 昂彦 ¹ 、畑野 敬史 ¹ 、原田 俊太 ¹ 、飯田 和昌 ¹ 、宇治原 徹 ¹ 、生田 博志 ¹	1. 名大工
13:30	22p-H103-3 ガルバノ走査型PLD装置の開発とターゲットの打ち分けによる2元組成薄膜の高速成膜	○丸山 伸伍 ¹ 、山王堂 尚輝 ¹ 、原田 龍馬 ¹ 、松本 祐司 ¹	1. 東北大院工
13:45	22p-H103-4 アブレーション化学種と雰囲気ガスの反応がハイドロキシアパタイト薄膜の表面形態とCa/P比に及ぼす影響	○長谷川 司 ¹ 、橋本 典也 ² 、西川 博昭 ³	1. 近大院生物理工、2. 大阪歯科大、3. 近大生物理工
14:00	22p-H103-5 NbO ₂ テンプレート層を用いた、PLD法によるTaO ₂ 薄膜の作製	○村岡 祐治 ^{1,2} 、藤本 佑樹 ¹ 、亀岡 美咲 ² 、松浦 由佳 ² 、砂川 正典 ¹ 、寺嶋 健成 ¹ 、脇田 高德 ¹ 、横谷 尚陸 ^{1,2}	1. 岡山大院自然科学、2. 岡山大境界面
14:15	22p-H103-6 前駆体溶液への非平衡プラズマ照射によるTiO ₂ 膜の作製	増田 優貴 ¹ 、○堀水 懸登 ¹ 、丹 祐人 ¹ 、金指 翔大 ¹ 、奥谷 昌之 ^{1,2}	1. 静岡大院工、2. 静岡大グリーン研
14:30	22p-H103-7 全ALD構成水蒸気ハイバリア膜～膜構成とバリア性の関係～	○座間 秀昭 ¹ 、本田 和広 ¹	1. アルバック超材研
14:45	22p-H103-8 室温において封止スペース内に形成したSiO ₂ 接着層の封止性	○歸山 敏之	
6.5 表面物理・真空 / Surface Physics, Vacuum			
3/19(Sat.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場			
9:00	19a-H113-1 入射電子線励起による金属ナノ構造中の局在プラズモンからの光放射	○市川 昌和 ¹	1. 東大院工
9:15	19a-H113-2 Si(100)上に成長させたErSi ₂ ナノワイヤーの構造解析	○高橋 一暉 ¹ 、尾坂 駿 ¹ 、鍵谷 浩行 ¹ 、田畑 博史 ¹ 、久保 理 ¹ 、片山 光浩 ¹	1. 阪大院工
9:30	19a-H113-3 Si(100)、{110}、{111}側面超構造創製	○服部 梓 ^{1,2} 、服部 賢 ³ 、竹本 昌平 ³ 、大門 寛 ³ 、田中 秀和 ¹	1. 阪大産研、2.JST さきがけ、3. 奈良先端大物質創成
9:45	奨 E 19a-H113-4 Scanning Tunneling Microscopic Analysis of Highly Phosphorus-Doped Si(111)-(7x7) Surface	○(DC)Hirulak Dilshan Siriwardena ¹ 、Thoru Yamashita ¹ 、Masaru Shimomura ¹	1. Shizuoka Univ.
10:00	休憩 / Break		
10:15	19a-H113-5 RHEEDによるZnO(0001)表面緩和の構造解析	○堀尾 吉巳 ¹ 、柚原 淳司 ² 、安部 功二 ³ 、高桑 雄二 ⁴ 、小川 修一 ⁴	1. 大同大工、2. 名大院工、3. 名工大、4. 東北大多元研
10:30	19a-H113-6 低速原子散乱分光法によるMgO(111)表面構造解析	○梅澤 憲司 ¹ 、塩尻 大士 ² 、松田 晃史 ² 、吉本 護 ² 、小粥 啓子 ³	1. 大阪府立大学総合、2. 東京工業大学院物質、3. (株)アブコ
10:45	19a-H113-7 擬似液体に浸漬させた酸化チタン単結晶表面のナノスケール解析	○笹原 亮 ¹ 、村上 達也 ¹ 、Le Tu ¹ 、附田 健太郎 ¹ 、富取 正彦 ¹	1. 北陸先端大
11:00	19a-H113-8 共存塩素によるTiO ₂ (110)上でのAu凝集反応に関する理論的考察	○多田 幸平 ¹ 、古賀 裕明 ² 、近藤 勇大 ¹ 、奥村 光隆 ^{1,2}	1. 阪大院理、2. 京大触媒電池
11:15	奨 E 19a-H113-9 Formation of Platinum (Pt _n , n = 1-7) on Rutile TiO ₂ (110) Surface	○(D)Furkan Alan ¹ 、Susan Aspera ¹ 、Hiroshi Nakanishi ¹ 、Hideaki Kasai ^{2,3}	1. Osaka University, 2. Akashi College, 3. University of Tokyo
11:30	19a-H113-10 絶縁性B ₂ 超薄膜のエッジ近傍におけるラテラルバンドベンディングの観察	○長岡 克己 ¹ 、内橋 隆 ¹ 、中山 知信 ^{1,2}	1. 物材機構、2. 筑大
3/19(Sat.) 13:15 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場			
13:15	19p-H113-1 ナノピペットにおける希ガスの真空コンダクタンス～その2～	○高見 知秀 ¹ 、後藤 忠彦 ² 、高桑 雄二 ²	1. 工学院大、2. 東北大多元研
13:30	19p-H113-2 TOF-SIMSによる耐熱鋼中の微量元素分布の観測	○渡邊 騎通 ¹ 、間宮 広明 ¹ 、阿部 富士雄 ² 、大久保 雅隆 ³ 、北澤 英明 ¹	1. 物材機構 量子ビーム、2. 物材機構 材料信頼性、3. 産総研 エレクトロニクス・製造領域
13:45	19p-H113-3 Cs/GaAs表面における表面処理の熱履歴と量子効率の関係、その2	○稲垣 雄大 ¹ 、田中 紘大 ¹ 、松田 匠平 ¹ 、飯島 北斗 ¹ 、目黒 多加志 ¹	1. 東理大
14:00	19p-H113-4 Si/Si間摩擦のその場高分解能電子顕微鏡観察	○音田 光一 ¹ 、福田 めぐみ ² 、木塚 徳志 ³	1. 筑波大院数理、2. 日工大、3. 筑波大物質
14:15	休憩 / Break		
14:30	E 19p-H113-5 Hydrazine Dissociation on Ni ₃ Mo Alloy with Pre-adsorbed OH	○(M2)Listra Yehezkiel Ginting ¹ 、Adhitya Gandaryus Saputro ¹ 、Hiroshi Nakanishi ¹ 、Wilson Agerico Dino ¹ 、Tomokazu Sakamoto ² 、Hirofumi Kishi ² 、Susumu Yamaguchi ² 、Hirohisa Tanaka ² 、Hideaki Kasai ^{1,3,4}	1. Osaka Univ., 2. Daihatsu Motor, 3. Univ. of Tokyo, 4. NITAC
14:45	19p-H113-6 テトラエトラコンタンの吸着によって引き起こされるAu(111)ショックレー状態の変化	○水島 啓貴 ¹ 、古池 晴信 ¹ 、石田 行章 ² 、鈴木 雄太 ¹ 、小澤 健一 ³ 、間瀬 一彦 ^{4,5} 、幸埴 ² 、金井 要 ¹	1. 東理大理工、2. 東大物性研、3. 東大院理工、4. 高エネ研 PF、5. 総研大
15:00	E 19p-H113-7 Magnetism and x-ray absorption spectra calculations of iron porphyrin	○Peter Krueger ¹ 、Yuki Yoshimoto ¹	1. Chiba Univ.
15:15	E 19p-H113-8 The theory of Photoelectron Yield Spectroscopy	○Shohei Tadano ¹ 、Peter Krueger ¹	1. Chiba Univ.
15:30	E 19p-H113-9 Calculating the Entropy Loss on Adsorption of Organic Molecules at Insulating Surfaces	○(D)Julian Gaberle ^{1,4} 、David Z. Gao ¹ 、Matthew Watkins ² 、Alexander Shluger ^{1,3}	1. UCL, 2. Univ. of Lincoln, 3. WPI-AIMR Tohoku Univ, 4. JAIST
3/20(Sun.) 9:30 - 11:30 口頭講演 (Poster Presentation) P2 会場			
奨 20a-P2-1	フレキシブル解水ヒーターに向けた導電性超撥水膜の作製	○(M1)松林 毅 ¹ 、天神林 瑞樹 ¹ 、真部 研吾 ¹ 、小峰 正嗣 ¹ 、白鳥 世明 ¹	1. 慶大理工

20a-P2-2	シリコン表面における正電荷による水素脱離促進効果	○豊島 安健 ¹	1.産総研省エネ
20a-P2-3	液相 PLIA 法を用いた SrTi _{1-x} Co _x O ₃ 光触媒薄膜の作製及び評価 2	○市原文彦 ¹ 、村田 悠馬 ¹ 、小野 洋 ¹ 、チュウ チャオキョン ² 、田中 勝己 ¹	1. 電通大先進理工, 2. 電通大国際交流セ
20a-P2-4	一次元 Frenkel-Kontorova モデルによる摩擦の研究	○佐藤 代吾 ¹ 、仙田 康浩 ¹ 、嶋村 修二 ¹	1. 山口大院理工
20a-P2-5	Si(111)-(√7×√3)-In の表面へのアクセプター分子およびドナー原子の吸着	○角 直也 ¹ 、長谷川 友里 ¹ 、山田 洋一 ¹ 、佐々木 正洋 ¹ 、吉澤 俊介 ² 、内橋 隆 ²	1. 筑波大数物, 2. 物材機構
20a-P2-6	Ge(110) 表面における Pt 及び Au 単一配向ナノワイヤーの作製と最表面電子状態計測	○渡邊 貴弘 ¹ 、山田 洋一 ¹ 、佐々木 正洋 ¹ 、境 誠司 ² 、山内 泰 ³	1. 筑波大数物, 2. 原子力機構, 3. 物材機構
20a-P2-7	水素終端層・酸化層脱離後の Si(110) 清浄表面解析	○(M1) 鈴木 翔太 ^{1,2} 、朝岡 秀人 ² 、魚住 雄輝 ² 、近 藤 啓悦 ² 、山口 憲司 ^{1,2}	1. 茨城大院理工, 2. 原子力機構
20a-P2-8	Cu(111) 面上の CO 層に吸着する CO 分子についての STM シミュレーション	○(M1) 山田 哲史 ¹ 、ピーター クリュージャー ¹	1. 千葉大融
20a-P2-9	Bi ₂ Se ₃ 表面の H ₂ O 吸着によるバンド構造の変化	○加瀬 真純 ¹ 、Peter Krüger ¹	1. 千葉大院融合

CS.4 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション / 6.6/12.2 Code-sharing session

3/20(Sun.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
9:00	20a-W631-1	ペント型ナノピペットを有する走査型イオン伝導顕微鏡の開発と生体組織の観察	○白澤 樹 ¹ 、平田 惇 ¹ 、水谷 祐輔 ² 、牛木 辰男 ² 、岩田 太 ¹	1. 静岡大工, 2. 新潟大医
9:15	奨 20a-W631-2	AFM による有機分子の高分解能室温観察	○(DC) 岩田 孝太 ¹ 、山崎 詩郎 ² 、Mutombo Pingo ³ 、Hapala Prokop ³ 、Ondracek Martin ³ 、Jelinek Pavel ³ 、杉本 宜昭 ^{1,4}	1. 阪大院工, 2. 東工大総理工, 3. チェコ科学アカデミー, 4. 東大新領域
9:30	20a-W631-3	金平坦面上に固定した量子ドット固定密度の評価	○伊藤 裕貴 ¹ 、坂上 弘之 ¹ 、鈴木 仁 ¹	1. 広島大先端研
9:45	奨 20a-W631-4	PCBM と CuPc が形成する 2D 混合構造に対するアニールの影響	○榊井 茜 ¹ 、坂上 弘之 ¹ 、高萩 隆行 ¹ 、鈴木 仁 ¹	1. 広島大先端研
10:00	20a-W631-5	KFM を用いた ITO/Ru 錯体/AuNPs 構造の局所電荷分布の計測	○丹下 直之 ¹ 、大塚 洋一 ¹ 、高木 大敬 ¹ 、西嶋 知史 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理
10:15	20a-W631-6	周波数ソフト法静電気力顕微鏡による有機薄膜太陽電池における光誘起電荷マッピング	○荒木 健人 ¹ 、家 裕隆 ² 、安藤 義雄 ² 、大山 浩 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理, 2. 阪大産研
10:30	休憩 / Break			
10:45	奨 20a-W631-7	時間分解静電気力顕微鏡による有機薄膜トランジスタのキャリアダイナミクスの可視化	○山岸 裕史 ¹ 、木村 知玄 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、野田 啓 ³ 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ, 3. 慶應大理工
11:00	20a-W631-8	時間分解静電気力顕微鏡による電極-有機半導体グレイン界面の局所電気特性評価	○木村 知玄 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
11:15	20a-W631-9	走査型プローブエレクトロスプレーイオン化質量イメージング法の高分解能化の検討	○大塚 洋一 ¹ 、小東 剛 ² 、嶋津 亮 ² 、岩田 太 ³ 、川 隆一 ² 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理, 2. 関大化生工, 3. 静大院工
11:30	20a-W631-10	各濃度溶液中における Streptavidin 2 次元結晶の液中 FM-AFM 高分解能構造観察	○(D) 崔 子鵬 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、平田 芳樹 ³ 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ, 3. 産総研
11:45	20a-W631-11	biotin 結合による streptavidin 2 次元結晶の構造変化のその場評価	○(B) 濱田 貴裕 ¹ 、宮本 眞之 ¹ 、木南 裕陽 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
12:00	20a-W631-12	3D-SFM を用いた磁気ディスク上における潤滑剤分子の 3 次元吸着構造計測	○中嶋 脩貴 ¹ 、宮澤 佳甫 ¹ 、豊田 真理子 ¹ 、相方 良介 ² 、清水 豪 ² 、曾田 孝雄 ² 、福岡 剛士 ^{1,3}	1. 金大理工, 2. MORESCO, 3. ACT-C
12:15	20a-W631-13	SAM 膜修飾電極を用いた c 型シクロム単一分子の電気伝導計測	○角田 早 ¹ 、大山 浩 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理

6.6 プローブ顕微鏡 / Probe Microscopy

3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7 会場				
	21a-P7-1	FM-AFM による SrTiO ₃ (100) 面上の固液界面構造評価 (2)	○長谷川 俊 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
	奨 21a-P7-2	走査型熱振動顕微鏡を用いたポリマー膜下の金ナノ粒子の可視化	○八尾 惇 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、木村 邦子 ¹ 、山田 啓文 ¹	1. 京大院工, 2. 京大白眉セ
	21a-P7-3	Au(111) 表面におけるメラミンを用いた分子ナノ構造の作製	○美濃 宏亮 ¹ 、岡田 有史 ¹ 、吉村 雅満 ² 、角野 広平 ¹	1. 京工織大, 2. 豊田工大
	21a-P7-4	金属ナノ粒子シートの電気特性および力学特性評価	○王 胖胖 ¹ 、荒木 祥平 ² 、田中 大輔 ³ 、龍崎 奏 ² 、岡本 晃一 ² 、玉田 薫 ²	1. 九大分子シス, 2. 九大先導, 3. 大分高専
	21a-P7-5	原子間力顕微鏡を用いた Ga/MgAl ₂ O ₄ (111) の観察	○西村 慶也 ¹ 、○岡田 有史 ¹ 、吉村 雅満 ² 、角野 広平 ¹	1. 京都工織大工芸, 2. 豊田工大
	21a-P7-6	TiO ₂ (110) 表面上の帯電領域の NC-AFM/KPFM 観察	○(PC) 小野田 稔 ^{1,2} 、Pang Chi Lung ³ 、Yurtsever Ayhan ¹ 、杉本 宜昭 ^{1,2}	1. 東大新領域, 2. 阪大院工, 3. UCL, 4. 阪大基礎工
	21a-P7-7	走査トンネル顕微鏡によるグラフェンオキサイドのナノスケール電子状態計測	○片野 諭 ¹ 、魏 濤 ¹ 、上原 洋一 ¹	1. 東北大通研
	21a-P7-8	STM に適した Ni(111) 基板の作成	○田中 裕行 ¹ 、谷口 正輝 ¹	1. 阪大産研
	21a-P7-9	グラフアイト上に CVD 成長した単層 Mo _{1-x} Re _x S ₂ の STM 観察	○吉田 昭二 ¹ 、竹内 高広 ¹ 、櫻田 龍司 ¹ 、○武内 修 ¹ 、森 勝平 ² 、佐々木 将悟 ² 、小林 裕 ² 、真庭 豊 ² 、宮田 耕充 ^{2,3} 、重川 秀実 ¹	1. 筑波大数理, 2. 首都大理工, 3. JST さきがけ
	奨 21a-P7-10	ベンゼンジチオール単一分子接合における分子形状効果の 3 次元計測	○(B) 杉田 佳弘 ¹ 、片山 智貴 ¹ 、吉田 昭二 ¹ 、武内 修 ¹ 、重川 秀実 ¹	1. 筑波大数理物質
3/21(Mon.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場				
13:15	招 21p-H113-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15 分) H/Fe ₃ O ₄ (001) 表面におけるフェルミ準位直下の局所状態密度測定	○樋浦 諭志 ¹ 、山崎 隆 ² 、城地 雅史 ¹ 、高橋 聡太郎 ¹	1. 北大院情報科学, 2. 北工学部, 3. 北大創成研
13:30	奨 21p-H113-2	Cu 表面上における NO の価電子状態と非弾性トンネル分光測定	○塩田 亮平 ^{1,2} 、奥山 弘 ¹ 、八田 振一郎 ¹ 、有賀 哲也 ¹	1. 京大院理, 2. 東大新領域
13:45	奨 21p-H113-3	単一銀ナノ粒子の形状変化と走査トンネル顕微鏡発光分光	○(M2) 寶槻 雅樹 ¹ 、片野 諭 ¹ 、上原 洋一 ¹	1. 東北大通研
14:00	奨 21p-H113-4	非接触原子間力顕微鏡を用いた Si と Ge 原子の識別	○(PC) 小野田 稔 ^{1,2} 、仁木 康平 ² 、杉本 宜昭 ^{1,2}	1. 東大新領域, 2. 阪大院工
14:15	奨 21p-H113-5	TERS 計測による多層カーボンナノチューブの 2D-band ピーク強度の局所依存性評価	○矢野 剛史 ¹ 、Songpol Chaunchaiyakul ¹ 、Pawel Krukowski ¹ 、赤井 恵 ¹ 、齋藤 彰 ¹ 、桑原 裕司 ¹	1. 阪大院工
14:30	奨 21p-H113-6	3D-FM-AFM を用いた固液界面における局所水和構造と表面原子構造との相関に関する研究	○(PC) 梅田 健一 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大院工, 2. 京大白眉セ
14:45	奨 21p-H113-7	高速走査型イオンコンダクタンス顕微鏡による細胞表面構造の非侵襲定量追跡	○(M2) 井田 大貴 ¹ 、高橋 康史 ^{2,3} 、熊谷 明哉 ⁴ 、珠 玖 仁 ¹ 、永末 智一 ^{1,4}	1. 東北大院, 2. 金沢大, 3. JST さきがけ, 4. 東北大 AIMR
15:00	奨 21p-H113-8	液体金属中 AFM の開発	○(M1) 田飼 伸匡 ¹ 、内田 辰徳 ¹ 、一井 崇 ¹ 、宇都 宮 徹 ¹ 、杉村 博之 ¹	1. 京大院工
15:15	休憩 / Break			

15:30	21p-H113-9	3D-SFM で取得した 3 次元水和分布像の溶媒探針近似モデルを用いた解析	○宮澤 佳甫 ¹ 、小林 成貴 ² 、Watkins Matthew ³ 、Shluger Alexander L. ³ 、天野 健一 ⁴ 、福岡 剛士 ^{1,5}	1. 金大院, 2. 埼玉大, 3.UCL, 4. 京大, 5.ACT-C
15:45	21p-H113-10	カルサイト結晶溶解過程において形成される遷移領域の高速 FM-AFM 解析	○川越 祐太 ¹ 、宮田 一輝 ¹ 、福岡 剛士 ^{1,2}	1. 金沢大, 2.ACT-C/JST
16:00	21p-H113-11	純水中のカルサイト表面で得られる原子分解能 FM-AFM 像の観察メカニズム	○宮田 一輝 ¹ 、Tracey John ² 、宮澤 佳甫 ¹ 、Spijker Peter ² 、Reischl Bernhard ³ 、Canova Filippo ² 、Rohl Andrew ³ 、Foster Adam ^{1,2} 、福岡 剛士 ^{1,4}	1. 金大院, 2.Aalto 大, 3.Curtin 大, 4.ACT-C
16:15	21p-H113-12	オープンループ電位顕微鏡を用いたアルミニウム合金中の金属間化合物周囲における腐食現象の観察	○岡本 貴浩 ¹ 、北川 拓弥 ¹ 、小澤 敬祐 ² 、浅川 雅 ³ 、福岡 剛士 ^{1,3,4}	1. 金沢大理工, 2. 神戸製鋼所, 3. 金沢大バイオ AFM センター, 4.ACT-C/JST
16:30	21p-H113-13	Bimodal FM-AFM を用いた KBr(100) 表面の大気中分子分解能観察	○大江 弘晃 ^{1,2} 、Kiralp Dominik ² 、Wastl Daniel S. ² 、Weymouth Alfred J. ² 、Giessibl Franz J. ² 、新井 豊子 ¹	1. 金大院自然, 2. レーゲンスブルク大
16:45	21p-H113-14	フィードバック冷却によるマイクロ片持ち梁の熱振動制振の限界	○鐘ヶ江 力 ¹ 、鍛冶 元晴 ² 、高城 亮馬 ² 、河村 良行 ^{1,2}	1. 福岡工大, 2. 福岡工大
17:00	21p-H113-15	厚いカンチレバーへの正面照射による誘起振動の解析	○山西 絢介 ¹ 、内藤 賀公 ¹ 、李 艶君 ¹ 、菅原 康弘 ¹	1. 阪大院工
17:15	21p-H113-16	液中原子間力顕微鏡のための広帯域・大振幅磁気励振回路の開発	○五十嵐 巧 ¹ 、鈴木 啓太 ¹ 、福岡 剛士 ^{1,2}	1. 金大, 2.ACT-C/JST
17:30	21p-H113-17	振幅変調型 AFM を用いた単一ナノ粒子の比誘電率測定	○木村 健二 ¹ 、本山 宗主 ¹ 、入山 恭寿 ¹	1. 名大院工
17:45	21p-H113-18	原子間力超音波顕微鏡共振スペクトロスコピー法を用いた高分子膜下のシリカナノ粒子の可視化	○野坂 俊太 ¹ 、八尾 惇 ¹ 、木村 邦子 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
3/22(Tue.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場				
10:00	22a-H113-1	アルミナ薄膜上の Pd クラスタへの CO 吸着の AFM 観察	○渡邊 友啓 ¹ 、横山 弘亮 ¹ 、多田 昌史 ¹ 、内藤 賀公 ¹ 、李 艶君 ¹ 、菅原 康弘 ¹	1. 阪大院工
10:15	22a-H113-2	チャージアンブを備えた nc-AFM による表面電子状態解析	○野上 真 ¹ 、新井 豊子 ² 、笹原 亮 ¹ 、富取 正彦 ¹	1. 北陸先端大, 2. 金沢大
10:30	E 22a-H113-3	Atomic dipole moment induced local surface potential on TiO ₂ (110) surface investigated by electrostatic force microscopy	○(D)HUANFEI WEN ¹ 、Masahide Suesada ¹ 、Yoshitaka Naitoh ¹ 、YanJun Li ¹ 、Yasuhiro Sugawara ¹	1.Osaka Univ.
10:45	22a-H113-4	非接触走査型非線形誘電率ポテンシオメトリとケルビンプローブフォース顕微鏡法の実験的比較	○(M2) 向出 周太 ¹ 、山末 耕平 ¹ 、阿部 真之 ² 、長 康雄 ¹	1. 東北大通研, 2. 阪大極限センター
11:00	22a-H113-5	走査型非線形誘電率ポテンシオメトリによる表面自発分極の測定に関する検討	○山末 耕平 ¹ 、長 康雄 ¹	1. 東北大通研
11:15	22a-H113-6	SNDM 線形誘電率ノイズイメージングに関する有限要素法シミュレーション	○平永 良臣 ¹ 、茅根 慎通 ¹ 、長 康雄 ¹	1. 東北大通研
11:30	22a-H113-7	超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡による永久磁石の破断面観察に向けた磁気イメージング手法の開発	○中山 翔太 ¹ 、江川 元太 ¹ 、木下 幸則 ¹ 、吉村 哲 ¹ 、○齊藤 準 ¹	1. 秋田大院工
11:45	E 22a-H113-8	High resolution magnetic imaging of perpendicular magnetic recording media by near-surface alternating magnetic force microscopy with amorphous FeCoSiB tip	○(PC)Kapa Srinivasa Rao ¹ 、Genta Egawa ¹ 、Yukinori Kinoshita ¹ 、Satoru Yoshimura ¹ 、Hitoshi Saito ¹	1.Akita Univ.
3/22(Tue.) 13:00 - 15:00 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場				
13:00	22p-H113-1	非接触原子間力顕微鏡におけるジュール発熱によるエネルギー散逸の研究	○稲村 竜 ¹ 、富取 正彦 ² 、新井 豊子 ¹	1. 金大院, 2. 北陸先端大
13:15	22p-H113-2	静電相互作用による AFM のエネルギー減衰	○仙田 康浩 ¹ 、嶋村 修二 ¹ 、ブロンクビスト ヤンネ ² 、山口大工, 2. アールト大ニエミネンリスト ²	
13:30	22p-H113-3	電気伝導と力学特性の同時測定による金ナノ接点の原子配列の考察	○橋本 遼太 ¹ 、村上 拓 ¹ 、新井 豊子 ¹ 、石塚 慧介 ² 、大島 義文 ² 、富取 正彦 ²	1. 金沢大院自然, 2. 北陸先端大院
13:45	22p-H113-4	真空中で石英から昇華させた SiO ₂ のルチル TiO ₂ (110) 表面への堆積	○附田 健太郎 ¹ 、笹原 亮 ¹ 、富取 正彦 ¹	1. 北陸先端大
14:00	22p-H113-5	ピコ秒レーザーパルスで照射した STM 探針-試料ギャップからの THz 発光	○上原 洋一 ¹ 、片野 諭 ¹ 、桑原 正史 ² 、鈴木 哲 ³	1. 東北大通研, 2. 産総研, 3. 仙台高専
14:15	22p-H113-6	高ばね定数カンチレバーを用いた FM-AFM による室温高分解能分子内構造観察	○山下 貴裕 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京都大学工, 2. 京大白眉セ
14:30	22p-H113-7	Cu(110) 上での磁性 Co 原子の操作	○山田 純平 ¹ 、徳田 郁実 ¹ 、尾崎 翔太 ¹ 、内藤 賀公 ¹ 、李 艶君 ¹ 、菅原 康弘 ¹	1. 阪大院工
14:45	22p-H113-8	Si(111)-(7x7) 表面上の Si テトラマーのスイッチ操作	山崎 詩郎 ^{1,2} 、前田 圭亮 ¹ 、○杉本 宜昭 ^{1,3} 、阿部 真之 ¹ 、Vladimir Zobic ⁴ 、Pou Pablo ⁵ 、Rodrigo Lucia ⁵ 、Mutombo Pingo ⁴ 、Perez Ruben ⁵ 、Jelinek Pavel ⁴ 、森田 清三 ¹	1. 阪大, 2. 東工大, 3. 東大, 4.ASCR, 5. マドリッド自治大
7 ビーム応用 / Beam Technology and Nanofabrication				
シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます				
3/19(Sat.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場				
19a-P1-1	Pd の水素化の環境制御型透過電子顕微鏡観察	○玉岡 武泰 ^{1,2} 、吉田 秀人 ¹ 、竹田 精治 ¹	1. 阪大産研, 2. 阪大工	
19a-P1-2	SEM 観察における有機高分子レジスト収縮の理論解析	○香山 真範 ¹ 、古川 雄基 ¹ 、川田 博昭 ¹ 、平井 義彦 ¹ 、安田 雅昭 ¹	1. 大阪府大工	
19a-P1-3	プラズマ電位制御型大電力パルススパッタによる Mo 雑状陰極構造の作製	○成田 智基 ¹ 、大家 湊 ¹ 、中野 武雄 ¹ 、長尾 昌善 ² 、大崎 壽 ²	1. 成蹊大理工, 2. 産総研	
19a-P1-4	中性子反射率周波数解析法による金-クロム積層膜/希硫酸水溶液界面構造の評価	○水沢 まり ¹ 、桜井 健次 ² 、山崎 大 ³ 、武田 全康 ³	1.CROSS 東海, 2. 物材機構, 3. 原子力機構	
19a-P1-5	クイック X 線反射率法の技術開発と応用	○桜井 健次 ¹	1. 物材機構	
19a-P1-6	XANAM による Au/SiO _x 試料表面での X 線誘起現象の 1 次元顕微分析	○鈴木 秀士 ¹ 、向井 慎吾 ² 、田 旺帝 ³ 、野村 昌治 ⁴ 、朝倉 清高 ²	1. 名大院工, 2. 北大触媒研, 3.ICU, 4.KEK-PF	
19a-P1-7	Atomic-scale and electronic structure of fcc- and hcp-type Ru nanosized catalyst	○Osami Sakata ¹ 、L. S. R. Kumara ¹ 、Chulho Song ¹ 、Anli Yang ¹ 、Shinji Kohara ¹ 、Kohei Kusada ² 、Hirokazu Kobayashi ² 、Hiroshi Kitagawa ²	1.NIMS/SPring-8, 2.Kyoto Univ.	
19a-P1-8	表面電荷反転 XPS 法による TaO _x ナノシート / SiO ₂ / Si 界面バンドオフセットの解析	○(B) 速水 脩平 ¹ 、豊田 智史 ¹ 、福田 勝利 ¹ 、菅谷 英生 ¹ 、中田 明良 ¹ 、森田 将史 ¹ 、内本 喜晴 ¹ 、松原 英一郎 ¹	1. 京都大学	
19a-P1-9	強磁性絶縁体 BaFeO ₃ 薄膜における時間分解軟 X 線磁気円二色性の観測	○和達 大樹 ^{1,2} 、津山 智之 ^{1,2} 、チャクラパティース パンカー ³ 、ボンティウス ニコ ⁴ 、シュスラー クリ スチャン ⁴ 、ファン ハロルド ^{3,5} 、十倉 好紀 ^{2,3}	1. 東大物性研, 2. 東工大, 3. 理研 CEMS, 4.HZB BESSYII, 5. スタンフォード大	

19a-P1-10	ホローカソードを陰極に用いた大面積イオン源の開発	○早川 太郎 ¹ 、永尾 友一 ¹ 、井内 裕 ¹	1. 日新イオン
19a-P1-11	ガラス基板上へのリップル構造形成制御	○平岡 陽祐 ¹ 、小川 幸大 ¹ 、kalita golap ¹ 、種村 眞幸 ¹	1. 名工大院工
19a-P1-12	固体表面へのクラスターイオンビーム照射による発光スペクトル	○織田 啓佑 ¹ 、龍頭 啓充 ¹ 、Musumeci Francesco ² 、竹内 光明 ¹ 、高岡 義寛 ¹	1. 京大光電子理工セ、2. カターニア大
19a-P1-13	X線光電子分光法 (HAXPES および GCIB-XPS) を用いたリチウムイオン二次電池正極における活物質表面および内部の分析	○稲葉 雅之 ¹ 、三井所 亜子 ¹ 、早川 敬済 ¹ 、大園 洋史 ¹ 、坪田 隆之 ¹	1. コベルコ科研
19a-P1-14	超低高度宇宙環境における原子酸素誘起材料劣化現象における窒素分子同時衝突効果の定量化	○横田 久美子 ¹ 、北一貴 ¹ 、山崎 勇希 ¹ 、田川 雅人 ¹	1. 神戸大院工
19a-P1-15	超音速酸素分子線による Cu ₃ Pd(111) 合金表面酸化過程	○津田 泰孝 ¹ 、牧野 隆正 ¹ 、吉越 章隆 ² 、福山 哲也 ¹ 、岡田 美智雄 ¹	1. 阪大理化、2. 原子力機構、3. 日立研
19a-P1-16	高出力レーザーを用いた非破壊固体粒子加速法の開発	○(M1) 守本 都 ¹ 、弘中 陽一郎 ² 、重森 啓介 ² 、野 孝好 ² 、田川 雅人 ¹ 、北澤 幸人 ³ 、阿藤 敏行 ⁴	1. 神戸大学、2. 阪大レーザー研、3. IHI、4. 東工大応セラ
19a-P1-17	分子流入を考慮した大気吸入型イオンエンジンの中性粒子シミュレーション	○(M1) 安河内 翼 ¹ 、白井 英之 ¹ 、三宅 洋平 ¹ 、川口 伸一郎 ¹ 、福田 雅人 ¹ 、横田 久美子 ¹ 、田川 雅人 ¹	1. 神戸大

7.1 X線技術 / X-ray technologies

3/19(Sat) 13:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) H137 会場			
13:15	19p-H137-1	相分離構造を有する超高分解度シンチレータ	○安居 伸浩 ¹ 、大橋 良太 ¹ 、鎌田 圭 ² 、吉川 彰 ^{2,3} 、田 透 ¹
13:30	19p-H137-2	超高分解度相分離シンチレータを用いた位相格子の自己像直接撮像による X 線位相イメージング	○大橋 良太 ¹ 、安居 伸浩 ¹ 、鎌田 圭 ² 、吉川 彰 ^{2,3} 、田 透 ¹
13:45	19p-H137-3	ゾーンプレート X 線顕微鏡を用いた定量的位相結像	○渡辺 紀生 ¹ 、青木 貞雄 ^{1,2}
14:00	19p-H137-4	骨形成メカニズム解明のための広視野高空間分解能タラポ型 X 線位相顕微鏡の開発	○呉 彦森 ^{1,2} 、高野 秀和 ^{1,2} 、星野 真人 ^{2,3} 、寺田 靖子 ³ 、松尾 光一 ⁴ 、矢代 航 ^{1,2} 、百生 敦 ^{1,2,3}
14:15	19p-H137-5	80 ~ 200eV 域定偏角分光器用酸化物膜付加高回折効率回折格子の設計	○小池 雅人 ¹ 、長野 哲也 ² 、笹井 浩行 ² 、浮田 龍一 ²
14:30	奨 19p-H137-6	X線用準結晶集光素子の設計	○(M1) 深水 嵩明 ¹ 、李 維率 ¹ 、星野 鉄哉 ¹ 、杉坂 純一郎 ² 、渡辺 紀生 ¹ 、青木 貞雄 ¹ 、伊藤 雅英 ¹
14:45	E 19p-H137-7	X-ray phase scanner using Talbot-Lau interferometry for non-destructive testing - II	○(P)Shivaji Bachche ¹ 、Masahiro Nonoguchi ² 、Koichi Kato ² 、Masashi Kageyama ² 、Takafumi Koike ² 、Masaru Kuribayashi ² 、Atsushi Momose ¹
15:00	奨 19p-H137-8	マイクロフォーカス X 線源と振幅格子を用いた X 線位相イメージングの検討	○(B) 細野 凌 ¹ 、森本 直樹 ¹ 、伊藤 康浩 ¹ 、山崎 周 ¹ 、佐野 孝成 ¹ 、土岐 貴弘 ² 、佐野 哲 ² 、細井 卓治 ¹ 、渡部 平司 ¹ 、志村 孝功 ¹
15:15	休憩 / Break		
15:30	19p-H137-9	PF BL-11D の分光器出力に重なる回折格子散乱光	○羽多野 忠 ¹ 、相原 翔学 ¹ 、江島 丈雄 ¹
15:45	19p-H137-10	レーザー生成 Bi プラズマ光源を用いた卓上型水の窓 X 線顕微鏡の開発	○(M1) 近藤 芳希 ¹ 、Dinh Thanh-Hung ² 、小野 祐一 ¹ 、荒居 剛己 ¹ 、原 広行 ¹ 、波多野 忠 ³ 、江島 丈雄 ³ 、東口 武史 ^{1,2}
16:00	19p-H137-11	波長 4.0nm 用軟 X 線顕微鏡の斜入射照明光学系の開発	○江島 丈雄 ¹ 、羽多野 忠 ¹ 、近藤 芳希 ² 、小野 祐一 ² 、デン タンフン ² 、東口 武史 ²
16:15	19p-H137-12	固体 Ar と N ₂ レーザープラズマの「水の窓」軟 X 線特性	○天野 壯 ¹
16:30	19p-H137-13	炭素の窓 X 線光源のスペクトル構造解析	○(M2) 原 広行 ¹ 、荒居 剛己 ¹ 、デン タンフン ² 、佐々木 明 ³ 、砂原 淳 ⁴ 、東口 武史 ^{1,2}
16:45	19p-H137-14	【注目講演】半導体リソグラフィ用 EUV 光源開発の最新結果	○高島 悠太 ¹ 、堀 司 ¹ 、植野 能史 ¹ 、阿部 保 ¹ 、藪 隆之 ¹ 、若菜 克彦 ¹ 、加藤 義章 ¹ 、柏崎 務 ¹ 、福田 修 ¹ 、藤巻 貴久 ¹ 、西村 祐一 ¹ 、竹中 怜 ¹ 、鈴木 徹 ¹ 、安藤 正彦 ¹ 、細田 裕計 ¹ 、宮下 光太郎 ¹ 、小山内 貴幸 ¹ 、齋藤 隆志 ¹ 、溝口 計 ¹
17:00	19p-H137-15	レーザー励起プラズマ EUV 光源ターゲット分散過程のモデル構築 (2)	○佐々木 明 ¹ 、砂原 淳 ² 、西原 功修 ³
17:15	19p-H137-16	レーザー照射ドロップレットの長時間シミュレーション	○砂原 淳 ¹ 、西原 功修 ² 、佐々木 明 ³
17:30	19p-H137-17	協同的トムソン散乱計測による LPP-EUV 光源プラズマ診断	○戸室 啓明 ¹ 、柳田 達哉 ¹ 、神家 幸一郎 ¹ 、スマングオルグ ¹ 、和田 靖典 ¹ 、國島 正人 ¹ 、児玉 健 ¹ 、富田 健太郎 ² 、佐藤 祐太 ² 、江口 寿明 ² 、築山 晶一 ² 、内野 喜一郎 ²

7.2 電子ビーム応用 / Applications and technologies of electron beams

3/21(Mon.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H137 会場			
13:15	招 21p-H137-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 焦点位置追尾が可能な実時間波動場再構成電子顕微鏡システムの開発	○田村 孝弘 ¹ 、木村 吉秀 ¹ 、高井 義造 ¹
13:30	21p-H137-2	2層グラフェンに形成したナノポアのエッジ構造	○(D) 狩野 絵美 ^{1,2} 、橋本 綾子 ^{1,2} 、竹口 雅樹 ^{1,2}
13:45	奨 21p-H137-3	走査型透過電子顕微鏡を用いた BaTiO ₃ 薄膜のナノドメイン構造解析	○小林 俊介 ¹ 、加藤 丈晴 ¹ 、幾原 雄一 ^{1,2} 、山本 剛久 ^{1,3}
14:00	21p-H137-4	REELS を用いた LiNi _{1/3} Mn _{1/3} Co _{1/3} O ₂ 電極におけるリチウム評価	○田口 昇 ¹ 、橋田 晃宜 ¹ 、栄部 比夏里 ¹ 、秋田 知樹 ¹
14:15	21p-H137-5	電気化学的に Li を脱離させた Li ₂ MnO ₃ 正極材料の電子顕微鏡観察	○橋田 晃宜 ¹ 、片岡 理樹 ¹ 、香山 正憲 ¹
14:30	21p-H137-6	カーボンナノチューブの電子線誘起エッチング	富田 雄人 ^{1,2} 、○吉田 秀人 ¹ 、竹田 精治 ¹
14:45	21p-H137-7	噴水型低エネルギー二次電子検出器による金属合金の観察	○関口 隆史 ¹ 、木村 隆 ¹ 、岩井 秀夫 ¹
15:00	21p-H137-8	Ptychographical phase retrieval の実像による拘束	○三石 和貴 ¹ 、下条 雅幸 ² 、竹口 雅樹 ¹
15:15	21p-H137-9	円環・円孔電極を用いた電界型 Cs コレクタの開発 (3)	○川崎 忠寛 ^{1,2} 、高井 康行 ³ 、小川 雄紀 ³ 、石田 高史 ² 、児玉 哲司 ³ 、富田 正弘 ⁴ 、松谷 貴臣 ⁵ 、生田 孝 ⁶
15:30	休憩 / Break		
15:45	21p-H137-10	高コヒーレンスビーム生成のための透明伝導体埋め込み型ナノスケール光陰極の製作	○(D) 澁谷 達則 ¹ 、林崎 規純 ² 、吉田 光宏 ³

16:00	21p-H137-11	Blunt W tip 上への Au 被覆ナノピラミッドの形成	○(M2) 浅井 泰尊 ¹ 、熊谷 輝成 ¹ 、村田 英一 ¹ 、大島 忠平 ²	1.名城大理工, 2.早大先進理工
16:15	奨 21p-H137-12	溝底から放出する二次電子の角度分布測定システム	○金 惠真 ¹ 、備前 大輔 ¹ 、波田野 道夫 ¹	1.日立中研
16:30	奨 21p-H137-13	単一カーボンナノチューブを電界放出電子源とする小型走査電子顕微鏡の開発	○大石 峻也 ¹ 、山崎 慎太郎 ¹ 、中原 仁 ¹ 、村田 英一 ² 、永井 滋一 ³ 、大野 輝昭 ⁴ 、安坂 幸師 ¹ 、齋藤 弥八 ¹	1.名大院工, 2.名城大院理工, 3.三重大院工, 4.テクネットクス工房
16:45	21p-H137-14	微小電界放出電子源アレイを用いた陰陰極 HARP 撮像板の画質向上の検討	○難波 正和 ¹ 、本田 悠葵 ¹ 、長尾 昌善 ² 、江上 典文 ³	1.NHK, 2.産総研, 3.近畿大
17:00	21p-H137-15	フィールドエミッタアレイを用いた耐放射線小型軽量撮像素子の開発	○後藤 康仁 ¹ 、辻 博司 ¹ 、長尾 昌善 ² 、増澤 智昭 ³ 、根尾 陽一郎 ³ 、三村 秀典 ³ 、岡本 保 ⁴ 、佐藤 信浩 ¹ 、秋吉 優史 ⁵ 、高木 郁二 ¹	1.京都市大, 2.産総研, 3.静岡大, 4.木更津高専, 5.大阪府大
17:15	奨 21p-H137-16	耐放射線性 FEA 撮像素子用 CdTe 光電変換膜のガンマ線耐性の評価	○猪狩 朋也 ¹ 、小口 情ハート ¹ 、岡本 保 ¹ 、後藤 康仁 ² 、佐藤 信浩 ² 、秋吉 優史 ³ 、高木 郁二 ²	1.木更津高専, 2.京都市大, 3.大阪府大
17:30	21p-H137-17	耐放射線性 FEA 撮像素子のための光電変換膜評価	○増澤 智昭 ¹ 、根尾 陽一郎 ¹ 、岡本 保 ² 、長尾 昌善 ³ 、後藤 康仁 ⁴ 、三村 秀典 ¹	1.静岡大, 2.木更津高専, 3.産総研, 4.京都市大
17:45	21p-H137-18	電子ビーム照射された絶縁体試料表面電位分布のワーキングディスタンスと印加バイアス依存性	○(M1) 東海 昌司 ¹ 、河本 拓也 ¹ 、小寺 正敏 ¹	1.大阪工大
18:00	21p-H137-19	走査電子顕微鏡内のフォッキング電子電流の測定	○(M1) 野田 拓 ^{1,2} 、萩原 佳史 ¹ 、小寺 正敏 ¹ 、Raynald Gauvin ²	1.大阪工業大学, 2.マギル大学
18:15	21p-H137-20	p 型シリコンフィールドエミッタからの光支援電子放射(III)	○嶋脇 秀隆 ¹ 、長尾 昌善 ² 、根尾 陽一郎 ³ 、三村 秀典 ³ 、若家 富士男 ⁴ 、高井 幹夫 ⁴	1.八戸工大, 2.産総研, 3.静岡大, 4.大阪大
18:30	21p-H137-21	GaAs 負性電子親和力カソードの応答速度について	○(MIC) 光野 圭悟 ¹ 、増澤 智昭 ¹ 、畑中 義式 ¹ 、根尾 陽一郎 ¹ 、三村 秀典 ¹	1.静岡大
18:45	21p-H137-22	第一原理計算を用いた転写モード法エミッタ用導電性セラミック材料の電子状態 (V)	○(M1) 伊藤 允人 ¹ 、中本 正幸 ¹ 、文 宗鉉 ¹	1.静岡大院工
7.3 微細パターン・微細構造形成技術 / Micro/Nano patterning and fabrication				
3/19(Sat) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) S224 会場				
13:30	19p-S224-1	PS-block-PMMA の選択的有機・無機ハイブリッド化 ~ Semi-static mode と continuous flow mode での比較 ~	○廣芝 伸哉 ¹ 、中川 勝 ¹	1.東北大 多元研
13:45	19p-S224-2	熱アニール法によるポリスチレンとポリジメチルシロキサンからなるブロック共重合体のランダム配向面内シリンダ構造の配向秩序解析	○山口 徹 ¹ 、藤原 聡 ¹	1.NTT 物性基礎研
14:00	19p-S224-3	光ナノインプリント法により作製した sub-100 nm 樹脂ガイドのトレンチ内での polystyrene-block-poly(methyl methacrylate) の誘導自己組織化	○(B) 金原 徹高 ¹ 、大窪 諒 ¹ 、廣芝 伸哉 ¹ 、中川 勝 ¹	1.東北大多元研
14:15	奨 19p-S224-4	熱ナノインプリント一括転写プロセスを用いた原子スケールポリマー基板への金ナノ粒子の配列パターン作製	○嶋田 航大 ¹ 、譚 ゴオン ¹ 、野沢 靖久 ¹ 、浦上 達宣 ² 、小山 浩司 ³ 、三田 正弘 ⁴ 、金子 智 ^{5,1} 、松田 晃史 ¹ 、吉本 護 ¹	1.東工大, 2.三井化学, 3.並木精密宝石, 4.協同インターナショナル, 5.神奈川県産技センター
14:30	19p-S224-5	熱インプリントによるタンパク質表面の直接パターンニング	○銘苅 春隆 ¹	1.産総研
14:45	19p-S224-6	ナノインプリントグラフォエピタキシーによって作製した液晶高分子ネガ型及びポジ型パターンの分子配向観察	○岡田 真 ¹ 、谷口 雄亮 ² 、春山 雄一 ¹ 、小野 浩司 ³ 、川月 喜弘 ² 、松井 真二 ¹	1.兵県大高度研, 2.兵県大工, 3.長岡技科大
15:00	19p-S224-7	ダブルナノインプリントグラフォエピタキシーによって作製した液晶高分子パターンの分子配向評価	○岡田 真 ¹ 、谷口 雄亮 ² 、春山 雄一 ¹ 、小野 浩司 ³ 、川月 喜弘 ² 、松井 真二 ¹	1.兵県大高度研, 2.兵県大工, 3.長岡技科大
15:15	19p-S224-8	ポーラスアルミナを用いたナノインプリントによる超撥水表面の形成	○柳下 崇 ¹ 、村越 海斗 ¹ 、近藤 敏彰 ¹ 、益田 秀樹 ¹	1.首都大学東京
15:30	休憩 / Break			
15:45	19p-S224-9	新規のリバーサルインプリントを用いた微細パターン付き三次元構造の作製	○(B) 澤田 裕樹 ¹ 、藤井 一緒 ¹ 、川田 博昭 ¹ 、安田 雅昭 ¹ 、平井 義彦 ¹	1.大府大
16:00	19p-S224-10	熱ナノインプリントにおける樹脂中での応力緩和の検討	○(B) 飯田 達矢 ¹ 、安田 雅昭 ¹ 、川田 博昭 ¹ 、平井 義彦 ¹	1.大府大工
16:15	19p-S224-11	原子間力顕微鏡で観察される膜厚 sub-100 nm での光硬化樹脂薄膜における表面弾性率の膜厚依存性	○(M1) 矢野 春菜 ¹ 、久保 祥一 ² 、中川 勝 ¹ 、梁 曉斌 ³ 、藤浪 想 ⁴ 、中嶋 健 ³	1.東北大多元研, 2.物機機構, 3.東大院理工, 4.理研放射光
16:30	19p-S224-12	両末端シラノール PDMS によって成膜した PDMS 離型膜の評価	○岡田 真 ¹ 、松井 真二 ¹	1.兵県大高度研
16:45	19p-S224-13	ナノインプリントにおける離型力及び欠陥率のモールド剛性依存性	○中村 直登 ¹ 、フロリアン カービン ² 、川田 博昭 ¹ 、平井 義彦 ¹	1.大府大, 2.フラ国高電子応用大
17:00	E 19p-S224-14	Induced stress during peeling release with various template stiffness in nanoimprint lithography	○(M2) Florian Chalvin ^{1,2} , Takamitsu Tochino ¹ , Naoto Nakamura ¹ , Masaaki Yasuda ¹ , Hiroaki Kawata ¹ , Yoshihiko Hirai ¹	1.Osaka Pref. Univ., 2.ENSEA
17:15	19p-S224-15	フェムト秒パルスレーザーを用いて作製したポリイミド孔版のホール形状と光硬化性液体の吐出量の関係	田辺 明 ¹ 、大町 弘毅 ¹ 、○中村 貴宏 ¹ 、佐藤 俊一 ¹ 、中川 勝 ¹	1.東北大多元研
17:30	19p-S224-16	光ナノインプリントリソグラフィを目指したレーザー加工による光硬化性液体塗布用孔版の作製	○関 健斗 ¹ 、永瀬 和郎 ² 、廣芝 伸哉 ¹ 、中川 勝 ¹ 、中村 貴宏 ¹	1.東北大多元研, 2.(株)ミノグループ
17:45	19p-S224-17	超音波ナノインプリントにおける脱着可能なモールド固定法	○銘苅 春隆 ¹ 、矢野 隆行 ²	1.産総研, 2.分子研
3/20(Sun) 9:30 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) S224 会場				
9:30	奨 20a-S224-1	フォトダイオードを用いた EUV レジストの透過率測定法の開発	○豆崎 大輝 ¹ 、渡辺 雅紀 ¹ 、井口 晴貴 ¹ 、原田 哲男 ¹ 、渡邊 健夫 ¹	1.兵庫県立大学
9:45	20a-S224-2	EUV リソグラフィの分子シミュレーション	○岩井 瑛規 ¹ 、川田 博昭 ¹ 、平井 義彦 ¹ 、安田 雅昭 ¹	1.大阪府大工
10:00	20a-S224-3	フィン型 SRAM のためのナノ OPC 製造考慮設計計算機シミュレーション	○門田 和也 ¹	1.ナノサイエンスラボ
10:15	20a-S224-4	半導体露光用エキシマレーザーのビーム面内偏光度分布の測定	○手井 大輔 ¹ 、熊崎 貴仁 ¹ 、對馬 弘明 ¹ 、黒須 昭彦 ¹ 、太田 毅 ¹ 、松永 隆 ¹ 、溝口 計 ¹	1.ギガフォトン株式会社
10:30	休憩 / Break			
10:45	20a-S224-5	液晶マトリックス投影露光時の階調制御による線幅均一性向上の検討	○堀内 敏行 ¹ 、羽根石 翔太 ¹ 、吉田 有美香 ¹ 、小林 宏史 ¹	1.東京電機大
11:00	20a-S224-6	ビルトインレンズマスクリソグラフィによる高段差ステップ上への露光	○田中 利樹 ¹ 、笹子 勝 ¹ 、菊田 久雄 ¹ 、川田 博昭 ¹ 、平井 義彦 ¹	1.大阪府立大

11:15	奨 20a-S224-7	非化学増幅型電子線レジストにおける露光特性の分子量依存性	○高山 智寛 ¹ 、岸村 由紀子 ¹ 、浅田 裕法 ¹ 、星野 亮 ¹ 1. 山口大院理工, 2. グルーオンラボ ^{1,2} 、河田 敦 ²
11:30	奨 20a-S224-8	新規アクリル系ポリマー型電子線レジストの露光特性(II)	○落合 俊介 ¹ 、高山 智寛 ¹ 、岸村 由紀子 ¹ 、浅田 裕 ¹ 1. 山口大, 2. 熊本大, 3. グルーオンラボ ¹ 、國武 雅司 ² 、星野 亮 ³ 、河田 敦 ³
11:45	20a-S224-9	ポリビニルピロリドン微細構造上でのAuナノ粒子形成と制御	○佃 諭志 ¹ 、岡本 一将 ² 、山本 洋揮 ³ 、古澤 孝弘 ³ 1. 東北大多元研, 2. 北大, 3. 阪大産研
7.5 イオンビーム一般 / Ion beams			
3/20(Sun.) 13:15 - 17:15 口頭講演(Oral Presentation) H137 会場			
13:15	20p-H137-1	高出力インパルスマグネトロンスパッタリング法を用いた高強度・サイズ選別ナノクラスターイオン源の開発	○角山 寛規 ^{1,2} 、張 初航 ² 、山本 宏晃 ³ 、戸名 正英 ³ 、1. 慶大理工, 2. JST-ERATO, 3. (株)アヤボ, 4. 慶應 KIPAS
13:30	20p-H137-2	金属内包シリコンナノクラスター薄膜の創成とその化学的安定性	○中嶋 敦 ^{1,2,3} 、洪田 昌弘 ² 、中谷 真人 ^{1,3} 、太田 努 ¹ 、1. 慶大理工, 2. 慶應義塾 KIPAS, 3. JST-ERATO
13:45	20p-H137-3	高出力インパルスマグネトロンスパッタリングで生成した金属クラスターイオンと窒素分子との反応の研究	○角山 寛規 ^{1,3} 、江口 豊明 ^{1,3} ○秋元 健吾 ¹ 、水内 勇 ¹ 、山本 宏晃 ² 、戸名 正英 ² 、1. 東北大院理工, 2. (株)アヤボ 塚本 恵三 ^{1,2} 、中野 元善 ¹ 、大下 慶次郎 ¹ 、美齊 津文典 ¹
14:00	E 20p-H137-4	Effect of Hydrogen Ion Beam Treatment on Si Nanocrystal/SiO ₂ Superlattice Memory Devices	○(DC)Shengwen Fu ¹ 、Huiju Chen ¹ 、ChuanFeng Shih ¹ 1.Cheng Kung Univ.
14:15	20p-H137-5	飛行時間型質量分析計に搭載した真空型帯電液滴ビーム銃による二次イオンの測定	○二宮 啓 ¹ 、境 悠治 ² 、十河 真生 ³ 、宮山 卓也 ³ 、1. 山梨大総合, 2. 山梨大クリーン, 3. アルバック・ファ 坂井 大輔 ³ 、渡邊 勝己 ³ 、チェン リーチュイン ¹ 、伊平岡 賢三 ²
14:30	20p-H137-6	高速重イオンを用いた大気圧 SIMS の開発と応用	○草刈 将一 ¹ 、藤井 麻樹子 ¹ 、瀬木 利夫 ¹ 、青木 学 ¹ 1. 京大院工 聡 ¹ 、松尾 二郎 ¹
14:45	20p-H137-7	低真空クラスター SIMS 分析技術の開発	○鈴木 敢士 ¹ 、草刈 将一 ¹ 、藤井 麻樹子 ¹ 、瀬木 利夫 ¹ 、青木 学聡 ¹ 、松尾 二郎 ¹
15:00	休憩 / Break		
15:15	20p-H137-8	MeV イオン照射 / 熱処理した Nd:YAG での非常に長い光吸収の裾	○雨倉 宏 ¹ 、Akhmadaliev S. ² 、Zhou S. ² 、Cheng F. ³ 1. 物材機構, 2. HZDR, 3. 山東大学
15:30	20p-H137-9	ダイヤモンド蛍光飛跡検出器のイオン種依存性	○立見 和雅 ¹ 、春山 盛善 ^{1,2} 、小野田 忍 ² 、寺地 徳之 ³ 、1. 群馬大工, 2. 原子力機構, 3. 物材機構, 4. 筑波大学 磯谷 順一 ⁴ 、加田 渉 ¹ 、大島 武 ² 、花泉 修 ¹
15:45	20p-H137-10	イオン液体 EMIM-BF ₄ イオンビームの固体表面照射効果	○(M1)西 和哉 ¹ 、上田 弘貴 ¹ 、藤井 志貴 ¹ 、竹内 光明 ¹ 、龍頭 啓亮 ¹ 、高岡 義寛 ¹ 1. 京大院工
16:00	20p-H137-11	イオン液体 EMIM-DCA イオンビームの表面処理応用に関する検討	○竹内 光明 ¹ 、星出 優輝 ¹ 、竹内 裕人 ¹ 、龍頭 啓亮 ¹ 、高岡 義寛 ¹ 1. 京大院工
16:15	20p-H137-12	ガラスクラスターイオンビーム照射による PEEK の表面改質	○魚住 裕樹 ¹ 、豊田 紀章 ¹ 、山田 公 ¹ 1. 兵庫県大院工
16:30	20p-H137-13	酢酸雰囲気下での O ₂ -GCIB 照射による金属エッチングの入射角依存性	○小川 晃広 ¹ 、豊田 紀章 ¹ 、山田 公 ¹ 1. 兵庫県立大院工
16:45	20p-H137-14	スキャン機構を用いた ClF ₃ 中性クラスター反応性エッチング	○瀬木 利夫 ¹ 、吉野 裕 ² 、小池 国彦 ² 、青木 学聡 ¹ 、1. 京大院工, 2. 岩谷産業 松尾 二郎 ¹
17:00	20p-H137-15	ガラスクラスターイオンビームを用いた表面活性化接合の検討	○佐々木 智也 ¹ 、豊田 紀章 ¹ 、山田 公 ¹ 1. 兵庫県立大院工

8 プラズマエレクトロニクス / Plasma Electronics

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

8.11 業績賞受賞記念講演 / Achievement Award Speech

3/20(Sun.) 10:45 - 11:30 口頭講演(Oral Presentation) KD 会場			
10:45	招 20a-KD-6	【第16回応用物理学会業績賞(研究業績)受賞記念講演】(45分) 半導体ドライエッチング技術の先駆的研究開発と産業展開への貢献	○堀池 靖浩 ¹ 1. 筑波大学

8.10 プラズマエレクトロニクス賞授賞式 / Plasma Electronics Award Ceremony

3/20(Sun.) 13:30 - 13:45 口頭講演(Oral Presentation) KD 会場			
13:30	20p-KD-1	プラズマエレクトロニクス賞授賞式	○豊田 浩孝 ¹ 1. プラズマエレクトロニクス分科会

8.9 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演 / Plasma Electronics Invited Talk

3/19(Sat.) 13:45 - 14:15 口頭講演(Oral Presentation) W241 会場			
13:45	招 19p-W241-1	【プラズマエレクトロニクス分科内招待講演】(30分) SiC パワーデバイス研究開発の現状と将来展望	○大森 達夫 ¹ 1. 三菱電機(株)開発本部

8.1 プラズマ生成・制御 / Plasma production and control

3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演(Poster Presentation) P5 会場				
奨 19p-P5-1	PBII 法を用いた芽胞菌の殺菌に与える包装の影響に関する基礎研究	○(B)狩野 卓也 ¹ 、下野 和洋 ¹ 、野口 央照 ¹ 、角川 幸治 ¹ 、林 兼也 ¹ 、齊藤 海 ¹ 、田中 武 ¹	1. 廣工大	
19p-P5-2	マイクロ波プラズマ液体処理におけるエネルギー効率向上	○滝藤 奨 ¹ 、伊藤 美智子 ^{1,2} 、高島 成剛 ² 、野村 記生 ³ 、北川 富則 ³ 、豊田 浩孝 ¹	1. 名大工, 2. ブラシア, 3. 三進製作所	
19p-P5-3	DBD プラズマアクチュエータにおける電流パルス間隔の数値解析	○(M1)佐藤 慎太郎 ¹ 、大西 直文 ¹	1. 東北大工	
19p-P5-4	YAG レーザーを用いた 1kW 級半導体レーザー維持プラズマの着火過程	○(M1)西本 昂司 ¹ 、松井 信 ¹	1. 静大工	
奨 19p-P5-5	大気圧を超える高圧マイクロ波プラズマの生成と診断	○井上 健一 ¹ 、シュタウス スヴェン ¹ 、金 載浩 ² 、寺嶋 和夫 ¹	1. 東大新領域, 2. 産総研	
3/21(Mon.) 9:00 - 12:00 口頭講演(Oral Presentation) W611 会場				
9:00	21a-W611-1	マイクロ波を用いた大気圧ラインプラズマの生成(III)	○宮田 弘志 ¹ 、進藤 春雄 ¹ 、磯村 雅夫 ¹ 、桑畑 周司 ¹ 1. 東海大院工	
9:15	21a-W611-2	大気圧非平衡放電プラズマによる界面活性剤水溶液の分解	○湯地 敏史 ¹ 、岡村 好美 ¹ 、有井 秀和 ¹ 、木之下 広幸 ¹ 、青木 慎二 ²	1. 宮崎大学, 2. ADTEC Plasma Tech.Co.,Ltd.
9:30	21a-W611-3	大気圧 RF 誘電体バリア放電における α と γ 放電モードの比較解析	○トニリチュ ¹	1. 計測エンジニア
9:45	21a-W611-4	大気圧 He/H ₂ O 直流グロー放電における負イオン生成の影響	○岡村 航太 ¹ 、白井 直機 ¹ 、内田 諭 ¹ 、枡久保 文嘉 ¹	1. 首都大院理工
10:00	21a-W611-5	大気圧 Ne 中のナノ秒パルス放電に対する数値解析—液体電極の導電率特性の調査—	○元島 一樹 ¹ 、白井 直機 ¹ 、内田 諭 ¹ 、枡久保 文嘉 ¹	1. 首都大院理工
10:15	休憩 / Break			

10:30	21a-W611-6	タンデム型 ECR イオン源における Xe プラズマ生成とその価数分布およびビーム制御	○大塚 拓郎 ¹ 、長家 知生 ¹ 、西岡田 卓也 ¹ 、萩野 尚吾 ¹ 、佐藤 文信 ¹ 、加藤 裕史 ¹	1. 阪大院工
10:45	奨 21a-W611-7	電子サイクロトロン共鳴イオン源プラズマにおける Xモード 4-6GHz マイクロ波導入実験	○西岡田 卓也 ¹ 、大塚 拓郎 ¹ 、萩野 尚吾 ¹ 、長家 知生 ¹ 、佐藤 文信 ¹ 、加藤 裕史 ¹	1. 阪大院工
11:00	奨 21a-W611-8	タンデム型 ECR イオン源における原子内包フラウンゲン相合成基礎実験	○長家 知生 ¹ 、西岡田 卓也 ¹ 、萩野 尚吾 ¹ 、大塚 拓郎 ¹ 、渡辺 拓人 ¹ 、内田 貴司 ² 、村松 正幸 ³ 、佐藤 文信 ¹ 、北川 敦志 ³ 、加藤 裕史 ¹ 、吉田 善一 ²	1. 阪大院工, 2. 東洋大学, 3. 放医研
11:15	21a-W611-9	タンデム型 ECR イオン源における鉄蒸発源開発と鉄イオンビーム生成	○萩野 尚吾 ¹ 、長家 知生 ¹ 、西岡田 卓也 ¹ 、大塚 拓郎 ¹ 、渡辺 拓人 ¹ 、村松 正幸 ² 、北川 敦志 ² 、佐藤 文信 ¹ 、加藤 裕史 ¹	1. 阪大院工, 2. 放医研
11:30	奨 21a-W611-10	円筒キャビティと固体アンプを用いたマイクロ波プラズマ生成 I I	○(M1) 長谷川 雄一 ¹ 、小川 大輔 ¹ 、中村 圭二 ¹ 、パー クスーナム ² 、小林 理 ² 、菅井 秀郎 ³	1. 中部大工, 2. アプライドマテリアルズ, 3. 名産研
11:45	奨 21a-W611-11	マイクロ波励起水中気泡内プラズマのパルス変動効果	○(M1) 北野 卓也 ¹ 、伊藤 卓也 ¹ 、鈴木 宏明 ¹ 、石島 達夫 ¹ 、田中 康規 ¹ 、上杉 喜彦 ¹	1. 金沢大
8.2 プラズマ診断・計測 / Plasma measurements and diagnostics				
3/20(Sun.) 9:15 - 10:30 口頭講演 (Oral Presentation) KD 会場				
9:15	招 20a-KD-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) プラズマ生成反応活性種供給過程における水表面構造の振動和周波発生分光による診断	○近藤 崇博 ^{1,2} 、伊藤 剛仁 ²	1. 東海大, 2. 阪大工
9:30	奨 20a-KD-2	二波長分光画像から求めた定性的窒素分子回転温度分布の定量化	○(M1) 佐々本 凌 ¹ 、松本 宇生 ¹ 、折居 英章 ¹ 、澤 泰二 ¹ 、西嶋 喜代人 ¹	1. 福岡大工
9:45	奨 20a-KD-3	電子密度測定用マイクロ波ミニプローブの開発	○(B) 堀田 将也 ¹ 、小川 大輔 ¹ 、中村 圭二 ¹ 、菅井 秀郎 ¹	1. 中部大工
10:00	奨 20a-KD-4	低コヒーレンス光干渉法を用いたハイパワーインパルスマグネトロンスパッタリングプロセスにおける高精度シリコン基板温度計測	○(M1) 服部 克宏 ¹ 、太田 貴之 ¹ 、小田 昭紀 ² 、上坂 裕之 ³	1. 名城大理工, 2. 千葉工大, 3. 名大院工
10:15	20a-KD-5	アルゴン・塩素プラズマにおける GaN ダメージのガス比依存性	○伴野 良継 ¹ 、小川 大輔 ¹ 、中野 由崇 ¹ 、中村 圭二 ¹	1. 中部大工
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場				
	奨 E 21p-P4-1	Effect of Electrode Material to Gardien Condenser Current-Voltage Characteristics	○(DC) Camille Corrales Lacdan ¹ 、Motoi Wada ¹	1. Doshisha Univ
	21p-P4-2	質量分析法による DLC 成膜用 Ar/CH ₄ プラズマの診断	○深井 駿 ¹ 、小田 昭紀 ¹ 、上坂 裕之 ² 、太田 貴之 ³	1. 千葉工大, 2. 名大機械, 3. 名城大理工
	21p-P4-3	分光学的手法による大気圧ミストプラズマ診断	○妻木 正尚 ¹ 、伊藤 剛仁 ¹	1. 阪大院工
8.3 プラズマ成膜・表面処理 / deposition of thin film and surface treatment				
3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P6 会場				
	19p-P6-1	裏面照射型粉体 PLD による機能性薄膜の作製 I	○川崎 仁晴 ¹ 、大島 多美子 ¹ 、柳生 義人 ¹ 、猪原 武士 ¹ 、山内 真紀子 ¹	1. 佐世保高専
	19p-P6-2	円筒型ターゲットを用いた高周波磁化プラズマスパッタによる AZO 薄膜の低温合成	○大津 康徳 ¹ 、住山 貴史 ¹ 、山口 真依 ¹ 、田原 竜夫 ² 、本村 大成 ²	1. 佐大院工, 2. 産総研
	19p-P6-3	スロット内生成マイクロ波プラズマを用いた高速プラズマ CVD	○(M1) 山本 毅毅 ¹ 、鈴木 陽香 ¹ 、豊田 浩孝 ^{1,2}	1. 名大工, 2. 名大プラズマナノ工学研究センター
	奨 19p-P6-4	ブルシアンブルー担持磁気ナノ微粒子の作製とその液中セシウムイオンの除去特性	○高柳 俊也 ¹ 、永津 雅章 ^{1,2}	1. 静大院工, 2. 静大創造院
	19p-P6-5	酸素混合プラズマを用いた熱電子発電用半導体エミッタの表面処理	○渡邊 孝俊 ¹ 、羽田 篤史 ¹ 、井上 健吾 ¹ 、萩野 明久 ¹	1. 静大院工
	19p-P6-6	大気圧プラズマジェットにより処理した熱電子発電器用 Si エミッタの電子放出特性	○(M1) 村田 健二郎 ¹ 、萩野 明久 ¹	1. 静大院工
	19p-P6-7	プラズマ支援原子層堆積法による a-TiN _x 薄膜の極低温合成 (II)	○柳 炳学 ¹ 、関 溪太 ¹ 、佐藤 哲也 ¹	1. 山梨大
	19p-P6-8	SiF ₄ 凝縮層の低速電子線誘起反応と水素原子のトンネル反応を利用した a-SiN _x の極低温合成	○坂巻 直 ¹ 、佐藤 哲也 ¹ 、中川 清和 ¹	1. 山梨大
3/22(Tue.) 9:00 - 12:45 口頭講演 (Oral Presentation) W611 会場				
9:00	22a-W611-1	ハイブリッド対向スパッタによる ITO 透明導電膜作製 - 可動棒磁石移動距離依存性 -	○諸橋 信一 ¹ 、辻田 圭佑 ¹ 、谷本 司 ¹ 、原田 直幸 ¹ 、村田 卓也 ¹	1. 山口大工
9:15	22a-W611-2	プラズマ支援反応性スパッタリングを用いたアモルファス IGZO 薄膜トランジスタの低温形成	○節原 裕一 ¹ 、中田 慶太郎 ¹ 、佐竹 義且 ¹ 、○竹中 弘祐 ¹ 、内田 儀一郎 ¹ 、江部 明憲 ²	1. 阪大接合研, 2. イー・エム・ディー
9:30	22a-W611-3	VHF-DC 重畳マグネトロンスパッタによる平坦性向上機構の検討	○巢山 拓 ¹ 、福井 崇史 ¹ 、瀬高 健太 ¹ 、笹井 健典 ¹ 、豊田 浩孝 ^{1,2}	1. 名大工, 2. 名大プラズマナノ工学研究センター
9:45	奨 22a-W611-4	イオンビームスパッタリングによる NaCl 膜の形成	○山野 将史 ¹ 、針谷 達 ¹ 、宮本 優 ¹ 、今井 貴大 ¹ 、須田 善行 ¹ 、滝川 浩史 ¹ 、神谷 雅男 ² 、瀧 真 ³ 、長谷川 裕史 ³ 、辻 信広 ³ 、西内 満美子 ⁴ 、榊 泰直 ⁴ 、近藤 公伯 ⁴	1. 豊橋技科大, 2. 伊藤光学, 3. オンワード技研, 4. 原子力機構
10:00	奨 22a-W611-5	ラジカル支援有機金属化学相成長法による InN 結晶成長	○高井 慎之介 ¹ 、蘆 翌 ¹ 、岩本 一希 ¹ 、小田 修 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、近藤 博基 ¹ 、石川 健治 ¹ 、関根 誠 ¹ 、堀 勝 ¹	1. 名大院工
10:15	奨 22a-W611-6	【注目講演】プラズマ励起化学気相堆積法で成長したアモルファスカーボン膜の吸収端近傍 X 線吸収微細構造における高周波電力依存性	○(M2) 杉浦 啓嗣 ¹ 、賈 凌雲 ¹ 、佐藤 俊一 ¹ 、近藤 博基 ¹ 、石川 健治 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、関根 誠 ¹ 、堀 勝 ¹	1. 名大院工
10:30	休憩 / Break			
10:45	奨 22a-W611-7	リモート窒素プラズマの照射による SiC の表面窒化における放電管材料の影響	○嶋林 正晴 ¹ 、栗原 一彰 ² 、佐々木 浩一 ¹	1. 北大工, 2. IMEC/Toshiba
11:00	22a-W611-8	大気圧低温プラズマを用いたレジストの除去	高井 智基 ¹ 、○山本 雅史 ¹ 、鹿間 共一 ¹ 、長岡 史郎 ¹ 、西山 聖 ² 、堀邊 英夫 ²	1. 香川高専, 2. 大阪市大
11:15	奨 22a-W611-9	水素ラジカルによるレジスト除去における除去速度の酸素添加量依存性	○山本 雅史 ¹ 、梅本 宏信 ² 、大平 圭介 ³ 、鹿間 共一 ¹ 、西山 聖 ⁴ 、堀邊 英夫 ⁴	1. 香川高専, 2. 静大, 3. 北陸先端大, 4. 大阪市大
11:30	奨 22a-W611-10	非平衡大気圧プラズマプロセスによる微細孔内の流速制御	○伊藤 巧 ¹ 、石川 健治 ¹ 、小野島 大介 ¹ 、湯川 博 ¹ 、橋爪 博司 ¹ 、田中 宏昌 ¹ 、木原 直人 ² 、龍腰 健太郎 ² 、小高 秀文 ² 、竹田 圭吾 ¹ 、近藤 博基 ¹ 、関根 誠 ¹ 、馬場 嘉信 ¹ 、堀 勝 ¹	1. 名大院工, 2. 旭硝子

11:45	22a-W611-11	ステンレスのクロムによる酸化層の生成におけるオゾンの影響	○田口 貢士 ¹ 、松本 将大 ¹ 、安達 稷 ¹ 、登尾 一幸 ¹	1. 魁半導体
12:00	22a-W611-12	低温プラズマによる黒鉛粉体のフッ化処理	○田口 貢士 ¹ 、安達 稷 ¹ 、松本 将大 ¹ 、登尾 一幸 ¹	1. 魁半導体
12:15	奨 22a-W611-13	誘電体バリア放電を用いた大気圧プラズマ窒化	○津留 卓斗 ¹ 、喜多村 圭一 ¹ 、市来 龍大 ¹ 、赤峰 修一 ¹ 、金澤 誠司 ¹	1. 大分大工
12:30	22a-W611-14	混合粉体ターゲットを用いた AZO のスパッタリング成膜	○大島 多美子 ¹ 、川崎 仁晴 ¹ 、柳生 義人 ¹ 、猪原 武一 ¹ 、佐世保高専 士 ¹ 、須田 義昭 ¹	1. 佐世保高専
8.4 プラズマエッチング / Plasma etching				
3/19(Sat.) 14:30 - 17:45 口頭講演(Oral Presentation) W621 会場				
14:30	19p-W621-1	ダウンフローエッチングにおける活性種輸送の考察	○石川 健治 ¹ 、関根 誠 ¹ 、林 俊雄 ¹ 、堀 勝 ¹ 、堀池 靖浩 ²	1. 名古屋大学, 2. 筑波大学
14:45	19p-W621-2	有機膜表面における活性種によるエッチング反応の基板温度依存性	○福永 裕介 ¹ 、堤 隆嘉 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、石川 健治 ¹	1. 名大院工
15:00	19p-W621-3	フーリエ変換赤外吸収分光法を用いたプラズマエッチングにおける基板表面温度測定	○(D) 中崎 暢也 ¹ 、福島 大介 ¹ 、宮田 浩貴 ¹ 、津田 博隆 ¹ 、鷹尾 祥典 ¹ 、江利口 浩二 ¹ 、斧 高一 ¹	1. 京大院工
15:15	19p-W621-4	層間絶縁膜へのプラズマダメージの電気解析手法	○(M1) 西田 健太郎 ¹ 、岡田 行正 ¹ 、鷹尾 祥典 ² 、江利口 浩二 ¹ 、斧 高一 ¹	1. 京大院工, 2. 横国大院工
15:30	19p-W621-5	He/H ₂ プラズマ照射による垂直磁化 CoFeB 膜への磁気ダメージ評価	○佐竹 真 ^{1,2} 、山田 将貴 ¹	1. 日立ハイテク, 2. 阪大院工
15:45	奨 19p-W621-6	H ₂ /Ar プラズマによる ITO エッチングに対する水素変質層の効果	○平田 瑛子 ¹ 、深沢 正永 ¹ 、重蔵 卓志 ¹ 、岡本 正喜 ¹ 、長畑 和典 ² 、李 虎 ² 、浜口 智志 ² 、辰巳 哲也 ¹	1. ソニー, 2. 阪大院工
16:00	休憩 / Break			
16:15	奨 19p-W621-7	負荷インピーダンス測定手法によるプラズマエッチングチャンパー内壁の監視	○笠嶋 悠司 ¹ 、上杉 文彦 ¹	1. 産総研
16:30	19p-W621-8	YOF セラミックスのプラズマ耐性評価	○津之浦 徹 ¹ 、吉田 克己 ¹ 、矢野 豊彦 ¹	1. 東工大
16:45	奨 19p-W621-9	ガラスの表面微細加工における金属添加物による影響の解析	○(M1) 吉武 高輝 ¹ 、石川 健治 ¹ 、関根 誠 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、近藤 博基 ¹ 、堀 勝 ¹	1. 名大院工
17:00	19p-W621-10	C ₂ F ₆ 分子の電子物性と解離	○林 俊雄 ¹ 、石川 健治 ¹ 、関根 誠 ¹ 、堀 勝 ¹	1. 名古屋大学工
17:15	19p-W621-11	中性粒子ビーム励起錯体反応による遷移金属エッチングメカニズムの Tight-binding 量子分子動力学法を用いた検討	○久保田 智広 ¹ 、伊藤 寿 ² 、久保 百司 ² 、寒川 誠二 ^{1,3}	1. 東北大流体研, 2. 東北大金研, 3. 東北大 WPI-AIMR
17:30	19p-W621-12	次世代高密度実装基板向けドライデスマア技術の開発	佐藤 宗之 ¹ 、森川 泰宏 ¹ 、○村山 貴英 ¹ 、谷 典明 ¹ 、米田 昌弘 ¹	1. アルバック
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演(Poster Presentation) P5 会場				
	21p-P5-1	吸引プラズマによる Si 基板の高速局所エッチング加工	○宮脇 淳 ¹ 、狩野 諒 ² 、菅 洋志 ² 、久保 利隆 ¹ 、安藤 淳 ¹ 、高橋 賢 ³ 、新堀 俊一郎 ³ 、清水 哲夫 ¹	1. 産総研, 2. 千葉工大, 3. 三友製作所
	21p-P5-2	中性粒子ビーム励起錯体反応を用いた遷移金属エッチングにおける吸着分子の影響	○久保田 智広 ¹ 、菊地 良幸 ² 、伊藤 寿 ³ 、久保 百司 ³ 、寒川 誠二 ^{1,4}	1. 東北大流体研, 2. 東京エレクトロン(株), 3. 東北大金研, 4. 東北大 WPI-AIMR
8.5 プラズマナノテクノロジー / nanotechnology.				
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演(Poster Presentation) P6 会場				
	21p-P6-1	斜め堆積反応性蒸着の基板角度変化における堆積シミュレーション	○(M1) 仲尾 昌浩 ¹ 、井上 泰志 ¹ 、高井 治 ²	1. 千葉工大, 2. 関東学院大
	21p-P6-2	高周波マグネトロンプラズマ CVD によるグラフェンの成長と解析	○(B) 石徹白 智 ¹ 、山田 隼也 ¹ 、河村 佑馬 ¹ 、林 康明 ¹	1. 京都工繊大
	21p-P6-3	大気開放型水素 / アルゴンプラズマジェットで合成される金ナノ粒子の粒径制御	○清水 禎樹 ¹ 、伯田 幸也 ¹	1. 産総研 ナノ材料
	21p-P6-4	レーザーアブレーションプラズマ粒子束照射イオン液体法によるシリコンナノ粒子合成	○伊藤 剛仁 ¹ 、津田 哲哉 ¹ 、宗岡 均 ² 、ピアド コーリー ¹ 、桑畑 進 ¹	1. 阪大工, 2. 東大新領域
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演(Oral Presentation) W621 会場				
9:00	22a-W621-1	メタンプラズマにおける化学反応解析のための有向グラフを用いたネットワーク構造分析(II)	○(M1) 信藤 恭佑 ¹ 、宮城 茂幸 ¹ 、橋 邦英 ² 、酒井 道 ¹	1. 滋賀県立大, 2. 大阪電通大
9:15	22a-W621-2	グラフェン成長初期過程のレーザー偏光解析モニタリング	○川野 正裕 ¹ 、山田 隼也 ¹ 、石徹白 智 ¹ 、○林 康明 ¹	1. 京都工繊大
9:30	22a-W621-3	プラズマ化学輸送法による h-BN 原子層の形成に向けて - キャリアガスの影響 2	○北嶋 武 ¹ 、中野 俊樹 ¹	1. 防大電気
9:45	22a-W621-4	ヘリウムプラズマ照射による鉄及びニオブの表面構造変化	○梶田 信 ¹ 、石田 智哉 ² 、三室 文明 ³ 、大野 哲靖 ²	1. 名大未来研, 2. 名大院工, 3. 名大工
10:00	奨 22a-W621-5	マグネトロンスパッタリングにより生成したスズ微粒子の保持および基板への輸送	○(BC) 高成 和史 ¹ 、ナファリザル ナヤン ² 、佐々木 浩一 ¹	1. 北海道大学, 2. Univ. Tun Hussein Onn Malaysia
10:15	22a-W621-6	コンパクトドリフトチューブを用いたプラズマ生成ダスト捕集	○白谷 正治 ¹ 、片山 龍一 ¹ 、古閑 一憲 ¹ 、山下 大輔 ¹ 、徐 鉉雄 ¹ 、板垣 奈穂 ¹ 、増崎 貴 ² 、芦川 直子 ² 、時谷 政行 ² 、西村 清彦 ² 、相良 明男 ² 、LHD 実験グループ ²	1. 九大シス情, 2. 核融合研
10:30	休憩 / Break			
10:45	招 22a-W621-7	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 水 / 有機溶液中ソリューションプラズマによる金ナノ粒子高速合成	○藤 智仁 ¹ 、上野 智永 ^{1,4} 、齋藤 永宏 ^{1,2,3,4}	1. 名大院工, 2. 名大グリモ, 3. 名大未来, 4. JST-CREST
11:00	奨 22a-W621-8	高圧液中レーザーアブレーション法を用いて作製した酸化亜鉛ナノ粒子酸素センサにおける酸素応答モデル	○後藤 拓 ¹ 、清水 禎樹 ² 、保田 英洋 ¹ 、伊藤 剛仁 ¹	1. 阪大院工, 2. 産総研
11:15	22a-W621-9	離散的ナノ柱状構造化 InN 薄膜の非水電解質中の AiEC における表面吸着物の変化	○(M2) 掛川 尊重 ¹ 、井上 泰志 ¹ 、高井 治 ²	1. 千葉工大, 2. 関東学院大
11:30	奨 22a-W621-10	プラズマスプレー PVD による Li イオン二次電池用 Si-Ni 複合ナノ負極の特性向上	○深田 航平 ¹ 、太田 遼至 ¹ 、神原 淳 ¹	1. 東大院工
11:45	奨 22a-W621-11	TiO ₂ ナノ粒子生成中の ICTP トーチ内における Ti 励起温度二次元分布	○兒玉 直人 ¹ 、北 健太郎 ¹ 、石坂 洋輔 ¹ 、田中 康規 ¹ 、上杉 喜彦 ¹ 、石島 達夫 ¹ 、末安 志織 ² 、中村 圭太郎 ²	1. 金大院自然, 2. 日清製粉グループ本社
8.6 プラズマライフサイエンス / Plasma life sciences				
3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演(Poster Presentation) P7 会場				
	19p-P7-1	大気圧プラズマ照射による大腸菌と酵母の不活化機構	○眞弓 尚大 ¹ 、林 信哉 ¹ 、井上 麻美 ² 、田代 康介 ²	1. 九大総理工, 2. 九大農学部, 3. 佐世保高専 久原 哲 ² 、柳生 義人 ³

奨	19p-P7-2	プラズマバブルによる遺伝子導入	○(B)大隣 啓志 ¹ 、尾形 宏輝 ¹ 、辻本 大介 ¹ 、山西 陽子 ^{1,2}	1.芝工大, 2.JST PRESTO
	19p-P7-3	プラズマガス温度が殺菌能に影響を与える要因調査	○堂山 英之 ¹ 、川野 浩明 ¹ 、高松 利寛 ² 、松村 有里子 ³ 、宮原 秀一 ¹ 、岩澤 篤郎 ³ 、東 健 ² 、沖野 晃俊 ¹	1.東工大総理工, 2.神戸大院医学, 3.東工大生命理工
	19p-P7-4	誘電体バリア放電によって生成された活性種による口腔がん細胞の不活化効果	○(D)小野 大帝 ¹ 、大坪 哲也 ¹ 、林 信哉 ¹ 、合島 恰	1.九大総理工, 2.佐賀大医
	19p-P7-5	誘電体バリア放電の生成条件による長寿命の中性活性種への影響	○松井 慧 ¹ 、池永 訓昭 ¹ 、作道 訓之 ¹	1.金沢工大
	19p-P7-6	大気圧低温プラズマによる心筋梗塞治療効果の検討に向けたモデルラットの作製方法の検討	○(MIC)脇田 諭 ¹ 、渡邊 寛輝 ¹ 、山下 諒祐 ¹ 、崎 拓哉 ¹ 、森 晃 ¹ 、和多田 雅哉 ¹ 、平田 孝道 ¹	1.都市大工
奨	19p-P7-7	血液凝固現象理解のための He / Ar 大気圧低エネルギープラズマの特性計測	○(DC)山田 大将 ^{1,2} 、堀田 朋敬 ^{1,2} 、榊田 創 ^{1,2} 、加藤 進 ² 、板垣 宏知 ² 、金 載浩 ² 、藤原 正純 ² 、木山 伸幸 ⁶ 、池原 讓 ⁴	1.筑波大院システム情報, 2.産総研 電子光, 3.産総研 ナノチューブ, 4.産総研 創薬基盤, 5.愛知県がんセンター, 6.山王病院
奨	19p-P7-8	抗体結合プラズマ修飾磁気ナノ粒子による液中大腸菌の選択的検出	○杉浦 邦昂 ¹ 、Viswan Anchu ² 、永津 雅章 ^{1,2}	1.静大院工, 2.静大創造院
	19p-P7-9	プラズマ照射による植物工場用培養液への影響評価	○(B)鬼頭 昌也 ¹ 、関 聡史 ¹ 、吉田 陵平 ¹ 、安井 晋示 ¹ 、庄子 和博 ² 、寺添 斉 ²	1.名工大, 2.電中研
奨	19p-P7-10	大気圧非平衡プラズマを用いた粉状茶葉の低温殺菌	○濱嶋 周平 ¹ 、河村 尚寿 ² 、永津 雅章 ¹	1.静岡大学, 2.クメタ製作所
奨	19p-P7-11	ガス流量制御空気プラズマ活性種の分生子発芽抑制効果	○嶋田 啓亮 ¹ 、小西 秀明 ¹ 、高島 圭介 ¹ 、金子 俊郎 ¹	1.東北大院工
	19p-P7-12	大気圧プラズマによる農産物連続殺菌装置の開発	○柳生 義人 ¹ 、宮本 大毅 ¹ 、作道 章一 ² 、三島 朋子 ⁴ 、西岡 輝美 ⁴ 、大島 多美子 ¹ 、猪原 武士 ¹ 、川崎 仁晴 ¹ 、林 信哉 ² 、須田 義昭 ¹	1.佐世保高専, 2.琉大医学, 3.九大総理工, 4.大阪府立環境農水研
	19p-P7-13	プラズマ活性培養液による抗腫瘍効果の制御とその細胞内分子機構	○田中 宏昌 ¹ 、水野 正明 ¹ 、石川 健治 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、橋爪 博司 ¹ 、中村 香江 ¹ 、梶山 広明 ¹ 、加納 浩之 ² 、岡崎 泰昌 ¹ 、豊國 伸哉 ¹ 、吉川 史隆 ¹ 、堀 勝 ¹	1.名古屋大, 2.NU エコエンジニアリング
	19p-P7-14	酸素ラジカル照射された溶液中の次亜塩素酸の酵母細胞活性への影響	○橋爪 博司 ¹ 、小林 潤 ² 、太田 貴之 ¹ 、伊藤 昌文 ²	1.名古屋大学, 2.名城大学理工
	19p-P7-15	プラズマ活性培養液処理による乳がん細胞の殺傷および増殖の観察	○橋爪 博司 ¹ 、田中 宏昌 ¹ 、中村 香江 ¹ 、石川 健治 ¹ 、加納 浩之 ² 、水野 正明 ¹ 、堀 勝 ¹	1.名古屋大学, 2.NU エコ
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W621 会場				
	9:00	21a-W621-1 支持脂質二重膜への誘電体バリア放電処理による表面構造変化の観察	○湯佐 佐太 ¹ 、須田 善行 ¹ 、山下 龍舞 ¹ 、滝川 浩文 ¹ 、針谷 達 ¹ 、手老 龍吾 ^{2,3}	1.豊技大電気・電子情報, 2.豊技大環境・生命, 3.豊技大 EIRIS
	9:15	21a-W621-2 プラズマ由来液中活性種が誘導する細胞内カルシウム濃度上昇・振動	○佐々木 渉太 ¹ 、保苅 雄太郎 ¹ 、神崎 展 ² 、金子 俊郎 ¹	1.東北大院工, 2.東北大院医工
	9:30	奨 21a-W621-3 誘電体バリア放電方式液中マイクロプラズマによる 2,6-ジプロモフェノール水溶液の分解	○(B)小島 信一郎 ¹ 、平山 けい子 ¹ 、秋津 哲也 ¹	1.山梨大工
	9:45	奨 21a-W621-4 酸素ラジカル照射によるマウス線維芽細胞の細胞生存性への影響	○(B)小泉 貴義 ¹ 、森 洋介 ¹ 、村田 富保 ¹ 、堀 勝 ² 、伊藤 昌文 ¹	1.名城大, 2.名古屋大
	10:00	奨 21a-W621-5 酸素ラジカル照射によるリン酸緩衝生理的食塩水中の微生物不活性化効果	○(M1)小林 剛士 ¹ 、橋爪 博司 ² 、太田 貴之 ¹ 、石川 健治 ² 、堀 勝 ² 、伊藤 昌文 ¹	1.名城大理工, 2.名大
	10:15	奨 21a-W621-6 液相微小プラズマを用いた接着細胞への薬剤分子導入	○保苅 雄太郎 ¹ 、佐々木 渉太 ¹ 、神崎 展 ² 、佐藤 岳彦 ³ 、金子 俊郎 ¹	1.東北大院工, 2.東北大院医工, 3.東北大流体研
	10:30	休憩 / Break		
	10:45	奨 21a-W621-7 プラズマ活性培養液 (PAM) 内活性酸素・窒素種の解析	○(M2)倉家 尚之 ¹ 、田中 宏昌 ¹ 、石川 健治 ¹ 、橋爪 博司 ¹ 、中村 香江 ² 、梶山 広明 ² 、吉川 史隆 ² 、近藤 隆 ³ 、水野 正明 ² 、竹田 圭吾 ¹ 、近藤 博基 ¹ 、関根 誠 ¹ 、堀 勝 ¹	1.名大院工, 2.名大医, 3.富山大
	11:00	奨 21a-W621-8 プラズマ活性培養液中の HeLa 細胞の動的観察	○(M1)古田 凌 ¹ 、橋爪 博司 ¹ 、石川 健治 ¹ 、田中 宏昌 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、太田 貴之 ² 、近藤 博基 ¹ 、伊藤 昌文 ² 、関根 誠 ¹ 、堀 勝 ¹	1.名大院工, 2.名城大
	11:15	奨 21a-W621-9 高速原子間力顕微鏡を用いたプラズマ活性培養液による脂質二重膜の形状変化の解析 (II)	○戸波 卓也 ¹ 、倉家 尚之 ¹ 、橋爪 博司 ¹ 、近藤 博基 ¹ 、石川 健治 ¹ 、竹田 圭吾 ¹ 、田中 宏昌 ¹ 、関根 誠 ¹ 、伊藤 昌文 ² 、手老 龍吾 ³ 、堀 勝 ¹	1.名大院工, 2.名城大, 3.豊橋技科大
	11:30	21a-W621-10 プラズマバブル水生成法の提案および殺菌効果の調査	○小林 智裕 ¹ 、菅原 修馬 ¹ 、川野 浩明 ¹ 、高松 利寛 ² 、松村 有里子 ³ 、宮原 秀一 ¹ 、岩澤 篤郎 ³ 、東 健 ² 、沖野 晃俊 ¹	1.東工大総理工, 2.神戸大院医学, 3.東工大生命理工
	11:45	E 21a-W621-11 Rate of O ₃ production in DBD chamber and its effect on spore surface modification	○(D)Mohammad Rasel Pervez, Takanori Inomata ¹ , Tatsuo Ishijima ¹ , Makiko Kakikawa ¹ , Yasunori Tanaka ¹ , Yohishiko Uesugi ¹ , Toshihiro Yano ² , Shoji Miwa ³ , Akinori Noguchi ⁴	1.kanazawa univ., 2.Kanazawa Gakuin Junior College, 3.Ishikawa Agri. Forest. Res. Cent., 4.Sodick Co., Ltd.
	12:00	奨 21a-W621-12 大気圧空気プラズマ中の活性種によるイネ防菌関連遺伝子に対する発現誘導効果	○小西 秀明 ¹ 、嶋田 啓亮 ¹ 、高島 圭介 ¹ 、安藤 杉尋 ² 、高橋 英樹 ² 、金子 俊郎 ¹	1.東北大院工, 2.東北大院農
3/21(Mon.) 15:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W621 会場				
	15:30	21p-W621-1 遺伝子変異体を用いた大気圧プラズマ滅菌における活性酸素の作用の検証	○松浦 寛人 ¹ 、藤山 貴友 ¹ 、奥野 泰希 ¹ 、坂元 仁 ¹ 、土戸 哲明 ¹	1.大阪府大
	15:45	21p-W621-2 大気圧プラズマ照射によって生じる DNA 損傷の molecular beacon による迅速計測	○栗田 弘史 ¹ 、宮近 沙希 ¹ 、安田 八郎 ¹ 、高島 和則 ¹ 、水野 彰 ¹	1.豊橋技科大
	16:00	21p-W621-3 酵母の遺伝子発現に FE-DBD プラズマが与える影響 — マイクロアレイ法を用いた解析 —	○柳生 義人 ¹ 、林 信哉 ² 、山崎 隆志 ¹ 、田中 眞子 ¹ 、大島 多美子 ¹ 、越村 匡博 ¹ 、宮本 大毅 ¹ 、猪原 武士 ¹ 、川崎 仁晴 ¹ 、須田 義昭 ¹	1.佐世保高専, 2.九大総理工
	16:15	21p-W621-4 プラズマ遺伝子・分子導入におけるクラスリン依存エンドサイトーシス	○大西 章仁 ¹ 、磯崎 勇希 ¹ 、木戸 祐吾 ^{1,2} 、池田 善久 ¹ 、本村 英樹 ¹ 、佐藤 晋 ^{1,3} 、橋 邦英 ¹ 、神野 雅文 ¹	1.愛媛大学理工, 2.パール工業, 3.ワイズ, 4.大阪電通大工
	16:30	21p-W621-5 プラズマ遺伝子導入法における細胞障害	○池田 善久 ¹ 、木戸 祐吾 ² 、本村 英樹 ¹ 、佐藤 晋 ^{1,3} 、神野 雅文 ¹	1.愛媛大院理工, 2.パール工業, 3.ワイズ
	16:45	21p-W621-6 プラズマ遺伝子導入機序に対する導入分子の影響	○佐藤 晋 ^{1,2} 、明上 純子 ¹ 、木戸 祐吾 ^{1,3} 、池田 善久 ¹ 、本村 英樹 ¹ 、神野 雅文 ¹	1.愛媛大学, 2.ワイズ, 3.パール工業

17:00	21p-W621-7	分子動力学法による膜構成分子と活性酸素種における反応機構の検討	○吉田 健人 ¹ 、白井 直機 ¹ 、内田 論 ¹ 、枡久保 文嘉 ¹	1. 首都大理工
17:15	21p-W621-8	プラズマによる液中化学種生成とその誘起する代謝応答シミュレーション	○幾世 和将 ¹ 、浜口 智志 ¹	1. 阪大工
17:30	奨 21p-W621-9	低 pH 法を用いた大気圧低温プラズマによるブタ皮膚面の殺菌	○横山 高史 ¹ 、井川 聡 ² 、北野 勝久 ¹	1. 阪大工, 2. 大阪産技研
17:45	21p-W621-10	反応速度論に基づくプラズマ処理水殺菌活性の pH 依存の物理化学機構	○北野 勝久 ¹ 、井川 聡 ² 、中島 陽一 ² 、横山 高史 ¹ 、谷 篤史 ³	1. 阪大工, 2. 大阪産技研, 3. 阪大理
8.7 プラズマ現象・新応用・融合分野 / Plasma phenomena, emerging area of plasmas and their new applications				
3/19(Sat.) 14:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W611 会場				
14:30	奨 19p-W611-1	c-C ₂ F ₆ ガスの電子衝突断面積	○(D)川口 悟 ¹ 、高橋 一弘 ¹ 、佐藤 孝紀 ¹ 、伊藤 秀 1. 室蘭工大	範 ¹
14:45	奨 19p-W611-2	ヘリコンプラズマを用いた CO ₂ のメタン化における CH ₄ 収率と生成速度の CO ₂ ガス流量依存性	○都甲 将 ¹ 、古閑 一憲 ¹ 、白谷 正治 ¹	1. 九州大学
15:00	奨 19p-W611-3	誘電体バリア放電の空間アフターグローガス中でのレーザー着火実験で観測された火炎核伝播の放電条件に対する依存性	○出口 祐世 ¹ 、佐々木 浩一 ¹	1. 北大工
15:15	奨 19p-W611-4	水面上プラズマを用いたグラファイトの親水化	○(M1)星野 修平 ¹ 、竹内 希 ¹	1. 東工大理工
15:30	奨 19p-W611-5	パルスダイアフラム放電による過酸化水素生成	○(M1)村松 純 ¹ 、佐伯 亮 ¹ 、安岡 康一 ¹	1. 東工大理工
15:45	奨 19p-W611-6	希ガスをを用いた低温プラズマ中の水滴の相変化	○(B)森山 誠 ¹ 、中村 圭二 ¹ 、小川 大輔 ¹	1. 中部大工
16:00	19p-W611-7	液相レーザーアブレーション誘起キャビテーション気泡での放電特性	高橋 裕太 ¹ 、○佐々木 浩一 ¹	1. 北大工
16:15	休憩 / Break			
16:30	19p-W611-8	プラズマ支援電解を用いた磁性ナノ粒子合成における溶存酸素の影響	○山崎 裕也 ¹ 、白井 直機 ¹ 、内田 論 ¹ 、枡久保 文嘉 ¹	1. 首都大理工
16:45	19p-W611-9	ダイアフラム放電による有機フッ素化合物 PFOS の分解	○衛藤 輝 ¹ 、竹内 希 ¹	1. 東工大
17:00	19p-W611-10	周辺雰囲気ガス制御型プラズマジェット照射による溶液中活性酸素・窒素種生成	○内田 儀一郎 ¹ 、中島 厚 ¹ 、伊藤 泰喜 ¹ 、竹中 弘祐 ¹ 、節原 裕一 ¹	1. 阪大接合研
17:15	19p-W611-11	【注目講演】水中密閉型気液界面プラズマ反応による CO ₂ から過ギ酸の合成 (I)	○橋 邦英 ¹ 、川崎 三津夫 ² 、中村 敏浩 ¹ 、森田 達夫 ³	1. 大阪電通大, 2. 京大工, 3. PM ディメンジョンズ
17:30	19p-W611-12	水中密閉型気液界面プラズマ反応による CO ₂ から過ギ酸の合成 (II)	○川崎 三津夫 ^{1,2} 、橋 邦英 ² 、中村 敏浩 ² 、森田 達夫 ³	1. 京大工, 2. 大阪電通大, 3. PM ディメンジョンズ (株)
17:45	19p-W611-13	三次元集積マイクロソリューシオンプラズマによる大腸菌の殺菌	○白藤 立 ¹ 、山本 純平 ¹ 、田中 健司 ¹ 、中西 猛 ¹ 、北村 昌也 ¹	1. 大阪市大工
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7 会場				
	21p-P7-1	水素プラズマを用いた二酸化炭素還元によるメタン生成反応	○佐藤 史明 ¹ 、飯塚 哲 ¹	1. 東北大院工
	奨 21p-P7-2	消化ガスの有効利用のための放電脱硫	○(M1)西岡 大介 ¹ 、高橋 一弘 ¹ 、佐藤 孝紀 ¹ 、伊藤 秀範 ¹	1. 室蘭工大
	21p-P7-3	水溶液中放電プラズマによるメチレンブルーの分解	高橋 武 ¹ 、松永 智生 ¹ 、高橋 繁希 ¹ 、吉村 拓充 ¹ 、○大川 博司 ^{1,2}	1. HSU 未来産業, 2. 山梨大院医工
	21p-P7-4	ソリューシオンプラズマを用いた HMF の新たな生成工程	○牟田 幸浩 ¹ 、Watthanaphanit Anyarat ² 、齋藤 永宏 ^{1,2,3,4}	1. 名大院工, 2. 名大 GREMO, 3. 名大未来社会創造機構, 4. JST-CREST, 5. マヒドン大理
	21p-P7-5	液体電極を用いた大気圧グロー放電による金ナノ粒子合成と放電条件との相関	二戸 愛仁 ¹ 、○白井 直機 ¹ 、内田 論 ¹ 、枡久保 文嘉 ¹	1. 首都大
	21p-P7-6	プラズマによる動的マイクロ波アンテナと電波クロッキングの数値解析	○山口 修平 ¹ 、Alexandre Bambina ¹ 、宮城 茂幸 ¹ 、酒井 道 ¹	1. 滋賀県立大工
	21p-P7-7	アルゴン雰囲気中でのメチレンブルー水溶液への大気圧プラズマジェット照射	○内田 雅人 ¹ 、磯村 雅夫 ¹ 、桑畑 周司 ¹	1. 東海大院工
	21p-P7-8	アルミ蒸着薄膜への大気圧プラズマジェット照射 (II)	○山口 健志 ¹ 、磯村 雅夫 ¹ 、桑畑 周司 ¹	1. 東海大院工
	21p-P7-9	イオン風を利用した大気浮遊粒子の捕集機構解析	○伊藤 智子 ¹ 、陈 龙威 ² 、浜口 智志 ¹	1. 阪大院工, 2. 中国科学院
	21p-P7-10	プラズマによる植物種子の性質変化と成長促進	中矢 大輝 ¹ 、松田 聡一郎 ¹ 、○大川 博司 ^{1,2}	1. HSU 未来産業, 2. 山梨大院医工
8.8 Plasma Electronics English Session				
3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P8 会場				
	奨 E 19p-P8-1	Development of High-Density RF Magnetized Sputtering Plasma Source with Square-Shaped Arrangement of Magnets for Uniform Target Utilization	○(D)MD AMZAD HOSSAIN ^{1,2,3} 、Koichirou Ikari ¹ 、Tsubasa Ide ¹ 、Yasunori Ohtsu ¹	1. Saga University, 2. JesUni SciTech, 3. RajUniv EngTech
3/21(Mon.) 15:30 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) W611 会場				
15:30	奨 E 21p-W611-1	Thermal Conductivity of SiNCs/Polymer Nanocomposite for Super Thermal Insulating Material	○(M2)Firman Bagja Juangsa ¹ 、Yoshiki Muroya ¹ 、Meguya Ryu ¹ 、Junko Morikawa ¹ 、Tomohiro Nozaki ¹	1. Tokyo Tech
15:45	奨 E 21p-W611-2	Copper induced hollow carbon nanospheres by arc discharge method: controlled synthesis and formation mechanism	○(D)Hu Rui ^{1,2} 、Wang Xiangke ² 、Nagatsu Masaaki ¹	1. Shizuoka Univ., 2. CAS
16:00	奨 E 21p-W611-3	Biomolecules Patterning via Atmospheric Pressure Plasma Jet for the Development of Carbon Nanotube Microarrays	○(D)Tomy Abuzairi ^{1,2} 、Mitsuru Okada ³ 、Nji R. Poespawati ² 、Retno W. Purnamaningsih ² 、Masaaki Nagatsu ^{1,3}	1. GSST, Shizuoka Univ., 2. Indonesia Univ., 3. GSE, Shizuoka Univ.
16:15	E 21p-W611-4	Effect of Plasma Treatment for Tensile Strength and Wear Resistance of Polyurethane Composing MWCNTs	○DAISUKE OGAWA ¹ 、Keiji Nakamura ¹	1. Chubu University
16:30	E 21p-W611-5	Efficient second-harmonic generation by microwave plasma with metamaterial effect (IV)	○Akinori Iwai ^{1,2} 、Yoshihiro Nakamura ¹ 、Osamu Sakai ²	1. Kyoto Univ., 2. Univ. Shiga Pref
16:45	E 21p-W611-6	UV Absorption Spectroscopy for Investigation of Ozonated Water	○(PC)JunSeok Oh ^{1,2} 、Hideki Yajima ³ 、Satsuki Ito ¹ 、Izumi Serizawa ³ 、Akimitsu Hatta ^{1,2}	1. Kochi Univ. Technol., 2. Center Nanotechnol., 3. ORC Manufacturing Co
17:00	E 21p-W611-7	Analysis of microplasma discharge process in sea water	○(D)Vladislav Anatolievich Gamaleev ¹ 、Hayato Morita ¹ 、Jun-Seok Oh ¹ 、Hiroshi Furuta ¹ 、Akimitsu Hatta ¹	1. Kochi Univ. of Tech.

9 応用物性 / Applied Materials Science

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

9.1 誘電材料・誘電体 / Dielectrics, ferroelectrics

3/19(Sat.) 13:45 - 15:00 口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場				
13:45	19p-W833-1	BaTiO ₃ の order-disorder モードのイオン分極への寄与	○(M2) 金原 一樹 ¹ 、保科 拓也 ¹ 、武田 博明 ¹ 、鶴見 敬章 ¹	1. 東工大院理工
14:00	E 19p-W833-2	Electroinduced anisotropy in phonon crystals by crossed electrode structure	○(D)Siarhei Dmitrich Barsukou ^{1,2} , Jun Kondoh ² , Siarhei Khakhomov ¹	1.Gomel State University, 2.Shizuoka University
14:15	奨 19p-W833-3	YAlO ₃ のテラヘルツ周波数帯における吸収スペクトル	○黒田 康裕 ¹ 、森本 貴明 ¹ 、大木 義路 ^{1,2}	1. 早大先進理工, 2. 早大材研
14:30	奨 19p-W833-4	非化学量論組成 Ba _{0.8} Sr _{0.2} TiO _{3-δ} におけるチューナブル特性と分極の寄与	○(M1) 大崎 浩司 ¹ 、寺西 貴志 ¹ 、林 秀考 ¹ 、岸本 昭 ¹	1. 岡大院自然
14:45	E 19p-W833-5	Electrical and Structural Properties of BiFeO ₃ -BaTiO ₃ lead-free piezoelectric ceramics	○(D)Sangwook Kim ¹ , Satoshi Wada ¹	1.Interdisciplinary Graduate School of Medicine and Engineering, University of Yamanashi
3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P9 会場				
19p-P9-1		KSr ₂ Nb ₂ O ₁₅ セラミックスの比誘電率温度特性におよぼす ZrO ₂ および Ta ₂ O ₅ 添加の影響	梶原 雅 ¹ 、梶原 優奈 ¹ 、味方 陵 ¹ 、○岩井 裕 ¹	1. 長岡高専
19p-P9-2		AlN 圧電薄膜への Mg と Nb の添加効果	上原 雅人 ^{1,3} 、○(M1) 重本 北斗 ³ 、長瀬 智美 ¹ 、會田 康弘 ² 、梅田 圭一 ² 、秋山 守人 ¹	1. 産総研, 2. 村田製作所, 3. 九大総理工
19p-P9-3		層状チタン酸を用いたチタン酸バリウム-チタン酸ビスマズナトリウム < 110 > 配向セラミックスの作製と圧電特性評価	○(MIC) 伊藤 亮 ¹ 、上野 慎太郎 ¹ 、中島 光一 ¹ 、董 敦灼 ² 、舞田 雄一 ² 、和田 智志 ¹	1. 山梨大, 2. 本多電子株式会社
19p-P9-4		(Bi _{0.5} Na _{0.5})TiO ₃ 系セラミックスの圧電的諸特性に対する機械的拘束の影響	○橋本 達彦 ¹ 、永田 肇 ¹ 、竹中 正 ¹	1. 東理大理工
19p-P9-5		BaTiO ₃ -(Bi _{1-x} K _x)TiO ₃ -Bi(Mg _{0.5} Ti _{0.5})O ₃ -BiFeO ₃ 系セラミックスの分極処理と圧電特性評価	○(MIC) 有泉 真 ¹ 、上野 慎太郎 ¹ 、中島 光一 ¹ 、和田 智志 ¹ 、峯本 尚 ²	1. 山梨大, 2. コニカミノルタ株式会社
19p-P9-6		ソルゲル法によるチタン酸バリウム系ナノ複合セラミックスの作製条件の最適化とその誘電特性	○(M1) 渡邊 美紀 ¹ 、上野 慎太郎 ¹ 、中島 光一 ¹ 、和田 智志 ¹	1. 山梨大学
19p-P9-7		マイクロ波加熱ソルゲル法を用いた BaTiO ₃ ナノキューブの合成および形状評価	○渡邊 睦己 ¹ 、近田 司 ¹ 、中島 光一 ¹ 、上野 慎太郎 ¹ 、和田 智志 ¹	1. 山梨大学
3/20(Sun.) 9:30 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場				
9:30	20a-W833-1	K(Ta,Nb)O ₃ 結晶、BaTiO ₃ 系セラミックスの電気熱量効果	○真岩 宏司 ¹	1. 湘南工大工
9:45	20a-W833-2	圧電応答顕微鏡による RFe ₂ O ₄ (R=Y,Tm) の相転移挙動の観察	○(B) 直田 哲明 ¹ 、小西 伸弥 ² 、藤田 晃司 ² 、鈴木 元也 ³ 、北條 元 ⁴ 、東正樹 ⁴ 、有馬 孝尚 ⁵ 、田中 勝久 ²	1. 京大工, 2. 京大院工, 3. 東工大技術部分析支援センター, 4. 東工大応セラ研, 5. 東大新領域
10:00	20a-W833-3	熱処理によるペロブスカイトイットリウムアルミネートの構造変化がフォトルミネセンスに与える影響	○(DC) 森本 貴明 ¹ 、大木 義路 ^{1,2}	1. 早大先進理工, 2. 早大材研
10:15	E 20a-W833-4	Electric Field Effect of Relaxor Ferroelectric 0.7Pb(Mg _{1/3} Nb _{2/3})O ₃ -0.3PbTiO ₃ Single Crystals Studied by Micro-Brillouin Scattering	○(D)Md Aftabuzzaman ¹ , Seiji Kojima ¹	1.Univ. Tsukuba
10:30	20a-W833-5	放電プラズマ焼結を用いて作製した (Bi _{0.5} K _{0.5})TiO ₃ -BiFeO ₃ -K(Nb _x Ta _{1-x})O ₃ 強誘電体の強誘電特性と結晶構造の組成依存性	○岩淵 徹 ¹ 、石田 直哉 ¹ 、北村 尚斗 ¹ 、井手本 康 ¹	1. 東理大理工
10:45		休憩 / Break		
11:00	20a-W833-6	ニオブ酸リチウム結晶の E(x) 光学振動モードとポラリトン分散関係：遠赤外分光エリブソメトリーとラマン散乱法	○小島 誠治 ¹ 、金原 一樹 ² 、保科 拓也 ² 、鶴見 敬章 ²	1. 筑波大数理, 2. 東工大理工
11:15	奨 20a-W833-7	(K,Na,Li)NbO ₃ 系強誘電体の強誘電特性、結晶・電子構造の組成依存	○水野 健一郎 ¹ 、石田 直哉 ¹ 、北村 直斗 ¹ 、井手本 康 ¹	1. 東理大理工
11:30	20a-W833-8	弾性定数による圧電セラミックスの材料設計	○小川 敏夫 ¹ 、池谷 泰輝 ¹	1. 静岡理工科大電子
11:45	20a-W833-9	圧電材料での強誘電体ドメインおよび結晶粒界の弾性定数による評価	○小川 敏夫 ¹ 、池谷 泰輝 ¹	1. 静岡理工科大電子
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子 / Nanowires and Nanoparticles				
3/19(Sat.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W834 会場				
9:00	19a-W834-1	Allylamine による P,B 同時ドーピング Si ナノ結晶の表面修飾	○多田 康洋 ¹ 、菅野 天 ¹ 、加納 伸也 ¹ 、杉本 泰 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大院工
9:15	19a-W834-2	B,P 同時ドーピングシリコンナノ結晶のエネルギー準位構造 (II)	○堀 祐輔 ¹ 、加納 伸也 ¹ 、杉本 泰 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大院工
9:30	19a-W834-3	多孔質 Si の液中紫外レーザー照射による Si ナノ結晶コロイドの作製条件の最適化	○(B) 須田 義規 ¹ 、渡邊 幹太 ¹ 、袁 澤 ² 、中村 俊博 ¹ 、安達 定雄 ¹	1. 群馬大院理工, 2. 筑波大院数理物質
9:45	19a-W834-4	多孔質 Si の液中紫外レーザー照射により作製した Si ナノ結晶コロイドの発光特性の評価	○(M1) 渡邊 幹太 ¹ 、袁 澤 ² 、中村 俊博 ¹ 、安達 真 ¹	1. 群馬大院理工, 2. 筑波大院数理物質
10:00	19a-W834-5	伸縮基板による Si ナノ結晶のエネルギー移動の効率の変化	○宮下 純一 ¹ 、松本 公久 ¹ 、野村 俊 ¹ 、神谷 和秀 ¹ 、稲田 貢 ² 、鈴木 伸哉 ³	1. 富山県立大, 2. 関西大, 3. 長野高等専門学校
10:15	19a-W834-6	糊殻から生成した Si 微粒子の発光に関する研究	○田中 拓也 ¹ 、松本 公久 ¹ 、野村 俊 ¹ 、神谷 和秀 ¹ 、稲田 貢 ² 、鈴木 伸哉 ³	1. 富山県立大, 2. 関西大, 3. 長野高等専門学校
10:30		休憩 / Break		
10:45	19a-W834-7	液中通電法によるナノ結晶の作成に対する電極と水溶液の依存性	○岡本 庸一 ^{1,3} 、山本 聖治 ¹ 、守本 純 ¹ 、中津川 博 ²	1. 防衛大材料, 2. 横浜国大工, 3. 物材機構
11:00	19a-W834-8	FePt ナノドットスタック構造における磁気伝導特性	○満行 優介 ¹ 、河瀬 平雅 ¹ 、牧原 克典 ¹ 、大田 晃生 ¹ 、池田 弥央 ¹ 、宮崎 誠一 ¹	1. 名古屋大学
11:15	E 19a-W834-9	Electronic structural study of Pd-Pt bimetallic alloy nanoparticles	○(P)Rosantha Kumara ¹ , Osami Sakata ¹ , Chulho Song ¹ , Anli Yang ¹ , Kohei Kusada ² , Hirokazu Kobayashi ² , Hiroshi Kitagawa ²	1.NIMS/SPring-8, 2.Kyoto Univ.
11:30	19a-W834-10	Size-effect of Pd and Ru nanoparticles revealed by Rietveld analysis using high-energy X-ray diffraction	○(PC)Chulho Song ¹ , Osami Sakata ¹ , L. S. R. Kumar ¹ , Shinji Kohara ¹ , Kohei Kusada ² , Hirokazu Kobayashi ² , Hiroshi Kitagawa ²	1.NIMS/SPring-8, 2.Kyoto Univ.

11:45	E 19a-W834-11	Algal assisted synthesis of iron oxide nanoparticles and dye removal studies	○ MohamedMatharSahib IbrahimKhaleelullah ¹ , Muralidharan Murugan ³ , Devasena Thiagarajan ³ , Radha Kuravappullam Vedhaiyan ³ , Yasuhiro Hayakawa ^{1,2}	1.GSST Shizuoka Univ, 2.RIE Shizuoka Univ, 3.Anna Univ.
3/19(Sat.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W834 会場				
13:30	招 19p-W834-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) MnAs/InAs ダブルヘテロ接合ナノワイヤの成長メカニズム	○小平 竜太郎 ¹ 、椛本 恭平 ¹ 、崎田 晋哉 ¹ 、原 真二 ¹	1.北海道大
13:45	19p-W834-2	GaAs ナノワイヤの成長後物質変換	○西岡 康平 ¹ 、石川 史太郎 ¹	1.愛媛大工
14:00	19p-W834-3	in-situ 直径変調法で作製した位置制御 InP/InAs ヘテロナノワイヤ	○章 国強 ^{1,2} 、館野 功太 ^{1,2} 、寒川 哲臣 ¹ 、後藤 秀樹 ¹	1.NTT 物性研, 2.NTT ナノエレクトロニクスセンタ
14:15	E 19p-W834-4	Self-Organized GaN Nanocolumns Grown on Silica Glass by RF-Molecular Beam Epitaxy	○(D)Andreas LiudiMulyo ^{1,2} , Yuta Konno ¹ , Helge Weman ² , Katsumi Kishino ¹	1.Sophia Univ., 2.NTNU
14:30	19p-W834-5	GaP ナノワイヤ結晶構造のドーピングによる変化	○館野 功太 ^{1,2} 、章 国強 ^{1,2} 、熊倉 一英 ²	1.NTT-NPC, 2.NTT 物性研
14:45	奨 19p-W834-6	Ge(111) 基板上 InGaAs ナノワイヤ選択成長	○(B)吉田 旭伸 ¹ 、富岡 克広 ^{2,3,4} 、石坂 文哉 ³ 、千葉 康平 ¹ 、本久 順一 ² 、福井 孝志 ³	1.北大工, 2.北大院, 3.量子集積センター, 4.JST さきがけ
15:00	19p-W834-7	分布ブラッグ反射膜上に形成した InGaAs/GaAs ナノワイヤ量子ドットレーザ	○館林 潤 ¹ 、Ho Jinfa ² 、太田 泰友 ^{1,2} 、加古 敏 ^{1,2} 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1.東大ナノ量子機構, 2.東大生研
15:15	19p-W834-8	自己触媒 VLS 法による n-InP/ i-GaNAs/ p-InP コアシェルナノワイヤの電気特性評価	○(M1)朝倉 啓太 ¹ 、荻野 雄大 ¹ 、高野 紘平 ¹ 、和保 孝夫 ¹ 、下村 和彦 ¹	1.上智大理工
15:30	休憩 / Break			
15:45	19p-W834-9	バイオテンプレート極限加工技術を用いた Si ナノピラーの作製と熱伝導率の測定	○菊池 亜紀広 ^{1,3} 、八尾 章史 ³ 、毛利 勇 ³ 、寒川 誠二 ² 、小野 崇人 ¹	1.東北大院工, 2.東北大 流体研, 3. セントラル硝子
16:00	19p-W834-10	3 ω法を用いた Quasi-Ballistic 領域におけるシリコンナノワイヤの熱輸送特性解析	○Zhuge Fuwei ¹ 、金井 真樹 ¹ 、長島 一樹 ¹ 、深田 直樹 ² 、柳田 剛 ¹	1.九大先導研, 2.物材機構
16:15	奨 E 19p-W834-11	Drastic improvement of effective carrier lifetimes in Si nanowires embedded with anodic aluminum oxide by post-deposition anneal	○(P)Hoang Van Nguyen ¹ , Shinya Kato ¹ , Noritaka Usami ^{1,2}	1.MEXT, FUTURE-PV Innovation, Japan Science and Technology Agency, 2.Graduate School of Engineering, Nagoya University
16:30	奨 E 19p-W834-12	Characterization of Dopant in Individual Si / Ge Core-Shell Nanowires Investigated by Atom Probe Tomography	○(DC)Bin Han ¹ , Yasuo Shimizu ¹ , Wipakorn Jevasuwan ² , Kotaro Nishibe ^{2,3} , Koji Inoue ¹ , Naoki Fukata ² , Yasuyoshi Nagai ²	1.IMR, Tohoku Univ., 2.NIMS, 3.Tsukuba Univ.
16:45	19p-W834-13	SiGe ナノワイヤにおける熱電特性の構造多形および原子配列依存性の理論的検討	○秋山 亨 ¹ 、菰田 貴都 ¹ 、中村 浩次 ¹ 、伊藤 智徳 ¹	1.三重大院工
17:00	19p-W834-14	Lowering the Growth Temperature of Vapor-liquid-solid Oxide Nanowires	○長島 一樹 ¹ 、Zhu Zetao ¹ 、Meng Gang ¹ 、金井 真樹 ¹ 、安西 宇宙 ² 、Zhuge Fuwei ¹ 、He Yong ¹ 、柳田 剛 ^{1,2}	1.九大先導研, 2.九大総理工
17:15	奨 19p-W834-15	結晶成長界面が決定する単結晶 SnO ₂ ナノワイヤの電子輸送特性 - VS 界面 対 LS 界面 -	○(M1)安西 宇宙 ¹ 、長島 一樹 ² 、Meng Gang ² 、Zhuge Fuwei ² 、関 岳人 ³ 、柴田 直哉 ³ 、柳田 剛 ^{1,2}	1.九大総理工, 2.九大先導研, 3.東大工
17:30	19p-W834-16	ゾル・ゲル法による MoO ₃ ナノロッドガスセンサ素子の創成	○菅原 徹 ¹ 、叢 樹仁 ¹ 、菅沼 克昭 ¹	1.阪大産研
17:45	奨 19p-W834-17	ナノ粒子を触媒とした鉄ナノワイヤの作製	○柳瀬 隆 ¹ 、荻原 初夏 ¹ 、三浦 拓也 ¹ 、翁 夢婷 ¹ 、長浜 太郎 ¹ 、島田 敏宏 ¹	1.北大工
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P7 会場				
	20p-P7-1	Si(111) 基板上 GaAs/GaAsBi マルチコアシェルナノワイヤの特性	○石川 史太郎 ¹ 、赤松 良彦 ¹ 、渡辺 健太郎 ² 、上杉 文彦 ³ 、朝比奈 俊輔 ⁴ 、Jahn Uwe ⁵ 、下村 哲 ¹	1.愛媛大院理工, 2.阪大基礎工, 3.物材機構, 4.日本電子, 5.Paul Drude Institut
	20p-P7-2	自己触媒 VLS 法による InP/GaNAs/InP コアマルチシェルナノワイヤの光学特性評価	○(B)高野 紘平 ¹ 、荻野 雄大 ¹ 、朝倉 啓太 ¹ 、和保 孝夫 ¹ 、下村 和彦 ¹	1.上智大理工
	20p-P7-3	MnAs/InAs ヘテロ接合ナノワイヤの磁区構造評価	○椛本 恭平 ¹ 、小平 竜太郎 ¹ 、崎田 晋哉 ¹ 、原 真二 ¹	1.北大
	20p-P7-4	アノードエッチングにより作製した GaAs ナノワイヤの電気特性に対する湿式水素曝露効果	○山田 航平 ¹ 、相川 慎也 ¹ 、橋本 英樹 ¹ 、阿相 英孝 ¹ 、小野 幸子 ¹	1.工学院大工
E	20p-P7-5	Improvement of Silicon Nanowire Solar Cells made by Metal Catalyzed Electroless and Nano-imprint lithography	○(D)JUNYI CHEN ^{1,2} , Wipakorn Jevasuwan ² , Naoki Fukata ^{1,2}	1.Univ. of Tsukuba, 2.NIMS
E	20p-P7-6	Si Nanowire Formation using Al-Catalyst with Various Substrate Temperatures	○Wipakorn Jevasuwan ¹ , Naoki Fukata ¹	1.NIMS
	20p-P7-7	プラスチック上 Ge 薄膜の結晶方位制御と垂直配向ナノワイヤ合成	○都甲 薫 ¹ 、中田 充紀 ¹ 、大谷 直生 ¹ 、Jevasuwan Wipakorn ² 、深田 直樹 ² 、未益 崇 ¹	1.筑波大数理物質, 2.物材機構
	20p-P7-8	Si/Ge コアシェルナノワイヤ中の結晶性およびドーピング制御	○西部 康太郎 ^{1,2} 、Jevasuwan Wipakorn ² 、Subramani Thiyaagu ² 、武井 俊朗 ² 、深田 直樹 ^{1,2}	1.筑波大院, 2.物材機構
	20p-P7-9	Ge/Si コアシェル ナノワイヤの熱電性能測定	○野口 智弘 ¹ 、Simanullang Marolop ¹ 、宇佐美 浩一 ¹ 、小寺 哲夫 ² 、小田 俊理 ^{1,2}	1.東工大量子ナノ研セ, 2.東工大電子物理
	20p-P7-10	ZnO ナノワイヤの形成過程と電気伝導	○野崎 正人 ¹ 、木塚 徳志 ²	1.筑波大院数理, 2.筑波大物質
	20p-P7-11	Environment-friendly Disposable Nonvolatile Resistive Switching Memory Composed of Nanocellulose	○長島 一樹 ¹ 、Celano Umberto ² 、古賀 大尚 ³ 、能木 雅也 ³ 、Zhuge Fuwei ¹ 、Meng Gang ¹ 、He Yong ¹ 、Fantini Andrea ² 、Boeck Jo De ² 、Jurczak Malgorzata ² 、Vandervorst Wilfried ² 、柳田 剛 ¹	1.九大先導研, 2.imec, 3.阪大産研
	20p-P7-12	エレクトロスピンニング法による繊維形成過程	○内田 健哉 ¹ 、中川 泰忠 ¹ 、植松 育生 ¹	1.(株)東芝
	20p-P7-13	表面コーティングした電界紡糸 ITO ナノファイバの色素増感太陽電池への応用	○(DC)郭 世榮 ¹ 、今田 慎二 ¹ 、堀江 雄二 ¹ 、野見山 輝明 ¹	1.鹿児島大院理工
E	20p-P7-14	Application of Self-standing Conductive Silica-ITO Nanofiber Mat to Dye Sensitized Solar Cells	○(D)Muhammad Zobayer BinMukhlis ¹ , Kousei Higashi ¹ , Yuji Horie ¹ , Teruaki Nomiyama ¹	1.Kagoshima Univ.
	20p-P7-15	Si 系剥片状ナノ材料の光物性・光触媒特性	○板原 浩 ¹ 、呉 暁勇 ² 、山崎 芳樹 ² 、今川 晴雄 ¹ 、殷 シュウ ² 、小島 一信 ² 、秩父 重英 ² 、佐藤 次雄 ²	1.豊田中研, 2.東北大
E	20p-P7-16	One-step deposition of PbS Quantum Dot harvesting layer with new-ligand for solid state heterojunction solar cells	○(D)CHAO DING ¹ , JIN CHANG ¹ , YAOHONG ZHANG ¹ , NAOTAKA FUJIKAWA ² , SHUZI HAYASE ^{2,4} , KENJI YOSHINO ^{3,4} , TARO TOYODA ^{1,4} , QING SHEN ^{1,4}	1.Univ. Electro-Commun, 2.Kyushu Inst. Tech, 3.Miyazaki Univ, 4.CREST JST
E	20p-P7-17	Performance of PbSe quantum dot based heterojunction solar cells: Dependence on ligand type	○(D)YaoHong Zhang ¹ , Chao Ding ¹ , Shuzi Hayase ^{2,4} , Yuhei Ogomi ² , Jin Chang ³ , Taro Toyoda ^{1,4} , Qing Shen ^{1,4}	1.Univ. Electro-Commun., 2.Kyushu Inst. Tech., 3.Nanjing Tech. Univ., 4.CREST JST

E 20p-P7-18	Synthesis and evaluation of Triethylamine-capped SnO ₂ nanostructures for dye sensitized solar cell applications.	○ Tarini Murugesan ¹ , Navaneethan Mani ¹ , Archana Jayaram ¹ , Yasuhiro Hayakawa ¹	1.RIE Shizuoka Univ
E 20p-P7-19	Tin Oxide Nanoparticles Prepared via Laser Ablation in Liquid	Tatsuki Owashi ¹ , Mitsuhiro Honda ² , ○ Sergei Kulinich ¹ , Takahiro Kondo ¹ , Satoru Iwamori ¹	1.Tokai University, 2.Nagoya Inst. Tech.
20p-P7-20	パルス細線放電法による有機物被覆マグネシウム粒子作製	○末松 久幸 ¹ 、田中 健太 ¹ 、鈴木 常生 ¹ 、中山 忠親 ¹ 、新原 皓一 ¹	1.長岡技術短大
9.3 ナノエレクトロニクス / Nanoelectronics			
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P8 会場			
20p-P8-1	粘菌の挙動を模倣した単電子情報処理回路の設計	○ (M1) 里見 航汰 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹	1.横国大院工
20p-P8-2	熱雑音導入による単電子連想記憶回路の性能向上の検討	○ (M1) 高野 誠 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹	1.横国大院工
奨 20p-P8-3	ゲート容量が非対称な共通ゲート四重ドット単電子ポンプの動作解析	○居藤 悠馬 ¹ 、今井 茂 ¹	1.立命館大理工
奨 20p-P8-4	高精度デジタルウェットエッチング技術による GaAs ナノ構造形成	○黒田 亮太 ^{1,2} 、佐藤 将来 ^{1,2} 、葛西 誠也 ^{1,2}	1.北大量子集積センター、2.北大院情報科学
20p-P8-5	プラズマ励起法を用いたナノ微粒子用原子層堆積装置開発	○菊地 航 ¹ 、鹿又 健作 ² 、有馬 ボシリアハンマド ² 、久保田 繁 ² 、廣瀬 文彦 ²	1.山形大工、2.山形大院理工
20p-P8-6	プラズマ励起法を用いた ZrO ₂ の室温原子層堆積	○野老 健太郎 ¹ 、鹿又 健作 ² 、有馬 ボシリアハンマド ² 、久保田 繁 ² 、廣瀬 文彦 ²	1.山形大工、2.山形大院理工
3/21(Mon.) 9:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S323 会場			
9:15	21a-S323-1 ミツパナに学ぶ単電子情報処理	○田鍋 俊彦 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹	1.横国大理工
9:30	21a-S323-2 単電子畳み込みニューラルネットワーク回路	○片山 亮 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹	1.横国大
9:45	奨 21a-S323-3 イジングスピンモデルの FPGA への実装と自然現象を模倣した新しいコンピューティング技術の検討	○ (B) 木原 裕介 ¹ 、齋藤 孝成 ¹ 、塩村 真幸 ¹ 、白樫 淳一 ¹	1.東京農工大大院工
10:00	奨 21a-S323-4 論理ゲートで表現された 2 次元イジング計算機による組合せ最適化問題の検討	○ (B) 塩村 真幸 ¹ 、齋藤 孝成 ¹ 、木原 裕介 ¹ 、白樫 淳一 ¹	1.東京農工大大院工
10:15	奨 21a-S323-5 金属探針を用いた GaAs ナノワイヤ表面局所電位変調による表面電子トラップの検出と評価	○佐藤 将来 ^{1,2} 、殷 翔 ^{1,2} 、黒田 亮太 ^{1,2} 、葛西 誠也 ^{1,2}	1.北大量集センター、2.北大院情報科学
10:30	21a-S323-6 単一分子識別に向けた静電塗布法による分子表面分散の検討	○岡本 翔真 ¹ 、黒田 亮太 ¹ 、葛西 誠也 ¹	1.北大
10:45	休憩 / Break		
11:00	奨 21a-S323-7 多孔質 AZO 電極を利用した銀析出型 EC 素子の発色特性	○岡 瑞樹 ¹ 、稲田 貢 ² 、齋藤 正 ²	1.関大院理工、2.関大システム理工
11:15	21a-S323-8 無電解金メッキナノギャップ電極の初期電極膜依存性	○ (M1) 越村 将臣 ¹ 、東 康男 ¹ 、真島 豊 ¹	1.東工大応セラ研
11:30	E 21a-S323-9 Molecular Single-Electron Transistor Device using Sn-Porphyrin Protected Gold Nanoparticles	○ (M1) Pipit Uky Vivitasari ¹ , Yasuo Azuma ¹ , Masanori Sakamoto ² , Toshiharu Teranishi ² , Yutaka Majima ¹	1.Tokyo Inst. of Tech., 2.Kyoto Univ.
11:45	21a-S323-10 フローティングゲート電極を有するナノ粒子単電子トランジスタ	○東 康男 ¹ 、坂本 雅典 ² 、寺西 利治 ² 、真島 豊 ¹	1.東工大応セラ、2.京大化研
12:00	E 21a-S323-11 Coulomb Staircase on Rigid Carbon-bridged Oligo(phenylenevinylene) between Electroless Au plated Nanogap Electrodes	○ (D) Chun Ouyang ^{1,2} , Yousoo Kim ² , Kohei Hashimoto ³ , Hayato Tsuji ³ , Eiichi Nakamura ³ , Yutaka Majima ¹	1.Tokyo Tech., 2.RIKEN, 3.Univ. of Tokyo
3/21(Mon.) 16:00 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) S323 会場			
16:00	21p-S323-1 銅フタロシアン誘導体を添加した金ナノ粒子単電子トランジスタにおける光応答解析	○山本 真人 ¹ 、東 康男 ² 、真島 豊 ² 、坂本 雅典 ³ 、寺西 利治 ³ 、石井 久夫 ^{1,4} 、野口 裕 ⁵	1.千葉大院融合、2.東工大応セラ、3.京大化研、4.千葉大先進、5.明治大理工
16:15	21p-S323-2 B,P 同時ドーピング Si ナノ結晶におけるクーロンブロッカーの観察	○東川 泰大 ¹ 、東 康男 ² 、真島 豊 ² 、加納 伸也 ¹ 、藤井 稔 ¹	1.神大院工、2.東工大応セラ
16:30	21p-S323-3 繰り返し金ナノ粒子を散布することで作製した単一電子素子	○守屋 雅隆 ¹ 、Tran Huong ¹ 、松本 和彦 ¹ 、島田 宏 ¹ 、木村 康男 ² 、平野 愛弓 ³ 、水柿 義直 ¹	1.電通大、2.東京工科大、3.東北大
16:45	21p-S323-4 直列接続型ナノギャップでのマイグレーション制御によって作製された単電子トランジスタ	○ (B) 井上 和貴 ¹ 、伊藤 智之 ¹ 、岡田 憲昂 ¹ 、滝川 主喜 ¹ 、伊藤 光樹 ¹ 、白樫 淳一 ¹	1.東京農工大大院工
17:00	21p-S323-5 低温下での通電によるナノギャップ系単電子トランジスタの作製と特性制御	○伊藤 智之 ¹ 、伊藤 光樹 ¹ 、滝川 主喜 ¹ 、岡田 憲昂 ¹ 、井上 和貴 ¹ 、白樫 淳一 ¹	1.東京農工大大院工
17:15	21p-S323-6 FPGA による EM カスタムハードウェアを用いた Au ナノワイヤの狭窄化とコンダクタンス制御特性	○金丸 祐真 ¹ 、加藤 木 悠 ¹ 、塩村 真幸 ¹ 、白樫 淳一 ¹	1.東京農工大大院工
17:30	21p-S323-7 リアルタイム OS を用いた時間確定的な通電による Au ナノワイヤのコンダクタンスの増加制御	○沼倉 憲彬 ¹ 、佐藤 秀亮 ¹ 、金丸 祐真 ¹ 、白樫 淳一 ¹	1.東京農工大大院工
CS.5 9.4 熱電変換、16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション / 9.4/16.2 Code-sharing session			
3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P13 会場			
19p-P13-1	高温薄膜熱電特性評価装置の開発 II	○ (M1) 佐々木 一真 ¹ 、内藤 智之 ¹ 、藤代 博之 ¹	1.岩手大工
19p-P13-2	Ba ₂ NaNb ₃ O ₁₅ の輸送及び熱電特性	○掛本 博文 ¹ 、常盤 祐汰 ² 、渡邊 拓哉 ³ 、小澤 健介 ³ 、入江 寛 ^{1,2,3}	1.山梨大学 クリーンエネルギー研究センター、2.工学部、3.大学院 医学工学総合教育部
19p-P13-3	Ca ₉ Bi ₁₀ MnO ₃ の粒径微細化が熱電特性に及ぼす影響	○中村 雄一 ¹ 、白井 小雪 ¹ 、井上 光輝 ¹	1.豊橋技科大
19p-P13-4	(LaO)CuSe、(BiO)CuSe の熱電特性の違い	○菅野 聖人 ¹ 、東谷 篤志 ² 、生天目 博文 ³ 、谷口 雅樹 ³ 、佐藤 仁 ³ 、アワベクリルスル ⁴ 、渡辺 忠孝 ¹ 、高野 良紀 ¹ 、高瀬 浩一 ¹	1.日大理工、2.摂南大理工、3.広大放射光、4.広大院理
19p-P13-5	AlMgB ₁₄ 基熱電変換材料の熱電特性制御と金属サイト占有率	○ (M2) 有松 英輝 ¹ 、藤間 卓也 ¹ 、高木 研一 ¹	1.東京都市大工
E 19p-P13-6	Synthesis of clathrate K ₈ Ga _x Al ₇ Si _{16-x} y with enhanced thermoelectric property	○ (PC) Shiva Kumar Singh ¹ , Motoharu Imai ¹	1.National Institute for Materials Science, 1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305-0047, Japan
奨 19p-P13-7	高キャリア濃度を有する Sb-doped Mg ₂ Si の作製と熱的安定性評価	○加藤 大輔 ^{1,2} 、岩崎 航太 ² 、吉野 正人 ¹ 、山田 智明 ¹ 、長崎 正雅 ¹	1.名古屋大、2.トヨタ紡織
19p-P13-8	Si/Mg ₂ Si コンポジットの微細組織と熱電特性	○ (DC) 窪内 将隆 ¹ 、林 慶 ¹ 、宮崎 謙 ¹	1.東北大院工
19p-P13-9	単結晶 SnSe への Sb 置換効果	○秋山 拓海 ¹ 、宮田 全展 ¹ 、西野 俊佑 ¹ 、伊藤 暢晃 ¹ 、大島 義文 ¹ 、小矢野 幹夫 ¹	1.北陸先端大
19p-P13-10	Si 系クラスレートにおける Ag 置換と熱電特性	○前島 理佐 ¹ 、上田 貴大 ¹ 、岡本 和也 ¹ 、阿武 宏明 ¹	1.山口東理大工
19p-P13-11	PLD 法を用いた SnSe 薄膜の作製と熱電性能	○原 貴充 ¹ 、内藤 智之 ¹ 、藤代 博之 ¹ 、伊藤 暁彦 ² 、後藤 孝 ²	1.岩手大工、2.東北大金研
19p-P13-12	基板表面に担持した Bi-Te 熱電微粒子の AFM 観察	○林 祐司 ¹ 、水谷 慎吾 ¹ 、西野 俊佑 ¹ 、宮田 全展 ¹ 、1.JAIST、2.株式会社 KELK 小矢野 幹夫 ¹ 、田中 哲史 ² 、福田 克史 ²	1.1.JAIST、2.株式会社 KELK

19p-P13-13	熱電インクを用いた Bi ₂ Te ₃ 配向ナノバルクの低温作製	○水谷 慎吾 ¹ 、林 祐司 ¹ 、西野 俊佑 ¹ 、宮田 全展 ¹ 、1.JAIST、2.株式会社 KELK
19p-P13-14	ビスマスナノ構造における表面状態の数値解析	○小矢野 幹夫 ¹ 、田中 哲史 ² 、福田 克史 ² 青野 友祐 ¹ 、○小峰 啓史 ¹ 、村田 正行 ² 、長谷川 靖 1.茨城大、2.産総研、3.埼玉大 洋 ³
19p-P13-15	擬一次元伝導体マイクロリボンの熱電特性評価	○佐久間 佑 ¹ 、西野 俊佑 ¹ 、宮田 全展 ¹ 、小矢野 幹 夫 ¹ 1.JAIST
3/20(Sun.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場		
13:45	20p-W323-1 TiO ₂ 結晶化ガラスによる可視光照射水分解	○高橋 寛 ¹ 、○吉田 和貴 ¹ 、寺門 信明 ¹ 、高橋 儀宏 ¹ 、1.東北大院工、2.東北大多元研 藤原 巧 ¹ 、加藤 英樹 ² 、垣花 真人 ²
14:00	20p-W323-2 VO ₂ 結晶化ガラス創製のための還元剤添加による析出相 制御	○村本 圭 ¹ 、寺門 信明 ¹ 、高橋 儀宏 ¹ 、藤原 巧 ¹ 1.東北大院工
14:15	20p-W323-3 (001) 配向した SrCuO ₂ ナノ結晶膜における面内熱拡散率 と構造の関係	○寺門 信明 ¹ 、高橋 良輔 ¹ 、高橋 儀宏 ¹ 、藤原 巧 ¹ 1.東北大院工
14:30	奨 20p-W323-4 偏光 CW レーザー光を用いたスピン熱伝導性 SrCuO ₂ の 異方的結晶化ラインの作製	○高橋 良輔 ¹ 、寺門 信明 ¹ 、高橋 儀宏 ¹ 、藤原 巧 ¹ 1.東北大工
14:45	休憩 / Break	
15:00	20p-W323-5 アモルファス SiGe フォノンニック結晶ナノ構造の熱伝導	○中川 純貴 ¹ 、Jeremie Maire ² 、澤野 憲太郎 ³ 、野 村 政宏 ^{1,4,5} 1.東大生研、2.LIMMS、3.東京都大総研、4.ナノ量子 機構、5.JST さきがけ
15:15	20p-W323-6 フォノンニック結晶におけるネック効果による熱伝導率の 低減	○柳澤 亮人 ¹ 、アヌフリエフ ロマン ¹ 、メール ジェ レミ ¹ 、野村 政宏 ^{1,2,3} 1.東大生研、2.ナノ量子機構、3.JST さきがけ
15:30	奨 E 20p-W323-7 Thermal conduction control by thermal phononics and its mechanisms	○(PC)Jeremie Kevin Maire ^{1,2} 、Roman Anufriev ¹ 、 Ryoto Yanagisawa ¹ 、Sebastian Volz ⁴ 、Masahiro Nomura ^{1,3,5} 1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LIMMS-CNRS/IIS, 3.Nanoquine, 4.EM2C CNRS, 5.JST PRESTO
15:45	20p-W323-8 Bi ナノワイヤーの磁場中における電気物性の解析	○村田 正行 ¹ 、山本 淳 ¹ 、長谷川 靖洋 ² 、小峰 啓史 1.産総研、2.埼玉大、3.茨城大 3
16:00	E 20p-W323-9 Thermoelectric Properties of Colloidal Quantum Dot Solids	○Satria Zulkarnaen Bisri ¹ 、Maria Ibanez ^{2,3} 、Maksym Kovalenko ^{2,3} 、Yoshihiro Iwasa ^{1,4} 1.RIKEN-CEMS, 2.ETH Zurich, 3.EMPA, 4.Univ. Tokyo
16:15	休憩 / Break	
16:30	20p-W323-10 プラズモニクスと Ge-Sn 材料を融合した光熱発電システ ムの構築	○小松 諒祐 ¹ 、西島 喜明 ¹ 、Gediminas Seniutinas ² 、1.横国大院工、2.スインバーン工科大 Saulius Juodkazis ²
16:45	20p-W323-11 ZnO ナノ構造を用いたフレキシブル熱電材料の熱拡散率	○和波 雅也 ¹ 、セルバラジ シャンティ ¹ 、鈴木 悠平 ¹ 、1.静大院工、2.マラヤ大 ベルスワミイ バンディヤラサン ¹ 、ファイズ サレ ² 、 下村 勝 ¹ 、村上 健司 ¹ 、池田 浩也 ¹
17:00	奨 20p-W323-12 エピタキシャル Ge ナノドット含有 Si 構造を用いた Si 系 熱電材料の性能向上	○(D)山岡 司祐人 ¹ 、渡辺 健太郎 ^{1,2} 、澤野 憲太郎 ³ 、1.阪大院基礎工、2.JST-CREST、3.東京都大総研 竹内 正太郎 ¹ 、酒井 朗 ¹ 、中村 芳明 ^{1,2}
17:15	奨 20p-W323-13 汎用性を向上した 2ω 法による熱電薄膜の熱伝導率測定	○奥畑 亮 ¹ 、渡辺 健太郎 ^{1,2} 、池内 賢朗 ³ 、石田 明広 ⁴ 、1.阪大基礎工、2.JST-CREST、3.アドバンス理工、4.静 岡大院工 中村 芳明 ^{1,2}
17:30	奨 E 20p-W323-14 Fabrication of ultrathin Ge-on-insulator by direct wafer- bonding	○(D)Manimuthu Veerappan ¹ 、Arivanandhan Mukannan ¹ 、Yasuhiro Hayakawa ¹ 、Hiroya Ikeda ¹ 1.Shizuoka Univ.
9.4 熱電変換 / Thermoelectric conversion		
3/21(Mon.) 9:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場		
9:30	21a-W323-1 新規遷移金属硫化物 V _x Tr _x M S ₆ の熱電物性と電子状態計 算	○(D)宮田 全展 ¹ 、西野 俊佑 ¹ 、尾崎 泰助 ^{1,2} 、小 矢野 幹夫 ¹ 1.北陸先端大、2.東大物性研
9:45	21a-W323-2 ペロフスカイト酸化物 Pr _{0.9} Sr _{0.1} Mn _{1-x} Fe _x O ₃ (0 ≤ x ≤ 1) の P 型熱電特性	○中津川 博 ¹ 、佐藤 文仁 ¹ 、齋藤 美和 ² 、岡本 庸一 3 1.横国大理工、2.神奈川大工、3.防衛大材料
10:00	奨 21a-W323-3 層状 Co 酸化物における微視的熱伝導現象とその抑制機 構	○(D)藤井 進 ¹ 、吉矢 真人 ^{1,2} 1.大阪大工、2.JFCC
10:15	21a-W323-4 層状空化物 NaMN ₂ (M=Ta, Nb) の電子状態と熱電輸送特 性の次元性	○大久保 勇男 ^{1,2} 、森 孝雄 ¹ 1.物材機構、2.JST- さきがけ
10:30	休憩 / Break	
10:45	奨 21a-W323-5 溶融合成した V 置換 MnSi ₂ の熱電特性	○(M1)濱田 陽紀 ¹ 、林 慶 ¹ 、宮崎 謙 ¹ 1.東北大院工
11:00	奨 21a-W323-6 ソフト化学法を用いた CrSi ₂ の合成と熱電特性評価	○中沢 駿仁 ¹ 、高松 智寿 ¹ 、飯島 喜彦 ² 、林 慶 ¹ 、 宮崎 謙 ¹ 1.東北大工、2.リコー未来技研
11:15	奨 21a-W323-7 Mg ₂ Si 薄膜の熱電特性に及ぼす歪みの影響	○黒川 満央 ¹ 、上原 陸雄 ¹ 、一ノ瀬 大地 ¹ 、清水 荘 雄 ¹ 、秋山 賢輔 ^{1,2} 、松島 正明 ¹ 、内田 寛 ³ 、木村 好 里 ¹ 、舟窪 浩 ¹ 1.東工大、2.神奈川県産業技術センター、3.上智大
11:30	E 21a-W323-8 Enhancement of power factor by energy filtering effect in Re substituted HMS	○(DC)Swapnil Chetan Ghodke ¹ 、Akio Yamamoto ² 、 Hiroshi Ikuta ¹ 、Tsunehiro Takeuchi ^{2,3} 1.Nagoya Univ., 2.Toyota Tech. Inst., 3.PRESTO
11:45	21a-W323-9 Ge-Sb-Te 準安定相バルク状熱電材料の作製条件の検討	○大本 達朗 ¹ 、○小菅 厚子 ¹ 1.阪府大ナノ
12:00	21a-W323-10 4元 Si クラスレート Rb-Na-X-Si(X=Ga,Zn) の電子構造	○赤井 光治 ¹ 、岸本 堅剛 ¹ 、小柳 剛 ¹ 、山本 節夫 ¹ 1.山口大
3/21(Mon.) 13:45 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場		
13:45	21p-W323-1 Na-In-Sn 系金属間化合物の結晶構造と熱電特性	○山田 高広 ¹ 、菅野 雅博 ¹ 、籠本 倫丈 ¹ 、永井 秀明 ³ 、1.東北大多元研、2.JST さきがけ、3.産総研 山根 久典 ¹
14:00	21p-W323-2 トンネル構造を有する Na ₂ ZnSn ₅ の熱電特性	○菅野 雅博 ¹ 、山田 高広 ^{1,2} 、山根 久典 ¹ 1.東北大多元研、2.JST さきがけ
14:15	奨 21p-W323-3 type-II クラスレート化合物 K ₆ Sr ₁₀ M ₄₀ Ge ₅₀ (M=Al,Ga) の作 製と熱電気的特性	○宇都宮 卓 ¹ 、岸本 堅剛 ¹ 、赤井 光治 ¹ 、浅田 裕法 1.山口大院理工 1、小柳 剛 ¹
14:30	21p-W323-4 Bi-Sb 合金の熱電物性への Te および Sn ドーピングの効 果	○村田 正行 ¹ 、國井 勝 ¹ 、李 哲虎 ¹ 、山本 淳 ¹ 1.産総研
14:45	21p-W323-5 Ga-P 同時添加による Ba ₈ Al ₁₆ Si ₃₀ クラスレートの機械的 特性への影響	○岡本 和也 ¹ 、上田 貴大 ¹ 、江本 優紀 ¹ 、阿武 宏明 1.山口東理大工 1
15:00	休憩 / Break	
15:15	21p-W323-6 Co _{1-x} Ni _x Sb ₃ の輸送および熱電特性に関する実験データの 解析の精密化 (IV) 一多重バンドのネルンスト係数の表 式と Co _{1-x} Ni _x Sb ₃ への応用一	○梶川 靖友 ¹ 1.島根大総合理工
15:30	21p-W323-7 熱電物性同時測定を用いた格子とキャリアの熱伝導率評 価	○大塚 美緒子 ¹ 、本間 亮英 ¹ 、長谷川 靖洋 ¹ 1.埼玉大工
15:45	21p-W323-8 酸化物超伝導体を用いた白金の絶対ゼーベック係数測定	○天谷 康孝 ¹ 、島崎 毅 ¹ 、河江 達也 ² 、藤木 弘之 ¹ 、1.産総研、2.九大工 山本 淳 ¹ 、金子 晋久 ¹
16:00	21p-W323-9 インピーダンススペクトロスコーピー法を用いた熱電モ ジュールの動特性評価	○長谷川 靖洋 ¹ 、本間 亮英 ¹ 、大塚 美緒子 ¹ 1.埼玉大工

16:15	奨 21p-W323-10	クラスレート化合物を用いたセグメント型熱電モジュールの作製	○石川 雄基 ¹ 、土谷 陽平 ¹ 、岸本 堅剛 ¹ 、小柳 剛 ¹ 、1. 山口大院理工、2. 産総研 長瀬 和夫 ² 、高澤 弘幸 ² 、山本 淳 ² 、赤井 光治 ¹ 、 浅田 裕法 ¹	
16:30	21p-W323-11	高密度集積化マイクロ熱電モジュールの設計法	○(M1)近藤 剛 ¹ 、高村 陽太 ² 、菅原 聡 ¹	1. 東工大像情報、2. 東工大電子物理
9.5 新機能材料・新物性 / New functional materials and new phenomena				
3/19(Sat) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P10 会場				
	19p-P10-1	第一原理計算による TlInSe ₂ , TlInS ₂ の電子状態解析	○石川 真人 ¹ 、中山 隆史 ¹ 、脇田 和樹 ² 、Nazim Mamedov ³	1. 千葉大学理学部、2. 千葉工科大学、3. アゼルバイジャン科学アカデミー
	19p-P10-2	固液注入表面の透過率・表面濡れ性の温度依存性	○(D) 真部 研吾 ¹ 、白鳥 世明 ¹	1. 慶大院理工
	19p-P10-3	白色発光アップコンバージョン蛍光体の作製および発光特性評価	○菖蒲 勇 ¹ 、野中 俊宏 ¹ 、大山 溪人 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
	19p-P10-4	アップコンバージョン蛍光体の青色発光に関する特性評価	○菖蒲 勇 ¹ 、野中 俊宏 ¹ 、大山 溪人 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
	19p-P10-5	Tm ³⁺ と Yb ³⁺ を共添加したアップコンバージョン蛍光体の特性評価	○杉村 健太郎 ¹ 、菖蒲 勇 ¹ 、野中 俊宏 ¹ 、大山 溪人 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大理工
	19p-P10-6	分子線蒸着法による GdH ₂ 薄膜の作製	○竹之内 郁人 ¹ 、坂井 琢磨 ¹ 、酒井 政道 ¹ 、樋口 宏二 ² 、北島 彰 ² 、長谷川 繁彦 ² 、中村 修 ³	1. 埼玉大院理工、2. 阪大産研、3. 岡山理科大
	19p-P10-7	3元タリウム化合物における光誘起変形の過渡応答特性	○益村 隆宏 ¹ 、沈 用球 ¹ 、脇田 和樹 ² 、Mamedov Nazim ³	1. 阪府大院工、2. 千葉工大大、3. アゼルバイジャン科学アカ
	19p-P10-8	マルチフェロイック 0.7BaTiO ₃ -0.3NiFe ₂ O ₄ コアシェルにおける磁気誘起抵抗の振る舞い	○柳沢 修実 ¹ 、藤本 隆士 ²	1. 弓削商船高専商船、2. 弓削商船高専電子機械
3/20(Sun.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) S323 会場				
13:45	20p-S323-1	表面増大赤外吸収現象におけるナノ粒子誘電率の影響	○津島 将導 ¹ 、中嶋 洋 ¹ 、石柳 佑汰 ¹ 、沢田 拓希 ² 、千葉 豪 ² 、熊谷 遊太 ³ 、島田 透 ³ 、鈴木 裕史 ¹	1. 弘前大院理工、2. 弘前大理工、3. 弘前大教育
14:00	20p-S323-2	表面増大赤外吸収現象が発現する金ナノ粒子サイズ最大値の波長依存性	○石柳 佑汰 ¹ 、中嶋 洋 ¹ 、津島 将導 ¹ 、沢田 拓希 ² 、千葉 豪 ² 、熊谷 遊太 ³ 、島田 透 ³ 、鈴木 裕史 ¹	1. 弘前大院理工、2. 弘前大理工、3. 弘前大教育
14:15	20p-S323-3	(A, X, Y)-Ag ゼオライトにおける Photoluminescence の励起波長依存性	○成田 翔 ¹ 、鈴木 裕史 ¹ 、宮永 崇史 ¹ 、中村 暦 ¹	1. 弘前大
14:30	20p-S323-4	低濃度水素を用いた Pd/Ni 二層触媒付き Y 薄膜の水素化とそのギブス自由エネルギー評価	○矢吹 康佑 ¹ 、青木 信彦 ¹ 、酒井 政道 ¹ 、松永 智善 ¹ 、飯笹 圭太郎 ¹ 、樋口 宏二 ² 、北島 彰 ² 、長谷川 繁彦 ² 、中村 修 ³	1. 埼玉大院理工、2. 阪大産研、3. 岡山理大
14:45	20p-S323-5	水熱合成法による TiO ₂ 粒子の合成とその直接噴霧型製膜技術の開発	○中根 茂行 ¹ 、河野 健太 ^{1,2} 、細野 真平 ^{1,2} 、安川 雪子 ² 、知京 豊裕 ¹ 、名嘉 節 ¹	1. 物材機構、2. 千葉工大大
15:00	休憩 / Break			
15:15	奨 20p-S323-6	Zn 部分置換による CaMn ₂ Bi ₂ 単結晶の強磁性誘起とその物性	○川口 直樹 ¹ 、畑野 敬史 ¹ 、飯田 和昌 ¹ 、生田 博志 ¹	1. 名大工
15:30	奨 20p-S323-7	【注目講演】強い相対論効果を持つ非磁性半金属 InBi 単結晶における巨大磁気抵抗	○(D) 大川 顕次郎 ¹ 、加納 学 ¹ 、並木 宏允 ¹ 、笹川 崇男 ¹	1. 東工大応セラ研
15:45	20p-S323-8	黒リンの常圧における単結晶育成とその物性評価 (II)	○(M1) 高橋 敬成 ¹ 、並木 宏允 ¹ 、笹川 崇男 ¹	1. 東工大応セラ研
16:00	休憩 / Break			
16:15	20p-S323-9	シアノフタロシアニンをビルディングブロックとしたポリフタロシアニンシート合成	○坂口 裕哉 ¹ 、田代 慎 ¹ 、萩原 政幸 ² 、木田 孝則 ² 、酒井 政道 ¹ 、福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、本多 善太郎 ¹	1. 埼玉大院理工、2. 阪大先端強磁場
16:30	20p-S323-10	金属フタロシアニンをを用いた遷移金属ドーピング炭素材料の合成と磁性	○佐藤 峻 ¹ 、金杉 彩能 ¹ 、萩原 政幸 ² 、木田 孝則 ² 、酒井 政道 ¹ 、福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、本多 善太郎 ¹	1. 埼玉大院理工、2. 阪大先端強磁場
16:45	20p-S323-11	2次元トポロジカル絶縁体 AlSb/InAs/GaSb/AlSb ヘテロ構造の断面 STM/STS 観測	○安藤 達人 ¹ 、加来 滋 ¹ 、吉野 淳二 ¹	1. 東工大大院理工
10 スピントロニクス・マグネティクス / Spintronics and Magnetics				
シンポジウムプログラムの p.33 ~ p.40 にございます				
3/19(Sat) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P1 会場				
	奨 19p-P1-1	強磁場中回転容器内で非定常時に生じる流れが配向粒子に及ぼす影響 - 回転容器内で発生する流れの可視化 -	○(M1C) 上西 陵太 ¹ 、安藤 努 ¹ 、廣田 憲之 ²	1. 日大生産工、2. 物材機構
	E 19p-P1-2	Crystallization of Lysozyme by LLIP Method in High Magnetic Fields	○(M1)tetsuya onotou ¹ , Isao Yamamoto ¹	1.YNU
	奨 E 19p-P1-3	Crystallization of Ice by LLIP Method under Magnetic Field II	○(B)Sae Kimoto ¹ , Yuta Kimura ¹ , Isao Yamamoto ¹	1.YNU
	19p-P1-4	強磁場下での液-液界面析出法による NaCl 結晶作製III	○(M2) 仙波 龍生 ¹ 、吉田 瞭佑 ¹ 、山本 勲 ¹	1. 横国大院工
	19p-P1-5	回転磁場を用いて 3 軸配向した擬単結晶 Fe ₃ C の結晶磁気異方性エネルギー	○寺井 智之 ¹ 、山本 祐義 ² 、福田 隆 ¹ 、掛下 知行 ¹ 、堀井 滋 ³ 、米村 光治 ²	1. 阪大工、2. 新日鐵住金、3. 京大院エネ科
	19p-P1-6	磁気電気化学キラリティーへのマイクロ電極の効果	○茂木 巖 ¹ 、青柿 良一 ² 、高橋 弘紀 ¹	1. 東北大金研、2. 職業大
	19p-P1-7	燐光材料の三重項状態を利用した物体の磁場中での非接触光マニピュレーション	○池添 泰弘 ¹ 、種部 千遥 ¹ 、湯澤 凌 ¹	1. 日工大
	19p-P1-8	永久磁石を用いたプラスチック材料のシングルストリーム磁気分離システム	○池添 泰弘 ¹ 、濱崎 裕介 ¹ 、湯澤 凌 ¹ 、畑澤 雅徳 ¹ 、藤田 裕嗣 ¹ 、箭竹 竜一 ¹	1. 日工大
	奨 19p-P1-9	回転磁場による磁化率変化に関する研究 - 磁気アルキメデス浮上による検証 -	○(M1) 朱 JUDY 俊翰 ¹ 、木村 史子 ¹ 、木村 恒久 ¹	1. 京大院農
	奨 19p-P1-10	回転磁場による反磁性の増強効果 - 磁場配向による検証 -	○木村 陽介 ¹ 、木村 史子 ¹ 、木村 恒久 ¹	1. 京大院農
	19p-P1-11	垂直磁化方式のトンネル型スピントロニクス素子実現に向けた非磁性金属層上への CoFe ₂ O ₄ 薄膜の作製と評価	○(B) 成瀬 克芳 ¹ 、来多 佑亮 ¹ 、田中 雅章 ¹ 、谷口 卓也 ² 、小野 輝男 ² 、壬生 攻 ¹	1. 名工大、2. 京大化研
	奨 19p-P1-12	Optimization of preparation conditions for Nd _{0.5} Bi _{0.5} Fe ₃ O ₁₂ thin films prepared by MOD Method for magneto-optical imaging plates	○(M2) Qi Liu ¹ , Gengjian Lou ¹ , Takahiro Hashinaka ¹ , Michimasa Sasaki ¹ , Takayuki Ishibashi ¹	1. Nagaoka.Univ.of Tech.
	E 19p-P1-13	Dynamical magnetoelectric switching of perpendicular exchange bias in Pt/Co/spacer/Cr ₂ O ₃ /Pt stacked films	○(P)Anh ThiVan Nguyen ¹ , Yu Shiratsuchi ¹ , Ryoichi Nakatani ¹	1.Grad. School of Eng. Sci., Osaka Univ.
	19p-P1-14	FMR measurements of Nd _{0.5} Bi _{0.5} Fe ₃ O ₁₂ (y = 0-1) thin films on glass substrates prepared by MOD method	○(D) Kouken Lou ¹ , Michimasa Sasaki ¹ , Nobuyasu Adachi ² , Takeshi Kato ³ , Satoshi Iwata ³ , Takayuki Ishibashi ¹	1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. Nagoya Inst. Tech., 3. Nagoya Univ.

19p-P1-15	ガラス基板上に作製した Co フェライト薄膜の磁気光学効果測定による評価	○(B)久保田 大志 ¹ 、目黒 燎 ¹ 、佐々木 教真 ¹ 、石 橋 隆幸 ¹	1.長岡技科大
奨 E 19p-P1-16	Enhancement of L2 ₁ ordering and spin-polarization of Co ₂ FeSi thin film by substitution of Fe with Ti	○(D)Jiamin CHEN ^{2,1} , Yuya Sakuraba ¹ , Yoshio Miura ^{3,1} , Takao Furubayashi ¹ , Kazuhiro Hono ^{1,2}	1.NIMS, 2.Tsukuba Univ., 3.Kyoto Inst. of Tech
19p-P1-17	垂直磁気異方性をもつ正方晶フェリ磁性 Mn ₂ N 薄膜の磁気構造	○(PC)伊藤 啓太 ^{1,2,3} 、具志 俊希 ¹ 、東小園 創真 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、白井 正文 ⁴ 、角田 匡清 ² 、末益 崇 ¹	1.筑波大数理物質、2.東北大工、3.学振 PD、4.東北大
19p-P1-18	異方性磁気抵抗効果を利用した Fe ₂ N 細線における磁壁の電流検出	○具志 俊希 ¹ 、伊藤 啓太 ^{1,2,3} 、東小園 創真 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、大里 啓孝 ⁴ 、杉本 喜正 ⁴ 、本多 周太 ⁵ 、末益 崇 ¹	1.筑波大 数理物質、2.東北大 工、3.学振、4.物材機構、5.関西大 シス理
19p-P1-19	パルスレーザー堆積法で作製した重金属ドーパ α-Fe ₂ O ₃ 薄膜の反強磁性磁気異方性評価	○(M2)安藤 聡伸 ¹ 、三神 和章 ¹ 、田中 雅章 ¹ 、壬 生 攻 ¹	1.名工大
19p-P1-20	MBE により成長した三元化合物 (Cr,Fe)Te 薄膜の磁気特性・構造特性へのアニール処理の効果	○(M1)鶴岡 英晃 ¹ 、金澤 研 ¹ 、黒田 眞司 ¹	1.筑大院数理物質
19p-P1-21	対向式スパッタリング法を用いた Ti ₂ O ₃ 薄膜のエピタキシャル成長及び磁気・輸送特性	○横田 壮司 ¹ 、平松 和樹 ¹ 、五味 学 ¹	1.名工大
19p-P1-22	漏洩磁場を利用したスピン量子十字デバイスの構造・磁気特性	○海住 英生 ¹ 、森 澄人 ¹ 、三澤 貴浩 ¹ 、小峰 啓史 ² 、中村 晃輔 ³ 、藤岡 正弥 ¹ 、西井 準治 ¹	1.北大電子研、2.茨大工、3.北大理
19p-P1-23	磁性・非磁性準周期多層膜の磁気特性	○本地 泰彦 ¹ 、児玉 俊之 ¹ 、富田 知志 ¹ 、細糸 信好 ¹ 、柳 久雄 ¹	1.奈良先端大物質
19p-P1-24	有機金属分解法を用いた準周期マグネティック結晶の作製	○國原 一真 ¹ 、本地 泰彦 ¹ 、中山 和之 ² 、富田 知志 ¹ 、細糸 信好 ¹ 、柳 久雄 ¹	1.奈良先端大、2.福岡大
19p-P1-25	診断と治療を目指した磁気ナノ微粒子の開発	○一柳 優子 ¹ 、石川 智也 ¹ 、山崎 貴大 ¹ 、森本 翔大 ¹ 、兵藤 公美典 ¹ 、酒井 元大 ¹	1.横国大院工
19p-P1-26	強磁性半導体に向けた Mn 添加 ZnO 薄膜の評価	○那須 菜穂 ¹ 、張 宇 ¹ 、箕輪 直輝 ¹ 、趙 新為 ¹	1.東理大理
19p-P1-27	第一原理計算による Sm ₂ Fe ₁₇ N ₃ の磁気特性	○柏谷 裕美 ¹ 、乙川 光平 ^{2,1} 、田中 真人 ¹ 、小川 博嗣 ¹ 、池浦 広美 ¹ 、豊川 弘之 ¹	1.産業技術総合研究所、2.早稲田大学
E 19p-P1-28	Magnetic properties in magnetron sputtering prepared Mn-doped ZnO thin films	○Yu Zhang ¹ , Nao Nasu ¹ , Xinwei Zhao ¹	1.Tokyo Univ. of Sci.
19p-P1-29	Fe ₃ O ₄ ナノ粒子単層膜および多層膜の磁気光学カー特性評価	○北條 大介 ¹ 、鈴木 和也 ¹ 、浅尾 直樹 ¹ 、水上 成美 ¹ 、阿尻 雅文 ¹	1.東北大学 WPI-AIMR
E 19p-P1-30	Effects of Asymmetrical Potential Barriers on Spin Injection into Nonmagnet	○Toshio Suzuki ¹	1.AIT
E 19p-P1-31	Domain wall dynamics in ferrimagnetic Tb/Co multilayer wires below and above the magnetic compensation point	○Masaaki Tanaka ¹ , Sho Sumitomo ¹ , Noriko Adachi ¹ , Syuta Honda ² , Ko Mibu ¹ , Hiroyuki Awano ³	1.Nagoya Inst. of Tech., 2.Kansai Univ., 3.Toyota Tech. Inst.
19p-P1-32	擬単結晶 Fe ₂ N 薄膜における異常ネルンスト効果の結晶方位依存性	○磯上 慎二 ¹ 、水口 将輝 ² 、高梨 弘毅 ²	1.国立福島高専、2.東北大金研
19p-P1-33	積層構造ナノワイヤにおける電流誘起磁壁移動の数値解析	○小峰 啓史 ¹ 、青野 友祐 ¹ 、安藤 亮 ¹	1.茨大工
19p-P1-34	磁気トルクとスピントルクによる磁気渦対共鳴の分離	○棚澤 友幾 ¹ 、能崎 幸雄 ¹	1.慶大理工
19p-P1-35	TbFeCo/RH ₂ (R=Y, Sc) のスピン注入時における磁気電気伝導特性評価	○西間木 誠 ¹ 、高尾 啓 ¹ 、松永 智善 ¹ 、飯笹 圭太郎 ¹ 、酒井 政道 ¹ 、樋口 宏二 ² 、北島 彰 ² 、大島 明博 ² 、長谷川 繁彦 ² 、黒川 雄一郎 ³ 、栗野 博之 ³	1.埼玉大理工、2.阪大産研、3.豊田工大
19p-P1-36	金属有機化合物分解法により作製した Ce:YIG 薄膜の評価	○平田 智士 ¹ 、小野 竜義 ¹ 、野田 和希 ¹ 、雨宮 嘉照 ¹ 、田部井 哲夫 ¹ 、横山 新 ¹	1.広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所
19p-P1-37	CoFe/MgO/n ⁺ -SOI を用いたスピン信号の Si 基板表面処理効果	○石川 瑞恵 ¹ 、杉山 英行 ¹ 、井口 智明 ¹ 、浜屋 宏平 ¹ 、手束 展規 ² 、斉藤 好昭 ¹	1.(株)東芝研開せ、2.阪大院基礎工、3.東北大院工
19p-P1-38	異常ホール効果が誘起する巨視的電場の伝播方程式	○酒井 政道 ¹	1.埼玉大理工
19p-P1-39	弾性表面波の力学的回転を用いたスピン流生成	○小林 大真 ¹ 、高橋 遼 ^{2,3,4} 、井口 亮 ^{2,4} 、松尾 衛 ^{2,3} 、前川 禎通 ^{2,3} 、齊藤 英治 ^{2,3,4,5} 、能崎 幸雄 ¹	1.慶大理工、2.ERATO-SQR、3.原研 ASRC、4.東北大金研、5.東北大 WPI-AIMR
E 19p-P1-40	Tunnel magnetoresistance effects of Co ₂ (Fe-Mn)Si/MgO/Co ₂ Fe ₃₀ magnetic tunnel junctions using Pd buffer layer	○(M2)Mingling Sun ^{1,2} , Shigeki Takahashi ³ , Takahide Kubota ² , Yoshiaki Sonobe ³ , Koki Takanashi ²	1.Grad. School of Eng., Tohoku Univ., 2.IMR, Tohoku Univ., 3.Samsung R&D Institute Japan
E 19p-P1-41	Change in Magnetic Anisotropy Energy with Electric Field for Fe-Pt-Pd Alloys	○Satoru Kikushima ¹ , Takeshi Seki ¹ , Koki Takanashi ¹	1.IMR, Tohoku Univ.
19p-P1-42	電圧印加ダイナミック磁化反転のエラー率に対する面内磁場の影響	○塩田 陽一 ¹ 、野崎 隆行 ¹ 、谷口 知大 ¹ 、薬師寺 啓 ¹ 、久保田 均 ¹ 、福島 章雄 ¹ 、湯浅 新治 ¹ 、鈴木 義茂 ¹	1.産総研スピン
E 19p-P1-43	Effect of voltage on the magneto-static spin waves in magnetic tunnel junction with perpendicular magnetization	○(P)Jaehun Cho ¹ , Shinji Miwa ¹ , Kay Yakushiji ² , Shingo Tamaru ² , Hitoshi Kubota ² , Akio Fukushima ² , Shinji Yuasa ² , Yoshishige Suzuki ¹	1.Osaka Univ., 2.AIST
E 19p-P1-44	Ferromagnetic resonance study on Y-type hexaferrite Ba _{0.5} Sr _{1.5} Zn ₂ Fe ₁₂ O ₂₂	○(P)Jaehun Cho ^{1,2} , Nam-Hui Kim ² , Jungbum Yoon ² , Kimyung Song ² , Namjung Hur ² , Chun-Yeol You ² , Seung-Young Park ³ , Myung-Hwa Jung ⁴ , Yuji Hiraoka ¹ , Tsuyoshi Kimura ¹ , Kohei Nawaoka ¹ , Shinji Miwa ¹ , Yoshishige Suzuki ¹	1.Osaka Univ., Japan, 2.Inha Univ., Korea, 3.KBSI, Korea, 4.Sogang Univ., Korea
19p-P1-45	MgO/Fe/MgO の第一原理電子状態計算	○吉川 大輝 ¹ 、小幡 正雄 ¹ 、金川 朋賢 ² 、太田 多一 ² 、小田 竜樹 ^{1,2}	1.金沢大自然、2.金沢大理工
19p-P1-46	イオン液体を用いた電気二重層による (Zn,Cr)Te の磁性変調	○百瀬 峻 ¹ 、和田 泰地 ¹ 、及川 晴義 ¹ 、黒田 眞司 ¹	1.筑大院数物
E 19p-P1-47	Fabrication of highly (001)-oriented Co ₂ Fe _{0.4} Mn _{0.6} Si Heusler alloy thin films deposited on thermally oxidized Si substrate	○Atsuo Ono ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ.
E 19p-P1-48	Investigation of Magnetic Tunnel Junction with high sensitivity for Eddy Current Testing	○(DC)Zhenhu Jin ¹ , Masahiko Abe ¹ , Motoki Endo ¹ , Kosuke Fujiwara ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ.
E 19p-P1-49	Highly sensitive MTJ arrays with amorphous CoFeSiB for bio-magnetic field sensor	○Cakir Sabri ¹ , Daiki Kato ¹ , Kosuke Fujiwara ¹ , Hiroshi Naganuma ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ.
19p-P1-50	両ピン構造 MTJ センサの作製とノイズ・シグナル測定	○吉川 大輝 ¹ 、藤原 耕輔 ¹ 、大兼 幹彦 ¹ 、城野 純一 ² 、土田 匡章 ² 、安藤 康夫 ¹	1.東北大院工、2.コニカミノルタ
E 19p-P1-51	Magneto-resistance Properties in Magnetic Tunnel Junctions with Amorphous CoFeSiB Electrode at Low Magnetic Field	○Daiki Kato ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Kosuke Fujiwara ¹ , Yuki Arai ¹ , Junichi Jono ² , Hiroshi Naganuma ¹ , Masaaki Tsuchida ² , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ., 2.Konica Minolta

19p-P1-52	強磁性・反強磁性複合相を有する Mn 添加 ZnSnAs ₂ 薄膜の磁気特性	○(PC) 日高 志郎 ¹ 、豊田 英之 ¹ 、内富 直隆 ¹	1.長岡技大
E 19p-P1-53	Magnetic properties and lateral spin-valve device application of MnAs/InAs/GaAs(111)B	○(D)Earul Islam ¹ , Masashi Akabori ¹	1.JAIST
E 19p-P1-54	Electronic states of Ce and magneto-transport characteristics in Ce doped Si films	○Yusuke Miyata ¹ , Ueno Kazuya ¹ , Yoshimura Takeshi ¹ , Ashida Atsushi ¹ , Fujimura Norifumi ¹	1.Osaka Pref. Univ.
奨 19p-P1-55	Room temperature operation of helicity switching using dual-electrode spin-LED	○青山 政樹 ¹ 、西沢 望 ¹ 、西林 一彦 ¹ 、宗片 比呂夫 ¹	1.東工大像情報
E 19p-P1-56	Temperature dependence of spin relaxation time in (110)-oriented GaAs/AlGaAs quantum wells	○Satoshi Iba ¹ , Hidekazu Saito ¹ , Ken Watanabe ² , Yuzo Ohno ² , Shinji Yuasa ¹	1.AIIST, 2.Univ. of Tsukuba
19p-P1-57	半導体からのキャリア注入による強磁性量子井戸におけるトンネルキャリアのスピン分極率の変調	○芦原 渉 ¹ 、若林 勇希 ¹ 、岡本 浩平 ¹ 、田中 雅明 ¹ 、大矢 忍 ¹	1.東大工
19p-P1-58	微細加工基板上化学気相成長により生成した高配向率を有するダイヤモンド中空素空孔中心のスピン特性	○藤田 留士郎 ¹ 、西條 蒼野 ¹ 、渡邊 幸志 ² 、赤羽 浩一 ³ 、伊藤 公平 ¹ 、早瀬 潤子 ¹	1.慶大理工, 2.産総研, 3.情報通信研究機構
E 19p-P1-59	Preparation of Mg _{1-x} Ti _x O-based magnetic tunnel junctions with CoFeB electrodes	○(DC)Tiar Ikh ^{1,2} , Shinya Kasai ² , Po-Han Cheng ^{1,2} , Tadakatsu Ohkubo ² , Yukiko Takahashi ² , Takao Furubayashi ² , Kazuhiro Hono ^{1,2}	1.Univ. of Tsukuba, 2.NIMS
19p-P1-60	Spacer layer thickness dependence of CPP-GMR effects in Co ₂ (Fe-Mn)Si/Li ₂ -Ag-Mg/Co ₂ (Fe-Mn)Si devices	○(M1) 伊奈 幸佑 ¹ 、窪田 崇秀 ¹ 、高梨 弘毅 ¹	1.東北大金研
19p-P1-61	静磁表面スピン波の非相反性に対するアンテナ-磁性層間の距離依存性	○中山 真伎 ¹ 、笠原 健司 ¹ 、眞砂 卓史 ¹	1.福岡大理
E 19p-P1-62	Resistance modulation by Rashba-Edelstein-like interfacial effect in CoFe/Cu/BiO films	○Junyeon Kim ¹ , Shutaro Karube ² , YoshiChika Otani ^{1,2}	1.CEMS, RIKEN, 2.ISSP, Univ. of Tokyo
奨 E 19p-P1-63	Signatures of Spin Nernst Effect in Metallic Bilayers	○(PC)Peng Sheng ¹ , Yuya Sakuraba ¹ , Seiji Mitani ¹ , Masamitsu Hayashi ¹	1.National Institute for Materials Science
19p-P1-64	回転 NMR における Berry 位相効果	○針井 一哉 ^{1,2} 、松尾 衛 ^{1,2} 、中堂 博之 ^{1,2} 、小野 正雄 ^{1,2} 、家田 淳一 ¹ 、岡安 悟 ^{1,2} 、前川 禎通 ^{1,2} 、齊藤 英治 ^{1,2,3}	1.原研先端研, 2.ERATO 量子整流, 3.東北大金研・AIMR
E 19p-P1-65	Sensor property of Magnetic Tunnel Junctions with superparamagnetic CoFeB free layer	○Kyohei Ishikawa ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Kosuke Fujiwara ¹ , Jyunichi Jyono ² , Masaaki Tsuchida ² , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ., 2.Konica Minolta Inc.
19p-P1-66	磁壁ピニング磁気抵抗効果素子の局所磁場応答	○葛西 紘貴 ¹ 、野崎 友貴 ¹ 、スバギョ アグス ¹ 、末岡 和久 ¹	1.北大情報科学
E 19p-P1-67	Shift register based on magnetic quantum cellular automata	○Naomichi Yoshioka ¹ , Nomura Hikaru ¹ , Nakatani Ryoichi ¹	1.Osaka Univ.
19p-P1-68	Si 表面上の Au 一元鎖におけるラッシュバ型スピン分裂バンド	○田口 一暁 ¹ 、角田 一樹 ¹ 、宮本 幸治 ² 、生天目 博文 ² 、谷口 雅樹 ² 、木村 昭夫 ¹ 、奥田 太一 ²	1.広大院理, 2.広大放射光セ
19p-P1-69	Mn ドープ InAs-GaSb 超格子の熱電特性	○武富 優綺 ¹ 、加来 滋 ¹ 、吉野 淳二 ¹	1.東京工業大学大学院理工学研究科物性物理学専攻
19p-P1-70	X線磁気門二色性を用いた希薄磁性半導体 Ga _{1-x} Gd _x As の原子磁気モーメント検出	○宮川 勇人 ¹ 、大西 吉行 ¹ 、小柴 俊 ¹ 、高橋 尚志 ² 、水牧 仁一朗 ³ 、河村 直己 ³ 、鈴木 基寛 ³	1.香川大工, 2.香川大教, 3.JASRI/SPring-8
E 19p-P1-71	Magnetic properties of (In,Fe)As grown on vicinal GaAs substrates	○Akihide Nagamine ¹ , Munehiko Yoshida ¹ , Masaaki Tanaka ² , Pham Nam Hai ¹	1.Tokyo Inst. Tech., 2.Univ. Tokyo
E 19p-P1-72	Enhancement of emission power in vortex spin torque oscillator	○Sumito Tsunegi ¹ , Kay Yakushiji ¹ , Hitoshi Kubota ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹	1.AIIST
19p-P1-73	Gate-all-around InAs ナノワイヤ FET におけるラッシュバスピン軌道相互作用の電界制御	○芦川 耶真登 ^{1,2} 、高瀬 恵子 ¹ 、Guoqiang Zhang ¹ 、籠野 功太 ¹ 、齊藤 志郎 ¹ 、佐々木 智 ^{1,2}	1.NTT 物性基礎研, 2.東北大理
E 19p-P1-74	Magnetization control of Co ferrite thin films by Kr ion implantation	○Yang Liu ¹ , Yuki Hisamatsu ¹ , Hideto Yanagihara ¹ , Daiki Oshima ² , Takeshi Katoh ² , Satoshi Iwata ² , Mibu ³ , Eiji Kita ¹	1.Univ. of Tsukuba, 2.Nagoya Univ., 3.Nagoya Inst. of Tech
CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」			
/ 10.1/10.2/10.3 Code sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena"			
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場			
9:00	奨 E 22a-W241-1	Electric-field effect on domain structure in MgO/CoFeB/Ta	○Takaaki Dohi ¹ , Shun Kanai ^{1,2} , Atsushi Okada ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{4,1,2} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}
9:15	E 22a-W241-2	Large voltage-induced magnetic anisotropy change in Cr/ultrathin Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions II	○Takayuki Nozaki ¹ , Anna Koziol-Rachwal ^{1,2} , Witold Skowronski ^{1,2} , Vadym Zayets ¹ , Yoichi Shiota ¹ , Shingo Tamaru ¹ , Hitoshi Kubota ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹ , Yoshishige Suzuki ^{1,2}
9:30	E 22a-W241-3	Different effects between Al- and Zr-insertion on voltage control of PMA at CoFeB/oxide interface	○Ryusuke Oishi ¹ , Weidong Li ¹ , Koji Kita ¹
9:45	22a-W241-4	希土類金属超薄膜における結晶磁気異方性の第一原理計算	○(D) 名和 憲嗣 ¹ 、池浦 雄志 ¹ 、中村 浩次 ¹ 、秋山 亨 ¹ 、伊藤 智徳 ¹ 、小口 多美夫 ²
10:00	奨 E 22a-W241-5	Laser-induced spin precessional dynamics in CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junction under the electric field	○yuta sasaki ¹ , Kazuya Suzuki ² , Satoshi Iihama ¹ , Atsushi Sugihara ² , Yasuo Ando ¹ , Shigemitsu Mizukami ²
10:15	奨 22a-W241-6	Fe MgO における界面ジャロンスキー-谷村相互作用の電圧変調	○(DC) 縄岡 孝平 ¹ 、三輪 真嗣 ¹ 、塩田 陽一 ^{1,2} 、野崎 隆行 ² 、湯浅 新治 ² 、水落 憲和 ¹ 、鈴木 義茂 ¹
10:30	休憩 / Break		
10:45	奨 E 22a-W241-7	Voltage modulation of interfacial spin direction at MnIr MgO with triple-Q spin state	○Minoru Goto ¹ , Kohei Nawaoka ¹ , Shinji Miwa ¹ , Shohei Hatanaka ¹ , Norikazu Mizuochi ¹ , Yoshishige Suzuki ¹
11:00	E 22a-W241-8	Electric-Field-Induced X-ray Magnetic Circular Dichroism for Studying Perpendicularly Magnetized Ni/Cu Multilayers	○Jun Okabayashi ¹ , Tomoyasu Taniyama ²
11:15	22a-W241-9	SrTiO ₃ バックゲートを用いた Co 極薄膜の電界効果：面方位依存性	○中澤 新悟 ¹ 、大日方 絢 ² 、千葉 大地 ² 、上野 和紀 ¹
11:30	奨 E 22a-W241-10	Electrical control of magnetism in electric double layer capacitors with a Co electrode	○Takamasa Hirai ¹ , Aya Obinata ¹ , Yuki Hibino ¹ , Tomohiro Koyama ¹ , Kazumoto Miwa ² , Shimpei Ono ² , Makoto Kohda ³ , Daichi Chiba ¹

11:45	奨 E 22a-W241-11	Mechanical modulation of magnetic anisotropy in Pt/Co films deposited on a flexible substrate	○ Shinya Ota ¹ , Ryo Asai ¹ , Takahiro Kozeki ² , Hirokazu Akamine ² , Tatsuya Fujii ² , Takahiro Namazu ² , Taishi Takenobu ³ , Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.Univ. of Tokyo, 2.Univ. of Hyogo, 3.Waseda Univ.
3/22(Tue.) 13:15 - 14:15 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場				
13:15	奨 E 22p-W241-1	Spin-orbit torque induced magnetization switching in W/CoFeB/MgO	○ (D)Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGupta ¹ , Hideo Sato ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{1,2,4} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
13:30	奨 E 22p-W241-2	Crystal Structure Dependence of Spin-Orbit Fields in Pt/Co/AIO Trilayer Structures	○ (M1)Minsik KONG ¹ , Hiromu Gamou ¹ , Makoto Kohda ¹ , Junsaku Nitta ¹	1.Tohoku Univ.
13:45	奨 E 22p-W241-3	Dot size dependence of magnetization switching by spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet structures	○ Aleksandr Kurenkov ¹ , Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGupta ¹ , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
14:00	E 22p-W241-4	Determination of spin-orbit torque effective field from magnetic domain wall creep velocity	○ Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.The Univ. of Tokyo
10.1 新物質創成 (酸化物・ホイスラー・金属磁性体等) / Emerging materials in spintronics and magnetics (excluding semiconductors)				
3/21(Mon.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場				
9:00	奨 E 21a-W241-1	Magnetic and structural properties of Ni ₃ Fe ₂₂ thin films sandwiched between borate glasses	○ (DC)TAKAHIRO MISAWA ¹ , Sumito Mori ¹ , Haruya Kasa ¹ , Masaya Fujioka ¹ , Hideo Kaiju ¹ , Junji Nishii ¹	1.Hokkaido Univ.
9:15	奨 21a-W241-2	ZnO ナノ結晶を表面に成長させた磁性ガーネット薄膜の磁気光学応答	○塩津 勇作 ¹ 、水戸 慎一郎 ¹ 、笹野 順司 ²	1. 東京高専、2. 豊橋技科大
9:30	21a-W241-3	Nd _{0.5} Bi _{2.5} Fe ₄ GaO ₁₂ 薄膜に生じた応力誘導磁気異方性の評価	○ (M1) 箸中 貴大 ¹ 、佐々木 教真 ¹ 、石橋 隆幸 ¹ 、加藤 剛士 ² 、岩田 聡 ² 、谷山 智康 ³	1. 長岡技大、2. 名古屋大、3. 東工大
9:45	奨 E 21a-W241-4	Spin-dependent tunneling in La _{0.67} Sr _{0.33} MnO ₃ -based magnetic tunnel junctions with an LaMnO ₃ barrier	○ Tatsuya Matou ¹ , Kento Takeshima ¹ , Masaaki Tanaka ¹ , Shinobu Ohya ¹	1.Tokyo Univ.
10:00	奨 E 21a-W241-5	Epitaxial growth of Bi _{1-x} Sb _x spin-Hall alloy on GaAs(111) substrates	○ Yugo Ueda ¹ , Pham Nam Hai ¹	1.Tokyo Tech
10:15	21a-W241-6	MBE 法による強磁性窒化物 Ni ₄ Fe _{1-x} N 薄膜のエピタキシャル成長	○ (B) 高田 郁弥 ¹ 、伊藤 啓太 ^{1,2,3} 、具志 俊希 ¹ 、東 小園 創真 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、末益 崇 ¹	1. 筑波大 数理解物質、2. 東北大 工、3. 学振
10:30	21a-W241-7	MgAl ₂ O ₄ 基板上への高配向 (α + α')-Fe ₁₀ N ₂ 薄膜のエピタキシャル成長	○ (M1) 東小園 創真 ¹ 、伊藤 啓太 ^{1,2,3} 、具志 俊希 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、末益 崇 ¹	1. 筑波大数理解物質、2. 東北大工、3. 学振
10:45	E 21a-W241-8	Antiperovskite ferromagnetic MnGaN films with perpendicular magnetic anisotropy	○ (PC)Hwachol Lee ¹ , Hiroaki Sukegawa ¹ , Jun Liu ^{1,2} , Zhenchao Wen ¹ , Tadakatsu Ohkubo ¹ , Shinya Kasai ¹ , Seiji Mitani ^{1,2} , Kazuhiro Hono ^{1,2}	1.MMU, NIMS, 2.Univ. of Tsukuba
11:00	21a-W241-9	極薄 MnGa 薄膜の室温成長	○鈴木 和也 ¹ 、杉原 敦 ¹ 、宮崎 照宜 ¹ 、水上 成美 ¹	1. 東北大 WPI-AIMR
11:15	E 21a-W241-10	Interfacial Exchange Coupling in FeCo/MnGa Studied by X-ray Magnetic Circular Dichroism	○ Jun Okabayashi ¹ , Kazuya Suzuki ² , Shigemi Mizukami ²	1.Univ. of Tokyo, 2.Tohoku Univ.
11:30	奨 E 21a-W241-11	Fabrication of Mn ₂ VAl full-Heusler epitaxial thin films for spin wave devices	○ Kenji Fukuda ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Hiroshi Naganuma ¹ , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku univ.
11:45	奨 E 21a-W241-12	Fabrication of Li _{0.7} Mn _{1-x} Co _x Al Thin Films for Magnetic Tunnel Junctions	○ Kenta Watanabe ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Miho Kubota ¹ , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ.
CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」				
/ 10.1/10.2/10.3 Code sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena"				
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場				
9:00	奨 E 22a-W241-1	Electric-field effect on domain structure in MgO/CoFeB/Ta	○ Takaaki Dohi ¹ , Shun Kanai ^{1,2} , Atsushi Okada ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{4,1,2} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
9:15	E 22a-W241-2	Large voltage-induced magnetic anisotropy change in Cr/ultrathin Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions II	○ Takayuki Nozaki ¹ , Anna Koziol-Rachwal ^{1,2} , Witold Skowronski ^{1,2} , Vadym Zayets ¹ , Yoichi Shiota ¹ , Shingo Tamaru ¹ , Hitoshi Kubota ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹ , Yoshishige Suzuki ^{1,3}	1.AIST, 2.AGH Univ., 3.Osaka Univ.
9:30	E 22a-W241-3	Different effects between Al- and Zr-insertion on voltage control of PMA at CoFeB/oxide interface	○ Ryusuke Oishi ¹ , Weidong Li ¹ , Koji Kita ¹	1.the Univ. of Tokyo
9:45	22a-W241-4	希土類金属超薄膜における結晶磁気異方性の第一原理計算	○ (D) 名和 憲嗣 ¹ 、池浦 雄志 ¹ 、中村 浩次 ¹ 、秋山 亨 ¹ 、伊藤 智徳 ¹ 、小口 多美夫 ²	1. 三重大院工、2. 阪大産研
10:00	奨 E 22a-W241-5	Laser-induced spin precessional dynamics in CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junction under the electric field	○ yuta sasaki ¹ , Kazuya Suzuki ² , Satoshi Iihama ¹ , Atsushi Sugihara ² , Yasuo Ando ¹ , Shigemi Mizukami ²	1.Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR
10:15	奨 22a-W241-6	Fe MgO における界面ジャロシンスキー守谷相互作用の電圧変調	○ (DC) 縄岡 孝平 ¹ 、三輪 真嗣 ¹ 、塩田 陽一 ^{1,2} 、野崎 隆行 ² 、湯浅 新治 ² 、水落 憲和 ¹ 、鈴木 義茂 ¹	1. 阪大院基礎工、2. 産総研ナノスピン
10:30	休憩 / Break			
10:45	奨 E 22a-W241-7	Voltage modulation of interfacial spin direction at MnIr MgO with triple-Q spin state	○ Minoru Goto ¹ , Kohei Nawaoka ¹ , Shinji Miwa ¹ , Shohei Hatanaka ¹ , Norikazu Mizuochi ² , Yoshishige Suzuki ¹	1.Osaka Univ., 2.Kyoto Univ.
11:00	E 22a-W241-8	Electric-Field-Induced X-ray Magnetic Circular Dichroism for Studying Perpendicularly Magnetized Ni/Cu Multilayers	○ Jun Okabayashi ¹ , Tomoyasu Taniyama ²	1.Univ. of Tokyo, 2.Tokyo Tech.
11:15	22a-W241-9	SrTiO ₃ バックゲートを用いた Co 極薄膜の電界効果：面方位依存性	○中澤 新悟 ¹ 、大日方 絢 ² 、千葉 大地 ² 、上野 和紀 ¹	1. 東大院総合、2. 東大院工
11:30	奨 E 22a-W241-10	Electrical control of magnetism in electric double layer capacitors with a Co electrode	○ Takamasa Hirai ¹ , Aya Obinata ¹ , Yuki Hibino ¹ , Tomohiro Koyama ¹ , Kazumoto Miwa ² , Shimpei Ono ² , Makoto Kohda ³ , Daichi Chiba ¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI, 3.Tohoku Univ.
11:45	奨 E 22a-W241-11	Mechanical modulation of magnetic anisotropy in Pt/Co films deposited on a flexible substrate	○ Shinya Ota ¹ , Ryo Asai ¹ , Takahiro Kozeki ² , Hirokazu Akamine ² , Tatsuya Fujii ² , Takahiro Namazu ² , Taishi Takenobu ³ , Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.Univ. of Tokyo, 2.Univ. of Hyogo, 3.Waseda Univ.

3/22(Tue.) 13:15 - 14:15 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場			
13:15	奨 E 22p-W241-1	Spin-orbit torque induced magnetization switching in W/CoFeB/MgO	○ (D)Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGupta ¹ , Hideo Sato ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{1,2,4} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4} 1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
13:30	奨 E 22p-W241-2	Crystal Structure Dependence of Spin-Orbit Fields in Pt/Co/AIO Trilayer Structures	○ (M1)Minsik KONG ¹ , Hiromu Gamou ¹ , Makoto Kohda ¹ , Junsaku Nitta ¹ 1.Tohoku Univ.
13:45	奨 E 22p-W241-3	Dot size dependence of magnetization switching by spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet structures	○ Aleksandr Kurenkov ¹ , Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGupta ¹ , Hideo Ohno ^{1,2,3,4} 1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
14:00	E 22p-W241-4	Determination of spin-orbit torque effective field from magnetic domain wall creep velocity	○ Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹ 1.The Univ. of Tokyo
10.2 スピントルク・スピンの流・回路・測定技術 / Spin torque, spin current, circuits, and measurement technologies			
3/21(Mon.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場			
13:15	21p-W241-1	Si系横型素子における室温スピン信号の増大	○ 岡孝保 ¹ , 石川瑞恵 ² , 藤田裕一 ¹ , 山田晋也 ¹ , 1. 阪大基礎工, 2. 東芝研究開発センター 金島岳 ¹ , 齊藤好昭 ² , 浜屋宏平 ¹
13:30	E 21p-W241-2	Effect of post annealing on spin accumulation and transport signals in Co ₂ FeSi/MgO/n ⁺ -Si on insulator devices	○ Ajay Tiwari ¹ , Tomoaki Inokuchi ¹ , Mizue Ishikawa ¹ , Hideyuki Sugiyama ¹ , Yoshiaki Saito ¹ 1.Toshiba Corporation
13:45	奨 E 21p-W241-3	An effect of gate voltage on thermally generated spin signals in Si spin-MOSFET	○ Naoto Yamashita ¹ , Yuichiro Ando ¹ , Hayato Koike ² , Tomoyuki Sasaki ² , Shinji Miwa ² , Kazuhito Tanaka ³ , Yoshishige Suzuki ² , Masashi Shiraishi ¹ 1.Kyoto Univ., 2.TDK Corp., 3.Osaka Univ.
14:00	E 21p-W241-4	Electrical Spin Injection into δ -doped n-type Germanium Using Co ₂ Fe _{0.4} Mn _{0.6} Si Heusler Alloy Film	○ Takeo Koike ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Astuo Ono ¹ , Tetsuro Takada ² , Hidekazu Saito ² , Yasuo Ando ¹ 1.Tohoku Univ., 2.AIST
14:15	E 21p-W241-5	Spin transport in a two-dimensional electron gas in an AlGaAs/GaAs structure at room temperature	○ Kenro Ohtomo ¹ , Yuichiro Ando ¹ , Teruya Shinjo ¹ , Tetsuya Uemura ² , Masashi Shiraishi ¹ 1.Kyoto Univ., 2.Hokkaido Univ.
14:30	E 21p-W241-6	Design and analysis of electric-field-assisted four-terminal nonlocal Si-channel MOS devices	○ Daiki Kitagata ¹ , Taiju Akushichi ¹ , Yota Takamura ² , Yusuke Shuto ¹ , Satoshi Sugahara ¹ 1.ISEL, Tokyo Tech, 2.Dept. of Physical Electronics, Tokyo Tech
14:45	E 21p-W241-7	Spin accumulation in a Si channel using a high-quality CoFe/MgO/Si spin injector	○ (D)Taiju Akushichi ¹ , Yota Takamura ² , Yusuke Shuto ¹ , Satoshi Sugahara ¹ 1.ISEL, Tokyo Tech, 2.Dept. of Physical Electron., Tokyo Tech
15:00	休憩/Break		
15:15	21p-W241-8	面直磁化膜を活用した二次元電子ガスへのスピン注入	○ 大杉廉人 ¹ , 間野由布子 ¹ , 好田誠 ¹ , 新田淳作 ¹ 1. 東北大工
15:30	E 21p-W241-9	Investigation of the inverse Rashba-Edelstein effect in Bi/Ag and Ag/Bi on ferromagnetic insulator	○ Masayuki Matsushima ¹ , Sergey Dushenko ^{1,2} , Ryo Ohshima ^{1,2} , Yuichiro Ando ¹ , Teruya Shinjo ¹ , Masashi Shiraishi ¹ 1.Kyoto Univ., 2.Osaka Univ.
15:45	E 21p-W241-10	Conversion of spin current into charge current in Bi _{0.85} Sb _{0.15}	○ Ryohei Kumamoto ¹ , Yuichiro Ando ¹ , Sergey Dushenko ^{1,2} , Teruya Shinjo ¹ , Masashi Shiraishi ¹ 1.Kyoto Univ., 2.Osaka Univ.
16:00	奨 E 21p-W241-11	Quantitative analysis of the nuclear spin dynamics in GaAs with irradiation by RF magnetic field	○ (D)Mahmoud Rasly Eldesouky ¹ , Zhichao Lin ¹ , Masafumi Yamamoto ¹ , Tetsuya Uemura ¹ 1.Hokkaido Univ.
16:15	奨 E 21p-W241-12	Temperature dependence of the electromotive force in the topological crystalline insulator SnTe induced by spin pumping	○ Akiyori Yamamoto ¹ , Tomonari Yamaguchi ² , Ryo Ishikawa ² , Ryota Akiyama ¹ , Yuki K. Wakabayashi ¹ , Shinji Kuroda ² , Shinobu Ohya ¹ , Masaaki Tanaka ¹ 1.The Univ. of Tokyo, 2.Univ. of Tsukuba
16:30	E 21p-W241-13	Thermal Imaging of Spin Peltier Effect in Magnetic Insulators	Shunsuke Daimon ¹ , Ryo Iguchi ¹ , Eiji Saitoh ^{1,2,3,4} , Kenichi Uchida ^{1,5} 1.IMR Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR Tohoku Univ., 3.JST ERATO-SQR, 4.ASRC JAEA, 5.JST PRESTO
16:45	21p-W241-14	Pyに中間層を挿入した膜における静磁表面波の減衰長の関係	○ 太田雅己 ¹ , 葛西伸哉 ² , 三谷誠司 ² , 笠原健司 ¹ , 福岡大理工, 2. 物材機構 1, 眞砂卓史 ¹
17:00	休憩/Break		
17:15	奨 E 21p-W241-15	Theoretical analysis of thermally-activated spin-transfer-torque switching in a conically-magnetized free layer	○ Rie Matsumoto ¹ , Hiroko Ara ^{2,1} , Shinji Yuasa ¹ , Hiroshi Imamura ¹ 1.AIST, 2.PRESTO, JST
17:30	E 21p-W241-16	Stability of out-of-plane precession with the application of a tilted magnetic field in spin torque oscillator having a planar free layer and a perpendicular polarizer	○ (P)ryo hiramatsu ¹ , hitoshi kubota ¹ , sumito tsunegi ¹ , shingo tamaru ¹ , kay yakushiji ¹ , akio fukushima ¹ , rie matsumoto ¹ , hiroshi imamura ¹ , shinji yuasa ¹ 1.AIST
17:45	奨 E 21p-W241-17	Electrical mutual synchronization in vortex spin torque oscillators	○ Sumito Tsunegi ¹ , Hitoshi Kubota ¹ , Kay Yakushiji ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹ 1.AIST
18:00	奨 E 21p-W241-18	Influence of spin polarization of SIL on oscillation behavior of a mag-flip spin-torque-oscillator (STO) device	○ Hossein SepehriAmin ¹ , S. Bosu ¹ , Y. Sakuraba ¹ , M. Hayashi ¹ , T. Schreff ² , C. Abert ³ , D. Suess ³ , K. Hono ¹ 1.NIMS, Tsukuba, Japan, 2.Danube University Krems, Austria, 3.Technical University of Vienna, Austria
18:15	E 21p-W241-19	Mag-flip spin torque oscillator using highly spin polarized Heusler alloy as spin injection layer for microwave assisted magnetic recording	○ (PC)Subrojati Bosu ¹ , Hossein Sepehri-Amin ¹ , Yuya Sakuraba ¹ , Shinya Kasai ¹ , Masamitsu Hayashi ¹ , Kazuhiro Hono ¹ 1.National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japan
18:30	奨 E 21p-W241-20	Vortex Spin-Torque Oscillator using Co ₂ (Fe,Mn)Si Heusler Alloys with various Fe-Mn Compositions	○ (DC)Tatsuya Yamamoto ¹ , Takeshi Seki ^{1,2} , Koki Takanashi ¹ 1.IMR, Tohoku Univ., 2.JST-PRESTO
18:45	E 21p-W241-21	Analysis of Magnetization Dynamics of a Perpendicular Magnetic Nanodot Using Microwave-Magnetic-Field-Induced Diode Effect	○ Hirofumi Suto ¹ , Kiwamu Kudo ¹ , Tazumi Nagasawa ¹ , Taro Kanao ¹ , Koichi Mizushima ¹ , Rie Sato ¹ 1.Corporate R&D Center, Toshiba
CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」			
/ 10.1/10.2/10.3 Code sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena"			
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場			
9:00	奨 E 22a-W241-1	Electric-field effect on domain structure in MgO/CoFeB/Ta	○ Takaaki Dohi ¹ , Shun Kanai ^{1,2} , Atsushi Okada ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{4,1,2} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4} 1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
9:15	E 22a-W241-2	Large voltage-induced magnetic anisotropy change in Cr/ultrathin Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions II	○ Takayuki Nozaki ¹ , Anna Koziol-Rachwal ^{1,2} , Witold Skowronski ^{1,2} , Vadym Zayets ¹ , Yoichi Shiota ¹ , Shingo Tamaru ¹ , Hitoshi Kubota ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹ , Yoshishige Suzuki ^{1,3} 1.AIST, 2.AGH Univ., 3.Osaka Univ.
9:30	E 22a-W241-3	Different effects between Al- and Zr-insertion on voltage control of PMA at CoFeB/oxide interface	○ Ryusuke Oishi ¹ , Weidong Li ¹ , Koji Kita ¹ 1.the Univ. of Tokyo
9:45	22a-W241-4	希土類金属超薄膜における結晶磁気異方性の第一原理計算	○ (D)名和憲嗣 ¹ , 池浦雄志 ¹ , 中村浩次 ¹ , 秋山亨 ¹ , 伊藤智徳 ¹ , 小口多美夫 ² 1. 三重大院工, 2. 阪大産研

10:00	奨 E 22a-W241-5	Laser-induced spin precessional dynamics in CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junction under the electric field	○ yuta sasaki ¹ , Kazuya Suzuki ² , Satoshi Iihama ¹ , Atsushi Sugihara ² , Yasuo Ando ¹ , Shigemi Mizukami ²	1.Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR
10:15	奨 22a-W241-6	Fe MgOにおける界面ジャロシンスキー守谷相互作用の電圧変調	○ (DC) 縄岡 孝平 ¹ 、三輪 真嗣 ¹ 、塩田 陽一 ^{1,2} 、野崎 隆行 ² 、湯浅 新治 ² 、水落 憲和 ¹ 、鈴木 義茂 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 産総研ナノスピ
10:30		休憩 / Break		
10:45	奨 E 22a-W241-7	Voltage modulation of interfacial spin direction at MnIr MgO with triple-Q spin state	○ Minoru Goto ¹ , Kohei Nawaoka ¹ , Shinji Miwa ¹ , Shohei Hatanaka ¹ , Norikazu Mizuochi ² , Yoshishige Suzuki ¹	1.Osaka Univ., 2.Kyoto Univ.
11:00	E 22a-W241-8	Electric-Field-Induced X-ray Magnetic Circular Dichroism for Studying Perpendicularly Magnetized Ni/Cu Multilayers	○ Jun Okabayashi ¹ , Tomoyasu Taniyama ²	1.Univ. of Tokyo, 2.Tokyo Tech.
11:15	22a-W241-9	SrTiO ₃ バックゲートを用いたCo極薄膜の電界効果: 面方位依存性	○ 中澤 新悟 ¹ 、大日方 絢 ² 、千葉 大地 ² 、上野 和紀 ¹	1. 東大院総合, 2. 東大院工
11:30	奨 E 22a-W241-10	Electrical control of magnetism in electric double layer capacitors with a Co electrode	○ Takamasa Hirai ¹ , Aya Obinata ¹ , Yuki Hibino ¹ , Tomohiro Koyama ¹ , Kazumoto Miwa ² , Shimpei Ono ² , Makoto Kohda ³ , Daichi Chiba ¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI, 3.Tohoku Univ.
11:45	奨 E 22a-W241-11	Mechanical modulation of magnetic anisotropy in Pt/Co films deposited on a flexible substrate	○ Shinya Ota ¹ , Ryo Asai ¹ , Takahiro Kozeki ² , Hirokazu Akamine ² , Tatsuya Fujii ² , Takahiro Namazu ² , Taishi Takenobu ³ , Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.Univ. of Tokyo, 2.Univ. of Hyogo, 3.Waseda Univ.
3/22(Tue.) 13:15 - 14:15		口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場		
13:15	奨 E 22p-W241-1	Spin-orbit torque induced magnetization switching in W/CoFeB/MgO	○ (D)Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGupta ¹ , Hideo Sato ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{1,2,4} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
13:30	奨 E 22p-W241-2	Crystal Structure Dependence of Spin-Orbit Fields in Pt/Co/AIO Trilayer Structures	○ (M1)Minsik KONG ¹ , Hiromu Gamou ¹ , Makoto Kohda ¹ , Junsaku Nitta ¹	1.Tohoku Univ.
13:45	奨 E 22p-W241-3	Dot size dependence of magnetization switching by spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet structures	○ Aleksandr Kurenkov ¹ , Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGupta ¹ , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
14:00	E 22p-W241-4	Determination of spin-orbit torque effective field from magnetic domain wall creep velocity	○ Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.The Univ. of Tokyo
10.3 GMR・TMR・磁気記録技術 / Giant magnetoresistance (GMR), tunnel magnetoresistance (TMR) and magnetic recording technologies				
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15		口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場		
9:00	招 E 20a-W241-1	[Young Scientist Presentation Award Speech] L ₁ 2 Ag-Mg ordered alloy spacer layer for Heusler alloy based current perpendicular-to-plane giant magnetoresistance devices	○ Takahide Kubota ¹ , Yusuke Ina ¹ , Zhencho Wen ¹ , Koki Takanashi ¹	1.IMR, Tohoku Univ.
9:15	E 20a-W241-2	Large tunnel magnetoresistance in Co ₂ FeAl/MgAl ₂ O ₃ /Co ₂ FeAl junctions free from the band folding effect	○ (D)Thomas Scheike ^{1,2} , Hiroaki Sukegawa ² , Koichiro Inomata ² , Tadakatsu Ohkubo ² , Kazuhiro Hono ^{1,2} , Seiji Mitani ^{1,2}	1.Tsukuba Univ., 2.NIMS
9:30	奨 E 20a-W241-3	Large enhancement of magnetoresistance in thin NiAl-inserted Co ₂ FeGa _{0.5} Ge _{0.5} /Ag/Co ₂ FeGa _{0.5} Ge _{0.5} CPP-GMR devices	○ (P)Jinwon Jung ¹ , Yuya Sakuraba ¹ , Taisuke Sasaki ¹ , Yoshio Miura ^{1,2} , Kazuhiro Hono ¹	1.National Institute for Materials Science, 2.Kyoto Institute of Technology
9:45	奨 E 20a-W241-4	Giant tunnel magnetoresistance using a cation-disorder MgAl ₂ O ₄ (001) epitaxial barrier deposited by a direct sputtering technique	○ (P)Mohamed Belmoubarik ¹ , Hiroaki Sukegawa ¹ , Tadakatsu Ohkubo ¹ , Seiji Mitani ¹ , Kazuhiro Hono ¹	1.NIMS
10:00	20a-W241-5	Fe ₃ O ₄ (110)を用いた強磁性トンネル接合の磁気伝導特性	○ (M2) 佐々木 駿 ¹ 、長浜 太郎 ² 、島田 敏宏 ²	1. 北大院総化, 2. 北大院工
10:15	E 20a-W241-6	Fabrication of a perpendicular-MTJ by utilizing an Ir/Co stack	○ Kay Yakushiji ^{1,2} , Hitoshi Kubota ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹	1.AIIST, 2.PRESTO
10:30		休憩 / Break		
10:45	E 20a-W241-7	Bias voltage and temperature dependence of magnetoresistance ratio in low resistance magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetization	○ (M2)Sogo Oikawa ¹ , Nobuki Tezuka ¹ , Masashi Matsuura ¹ , Satoshi Sugimoto ¹ , Toshikazu Irisawa ² , Kazumasa Nishimura ² , Takuya Seino ²	1.Tohoku Univ., 2.CANON ANELVA Corp.
11:00	奨 E 20a-W241-8	Wide-dynamic-range magnetic sensor based on magnetic tunnel junction with perpendicularly magnetized [Co/Pd]-based reference layer	○ (DC)Takafumi Nakano ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Takamoto Furuichi ² , Kenichi Ao ² , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ., 2.DENSO CORP.
11:15	E 20a-W241-9	TMR properties in MTJs with non-uniform magnetic structure	○ Motoki Endo ¹ , Mikihiko Oogane ¹ , Yasuo Ando ¹	1.Tohoku Univ.
11:30	E 20a-W241-10	Large magnetocapacitance effect at room temperature in magnetic tunnel junctions	○ Hideo Kaiju ¹ , Masashi Takei ¹ , Takahiro Misawa ¹ , Taro Nagahama ² , Junji Nishii ¹ , Gang Xiao ³	1.RIES Hokkaido Univ., 2.Eng. Hokkaido Univ., 3.Phys. Brown Univ.
11:45	奨 E 20a-W241-11	Observation of tunneling magnetoresistance in trilayer structures composed of group-IV ferromagnetic semiconductor Ge _{1-x} Fe _x , MgO, and Fe	○ Kohei Okamoto ¹ , Yuuki Wakabayashi ¹ , Wataru Ashihara ¹ , Yoshisuke Ban ¹ , Shoichi Sato ¹ , Masaaki Tanaka ¹ , Shinobu Ohya ¹	1.The Univ. of Tokyo
12:00	奨 E 20a-W241-12	Vertical spin electric double layer transistor	○ Hiroshi Terada ¹ , Le Duc Anh ¹ , Shinobu Ohya ¹ , Yoshihiro Iwasa ¹ , Masaaki Tanaka ¹	1.The Univ. of Tokyo
10.4 半導体・有機・光・量子スピントロニクス / Semiconductors, organic, optical, and quantum spintronics				
3/19(Sat.) 16:00 - 19:00		口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場		
16:00	19p-W241-2	Ga _{1-x} Mn _x Asの巨大熱電能の起源の解明	○ 荒川 和哉 ¹ 、武富 優綺 ¹ 、加来 滋 ¹ 、吉野 淳二 ¹	1. 東工大理工物性物理
16:15	E 19p-W241-3	Observation of spontaneous spin-splitting in the band structure of n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As	○ (D)Anh Duc Le ¹ , Nam Hai Pham ² , Masaaki Tanaka ¹	1.Tokyo Univ., 2.Tokyo Inst. of Tech.
16:30	E 19p-W241-4	Helicity dependent photocurrent at RT from a Fe/x-ALO ₃ /p-GaAs Schottky junction	○ (D)Ronel Intal Roca ¹ , Nozomi Nishizawa ¹ , Hiro Munekata ¹	1.Tokyo Tech
16:45	19p-W241-5	キャリアアチューニングによるトポロジカル絶縁体(Sb _{1-x} Bi _x) ₂ Te ₃ の非平衡持続時間の制御	○ 角田 一樹 ¹ 、朱 思源 ¹ 、石田 行章 ² 、叶 茂 ³ 、田口 一暎 ¹ 、奥田 太一 ⁴ 、生天目 博文 ⁴ 、谷口 雅樹 ⁴ 、Konstantin Kokh ⁵ 、Oleg Tereshchenko ⁵ 、辛 植 ² 、木村 昭夫 ¹	1. 広大院理, 2. 東大物性研, 3. 中国科学院, 4. 広大放射光セ, 5. ノヴォシビルスク大学

17:00	19p-W241-6	トポロジカル絶縁体 Bi_2Te_3 における表面光起電力効果およびディラック電子ダイナミクス	○吉川 智己 ¹ 、角田 一樹 ² 、石田 行章 ³ 、陳 家華 ² 、Nuramat Munisa ² 、Kokh Konstantin ¹ 、Tereshchenko Oleg ⁴ 、辛 埴 ³ 、木村 昭夫 ^{1,2}	1. 広島大理、2. 広島大院理、3. 東大物性研、4. ノヴォシビルスク大
17:15	奨 E 19p-W241-7	【注目講演】 Quantum manipulation of spins in diamond via magnetic field gradients	○(DC)Keigo Arai ¹ 、Junghyun Lee ¹ 、Huiliang Zhang ² 、Ronald Walsworth ²	1.MIT, 2.Harvard Univ.
17:30		休憩 / Break		
17:45	19p-W241-8	時間分解ファラデー回転法による InGaAs/InAlAs 多重量子井戸における電子 g 因子測定	○森田 健 ¹ 、奥村 朗人 ¹ 、石谷 善博 ¹ 、北田 貴弘 ² 、井須 俊郎 ²	1. 千葉大院工、2. 徳大院フロンティア
18:00	奨 E 19p-W241-9	Temperature dependence of spin relaxation time in GaAs/AlGaAs resonant tunneling bi-quantum-well	○Yoshiki Nakamura ¹ 、Takanori Aritake ¹ 、Hao Wu ¹ 、Canyu Jiang ¹ 、Ko Nakayama ¹ 、Shunichi Muto ² 、Atsushi Tackeuchi ¹	1.Waseda Univ., 2.Hokkaido Univ.
18:15	E 19p-W241-10	Enhancement of spin transport length with tailored spin-orbit interactio	○Yoji Kunihashi ¹ 、Haruki Sanada ¹ 、Hideki Gotoh ¹ 、Koji Onomitsu ¹ 、Makoto Kohda ² 、Junsaku Nitta ² 、Tetsuomi Sogawa ¹	1.NTT BRL, 2.Tochoku Univ.
18:30	奨 E 19p-W241-11	Observation of spin relaxation in GaAs/GaAsP strained-compensated superlattice	○shunsuke ohki ¹ 、Xiuguang Jin ² 、Masaki Asakawa ¹ 、Tomoki Ishikawa ¹ 、Atsushi Tackeuchi ¹	1.Waseda Univ., 2.KEK
18:45	19p-W241-12	磁気近接効果によるグラフェン / YIG 接合の誘起スピン偏極	○境 誠司 ^{1,2} 、ソロキン パベル ³ 、園谷 志郎 ¹ 、楠 本 洋 ¹ 、四谷 晋太郎 ^{4,5} 、安藤 和也 ^{4,5} 、山内 泰 ²	1. 原研先端基礎、2. 物材機構、3. 超硬・新規炭素材料研、4. 慶徳大、5. さきがけ

11 超伝導 / Superconductivity

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

3/20(Sun.) 9:30 - 11:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場		
20a-P3-1		穴のあいた超伝導ナノストリップにおける量子化磁束の運動	○中野 侑 ^{1,2} 、○馬渡 康徳 ² 、西尾 太郎 ¹	1. 東理大、2. 産総研
20a-P3-2		パルス印加法を用いた Bi-2212 固有接合の c 軸方向における温度分布の検討	○佐藤 康紀 ¹ 、及川 大 ¹ 、岩塚 紳矢 ¹ 、安藤 浩哉 ¹ 、杉浦 藤虎 ¹ 、塚本 武彦 ¹	1. 豊田高専
20a-P3-3		高温超伝導体 Bi2212 を用いたテラヘルツ波光源のパッケージ化	○土居 卓司 ¹ 、辻本 学 ² 、Elarabi Asem ¹ 、温 一凡 ¹ 、掛谷 一弘 ¹	1. 京大院工、2. 筑波大学
20a-P3-4		黒鉛とアルカンからなる導体の室温超電導性の証拠一室温における臨界磁場の測定	○川島 康 ¹	1. 東海大工
20a-P3-5		Cu_2O を原料とした Sr-Ca-Cu-O 系超伝導体の合成と特性評価	○篠田 聖 ¹ 、Sklyarova Anastasia ¹ 、鈴木 常生 ¹ 、中山 忠親 ¹ 、末松 久幸 ¹ 、新原 浩一 ¹	1. 極限エネルギー密度工学研究センター
20a-P3-6		$\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_{7-d}$ 高圧相超伝導体の電気抵抗率	○南雲 智博 ¹ 、青葉 知弥 ² 、鈴木 常生 ¹ 、中山 忠親 ¹ 、末松 久幸 ¹ 、新原 浩一 ¹	1. 長岡技術科学大学 極限エネルギー密度工学研究センター、2. 豊橋技術科学大学
20a-P3-7		固相反応法による $\text{RuSr}_2\text{GdCu}_2\text{O}_8$ 単結晶合成とその特性評価	○(M1) 番場 幸大 ¹ 、八巻 和宏 ¹ 、入江 晃巨 ¹	1. 宇都宮大工
20a-P3-8		KOH フラックス法を用いた $\text{NdBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_y$ 膜の作製条件と Nd/Ba 置換の関係	○船木 修平 ¹ 、奥西 亮太 ¹ 、宮地 優悟 ¹ 、山田 容士 ¹	1. 島根大総理工
20a-P3-9		Si イオンを照射した YBCO 薄膜の表面抵抗の磁場依存性	○高梨 直希 ¹ 、近藤 雅也 ¹ 、松井 浩明 ² 、齊藤 敦 ¹ 、中島 健介 ¹ 、大嶋 重利 ¹	1. 山形大工、2. 産総研
奨 20a-P3-10		NaF を用いた $\text{Bi}_2(\text{O},\text{F})_2\text{S}_2$ 超伝導体の作製	○(B) 高橋 夏海 ¹ 、長尾 雅則 ¹ 、綿打 敏司 ¹ 、田中 功 ¹	1. 山梨大クリスタル研
20a-P3-11		$\text{Pr}(\text{O}, \text{F})\text{BiS}_2$ 単結晶における Pr 価数の XPS による評価	○石井 聡 ¹ 、本宮 靖章 ¹ 、三浦 章 ² 、長尾 雅則 ³	1. 東京電機大理工、2. 北大、3. 山梨大
20a-P3-12		電気化学的析出法による $\text{FeSe}_{1-x}\text{Te}_x$ の作製と物性	○渡辺 宣朗 ¹ 、増井 孝彦 ² 、小池 翔磨 ¹ 、本村 美乃理 ¹ 、吉田 溪 ¹ 、住吉 理愛 ¹	1. 関東学院大理工、2. 近大理工
20a-P3-13		フッ素フリー MOD-GdBCO 膜形成における K 添加依存性	○(M1) 山口 晶平 ¹ 、喜多 隆介 ¹ 、久保 勇人 ² 、三浦 大介 ² 、山田 和広 ³ 、金子 賢治 ³	1. 静大院工、2. 首都大院工、3. 九大院工
20a-P3-14		エアロゾルデポジションによる酸化物超電導体 $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-x}$ 膜の作製と評価	○金谷 康平 ¹ 、佐藤 祐喜 ¹ 、吉門 進三 ¹	1. 同大理工
20a-P3-15		種膜を用いた KOH フラックス法によるクラックフリー YCa_{124} 膜の作製	○添田 圭佑 ¹ 、児島 康大 ¹ 、奥西 亮太 ¹ 、宮地 優悟 ¹ 、船木 修平 ¹ 、山田 容士 ¹	1. 島根大 総理工
20a-P3-16		ナノ粒子の空間分布による YBCO 薄膜の J_c の異方性の制御	○末吉 哲郎 ¹ 、浦口 雄世 ¹ 、末永 桃太郎 ¹ 、古澤 隆章 ¹ 、藤吉 孝則 ¹	1. 熊大工
20a-P3-17		引き抜き法による BaHfO_3 導入 EuBCO 線材の低温高磁場特性の評価	○鈴木 匠 ¹ 、小野寺 優太 ¹ 、井上 昌睦 ¹ 、東川 甲平 ¹ 、衣斐 顕 ² 、吉田 朋 ² 、町 敬人 ² 、和泉 輝郎 ² 、木須 隆暢 ¹	1. 九州大学、2. ISTEK
20a-P3-18		冷凍機冷却による半円状 MgB_2 超電導バルク磁石の性能評価	○石原 篤 ¹ 、赤坂 友幸 ¹ 、富田 優 ¹ 、岸尾 光二 ²	1. 鉄道総研、2. 東大院工
20a-P3-19		多層リング状バルク超電導体における磁場補正	○赤坂 友幸 ¹ 、石原 篤 ¹ 、福本 祐介 ¹ 、富田 優 ¹ 、禹 泰城 ² 、関野 正樹 ² 、大崎 博之 ²	1. 鉄道総研、2. 東大
20a-P3-20		電界放射を抑制できる NMR 超伝導検出コイル形状の検討	○北嶋 慶太 ¹	1. 山形大学院理工
20a-P3-21		高感度磁気センサを用いた磁気異常検出装置の開発	○増谷 夏輝 ¹ 、廿日出 好 ¹	1. 近畿大学
20a-P3-22		ドローンを用いた磁気異常計測装置の開発	○藤田 裕二 ¹ 、笹川 友希 ¹ 、増谷 夏輝 ¹ 、廿日出 好 ¹	1. 近大工
20a-P3-23		中赤外光検出器の高周波化に向けたスロットアンテナの検討	○堀川 隼世 ¹ 、川上 彰 ² 、兵頭 政春 ³ 、島影 尚 ⁴	1. 福井高専、2. 情通機構、3. 金沢大理工、4. 茨城大学
20a-P3-24		中赤外光検出器アンテナの検出角度依存性の評価	○小原 涼輔 ¹ 、島影 尚 ¹ 、堀川 隼世 ² 、川上 彰 ³	1. 茨城大学、2. 福井高専、3. 情通機構
20a-P3-25		GHz 帯電磁波を照射されたジョセフソン接合におけるカオスシミュレーション	○日渡 涼 ¹ 、田村 幸英 ¹ 、島影 尚 ¹	1. 茨城大学
20a-P3-26		マイクロ波 SQUID マルチプレクサのチャネル間漏話	○平山 文紀 ¹ 、入松川 知也 ^{1,2} 、佐々木 仁 ¹ 、佐藤 昭 ¹ 、山森 弘毅 ¹ 、永沢 秀一 ¹ 、福田 大治 ¹ 、日高 睦夫 ¹ 、佐藤 泰 ¹ 、神代 暁 ¹ 、大野 雅史 ² 、高橋 浩之 ²	1. 産総研、2. 東大工
20a-P3-27		NIS トンネル接合型固体冷凍素子開発 V	○柏谷 聡 ¹ 、柏谷 裕美 ¹ 、小柳 正男 ¹	1. 産総研
20a-P3-28		動的に制御可能な超伝導位相制御回路の設計とその評価	○山本 竜平 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横国大理工
20a-P3-29		超伝導回路におけるトラップされた磁束が与える影響の調査	○今井 響 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横国大院工
20a-P3-30		HfO_x を障壁層とした NbTiN トンネル接合の作製と評価	○宗本 健太郎 ¹ 、山本 直輝 ¹ 、赤池 宏之 ¹ 、藤巻 朗 ¹	1. 名大工院
20a-P3-31		磁束量子パラメロン回路を用いたランダムアクセスメモリの提案	○高山 広 ¹ 、竹内 尚輝 ¹ 、辻 直樹 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横国大

11.1 基礎物性 / Fundamental properties				
3/19(Sat.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場				
10:00	19a-W833-1	生体材料鋳型による YBa ₂ Cu ₃ O _{7-δ} マイクロ / ナノワイヤの合成と評価	○(M1) 松本 裕介 ¹ 、的場 正憲 ¹ 、海住 英生 ² 、西井 準治 ² 、Hall Simon ³ 、神原 陽一 ¹	1. 慶大理工, 2. 北大電子研, 3. Univ. of Bristol
10:15	19a-W833-2	MgO/Mg ₂ Si/MgB ₂ ナノ複合結晶の超伝導特性	上野 勝也 ¹ 、長嶋 廉仁 ² 、瀬戸 雄介 ¹ 、松本 恵 ¹ 、櫻井 敬博 ¹ 、太田 仁 ¹ 、○内野 隆司 ¹	1. 神戸大, 2. 日本板硝子
10:30	19a-W833-3	ゲートチューナブルな Nb/Bi ₂ Te ₃ /Nb 接合の特性	○明連 広昭 ¹ 、Ngabonziza Prosper ² 、Stehno Martin, P ² 、Brinkman Alexander ²	1. 埼玉大院, 2. トウエンテ大
10:45	奨 19a-W833-4	超伝導ナノ細線の電場応答特性のシミュレーション	○(DC) 田口 真彦 ^{1,2} 、都倉 康弘 ² 、川畑 史郎 ¹	1. 産総研ナノエレ, 2. 筑波大数理物質
11:00	奨 19a-W833-5	Bi ₂ Sr ₂ CaCu ₂ O _{8+δ} 固有ジョセフソン接合における第 2 スイッチの臨界電流密度依存性	○野村 義樹 ¹ 、岡本 陸 ¹ 、神原 仁志 ¹ 、掛谷 一弘 ¹	1. 京大院工
11:15	19a-W833-6	高温超伝導体単結晶 Bi ₂ Sr ₂ CaCu ₂ O _{8+δ} を用いた正方形型単独メサ構造からの THz 波発振特性 II	○久保 裕之 ¹ 、柏木 隆成 ¹ 、坂本 和輝 ¹ 、北村 健郎 ¹ 、渡邊 千春 ¹ 、幸 良彦 ¹ 、柴野 雄紀 ¹ 、桂川 拓也 ¹ 、田中 大河 ¹ 、湯浅 拓実 ¹ 、小守 優貴 ¹ 、榎本 拓真 ¹ 、辻本 学 ¹ 、山本 卓 ² 、南 英俊 ¹ 、門脇 和男 ¹	1. 筑波大数理物質, 2. ウルム大学
11:30	19a-W833-7	Stand-alone 型 HTS-THz 波発振デバイスの作製と発振特性	○南 英俊 ¹ 、渡邊 千春 ¹ 、小守 優貴 ¹ 、北村 健郎 ¹ 、柴野 雄紀 ¹ 、久保 裕之 ¹ 、坂本 和輝 ¹ 、幸 良彦 ¹ 、桂川 拓也 ¹ 、柏木 隆成 ¹ 、山本 卓 ² 、門脇 和男 ¹	1. 筑波大数理物質
11:45	19a-W833-8	薄型高温超伝導体 BSCCO への面内スピン注入	○村田 健一郎 ¹ 、大高 和人 ¹ 、八巻 和宏 ¹ 、入江 晃 亘 ¹	1. 宇都宮大工
3/20(Sun.) 13:15 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場				
13:15	奨 20p-W833-1	金属ダイヤモンドを電極とした新しい DAC による 30 GPa への到達	○松本 凌 ^{1,2} 、笹間 陽介 ^{1,2} 、藤岡 正弥 ^{1,3} 、入船 徹男 ⁴ 、田中 将嗣 ¹ 、山口 尚秀 ^{1,2} 、竹屋 浩幸 ¹ 、高野 義彦 ^{1,2}	1. 物材機構, 2. 筑波大学, 3. 北海道大学, 4. 愛媛大学
13:30	20p-W833-2	RE247 焼結体の臨界温度	○下山 淳一 ¹ 、都所 恒輝 ¹ 、辻岳 千里 ² 、堀井 滋 ³ 、岸尾 光二 ²	1. 青学大, 2. 東大, 3. 京大
13:45	20p-W833-3	Cu 核スピンから見た超伝導性 Pr247 の電子状態と Y124 の三軸配向	池田 宏輔 ¹ 、坂井 祐大 ¹ 、林 昂平 ¹ 、松本 啓佑 ¹ 、三浦 敬典 ¹ 、大滝 達也 ¹ 、○佐々木 進 ¹ 、堀井 滋 ² 、下山 淳一 ³ 、土井 俊哉 ²	1. 新潟大自, 2. 京大院エネ科, 3. 青学院理工
14:00	20p-W833-4	間欠回転磁場下でのコロイドプロセスによる REBa ₂ Cu ₃ O ₇ 二軸配向成型体の作製	○堀井 滋 ¹ 、藤岡 祥太郎 ¹ 、西岡 寛広 ¹ 、土井 俊哉 ¹	1. 京大院エネ科
14:15	20p-W833-5	双晶を含む REBa ₂ Cu ₃ O ₇ 粉末の磁場配向挙動に与える酸素アニールの影響	○西岡 寛広 ¹ 、堀井 滋 ¹ 、藤岡 祥太郎 ¹ 、土井 俊哉 ¹	1. 京大院エネ科
14:30	奨 20p-W833-6	歪制御した無限層 Sr _{0.875} La _{0.125} CuO ₂ スパッタ薄膜の超伝導特性	○作間 啓太 ¹ 、伊藤 雅崇 ¹ 、羽尻 哲也 ¹ 、植田 研二 ¹ 、浅野 秀文 ¹	1. 名大院工
14:45		休憩 / Break		
15:00	20p-W833-7	スパッタリング法により作製した無限層構造 CaCuO ₂ の高い導電性	○丸山 萌 ¹ 、七尾 美子 ¹ 、内藤 方夫 ¹	1. 農工大工
15:15	20p-W833-8	Transport properties of superconducting electron doped Pr _{2-x} Ce _x CuO _{4+δ}	○池田 愛 ¹ 、Krockenberger Yoshiharu ¹ 、入江 宏 ¹ 、山本 秀樹 ¹	1. NTT 物性研
15:30	20p-W833-9	RuGd1222 の元素置換効果と結晶育成	○八巻 和宏 ¹ 、番場 幸大 ¹ 、入江 晃 亘 ¹	1. 宇都宮大工
15:45	20p-W833-10	傾斜基板を用いた MOD 法による双晶構造のない (11n) 配向 Bi2212 薄膜の作製	○山田 靖幸 ¹ 、加藤 孝弘 ¹ 、石橋 隆幸 ¹ 、岡元 智一郎 ¹	1. 長岡技科大
16:00	20p-W833-11	低温での O ₃ 酸化による銀酸化物の合成	○七尾 美子 ¹ 、伊藤 陸 ¹ 、内藤 方夫 ¹	1. 農工大工
16:15	20p-W833-12	分子線エピタキシー成長による二次元エレクトライド Sr ₂ N の作製と評価	○武田 力丸 ¹ 、山口 紘一 ¹ 、内藤 方夫 ¹	1. 農工大工
16:30		休憩 / Break		
16:45	20p-W833-13	REFeAs(O,F) の超伝導特性に対する Sn 添加および RE 混合効果	○林 功輔 ¹ 、荻野 拓 ¹ 、焼田 裕之 ¹ 、下山 淳一 ² 、岸尾 光二 ¹	1. 東大院工, 2. 青学大院理工
17:00	20p-W833-14	CrP 層を持つ層状化合物の探索と物性評価	○市原 義悠 ¹ 、荻野 拓 ¹ 、焼田 裕之 ¹ 、下山 淳一 ² 、岸尾 光二 ¹	1. 東大院工, 2. 青学大院理工
17:15	20p-W833-15	Nb _{1-x} Ta _x (Se _{1-y} S _y) ₃ (x=0-1, y=0-0.2) の高圧合成および超伝導特性	○山本 文子 ^{1,2} 、十倉 好紀 ²	1. 芝浦工大, 2. 理研
17:30	20p-W833-16	Cd 添加 LaO(F)BiS ₂ 超伝導体単結晶の育成と評価	○長尾 雅則 ¹ 、綿打 敏司 ¹ 、高野 義彦 ² 、田中 功 ¹	1. 山梨大院クリスタル研, 2. 物材機構
17:45	奨 20p-W833-17	Bi ²⁺ 正方格子を持つ新規層状酸化物超伝導体 Y ₂ O ₃ Bi	○(DC) 清 良輔 ^{1,2} 、気谷 卓 ³ 、福村 知昭 ³ 、川路 均 ³ 、長谷川 哲也 ¹	1. 東大院理, 2. 東北大院理, 3. 東工大応セラ研
18:00	奨 20p-W833-18	磁束フローから見た鉄系超伝導体の超伝導ギャップ構造	○(DC) 岡田 達典 ¹ 、今井 良宗 ¹ 、前田 京剛 ¹	1. 東大院総合
11.2 薄膜、厚膜、テープ作製プロセスおよび結晶成長 / Thin and thick superconducting films, coated conductors and film crystal growth				
3/21(Mon.) 9:00 - 10:15 口頭講演 (Oral Presentation) W834 会場				
9:00	21a-W834-1	異なる BMO 添加量を持った REBCO 薄膜中におけるナノロード自己組織化の結晶成長シミュレーション	○一野 祐亮 ^{1,2} 、吉田 隆 ²	1. 名大未来研, 2. 名大院工
9:15	21a-W834-2	a- 軸配向膜の作製と評価	○高井 洋輔 ¹ 、塚原 志穂 ² 、一瀬 中 ³ 、末吉 哲郎 ⁴ 、藤吉 孝則 ⁴ 、向田 昌志 ¹	1. 九大院工, 2. 九工大, 3. 電中研, 4. 熊大院工
9:30	奨 21a-W834-3	絶縁性 FeSe 極薄膜における電界誘起超伝導	○半沢 幸太 ¹ 、佐藤 光 ¹ 、平松 秀典 ^{1,2} 、神谷 利夫 ^{1,2} 、細野 秀雄 ^{1,2}	1. 東工大応セラ研, 2. 東工大元素戦略
9:45	21a-W834-4	膜厚の異なる電子ビーム蒸着 MgB ₂ 薄膜の臨界電流特性	○下田 佑太郎 ¹ 、竹原 寛人 ¹ 、堀井 滋 ¹ 、土井 俊哉 ¹ 、楠 敏明 ² 、一瀬 中 ³	1. 京大院エネ科, 2. 日立製作所, 3. 電中研
10:00	21a-W834-5	種々のバリア材料を用いたオール MgB ₂ ジョセフソン接合の作製 (2)	○迫田 将仁 ¹ 、菊池 素之 ¹ 、内藤 方夫 ¹	1. 農工大工
11.3 臨界電流、超伝導パワー応用 / Critical Current, Superconducting Power Applications				
3/20(Sun.) 13:45 - 16:45 口頭講演 (Oral Presentation) W810 会場				
13:45	招 20p-W810-1	【第 6 回女性研究者研究業績・人材育成賞 (小館香椎子賞) 受賞記念講演】 (30 分) 高 Jc 超伝導材料開発と石狩での直流送電システム実証試験	○筑本 知子 ¹	1. 中部大
14:15	20p-W810-2	YBCO 薄膜の磁束ピン止め特性に及ぼす微細 Y ₂ O ₃ ナノ析出物のサイズ効果	○山崎 裕文 ¹ 、松井 浩明 ¹	1. 産総研
14:30	20p-W810-3	BaHfO ₃ 導入 EuBCO 線材の広範な実用環境下における電流輸送特性	○井上 昌睦 ¹ 、高崎 建 ¹ 、今村 和孝 ¹ 、鈴木 匠 ¹ 、東川 甲平 ¹ 、衣斐 顕 ² 、吉田 朋 ² 、和泉 輝郎 ² 、木須 隆暢 ¹	1. 九大院シス情, 2. 超伝導工研

14:45	奨 20p-W810-4	EuBCO コート線材における磁化緩和挙動と支配因子	○小野寺 優太 ¹ 、今村 和孝 ¹ 、鈴木 匠 ¹ 、東川 甲平 ¹ 、井上 昌睦 ¹ 、衣斐 顕 ² 、吉田 朋 ² 、町 敬人 ² 、和泉 輝郎 ² 、木須 隆暢 ¹	1. 九大院シス情, 2. ISTECSRL
15:00	奨 20p-W810-5	高磁界磁気顕微法による BaHfO ₃ 導入 EuBCO 線材の臨界電流特性評価	○市村 彰吾 ¹ 、高崎 建 ¹ 、鈴木 匠 ¹ 、小野寺 優太 ¹ 、東川 甲平 ¹ 、井上 昌睦 ¹ 、衣斐 顕 ² 、吉田 朋 ² 、和泉 輝郎 ² 、木須 隆暢 ¹	1. 九州大学, 2. ISTECSRL
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 20p-W810-6	人工ビビを導入した REBCO 線材における磁界中局所臨界電流の長手方向分布評価	○(M1) 福岡 貴裕 ¹ 、東川 甲平 ¹ 、今村 和孝 ¹ 、井上 昌睦 ¹ 、五十嵐 光則 ² 、柿本 一臣 ² 、飯島 康裕 ² 、和泉 輝郎 ³ 、木須 隆暢 ¹	1. 九大シス情, 2. フジクラ, 3. ISTECSRL
15:45	奨 20p-W810-7	Bi2223 高温超伝導線材の電流輸送特性の定式化	○(M1) 呂 琳 ¹ 、鈴木 匠 ¹ 、高崎 建 ¹ 、大村 俊介 ¹ 、井上 昌睦 ¹ 、東川 甲平 ¹ 、木須 隆暢 ¹	1. 九州大学
16:00	20p-W810-8	Ex situ PIT 法による (Ba(Sr),K)Fe ₂ As ₂ 線材の臨界電流特性	○熊倉 浩明 ¹ 、Zhaoshun Gao ¹ 、松本 明善 ¹ 、戸叶 一正 ¹	1. 物材機構
16:15	20p-W810-9	QMG ⁺ リングの 10T 強磁場着磁とひずみ特性	○森田 充 ¹	1. 新日鐵住金
16:30	20p-W810-10	縦磁界下の超伝導細線における磁束線の運動に関する TDGL シミュレーション	○増田 嘉道 ¹ 、小田部 荘司 ¹ 、木内 勝 ¹ 、馬渡 康徳 ¹ 、松野 哲也 ²	1. 九工大, 2. 産総研, 3. 有明高専
11.4 アナログ応用および関連技術 / Analog applications and their related technologies				
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場				
9:00	21a-W833-1	究極的な極低暗計数率を有する SSPD の作製	○柴田 浩行 ¹ 、清水 薫 ² 、武居 弘樹 ² 、都合 康弘 ²	1. 北見工大, 2. NTT 物性研
9:15	21a-W833-2	誘電体多層膜付きインターリーブ型 SSPD アレイの開発	○山下 太郎 ¹ 、三木 茂人 ¹ 、寺井 弘高 ¹	1. 情通機構
9:30	21a-W833-3	超伝導ナノワイヤ単一光子検出器による光子数検出器の提案	○塩島 俊也 ¹ 、成瀬 雅人 ¹ 、田井野 徹 ¹ 、明連 広昭 ¹	1. 埼玉大院
9:45	21a-W833-4	アバランシェ型超伝導ナノワイヤ単一光子検出素子の特性評価	○三木 茂人 ¹ 、山下 太郎 ¹ 、寺井 弘高 ¹	1. 情通機構
10:00	21a-W833-5	導波路結合型 SSPD の作製プロセスの検討	○和木 健太郎 ^{1,2} 、山下 太郎 ² 、井上 振一郎 ^{2,3} 、三木 茂人 ² 、寺井 弘高 ² 、生田 力三 ¹ 、山本 俊 ¹ 、井元 信之 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 情通機構, 3. JST さきがけ
10:15	21a-W833-6	超伝導ナノストリップによる新型クライオトロンにおける電流集中と臨界電流	○馬渡 康徳 ¹	1. 産総研
10:30		休憩 / Break		
10:45	21a-W833-7	超伝導転移端センサによる単一光子の分光測定	○福田 大治 ^{1,2} 、丹羽 一樹 ¹ 、小林 稜 ^{1,2} 、沼田 孝之 ¹ 、田辺 稔 ¹ 、神代 暁 ¹ 、井上 修一郎 ²	1. 産総研, 2. 日大
11:00	21a-W833-8	ナノアンテナを用いた超伝導中赤外光検出器の光応答特性	○川上 彰 ¹ 、島影 尚 ² 、堀川 隼世 ³ 、兵頭 政春 ⁴ 、田中 秀吉 ¹	1. 情通機構, 2. 茨城大院, 3. 福井高専, 4. 金沢大
11:15	21a-W833-9	原子層堆積法により成膜した窒化ニオブ (NbN) 膜の超伝導特性	○浮辺 雅宏 ¹ 、藤井 剛 ¹ 、志岐 成友 ¹ 、大久保 雅隆 ¹	1. 産総研
11:30	21a-W833-10	1024 素子超伝導トンネル接合アレイ検出器	○藤井 剛 ¹ 、浮辺 雅宏 ¹ 、大久保 雅隆 ¹	1. 産総研
11:45	21a-W833-11	ミリ波オンチップ超伝導分光器カメラの冷却光学特性評価	○新井 慧 ¹ 、成瀬 雅人 ¹ 、美馬 寛 ² 、大谷 知行 ² 、田井野 徹 ¹ 、明連 広昭 ¹	1. 埼玉大院理工, 2. 理研
12:00	21a-W833-12	拡張 Mattis-Bardeen 理論による超伝導共振器の解析	○野口 卓 ¹ 、関根 正和 ² 、Agnes Dominjon ¹ 、関本 裕太郎 ¹	1. 国立天文台, 2. 東大理
3/21(Mon.) 13:45 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) W833 会場				
13:45	招 21p-W833-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) HTS-SQUID と近赤外光を用いた MPI システムによる皮膚下 MNP 検出の検討	○森田 洪爾 ¹ 、松永 恭暁 ¹ 、堺 健司 ¹ 、紀和 利彦 ¹ 、塚田 啓二 ¹	1. 岡山大自然
14:00	21p-W833-2	二つの検出コイルを用いた磁気ナノ粒子分布の 3 次元画像化	○辻田 祐也 ¹ 、森下 学 ¹ 、笹山 瑛由 ¹ 、円福 敬二 ¹	1. 九大シス情
14:15	21p-W833-3	地下 300m での高温超伝導 SQUID の冷却技術	○波頭 経裕 ¹ 、塚本 晃 ¹ 、安達 成司 ¹ 、渡辺 英久 ² 、石川 浩浩 ² 、岡田 力 ² 、加藤 文人 ³ 、国司 洋介 ³ 、吉松 圭太 ³ 、原田 誠 ³ 、田辺 圭一 ¹	1. 超伝導工研, 2. 三井金属資源開発, 3. 石油天然ガス・金属鉱物資源機構
14:30	奨 21p-W833-4	SQUID センサを用いた磁気的免疫検査法における磁化方法の改善	○中村 洗太 ¹ 、浦 正和 ¹ 、高藤 佳嗣 ¹ 、笹山 瑛由 ¹ 、吉田 敬 ¹ 、円福 敬二 ¹	1. 九大システム情報
14:45	21p-W833-5	LN ₂ 冷却銅巻線極小コイルを用いた超低磁場 SQUID-NMR の検討	○出町 一馬 ¹ 、廣瀬 勇野 ¹ 、八田 純一 ¹ 、有吉 誠一 ¹ 、田中 三郎 ¹	1. 豊橋科大
15:00	21p-W833-6	STM-SQUID 顕微鏡の距離変調による試料表面上の局所磁場計測	○宮戸 祐治 ¹ 、芦塚 拓也 ¹ 、糸崎 秀夫 ¹	1. 阪大院基礎工
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 21p-W833-7	高温超伝導コイルを用いた鉄板厚測定及びシミュレーション	○笹山 瑛由 ¹ 、石田 智樹 ¹ 、松尾 政晃 ¹ 、円福 敬二 ¹	1. 九大院シス情
15:45	奨 21p-W833-8	超伝導コイルと一体化した磁気センサの非破壊検査応用	○松永 恭暁 ¹ 、森田 洪爾 ¹ 、堺 健司 ¹ 、紀和 利彦 ¹ 、塚田 啓二 ¹	1. 岡山大自然
16:00	21p-W833-9	超音波ガイド波と HTS-SQUID を組み合わせたりモート非破壊試験技術の開発 - その 1 -	○廿日出 好 ¹ 、小林 奉樹 ¹ 、中家 早紀 ¹ 、増谷 夏輝 ¹	1. 近大工
16:15	21p-W833-10	超伝導デュアルバンドパス共振器の共振周波数独立調整法の検討	○海野 雄丈 ¹ 、關谷 尚人 ¹	1. 山梨大工
16:30	21p-W833-11	送信用超伝導デュアルモードダブルストリップ共振器フィルタの耐電力特性	○櫻井 佑樹 ¹ 、藤原 幸貴 ¹ 、關谷 尚人 ¹	1. 山梨大工
16:45	21p-W833-12	超伝導共振器の中心周波数シフトに関する検討	○鈴木 悠介 ¹	1. 山形大学院理工
17:00	21p-W833-13	超伝導テープ線材を用いた無線電力伝送システムの検討	○關谷 尚人 ¹ 、文珠川 祐輝 ¹	1. 山梨大工
11.5 接合、回路作製プロセスおよびデジタル応用 / Junction and circuit fabrication process, digital applications				
3/20(Sun.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) W834 会場				
13:45	20p-W834-1	単一磁束量子リング・オシレータのジッタの評価	○下田 知毅 ¹ 、佐野 京佑 ¹ 、阿部 裕 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横浜国大院工
14:00	奨 20p-W834-2	動作点調節機能を有する SFQ 入力インターフェース回路の評価	○宮嶋 茂之 ¹ 、山下 太郎 ¹ 、三木 茂人 ¹ 、寺井 弘高 ¹	1. 情報機構
14:15	奨 20p-W834-3	HSTP プロセスでの AQFP セルライブラリの設計	○安藤 拓生 ¹ 、竹内 尚輝 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横国大
14:30	奨 20p-W834-4	直列接続多元超伝導検出器及び SFQ 読み出し回路による検出位置特定	○神谷 恭平 ¹ 、上阪 岬 ¹ 、内藤 亮介 ¹ 、田中 雅光 ¹ 、Bozbey Ali ² 、藤巻 朗 ¹	1. 名大院, 2. TOBB UET

14:45	奨 20p-W834-5	Nb/Al/AIO ₂ /Al/Nb 接合におけるサブギャップ電流の考察	○(M2)池谷 瑞基 ¹ 、酒井 剛 ¹ 、小嶋 崇文 ² 、野口 卓 ²	1. 電通大, 2. 国立天文台
15:00	奨 20p-W834-6	Nb/PdNi/Nb 磁性ジョセフソン接合の作製	○栗原 卓也 ¹ 、伊藤 大 ¹ 、谷口 壮耶 ¹ 、赤池 宏之 ¹ 、藤巻 朗 ¹	1. 名大院工
15:15		休憩 / Break		
15:30	20p-W834-7	カレントリサイクル技術を用いた単一磁束量子時間測定回路の低電流化	○佐野 京佑 ^{1,2} 、下田 知毅 ¹ 、阿部 裕 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横浜国大工, 2. 学振特別研究員
15:45	20p-W834-8	高温超伝導 Nano-cryotron による高インピーダンストランジスタの作製	○伊藤 雄記 ¹ 、○鈴木 雅斗 ¹ 、田中 雅光 ¹ 、藤巻 朗 ¹ 、赤池 宏之 ¹	1. 名大工
16:00	20p-W834-9	シリコンディープエッチングを用いた光・電気変換器への光ファイバセルフアライメント手法の検討	○寺井 弘高 ¹ 、三木 茂人 ¹ 、山下 太郎 ¹ 、宮嶋 茂之 ¹	1. 情通機構
16:15	20p-W834-10	SFQ RAM の構築に向けたメモリセルとデコーダ回路の設計と評価	○五十嵐 丈 ¹ 、宮西 駿 ¹ 、鈴木 秀雄 ¹ 、山梨 裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横国大
16:30	20p-W834-11	磁性体を用いた超伝導位相シフトのための磁化の個別制御に関する検討	○谷口 壮耶 ¹ 、伊藤 大 ¹ 、石川 航太 ¹ 、黒川 綜太 ¹ 、田中 雅光 ¹ 、赤池 宏之 ¹ 、藤巻 朗 ¹	1. 名大院工
16:45	20p-W834-12	AQFP 回路の論理しきい値におけるグレーゾーンのシミュレーション	○松島 孝 ¹ 、竹内 尚輝 ¹ 、Ortlepp Thomas ² 、裕希 ¹ 、吉川 信行 ¹	1. 横国大, 2. The CiS

12 有機分子・バイオエレクトロニクス / Organic Molecules and Bioelectronics

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

12.1 作製・構造制御 / Fabrications and Structure Controls

3/19(Sat.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2 会場				
	19a-P2-1	金・銀ナノ粒子分散溶液の蒸発による自己集積過程の理論解析	○田村 守 ¹ 、岡本 晃一 ² 、玉田 薫 ² 、飯田 琢也 ¹	1. 阪府大院理, 2. 九大先導研
	19a-P2-2	高分子錯体ナノ結晶の反応活性面を認識した選択的表面修飾	○鈴木 龍樹 ¹ 、小野寺 恒信 ¹ 、笠井 均 ¹ 、及川 英俊 ¹	1. 東北大多元研
	19a-P2-3	ダイヤモンドナノ粒子の電気泳動堆積過程の溶液電位解析	○後藤 洋介 ¹ 、田中 邦明 ¹ 、大石 不二夫 ² 、白井 博 ¹	1. 農工大工, 2. 神奈川大理
	19a-P2-4	低 Tg 高分子表面からの金属原子離脱現象を利用した希少金属の集積蒸着	○王 陸 ¹ 、辻岡 強 ¹	1. 阪教大
	19a-P2-5	垂直配向尿素オリゴマー薄膜の作製と構造・電気特性評価	福富 達也 ¹ 、○森本 勝大 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、石田 謙司 ¹	1. 神戸大院工
	19a-P2-6	ポリプロピレン蒸着膜の作製における基板温度の影響	○佐藤 慶太 ¹ 、庭野 俊裕 ¹ 、田中 邦明 ¹ 、畠山 温 ¹ 、白井 博明 ¹	1. 農工大工
	19a-P2-7	ナフタレンジイミド骨格を持つビニル高分子薄膜の蒸着重合	○(M1) 富田 啓輔 ¹ 、藤田 浩士 ² 、白井 聡 ² 、田中 邦明 ¹ 、白井 博明 ¹	1. 農工大院工, 2. 新潟大院工
	19a-P2-8	イオンアシスト蒸着法を用いたナノ接着層の形成	○(M1) 河村 拓 ¹ 、田中 邦明 ¹ 、白井 博明 ¹	1. 農工大院工
	19a-P2-9	奇数鎖アルキル基をもつクォーターチオフェン薄膜の構造評価	○廣内 大地 ¹ 、小鹿 晋法 ¹ 、小津澤 智之 ² 、廣沢 一郎 ² 、鈴木 充朗 ³ 、山田 容子 ³ 、吉本 則之 ¹	1. 岩手大工, 2. 高輝度光化学研究セ, 3. 奈良先端大物質
	19a-P2-10	真空蒸着法を用いた HC(NH ₂) ₂ PbI ₃ 薄膜の作製	梶川 剛志 ¹ 、松本 晃尚 ² 、松岡 佑樹 ² 、○田中 仙君 ²	1. 近畿大院総合理工, 2. 近畿大院工
	19a-P2-11	ミストデポジション法によるペロブスカイト結晶の作製と太陽電池への応用	○香取 重尊 ¹ 、南條 勘治 ¹ 、廣木 一亮 ¹ 、織田 真也 ¹ 、人羅 俊実 ²	1. 津山高専, 2. 株式会社 フロスフィア
	19a-P2-12	Cl 添加によるバンドギャップの揺らぎに対するペロブスカイト太陽電池への影響	○宮野 一 ¹ 、吉田 清孝 ¹ 、伊藤 省吾 ² 、橋本 明弘 ¹ 、牧野 哲臣 ¹	1. 福井大工, 2. 兵庫県大
	19a-P2-13	静電スプレー堆積法で作製した P3HT:PCBM バルクヘテロ接合太陽電池に与える溶媒蒸気アニールの効果	○石間 康久 ¹ 、高橋 和志 ¹ 、小野島 紀夫 ¹	1. 山梨大
	19a-P2-14	静電塗布法の溶媒蒸発時間制御による高配向 P3HT:PCBM 膜の成膜	○戸田 明日来 ¹ 、高比良 和也 ¹ 、鈴木 勝己 ¹ 、福田 武司 ¹ 、齋藤 慎彦 ² 、尾坂 格 ²	1. 埼玉大院理工, 2. 理研 CEMS
	19a-P2-15	摩擦転写法による有機デバイスの n-バッファ層形成	○谷垣 宣孝 ¹ 、溝黒 登志子 ¹	1. 産総研無機機能
	19a-P2-16	発光層にイオン液体を含有した偏光有機 EL 素子の作製と評価	○永木 寛人 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、石田 謙司 ¹	1. 神戸大院工
	19a-P2-17	レーザーアニールによる熱変換有機薄膜の作製と太陽電池への応用	○杉森 達哉 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、葛原 大帆 ² 、山田 容子 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、石田 謙司 ¹	1. 神戸大工, 2. 奈良先端大
	19a-P2-18	塩添加による滑液性表面の防霜性能向上	○(M1) 守谷 越夫 ² 、小峰 正嗣 ¹ 、天神林 瑞樹 ² 、真部 研吾 ² 、白鳥 世明 ^{1,2}	1. 慶大院理工, 2. 慶大院理工
	19a-P2-19	新規感光性親撥材料による基材表面の親液性・撥液性制御	○田中 健朗 ¹ 、浜口 仁 ¹ 、栗山 敬祐 ¹	1. JSR
	19a-P2-20	動く光が誘起する分子流動と配向パターン制御	○久野 恭平 ¹ 、穴戸 厚 ^{1,2}	1. 東工大資源研, 2. JST さきがけ
	19a-P2-21	バーコート法による液晶性フタロシアニン分子配向薄膜の作製	○宇野 貴志 ¹ 、大森 雅志 ¹ 、中谷 光宏 ¹ 、藤井 彰彦 ¹ 、尾崎 雅則 ¹	1. 阪大院工
	19a-P2-22	異なる鎖長を持つシアノビフェニル液晶の選択的吸着	陶山 駿 ¹ 、○関 真悟 ¹ 、長田 健太郎 ¹ 、松原 亮介 ¹ 、久保野 敦史 ¹	1. 静大院工
	E 19a-P2-23	Formation of diffraction grating in photo-cross-linkable liquid crystalline composite by using galvano system	○(M1) TIEN MINH TRAN ¹ 、Takashi Shoho ¹ 、Moritsugu Sakamoto ¹ 、Kohei Noda ¹ 、Tomoyuki Sasaki ¹ 、Kohei Goto ² 、Nobuhiro Kawatsuki ³ 、Hiroshi Ono ¹	1. Nagaoka Univ. of Tech., 2. Nissan Chemical Industries, 3. Univ. of Hyogo
	19a-P2-24	Al ₂ O ₃ 表面に対するグリシンの吸着挙動	○齋藤 絢香 ¹ 、西川 博昭 ²	1. 近大院生物理工, 2. 近大生物理工
3/19(Sat.) 13:45 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) W242 会場				
	13:45	19p-W242-1 光学式流量モニタを用いた有機蒸着プロセスの安定化	○末次 大輔 ¹ 、小岩崎 剛 ¹ 、大熊 崇文 ¹	1. パナソニック
	14:00	19p-W242-2 基板 - 鎖状分子間極性相互作用が関与する薄膜形成初期における素過程の基板温度依存性	○竹田 治生 ¹ 、阿部 峰大 ¹ 、蓬菜 健一 ¹ 、神谷 正紀 ¹ 、松原 亮介 ¹ 、久保野 敦史 ¹	1. 静大院工
	14:15	19p-W242-3 有機グラフトエポキシ分子の分子動力学シミュレーション 2 - 面内方位の変化を引き起こすメカニズム -	○池田 進 ¹	1. 東北大 WPI-AIMR
	14:30	19p-W242-4 液晶溶媒により成長した C ₆ BTBT 単結晶膜における結晶軸方位の評価	○柴田 陽生 ¹ 、松崎 智也 ¹ 、石鍋 隆宏 ¹ 、藤掛 英夫 ¹	1. 東北大
	14:45	E 19p-W242-5 Multi-layer coating of oriented conjugated polymer films via FTM method	○(D) MANISH PANDEY ¹ 、Shuichi Nagamatsu ^{2,3} 、Shyam S. Pandey ¹ 、Shuzi Hayase ^{1,3} 、Wataru Takashima ^{1,3}	1. Grad. Sch. of LSSE, Kyushu Inst. Technol., 2. Dept. of CSE, Kyushu Inst. Technol., 3. RCAET, Kyushu Inst. Technol.

15:00	19p-W242-6	添加剤導入による P3HT 薄膜の結晶成長過程のその場観察評価	○(M1) 新井 康司 ^{1,2} , 宮寺 哲彦 ² , 小金澤 智之 ³ , 秋山 雄希 ^{1,2} , 杉田 武 ² , 近松 真之 ² , 八木 修平 ¹ , 矢口 裕之 ¹	1. 埼玉大, 2. 産総研・太陽光, 3. 高輝度光科学研究センター
15:15	19p-W242-7	交互欠電塗布法を用いて作製したグラデーション構造有機太陽電池	鈴木 勝己 ¹ , ○福田 武司 ¹	1. 埼玉大
3/20(Sun.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) W242 会場				
9:00	奨 20a-W242-1	ナノミスト堆積法による Alq ₃ /NPB 低分子積層構造の成膜特性	○(B) 上田 裕之 ¹ , 高塚 祐輔 ¹ , 新沼 佳樹 ¹ , 寺田 諒 ¹ , 菊池 昭彦 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテクセンター
9:15	奨 20a-W242-2	静電塗布法を用いた MoO ₃ 水溶液の成膜と逆型有機薄膜太陽電池	○裏谷 雄大 ¹ , 鈴木 勝己 ¹ , 福田 武司 ¹ , 鎌田 憲彦 ¹ , 本多 善太郎 ¹	1. 埼玉大
9:30	奨 20a-W242-3	Poly(3-hexylthiophene) を皮膜した Au@SiO ₂ ナノ粒子の作製法の確立	○宮川 佳奈 ¹ , 渡部 大輝 ¹ , 内貴 博之 ² , 雲林院 宏 ³ , 有田 稔彦 ³ , 増原 陽人 ^{1,5}	1. 山形大理工, 2. 関西学院大, 3. ルーヴアン・カトリック大, 4. 東北大多元研, 5. 有機エレクトロニクス研究センター
9:45	奨 20a-W242-4	フラーレンを含む電荷移動錯体のナノ結晶化	○伊藤 充史 ^{1,4} , 吉田 司 ^{1,4} , 中山 健一 ^{1,4} , 松井 淳 ² , サリチフチ N. S. ³ , 増原 陽人 ^{1,4}	1. 山形大学院理工, 2. 山形大理工, 3. ヨハネスケプラー大学リッツ, 4. 有機エレクトロニクス研究センター
10:00	奨 20a-W242-5	再沈法における (S)-(-)-1-Phenylethylamine による C ₆₀ ナノ結晶成長抑制効果の解明	○伊藤 直子 ¹ , 志藤 慶治 ¹ , 増原 陽人 ²	1. 山形大理工, 2. 有機エレクトロニクス研究センター
10:15	奨 20a-W242-6	窒素添加 LaB ₆ 界面層による p 型ペナタセン OFET の界面制御	○(M2) 前田 康貴 ¹ , 大見 俊一郎 ¹ , 後藤 哲也 ² , 大見 忠弘 ²	1. 東工大総理工, 2. 東北大未来研
10:30	奨 20a-W242-7	強誘電性高分子を用いた印刷型フォースセンサーの作製	○関根 智仁 ¹ , 菅野 亮 ¹ , 田代 智也 ¹ , 福田 憲二郎 ² , 熊木 大介 ¹ , Fabrice D. D. Santos ³ , 宮保 淳 ⁴ , 時任 静士 ¹	1. 山形大 ROEL, 2. 理研, 3. Piezotech, 4. アルケマ
10:45	奨 20a-W242-8	交互吸着法による高分子ナノシート上への金属有機構造体の構築	○(M1) 大原 浩明 ¹ , 山本 俊介 ¹ , 小野寺 恒信 ¹ , 笠井 均 ¹ , 及川 英俊 ¹ , 宮下 徳治 ¹ , 三ツ石 方也 ¹	1. 東北大学多元研
11:00	奨 20a-W242-9	AlFe ₂ O ₄ ナノ粒子-C ₁₆ 混合 LB 膜を用いた VA-CNT 合成および直径評価	○佐藤 太河 ¹ , 中村 健太郎 ¹ , 高際 翔太 ¹ , 串田 正人 ¹	1. 千葉大院工
11:15	奨 20a-W242-10	光重合が誘起する分子配向メカニズムの検討とパターン形成	○倉田 陽介 ¹ , 久野 恭平 ¹ , 相沢 美帆 ¹ , 穴戸 厚 ^{1,2}	1. 東工大資源研, 2. JST さきがけ
11:30	奨 20a-W242-11	赤外 pMAIRS 法を用いた有機半導体薄膜の構造異方性解析	○塩谷 暢貴 ¹ , 波田 美耶子 ¹ , 下赤 卓史 ¹ , 枝 和男 ² , 長谷川 健 ¹	1. 京大化研, 2. 神戸大院理
3/20(Sun.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W242 会場				
13:45	20p-W242-1	ナノ電解法によるフタロシアニン系ナノ単結晶の作製と電子特性	○長谷川 裕之 ^{1,2}	1. 北大院理, 2. 情報通信研・未来
14:00	20p-W242-2	Ag(111) 上における SnCl ₂ Pc の二次元膜構造	○井岡 雄以 ¹ , Zwick Christian ³ , Forker Roman ³ , 米澤 恵一郎 ¹ , 田子 達寛 ¹ , 上羽 貴大 ² , Fritz Torsten ³ , 解良 聡 ² , 奥平 幸司 ¹	1. 千葉大院, 2. 分子研, 3. Jena 大
14:15	20p-W242-3	π 共役系ユニットの低次元・高密度集積化	○山本 俊介 ¹ , 仁科 七重 ¹ , 松井 淳 ² , 宮下 徳治 ¹ , 三ツ石 方也 ¹	1. 東北大多元研, 2. 山形大理工
14:30	20p-W242-4	混合アルカンチオール SAM 修飾による高被覆率金ナノ粒子 2 次元配列膜	○坂本 謙二 ¹ , Thuy Ung Thi Dieu ² , 西山 聡子 ¹ , 柳田 さやか ¹ , Liem Nguyen Quang ² , 三木 一司 ^{1,3}	1. 物材機構, 2. IMS-VAST, 3. 筑波大数物
14:45	20p-W242-5	粒子間分子架橋構造を有する銀微粒子二次元膜の作製と評価	○斉藤 昂 ¹ , 龍崎 奏 ¹ , 岡本 晃一 ¹ , 玉田 薫 ¹	1. 九大先導研
15:00	20p-W242-6	対称性の破れ構造を持つプラズモニックナノシェルの精密構造制御と評価	○吉嶺 浩司 ¹ , 内田 修平 ¹ , 是津 信行 ^{1,2} , 手嶋 勝弥 ^{1,2}	1. 信州大工, 2. 信州大環エネ研
15:15	20p-W242-7	多孔質シリカ中空カプセルの内包物の徐放性と内包量と放出量の関係	○山口 優 ¹ , 加藤 徳剛 ¹	1. 明大理工
15:30	20p-W242-8	ポリマー電着法を用いたマイクロレンズアレイの作製と屈折率測定	○金岡 祐介 ^{1,2} , 山東 悠介 ¹ , 田中 剛 ¹ , 佐藤 和郎 ¹ , 村上 修一 ¹ , 櫻井 芳昭 ¹ , 谷田 純 ²	1. 阪産産技研, 2. 阪大院工
15:45	休憩/Break			
16:00	20p-W242-9	ナノミスト堆積法による低分子有機薄膜の成膜条件依存性	○寺田 諒 ¹ , 新沼 佳樹 ¹ , 高塚 祐輔 ¹ , 上田 裕之 ¹ , 菊池 昭彦 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテクセンター
16:15	20p-W242-10	パルス電解重合法により作製したポリピロロールナノ構造化バイオセンサ (第二報)	○小野田 光宣 ¹ , Daluwathu M.G. Preethichandra ²	1. 兵庫県立大, 2. セントラルクイーンズランド大
16:30	20p-W242-11	Ag ナノワイヤ複合セルロースナノファイバー紙の配向性	○丹保 浩行 ¹ , 岩坪 聡 ¹ , 奈須野 雅明 ¹ , 小幡 勤 ¹	1. 富山県工技セ
16:45	20p-W242-12	液晶性フタロシアニンの過冷却を用いた薄膜中における一軸結晶成長	○Ramanarivo Fiderana Mihary ¹ , 東 卓也 ¹ , 大森 雅志 ¹ , 須藤 孝一 ¹ , 藤井 彰彦 ¹ , 尾崎 雅則 ¹	1. 阪大院工
17:00	20p-W242-13	配向ナノファイバーによる厚い液晶デバイスの応答時間改善	○Duong Quoc Toan ¹ , 尾崎 良太郎 ² , 井上 曜 ¹ , 森武 洋 ¹	1. 防衛大, 2. 愛媛大
17:15	20p-W242-14	配向した主鎖型液晶エラストマーの昇降温における自発変形	○平岡 一幸 ¹ , 篠崎 凌 ¹ , 住友 昌平 ¹	1. 東京工芸大
17:30	20p-W242-15	光反応性複合体液晶を用いた光配向定量手法の提案	○小歩 岳史 ¹ , Tran Minh Tien ¹ , 坂本 盛嗣 ¹ , 野田 浩平 ¹ , 佐々木 友之 ¹ , 川月 喜弘 ² , 後藤 浩平 ³ , 小野 浩司 ¹	1. 長岡技科大, 2. 兵庫県立大, 3. 日産化学工業
17:45	20p-W242-16	2 量体液晶の多重相転移における熱拡散率・熱浸透率同時測定	○劉 芽久哉 ¹ , Anna Zep ² , 謝 曉晨 ⁴ , 荒岡 史人 ⁴ , Damian Pocięcha ² , Ewa Gorecka ² , 竹添 秀男 ^{2,3} , 森川 淳子 ¹	1. 東工大, 2. ワルシャワ大, 3. 豊田理研, 4. 理研
CS.4 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション / 6.6/12.2 Code-sharing session				
3/20(Sun.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
9:00	20a-W631-1	ベント型ナノピペットを有する走査型イオン伝導顕微鏡の開発と生体組織の観察	○白澤 樹 ¹ , 平田 惇 ¹ , 水谷 祐輔 ² , 牛木 辰男 ² , 岩田 太 ¹	1. 静岡大工, 2. 新潟大医
9:15	奨 20a-W631-2	AFM による有機分子の高分解能室温観察	○(DC) 岩田 孝太 ¹ , 山崎 詩郎 ² , Mutombo Pingo ³ , Hapala Prokop ³ , Ondracek Martin ³ , Jelinek Pavel ³ , 杉本 宜昭 ^{1,4}	1. 阪大院工, 2. 東工大総理工, 3. チェコ科学アカデミー, 4. 東大新領域
9:30	20a-W631-3	金平坦面上に固定した量子ドット固定密度の評価	○伊藤 裕貴 ¹ , 坂上 弘之 ¹ , 鈴木 仁 ¹	1. 広島大先端研
9:45	奨 20a-W631-4	PCBM と CuPc が形成する 2D 混合構造に対するアニールの影響	○榎井 茜 ¹ , 坂上 弘之 ¹ , 高萩 隆行 ¹ , 鈴木 仁 ¹	1. 広島大先端研
10:00	20a-W631-5	KFM を用いた ITO/Ru 錯体/AuNPs 構造の局所電荷分布の計測	○丹下 直之 ¹ , 大塚 洋一 ¹ , 高木 大敬 ¹ , 西嶋 知史 ¹ , 松本 卓也 ¹	1. 阪大院理
10:15	20a-W631-6	周波数シフト法静電気力顕微鏡による有機薄膜太陽電池における光誘起電荷マッピング	荒木 健人 ¹ , 家 裕隆 ² , 安蘇 義雄 ² , 大山 浩 ¹ , 松本 卓也 ¹	1. 阪大理工, 2. 阪大産研
10:30	休憩/Break			

10:45	奨 20a-W631-7	時間分解静電気力顕微鏡による有機薄膜トランジスタのキャリアダイナミクスの可視化	○山岸 裕史 ¹ 、木村 知玄 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、野田 啓 ³ 、山田 啓文 ¹	1. 京大工、2. 京大白眉セ、3. 慶應大理工
11:00	20a-W631-8	時間分解静電気力顕微鏡による電極-有機半導体グレイン界面の局所電気特性評価	○木村 知玄 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工、2. 京大白眉セ
11:15	20a-W631-9	走査型プローブエレクトロスプレーイオン化質量イメージング法の高分解能化の検討	○大塚 洋一 ¹ 、小東 剛 ² 、嶋津 亮 ² 、岩田 太 ³ 、荒川 隆一 ² 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理、2. 関大化工、3. 静大院工
11:30	20a-W631-10	各濃度溶液中における Streptavidin 2 次元結晶の液中 FM-AFM 高分解能構造観察	○(D) 崔子鵬 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、平田 芳樹 ³ 、山田 啓文 ¹	1. 京大工、2. 京大白眉セ、3. 産総研
11:45	20a-W631-11	biotin 結合による streptavidin 2 次元結晶の構造変化のその場評価	○(B) 濱田 貴裕 ¹ 、宮本 真之 ¹ 、木南 裕陽 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工、2. 京大白眉セ
12:00	20a-W631-12	3D-SFM を用いた磁気ディスク上における潤滑剤分子の 3 次元吸着構造計測	○中嶋 脩貴 ¹ 、宮澤 佳甫 ¹ 、豊田 真理子 ¹ 、相方 良介 ² 、清水 豪 ² 、曾田 孝雄 ² 、福岡 剛士 ^{1,3}	1. 金大理工、2. MORESCO、3. ACT-C
12:15	20a-W631-13	SAM 膜修飾電極を用いた c 型シトクロム単一分子の電気伝導計測	○角田 早 ¹ 、大山 浩 ¹ 、○松本 卓也 ¹	1. 阪大理
12.2 評価・基礎物性 / Characterization and Materials Physics				
3/19(Sat) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P11 会場				
	19p-P11-1	TOF および EFISHG による Au/pentacene/polyimide/ITO 素子のキャリア移動度測定	○(M1) 須永 将司 ¹ 、田口 大 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大理工
	19p-P11-2	300 K 伝達特性と電流 DLTS 測定による有機 TFT のトラップ評価	○大田 貴士 ¹ 、赤沼 秀幸 ¹ 、中嶋 健登 ¹ 、○徳田 豊 ¹ 、1. 愛知工大、2. (株) デンソー	
	19p-P11-3	シリコン (111)/フェロセン誘導体 SAM/液体金属接合の整流特性	○宇都宮 徹 ¹ 、鄭 安純 ¹ 、一井 崇 ¹ 、杉村 博之 ¹	1. 京大院工
	19p-P11-4	鉄ポルフィリン分子の X 線円偏光 2 色性の理論的研究	○(M2) 吉本 有輝 ¹ 、クリューガー ビーター ¹	1. 千葉大院融合
	19p-P11-5	オール印刷ポリイミド静電容量型湿度センサーとリアルタイム混合ガス制御・計測システムの開発	○袁 子涵 ¹ 、伊東 栄次 ¹	1. 信州大工
	19p-P11-6	光励起下における有機半導体薄膜からの大気中光電子放出	○細貝 拓也 ¹ 、松崎 弘幸 ¹ 、古部 昭広 ^{1,2} 、中村 健 ¹	1. 産総研 分析計測標準、2. 徳島大
	19p-P11-7	バイアス印加 HAXPES 測定による有機トランジスタ動作中の有機半導体層内部の電位分布観察 II	○渡辺 剛 ¹ 、多田 圭佑 ² 、安野 聡 ¹ 、吉本 則之 ² 、広沢 一郎 ¹	1. 高輝度光科学研究セ、2. 岩手大工
	19p-P11-8	Ag(110) 上 DNTT 分子層の積層過程の分子レベル構造計測	○長谷川 友里 ¹ 、山田 洋一 ¹ 、細貝 拓也 ² 、若山 裕 ³ 、佐々木 正洋 ¹	1. 筑波大数理、2. 産総研、3. 物材機構 WPI-MANA
	19p-P11-9	椀状分子 sumanene 単分子層の構造計測	○前田 拓郎 ¹ 、長谷川 友里 ¹ 、コスワッタゲ ラシカ ² 、山田 洋一 ¹ 、佐々木 正洋 ¹	1. 筑波大数理、2. 千葉大先進
	19p-P11-10	自己束縛励起子間の協力的相互作用	○松田 一真 ¹ 、篠塚 雄三 ¹	1. 和歌山大院シス工
	19p-P11-11	MEH-PPV/H ₂ TPP(COOH) 積層膜における励起エネルギー移動	○水野 斎 ¹ 、那須 俊佑 ¹ 、廣光 一郎 ¹	1. 島根大総理工
	19p-P11-12	電界誘起光第 2 次高調波発生法による摩擦帯電の直接観察系の構築	○樽茶 好彦 ¹ 、田口 大 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大理工
	19p-P11-13	~Kapton 型 polyimide と Al の摩擦による接触帯電~湿度条件を制御したシラン系自己組織化膜 (SAM) 上ベンタセン薄膜の分子配向評価	○坪井 洋大 ¹ 、間瀬 一彦 ^{2,3} 、小澤 健一 ⁴ 、吉田 弘幸 ¹ 、奥平 幸司 ¹	1. 千葉大院融合、2. KEK 物構研、3. 総研大、4. 東大院理工
	19p-P11-14	カーボンナノチューブ・ポリ酸ネットワークのニューロン発火特性のカオス解析	○(M2) 付 凌翔 ¹ 、田向 権 ¹ 、小川 琢治 ² 、田中 啓文 ¹	1. 九州工業大学、2. 大阪大学
3/21(Mon) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
9:00	21a-W631-1	臭化鉛ペロブスカイト結晶のラマンスペクトル	○(M2) 亀井 未亜 ¹ 、古川 行夫 ¹ 、松本 祐樹 ² 、下位 幸弘 ² 、片木 京子 ³ 、山田 康治 ⁴	1. 早大院先進理工、2. 産業技術総合研究所、3. 次世代化学材料評価技術研究組合、4. 日大生産工
9:15	奨 21a-W631-2	ピスマスドーブヨウ化スズ立方晶ペロブスカイトの電気物性と電子構造	○(M1) 小林 佳介 ¹ 、長谷川 裕之 ^{2,3} 、高橋 幸裕 ^{1,2} 、原田 潤 ^{1,2,3} 、稲辺 保 ^{1,2,3}	1. 北大院総化、2. 北大院理、3. JST-CREST
9:30	21a-W631-3	ハロゲン化スズペロブスカイトにおける電気物性と電子構造	○長谷川 裕之 ¹ 、高橋 幸裕 ¹ 、原田 潤 ¹ 、稲辺 保 ¹	1. 北大院理
9:45	21a-W631-4	導電性探針 AFM によるグラファイト上三脚分子の電気伝導計測	○大塚 洋一 ¹ 、家 裕隆 ² 、安蘇 芳雄 ² 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理、2. 阪大産研
10:00	奨 21a-W631-5	マイクロ波共振を用いたチエノアセンの特異な電荷輸送特性の解明	○筒井 祐介 ¹ 、崔 旭鎮 ¹ 、櫻井 庸明 ¹ 、関 修平 ¹	1. 京大院工
10:15	21a-W631-6	マイクロ波法を用いた n 型有機半導体の界面電子移動度評価	○井上 純一 ¹ 、筒井 祐介 ¹ 、崔 旭鎮 ¹ 、櫻井 庸明 ¹ 、関 修平 ¹	1. 京大院工
10:30		休憩 / Break		
10:45	21a-W631-7	ナノギャップ電極間に形成された Ru 錯体 / AuNP / Ru 錯体構造の電気特性	○西嶋 知史 ¹ 、大塚 洋一 ¹ 、丹下 直之 ¹ 、高木 大敬 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理
11:00	21a-W631-8	被覆型長鎖オリゴチオフェンの電気伝導度の理論計算	○大戸 達彦 ¹ 、岡本 祐治 ² 、利根 紗織 ² 、家 裕隆 ² 、山田 亮 ¹ 、安蘇 芳雄 ² 、冨田 博一 ¹	1. 阪大院基礎工、2. 阪大産研
11:15	21a-W631-9	10 ⁻⁶ g/m ² /day 台の水蒸気透過度を測定するための水蒸気透過度測定装置と標準ガスバリアフィルムの開発	○吉田 肇 ¹ 、新井 健太 ¹ 、小島 時彦 ¹ 、蛭名 武雄 ¹ 、石井 亮 ¹ 、相澤 崇史 ¹ 、鈴木 麻実 ¹	1. 産総研
11:30	21a-W631-10	ITO/Ru 錯体 / Au ナノ粒子構造の導電性探針 AFM を用いた電気伝導計測	○高木 大敬 ¹ 、大塚 洋一 ¹ 、丹下 直之 ¹ 、西嶋 知史 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理
11:45	21a-W631-11	横方向 TOF 法における解析手法の開発	○(DC) 向後 潤一 ¹ 、石川 謙 ¹	1. 東工大
3/21(Mon) 13:30 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
13:30	21p-W631-1	ポリオキシメタレート系のナノスケール構造体と電気特性	○岸本 裕幸 ¹ 、山口 晴正 ¹ 、蔡 徳七 ¹ 、大山 浩 ¹ 、中村 一平 ² 、綱島 亮 ² 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理、2. 山口大院理工
13:45	奨 21p-W631-2	PEDOT:PSS ワイヤに発現する低温非線形電気伝導	○小川 尚純 ¹ 、赤井 恵 ¹ 、齋藤 彰 ¹ 、桑原 裕司 ¹	1. 阪大院工
14:00	奨 21p-W631-3	ドーピングしたホモエピ-ルン単結晶における Hall 効果	○大橋 知佳 ^{1,2} 、新村 祐介 ^{2,6} 、渡瀬 星児 ^{3,6} 、伊崎 昌伸 ^{4,6} 、内藤 裕義 ^{5,6} 、平本 昌宏 ^{1,2,6}	1. 総研大、2. 分子研、3. 大阪市工研、4. 豊橋技科大、5. 大阪府大、6. NEDO
14:15	奨 21p-W631-4	直鎖カルバゾールオリゴマー単分子接合の電流電圧特性	○(B) 美濃出 圭悟 ¹ 、アルブレヒト 健 ² 、波多 健太 ¹ 、下店 隆史 ¹ 、大戸 達彦 ¹ 、山田 亮 ¹ 、山元 公寿 ² 、冨田 博一 ¹	1. 阪大基礎工、2. 東工大資源研
14:30	21p-W631-5	DNA を鋳型としたタンパク質集合体のナノスケール電気伝導特性	○山口 晴正 ¹ 、大塚 洋一 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理
14:45	21p-W631-6	C ₆₀ 単結晶を用いた電界効果トランジスタの温度依存性	○宮林 亨 ¹ 、村田 秀信 ¹ 、平井 匡彦 ² 、青木 伸之 ^{3,4} 、橋 勝 ¹	1. 横浜市立大物質システム科学、2. オーストラリア科学産学連携機構、3. 千葉大院融合科学、4. さきがけ

15:00	21p-W631-7	自己ドーブ型ポリアニリンのナノスケールグレイン内伝導	○(M1)宇佐美 雄生 ¹ 、今村 健太郎 ² 、赤井 智喜 ² 、蔡 徳七 ¹ 、大山 浩 ¹ 、小林 光 ² 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理, 2. 阪大産研
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 21p-W631-8	過渡蛍光減衰法によるキャリア輸送の直接観測	○安部 健太郎 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大理工
15:45	奨 21p-W631-9	単分子素子実現に向けた吸着サイト選択的な単分子分光法の開発	○金子 哲 ¹ 、村井 大午 ¹ 、中村 恒夫 ² 、池田 勝佳 ³ 、塚越 一仁 ⁴ 、木口 学 ¹	1. 東工大 理工, 2. 産総研ナノシステム, 3. 名工大フロンティア, 4. 物材研 MANA
16:00	奨 E 21p-W631-10	Studying Magnetic Field Effect on Pentacene Field Effect Transistor Using Impedance Spectroscopy	○ SongToan Pham ¹ , Hirokazu Tada ¹	1. Graduate School of Engineering Science, Osaka University
16:15	奨 E 21p-W631-11	Microfluidic based transmission surface plasmon resonance measurement developed for biosensor applications	○ Chutiparn Lertvachirapaiboon ¹ , Akira Baba ¹ , Sanong Ekgasit ² , Kazunari Shinbo ¹ , Keizo Kato ¹ , Futao Kaneko ¹	1. Graduate School of Science and Technology, Niigata Univ., 2. Sensor Research Unit, Chulalongkorn Univ.
16:30	21p-W631-12	ナノギャップ電極を用いたマグネシウムイオン添加DNAの電気伝導性計測	○(B)江藤 理香 ¹ 、大塚 洋一 ¹ 、山口 晴正 ¹ 、松本 卓也 ¹	1. 阪大院理
16:45	21p-W631-13	変位電流測定と電界誘起光第2次高調波発生法による2層有機素子の移動度の評価	○野間 大史 ¹ 、田口 大 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大・理工
17:00	21p-W631-14	熱刺激電流 (TSC)-EFISHG 及び CMS による MIS 構造素子 (IZO/polyimide/ α -NPD/Au) のトラップ評価	○細川 英機 ¹ 、田口 大 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大理工
3/22(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
9:00	22a-W631-1	ボロン酸型蛍光プローブにおける電子移動反応の距離依存性	○嶋岡 浩明 ¹ 、田之上 大地 ¹ 、杉田 巧 ¹ 、南部 伸孝 ¹ 、橋本 剛 ¹ 、早下 隆士 ¹ 、江馬 一弘 ¹	1. 上智大理工
9:15	22a-W631-2	走査型アトムプローブによるアミノ酸の原子レベルでの解析: グルタミンとグルタミン酸	○西川 治 ¹ 、谷口 昌宏 ²	1. 金沢大産学連携, 2. 金沢大応化
9:30	奨 22a-W631-3	微小角入射広角 X 線散乱による液晶性フタロシアニン配向薄膜の結晶構造解析	○大森 雅志 ¹ 、宇野 貴志 ¹ 、中野 知佳 ¹ 、藤井 彰彦 ¹ 、尾崎 雅則 ¹	1. 阪大院工
9:45	奨 22a-W631-4	3D-SFM による HDD 用磁気ディスク上の潤滑層の3次元分子吸着構造計測	○宮澤 佳甫 ¹ 、中嶋 脩貴 ¹ 、豊田 真理子 ¹ 、相方 良介 ² 、清水 豪 ² 、曾田 孝雄 ² 、福岡 剛士 ^{1,3}	1. 金大院, 2. MORESCO, 3. ACT-C
10:00	奨 22a-W631-5	波長掃引型紫外光電子分光による状態密度のワイドレンジ計測: サブ ppm レベルの超高感度検出	○佐藤 友哉 ¹ 、金城 拓海 ¹ 、山崎 純暉 ¹ 、石井 久夫 ^{1,2,3}	1. 千葉大融合, 2. 千葉大先進, 3. 千葉大 MCRC
10:15	奨 22a-W631-6	気相 α 共役平面系有機分子における再配向エネルギーの定量的見積り	○山口 拓真 ^{1,2} 、米澤 恵一郎 ¹ 、須田 洋輔 ¹ 、佐藤 一至 ¹ 、上羽 貴大 ^{2,3} 、解良 聡 ^{1,2,3}	1. 千葉大融合, 2. 分子研, 3. 総研大
10:30		休憩 / Break		
10:45	22a-W631-7	有機薄膜の電子準位への永久四重極の影響	○吉田 弘幸 ¹	1. 千葉大融合
11:00	22a-W631-8	MD 計算によるグラファイト電極と界面を形成するイオン液体の構造化・ダイナミクスと電気二重層形成の解析	○宮本 洋雄 ¹ 、横田 泰之 ² 、今西 哲士 ¹ 、稲垣 耕司 ³ 、森川 良忠 ³ 、○福井 賢一 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 理研, 3. 阪大院工
11:15	22a-W631-9	エネルギー的な乱れのある分子固体中での有効移動度の温度依存性	○関 和彦 ¹ 、ポイチック マリウス ²	1. 産総研ナノ材料, 2. ウッジ工科大学
11:30	22a-W631-10	PTCDA 基板への金属原子吸着の化学的傾向: 第一原理計算による検討	○川端 康平 ¹ 、中山 隆史 ¹	1. 千葉大理
11:45	22a-W631-11	Theory of electronic structures for diatomic molecules: First principles calculations for carbon and silicon molecules	○(D)Daisuke Yoshida ¹ , Hannes Raebiger ¹	1. Yokohama National University
12:00	22a-W631-12	構造秩序性に支配されたエネルギーのディスオーダーと有機半導体の電荷輸送	○大野 玲 ¹ 、高屋敷 由紀子 ¹ 、新田 武父 ¹ 、飯野 裕明 ¹ 、半那 純一 ¹	1. 東工大像情報
3/22(Tue.) 13:15 - 14:45 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
13:15	22p-W631-1	α 共役系高分子配向薄膜内の分子性アクセプタの配向評価	○永松 秀一 ¹ 、高嶋 授 ¹ 、パンディ シャム ¹ 、新海 聡子 ¹ 、早瀬 修二 ¹	1. 九工大
13:30	22p-W631-2	ベンタセン単結晶の表面浄化法と電子構造	○水野 裕太 ¹ 、山本 真之 ¹ 、日笠 正隆 ² 、金城 拓海 ¹ 、浦上 裕希 ¹ 、間瀬 一彦 ^{3,4} 、出田 真一郎 ^{4,5} 、田中 清尚 ^{4,5} 、石井 久夫 ^{1,6} 、奥平 幸司 ¹ 、吉田 弘幸 ¹ 、中山 泰生 ²	1. 千葉大融合, 2. 東理大理工, 3. 高エネ研, 4. 総研大, 5. 分子研, 6. 千葉大先進
13:45	22p-W631-3	ベンタセン単結晶上 C ₆₀ ヘテロエピタキシャル構造の精密決定	○中山 泰生 ¹ 、水野 裕太 ² 、鶴田 諒平 ¹ 、細貝 拓也 ³ 、小金澤 智之 ⁴ 、山本 真之 ² 、Hinderhofer Alexander ⁵ 、Gerlach Alexander ⁶ 、Frank Heiko ⁶ 、Schreiber Frank ⁵ 、石井 久夫 ^{2,6} 、上野 信雄 ²	1. 東理大理工, 2. 千葉大融合, 3. 産総研, 4. JASRI, 5. チュービンゲン大, 6. 千葉大先進
14:00	22p-W631-4	HAT-CN をドーブした α -NPD 膜の高感度紫外光電子分光	○山崎 純暉 ¹ 、金城 拓海 ¹ 、佐藤 友哉 ¹ 、武田 祐希 ¹ 、中山 泰生 ² 、石井 久夫 ^{1,3,4}	1. 千葉大融合, 2. 東理大理工, 3. 千葉大先進, 4. 千葉大 MCRC
14:15	22p-W631-5	Ag(111) 上 SnCl ₂ Pc 薄膜の表面化学: X 線定在波法による吸着構造の解析	○上羽 貴大 ^{1,2} 、田子 達寛 ³ 、Gerben Straaten ⁴ 、Markus Franke ⁴ 、Marco Gruenewald ⁴ 、Tien-Lin Lee ⁴ 、Pardeep Kumar Thakur ⁴ 、Christian Zwick ⁵ 、Roman Forke ⁵ 、Torsten Fritze ⁵ 、Christian Kumpf ⁴ 、解良 聡 ^{1,2,3}	1. 分子科学研究所, 2. 総合研究大学院大学, 3. 千葉大融合, 4. ユーリッヒ研究センター, 5. イエナ大学, 6. ダイヤモンド放射光施設
14:30	22p-W631-6	Ag(111) 上 SnCl ₂ Pc 薄膜の表面化学: 光電子分光による電子状態	○(M1) 田子 達寛 ¹ 、米澤 恵一郎 ¹ 、上羽 貴大 ² 、井岡 雄以 ¹ 、Qi Wang ³ 、須田 洋輔 ¹ 、Nabi Aghdassi ³ 、山根 宏之 ² 、小杉 信博 ² 、奥平 幸司 ¹ 、吉田 弘幸 ¹ 、Steffen Duhm ³ 、解良 聡 ^{1,2}	1. 千葉大院, 2. 分子研, 3. 蘇州大
12.3 機能材料・萌芽的デバイス / Functional Materials and Novel Devices				
3/19(Sat.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場				
	19a-P3-1	生物模倣表面による効果的な液体輸送	○武藤 光司 ¹ 、伊藤 嵩人 ² 、石井 大佑 ²	1. 名工大, 2. 名大院工
	19a-P3-2	新規オリゴチオフェン系化合物の光学特性	○橋 浩昭 ¹ 、秋山 雄希 ^{1,2} 、宮寺 哲彦 ¹ 、矢口 裕之 ² 、阿澄 玲子 ¹ 、近松 真之 ¹	1. 産総研, 2. 埼玉大理工
	19a-P3-3	ジアリールエテンのキャリア注入異性化反応の素過程の研究	○山本 一樹 ¹ 、辻岡 強 ¹	1. 阪教大
	19a-P3-4	ピスチルベンゼン誘導体の電子吸引性置換基効果	○望月 博孝 ¹ 、近松 真之 ¹	1. 産総研太陽光
	19a-P3-5	過酸化水素を利用した新規グラフェン誘導体合成法の検討	○(D) 内野 聖子 ¹ 、大竹 亜紗美 ¹ 、滝澤 登 ¹ 、坂口 幸一 ¹	1. 佐賀大院工
	19a-P3-6	レーザーダイオードを用いた分散性測定装置の作製と酸化グラフェン分散液の分散性評価	○(D) 大竹 亜紗美 ¹ 、内野 聖子 ¹ 、坂口 幸一 ¹	1. 佐賀大院工
	19a-P3-7	大気圧プラズマ法による親水化グラファイトの合成	○白鳥 武 ¹ 、内野 聖子 ¹ 、梶山 孝太郎 ¹ 、坂口 幸一 ¹	1. 佐賀大院工

19a-P3-8	大気圧プラズマ法により作製された親水性酸化グラファイトの特性評価	○黒木 惟 ¹ 、梶山 孝太郎 ¹ 、白鳥 武 ¹ 、内野 聖子 ¹ 、1. 佐賀大学 坂口 幸一 ¹
19a-P3-9	エステル化反応による有機溶媒親和性グラフェン誘導体の合成	○(M1) 島 靖卓 ¹ 、大竹 亜紗美 ¹ 、平川 あい ¹ 、坂口 幸一 ¹
19a-P3-10	赤色蛍光色素を用いた液晶の光応答挙動	○(B) 岡 沙樹 ¹ 、古川 元行 ¹ 、木下 基 ¹
19a-P3-11	有機薄膜混晶内の亀裂で構成されるキャビティからのレーザー発振	○(MIC) 萬徳 匡昭 ¹ 、市田 正夫 ² 、梅津 郁朗 ² 、1. 甲南大院自然, 2. 甲南大理工 杉村 陽 ² 、青木 珠緒 ²
19a-P3-12	銅フタロシアニン-無金属フタロシアニン混合液晶の電荷輸送特性	○渡辺 光一 ¹ 、仲川 大 ¹ 、藤井 彰彦 ¹ 、清水 洋 ² 、1. 阪大院工, 2. 産総研ユビキタス 尾崎 雅則 ¹
19a-P3-13	OFET 型 THz 波センサ中の蓄積キャリアによる THz 波吸収の解析	○志水 祐貴 ¹ 、木元 鴻太郎 ¹ 、藤井 勝之 ² 、小島 広 ¹ 、1. 奈良先端大物質, 2. 南山大理工, 3. 静大院工 孝 ¹ 、松原 亮介 ³ 、中村 雅一 ¹
奨 19a-P3-14	情報分子を用いたネットワーク構造体を創発する実験系の構築	○(PC) 高橋 慧 ^{1,2} 、松尾 宗征 ¹ 、伴野 太祐 ³ 、豊田 太郎 ¹
奨 19a-P3-15	共役ポリマー WGM 共振器による高効率・高指向性放射エネルギー移動	○榎田 創 ¹ 、ブラム ダニエル ² 、柴崎 浩輔 ¹ 、齋 藤 仁志 ¹ 、タンダオ ^{3,4} 、石井 智 ^{3,4} 、長尾 忠昭 ^{3,4} 、機構, 4. JST-CREST 桑原 純平 ¹ 、神原 貴樹 ¹ 、木島 正志 ¹ 、ロルケ アクセル ² 、山本 洋平 ¹
19a-P3-16	石炭ピッチ薄膜の結晶性向上とキャリア輸送特性	○福田 武司 ¹ 、山形 憲一 ² 、山下 誠 ³
19a-P3-17	有機感圧センサにおける力学センシング性能に関する研究	○小村 将大 ¹ 、森本 勝大 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、1. 神戸大院工 石田 謙司 ¹
19a-P3-18	光導電体を利用した有機強誘電体の光分極反転制御	○堀井 浩司 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、石田 謙司 ¹
19a-P3-19	垂直配向 VDF オリゴマー薄膜の焦電センサ特性	森 陽光 ¹ 、○小柴 康子 ¹ 、小谷 哲浩 ² 、金村 崇 ² 、1. 神戸大院工, 2. ダイキン工業 三崎 雅裕 ¹ 、石田 謙司 ¹
19a-P3-20	アリアルクラウンエーテル錯体を用いた安定な n 型単層カーボンナノチューブの作製	○池田 智博 ¹ 、野々口 斐之 ¹ 、河合 壯 ¹
19a-P3-21	巨大ゼーベック係数を示す有機低分子における振電相互作用の評価	○小島 広孝 ¹ 、阿部 竜 ¹ 、藤原 史弥 ¹ 、中川 真理雄 ¹ 、1. 奈良先端大物質 中村 雅一 ¹
19a-P3-22	表面プラズモンを利用したアゾベンゼン薄膜の回折光増強	○佐藤 将太郎 ^{1,2} 、岡本 隆之 ² 、川本 益輝 ² 、鷹取 賢太郎 ^{2,3} 、磯島 隆史 ² 、佐々 高史 ² 、佐々木 健夫 ¹ 、 石橋 幸治 ²
19a-P3-23	微細溝構造を用いた双安定界面のフレクソ分極による HAN セルにおける双安定スイッチングの検討	○伊皆 健太郎 ¹ 、中村 柊介 ¹ 、工藤 幸寛 ¹ 、高橋 泰樹 ¹
19a-P3-24	ポリマーフィラメント格子を配置した液晶セルの過渡応答特性	○渡辺 大貴 ¹ 、工藤 幸寛 ¹ 、高橋 泰樹 ¹
19a-P3-25	液晶メタマテリアルにおける Dyakonov 表面波の存在条件に対する分散金属ナノ粒子の影響	○松井 龍之介 ^{1,2}
19a-P3-26	スリット電極型液晶シリンドリカルレンズアレイによる光偏向効果 (III)	○内田 勝 ¹ 、柴瀬 智 ¹ 、王 濱 ¹
19a-P3-27	液晶位相変調器を用いたミリ波アンテナアレイシステムの検討	○永澤 雅 ¹ 、笹森 崇行 ¹ 、磯田 陽次 ¹ 、真坂 護 ² 、1. 秋田県大システム, 2. 由利工業株式会社 伊藤 謙二 ² 、伊東 良太 ¹ 、本間 道則 ¹ 、能勢 敏明 ¹
19a-P3-28	多孔質 PMMA 材料を用いたミリ波用フレネルゾーンプレート	○大野 真之介 ¹ 、伊東 良太 ¹ 、本間 道則 ¹ 、能勢 敏明 ¹
19a-P3-29	ヘルフリッヒ変形が誘起されたコレステリック液晶の光学特性	○井上 曜 ¹ 、森武 洋 ¹
19a-P3-30	微細な配向パターンを有するハイブリッド液晶セルの配向特性	○安藝 諭宇馬 ¹ 、本間 道則 ¹ 、能勢 敏明 ¹
19a-P3-31	二次元的な周期配向パターンを有する液晶回折格子における回折特性	○(M1) 高橋 夏輝 ¹ 、本間 道則 ¹ 、能勢 敏明 ¹
19a-P3-32	ポリ 4 ビニルピリジンのラビング膜における n 型液晶配向特性	工藤 恭輔 ¹ 、小箱 輝 ¹ 、長沼 耀太 ¹ 、○山口 留美子 ¹
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W351 会場		
9:00	20a-W351-1 放射加熱温度変調法による強誘電性有機導体の焦電流観測: 変調温度と自発分極の決定	○(M1) 松本 健汰 ¹ 、山本 薫 ¹ 、村田 晃一 ¹ 、鈴木 智博 ¹ 、川島 大樹 ¹ 、横山 直 ¹
9:15	20a-W351-2 有機強誘電体自立膜を用いた透明焦電型赤外線センサの作製と評価	○川本 遼 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、石田 謙司 ¹
9:30	20a-W351-3 電界印加蒸着による VDF オリゴマー薄膜の分極制御と焦電応答特性	○酢谷 陽平 ¹ 、森 陽光 ² 、小谷 哲浩 ³ 、金村 崇 ³ 、1. 神戸大工, 2. 神戸大院工, 3. ダイキン工業 小柴 康子 ² 、三崎 雅裕 ² 、石田 謙司 ²
9:45	20a-W351-4 苦味センサ用脂質高分子膜の表面特性と電位応答の関係	○矢田部 塁 ² 、原田 裕平 ¹ 、野田 純平 ¹ 、池崎 秀和 ³ 、都甲 潔 ^{1,2}
10:00	20a-W351-5 らせん状ポリイソシアニドを用いた ReRAM の動作機構解析	○櫻川 康志 ¹ 、高木 遊学 ² 、井改 知幸 ² 、酒井 平祐 ¹ 、1. 北陸先端大マテリアル, 2. 金沢大学 前田 勝浩 ² 、村田 英幸 ¹
10:15	20a-W351-6 アルキルスルホン化ポリイミド主鎖一軸配向膜の吸湿により発現する液晶構造解析	○後藤 峻介 ¹ 、原 光生 ¹ 、長尾 祐樹 ² 、永野 修作 ³
10:30	休憩 / Break	
10:45	奨 20a-W351-7 液晶配向場中における分子配向性マイクロ粒子まわりの面内弾性歪	○今村 弘毅 ¹ 、吉田 浩之 ^{1,2} 、尾崎 雅則 ¹
11:00	奨 20a-W351-8 高分子 / ネマティック液晶複合材料の電気光学効果に及ぼすモノマー濃度の影響	○前田 恭孝 ¹ 、小橋 淳二 ¹ 、吉田 浩之 ¹ 、尾崎 雅則 ¹
11:15	奨 20a-W351-9 厚いコレステリック液晶セルを用いた複屈折変調デバイス	○服部 真代 ¹ 、井上 曜 ¹ 、森武 洋 ¹
11:30	奨 20a-W351-10 基板濡れ性を用いた液晶セル内での高分子壁の形成	○川守田 聖矢 ¹ 、柴田 陽生 ¹ 、石鍋 隆宏 ¹ 、藤掛 英夫 ¹
11:45	奨 20a-W351-11 湾曲したポリカーボネート基板の位相差特性の評価と光学補償	○(B) 本田 秀一 ¹ 、石鍋 隆宏 ¹ 、柴田 陽生 ¹ 、藤掛 英夫 ¹
12:00	20a-W351-12 強い波長選択性を有する振れ配向液晶回折格子	○河合 孝太郎 ¹ 、坂本 盛嗣 ¹ 、野田 浩平 ¹ 、佐々木 友之 ¹ 、川月 喜弘 ² 、小野 浩司 ¹

3/20(Sun.) 13:45 - 18:00		口頭講演 (Oral Presentation) W351 会場	
13:45	招 20p-W351-1	【有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演】(30分) 表面プラズモン共鳴励起を利用した有機デバイスへの応用	○馬場 暁 ¹ 、ラートパチラバイポーン チュティパー 1. 新潟大工 ン ¹ 、新保 一成 ¹ 、加藤 景三 ¹ 、金子 双男 ¹
14:15	20p-W351-2	アルミニウムチップ上に調製したジアリールエテン薄膜における光異性化と結晶化の in-situ 顕微分光イメージング	○加登山 太河 ¹ 、西村 涼 ² 、當麻 真奈 ¹ 、内田 欣吾 ¹ 。1. 関西学院大学理工, 2. 龍谷大学理工 ² 、田和 圭子 ¹
14:30	20p-W351-3	ジアリールエテン上における金属蒸着選択性の金属種依存性	○(B) 松本 彩希 ¹ 、辻岡 強 ¹ 1. 阪教大
14:45	20p-W351-4	無機ナノシート/イリジウム錯体複合薄膜の金属上での発光特性	○尾崎 良太郎 ¹ 、山田 達也 ¹ 、門脇 一則 ¹ 、佐藤 久 ¹ 。愛媛大工, 2. 愛媛大理 子 ²
15:00	20p-W351-5	ナノインプリンティングによる伝搬型表面プラズモン共鳴増強逆型有機薄膜太陽電池の検討	○(D) 原 一馬 ¹ 、ラートパチラバイポーン チュティパー 1. 新潟大 バーン ¹ 、馬場 暁 ¹ 、新保 一成 ¹ 、加藤 景三 ¹
15:15	E 20p-W351-6	Lateral Electron Collection Using High Mobility PTCDI-C8 for the Application of Organic Solar Cells	○(D) Thidarat Kunawong ^{1,2} , Mitsuru Kikuchi ^{1,5} , Masaki Hirota ^{1,5} , Yusuke Shinmura ^{1,5} , Hiroyoshi Naito ^{4,5} , Aya Myint Moh ^{3,5} , Masanobu Izaki ^{3,5} , Masahiro Hiramoto ^{1,5} ○ Sergei Manzhos ¹ , Yingqian Chen ¹
15:30	E 20p-W351-7	Mechanism of Interaction of Li with Tetracyanoethylene (TCNE) and Tetracyanoquinodimethane (TCNQ): Promising Materials for Organic Batteries	1. Ntl Uni of Singapore
15:45	E 20p-W351-8	A New Type of Multilevel Organic Field Effect Memory Transistors using Lithium-ion-encapsulated Fullerene	○(D) Cuong Manh Tran ^{1,2} , Heisuke Sakai ¹ , Yuki Kawashima ³ , Kei Ohkubo ^{3,4,5,6} , Shunichi Fukuzumi ^{1,5,6} , Hideyuki Murata ¹
16:00	休憩 / Break		
16:15	20p-W351-9	可視光全域に共振ピークを持つ共役高分子マイクロ共振器	○榊田 創 ¹ 、岡部 真之介 ¹ 、佐伯 昭紀 ² 、タン ダオ ^{3,4} 、石井 智 ^{3,4} 、長尾 忠昭 ^{3,4} 、木島 正志 ¹ 、山本 洋平 ¹
16:30	奨 20p-W351-10	エピタキシャル成長させた TPCO 単一ナノドット結晶からの光励起レーザー発振	○(M1) 島井 一輝 ¹ 、水野 圭 ² 、阪東 一毅 ² 、佐々木 史雄 ³ 、柳 久雄 ¹
16:45	奨 20p-W351-11	蒸着膜転写法によるシアノ基置換 TPCO 誘導体多結晶膜からの発光増幅特性	○土屋 翔平 ¹ 、佐々木 史雄 ² 、柳 久雄 ¹ 1. 奈良先端大物質, 2. 産総研電子光技術
17:00	奨 20p-W351-12	単一の蛍光色素を添加したポリマーマイクロ共振器からの多色共鳴発光と光伝搬	○岡田 大地 ¹ 、中村 貴志 ¹ 、Braam Daniel ² 、Thang Dao ^{3,4} 、石井 智 ^{3,4} 、長尾 忠昭 ^{3,4} 、Lorke Axel ² 、鍋 島 達弥 ¹ 、山本 洋平 ¹
17:15	20p-W351-13	Optically pumped lasing from single-crystal perovskite of CH ₃ NH ₂ PbBr ₂	グエン ファン カオ ¹ 、香月 浩之 ¹ 、佐々木 史雄 ² 、柳 久雄 ¹
17:30	20p-W351-14	J 会合体金属マイクロキャビティにおける発光増幅	○水野 齋 ¹ 、石墨 淳 ² 、柳 久雄 ² 、岡野 泰彬 ³ 、大森 賢治 ³ 、廣光 一郎 ¹
17:45	20p-W351-15	ホルムアミジニウム系ペロブスカイト半導体の光励起レーザー発振	○佐々木 史雄 ¹ 、Nguyen Van-Cao ² 、柳 久雄 ² 1. 産総研電子光技術, 2. 奈良先端大物質
3/21(Mon.) 9:30 - 12:15		口頭講演 (Oral Presentation) W351 会場	
9:30	21a-W351-1	DNA 複合体にドープしたヘミシアニン色素の光学特性および波長可変レーザー発振	○(M1) 鈴木 優稀 ¹ 、川辺 豊 ¹ 1. 千歳科技大
9:45	21a-W351-2	ポリビニルカルバゾールサブミクロンファイバの光導波特性評価	○石井 佑弥 ¹ 、里園 翔太 ¹ 、大森 啓翔 ¹ 、福田 光男 ¹ 1. 豊技大
10:00	21a-W351-3	Si ₃ N ₄ /EO ポリマー MZI 変調器	○佐藤 光 ¹ 、石野 雅章 ¹ 、山本 和広 ^{1,2} 、横山 士吉 ^{1,2} 1. 九大総理工, 2. 九大先導研
10:15	21a-W351-4	銀ナノ粒子-キナクリドン複合フィルムの負性抵抗	○藤野 正家 ¹ 、増田 雄貴 ¹ 、石関 悠希 ¹ 、アイヴィー ホー ワンリン ¹ 1. 群馬高専
10:30	21a-W351-5	銀ナノ粒子-酸化チタンハイブリッドフィルムの光電導(2)	○山崎 健輝 ¹ 、石田 拓馬 ¹ 、武者 拓人 ¹ 、藤野 正家 ¹ 。1. 群馬高専, 2. 長岡高専, 3. 豊橋技科大 ¹ 、片桐 裕則 ² 、河村 剛 ³ 、松田 厚範 ³
10:45	休憩 / Break		
11:00	21a-W351-6	一回のホログラフィック露光で作製した高分子分散液晶による偏光制御型の波長切換え素子	○垣内田 洋 ¹ 、荻原 昭文 ² 1. 産総研, 2. 神戸高専
11:15	21a-W351-7	光架橋性高分子液晶を用いたファブリペロ構造を有する偏光回折格子の回折特性制御	○山口 春樹 ¹ 、河合 孝太郎 ¹ 、坂本 盛嗣 ¹ 、野田 浩平 ¹ 、佐々木 友之 ¹ 、川月 喜弘 ² 、小野 浩司 ¹
11:30	21a-W351-8	ガルバノ 描画法による多値異方性回折素子の形成	○野田 浩平 ¹ 、河合 孝太郎 ¹ 、坂本 盛嗣 ¹ 、佐々木 友之 ¹ 、川月 喜弘 ² 、小野 浩司 ¹
11:45	21a-W351-9	光架橋性高分子液晶を用いて作製されたキラル分子添加回折格子液晶セルの回折特性制御	○志村 礼 ¹ 、河合 孝太郎 ¹ 、坂本 盛嗣 ¹ 、野田 浩平 ¹ 、佐々木 友之 ¹ 、川月 喜弘 ² 、小野 浩司 ¹
12:00	21a-W351-10	DNA 添加液晶の CD スペクトル測定	○杉崎 一生 ¹ 1. 東理大基礎工
3/21(Mon.) 13:45 - 18:00		口頭講演 (Oral Presentation) W351 会場	
13:45	招 21p-W351-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 導電性高分子ナノシートの開発と生体電極への応用	○山岸 健人 ¹ 、藤枝 俊宣 ^{1,2} 、武岡 真司 ¹ 1. 早大院先進理工, 2. JST さきがけ
14:00	奨 21p-W351-2	伸縮性導電性高分子を電極に用いたフレキシブルセンサの作製	○(B) 近藤 貴弘 ¹ 、佐藤 正樹 ¹ 、奥崎 秀典 ¹ 1. 山梨大院
14:15	奨 21p-W351-3	薄膜 PDMS ラベルを用いた湾曲フィルム基板のひずみ解析	○福原 素之 ¹ 、赤松 範久 ¹ 、小池 泰徳 ¹ 、藤川 茂紀 ^{1,2} 、穴戸 厚 ^{1,3} 1. 東工大資源研, 2. 九大 WPI-I2CNER, 3. JST さきがけ
14:30	奨 21p-W351-4	薄膜グラファイトを用いたウェアラブル歪センサによる楽器演奏モニタリング	○齋藤 孝成 ¹ 、木原 裕介 ¹ 、白樫 淳一 ¹ 1. 東京農工大理工
14:45	奨 21p-W351-5	導電性高分子を電極に用いたフレキシブルスーパーキャパシタ	○(B) 齋藤 春樹 ¹ 、竹澤 裕美 ¹ 、奥崎 秀典 ¹ 1. 山梨大院
15:00	21p-W351-6	低電圧駆動アクティブ型有機圧力センサの開発	○辻 裕司 ¹ 、酒井 平祐 ¹ 、村田 英幸 ¹ 1. 北陸先端大マテリアル
15:15	21p-W351-7	エレクトレット-有機半導体感圧デバイスの作製と性能評価	○小笹 健仁 ¹ 、延島 大樹 ¹ 、栗原 一徳 ¹ 、植村 聖 ¹ 、吉田 学 ¹ 1. 産総研 FLEC
15:30	奨 21p-W351-8	エレクトロスピンニング法で作製した不織ファイバー膜の圧電的挙動の発現	○延島 大樹 ¹ 、石井 佑弥 ² 、酒井 平祐 ³ 、吉田 学 ¹ 、植村 聖 ¹ 1. 産総研 FLEC, 2. 豊技大, 3. 北陸先端大
15:45	休憩 / Break		
16:00	招 21p-W351-9	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 編状ドーピングされた CNT 紡績糸による熱電布の作製	○伊藤 光洋 ¹ 、小泉 拓也 ¹ 、阿部 竜 ¹ 、小島 広孝 ¹ 、中村 雅一 ¹ 1. 奈良先端大
16:15	21p-W351-10	P3HT ナノファイバーの配向制御と熱電変換特性	○成田 光 ¹ 、下村 武史 ¹ 1. 農工大理工

16:30	奨 21p-W351-11	有機強誘電体の分極を利用したカーボンナノチューブのゼーベック係数制御	○堀家 匠平 ¹ 、小柴 康子 ¹ 、三崎 雅裕 ¹ 、齋藤 毅 ² 、石田 謙司 ¹	1. 神戸大院工, 2. 産総研
16:45	奨 21p-W351-12	1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene を内包した N 型単層カーボンナノチューブの熱電特性	○飯原 友 ¹	1. 奈良先端大
17:00	奨 21p-W351-13	溶液中における浮遊生物質の形状分布解析法に基づくナノバイオセンサーの開発	○龍崎 奏 ¹ 、筒井 真楠 ² 、安井 隆雄 ³ 、横田 一道 ² 、玉田 薫 ¹ 、馬場 嘉信 ³ 、谷口 正輝 ²	1. 九大先導研, 2. 阪大産研, 3. 名大工学
17:15	奨 21p-W351-14	酸処理による PEDOT/PSS の構造変化と高導電化	○(B)野田 飛鳥 ¹ 、堀井 辰衛 ¹ 、奥崎 秀典 ¹	1. 山梨大院
17:30	奨 21p-W351-15	ポリフェニレンピレン誘導体への p 型および n 型ドーピング	○(M2)崎山 晋 ¹ 、小村 拓也 ¹ 、水谷 直貴 ² 、藤田 克也 ^{1,2}	1. 九大総理工, 2. 九大先導研
17:45	21p-W351-16	曲面含窒素 π 共役分子の合成とフラレン包摂挙動	○廣戸 聡 ¹ 、横井 寛生 ¹ 、酒巻 大輔 ² 、関 修平 ² 、忍久保 洋 ¹	1. 名大院工, 2. 京大院工
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W351 会場				
9:00	22a-W351-1	ポリチオフェン誘導体のナノファイバー形成メカニズムのシミュレーション	○伊藤 大樹 ¹ 、三浦 俊明 ² 、下村 武史 ¹	1. 農工大院工, 2. 産総研
9:15	22a-W351-2	導電性高分子薄膜の分子配向構造の深さ方向解析	水野 佑 ¹ 、大野 慶太 ¹ 、原 光生 ¹ 、○永野 修作 ² 、山本 勝宏 ³ 、関 隆広 ¹	1. 名大院工, 2. 名大 BVL, 3. 名工大院工
9:30	22a-W351-3	フラレン含有ポリマーのメモリ動作メカニズム	○中島 安理 ¹ 、藤井 大樹 ¹	1. 広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研
9:45	22a-W351-4	低抵抗多孔質電極によるエレクトロクロミック表示素子の高速応答化	○渡邊 雄一 ¹ 、末森 浩司 ¹ 、星野 聡 ¹	1. 産総研 FLEC
10:00	22a-W351-5	電気光学色素の超分極率及び吸収スペクトルに及ぼすチエンジピニレン π 共役系部位に関するエチレンジオキシンの効果	○山田 俊樹 ¹ 、青木 勲 ¹ 、山田 千由美 ¹ 、大友 明 ¹	1. 情通機構
10:15	休憩 / Break			
10:30	招 22a-W351-6	【有機分子・バイオエレクトロニクス分科内招待】(30分) マイクロ流体技術のマルチカラー有機発光デバイスへの応用	笠原 崇史 ¹ 、小林 直史 ¹ 、江面 知彦 ² 、石松 亮一 ³ 、大島 寿郎 ⁴ 、津脇 美帆 ¹ 、桑江 博之 ¹ 、今任 稔彦 ³ 、庄子 習一 ¹ 、安達 千波矢 ³ 、○水野 潤 ¹	1. 早大, 2. SHUTECH, 3. 九大, 4. 日産化学工業
11:00	22a-W351-7	交流駆動型二重絶縁有機 EL の発光特性評価	○畠田 貴文 ¹ 、藤田 克彦 ^{1,2}	1. 九州大総理工, 2. 九州大先導研
11:15	22a-W351-8	有機超酸処理による単層 MoS ₂ の 100% 近いフォトルミネッセンス量子収率化	○Kiriya Daisuke ¹ 、Amani Matin ¹ 、Lien Der-Hsien ¹ 、Javey Ali ¹	1. UC Berkeley
11:30	22a-W351-9	酸化半導体回折格子上の有機半導体結晶からの発光	北澤 武範 ¹ 、○山雄 健史 ¹ 、堀田 取 ¹	1. 京工織大材料化学
11:45	22a-W351-10	有機ナノファイバーコンポジットフィルム半導体特性	○八木 杜仁 ¹ 、下村 武史 ¹	1. 農工大院工
12.4 有機 EL・トランジスタ / Organic light-emitting devices and organic transistors				
3/19(Sat.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場				
	19a-P4-1	カルボニル架橋ビチアゾール骨格を含む n 型半導体材料を用いた有機 CMOS インバータ	○二谷 真司 ¹ 、家 裕隆 ¹ 、Cedric Rolin ² 、Paul Heremans ² 、安藤 芳雄 ¹	1. 阪大産研, 2. imec
	19a-P4-2	背面露光法を利用して作製した表面処理電極を有するペントセン薄膜トランジスタ	○高橋 一 ¹ 、花房 佑樹 ¹ 、北村 雅季 ^{1,2}	1. 神戸大工, 2. 東大ナノ量子機構
	19a-P4-3	ポリシルセスキオキサンゲート絶縁膜の表面処理によるペントセン薄膜トランジスタのキャリア移動度向上	○道浦 大祐 ¹ 、中原 佳夫 ¹ 、宇野 和行 ¹ 、田中 一郎 ¹	1. 和歌山大システム工
	19a-P4-4	ゲート絶縁膜に窒化処理を施した有機トランジスタの作製と評価	○中尾 弘樹 ¹ 、岩崎 好孝 ¹ 、上野 智雄 ¹	1. 農工大院工
	19a-P4-5	分子制御された有機半導体単結晶 / PMMA 薄膜間の相分離界面におけるキャリア伝導	○牧田 龍幸 ¹ 、岸 柁之 ² 、安中 辰朗 ² 、佐々木 真理 ¹ 、松井 弘之 ^{1,2} 、三津井 親彦 ² 、早川 晃鏡 ^{3,4} 、岡本 きかげ、5. バイクリスタル 敏宏 ^{1,2,4} 、竹谷 純一 ^{1,2,5}	1. 東大工, 2. 東大院新領域, 3. 東工大院理工, 4. JST さ
	19a-P4-6	TIPS pentacene/PMMA ブレンド溶液を用いた静電スプレー堆積法による有機トランジスタの作製	○(M2)原 和寛 ¹ 、小野島 紀夫 ¹	1. 山梨大学
	19a-P4-7	コロイダルナノドット単粒子膜をフローティングゲート層に用いた有機メモリトランジスタ	○中野 史堀 ¹ 、阪川 秀紀 ¹ 、宇野 和行 ¹ 、田中 一郎 ¹	1. 和歌山大システム工
	19a-P4-8	ボトムコンタクト型フラレン C ₆₀ トランジスタの電極表面処理効果	○花房 佑樹 ¹ 、高橋 一 ¹ 、北村 雅季 ^{1,2}	1. 神戸大工, 2. 東大ナノ量子機構
	19a-P4-9	ウェットプロセスを用いた有機 D フリップフロップの作製	○境 駿希 ¹ 、松井 弘之 ¹ 、田中 秀幸 ¹ 、竹谷 純一 ^{1,2}	1. 東大新領域, 2. バイクリスタル
	19a-P4-10	塗布型トップゲート有機トランジスタメモリの作製と評価	○塩野 郁弥 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大阪府大, 2. 大阪府大分子エレクトロニックデバイス研
	19a-P4-11	金ナノ粒子ポリマー抵抗メモリのパルス電圧による抵抗変化	○(M2)野田 悠太 ¹	1. 九州大学総合理工学量子プロセス理工学専攻
	19a-P4-12	アクリルダンおよびトリアジン骨格を有する TADF 材料を用いた高効率塗布型 OLED および高効率塗布型ホストフリー OLED の開発	○和田 啓幹 ¹ 、志津 功将 ¹ 、久保 勝誠 ¹ 、福島 達也 ¹ 、鈴木 克明 ¹ 、三輪 卓也 ¹ 、田中 啓之 ² 、安達 千波矢 ^{2,3} 、梶 弘典 ¹	1. 京大化研, 2. 九大 OPERA, 3. JST-ERATO
	19a-P4-13	緑色りん光性シクロメタル白金錯体 (II) の PL および EL 特性	○櫻井 芳昭 ¹ 、八木 繁幸 ² 、Qiang Chen ² 、重広 龍矢 ² 、前田 壮志 ² 、中澄 博行 ²	1. 産技研, 2. 府大院工
	19a-P4-14	ベンジジチオフェンダイマー誘導体を用いた有機薄膜トランジスタ	○山下 真由子 ¹ 、福村 光平 ¹ 、後藤 扶美子 ¹ 、大須 賀 秀次 ¹ 、宇野 和行 ¹ 、田中 一郎 ¹	1. 和歌山大システム工
	19a-P4-15	DBTTT 骨格の開発と有機単結晶トランジスタの特性評価	○(M1)小野塚 智也 ¹ 、筒井 雅宜 ² 、岡本 一男 ² 、功刀 義人 ¹	1. 東海大院工, 2. ウシオケミックス (株)
	19a-P4-16	可溶性側鎖を有するアントラジチオフェン系ポリマーの開発と有機電界効果トランジスタへの応用	○(D)兵頭 恵太 ¹ 、森 裕樹 ¹ 、西原 康師 ¹	1. 岡山大院自然
	19a-P4-17	対称・非対称型 BTBT 誘導体を用いた有機トランジスタ	○東野 寿樹 ¹ 、上田 顕 ¹ 、森 初果 ¹	1. 東大物性研
	19a-P4-18	ヘテロ環式イソインジゴ類縁体を用いた有機電界効果トランジスタ	○劉 東昊 ¹ 、増田 直彰 ¹ 、芦沢 実 ¹ 、川本 正 ¹ 、松本 英俊 ¹ 、森 健彦 ¹	1. 東工大院理工
	19a-P4-19	インピーダンス分光による逆構造有機発光ダイオードの電荷移動度評価	○高田 誠 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大阪府立大, 2. 大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研
	19a-P4-20	逆構造有機発光ダイオードの電子注入過程	○高田 誠 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大阪府立大, 2. 大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研
	19a-P4-21	極薄酸化ナノシートを電子注入層として用いた反転型高分子 EL 素子	○長谷部 大知 ¹ 、伊東 栄次 ¹ 、福田 勝利 ² 、森田 将史 ²	1. 信州大工, 2. 京都大学
	19a-P4-22	金属酸化物を陰極とした有機発光ダイオード構造を用いた TADF 材料の輸送特性評価	○長谷川 純也 ¹ 、高田 誠 ¹ 、末永 悠 ¹ 、小林 隆史 ^{1,2} 、永瀬 隆 ^{1,2} 、安達 千波矢 ^{3,4} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大府大工, 2. 大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研, 3. 九大 OPERA, 4. 九大 JST-ERATO
	19a-P4-23	ユピキタス元素による逆構造有機発光ダイオードの作製と評価	○石原口 賢太 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大阪府立大, 2. 大阪府立大分子エレクトロニックデバイス研

19a-P4-24	有機ペロブスカイト層を電子輸送層として利用した逆構造型有機 EL 素子の作製	○(M1) 坂井田 雅人 ¹ 、伊藤 巧 ¹ 、石黒 雄大 ¹ 、森 竜雄 ¹	1. 愛知工大
19a-P4-25	蛍光顕微イメージングによるペンタセン FET における電荷分布評価	○間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大理工
E 19a-P4-26	Gate-bias and temperature dependent characteristics in organic thin-film transistors with MoO ₃ /Au electrode structure	○BINTI SHAARI SAFIZAN ¹ , Shigeki Naka ¹ , Hiroyuki Okada ¹	1.Univ. of Toyama
19a-P4-27	縦型有機トランジスタにおけるゲート構造の解析	○小林 心 ¹ 、大橋 昇 ¹ 、上野 純平 ¹ 、杉山 睦 ² 、工藤 一浩 ³ 、渡邊 康之 ¹	1. 諏訪東京理科大工, 2. 東京理科大理工, 3. 千葉大院工
19a-P4-28	原子間力顕微鏡ポテンションメトリによるアセン類単結晶トランジスタの動作時電位分布測定	○石貝 創 ¹ 、中嶋 識之 ¹ 、松原 亮介 ² 、小島 広孝 ¹ 、中村 雅一 ¹	1. 奈良先端大, 2. 静大院工
19a-P4-29	ラミネート法による半透明有機 EL 素子の電子注入層厚依存性	○西岡 西樹 ¹ 、○中 茂樹 ¹ 、岡田 裕之 ¹	1. 富山大工
19a-P4-30	トップエミッション型有機 EL 素子向け新規 Al 合金アノード電極	○西山 功兵 ¹ 、越智 元隆 ¹ 、釘宮 敏洋 ¹ 、金丸 守賀 ²	1. 神戸製鋼所, 2. コベルコ科研
19a-P4-31	Au ナノクラスターの発光特性と発光電気化学セルへの適用	○(M1) 瀧澤 大介 ¹ 、西出 宏之 ¹ 、錦谷 慎範 ¹ 、内田 聡一 ² 、魯 玥 ² 、西村 涼 ²	1. 早大理工, 2.JX エネルギー (株)
3/20(Sun.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) W521 会場			
13:45	招 20p-W521-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 有機 EL 非晶質膜中の分子配向の成膜条件依存性とその直接的簡易評価	○酒井 義也 ¹ 、福田 瑞香 ² 、柴田 真希 ² 、横山 大輔 ^{1,2,3}
14:00	奨 20p-W521-2	Monte Carlo シミュレーションによる非晶質有機膜内の電荷輸送解析	○浦谷 浩輝 ¹ 、志津 功将 ¹ 、鈴木 不律 ¹ 、福島 達也 ¹ 、梶 弘典 ¹
14:15	奨 20p-W521-3	分子内・分子間水素結合を利用した水平配向性ビビリジン誘導体電子輸送材料の開発	○(D) 渡邊 雄一郎 ¹ 、笹部 久宏 ^{1,2} 、大久 哲 ^{1,2} 、小金澤 智之 ³ 、片桐 洋史 ^{1,2} 、横山 大輔 ^{1,2} 、城戸 淳二 ^{1,2}
14:30	奨 E 20p-W521-4	Horizontal molecular orientation in solution-processed glassy organic thin films based on oligofluorene derivatives	○(D)Li Zhao ¹ , Takeshi Komino ^{1,2,3} , Munetomo Inoue ¹ , Ju-Hyung Kim ¹ , Jean-Charles Ribierre ^{1,3} , Chihaya Adachi ^{1,2,3}
14:45	20p-W521-5	極低温励起状態挙動による蒸着膜とスピコート膜の膜質評価	○畠 善幸 ¹ 、立花 宏 ² 、井上 晴夫 ²
15:00	20p-W521-6	塗布性膜可能な金属酸化物ホール注入層による有機 EL 素子の長寿命化	○(M2) 各務 彰 ¹ 、大久 哲 ¹ 、夫 勇進 ¹ 、千葉 貴之 ¹ 、城戸 淳二 ¹
15:15	休憩 / Break		
15:30	20p-W521-7	定常光および時間分解 PL 分光法によるりん光有機 EL 素子の劣化機構解析	○大山 詩歩 ¹ 、久保 友明 ² 、杉本 和則 ² 、吉岡 俊博 ² 、大畑 浩 ² 、宮口 敏 ² 、筒井 哲夫 ² 、酒井 平祐 ¹ 、村田 英幸 ¹
15:45	20p-W521-8	電界誘起光第 2 次高調波法による 2 層積層有機 EL (IZO/a-NPD/Alq3/Al) 素子の長時間駆動による破壊前駆現象としての電荷蓄積現象の測定	○田口 大 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹
16:00	奨 20p-W521-9	塗布型白色りん光マルチフォトンエミッション有機 EL 素子	○千葉 貴之 ¹ 、引地 達也 ¹ 、夫 勇進 ¹ 、城戸 淳二 ¹
16:15	奨 20p-W521-10	Mg-Au 合金陰極による有機 EL 素子の電気安定性の向上	○(M1) 新井 啓矢 ¹ 、中野谷 一 ^{1,2} 、森本 京 ^{1,2} 、安達 千波矢 ^{1,2}
16:30	20p-W521-11	ピアントラセン分子による、遅延蛍光を示さない蛍光有機 EL 素子	○夫 勇進 ^{1,2} 、佐竹 麗 ¹ 、大友 崇裕 ¹ 、林 里香 ¹ 、佐藤 徹 ^{3,4} 、佐藤 啓文 ^{3,4} 、片桐 洋史 ¹ 、笹部 久宏 ¹ 、城戸 淳二 ¹
16:45	休憩 / Break		
17:00	奨 20p-W521-12	電荷移動励起状態を持つ TADF 材料における高次三重項励起状態の影響	○長谷山 翔太 ¹ 、高木 絢生 ¹ 、丹羽 顕嗣 ¹ 、小林 隆史 ^{1,2} 、永瀬 隆 ^{1,2} 、合志 憲一 ^{3,4} 、安達 千波矢 ^{3,4} 、内 大 ¹ 、藤 裕義 ^{1,2}
17:15	20p-W521-13	スカイブルー発光 TADF 材料 2CzPN における光誘導吸収測定	○丹羽 顕嗣 ¹ 、長谷山 翔太 ¹ 、高木 絢生 ¹ 、小林 隆史 ^{1,2} 、永瀬 隆 ^{1,2} 、合志 憲一 ^{3,4} 、安達 千波矢 ^{3,4} 、内 大 ¹ 、藤 裕義 ^{1,2}
17:30	20p-W521-14	三配位ホウ素骨格に基づいた熱活性化遅延蛍光材料の開発	○鈴木 克明 ¹ 、久保 勝誠 ¹ 、志津 功将 ¹ 、福島 達也 ¹ 、若宮 淳志 ¹ 、村田 靖次郎 ¹ 、安達 千波矢 ^{2,3} 、梶 弘典 ¹
17:45	20p-W521-15	外部量子効率 25% を実現する水色熱活性化遅延蛍光有機 EL デバイスの開発	○(D) 小松 龍太郎 ¹ 、笹部 久宏 ^{1,2} 、清野 雄基 ¹ 、中尾 晃平 ¹ 、城戸 淳二 ^{1,2}
18:00	20p-W521-16	炭素・水素・窒素のみからなる新規緑色発光材料を用いた外部量子効率 40% を超える有機 EL デバイス	○福島 達也 ¹ 、志津 功将 ¹ 、鈴木 克明 ¹ 、久保 勝誠 ¹ 、鈴木 不律 ¹ 、小簀 剛 ² 、安達 千波矢 ^{2,3} 、梶 弘典 ¹
3/21(Mon.) 9:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W521 会場			
9:30	21a-W521-1	ドナー・アクセプタ型フルオレン系共役高分子を用いた積層型高分子発光トランジスタからの多色発光とキャリア伝導	○梶 博武 ¹ 、大友 隆弘 ¹ 、尾崎 雅則 ¹ 、大森 裕 ¹
9:45	E 21a-W521-2	Quasi Continuous-wave Lasing in Organic Thin-film Distributed Feedback systems	○(P)SANGARANGE DONATULA SANDANAYAKA ^{1,2} , Toshinori Matsushima ^{1,2} , Chihaya Adachi ^{1,2}
10:00	E 21a-W521-3	Quasi-continuous-wave lasing in a solvent-free liquid molecular semiconductor	○JeanCharles Ribierre ^{1,2} , Atula S.D. Sandanayaka ^{1,2} , Ju-Hyung Kim ³ , Delphine Pitrat ⁴ , Li Zhao ¹ , Toshinori Matsushima ^{1,2} , Chantal Andraud ¹ , Chihaya Adachi ^{1,2}
10:15	21a-W521-4	高分子 LEC による有機半導体レーザーへの挑戦: サブマイクロ秒パルス駆動による三重項問題の解決	伊藤 瞭太 ¹ 、○坂上 知 ¹ 、竹延 大志 ^{1,2}
10:30	21a-W521-5	ポリフルオレン誘導体及びイオン性 Ir 錯体を用いた白色発光電気化学セル (LEC) の発光特性	○須賀 甲太郎 ¹ 、西出 宏之 ¹ 、錦谷 慎範 ¹ 、内田 聡一 ² 、西村 涼 ²
10:45	21a-W521-6	変位電流評価法を用いた電気化学発光セルの動作機構解析	○野口 裕 ¹ 、佐野 早紀 ¹
11:00	休憩 / Break		

11:15	21a-W521-7	減圧加熱処理による逆型量子ドット LED の駆動電圧低減	○(M1) 菱沼 賢智 ¹ 、福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、牧 純也 ¹ 、本多 善太郎 ¹	1. 埼玉大学
11:30	21a-W521-8	高感度光電子分光による ITO/PEI/Bebq ₂ 界面の電子構造の観測	○清水 康平 ¹ 、深川 弘彦 ² 、森井 克行 ³ 、金城 拓海 ⁴ 、佐藤 友哉 ⁴ 、石井 久夫 ^{4,5,6}	1. 千葉大工, 2. NHK 技研, 3. 日本触媒, 4. 千葉大院融合, 5. 千葉大先進, 6. 千葉大 MCRC
11:45	21a-W521-9	Alq ₃ を用いた有機発光ダイオードの劣化機構の ESR 研究	○(M1) 佐藤 豪 ¹ 、孫 東鉉 ¹ 、伊藤 泰亮 ¹ 、丸本 一弘 ^{1,2}	1. 筑波大数物, 2. 筑波大学学際セ
12:00	21a-W521-10	電荷変調分光法を用いた Au/pentacene/ poly(vinylidene fluoride trifluoroethylene) /ITO 素子の界面蓄積キャリアのエネルギー準位評価	○大塚 貴子 ¹ 、田口 大 ¹ 、間中 孝彰 ¹ 、岩本 光正 ¹	1. 東工大理工
3/21(Mon.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) W521 会場				
13:45	招 21p-W521-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 分子化合物半導体による n 型薄膜トランジスタの展望	○柴田 陽生 ¹ 、堤 潤也 ² 、松岡 悟志 ² 、峯廻 洋美 ² 、荒井 俊人 ³ 、長谷川 達生 ^{2,3}	1. 東北大, 2. 産総研 FLEC, 3. 東大工
14:00	21p-W521-2	ピチアゾール誘導体を用いた大気安定 n 型有機トランジスタ	○飯嶋 広大 ¹ 、Yann Le Gal ² 、Agathe Filatre-Furcate ² 、Dominique Lorcy ² 、東野 寿樹 ³ 、森 健彦 ¹	1. 東工大理工院, 2. レンズ第一大, 3. 東大物性研
14:15	21p-W521-3	BXBX (X = S, Se) 錯体を用いた有機電界効果トランジスタ	○佐藤 諒之介 ¹ 、堂岸 優貴 ¹ 、東野 寿樹 ² 、角屋 智史 ³ 、川本 正 ¹ 、森 健彦 ¹	1. 東工大理工院, 2. 東大物性研, 3. 兵庫県立大物質理
14:30	奨 21p-W521-4	自己組織化単分子膜を用いた両極性半導体のキャリア制御	○中野 正浩 ¹ 、尾坂 格 ¹ 、瀧宮 和男 ¹	1. 理研
14:45	奨 21p-W521-5	チアジアプロキノキサリンイミド骨格を有する大気安定 n 型半導体ポリマーの合成とキャリア輸送特性	○(M2) 長谷川 司 ¹ 、芦沢 実 ¹ 、青柳 晃太郎 ¹ 、内 進 ¹ 、松本 英俊 ¹	1. 東工大理工院
15:00	奨 21p-W521-6	ラミネーションコンタクト電極を用いた a-(BEDT-TTF) ₂ I ₃ 微細結晶による FET の作製	○後藤 大河 ¹ 、多田 裕作 ² 、酒井 正俊 ² 、岡田 悠悟 ^{2,3} 、山内 博 ¹ 、工藤 一浩 ²	1. 千葉大工, 2. 千葉大院工, 3. 千葉大先進科学センター
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 21p-W521-7	2 分子層有機半導体単結晶膜による低接触抵抗トランジスタ	○(M1) 山村 祥史 ¹ 、Hausermann Roger ¹ 、松井 弘之 ¹ 、三津井 親彦 ¹ 、岡本 敏宏 ^{1,2} 、竹谷 純一 ^{1,3}	1. 東大院新領域, 2. JST さきがけ, 3. パイクリスタル
15:45	奨 21p-W521-8	混合系有機半導体を用いた印刷銅電極有機 TFT の高性能化	○松浦 陽 ¹ 、乗田 翔平 ² 、福田 貴 ³ 、熊木 大介 ^{2,4} 、時任 静士 ^{2,4}	1. 山形大工, 2. 山形大院理工, 3. 東ソー, 4. 山形大 ROEL
16:00	奨 21p-W521-9	印刷デュアルゲート型有機トランジスタのバイオセンサ応用	○南 豪 ^{1,2} 、陳 奕璞 ^{1,2} 、南木 創 ^{1,2} 、竹田 泰典 ^{1,2} 、眞野 泰誠 ^{1,2} 、福田 憲二郎 ³ 、時任 静士 ^{1,2}	1. 山形大院理工, 2. 山形大 ROEL, 3. 理研
16:15	奨 21p-W521-10	18 nm 厚みのバリレン絶縁膜を用いた 2 V 駆動有機トランジスタ	○近藤 雅哉 ^{1,2} 、植村 隆文 ¹ 、松本 孝典 ¹ 、荒木 徹平 ^{1,2} 、吉本 秀輔 ^{1,2} 、関谷 毅 ^{1,2}	1. 阪大産研, 2. 阪大院工
16:30	奨 21p-W521-11	ゲート変調イメージングによる多結晶有機薄膜トランジスタの蓄積キャリアマッピング II	○松岡 悟志 ¹ 、堤 潤也 ¹ 、山田 寿一 ¹ 、鎌田 俊英 ^{1,2} 、長谷川 達生 ^{1,3}	1. 産総研, 2. 筑波大数物, 3. 東大工
16:45	21p-W521-12	イオンゲル駆動両極性有機薄膜トランジスタの高電荷密度状態における ESR 研究	○井口 翔平 ¹ 、櫻井 勇希 ¹ 、藤田 直大 ¹ 、丸本 一弘 ^{1,2}	1. 筑波大数物, 2. 筑波大学学際セ
17:00		休憩 / Break		
17:15	21p-W521-13	塗布型有機単結晶トランジスタにおけるノイズとデバイス性能の関係	○菅原 浩剛 ¹	1. 東大新領域
17:30	21p-W521-14	可溶性 DNTT 誘導体を用いた塗布製膜トランジスタの高性能化	○澤本 尚典 ^{1,2} 、杉野 寛佳 ¹ 、尾坂 格 ¹ 、瀧宮 和男 ¹	1. 理研 CEMS, 2. 埼玉大院理工
17:45	21p-W521-15	液晶性 Ph-BTBT 誘導体の側鎖構造が与える有機トランジスタ特性への効果	○飯野 裕明 ¹ 、白井 孝之 ¹ 、半那 純一 ¹	1. 東工大像情報
18:00	21p-W521-16	高移動度有機無機ペロブスカイトトランジスタ	○松島 敏則 ^{1,2} 、Sunbin Hwang ¹ 、Atula S. D. Sandanayaka ^{1,2} 、Chuanjiang Qin ^{1,2} 、藤原 隆 ³ 、安達 千波矢 ^{1,2}	1. 九大 OPERA, 2. JST ERATO, 3. ISIT
18:15	21p-W521-17	低誘電率ゲート絶縁膜を用いた多結晶 Ph-BTBT-10 電界効果トランジスタの低電圧駆動特性	○國井 正文 ¹ 、飯野 裕明 ¹ 、半那 純一 ¹	1. 東工大 像情報
18:30	21p-W521-18	Yb 界面制御層を用いたルブレ薄膜のチャネル領域結晶化に関する検討	○古山 脩 ¹ 、大見 俊一郎 ¹	1. 東工大総理工
3/22(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W521 会場				
9:00	22a-W521-1	トップゲート構造を有する塗布型有機電界効果トランジスタの高動作安定性	○高木 謙一郎 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大阪府大院工, 2. 大阪府大 分子エレクトロニックデバイス研
9:15	22a-W521-2	トップゲート構造による塗布型 n チャネル有機トランジスタの高移動度化	○末永 悠 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2}	1. 大阪府大, 2. 大阪府大分子エレクトロニックデバイス研
9:30	22a-W521-3	ブッシュコート法を用いた高移動度新規 n 型有機 TFT の低電圧化	○(B) 青木 峻介 ^{1,2} 、栗原 一徳 ² 、垣田 一成 ³ 、田中 康裕 ³ 、吉田 学 ² 、河合 武司 ¹	1. 東理大工, 2. 産総研, 3. 宇部興産
9:45	22a-W521-4	連続的超音波溶解による有機薄膜トランジスタの作製	○酒井 正俊 ¹ 、佐々木 達彦 ¹ 、高 徳幸 ¹ 、岡田 悠悟 ¹ 、山内 博 ¹ 、貞光 雄一 ² 、品村 祥司 ² 、工藤 一浩 ¹	1. 千葉大院工, 2. 日本化薬
10:00	22a-W521-5	スリットコータを用いた塗布法による大面積有機単結晶薄膜の作成	○五十川 良則 ¹ 、諫早 伸明 ² 、小森 真梨子 ² 、宇野 真由美 ^{3,4} 、竹谷 純一 ^{2,3,4}	1. タツモ, 2. パイクリスタル, 3. 阪府産技研, 4. 東大新領域
10:15	22a-W521-6	毛細管現象を利用した微小溝への有機半導体インクのパターンニング	○清水 祐鷹 ¹ 、山内 博 ¹ 、岡田 悠悟 ² 、飯塚 正明 ³ 、酒井 正俊 ¹ 、工藤 一浩 ¹	1. 千葉大院工, 2. 千葉大先進科学, 3. 千葉大教育
10:30		休憩 / Break		
10:45	22a-W521-7	自己組織化単分子絶縁膜の短時間成膜と温度依存性	○栗原 一徳 ¹ 、吉田 学 ¹	1. 産総研
11:00	22a-W521-8	真空蒸着による揮発性油中でのベンタセン単結晶成長と電場印加による単結晶の配向制御	○高山 大希 ¹ 、小槻 賢志 ² 、小幡 誠司 ¹ 、斉木 幸一朗 ^{1,2}	1. 東大新領域, 2. 東大院理
11:15	22a-W521-9	AuGe ソース / ドレイン電極を用いたボトムコンタクト型ベンタセン OFET の作製	○廣木 瑞葉 ¹ 、前田 康貴 ¹ 、大見 俊一郎 ¹	1. 東工大総理工
11:30	22a-W521-10	有機半導体 Ph-BTBT-C10 大面積層状単結晶薄膜トランジスタにおけるアクセス抵抗の影響	○(M1) 浜井 貴樹 ^{1,2} 、峯廻 洋美 ² 、井上 悟 ³ 、荒井 俊人 ¹ 、長谷川 達生 ^{1,2}	1. 東大物工, 2. 産総研, 3. 日本化薬
11:45	22a-W521-11	改良型 TLM による CNT-TFT の Transfer length 測定	○殿内 規之 ^{1,3} 、遠藤 浩幸 ^{1,3} 、二瓶 史行 ¹ 、横田 知之 ² 、染谷 隆夫 ^{2,3}	1. NEC, 2. 東大工, 3. NanoQuine
12:00	22a-W521-12	SuPR-NaP 銀電極の表面化学修飾効果：修飾基に応じたキャリア注入効率の変化と経時劣化の抑制	○青島 圭佑 ^{1,2} 、福原 克郎 ² 、山田 寿一 ² 、富樫 貴成 ³ 、栗原 正人 ³ 、荒井 俊人 ¹ 、長谷川 達生 ^{1,2}	1. 東京大工, 2. 産総研 FLEC, 3. 山形大
3/22(Tue.) 13:15 - 14:45 口頭講演 (Oral Presentation) W521 会場				
13:15	22p-W521-1	High-k 高分子絶縁膜を用いた塗布型低電圧駆動有機トランジスタ	○(B) 田代 智也 ¹ 、菅野 亮 ¹ 、関根 智仁 ¹ 、福田 憲二郎 ² 、熊木 大介 ¹ 、Fabrice D. Santos ³ 、宮保 淳 ⁴ 、会社 時任 静士 ¹	1. 山形大 ROEL, 2. 理研, 3. Piezotech, 4. アルケマ株式会社
13:30	22p-W521-2	有機トランジスタを用いた印刷 1T1C 型有機強誘電体メモリ	○菅野 亮 ¹ 、関根 智仁 ¹ 、福田 憲二郎 ² 、熊木 大介 ¹ 、福田 貴 ³ 、Santos Fabrice D. D. ⁴ 、宮保 淳 ⁵ 、時 任 静士 ¹	1. 山形大 ROEL, 2. 理研, 3. 東ソー, 4. Piezotech, 5. アルケマ

13:45	22p-W521-3	全塗布プロセスと有機半導体単結晶による5V駆動強誘電メモリトランジスタ	○都竹 康太郎 ¹ 、村上 寛子 ¹ 、境 駿希 ¹ 、山村 祥史 ¹ 、岸村 眞治 ¹ 、奈幡 明子 ¹ 、横山 嵩祥 ² 、大鷲 祐貴 ² 、和知 弘 ³ 、伊東 正浩 ³ 、山中 茂樹 ³ 、松井 弘之 ¹ 、三津井 親彦 ¹ 、岡本 敏宏 ^{1,4} 、竹谷 純 ^{1,5}	1. 東大新領域, 2. トップフォーラムズ, 3.EEJA, 4.JST さきがけ, 5. バイクリスタル
14:00	22p-W521-4	有機トランジスタを用いた生体信号増幅回路の開発	○植村 隆文 ¹ 、松本 孝典 ¹ 、近藤 雅哉 ¹ 、根津 俊一 ¹ 、森井 克行 ³ 、関谷 毅 ¹	1. 阪大産研, 2. パナソニック株式会社, 3. 株式会社日本吉本 秀輔 ¹ 、荒木 徹平 ¹ 、笹井 謙一 ^{2,1} 、新居 知哉 ^{3,1} 、触媒
14:15	22p-W521-5	フェナセン系薄膜電界効果トランジスタの論理回路応用	三上 隆弘 ¹ 、○江口 律子 ¹ 、下 佑馬 ¹ 、浜尾 志乃 ¹ 、後藤 秀徳 ¹ 、岡本 秀毅 ¹ 、林 靖彦 ¹ 、久保園 芳博 ¹	1. 岡山大院自然
14:30	22p-W521-6	有機単結晶 CMOS による高速 D フリップフロップ回路	○田中 秀幸 ¹ 、岸村 眞治 ¹ 、山村 祥史 ¹ 、大塚 貴裕 ¹ 、松井 弘之 ¹ 、佐々木 真理 ¹ 、宇野 真由美 ² 、諫早 伸明 ³ 、横山 嵩祥 ⁴ 、大鷲 祐貴 ⁴ 、谷口 和也 ⁵ 、加藤 哲弥 ⁵ 、片山 雅之 ⁵ 、三津井 親彦 ¹ 、岡本 敏宏 ^{1,6} 、宇佐美 由久 ⁷ 、伊藤 政隆 ³ 、竹谷 純 ^{1,3}	1. 東大新領域, 2. 阪府産技研, 3. バイクリスタル, 4. トップフォーラムズ, 5. デンソー, 6. JST さきがけ, 7. 富士フィルム
12.5 有機太陽電池 / Organic solar cells				
3/19(Sat.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P5 会場				
	19a-P5-1	DA 型高分子半導体溶液薄膜における界面配向形成の MD 計算による検討	○米谷 慎 ¹ 、松岡 悟志 ¹ 、堤 潤也 ¹ 、長谷川 達生 ^{2,1}	1. 産総研, 2. 東大
	19a-P5-2	光誘導吸収測定による全高分子型薄膜太陽電池の物性評価	○中 美 総司 ¹ 、成岡 達彦 ¹ 、丹羽 顕嗣 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2,3}	1. 大府大工, 2. 大府大 RIMED, 3. JST-CREST
E	19a-P5-3	Improving the Efficiency of Plasmonic Organic Solar Cells via Urchin-Like Gold Nanoparticles	○(D)APICHAT PANGDAM ^{1,2} , Sanong Ekasit ² , Chuchaat Thammacharoen ² , Chutiparn Lertvachirapaiboon ¹ , Kazunari Shinbo ¹ , Keizo Kato ¹ , Futao Kaneko ¹ , Akira Baba ¹	1. Niigata Univ., 2. Chulalongkorn Univ.
E	19a-P5-4	Enhanced Performance of Polymer Solar Cells by Incorporating Metal Nanoparticles into PEDOT:PSS layer with Metallic Grating Top Electrode	○(D)Thitirat Putmin ^{1,2} , Kontad Ounnunkad ² , Chutiparn Lertvachirapaiboon ¹ , Kazunari Shinbo ¹ , Keizo Kato ¹ , Futao Kaneko ¹ , Akira Baba ¹	1. Niigata Univ., 2. Chiang Mai Univ.
	19a-P5-5	熱変換型ドナー DPP-BP を用いた有機薄膜太陽電池におけるアルキル鎖長依存性	○熊谷 大地 ^{1,5} 、高橋 功太郎 ² 、工藤 尚樹 ⁴ 、小澤 智之 ⁶ 、葛原 大軌 ² 、増尾 真弘 ³ 、生駒 忠昭 ^{4,7} 、山田 容子 ² 、中山 健一 ^{1,5}	1. 山形大工, 2. 奈良先端大物質, 3. 関西学院大理工, 4. 新潟大, 5. 山形大 ROEL, 6. JASRI, 7. 新潟大機分セ
	19a-P5-6	光変換基を持つフラーレン誘導体を用いた BHJ 型有機薄膜太陽電池	○大和 雅樹 ^{1,3} 、川ノ上 貴裕 ² 、川尻 和己 ² 、山口 裕二 ^{1,3} 、鈴木 充朗 ² 、山田 容子 ² 、中山 健一 ^{1,3}	1. 山形大工, 2. 奈良先端大物質, 3. 山形大 ROEL
	19a-P5-7	七員環を有するフラーレン誘導体の合成と有機太陽電池への応用	○中川 貴文 ¹ 、小波 佳祐 ² 、Zhang Ying ¹ 、岡田 洋史 ¹ 、松尾 豊 ¹	1. 東大院理, 2. 都産技研
奨	19a-P5-8	フッ素含有基導入による有機薄膜太陽電池の開放電圧制御	○古川 晴一 ^{1,2} 、込山 英秋 ^{2,3} 、安田 琢磨 ^{1,2,3}	1. 九大院工, 2. 九大稲盛フロンティア研, 3. 九大 I2CNER
	19a-P5-9	逆構造有機薄膜太陽電池の効率向上メカニズム	○村田 憲保 ¹ 、米川 稷 ¹ 、杉山 拓也 ¹ 、永瀬 隆 ^{1,2} 、小林 隆史 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2,3}	1. 大阪府立大学, 2. 大阪府立大学分子エレクトロニックデバイス研, 3. JST-CREST
	19a-P5-10	開放光起電力減衰法による有機薄膜太陽電池の電荷寿命評価—二分子再結合の重要性—	○杉山 拓也 ¹ 、中島 真実 ² 、大下 浄治 ² 、永瀬 隆 ^{1,3} 、小林 隆史 ^{1,3} 、内藤 裕義 ^{1,3,4}	1. 阪府大工, 2. 広大, 3. 阪府大分子エレクトロニックデバイス研, 4. JST-CREST
奨 E	19a-P5-11	Surface potential mapping in terraced bilayer perylene derivative and phthalocyanine: A study about charge redistribution in p-n domain interfaces	○(D)ahmad bin Mohdfairus ¹ , Tomokazu Iyoda ¹ , Toshiyuki Abe ² , Keiji Nagai ¹	1. Integ. Mol. Eng. Div., Chem. Res. Lab., Tokyo Tech., 2. Dept. of Frontier Mater. Chem., Hirosaki Univ.
	19a-P5-12	有機薄膜太陽電池の乱れた界面における励起子解離・束縛の量子過程	○飯塚 秀行 ¹ 、柁湯 慶充 ¹ 、中山 隆史 ¹	1. 千葉大理
	19a-P5-13	電界塗布法により製膜された P3HT:PC ₆₁ BM 粒子の構造解析	○(P)大橋 昇 ¹ 、吉田 一貴 ¹ 、桑野 航平 ¹ 、渡邊 康之 ¹ 、小澤 智之 ²	1. 諏訪東京理科大工, 2. 高輝度光化学研究セ
	19a-P5-14	PEDOT:PSS/Si 太陽電池への5種類の添加物の効果	○(M1)池田 なつみ ¹ 、加治屋 大介 ^{2,3} 、小澤 智之 ⁴ 、齋藤 健一 ^{1,2,3}	1. 広大院理, 2. 広大自然セ, 3. 広大理, 4. 高輝度光科学研究セ
	19a-P5-15	ナノ粒子高分散金属アルコキシドを用いた有機無機薄膜太陽電池	○加藤 岳仁 ¹ 、生沼 千広 ¹ 、伊澤 悟 ¹ 、田中 好一 ¹ 、萩原 直樹 ² 、加藤 有行 ³	1. 小山高専, 2. アシザワ・ファインテック, 3. 長岡技大
	19a-P5-16	電気泳動法により成膜した TiO ₂ 光電極を用いたプラスチック基板上色素増感太陽電池におけるホットプレス温度依存性	○(M1)森田 啓介 ¹ 、米田 真 ¹ 、加藤 諒一 ¹ 、村田 佑里恵 ¹ 、Mohamado Choudhury ¹ 、岸 直希 ¹ 、曾我 哲夫 ¹	1. 名工大工
	19a-P5-17	BiI ₃ を用いた塗布型薄膜太陽電池の作製	○笹川 祥平 ¹ 、江部 日南子 ¹ 、荒木 秀明 ¹	1. 長岡高専
E	19a-P5-18	Counter Electrodes Prepared by Few Layer and Multilayer Graphene Mixed with Molybdenum Disulfide for Platinum-Free Dye-Sensitized Solar Cells	○(B)YU-CHEN CHOU ¹ , Huai-Yi Chen ¹	1. Huafan Univ.
E	19a-P5-19	Platinum-Free Counter Electrodes Prepared Using Cobalt and Nickel Nanopowders for Dye-Sensitized Solar Cells	○(B)Ching-Yen Wang ¹ , Huai-Yi Chen ¹	1. Huafan Univ.
	19a-P5-20	FAP b I _x Br _{3-x} 系ペロブスカイト薄膜作成時における IPA 溶媒の役割	○白井 肇 ¹ 、山中 孝紀 ¹ 、船田 修二 ¹ 、内海 一馬 ¹ 、薄葉 康平 ¹ 、石川 良 ¹	1. 埼玉大理工研
奨 E	19a-P5-21	Moisture and Oxygen Induced Enhancement of the Conductivity in LiTFSI Doped spiro-OMeTAD films	○(D)Zafer Hawash ¹ , Luis Ono ¹ , Yabing Qi ¹	1. OIST graduate Univ.
	19a-P5-22	有機ペロブスカイト太陽電池における TiO ₂ 緻密層の影響 ~ Spray 熱分解法と Spin コート法による比較~	○八木 崇徳 ^{1,2} 、エゼ ヴィンセント・オビオゾ ^{1,2} 、森 竜雄 ¹	1. 愛知工大, 2. 森研
	19a-P5-23	ペロブスカイト / Si モノリシックタンデムセルのための p ⁺ -Si / TiO ₂ 再結合層	○(M1)立石 義和 ¹ 、松田 拓夫 ¹ 、山下 兼一 ¹ 、喜多 隆 ²	1. 京工織大院工芸, 2. 神戸大院工
	19a-P5-24	スズペロブスカイト化合物の調製と安定性 2	○星 肇 ¹ 、重枝 直志 ¹	1. 山口東京理科大工
	19a-P5-25	有機無機ハイブリッド太陽電池におけるペロブスカイト層の作製条件の最適化	○三宅 智也 ¹	1. 岡大工
	19a-P5-26	エレクトロリメッセンス測定時の電圧印加によるペロブスカイト太陽電池への影響	○(M1)山本 智妃呂 ¹ 、前田 勝典 ¹ 、山川 ジョエル ¹ 、金子 哲也 ¹ 、功刀 義人 ¹ 、磯村 雅夫 ¹	1. 東海大院工
	19a-P5-27	第一原理計算を用いたペロブスカイト型太陽電池の安定構造探索	○山本 久美子 ¹ 、飯久保 智 ¹ 、尾込 裕平 ¹ 、早瀬 修二 ¹	1. 九工大生命体
	19a-P5-28	ハロゲン混合 CH ₂ (NH ₂) ₂ PbX ₃ 太陽電池の Band gap 制御	○(M1)内海 一馬 ¹ 、沼田 陽平 ² 、宮坂 力 ² 、白井 肇 ¹	1. 埼玉大理工研, 2. 桐蔭横浜大院工

19a-P5-29	ZnO ナノ構造体を電子輸送層に用いたペロブスカイト型太陽電池の作製および特性評価 (II)	藤林 真衣歩 ¹ 、稲見 栄一 ² 、○緒方 啓典 ^{1,2}	1. 法政大院理工学研究科, 2. 法政大マクロ・ナノ研
19a-P5-30	浸漬法を用いた CH ₃ NH ₃ PbI ₃ ペロブスカイト太陽電池における溶媒の検討	○藤原 隆 ¹ 、寺川 しのぶ ² 、松島 敏則 ² Chuanjiang QIN ² 、八尋 正幸 ¹ 、安達 千波矢 ^{1,2}	1. 九州先端研, 2. 九大 OPERA
19a-P5-31	逆オパール構造 TiO ₂ 電極を用いた量子ドット増感太陽電池の界面修飾効果	○(B) 堀 奏江 ¹ 、廣中 基記 ¹ 、豊田 太郎 ^{1,3} 、早瀬 修二 ^{2,3} 、沈 青 ^{1,3}	1. 電通大先進理工, 2. 九工大生命体工, 3. JST-CREST
19a-P5-32	水熱合成 TiO ₂ ナノロッド電極を用いた CdSe 量子ドット増感太陽電池の光電変換特性	○(M1) 梶 知史 ¹ 、佐藤 光希 ^{1,2} 、豊田 太郎 ^{1,4} 、尾 込 裕平 ^{3,4} 、早瀬 修二 ^{3,4} 、沈 青 ^{1,4}	1. 電通大先進理工, 2. 中央大理工, 3. 九工大生命体工, 4. JST CREST
19a-P5-33	CdSe 量子ドット増感逆オパール構造 TiO ₂ 太陽電池の光電変換特性 - 光強度依存性 -	○(M1) 廣中 基記 ¹ 、豊田 太郎 ^{1,4} 、佐藤 光希 ^{1,2} 、堀 奏江 ¹ 、尾込 裕平 ^{3,4} 、早瀬 修二 ^{3,4} 、沈 青 ^{1,4}	1. 電通大先進理工, 2. 中央大理工, 3. 九工大生命体工, 4. JST CREST
19a-P5-34	CuInS ₂ 量子ドットのホットキャリア緩和のダイナミクス - ZnS 表面パッシベーション効果 -	○(M1C) 出石 拓也 ¹ 、張 耀紅 ¹ 、佐藤 光希 ^{1,3} 、豊田 太郎 ^{1,4} 、早瀬 修二 ^{2,4} 、片山 建二 ³ 、沈 青 ^{1,4}	1. 電通大先進理工, 2. 九工大生命体工, 3. 中大理工, 4. JST CREST
19a-P5-35	過渡吸収法を用いた PbS/CdS 複合化量子ドット増感太陽電池の光励起キャリア移動過程の解明	○(M2) 佐藤 光希 ^{1,2} 、小野 敬太 ² 、出石 拓也 ² 、桑原 彰太 ¹ 、片山 建二 ¹ 、豊田 太郎 ^{2,3} 、沈 青 ^{2,3}	1. 中大理工, 2. 電通大, 3. JST CREST
19a-P5-36	PbS 量子ドットの CdCl ₂ 表面修飾による蛍光効率向上と光励起キャリアダイナミクスの変化	○(B) 中澤 直樹 ¹ 、出石 拓也 ¹ 、小野 敬太 ¹ 、小林 宗右 ¹ 、張 耀紅 ¹ 、丁 超 ¹ 、豊田 太郎 ^{3,1} 、早瀬 修二 ^{2,3} 、沈 青 ^{1,3}	1. 電通大先進理工, 2. 九工大, 3. JST CREST
19a-P5-37	化学溶液析出法で作製した Sb ₂ S ₃ の光吸収特性と増感太陽電池への応用 - Sb ₂ S ₃ の吸着時間依存性と熱処理効果 -	○(B) 藤野 秀一朗 ¹ 、山崎 康平 ¹ 、佐藤 光希 ^{2,1} 、小野 敬太 ¹ 、豊田 太郎 ^{1,4} 、早瀬 修二 ^{3,4} 、沈 青 ^{1,4}	1. 電通大先進理工, 2. 中大理工, 3. 九工大生命体工, 4. JST CREST
19a-P5-38	有機・無機ハイブリッド太陽電池における ZnO ナノ粒子の凝集効果	○谷 良介 ¹ 、石墨 淳 ¹ 、柳 久雄 ¹	1. 奈良先端大物質
3/19(Sat.) 13:00 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場			
13:00	19p-W531-1	C ₂ SnI ₆ 量子ドットの合成と物性評価	○太田 剛 ¹ 、小柳 嗣雄 ¹ 、Gaurav Kapil ² 、尾込 裕平 ¹ 、吉野 賢二 ³ 、沈 青 ⁴ 、豊田 太郎 ⁴ 、村上 拓郎 ⁵ 、瀬川 浩司 ² 、早瀬 修二 ¹
13:15	19p-W531-2	Si ナノ粒子を活性層とする有機・無機複合型太陽電池の作製と評価	○磯部 希 ¹ 、三宅 伴季 ¹ 、齊藤 正 ² 、稲田 貢 ²
13:30	19p-W531-3	PbS 量子ドット / ZnO 太陽電池の光電変換特性の温度依存	王 海濱 ¹ 、○久保 貴哉 ¹ 、中崎 城太郎 ¹ 、瀬川 浩司 ¹
13:45	19p-W531-4	固体型 PbS 量子ドット太陽電池における電荷分離・輸送メカニズム - 欠陥単位と電荷輸送の関係 -	○(M2) 小野 敬太 ¹ 、豊田 太郎 ^{1,4} 、尾込 裕平 ^{2,4} 、早瀬 修二 ^{2,4} 、吉野 賢二 ^{3,4} 、沈 青 ^{1,4}
14:00	19p-W531-5	ルチル型 TiO ₂ 結晶に吸着した CdSe 量子ドットの光吸収と光誘起電子移動の異方性	○豊田 太郎 ^{1,5} 、Yindeesuk Witoon ¹ 、神山 慶太 ² 、片山 建二 ³ 、早瀬 修二 ^{4,5} 、沈 青 ^{1,5}
14:15	19p-W531-6	Study on electron dynamics in Au-TiO ₂ nanoparticle system using PEEM and fs laser (3) --- bandgap energy and electron affinity of individual TiO ₂ particle---	李 博超 ¹ 、李 浩 ¹ 、李 博宇 ¹ 、林 景全 ¹ 、○富江 敏尚 ^{1,2}
14:30	19p-W531-7	Study on electron dynamics in Au-TiO ₂ nanoparticle system using PEEM and fs laser (4) --- vacuum level of individual particle---	李 博超 ¹ 、李 浩 ¹ 、李 博宇 ¹ 、林 景全 ¹ 、○富江 敏尚 ^{1,2}
14:45	E 19p-W531-8	Effect of additives on the 1-D Nanostructured Fluorine-Doped Tin Oxide Thin Films	Ajith Bandara ¹ 、Masayuki Okuya ² 、Masaru Shimomura ² 、○Kenji Murakami ² 、R.M.G. Rajapakse ³
15:00	休憩 / Break		
15:15	19p-W531-9	高屈折率差サブ波長回折格子による無反射膜の提案	○谷沢 元春 ¹ 、久住 拓司 ¹ 、丸山 武男 ¹ 、面 雅也 ¹
15:30	E 19p-W531-10	Optical manipulation of light with nanostructure by using stamping technique for enhancing the photon harvesting property in OPVs	○(P)Soowon Heo ¹ 、Keisuke Tajima ¹
15:45	19p-W531-11	光誘起 ESR 法を用いた PCE10:PC ₇₁ BM 高分子太陽電池における素子動作時の電荷蓄積の直接観測	○(M1)Rachmat VanadianAstari ¹ 、久保寺 貴也 ¹ 、孫 東鉉 ¹ 、丸本 一弘 ^{1,2}
16:00	19p-W531-12	チオフェン-チアゾロチアゾールポリマー:PCBM 有機薄膜における初期電荷分離機構	阿児 拓海 ¹ 、立川 貴士 ¹ 、尾坂 格 ² 、○小堀 康博 ¹
16:15	19p-W531-13	高分子太陽電池における界面 CT 励起子の解離機構	○(M1) 奥山 拓夢 ¹ 、玉井 康成 ¹ 、大北 英生 ¹ 、辨 天 宏明 ¹ 、伊藤 紳三郎 ¹
16:30	E 19p-W531-14	Charge Carrier Generation at Pentacene-C60 Donor-Acceptor Interfaces	○Richard Murdey ¹ 、Kazuto Nakao ¹ 、Naoki Sato ¹
16:45	休憩 / Break		
17:00	19p-W531-15	結晶性高分子太陽電池における開放電圧の起源	○(M1) 部谷 拓斗 ¹ 、大北 英生 ¹ 、辨 天 宏明 ¹ 、伊藤 紳三郎 ¹ 、齋藤 慎彦 ² 、尾坂 格 ²
17:15	19p-W531-16	変調分光法による有機薄膜太陽電池の移動度評価	○成岡 達彦 ¹ 、中 美 総司 ¹ 、小林 隆史 ^{1,2} 、永瀬 隆 ^{1,2} 、内藤 裕義 ^{1,2,3}
17:30	19p-W531-17	CuPc/C ₆₀ 有機薄膜太陽電池のバルス光励起キャリア輸送特性	○三宅 伴季 ¹ 、磯部 希 ¹ 、齊藤 正 ² 、稲田 貢 ²
17:45	19p-W531-18	有機半導体界面の励起子解離過程における界面ポテンシャル効果	○(M2) 柘 湯 慶充 ¹ 、飯塚 秀行 ¹ 、中山 隆史 ¹
18:00	19p-W531-19	固体 NMR 分光法によるバルクヘテロ接合有機薄膜太陽電池への添加剤効果の解析 (IV)	○(M1) 河野 紗希 ¹ 、緒方 啓典 ^{1,2}
3/20(Sun.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場			
9:00	20a-W531-1	CH ₃ NH ₃ PbI ₃ ペロブスカイト半導体の光学特性	白山 将基 ¹ 、門脇 英之 ¹ 、宮寺 哲彦 ² 、杉田 武 ² 、玉腰 正人 ¹ 、加藤 雅人 ¹ 、藤岡 健正 ¹ 、村田 大輔 ¹ 、原 昌太 ¹ 、村上 拓郎 ² 、藤本 祥平 ¹ 、近松 真之 ² 、○藤原 裕之 ¹
9:15	奨 20a-W531-2	分光感度シミュレーションによる高効率 CH ₃ NH ₃ Pb(I,Br) ₂ /Cu(In,Ga)Se ₂ 2 端子タンデム型太陽電池のデバイス設計	○玉腰 正人 ¹ 、藤本 祥平 ¹ 、藤岡 健正 ¹ 、藤原 裕之 ¹
9:30	奨 20a-W531-3	低温製膜 SnO ₂ -Brookite TiO ₂ 電子収集層を用いたフレキシブルペロブスカイト太陽電池	○(PC) 古郷 敦史 ¹ 、實平 義隆 ¹ 、池上 和志 ¹ 、宮 坂 力 ¹

9:45	奨 20a-W531-4	軟X線照射が引き起こす $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ ペロブスカイト太陽電池の表面状態の変化	○元木 啓介 ^{1,2} 、宮澤 優 ¹ 、小林 大輔 ² 、池上 和志 ⁴ 、宮坂 力 ⁴ 、山本 知之 ¹ 、廣瀬 和之 ²	1.早大理工, 2.JAXA 宇宙研, 3.JAXA 研究開発部門, 4.桐蔭横浜大工
10:00	奨 20a-W531-5	光強度によるペロブスカイト型太陽電池の特性変化	○來福 至 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、張 松 ¹ 、伊藤 省吾 ² 、浦 岡 行治 ¹	1.奈良先端大, 2.兵庫県立大
10:15		休憩 / Break		
10:30	奨 E 20a-W531-6	Facile Fabrication of Planar Perovskite Solar Cells via One-Step Spin-Coating and Antisolvent Bath Methods	○(D)Vincent Obiozo Eze ¹ , Mori Tatsuo ¹	1.Aichi Inst. of Tech.
10:45	奨 E 20a-W531-7	Charge Carrier Accumulation Studies in Organic-Inorganic Lead Halide Perovskite Solar Cells	○(P)Teresa Ripolles ¹ , Ajay Kumar Baranwal ¹ , Koji Nishinaka ¹ , Yuhei Ogomi ¹ , Germa Garcia-Belmonte ² , Shuzi Hayase ¹	1.KIT for Kyushu Institute of Technology, Japan, 2.INAM for Institut de Materials Avancats, Spain
11:00	奨 E 20a-W531-8	Secondary growth of perovskite crystal for pinhole-free perovskite layers with large single-crystal grains	○Teng Ma ^{1,2} , Daisuke Tadaki ^{1,2} , Ayumi Hirano-Iwata ^{1,2} , Michio Niwano ^{1,2}	1.Tohoku Univ., 2.JST-CREST
11:15	奨 20a-W531-9	Open-Circuit Voltage of Perovskite Solar Cells with Different Grain Sizes	○(DC)Kim HyungDo ¹ , Ohkita Hideo ^{1,2} , Bente Hiroaki ¹ , Ito Shinzaburo ¹	1.Kyoto Univ., 2.JST Presto
11:30	奨 20a-W531-10	完全印刷・ホール輸送層フリー・炭素二重結合フリーペロブスカイト太陽電池の耐久性試験	○(M1)金谷 周翔 ¹ 、伊藤 省吾 ¹ 、水田 凱 ¹ 、仁科 智也 ¹	1.兵県大工
3/20(Sun.) 13:00 - 18:30		口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場		
13:00	奨 20p-W531-1	異種立体規則性 P3HT の混合による分子形態変化と光電変換効率の向上	○齋藤 陽介 ¹ 、平田 誠 ¹ 、尾花 良哲 ¹ 、松澤 伸行 ¹	1.ソニー(株) R&D PF
13:15	奨 20p-W531-2	アルキル置換フェナントロジチオフェン系半導体ポリマーを用いた有機薄膜太陽電池の光電変換特性	○森 裕樹 ¹ 、遠山 亮太 ¹ 、高橋 竜輔 ¹ 、原 脩人 ¹ 、西原 康師 ¹	1.岡山大学院自然
13:30	奨 20p-W531-3	P3HT/PCBM 積層型太陽電池の素子特性に及ぼすチオフェン環の配向角度の影響	○伊東 嶺 ¹ 、小野 祐太郎 ¹ 、酒井 平祐 ¹ 、長尾 祐樹 ¹ 、村田 英幸 ¹	1.北陸先端大マテリアル
13:45	奨 20p-W531-4	PEDOT:PSS 薄膜の構造とハイブリッド太陽電池の光電変換特性	○(M1)池田 なつみ ¹ 、加治屋 大介 ^{2,3} 、小金澤 智之 ⁴ 、齋藤 健一 ^{1,2,3}	1.広大院理, 2.広大自然セ, 3.広大理, 4.高輝度光科学 研究セ
14:00	奨 20p-W531-5	電流計測原子間力顕微鏡で明らかにする共役高分子薄膜の電荷輸送構造	○(DC)尾坂 美樹 ¹ 、近藤 祐也 ¹ 、辨天 宏明 ¹ 、大北 英生 ¹ 、伊藤 紳三郎 ¹	1.京大院工
14:15	奨 E 20p-W531-6	Interface Engineering of Inverted Organic Solar Cells using V-Shaped Polyaromatic Amphiphile as Fullerene-catching Surface Modifier	○(D)Il Jeon ¹ , Sasa Zeljkovic ² , Kei Kondo ³ , Michio Yoshizawa ³ , Munetaka Akita ³ , Yutaka Matsuo ¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.Uni. of Banja Luka, 3.Tokyo Inst. of Tech.
14:30	奨 20p-W531-7	非ハロゲン系溶媒を用いた静電塗布法による有機薄膜太陽電池	○高比良 和也 ¹ 、戸田 明日来 ¹ 、鈴木 勝己 ¹ 、福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、本田 善太郎 ¹	1.埼玉大工
14:45		休憩 / Break		
15:00	招 20p-W531-8	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 高開放電圧を目指した新規半導体ポリマーの開発と有機薄膜太陽電池特性	○齋藤 慎彦 ¹ 、尾坂 格 ¹ 、瀧宮 和男 ¹	1.理研 CEMS
15:15	20p-W531-9	フラーレン誘導体による有機薄膜太陽電池の高電圧化	○辛川 誠 ¹ 、永井 隆文 ² 、足達 健二 ² 、家 裕隆 ¹ 、安蘇 芳雄 ¹	1.阪大産研, 2.ダイキン
15:30	20p-W531-10	超分子ナノロッドを用いた有機太陽電池におけるアルキル鎖長依存性	○木崎 陽弘 ^{1,2} 、大内 隼人 ³ 、林 旭 ³ 、矢貝 史樹 ¹ 、中山 健一 ^{1,2}	1.山形大学院理工, 2.山形大 ROEL, 3.千葉大学院工
15:45	20p-W531-11	光変換前駆体法を用いた塗布積層型有機薄膜太陽電池のアニール処理	○(M1)高平 勝也 ^{1,3} 、山口 裕二 ^{1,3} 、鈴木 充朗 ² 、山田 容子 ² 、中山 健一 ^{1,3}	1.山形大学院理工, 2.奈良先端大物質, 3.山形大 ROEL
16:00	E 20p-W531-12	Charge Transport Characteristics and Phase Behavior in a Binary Blend of Discotic Liquid Crystalline Materials for Solution-Processed Organic Solar Cells	○(P)Woong Shin ¹ , Yumi Higuchi ¹ , Kouki Kawano ¹ , Lidia Sosa-Vargas ¹ , Hiromichi Itani ^{1,2} , Akihiko Fujii ² , Masanori Ozaki ² , Yo Shimizu ¹	1.National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Kansai Center, 2.Osaka University
16:15	20p-W531-13	液晶性フタロシアニン-テトラベンゾボルフィリン 2成分混合系におけるキャリア移動度と膜状態	○川野 倅暉 ¹ 、井谷 弘道 ^{2,1} 、藤井 彰彦 ² 、尾崎 雅則 ² 、清水 洋 ¹	1.産総研関西, 2.阪大院工
16:30	20p-W531-14	TCNI をドナーとする新規有機 CT 結晶の合成	○安原 大智 ¹ 、松井 淳 ¹ 、吉田 司 ¹	1.山形大
16:45		休憩 / Break		
17:00	20p-W531-15	高効率ポリマー有機薄膜太陽電池の高耐久化	○渡辺 伸博 ¹ 、山本 修平 ¹ 、下村 悟 ¹ 、浅香 圭亮 ¹ 、北澤 大輔 ¹ 、多田 和也 ¹	1.東レ先端材料研
17:15	20p-W531-16	PTB7:C ₇₀ バルクヘテロジャンクション型光電池の低照射光特性		1.兵庫県立大工
17:30	20p-W531-17	低分子系有機薄膜太陽電池界面における励起子失活抑制と高効率化	○佐野 健志 ¹ 、庄 陶鈞 ² 、城戸 淳二 ²	1.山形大 INOEL, 2.山形大 ROEL
17:45	20p-W531-18	高移動度有機半導体を用いた横方向ホール収集型太陽電池	○廣田 真樹 ^{1,3} 、新村 祐介 ^{1,3} 、菊地 満 ^{1,3} 、阿部 正宏 ^{2,3} 、貞光 雄一 ² 、内藤 裕義 ^{3,4} 、平本 昌宏 ^{1,3}	1.分子研, 2.日本化薬, 3.NEDO, 4.大阪府大
18:00	20p-W531-19	MoO ₃ / Mg / Al 陰極を用いたバルクヘテロ接合型有機薄膜太陽電池の作製と評価	○石川 岩道 ¹ 、仲本 裕介 ¹ 、○景山 弘 ¹	1.琉球大工
18:15	20p-W531-20	カーボンナノチューブ透明導電膜を用いた有機薄膜太陽電池	○周 英 ¹ 、齋藤 毅 ¹ 、宮寺 哲彦 ¹ 、近松 真之 ¹ 、島 田 悟 ¹ 、阿澄 玲子 ¹	1.産総研
3/21(Mon.) 9:00 - 12:00		口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場		
9:00	21a-W531-1	結晶配向性を制御した酸化チタン膜上における二次元ペロブスカイト結晶の太陽電池特性	○實平 義隆 ¹ 、沼田 陽平 ¹ 、宮坂 力 ¹	1.桐蔭横浜大院工
9:15	21a-W531-2	チオシアネートを有する 2次元擬ペロブスカイトを用いたペロブスカイト太陽電池に関する研究	○沼田 陽平 ¹ 、實平 義隆 ¹ 、宮坂 力 ¹	1.桐蔭横浜大学
9:30	21a-W531-3	Perovskite 塗布型太陽電池における多孔質基板の影響	○廣谷 太佑 ¹ 、尾込 裕平 ^{1,3} 、沈 青 ^{2,3} 、豊田 太郎 ^{2,3} 、早瀬 修二 ^{1,3}	1.九工大院, 2.電通大, 3.JST-CREST
9:45	21a-W531-4	Pb-xanthate 太陽電池のイオン傾斜に関する研究	○西村 昭美 ¹ 、○廣谷 太佑 ¹ 、尾込 裕平 ^{1,4} 、沈 青 ^{2,4} 、吉野 賢二 ^{3,4} 、豊田 太郎 ^{2,4} 、早瀬 修二 ^{1,4}	1.九工大院, 2.電通大, 3.宮崎大学, 4.JST-CREST
10:00	21a-W531-5	Perovskite 太陽電池における低温プロセス手法の検討	○西村 澁平 ¹ 、尾込 裕平 ^{1,4} 、沈 青 ^{2,4} 、吉野 賢二 ^{3,4} 、豊田 太郎 ^{2,4} 、早瀬 修二 ^{1,4}	1.九工大院, 2.電通大, 3.宮崎大, 4.JST-CREST
10:15	21a-W531-6	多孔性 PbI ₂ 薄膜を前駆体とする (FAPbI ₃) _x (MAPbBr ₃) _{1-x} 薄膜の作製及び評価	○石川 良 ¹ 、上野 啓司 ¹ 、白井 肇 ¹	1.埼玉大院理工
10:30		休憩 / Break		
10:45	21a-W531-7	CH ₃ NH ₃ PbBr ₃ 単結晶の時空間分解発光ダイナミクス	○(M2)山田 琢允 ¹ 、中池 由美 ¹ 、若宮 淳志 ¹ 、金光 義彦 ¹	1.京大化研

11:00	E 21a-W531-8	Real-Space Imaging of the Atomic Structure of Organic-Inorganic Perovskite	○(P)Robin Ohmann ¹ , Luis K. Ono ¹ , Hui-Seon Kim ² , Haiping Lin ³ , Michael V. Lee ¹ , Youyong Li ³ , Nam-Gyu Park ² , Yabing Qi ¹	1.Energy Materials and Surface Sciences Unit (EMSS), Okinawa Institute of Science and Technology Graduate Univ. (OIST), 2.School of Chemical Engineering and Department of Energy Science, Sungkyunkwan Univ. (SKKU), 3.Inst. of Functional Nano and Soft Materials (FUNSOM), Soochow Univ.
11:15	21a-W531-9	ペロブスカイト太陽電池における光生成キャリア輸送特性の地下層依存性	○稲見 栄一 ¹ , 森川 弘理 ² , 藤林 真衣歩 ² , 石垣 隆正 ^{1,2} , 緒方 啓典 ^{1,2}	1.法政大マクロ・ナノ研, 2.法政大院理工
11:30	E 21a-W531-10	Exciton dynamics in CH ₃ NH ₃ PbI ₃ single crystals	○(P)Le Quang Phuong ^{1,2} , Yumi Nakaïke ¹ , Atsushi Wakamiya ¹ , Yoshihiko Kanemitsu ^{1,2}	1.Kyoto University, 2.JST-CREST
11:45	21a-W531-11	発光・光電流の顕微イメージング分光によるハロゲン化鉛ペロブスカイト太陽電池のキャリアダイナミクスの研究	○(M2)山下 大喜 ^{1,2} , 半田 岳人 ¹ , 山田 琢允 ¹ , 井原 章之 ¹ , 田原 弘量 ¹ , 嶋崎 愛 ¹ , 若宮 淳志 ¹ , 金光 義彦 ¹	1.京大化研, 2.大阪府大院工
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場				
9:00	22a-W531-1	部分置換ペロブスカイトの構造と電子状態に関する理論計算	○木村 翔 ¹ , 高羽 洋充 ¹	1.工学院大工
9:15	22a-W531-2	ペロブスカイト/Si タンデム型太陽電池開発を加速するコンビナトリアルデバイスプロセスシステムの設計指針	○松木 伸行 ¹ , 鯉沼 秀臣 ²	1. 神奈川大, 2. 東大新領域
9:30	22a-W531-3	有機無機ハイブリッド積層膜のコンビナトリアル分子層エピタキシーシステムとハライドペロブスカイト材料開発への応用	○川嶋 一裕 ¹ , 岡本 裕二 ² , 豊蔵 信夫 ¹ , 高橋 竜太 ³ , Lippmaa Mikk ³ , 鈴木 義和 ² , 伊高 健治 ⁴ , 松木 伸行 ⁵ , 鯉沼 秀臣 ¹	1. 東大新領域, 2. 筑波大, 3. 東大物性研, 4. 弘前大, 5. 神奈川大
9:45	E 22a-W531-4	Perovskite Solar Cells by Chemical Vapor Deposition	○(P)Matthew Ryan Leyden ¹ , Yabing Qi ¹	1.OIST
10:00	E 22a-W531-5	Rapid Perovskite Formation by CH ₃ NH ₂ Gas-Induced Intercalation and Reaction of PbI ₂	○Yabing Qi ¹ , Sonia R. Raga ¹ , Luis K. Ono ¹	1.Okinawa Inst. of Sci. & Tech.
10:15	22a-W531-6	有機スズ化合物を使用したペロブスカイト太陽電池の特性向上	○尾込 裕平 ¹ , 沈 青 ^{2,4} , 吉野 賢二 ^{3,4} , 豊田 太郎 ^{2,4} , 早瀬 修二 ^{1,4}	1. 九工大院生命体工, 2. 電通大先進理工, 3. 宮崎大工, 4.JST-CREST
10:30		休憩/Break		
10:45	22a-W531-7	発光分光によるハロゲン化鉛ペロブスカイト太陽電池の劣化機構研究	○(M1)半田 岳人 ¹ , Tex David Michael ¹ , 田原 弘量 ¹ , 嶋崎 愛 ¹ , 阿波連 知子 ¹ , 若宮 淳志 ¹ , 金光 義彦 ¹	1. 京大化研
11:00	22a-W531-8	ペロブスカイト太陽電池の初期劣化モデルに関する考察	○松下 明生 ¹ , 藤村 慎也 ¹ , 根上 卓之 ¹	1. パナソニック
11:15	22a-W531-9	サイズが異なる有機カチオンを用いたペロブスカイト太陽電池の劣化挙動の比較	○古本 嘉和 ¹ , 山本 晃平 ¹ , Shahiduzzaman Md. ¹ , 桑原 貴之 ^{1,2} , 高橋 光信 ^{1,2} , 當磨 哲也 ^{1,2,3}	1. 金沢大院自, 2. 金沢大 RSET, 3. InFniti
11:30	E 22a-W531-10	Stability issues in perovskite-based solar cells	○(P)Luis Katsuya Ono ¹ , Sonia Ruiz Raga ¹ , Yuichi Kato ¹ , Mikas Remeika ¹ , Shenghao Wang ¹ , Michael Vernon Lee ¹ , Andrew Justin Winchester ¹ , Atsushi Gabe ¹ , Yabing Qi ¹	1.Okinawa Inst. of Sci. and Technol.
11:45	E 22a-W531-11	Material characterization of lead free air stable Cs ₂ SnI ₆ and its quantum dot for perovskite solar cells	○(P)GAURAV KAPIL ¹ , Takeshi Ohta ² , Yuhei Ogomi ² , Tsuguo Koyonagi ² , Kenji Yoshino ³ , Qin Shen ⁴ , Takuro N. Murakami ⁵ , Hiroshi Segawa ¹ , Shuzi Hayase ²	1.Uni.Tokyo, 2.Kyu.Inst.Tech., 3.Uni.Miya., 4.Uni.Elect., 5.Adv.Ind.Sc.&Tech.
3/22(Tue.) 13:00 - 14:45 口頭講演 (Oral Presentation) W531 会場				
13:00	22p-W531-1	フッ化アルキルアミンを使用したペロブスカイト太陽電池の電荷分離界面制御	○(M2)森谷 昌平 ¹ , 渡部 直弥 ¹ , 尾込 裕平 ^{1,4} , 沈 青 ^{2,4} , 吉野 賢二 ^{3,4} , 豊田 太郎 ^{2,4} , 早瀬 修二 ^{1,4}	1. 九工大院生命体工, 2. 電通大先進理工, 3. 宮崎大工, 4.JST-CREST
13:15	22p-W531-2	ペロブスカイト CsPbI ₃ の遅いホットキャリア緩和と P3HT への高速ホール移動	○沈 青 ^{1,5} , Ripolles Teresa ² , 尾込 裕平 ² , 西中 浩二 ² , 出石 拓也 ¹ , 片山 建二 ³ , 豊田 太郎 ^{1,5} , 吉野 賢二 ^{4,5} , 早瀬 修二 ^{2,5}	1. 電通大先進理工, 2. 九工大生命体工, 3. 中央大理工, 4. 宮崎大工, 5.JST-CREST
13:30	22p-W531-3	有機金属ハロゲン化物ペロブスカイト薄膜における欠陥構造と分子運動性の分光学的研究 (II)	○緒方 啓典 ^{1,2} , 稲見 栄一 ²	1. 法政大院理工学研究所, 2. 法政大マクロ・ナノ研
13:45	22p-W531-4	低温・溶液プロセスで作製したペロブスカイト太陽電池の表面改質による特性向上	○白井 康裕 ¹ , Tripathy Neeti ¹ , 柳田 真利 ¹ , 加連 明也 ¹ , 宮野 健次郎 ¹	1. 物質・材料研究機構
14:00	22p-W531-5	斜入射 X 線回折による有機鉛ペロブスカイト結晶形成過程のリアルタイム解析	○宮寺 哲彦 ¹ , 柴田 陽生 ² , 小倉澤 智之 ³ , 村上 拓郎 ¹ , 杉田 武 ¹ , 谷垣 宣孝 ⁴ , 近松 真之 ¹	1. 産総研太陽光, 2. 東北大工, 3. JASRI, 4. 産総研無機機能材料
14:15	22p-W531-6	有機-無機ハイブリッドペロブスカイト太陽電池の Scaffold 酸化物の結晶面効果	○米谷 真人 ^{1,2} , 堅山 瑛人 ¹ , 大村 葵 ¹ , 椿 俊太郎 ¹ , 鈴木 榮一 ¹ , 瀬川 浩司 ² , 和田 雄二 ¹	1. 東工大院理工, 2. 東大先端研
14:30	22p-W531-7	CH ₃ NH ₃ PbBr ₃ を用いたペロブスカイト太陽電池の作製と評価	○中村 友 ¹ , 古川 行夫 ¹	1. 早大院先進理工
CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオ・プロセスとセンシングの融合に向けて」/ 3.7/12.6/12.7 Code-sharing session				
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場				
13:45	招 21p-W331-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) フェムト秒レーザーアブレーションを用いた成長機構転換によるタンパク質結晶の高品質化	○富永 勇佑 ¹ , 丸山 美帆子 ¹ , 吉村 政志 ¹ , 杉山 成 ² , 安達 宏昭 ^{1,3} , 塚本 勝男 ¹ , 松村 浩由 ^{3,4} , 高野 和文 ^{3,5} , 村上 聡 ^{3,6} , 井上 豪 ^{1,3} , 吉川 洋史 ^{1,7} , 森 勇介 ^{1,3}	1. 阪大院工, 2. 阪大院理, 3. 創晶, 4. 立命大生科, 5. 京府大院生環, 6. 東工大院生理工, 7. 埼玉大
14:00	奨 21p-W331-2	フォトニック結晶ナノレーザーでの電気化学センシング	○渡部 工 ¹ , 古田 祐樹 ¹ , 高橋 大智 ¹ , 長谷川 湧 ¹ , 横国大・院工馬場 俊彦 ¹	1. 横国大・院工
14:15	奨 21p-W331-3	マイクロ流路内における生分解性粒子支援フェムト秒レーザー外来分子導入	○石井 敦浩 ¹ , 有安 和優 ¹ , 三橋 龍樹 ¹ , Dag Heinemann ² , Alexander Heisterkamp ^{2,3} , 寺川 光洋 ¹	1. 慶大院理工, 2. レーザーセンターハノーバー, 3. ライプニッツ大学ハノーバー
14:30	奨 21p-W331-4	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での微小物体の高速ソーティング	○山川 健 ^{1,4} , 萩原 宏規 ^{1,4} , 飯野 敬矩 ^{1,4} , 田中 直樹 ^{2,4} , 芝田 悠大 ^{2,4} , 野沢 泰祐 ^{2,4} , 磯崎 瑛宏 ^{2,4} , Dino Di Carlo ^{3,4} , 合田 圭介 ^{2,3,4} , 細川 陽一郎 ^{1,4}	1. 奈良先端大物質, 2. 東大院理, 3. UCLA, 4. JST
14:45	21p-W331-5	レーザー走査光触媒リソグラフィを活用した液中細胞パターンニング	○(M1)藤城 翔偉 ¹ , 関根 浩平 ¹ , 河野 翔 ¹ , 池田 丈 ² , 黒田 章夫 ² , 山本 英明 ³ , 谷井 孝至 ¹	1. 早大理工, 2. 広大先端研, 3. 東北大学際研
15:00	21p-W331-6	マイクロ流路作製のための LPP EUV 光による PDMS の加工	○浦井 ひかり ¹ , 小川 瑞生 ¹ , 深見 慎太郎 ¹ , 鳥居 周一 ¹ , 牧村 哲也 ¹ , 中村 大輔 ² , 高橋 昭彦 ² , 岡田 龍雄 ² , 新納 弘之 ³	1. 筑波大院数理, 2. 九大院シス情, 3. 産総研
15:15		休憩/Break		
15:30	21p-W331-7	金属ナノ粒子を用いたレーザー直接描画法による 3次元マイクロ構造体の形成	○渡辺 明 ¹ , 蔡 金光 ¹	1. 東北多元研
15:45	21p-W331-8	Bull's Eye 構造のプラズモニックチップを用いた蛍光標識ナノ粒子の蛍光顕微鏡観察	○泉 章太 ¹ , 細川 千絵 ² , 當麻 真奈 ¹ , 田和 圭子 ¹	1. 関西学院大理工, 2. 産総研

16:00	21p-W331-9	遺伝改変フェリチンによる離散金ナノ粒子アレイ作製技術の構築	○信澤 和行 ¹ 、岡本 尚文 ² 、Chong Karen Siew Ling ³ 、山下 一郎 ^{1,2}	1. 阪大院工, 2. 奈良先端大物質, 3. IMRE A*STAR
16:15	21p-W331-10	汎用グリーンレーザーによるフッ素ポリマーの微細加工技術開発および水棲微生物観察用バイオチップ作製	○根本 佳祐 ¹ 、小川 達也 ¹ 、花田 修賢 ^{1,2}	1. 弘前大理工, 2. 理研
16:30	21p-W331-11	集光フェムト秒レーザーを用いた単一細胞刺激による神経細胞ネットワークの活動特性	○中川 裕太 ^{1,2} 、工藤 卓 ² 、田口 隆久 ³ 、細川 千絵 ¹	1. 産総研, 2. 関西学院大理工, 3. 情通機構
16:45	21p-W331-12	物理ストレスを受けたミトコンドリアの力印加共焦点顕微鏡による活性酸素応答測定	○本田 諭志 ¹ 、李 永波 ¹ 、上田 雅 ¹ 、長崎 秀昭 ¹ 、岩見 健太郎 ¹ 、太田 善浩 ¹ 、梅田 倫弘 ¹	1. 農工大
17:00		休憩 / Break		
17:15	21p-W331-13	Measurement of Reactive Species for the Development of Plasma-on-Chip	○吳 準席 ^{1,2} 、小島 信也 ³ 、八田 章光 ^{1,2} 、佐々木 実 ³ 、熊谷 慎也 ³	1. Kochi Univ. Technol., 2. Center Nanotechnol., 3. Toyota Technol. Inst.
17:30	21p-W331-14	可視光照射によるバイオセンシング用銀ナノ構造基板の作製	○吉川 裕之 ¹ 、沈 正君 ¹ 、廣納 麻美 ¹ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大院工
17:45	21p-W331-15	神経細胞表面のグルタミン酸受容体分子の初期集合状態に依存した光捕捉過程	○前澤 安代 ¹ 、岸本 龍典 ^{1,2} 、工藤 卓 ² 、田口 隆久 ³ 、細川 千絵 ^{1,2}	1. 産総研 バイオメディカル, 2. 関西学院大 理工, 3. 情通機構 脳情報
18:00	21p-W331-16	界面レーザー捕捉による局所的タンパク濃度上昇・結晶化促進の顕微分光	○三浦 篤志 ^{1,2} 、吉松 泉 ² 、喜多村 昇 ^{1,2}	1. 北大院理, 2. 北大院総化
18:15	21p-W331-17	光発熱集合効果を用いた高速細菌数測定法の原理構築	○山本 靖之 ^{1,2} 、清水 恵美 ² 、西村 勇姿 ¹ 、床波 志保 ² 、飯田 琢也 ¹	1. 阪府大院理, 2. 阪府大院工
18:30	21p-W331-18	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での単一細胞の高速操作: 操作性の流速およびレーザー強度依存性	○萩原 宏規 ^{1,4} 、山川 健 ^{1,4} 、飯野 敬矩 ^{1,4} 、田中 直樹 ^{2,4} 、芝田 悠大 ^{2,4} 、野沢 泰佑 ^{2,4} 、磯崎 瑛宏 ^{2,4} 、Dino Di Carlo ^{3,4} 、合田 圭介 ^{2,3,4} 、細川 陽一郎 ^{1,4}	1. 奈良先端大物質, 2. 東大院理, 3. UCLA, 4. JST
18:45	21p-W331-19	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたオープンチップ中の高速流体からの細胞分取	○飯野 敬矩 ^{1,3} 、山川 健 ^{1,3} 、萩原 宏規 ^{1,3} 、佐久間 臣耶 ^{2,3} 、早川 健 ^{2,3} 、益田 泰輔 ^{2,3} 、新井 史人 ^{2,3} 、細川 陽一郎 ^{1,3}	1. 奈良先端大物質創成, 2. 名大院工, 3. JST
12.6 ナノバイオテクノロジー / Nanobiotechnology				
3/19(Sat.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場				
9:00	19a-W323-1	2次元材料表面にβシート構造を形成する新規機能性ペプチドの開発	○佐久間 洗平 ¹ 、深田 拓人 ¹ 、早水 裕平 ¹	1. 東工大早水研究室
9:15	19a-W323-2	クマゼミの羽が持つ機能性ナノ表面とその模倣	○伊藤 健 ¹ 、田中 琢聖 ¹ 、清水 智弘 ¹ 、新宮原 正三 ¹	1. 関西大システム理工
9:30	19a-W323-3	バイオ分子マイクロ構造の自己組織化過程の制御と評価	○櫻井 亮 ¹ 、コレブドット ¹ 、青野 正和 ¹	1. 物材研, MANA
9:45	19a-W323-4	高圧力顕微鏡法による細菌ペンの構造変化イメージング	○西山 雅祥 ¹ 、曾和 義幸 ²	1. 京大自眉, 2. 法政大生命
10:00	19a-W323-5	分子認識機能性ポリマーを利用した細胞検出法	○沼田 紘志 ¹ 、中瀬 生彦 ² 、田村 守 ¹ 、飯田 琢也 ³ 、床波 志保 ¹	1. 阪府大院工, 2. 阪府大ナノ科学材料セ, 3. 阪府大理工
10:15		休憩 / Break		
10:30	奨 19a-W323-6	ハイドロゲル製電気刺激培養システムの開発と骨格筋機能評価	○(M1) 佐藤 寛崇 ¹ 、平田 卓也 ¹ 、阿部 結奈 ¹ 、長 峯 邦明 ¹ 、甲斐 洋行 ¹ 、梶 弘和 ¹ 、西澤 松彦 ¹	1. 東北大工
10:45	奨 E 19a-W323-7	A Porous Polymer Microneedle Array for Interstitial Fluid Monitoring	○(M2) Liming Liu ¹ 、Hiroyuki Kai ¹ 、Kohtaro Matsuzaka ¹ 、Kuniaki Nagamine ¹ 、Mastuhiko Nishizawa ¹	1. Tohoku Univ
11:00	奨 19a-W323-8	伸縮性バイオ燃料電池を用いた汗中乳酸センサの開発	○(M1) 加藤 悠人 ¹ 、高井 優樹 ¹ 、小川 雄大 ¹ 、甲斐 洋行 ¹ 、西澤 松彦 ¹	1. 東北大院工
11:15	19a-W323-9	ボロン酸基を側鎖に有するポリマーを用いたグラフェン・グルコースセンサの開発	○(DC) 増島 弘顕 ¹ 、細川 竜平 ¹ 、早水 裕平 ¹ 、道 信 剛志 ¹	1. 東工大院理工
11:30	19a-W323-10	CNT 複合 CF クロスの酵素機能電極への応用と CNT 添加効果	○鬼塚 麻季 ¹ 、小向 拓治 ¹ 、宋 慶盛 ² 、加納 健司 ²	1. ニッタ株, 2. 京大院農
11:45	奨 19a-W323-11	清浄表面を持つカーボンナノチューブ楕円電極の作製と評価	○牛山 拓也 ¹ 、グエン ヴィエット ¹ 、岸本 茂 ¹ 、大野 雄高 ^{1,2}	1. 名大工, 2. 名大未来研
12:00	19a-W323-12	大腸菌吸着によるグラフェンのアンピポラ特性変化	○Mulyana Yana ¹ 、上沼 睦典 ¹ 、岡本 尚文 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、山下 一郎 ¹ 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端大
3/19(Sat.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場				
13:45	奨 19p-W323-1	超格子構造中の DNA 被覆金ナノ粒子の融合に向けた粒子間距離収縮とナノ粒子融合	○(B) 鷲見 隼人 ¹ 、磯貝 卓巳 ¹ 、中田 咲子 ¹ 、吉田 直矢 ¹ 、原田 俊太 ¹ 、宇治原 徹 ¹ 、田川 美穂 ¹	1. 名大
14:00	奨 19p-W323-2	PEG フェリチンを用いた無機ナノ粒子の分散配置	○多和 勇樹 ¹ 、上沼 睦典 ¹ 、藤本 裕太 ¹ 、岡本 尚文 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、山下 一郎 ¹ 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端大
14:15	奨 19p-W323-3	特異的認識ペプチドを用いた金ナノ粒子の高密度配置	○岡崎 駿 ¹ 、上沼 睦典 ¹ 、岡本 尚文 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、山下 一郎 ¹ 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端大
14:30	奨 19p-W323-4	抗原抗体反応により凝集したラテックス粒子の SEM 観察	○山本 興子 ¹ 、小野 雪夫 ² 、平野 匡章 ¹ 、足立 作一 ¹	1. 日立研開, 2. 日立ハイテクノロジーズ
14:45	奨 19p-W323-5	サブミクロンポアを用いたラテックス粒子の抵抗パルス測定による抗原抗体反応の単分子計測	○高倉 樹 ¹ 、柳 至 ¹ 、後藤 佑介 ¹ 、石毛 悠 ¹ 、小原 賢信 ¹	1. 日立研開
15:00	19p-W323-6	近接複数ナノポアのイオン電流評価	○横田 一暉 ¹ 、Lee Steven ¹ 、筒井 真楠 ¹ 、谷口 正輝 ¹ 、川合 知二 ¹	1. 阪大産研
15:15	奨 19p-W323-7	絶縁被覆ナノギャップ電極を用いた液中タンパク質識別	○有馬 彰秀 ¹ 、筒井 真楠 ¹ 、谷口 正輝 ¹	1. 阪大産研
15:30	19p-W323-8	縦型ナノトランジスタを用いたバイオセンサに向けた微細流路の作製	○遠田 康平 ¹ 、角田 充俊 ¹ 、山内 博 ¹ 、酒井 正俊 ¹ 、工藤 一浩 ¹	1. 千葉大学
15:45		休憩 / Break		
16:00	19p-W323-9	導波路型バクテリオドブシン光応答セルによる時間微分型光応答電流の高効率化	○山田 俊樹 ¹ 、春山 喜洋 ¹ 、笠井 克幸 ¹ 、梶 貴博 ¹ 、富成 征弘 ¹ 、田中 秀吉 ¹ 、大友 明 ¹	1. 情通機構
16:15	奨 19p-W323-10	バクテリオドブシン光センサの時間周波数特性における pH 緩衝液効果	○(M2) 宮下 一馬 ¹ 、笠井 克幸 ² 、春山 喜洋 ² 、岡田 佳子 ¹	1. 電通大先進理工, 2. 情報通信研究機構
16:30	奨 19p-W323-11	親水基の異なるリン脂質リポソームを用いたマイクロカスケードセンサによる Aβ タンパク質識別能力の評価	○(P) 張 子洋 ¹ 、村上 祐樹 ¹ 、谷口 智哉 ¹ 、寒川 雅之 ² 、山下 馨 ¹ 、野田 実 ¹	1. 京都工芸繊維大学, 2. 新潟大学
16:45	奨 19p-W323-12	DDAB 平面脂質二重膜の相転移過程の直接観察	○磯貝 卓巳 ¹ 、中田 咲子 ¹ 、赤田 英里 ¹ 、吉田 直矢 ¹ 、鷲見 隼人 ¹ 、手老 龍吾 ² 、原田 俊太 ¹ 、宇治原 徹 ¹ 、田川 美穂 ¹	1. 名大院工, 2. 豊橋技科大
17:00	19p-W323-13	ナノスケール表面平坦性を保った化学修飾基板上への繋ぎ留め型支持脂質二重膜の作製	○(M1) 新山 侑哉 ¹ 、三澤 宣雄 ^{2,3} 、手老 龍吾 ^{1,2}	1. 豊技大 環境・生命, 2. 豊技大 EIRIS, 3. KAST

17:15	19p-W323-14	浸透圧差による架橋膜の変形とベシクル融合促進	○大嶋 梓 ¹ 、櫻村 吉晃 ¹ 、住友 弘二 ¹ 、中島 寛 ¹	1.NTT 物性基礎研
17:30	19p-W323-15	微細加工イオンチャンネルチップにおけるチャンネル包埋促進	○平野 愛弓 ¹ 、吉田 美優 ¹ 、荒木 駿 ¹ 、山本 英明 ² 、庭野 道夫 ³	1. 東北大院医工, 2. 東北大学際研, 3. 東北大通研
17:45	19p-W323-16	支持脂質膜へのリポ多糖およびコレステロール修飾ゼラチンの結合: 膜面積閉じ込め効果と膜張力効果	○片岡 知歩 ¹ 、貝塚 芳久 ¹ 、田口 哲志 ¹	1. 物材機構
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場				
9:00	20a-W323-1	電子線誘起局所電界操作によるバイオ分子操作と in-situ リソグラフィ	○星野 隆行 ¹ 、宮廻 裕樹 ¹ 、満洲 邦彦 ¹	1. 東大院情理
9:15	20a-W323-2	SHG 強度による細胞膜損傷の評価と微粒子内在化が細胞膜に与える影響	○齋藤 晴之 ¹ 、加藤 徳剛 ¹	1. 明大理工
9:30	奨 20a-W323-3	近赤外分光法に基づく DNA 電気泳動ゲルの非染色イメージング	○安田 充 ¹ 、苔口 祐佳 ¹ 、秋元 卓央 ² 、尾崎 幸洋 ¹	1. 関西学院大理工, 2. 東京工科大応用生物
9:45	奨 20a-W323-4	界面活性剤ミセル存在下における発光性水酸アパタイトナノ結晶の合成と特性	○片岡 卓也 ¹ 、柴 弘太 ² 、多賀谷 基博 ¹	1. 長岡技科大工, 2. 物材機構 ICYS
10:00	20a-W323-5	FMO 法に基づく高分子材料とシリカナノ粒子の相互作用モデリング	○加藤 幸一郎 ¹ 、石川 雄太郎 ² 、奥脇 弘次 ² 、川田 修太郎 ² 、望月 祐志 ^{2,3} 、小沢 拓 ⁴	1. みずほ情報総研, 2. 立教大理, 3. 東大生産研, 4. JSOL
10:15	奨 20a-W323-6	FMO 計算を援用する高分子マルチスケールシミュレーション	○奥脇 弘次 ¹ 、川田 修太郎 ¹ 、望月 祐志 ^{1,2} 、大島 広介 ³ 、小沢 拓 ³	1. 立教大理, 2. 東大生産研, 3. JSOL
10:30		休憩 / Break		
10:45	奨 20a-W323-7	液中 FM-AFM による plasmid DNA のナノスケール水和構造計測	○木南 裕陽 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
11:00	20a-W323-8	液中 FM-AFM による DNA オリガミにおける crossover 構造評価 (2)	○黄 雲飛 ¹ 、馬 志鵬 ¹ 、木南 裕陽 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹ 、田畑 修 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
11:15	奨 20a-W323-9	AFM ナノ力学測定による材料結合ヘプチドの親和性評価手法の開発	○(D) 望月 誠仁 ¹ 、小口 真弘 ¹ 、Kim Seong-Oh ² 、Jackman Joshua A. ² 、小川 哲 ¹ 、Lkhamnsuren Ganchimeg ¹ 、Cho Nam-Joon ² 、林 智広 ^{1,3}	1. 東工大 総理工, 2. 南洋理工大学, 3. 理研
11:30	20a-W323-10	光熱励振法を使用した振幅変調モード原子間顕微鏡によるナノスケール空間における水の動力学的応答の解析	○(M2) 丹生 隆 ¹ 、小川 哲 ¹ 、林 智広 ^{1,2}	1. 東工大 総理工, 2. 理研
11:45	20a-W323-11	3次元走査型顕微鏡による揺動するナノ分子鎖の液中実空間計測	○稲田 なつみ ¹ 、高尾 一史 ¹ 、浅川 雅 ^{1,2} 、福岡 剛士 ^{1,2,3}	1. 金大院, 2. 金大バイオ AFM セ, 3. JST ACT-C
12:00	20a-W323-12	生物試料観察のための高速走査型イオン伝導顕微鏡の開発	○渡辺 信嗣 ¹ 、安藤 敏夫 ^{1,2}	1. 金沢大バイオ AFM, 2. JST CREST
3/20(Sun.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P11 会場				
	E 20p-P11-1	Modification of Carbon-Based Materials with MPC Polymer Brush for Applications in Intracellular Nanosensors	○(M1) Tinnlea Uen ¹ 、Keiichiro Kushirol ¹ 、Madoka Takai ¹	1. The Univ. of Tokyo
	20p-P11-2	ナノ構造の導入による電気化学顕微鏡用マイクロ電極の高感度化	○池上 真志樹 ¹ 、平野 悠 ¹ 、三重 安弘 ¹ 、小松 康雄 ¹	1. 産総研
	奨 E 20p-P11-3	Improving Surface Plasmon Resonance Immunosensor Based on Graphene Oxide/PEDOT/PSS Film	○(D) Chamhari Pothipor ^{1,2} 、Kontad Uunnunkad ² 、Chutiparn Lertvachirapaiboon ¹ 、Kazunari Shinbo ¹ 、Keizo Kato ¹ 、Futao Kaneko ¹ 、Akira Baba ¹	1. Niigata Univ. for Niigata University, 2. Chiang Mai Univ. for Chiang Mai University
	20p-P11-4	薄膜干渉基板を用いた高感度ラマン分光イムノアクセス	○安田 充 ¹ 、秋元 卓央 ² 、尾崎 幸洋 ¹	1. 関西学院大理工, 2. 東京工科大応用生物
	20p-P11-5	自己組織化単分子膜修飾ナノ粒子を用いた標的遺伝子の高感度検出	○江刺家 恵子 ¹ 、水口 高翔 ¹ 、齋木 敏治 ¹	1. 慶大理工
	20p-P11-6	液中金ナノ粒子サンドイッチアクセス法による標的 DNA の高感度検出	○水口 高翔 ¹ 、江刺家 恵子 ¹ 、齋木 敏治 ¹	1. 慶大理工
	20p-P11-7	集光レーザーアニリングによる貴金属ナノ構造の作製と SERS 特性の評価	○中川 亮 ¹ 、吉川 裕之 ¹ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大院工
	20p-P11-8	四重極マイクロポアによる微粒子通過位置制御	○筒井 真楠 ¹ 、横田 一道 ¹ 、谷口 正輝 ¹ 、川合 知二 ¹	1. 阪大産研
	20p-P11-9	ナノポアやナノスリットを通過する際に発生する DNA の詰まりのメカニズム	○坂下 直人 ¹ 、加藤 佑太 ¹ 、石田 研太郎 ¹ 、三井 敏之 ¹	1. 青学大理工
	20p-P11-10	トンネル電流生体高分子識別法による単分子温度変化挙動の観察	○大城 敬人 ¹ 、筒井 真楠 ¹ 、横田 一道 ¹ 、谷口 正輝 ¹	1. 阪大産研
	20p-P11-11	熱電応用に向けた PEG 修飾フェリチンによるナノ構造形成	○藤本 裕太 ¹ 、上沼 陸典 ¹ 、多和 勇樹 ¹ 、岡本 尚文 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、山下一郎 ¹ 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端大
	20p-P11-12	機械学習を援用した Chignolin のアミノ酸残基間の相互作用解析	○望月 祐志 ^{1,2} 、古明地 勇人 ³ 、井山 剛志 ¹ 、奥沢 明 ⁴ 、牧村 健 ⁴ 、中西 貴哉 ⁴ 、田中 成典 ⁵	1. 立教大理, 2. 東大生研, 3. 産総研バイオ, 4. (株)ナレッジコミュニケーション, 5. 神戸大院情
	20p-P11-13	ペプチド類のフラグメント分子軌道計算	○川田 修太郎 ¹ 、坂口 正貴 ¹ 、米倉 伊吹 ¹ 、奥脇 弘次 ¹ 、望月 祐志 ^{1,2} 、福澤 薫 ^{2,3}	1. 立教大理, 2. 東大生産研, 3. 日大松戸歯
	20p-P11-14	FM-AFM による脂質二重膜上 streptavidin 2次元結晶の分子スケール構造観察	○宮本 眞之 ¹ 、木南 裕陽 ¹ 、小林 圭 ^{1,2} 、山田 啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
	20p-P11-15	光熱励振法を用いた振幅変調型原子間顕微鏡による 2次元分子認識マッピング	○丹生 隆 ¹ 、小川 哲 ¹ 、大橋 りな ¹ 、○林 智広 ^{1,2}	1. 東工大 総理工, 2. 理研
	20p-P11-16	グリフ細胞の機能解明へ向けたシナプス領域の近接場イメージング (II)	○酒井 優 ¹ 、岡部 菜央 ¹ 、櫻井 杏梨 ¹ 、篠崎 陽一 ² 、柴田 圭輔 ² 、繁富 英治 ² 、小泉 修一 ² 、内山 和治 ¹ 、堀 裕和 ¹ 、小林 潔 ¹	1. 山梨大工, 2. 山梨大医
	20p-P11-17	SiO ₂ 吸着ペプチドの作製と球殻状タンパク質外表面へ提示	○岡本 尚文 ¹ 、北川 坦 ¹ 、浦岡 行治 ¹ 、山下一郎 ^{1,2}	1. 奈良先端大, 2. 阪大院工
	20p-P11-18	シランカップリング剤修飾 SiN 基板表面における脂質膜の流動性評価	○山浦 大地 ¹ 、仲山 智明 ¹ 、木村 康男 ² 、平野 愛弓 ³ 、荻野 俊郎 ¹	1. 横浜国大, 2. 東京工科大, 3. 東北大
	20p-P11-19	ホスト細胞同定に向けたエクソソーム基板吸着様態の特徴抽出	○伊藤 和希 ¹ 、小川 裕太 ¹ 、横田 圭司 ¹ 、松村 幸子 ² 、南澤 宝美后 ² 、菅 加奈子 ² 、芝 清隆 ² 、木村 康男 ³ 、平野 愛弓 ⁴ 、荻野 俊郎 ¹	1. 横国大院工, 2. がん研, 3. 東京工科大, 4. 東北大院医
	20p-P11-20	hERG 含有プロテオリポソームによる支持脂質二重膜形成と膜内構造体のサイズ分布の評価	○福本 幸平 ¹ 、吉田 美優 ² 、平野 愛弓 ² 、庭野 道夫 ^{2,3} 、手老 龍吾 ^{1,4}	1. 豊技大 環境・生命, 2. 東北大院医工, 3. 東北大通研, 4. 豊技大 EIIRIS
	20p-P11-21	二次元系原子膜と脂質分子膜の融合デバイスへ向けた要素技術開拓	○(M1) 磯部 亜紀子 ¹ 、寺崎 真志 ¹ 、木村 康男 ² 、平野 愛弓 ³ 、荻野 俊郎 ¹	1. 横国大院工, 2. 東京工科大, 3. 東北大院医工

20p-P11-22	Investigation for Association between the Structure of Partially Fluorinated Lipid Bilayer and Fluorescence Emission from Incorporated Dye-Lipid	○(P)Toshinori Motegi ¹ , Toshiyuki Takagi ² , Toshiyuki Kanamori ² , Masashi Sonoyama ³ , Ryugo Tero ¹	1.Toyohashi Univ. Tech., EIIIRIS, 2.Nat. Inst. Adv. Ind. Sci. Technol. (AIST), 3.Gunma Univ., Grad. Sch. Eng., 4.Toyohashi Univ. Tech., Dep. Environ. Life Sci.
20p-P11-23	液中環境下における金ナノ粒子の脂質二重膜への導入評価	○(M1)坂口 直駿 ¹ , 仲山 智明 ¹ , 木村 僚佑 ¹ , 木村 康男 ² , 平野 愛弓 ³ , 荻野 俊郎 ¹	1.横国大院工, 2.東京工科大, 3.東北大院医工
20p-P11-24	バイオデバイス応用にに向けた巨大ベシクルの作製と評価	○(M1)木村 僚佑 ¹ , 仲山 智明 ¹ , 坂口 直駿 ¹ , 木村 康男 ² , 平野 愛弓 ³ , 荻野 俊郎 ¹	1.横国大院工, 2.東京工科大, 3.東北大院医工
20p-P11-25	アルミナ表面上における脂質膜の展開と微小井戸上の架橋膜形成	○櫻村 吉晃 ¹ , 大嶋 梓 ¹ , 住友 弘二 ¹ , 中島 寛 ¹	1.NTT 物性基礎研
CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオ プロセッシングとセンシングの融合に向けて」/ 3.7/12.6/12.7 Code-sharing session			
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場			
13:45	招 21p-W331-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) フェムト秒レーザーアブレーションを用いた成長機構転換によるタンパク質結晶の高品質化	○富永 勇佑 ¹ , 丸山 美帆子 ¹ , 吉村 政志 ¹ , 杉山 成 ² , 1.阪大院工, 2.阪大院理, 3.創品, 4.立命大生科, 5.京安達 宏昭 ^{1,3} , 塚本 勝男 ¹ , 松村 浩由 ^{3,4} , 高野 和文 ⁵ , 府大院生環, 6.東工大院生理工, 7.埼玉大 3.5, 村上 聡 ^{3,6} , 井上 豪 ^{1,3} , 吉川 洋史 ^{1,7} , 森 勇介 ^{1,3}
14:00	奨 21p-W331-2	フォトニック結晶ナノレーザーでの電気化学センシング	○渡部 工 ¹ , 古田 祐樹 ¹ , 高橋 大智 ¹ , 長谷川 湧 ¹ , 1.横国大・院工 馬場 俊彦 ¹
14:15	奨 21p-W331-3	マイクロ流路内における生分解性粒子支援フェムト秒レーザー外来分子導入	○石井 敦浩 ¹ , 有安 和優 ¹ , 三橋 龍樹 ¹ , Dag Heinemann ² , Alexander Heisterkamp ^{2,3} , 寺川 光洋 ¹
14:30	奨 21p-W331-4	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での微小物体の高速ソーティング	○山川 健 ^{1,4} , 萩原 宏規 ^{1,4} , 飯野 敬矩 ^{1,4} , 田中 直樹 ^{2,4} , 1.奈良先端大物質, 2.東大院理, 3.UCLA, 4.JST 芝田 悠大 ^{2,4} , 野沢 泰祐 ^{2,4} , 磯崎 瑛宏 ^{2,4} , Dino Di Carlo ^{3,4} , 合田 圭介 ^{2,3,4} , 細川 陽一郎 ^{1,4}
14:45	21p-W331-5	レーザー走査光触媒リソグラフィを活用した液中細胞パターンニング	○(M1)藤城 翔偉 ¹ , 関根 浩平 ¹ , 河野 翔 ¹ , 池田 丈 ² , 1.早大理工, 2.広大先端研, 3.東北大学際研 黒田 章夫 ² , 山本 英明 ³ , 谷井 孝至 ¹
15:00	21p-W331-6	マイクロ流路作製のためのLPP EUV光によるPDMSの加工	○浦井 ひかり ¹ , 小川 瑞生 ¹ , 深見 慎太郎 ¹ , 鳥居 周一 ¹ , 牧村 哲也 ¹ , 中村 大輔 ² , 高橋 昭彦 ² , 岡田 龍雄 ² , 新納 弘之 ³
15:15	休憩/Break		
15:30	21p-W331-7	金属ナノ粒子を用いたレーザー直接描画法による3次元マイクロ構造体の形成	○渡辺 明 ¹ , 蔡 金光 ¹
15:45	21p-W331-8	Bull's Eye構造のプラズモニクチップを用いた蛍光標識ナノ粒子の蛍光顕微鏡観察	○泉 章太 ¹ , 細川 千絵 ² , 當麻 真奈 ¹ , 田和 圭子 ¹
16:00	21p-W331-9	遺伝変異フェリチンによる離散金ナノ粒子アレイ作製技術の構築	○信澤 和行 ¹ , 岡本 尚文 ² , Chong Karen Siew Ling ³ , 山下 一郎 ^{1,2}
16:15	21p-W331-10	汎用グリーンレーザーによるフッ素ポリマーの微細加工技術開発および水棲微生物観察用バイオチップ作製	○根本 佳祐 ¹ , 小川 達也 ¹ , 花田 修賢 ^{1,2}
16:30	21p-W331-11	集光フェムト秒レーザーを用いた単一細胞刺激による神経細胞ネットワークの活動特性	○中川 裕太 ^{1,2} , 工藤 卓 ² , 田口 隆久 ³ , 細川 千絵 ¹
16:45	21p-W331-12	物理ストレスを受けたミトコンドリアの力印加共焦点顕微鏡による活性酸素応答測定	○本田 諭志 ¹ , 李 永波 ¹ , 上田 雅 ¹ , 長崎 秀昭 ¹ , 1.農工大 岩見 健太郎 ¹ , 太田 善浩 ¹ , 梅田 倫弘 ¹
17:00	休憩/Break		
17:15	21p-W331-13	Measurement of Reactive Species for the Development of Plasma-on-Chip	○吳 準席 ^{1,2} , 小島 信也 ³ , 八田 章光 ^{1,2} , 佐々木 実 ³ , 1.Kochi Univ. Technol., 2.Center Nanotechnol., 3.Toyota Technol. Inst.
17:30	21p-W331-14	可視光照射によるバイオセンシング用銀ナノ構造基板の作製	○吉川 裕之 ¹ , 沈 正君 ¹ , 廣納 麻美 ¹ , 民谷 栄一 ¹
17:45	21p-W331-15	神経細胞表面のグルタミン酸受容体分子の初期集合状態に依存した光捕捉過程	○前澤 安代 ¹ , 岸本 龍典 ^{1,2} , 工藤 卓 ² , 田口 隆久 ³ , 1.産総研 バイオメディカル, 2.関西学院大 理工, 3.情通機構 脳情報 細川 千絵 ^{1,2}
18:00	21p-W331-16	界面レーザー捕捉による局所的タンパク濃度上昇・結晶化促進の顕微分光	○三浦 篤志 ^{1,2} , 吉松 泉 ² , 喜多村 昇 ^{1,2}
18:15	21p-W331-17	光発熱集合効果を用いた高速細菌数測定法の原理構築	○山本 靖之 ^{1,2} , 清水 恵美 ² , 西村 勇姿 ¹ , 床波 志保 ² , 1.阪大院理, 2.阪大院工 飯田 琢也 ¹
18:30	21p-W331-18	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での単一細胞の高速操作: 操作性の流速およびレーザー強度依存性	○萩原 宏規 ^{1,4} , 山川 健 ^{1,4} , 飯野 敬矩 ^{1,4} , 田中 直樹 ^{2,4} , 1.奈良先端大物質, 2.東大院理, 3.UCLA, 4.JST 芝田 悠大 ^{2,4} , 野沢 泰祐 ^{2,4} , 磯崎 瑛宏 ^{2,4} , Dino Di Carlo ^{3,4} , 合田 圭介 ^{2,3,4} , 細川 陽一郎 ^{1,4}
18:45	21p-W331-19	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたオープンチップ中の高速流体からの細胞分取	○飯野 敬矩 ^{1,3} , 山川 健 ^{1,3} , 萩原 宏規 ^{1,3} , 佐久間 臣耶 ^{2,3} , 早川 健 ^{2,3} , 益田 泰輔 ^{2,3} , 新井 史人 ^{2,3} , 細川 陽一郎 ^{1,3}
12.7 医用工学・バイオチップ / Biomedical Engineering and Biochips			
3/19(Sat.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場			
9:00	19a-W331-1	磁石回転によるField Cycle MRIの開発	○小林 竜馬 ¹ , 飯倉 淳 ² , 大久保 雄二 ³ , 梶原 秀則 ¹ , 1.九大レドックスナビ, 2.富士電機, 3.メイコー ² , 内海 英雄 ¹
9:15	19a-W331-2	グラフェンFETを用いた酵素反応計測とピロリ菌検出への応用	○小野 亮生 ¹ , 川田 拓哉 ¹ , 金井 康 ¹ , 大野 恭秀 ² , 1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大 前橋 兼三 ³ , 井上 恒一 ¹ , 松本 和彦 ¹
9:30	19a-W331-3	金属・微小空隙・絶縁体・半導体構造センシングデバイスの製作	○石丸 頌子 ¹ , 森田 美穂 ¹ , 川合 健太郎 ¹ , 有馬 健 ¹
9:45	19a-W331-4	化学蛍光法によるインフルエンザウイルスの光ファイバ型免疫測定に関する研究	○岸川 知里 ¹ , 鈴木 友梨香 ¹ , 齋藤 真奈 ² , 宮島 久 ¹ , 1.医科歯科大院, 2.文京学院大, 3.日本学術振興会, 4.医 美子 ³ , 當麻 浩司 ⁴ , 荒川 貴博 ⁴ , 下村 弘治 ² , 三 科歯科大生材研 林 浩二 ^{1,4}
10:00	奨 19a-W331-5	補酵素NADH減少のUV-LED励起蛍光検出によるアセトン用バイオセンサー(生化学式ガスセンサー)と呼吸ガス計測応用	○鈴木 卓磨 ¹ , 簡 伯任 ¹ , 叶 明 ² , 當麻 浩司 ² , 荒川 貴博 ² , 三林 浩二 ^{1,2}
10:15	19a-W331-6	コレステロール含有リポソームによるカンチレバーバイオセンサーのAβ検出感度の向上	○村上 祐樹 ¹ , 張子洋 ¹ , 谷口 智哉 ¹ , 寒川 雅之 ² , 1.京工織大, 2.新潟大 山下 馨 ¹ , 野田 実 ¹
10:30	休憩/Break		
10:45	19a-W331-7	蛍光分子封入リポソームセンサーによるアミロイドβタンパク質の検出	○今村 亮太 ¹ , 張子洋 ¹ , 島内 寿徳 ² , 村田 直樹 ¹ , 1.京都工織大, 2.岡山大 山下 馨 ¹ , 福澤 理行 ¹ , 野田 実 ¹
11:00	19a-W331-8	アレイデバイスによるリポソーム-タンパク質間相互作用の誘電分散解析	○川崎 雅大 ¹ , 吉川 知貴 ¹ , 張子洋 ¹ , 山下 馨 ¹ , 1.京工織大工芸 野田 実 ¹

11:15	奨	19a-W331-9	マイクロパターン表面を用いた培養神経回路の構造-機能制御	○山本 英明 ¹ 、石原 広識 ² 、河野 翔 ² 、千田 雄大 ³ 、1. 東北大学際研、2. 早大理工、3. 東北大通研、4. 東北大松村 亮祐 ⁴ 、平野 愛弓 ⁴ 、久保田 繁 ⁵ 、谷井 孝至 ² 、医工、5. 山形大理工 庭野 道夫 ³
11:30		19a-W331-10	細胞シートの電気抵抗を活用した神経細胞外計測の信号増強	○松村 亮祐 ^{1,4} 、山本 英明 ² 、平野 愛弓 ¹ 、庭野 道夫 ³ 1. 東北大院医工、2. 東北大学際研、3. 東北大通研、4. 学振 DCI
11:45		19a-W331-11	神経細胞ネットワークハイスループットスクリーニング装置に適したネットワーク構造の開発	○栗田 裕子 ¹ 、宇野 秀隆 ¹ 、王志宏 ¹ 、吉村 由美子 ¹ 1. 名古屋大学 グリーンモビリティ、2. 生理学研究所 2、小松 由紀夫 ² 、宇理須 恒雄 ¹
12:00	E	19a-W331-12	Fabrication of planar patch clamp chip by Bosch process and neuron network formation using this chip	○Zhihong Wang ^{1,2} 、Hidetaka Uno ^{1,2} 、Satoru Nakao ³ 、1.Nagoya Univ., 2.JST CREST、3.IIMS、4.Nagoya Univ., Noriko Takada ³ 、Masaki Aoyama ³ 、Mitsukazu Suzui ³ 、Engin., 5.Tohoku Univ. Yasushi Nakahara ⁴ 、Hirotoshi Sugiura ⁴ 、Takayuki Hasegawa ⁴ 、Fumihito Arai ⁴ 、Hideaki Yamamoto ⁵ 、 Tsuneo Urisu ^{1,2}
3/19(Sat.) 13:45 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場				
13:45		19p-W331-1	スマートフォン取付型センシングシステムによる溶液中グルコース濃度の電気化学的測定	○(B) 藤本 拓也 ¹ 、河原 翔梧 ¹ 、瀨上 幸男 ¹ 、下川 翔士 ¹ 、中村 瑛甫 ¹ 、深山 賢一 ¹ 、釜堀 政男 ² 、宇野 重康 ¹
14:00		19p-W331-2	スマートフォン取付型センシングシステムによるクロマトグラフィーペーパー酵素電極を用いたエタノールガスの電気化学的検出	○(B) 河原 翔梧 ¹ 、瀨上 幸男 ¹ 、下川 翔士 ¹ 、中村 瑛甫 ¹ 、呉竹 龍巳 ¹ 、釜堀 政男 ² 、宇野 重康 ¹
14:15		19p-W331-3	SPR・インピーダンス同時測定による生細胞モニタリングに向けた電気化学インピーダンス法の基礎検討	○(B) 吉崎 恭平 ¹ 、柳瀬 雄輝 ² 、宇野 重康 ¹
14:30		19p-W331-4	「ハ」の字型電極を用いた誘電泳動による1細胞送り出しシステム	○濱田 拓也 ¹ 、西元 稜太 ¹ 、須田 隆夫 ¹
14:45		19p-W331-5	非対称平面電極を用いた誘電泳動による白血球の分離 II	○濱田 昌也 ¹ 、須田 隆夫 ¹
15:00		19p-W331-6	CMOS チップ上微小流路に向けたクロマトグラフィーペーパーとシリコンによる流路作製	○(B) 山岡 克行 ¹ 、江口 潤 ¹ 、宇野 重康 ¹
15:15		19p-W331-7	クロマトグラフィーペーパー流路と CMOS バイオセンサチップの統合	○(B) 江口 潤 ¹ 、山岡 克行 ¹ 、宇野 重康 ¹
15:30		19p-W331-8	アレルギー検査用細胞分離マイクロチップの分離率評価	○小林 孝一郎 ¹ 、坂本 憲児 ¹ 、柳瀬 雄輝 ² 、秀 道広 ² 、三宅 亮 ³ 1. 九工大、2. 広大医、3. 東大院工
15:45			休憩 / Break	
16:00	奨	19p-W331-9	LSPR-TIRF 顕微鏡を用いた高分解能細胞イメージング	○(M1) 増田 志穂美 ¹ 、柳瀬 雄輝 ² 、白倉 英治 ³ 、岡本 晃一 ¹ 、玉田 薫 ¹ 1. 九州大学先導研、2. 広島大学、3. 名古屋大学
16:15		19p-W331-10	ポリドーパミン薄膜の表面プラズモン増強蛍光バイオセンサのタンパク質接着層への応用	○當麻 真奈 ¹ 、田和 圭子 ¹
16:30		19p-W331-11	血液型判定のための導波モードセンサ用マイクロ流路チップ	○芦葉 裕樹 ¹ 、藤巻 真 ¹ 、栗津 浩一 ¹ 、田中 寅彦 ² 、1. 産総研、2. 日大医 横島 誠 ²
16:45		19p-W331-12	酸化亜鉛プラズモニクチップを用いたサンドイッチ型高感度イムノセンシング	○田和 圭子 ¹ 、角谷 真詩 ¹ 、笹川 知里 ¹ 、筋野 拓馬 ¹ 、1. 関西学院大理工、2. 東北大工 2、中澤 光 ² 、梅津 光史 ²
17:00		19p-W331-13	分子鋳型ポリマー粒子を活用したポイントオブケア向け検査チップの検出下限濃度	○谷口 伸一 ¹ 、村瀬 敦郎 ² 、北山 雄己哉 ² 、竹内 俊文 ² 1. 日立研開、2. 神戸大院工
17:15	奨	19p-W331-14	分子インプリントポリマー修飾プラズモニクチップによるヒト血清アルブミンの高感度プラズモニクセンシング	○(M2) 松浦 亮 ¹ 、高野 恵里 ¹ 、田和 圭子 ² 、砂山 博文 ¹ 、北山 雄己哉 ¹ 、竹内 俊文 ¹
17:30	奨	19p-W331-15	分子鋳型インターフェイスを用いた糖鎖認識トランジスタの創製	○(M1) 西谷 象一 ¹ 、加治佐 平 ² 、坂田 利弥 ¹
17:45		19p-W331-16	分子鋳型ゲルゲート電界効果トランジスタの速度論的解析	○加治佐 平 ¹ 、坂田 利弥 ²
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場				
9:00	奨	20a-W331-1	人工視覚システム用 CMOS チップ内臓スマート電極デバイスの作製と動作実証	○(M1) 吉村 彰人 ¹ 、川崎 凌平 ¹ 、野田 俊彦 ¹ 、田代 洋行 ^{1,2} 、竹原 宏明 ¹ 、笹川 清隆 ¹ 、徳田 崇 ¹ 、太田 淳 ¹
9:15	奨	20a-W331-2	分散型アーキテクチャによる広範囲被覆可能な埋込型の光電気 BMI デバイス	○岩崎 聡 ¹ 、野口 知暉 ¹ 、竹原 宏明 ¹ 、野田 俊彦 ¹ 、1. 奈良先端大 笹川 清隆 ¹ 、徳田 崇 ¹ 、太田 淳 ¹
9:30	奨	20a-W331-3	複数の生体信号を同時計測可能な多用途生体信号計測システムの設計と評価	○伊藤 圭汰 ¹ 、谷 卓治 ¹ 、岩上 卓磨 ¹ 、宇野 正真 ¹ 、1. 東北大院工、2. 東北大工、3. 長崎総科大、4. 東北大院 後藤 竜也 ¹ 、竹澤 好樹 ² 、西野 悟 ³ 、清山 浩司 ³ 、 医工 田中 徹 ^{1,4}
9:45	奨	20a-W331-4	集積化脳神経プローブシステムの過熱保護用温度検出回路の設計	○西野 悟 ¹ 、谷 卓治 ² 、岩上 卓磨 ² 、伊藤 圭汰 ² 、1. 長崎総科大、2. 東北大院工、3. 東北大院医工、4. 東北 宇野 正真 ² 、後藤 竜也 ² 、竹澤 好樹 ⁴ 、清山 浩司 ¹ 、大工 田中 徹 ^{2,3}
10:00	奨	20a-W331-5	矩形波電流源を有したインピーダンス計測回路の設計	○岩上 卓磨 ¹ 、谷 卓治 ¹ 、伊藤 圭汰 ¹ 、宇野 正真 ¹ 、1. 東北大院工、2. 東北大工、3. 長崎総科大、4. 東北大院 後藤 竜也 ¹ 、竹澤 好樹 ² 、西野 悟 ³ 、清山 浩司 ³ 、 医工 田中 徹 ^{1,4}
10:15			休憩 / Break	
10:30		20a-W331-6	顕微 LSPR イメージングを用いた好中球の単一細胞解析	○(M2) 三田 大樹 ¹ 、西出 真之 ² 、堀井 拓真 ¹ 、吉川 裕之 ¹ 、高松 漂太 ² 、齋藤 真人 ¹ 、伊賀 光博 ³ 、 熊ノ郷 淳 ² 、民谷 栄一 ¹
10:45		20a-W331-7	ホルダ型ピエゾ抵抗カンチレバを用いたマウス受精卵質量測定	○網野 慶明 ¹ 、齋藤 暁子 ² 、高城 翔太 ¹ 、角田 一樹 ³ 、1. 群馬大院理工、2. 東京大院工、3. 群馬大工 保坂 純男 ¹ 、坂田 利弥 ² 、○曾根 逸人 ¹
11:00	奨	20a-W331-8	再生軟骨細胞基質産生測定に向けた硫酸化グリコサミノグリカン計測センサの創製	○佐竹 皓宇 ¹ 、齋藤 暁子 ¹ 、加治佐 平 ¹ 、水野 秀一 ² 、坂田 利弥 ¹
11:15	奨	20a-W331-9	CMOS イメージセンサを用いた培養細胞のオンチップ蛍光計測システム	○(M1) 大澤 和嵩 ¹ 、竹原 宏明 ¹ 、野田 俊彦 ¹ 、笹川 清隆 ¹ 、徳田 崇 ¹ 、太田 淳 ¹
11:30		20a-W331-10	広ダイナミックレンジ化を目指した基板電位制御可能なフィルタフリー蛍光検出センサ	○森脇 優 ¹ 、田中 清嗣 ¹ 、高橋 一浩 ^{1,2} 、岩田 達哉 ¹ 、1. 豊橋技科大、2. JST-CREST 1、秋田 一平 ¹ 、太斎 文博 ¹ 、木村 安行 ¹ 、石田 誠 ¹ 、 澤田 和明 ^{1,2}
11:45	奨	20a-W331-11	GABA とグルタミン酸のイメージングを目指した H ₂ O ₂ センサの開発	○(M1) 奥村 悠基 ¹ 、奥村 弘一 ^{1,2} 、岩田 達哉 ^{1,2} 、1. 豊橋技科大、2. 科学技術振興機構 石田 誠 ¹ 、澤田 和明 ^{1,2}

12:00	奨 20a-W331-12	ATP イメージセンサの出力特性に及ぼす酵素膜組成の影響	○(M2)土井 英生 ¹ 、堀尾 智子 ¹ 、岩田 達哉 ¹ 、奥 村 弘一 ¹ 、服部 敏明 ¹ 、石田 誠 ¹ 、澤田 和明 ¹	1. 豊橋技科大
3/20(Sun.) 13:45 - 15:45	口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場			
13:45	奨 20p-W331-1	応力センサ集積シリコン神経プローブの開発	○原島 卓也 ¹ 、谷 卓治 ¹ 、鈴木 雄策 ¹ 、森川 拓夷 ² 、木野 久志 ³ 、福島 誉史 ¹ 、田中 徹 ^{1,4}	1. 東北大院工、2. 東北大工、3. 東北大学際研、4. 東北大院医工
14:00	20p-W331-2	脳深部刺入可能なフレキシブルケーブル一体化シリコン神経プローブの開発	○森川 拓夷 ¹ 、谷 卓治 ² 、原島 卓也 ² 、鈴木 雄策 ² 、木野 久志 ³ 、福島 誉史 ² 、田中 徹 ^{2,4}	1. 東北大工、2. 東北大院工、3. 東北大学際研、4. 東北大院医工
14:15	20p-W331-3	高い電荷注入能力と低インピーダンス特性を持つ PEDOT/Pt-black マイクロ電極デバイスの神経刺激応用伸縮可能なフレキシブルバイオプローブ電極フィルムの製作	○(M1)山口 健太郎 ¹ 、田中 将徳 ¹ 、山際 翔太 ¹ 、澤畑 博人 ¹ 、沼野 利佳 ³ 、石田 誠 ^{1,2} 、河野 剛士 ¹	1. 豊橋技科大電、2. EIIRIS、3. 豊橋技科大環
14:30	奨 20p-W331-4	埋植型デバイスによる広範囲イメージングに向けた励起光除去性能改善	○須永 圭紀 ¹ 、春田 牧人 ¹ 、山口 貴大 ¹ 、桂木 優治 ¹ 、竹原 宏明 ¹ 、野田 俊彦 ¹ 、笹川 清隆 ¹ 、徳田 崇 ¹ 、太田 淳 ¹	1. 奈良先端大
15:00	奨 20p-W331-6	埋植型デバイスへの導入に向けたハイドロゲルの光学特性評価	○(M1)桂木 優治 ¹ 、須永 圭紀 ¹ 、竹原 宏明 ¹ 、野田 俊彦 ¹ 、笹川 清隆 ¹ 、徳田 崇 ¹ 、太田 淳 ¹	1. 奈良先端大
15:15	20p-W331-7	唾液グルコース計測のための BLE 無線通信式マウスガード型バイオセンサに関する研究	仁田 大輝 ¹ 、○荒川 貴博 ² 、當麻 浩司 ² 、竹内 周平 ³ 、関田 俊明 ³ 、岩崎 泰彦 ⁴ 、水口 俊介 ³ 、三林 浩二 ^{1,2}	1. 医科歯科大院、2. 医科歯科大生材研、3. 医科歯科大歯学部、4. 関西大化生工
15:30	20p-W331-8	化学駆動式の薬物放出システムを用いたグルコース濃度の自律制御に関する研究	○森 大典 ¹ 、栗原 康司 ² 、ムンフジャルガル ムンフバヤル ³ 、當麻 浩司 ³ 、荒川 貴博 ³ 、矢野 和義 ¹ 、三林 浩二 ^{2,3}	1. 東京工科大、2. 医科歯科大院、3. 医科歯科大生材研
3/20(Sun.) 16:00 - 18:00	ポスター講演 (Poster Presentation) P12 会場			
	20p-P12-1	地形的なパターンによる筋芽細胞 C2C12 の運動への影響	○奥谷 智裕 ¹ 、我妻 玲 ¹ 、米谷 玲皇 ² 、満洲 邦彦 ¹ 、星野 隆行 ¹	1. 東大院情理、2. 東大院工
	20p-P12-2	一細胞レベルでのエクソソーム解析に向けたマイクロ流体デバイスの開発	○(M1)筒井 敬悟 ¹ 、Espulgar Wilfred Villariza ¹ 、齋藤 真人 ¹ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大院工
	20p-P12-3	水晶振動子上にプラズマ開始重合で形成した分子インプリントポリマー膜を用いるヘパリンセンサ	○有田 智彦 ¹ 、六車 仁志 ¹ 、吉見 靖男 ¹	1. 芝浦工大
	20p-P12-4	長尺カーボンナノチューブを用いる夾雑物質存在下でのニコチンアミドアデニンジスクレオチドの選択的電気化学検出	○岡崎 優太 ¹ 、井上 佑紀 ¹ 、六車 仁志 ¹ 、井上 均 ² 、大澤 達也 ²	1. 芝浦工大、2. 日本資材
	20p-P12-5	フォトニック結晶ナノレーザセンサを用いた統合失調症関連タンパク質 CRMP1 の検出	○古田 祐樹 ¹ 、野本 宗孝 ² 、五嶋 良郎 ² 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大、2. 横浜市大
	20p-P12-6	Filter-free fluorescence sensor with high performance by the surface planarization of polysilicon photogate	○(D)Yongjoon Choi ¹ 、Kazuhiro Takahashi ¹ 、Motoharu Matsuda ¹ 、Ken Hizawa ¹ 、Yu Moriwaki ¹ 、Fumihiko Dasai ¹ 、Yasuyuki Kimura ¹ 、Ipppei Akita ¹ 、Tatsuya Iwata ¹ 、Kazuaki Sawada ¹ 、Makoto Ishida ¹	1. Toyohashi Univ.
E	20p-P12-7	Development of a patterning technique for enzyme-immobilized membranes using cross-linkable polymer	○(DC)Lee Youna ¹ 、Tomoko Horio ¹ 、Koichi Okumura ^{1,2} 、Tatsuya Iwata ^{1,2} 、Kazuhiro Takahashi ^{1,2} 、Makoto Ishida ^{1,2} 、Kazuaki Sawada ^{1,2}	1. Toyohashi Univ.、2. EIIRIS
	20p-P12-8	差動 Si リング光共振器センサー温度特性のばらつき評価	○横山 脩平 ¹ 、谷口 智哉 ¹ 、雨宮 嘉照 ¹ 、池田 丈 ^{2,1} 、黒田 章夫 ^{2,1} 、横山 新 ¹	1. 広島大ナノデバ、2. 広島大分子生命
E	20p-P12-9	Pressure-free nanoimprinting at room temperature for plasmonic biosensors	○Shu Jiang ¹ 、Masato Saito ¹ 、Eiichi Tamiya ¹	1. Osaka Univ.
	20p-P12-10	差動 Si リングバイオセンサーの検出原理の検証	○谷口 智哉 ^{1,2} 、横山 脩平 ^{1,2} 、雨宮 嘉照 ¹ 、池田 丈 ^{3,1} 、黒田 章夫 ^{3,1} 、横山 新 ^{1,2}	1. 広島大ナノデバイス・バイオ融合科学研、2. 先端研究科半導体集積科学専攻、3. 分子生命機能科学専攻
E	20p-P12-11	A fluorescence imaging device with a portable system for detection of nitric oxide	○(D)Anek Wuthayavanich ¹ 、Makito Haruta ¹ 、Hiroaki Takehara ¹ 、Toshihiko Noda ¹ 、Kiyotaka Sasagawa ¹ 、Takashi Tokuda ¹ 、Jun Ohta ¹	1. Nara Inst. of Sci. and Tech.
	20p-P12-12	生体親和性酸化亜鉛ナノ粒子への金担持と光学特性	飯塚 真理 ¹ 、○藤井 政俊 ¹ 、橋本 英樹 ² 、藤田 恭久 ³	1. 島根大、2. 島根大戦略的研究推進センター、3. 島根大院総合理工
	20p-P12-13	細胞 / グラフェンゲートトランジスタにおける表面化学修飾の影響	○(M1)西 七津紀 ¹ 、西村 光太郎 ¹ 、津島 幸平 ¹ 、曾田 将来 ¹ 、陳 嘯 ¹ 、村上 剛浩 ¹ 、宮澤 雄弥 ² 、加治 佐平 ² 、加藤 大 ³ 、米谷 玲皇 ¹ 、千足 昇平 ¹ 、丸山 茂夫 ¹ 、坂田 利弥 ¹	1. 東大工、2. (株)PROVIGATE、3. 東大薬
	20p-P12-14	ファージディスプレイ法を用いた抗 3- (1-ナフトイル) インドール誘導体抗体の作製と評価	○田中 真司 ¹ 、中山 浩 ¹ 、村岡 仁 ¹ 、吉田 麻衣子 ³ 、村上 明一 ²	1. パナソニック先技本、2. 琉大医研、3. 抗工研セ
奨 E	20p-P12-15	Study on specific monitoring of histamine for allergy test	○(M2)Haoyue Yang ¹ 、Akiko Saito Saito ¹ 、Taira Kajisa Kajisa ² 、Yuki Yanase ³ 、Toshiya Sakata ¹	1. School of Engineering, Univ. of Tokyo、2. PROVIGATE Inc.、3. Graduate School of Biomedical and Health Sciences, Hiroshima Univ.
	20p-P12-16	高次ナノ構造体を用いた微量分子検出	○山口 明啓 ¹ 、福岡 隆夫 ¹ 、内海 裕一 ¹	1. 兵庫県大
	20p-P12-17	電気泳動の分子篩いと DNA 一塩基の分離分析	○山口 佳則 ^{1,2} 、寶 暁鳴 ¹	1. 華東理工大院理、2. 阪大院工
	20p-P12-18	高感度ガス分析装置を利用した呼吸検査システムのソフトウェア解析	○樺澤 匠 ¹ 、東城 裕樹 ¹ 、鶴岡 誠 ¹	1. 東京工科大
奨	20p-P12-19	血漿分離のための血球沈降孔の形状最適化	○(DC)黒田 千愛 ¹ 、大木 義隆 ^{1,2} 、芦葉 裕樹 ³ 、藤巻 真 ³ 、粟津 浩一 ³ 、田中 寅彦 ⁴ 、横島 誠 ⁴	1. 早大先進理工、2. 早大材研、3. 産総研、4. 日大医
	20p-P12-20	光ピックアップ型 ELISA 用抗体修飾チップと小型測定システムの構築	○吉川 裕之 ¹ 、芳永 真 ¹ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大院工
	20p-P12-21	遺伝子情報計測における蛍光標識物質の影響	○山崎 勇樹 ¹ 、古家 竜之輔 ¹ 、奥脇 聖史 ¹ 、湯沢 友之 ¹ 、鶴岡 誠 ¹	1. 東京工科大
E	20p-P12-22	Study on peptide-functionalized single-walled carbon nanotube field effect transistor for aptasensor	○Tung Thanh Nguyen ¹ 、Trong Tue Phan ¹ 、Thi Ngoc Lien Truong ² 、Yasuhide Ohno ³ 、Kenzo Maehashi ⁴ 、Kazuhiko Matsumoto ⁵ 、Manish Biyani ¹ 、Yuzuru Takamura ¹	1. Japan Advanced Inst. of Sci. and Tech.、2. HUST、3. Tokushima Univ.、4. Tokyo Univ. Agr. Tech.、5. Osaka Univ. ISIR
	20p-P12-23	フォトニック結晶ナノレーザによる DNA の高感度検出	○長谷川 湧 ¹ 、渡部 工 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大院工
	20p-P12-24	GaNAsP 半導体イメージングプレートによる様々な細胞イメージング	○酒本 真衣 ¹ 、景山 達斗 ¹ 、福田 淳二 ¹ 、馬場 俊彦 ¹	1. 横国大・院工
	20p-P12-25	プレーナーパッチクランプによる単一細胞解析 - 細胞内容物の抽出と mRNA の定量解析 -	○宇野 秀隆 ^{1,3} 、王 志宏 ^{1,3} 、石垣 診祐 ^{2,3} 、浮田 芳昭 ^{3,4} 、高村 禰 ^{3,5} 、宇理須 恒雄 ^{1,3}	1. 名大 グリモ、2. 名大医、3. JST-CREST、4. 山梨大、5. 北陸先端大

奨	20p-P12-26	ウイルス検出のための糖鎖機能化グラフェン FET の修飾糖鎖の検討	○林 亮太 ¹ 、小野 亮生 ¹ 、金井 康 ¹ 、大野 恭秀 ^{1,2} 、前橋 兼三 ^{1,3} 、井上 恒一 ¹ 、渡邊 洋平 ⁴ 、河原 敏男 ⁵ 、5. 中部大、6. 香川大 鈴木 康夫 ⁵ 、中北 慎一 ⁶ 、松本 和彦 ¹	1. 阪大産研、2. 徳島大、3. 東京農工大、4. 京都府立医大、	
	20p-P12-27	溶解材を用いたシリコンウイスカ神経電極の実装技術と in vivo 評価	○テオ ドンシュン ¹ 、澤畑 博人 ¹ 、山際 翔太 ¹ 、守谷 愛理 ¹ 、大井 英生 ¹ 、安東 頼子 ¹ 、沼野 利佳 ¹ 、石田 誠 ¹ 、鯉田 孝和 ¹ 、河野 剛士 ¹	1. 豊橋技科大	
	20p-P12-28	倒立型電子線描画を用いた細胞膜電穿孔現象	○吉岡 基 ¹ 、宮廻 裕樹 ¹ 、我妻 玲 ¹ 、満洲 邦彦 ¹ 、星野 隆行 ¹	1. 東大情理	
	20p-P12-29	Low temperature solution-processed lead-zirconium-titanate thin film actuator for highly integrated biochip	○(P)TUE TRONG PHAN ^{1,2} 、Reiji Shimura ^{1,2} 、Yuki Tagashira ¹ 、Yoshiaki Ukita ^{2,3} 、Keisuke Satou ⁴ 、Kazuhiro Fukada ^{1,2} 、Tatsuya Shimoda ^{1,2} 、Yuzuru Takamura ^{1,2}	1.JAIST、2.JST-CREST、3.Yamanashi Uni.、4.JSR	
	20p-P12-30	エレクトロスピンニング法を用いた血液凝固性ナノファイバー	○(B)高橋 圭佑 ¹ 、朴 駿容 ² 、白鳥 世明 ²	1. 慶大理工、2. 慶大院理工	
	20p-P12-31	フローサイトメトリーを用いた抗 CD3 抗体 -CdSe/ZnS 量子ドット 結合体の生細胞内への導入効率評価	○宇高 光 ¹ 、福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、鈴木 美穂 ¹	1. 埼玉大院理工	
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場					
9:00	奨	21a-W331-1	マイクロフルイディクスを用いた BEAMing 法の基礎検討	○山脇 幸也 ¹ 、川本 泰子 ¹ 、中野 毅 ¹ 、田川 礼人 ¹	1. シスメックス 中央研
9:15	奨	21a-W331-2	遠心熱対流 PCR の流体解析と薬剤耐性遺伝子の迅速検出	○高橋 和也 ¹ 、齋藤 真人 ¹ 、山本 倫久 ² 、明田 幸宏 ² 、朝野 和典 ³ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大院工、2. 阪大微研、3. 阪大院医
9:30		21a-W331-3	熱対流制御によるイムノアッセイの迅速化検討	○田所 達郎 ¹ 、齋藤 真人 ¹ 、民谷 栄一 ¹	1. 阪大工
9:45	奨	21a-W331-4	自己制御型遠心流体デバイスにおける自動液体置換機構の検討	○岡本 俊哉 ¹ 、浮田 芳昭 ¹	1. 山梨大工
10:00	奨	E 21a-W331-5	Chemical synthesis of oligonucleotides using mild reagents aiming to tag synthesis on-chip for single cell analysis with positional information	○(P)Rahul Bhardwaj ^{1,2} 、Yuzuru Takamura ^{1,2}	1.Japan Advanced Institute of Science and Technology、2.Japan Science and Technology、CREST
10:15		21a-W331-6	銀ナノ粒子を用いた電気化学免疫センサの開発	○堀 信康 ¹ 、近江 みゆき ² 、桐村 浩哉 ¹ 、高村 禪 ²	1. シスメックス、2.JAIST
10:30			休憩 / Break		
10:45		21a-W331-7	マイクロ血球分離フィルタに関する研究	○加藤 拓真 ¹	1. 阪大工
11:00		21a-W331-8	2 液接触界面領域で生じるフィブリン網の分子透過性観察	○井上 鈴代 ¹ 、林 勝義 ¹ 、岩崎 弦 ¹ 、瀬山 倫子 ¹ 、小泉 弘 ¹	1. NTT先端集積デバイス研究所
11:15		21a-W331-9	マイクロ流路を用いたナノ粒子の 1 粒子マルチパラメーター解析 -濃度定量測定- の検討	○鬼柳 知 ¹ 、赤木 貴則 ¹ 、一木 隆範 ¹	1. 東大院工
11:30		21a-W331-10	AFM 測定を容易にする細胞外ベシクル分析用マイクロ流体デバイスの開発	○住川 元延 ¹ 、倉持 宏実 ¹ 、赤木 貴則 ¹ 、一木 隆範 ^{1,2}	1. 東大工、2. ナノ医療イノベーション
11:45		21a-W331-11	共有結合による基板上へのタンパク質の自発的固定化技術の開発	○若井 涼 ¹ 、上野 真吾 ^{1,2} 、一木 隆範 ^{1,2}	1. 東大工、2. ナノ医療イノベーションセンター
12:00		21a-W331-12	エクソソームの選択的分離に向けたマイクロフリーフロー電気泳動デバイスの開発	○久保田 涼介 ¹ 、一木 隆範 ^{1,2}	1. 東大院工、2. ナノ医療イノベーションセンター

13 半導体 / Semiconductors

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

13.1 Si 系基礎物性・表面界面・シミュレーション / Fundamental properties, surface and interface, and simulations of Si related materials

3/19(Sat.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場					
9:00		19a-S223-1	次世代 TCAD(1) 複数デバイスと回路の強連成による一括解析	○原田 昌紀 ¹ 、桑原 匠史 ¹ 、大倉 康幸 ¹ 、山口 憲 ¹ 、小池 秀耀 ¹	1. アドバンスソフト
9:15		19a-S223-2	次世代 TCAD(2) 3 次元デバイスシミュレータによる 5 段 CMOS インバータチェーンの一括過渡解析	○萩原 敦 ¹ 、原田 昌紀 ¹ 、桑原 匠史 ¹ 、大倉 康幸 ¹ 、山口 憲 ¹ 、小池 秀耀 ¹	1. アドバンスソフト (株)
9:30		19a-S223-3	次世代 TCAD(3) 3 次元デバイスシミュレータを用いた並列計算	○桑原 匠史 ¹ 、大倉 康幸 ¹ 、山口 憲 ¹ 、小池 秀耀 ¹	1. アドバンスソフト
9:45		19a-S223-4	次世代 TCAD(4) モンテカルロイオン注入の畳み込み積分法の検討	○大倉 康幸 ¹ 、山口 憲 ¹ 、小池 秀耀 ¹	1. アドバンスソフト
10:00		19a-S223-5	超低電圧駆動フィン型 SRAM のためのナノ OPC 製造考慮設計計算機シミュレーション	○門田 和也 ¹	1. ナノサイエンスラボ
10:15		19a-S223-6	遠くに飛んだデルタ線によるソフトエラーに対するスクエリングの効果	○淵田 紳平 ^{1,2} 、小林 大輔 ^{1,2} 、廣瀬 和之 ^{1,2}	1. 東大院工、2. 宇宙研
10:30	奨	19a-S223-7	二光子吸収過程を用いたレーザーによるソフトエラーシミュレーションの焦点位置依存性の数値解析	○井辻 宏章 ^{1,2} 、小林 大輔 ^{1,2} 、廣瀬 和之 ^{1,2}	1. 東大院工、2.JAXA 宇宙研
10:45			休憩 / Break		
11:00		19a-S223-8	Source/Drain 領域のバンドギャップ制御による SOI-MOSFET の寄生バイポーラ効果の抑制	○(M1)和田 雄友 ¹ 、山本 航汰 ¹ 、高橋 芳浩 ¹ 、呉 研 ¹	1. 日大理工
11:15	奨	19a-S223-9	横型 Tunnel FET の閾値状態の定義についての考察	○森 義暁 ¹ 、佐藤 伸吾 ¹ 、大村 泰久 ¹	1. 関西大
11:30		19a-S223-10	ニューラルネットワークを用いたナノデバイス特性の機械学習	○古林 せなみ ¹	1. 早大
11:45	奨	19a-S223-11	サブ 10nm チャネル長 Si ナノワイヤ MOSFET の量子輸送シミュレーション	○平井 佑昂 ¹ 、土屋 英昭 ¹ 、小川 真人 ¹	1. 神戸大工
12:00		19a-S223-12	単原子層半導体における局在不純物の電子輸送特性への影響	○五十嵐 玲太 ¹	1. 筑波大理工
12:15		19a-S223-13	分子動力学法による低熱伝導率 SiGe 構造の探索	○高橋 憲彦 ¹ 、金田 千穂子 ¹	1. 富士通研
3/19(Sat.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P2 会場					
		19p-P2-1	大気中アンモニアを施した β -FeSi ₂ バルク単結晶の PL 特性 (2)	○(B)小林 治哉 ¹ 、佐藤 桂輔 ¹ 、中岡 鑑一郎 ¹ 、原 嘉昭 ¹	1. 茨城高専
		19p-P2-2	Ge コア Si 量子ドットの発光メカニズム	○近藤 圭悟 ¹ 、池田 弥央 ¹ 、牧原 克典 ¹ 、宮崎 誠一 ¹	1. 名大院工
		19p-P2-3	電子テンション密度を用いた局所電気伝導特性の解析	○瀬波 大土 ¹ 、埜崎 寛雄 ¹ 、市川 和秀 ¹ 、立花 明知 ¹	1. 京大工
		19p-P2-4	STI 型 ULSI 素子の転位蓄積に伴う電気特性変化 (3)	○米窪 駿 ¹ 、嵐 祥吾 ² 、佐藤 満弘 ² 、山口 憲 ³ 、丸 泉 琢也 ¹	1. 東京都市大工、2. 北見工大工、3. アドバンスソフト
		19p-P2-5	スーパー接合構造を持つ SBCD の逆回復特性シミュレーション	○(M1)對馬 広隆 ¹ 、工藤 嗣友 ² 、菅原 文彦 ¹	1. 東北学院大工、2. 神奈川工科大

3/19(Sat) 15:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場				
15:30	19p-S223-1	ランダム行列フォノンモデルに基づく NEGF シミュレーション	美里劫 夏南 ¹ 、○森 伸也 ¹	1. 阪大工
15:45	19p-S223-2	フォノン輸送シミュレーションにおける境界条件の影響	上野 晃弘 ¹ 、小池 慎治 ¹ 、○森 伸也 ¹	1. 阪大工
16:00	19p-S223-3	Ge コア Si 量子ドットにおける Ge コアサイズが PL 特性に及ぼす影響	○(B) 山田 健太郎 ¹ 、近藤 圭悟 ¹ 、池田 弥央 ¹ 、牧 原 克典 ¹ 、宮崎 誠一 ¹	1. 名大院工
16:15	19p-S223-4	誘電率ミスマッチによる高ドーブ Si 薄膜中の不純物のイオン化エネルギー上昇の解析	○田中 貴久 ¹ 、高橋 綱己 ¹ 、内田 建 ¹	1. 慶應大理工 電子工
16:30	奨 19p-S223-5	走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた dC/dV と dC/dz 測定によるキャリア濃度の定量化に関する研究	○劉 彬 ¹ 、平永 良臣 ¹ 、茅根 慎通 ¹ 、長 康雄 ¹	1. 東北大学
16:45	奨 19p-S223-6	Ar/H ₂ 熱処理による Si(100) 表面の原子レベル平坦化に関する検討	○(D) 工藤 聡也 ¹ 、大見 俊一郎 ¹	1. 東工大
17:00	19p-S223-7	シリコン酸化膜熱脱離によるボイド内リング構造形成の雰囲気依存性	○遠田 義晴 ¹ 、長内 翔大 ¹ 、小笠原 崇仁 ¹	1. 弘大院理工
17:15	19p-S223-8	SiO ₂ /Si 界面層付近での水素分子の凝集現象の解析	○加藤 弘一 ¹ 、福谷 克之 ¹	1. 東大生産研
17:30	19p-S223-9	半導体プロセスのための人工知能融合吸着シミュレータの開発	○佐藤 絵美 ¹ 、佐藤 愛美 ¹ 、小原 幸子 ¹ 、稲葉 賢二 ¹ 、石澤 由紀江 ¹ 、宮野 正之 ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、畠山 望 ¹ 、宮本 明 ¹ 、パトリック ボノー ¹	1. 東北大学
17:45	19p-S223-10	70°C希塩酸水溶液中におけるフィルターの除粒子性能評価	○高倉 知征 ¹ 、都築 修一 ¹	1. 日本ボール
13.2 探索的材料物性・基礎物性 / Exploratory Materials, Physical Properties, Devices				
3/20(Sun.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P13 会場				
	20p-P13-1	イオンビームスパッタ蒸着法を用いた高品位 Er ₂ O ₃ 薄膜の作製	○藤田 将弥 ^{1,2} 、朝岡 秀人 ² 、山口 憲司 ²	1. 茨城大学, 2. 原子力機構
奨	20p-P13-2	不純物を添加した溶融マグネシウムシリサイド結晶の耐酸化性	○(B) 今野 嵩 ¹ 、大坪 翼 ¹ 、中野 浩平 ¹ 、鶴殿 治彦 ¹	1. 茨城大工
	20p-P13-3	短時間熱拡散で作製した Mg ₂ Si-pn 接合ダイオードの電気・光学特性	○鬼沢 雄馬 ¹ 、堀 信彦 ¹ 、秋山 智洋 ¹ 、江坂 文孝 ² 、鶴殿 治彦 ¹	1. 茨城大工, 2. 原子力機構
奨	20p-P13-4	垂直ブリッジマン法で成長した高純度 Mg ₂ Si 結晶の結晶性評価	○(B) 中野 浩平 ¹ 、大坪 翼 ¹ 、今野 嵩 ¹ 、鶴殿 治彦 ¹	1. 茨城大工
	20p-P13-5	CaSi ₂ をテンプレートとしたクエン酸、リンゴ酸及び EDTA 溶液処理による Si 系ナノ構造物の作製	○熊澤 佑貴 ¹ 、佐々木 謙太 ² 、孟 祥 ³ 、袁 佩玲 ³ 、立岡 浩一 ²	1. 静岡大工, 2. 静岡大院工, 3. 静岡大院創造
	20p-P13-6	AgNO ₃ /HF 溶液の繰り返し処理によるシリコンワイヤの作製	○中山 誠 ¹ 、鈴木 崇倫 ¹ 、立岡 浩一 ¹	1. 静大院工
	20p-P13-7	β-FeSi ₂ /Si ヘテロエピタキシャル構造のイオンチャネリング	○前田 佳均 ¹ 、寺井 慶和 ¹ 、鳴海 一雅 ²	1. 九工大, 2. 原子力機構
	20p-P13-8	β-FeSi ₂ エピタキシャル膜における直接遷移エネルギーの成長温度依存性	○塚本 裕明 ¹ 、飯沼 元輝 ² 、山口 陽己 ¹ 、村社 尚紀 ² 、山崎 一輝 ² 、寺井 慶和 ^{1,2}	1. 鹿児島大理工, 2. 九工大情報工
	20p-P13-9	スパッタリング法で作製した β-FeSi ₂ 多結晶薄膜内の不純物濃度分析	○服部 哲 ¹ 、東 貴彦 ¹ 、池田 修哉 ² 、扇 和也 ² 、寺井 慶和 ^{1,2}	1. 鹿児島大理工, 2. 九工大情報工
	20p-P13-10	シリサイド系半導体材料 BaSi ₂ を用いた Si ベースヘテロ接合太陽電池の作製	○塚原 大地 ¹ 、武内 大樹 ¹ 、Weijie Du ¹ 、高部 涼太 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、宇佐美 徳隆 ² 、末益 崇 ¹	1. 筑波大院, 2. 名古屋大
	20p-P13-11	RF スパッタリング法による多結晶 BaSi ₂ 薄膜の形成	○横山 晟也 ¹ 、沼田 雅実 ² 、倉持 豪人 ² 、都甲 薫 ¹ 、末益 崇 ¹	1. 筑波大院, 2. 東ソー株式会社
	20p-P13-12	スパッタ法による窒素ドーブ FeSi ₂ 薄膜の作製とその電気特性	○馬場 隆司 ¹ 、岸本 純宗 ¹ 、○吉武 剛 ¹	1. 九州大学総理工
	20p-P13-13	p 型 InP および GaN 中の最近接ホッピング伝導に対するホール因子	○梶川 靖友 ¹	1. 島根大総理工
	20p-P13-14	Mn ドーブ GaAs 中の最近接ホッピング伝導に対するホール因子	○梶川 靖友 ¹	1. 島根大総理工
3/21(Mon.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場				
9:00	招 21a-S223-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) Si(111) 基板上 BaSi ₂ エピタキシャル膜の双晶粒界に対する第一原理計算	○馬場 正和 ¹ 、香山 正憲 ² 、都甲 薫 ¹ 、末益 崇 ^{1,3}	1. 筑波大院数理, 2. 産総研電池技術, 3. JST-CREST
9:15	E 21a-S223-2	Defect Physics in BaSi ₂ absorber	○(PC) Mukesh Kumar ¹ , Naoto Umezawa ¹ , Motoharu Imai ¹	1. Nat Inst. for Mat Sci
9:30	21a-S223-3	硬 X 線光電子分光法による a-Si/BaSi ₂ のバンドアライメント測定	○高部 涼太 ¹ 、武内 大樹 ¹ 、Du Weijie ¹ 、伊藤 啓太 ^{1,2,3} 、都甲 薫 ¹ 、上田 茂典 ⁴ 、木村 昭夫 ⁵ 、末益 崇 ¹	1. 筑波大, 2. 日本学術振興会, 3. 東北大, 4. NIMS, 5. 広島大
9:45	21a-S223-4	a-Si 層挿入による表面電極/BaSi ₂ 間の接触抵抗低減	○谷内 卓 ¹ 、武内 大樹 ¹ 、高部 涼太 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、末益 崇 ^{1,2}	1. 筑波大学, 2. JST-CREST
10:00	21a-S223-5	BaSi ₂ 薄膜太陽電池における p 型エミッタ層材料の探索	○(B) 高橋 一真 ¹ 、中川 慶彦 ¹ 、原 康祐 ² 、黒川 康良 ¹ 、宇佐美 徳隆 ¹	1. 名大院工, 2. 山梨大クリスタル研
10:15	奨 21a-S223-6	光電子分光による Cr 添加 AlN のバンド構造の研究	○(M1) 立溝 信之 ¹ 、園田 早紀 ¹ 、山根 宏之 ² 、田中 清尚 ²	1. 京都工繊大, 2. 分子研
10:30	奨 21a-S223-7	Mo ₆ クラスタ錯体化合物の電子構造と組成の相関性	○(D) 齋藤 典生 ^{1,2,3} 、コーディエ ステファン ^{4,5} 、和田 芳樹 ^{2,3} 、大澤 健男 ^{2,3} 、ルモワンス ビエリック UMR6226, 5. 仏レンズ第一大, 6. 仏 UMI3629, 7. 東工大 ^{4,5} 、グラスセ ファビアン ^{2,6} 、クロス S. ジェフリー ¹ 、元素大橋 直樹 ^{2,3,7}	1. 東工大, 2. 物・材機構, 3. NIMS-サンゴパン COE, 4. 仏
10:45		休憩/Break		
11:00	21a-S223-8	磁性 AFM 探針を用いた Fe ₃ Si ナノドットの電子輸送特性評価	○(DC) 張 海 ¹ 、満行 優介 ¹ 、牧原 克典 ¹ 、池田 弥央 ¹ 、大田 晃生 ¹ 、宮崎 誠一 ¹	1. 名古屋大学
11:15	21a-S223-9	Fe/FeSi ₂ /Fe ₃ Si スピンバルブ素子の作製と評価	○中嶋 一敬 ¹ 、石橋 和也 ¹ 、堺 研一郎 ² 、○吉武 剛 ¹	1. 九州大学総理工, 2. 久留米高専
11:30	21a-S223-10	ナノアモルファス層状窒化炭素の光学的性質における非晶質性	○山本 淳司 ¹ 、平井 正明 ² 、安井 望 ² 、財部 健一 ² 、松石 清人 ¹	1. 筑波大数物, 2. 岡山理大
11:45	21a-S223-11	VLS 成長法による Si 基板上への Ga 添加 ZnO ナノワイヤの作製	○中根 孝弥 ¹ 、井川 翔太 ¹ 、石山 武 ¹	1. 豊技大
12:00	21a-S223-12	半導体デバイス型水素センサの動作機構の研究	○色川 芳宏 ¹	1. 物材機構
12:15	奨 21a-S223-13	Pseudo-MOS を使った SOI 基板の ac 解析手法の検討	○鎌田 勲 ¹ 、佐藤 伸吾 ¹ 、大村 泰久 ¹	1. 関西大

3/21(Mon.) 13:30 - 18:00		口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場	
13:30	21p-S223-1	Ba _{1-x} Sr _x Si ₂ の電子構造	○今井 基晴 ¹ 、Kumar Mukesh ² 、梅澤 直人 ¹ 1. 物材機構
13:45	21p-S223-2	アンドープ BaSi ₂ 蒸着膜へのポストアニール効果	○須原 貴道 ^{1,2} 、村田 晃一 ² 、Navabi Aryan ² 、Che Xiaoyu ² 、中川 慶彦 ¹ 、原 康祐 ³ 、黒川 康良 ¹ 、未益 崇 ⁴ 、Wang Kang L. ² 、宇佐美 徳隆 ¹ 1. 名古屋大、2.UCLA、3. 山梨大、4. 筑波大
14:00	21p-S223-3	高速成膜による BaSi ₂ 蒸着膜の構造・特性変化	○原 康祐 ¹ 、Trinh Thi Cham ² 、黒川 康良 ² 、有元 圭介 ¹ 、山中 淳二 ¹ 、中川 清和 ¹ 、未益 崇 ³ 、宇佐美 徳隆 ² 1. 山梨大クリスタル研、2. 名大院工、3. 筑波大院数理工
14:15	21p-S223-4	Na 内包 II 型 Ge クラスレート膜の表面処理および物性評価	○杉井 南斗 ¹ 、萬條 宏行 ¹ 、向井 哲也 ¹ 、曾根 和詩 ¹ 、大橋 史隆 ¹ 、飯田 民夫 ² 、久米 徹二 ¹ 、ヒマンシュ シャカール ジャ ¹ 、野々村 修一 ¹ 1. 岐阜大工、2. 岐阜高専
14:30	21p-S223-5	半導体ナノスケール構造欠陥中の光キャリア寿命と欠陥準位密度	○福本 恵紀 ¹ 、恩田 健 ² 、腰原 伸也 ² 1. 高エネ研、2. 東工大
14:45	E 21p-S223-6	Photoresponse property of BaSi ₂ film grown on Si substrate by vacuum evaporation	○(P)Cham Thi Trinh ¹ 、Yoshihiko Nakagawa ¹ 、Kosuke O. Hara ² 、Ryota Takabe ³ 、Takashi Suemasu ³ 、Noritaka Usami ¹ 1.Nagoya Univ、2.Univ. of Yamanashi、3.Univ. of Tsukuba
15:00	E 21p-S223-7	Minority-carrier lifetime of BaSi ₂ formed on various multicrystalline Si substrates	○YUNPENG LI ¹ 、Cham Thi Trinh ² 、Ryota Takabe ¹ 、Kaoru Toko ¹ 、Takashi Sekiguchi ³ 、Noritaka Usami ² 、Takashi Suemasu ¹ 1.Univ. Tsukuba、2.Nagoya Univ.、3.NIMS
15:15	21p-S223-8	偏光ラマンスペクトル測定による BaSi ₂ の分子振動モード解析	○山口 陽己 ¹ 、村社 尚紀 ² 、山崎 一輝 ² 、尾方 済人 ¹ 、塚本 裕明 ¹ 、未益 崇 ³ 、寺井 慶和 ^{1,2} 1. 鹿児島大理工、2. 九工大情報工、3. 筑波大数理工
15:30	休憩/Break		
15:45	21p-S223-9	Si 基板上的歪み Ge 薄膜のラマン評価	○(B) 酒井 駿也 ¹ 、山村 和也 ¹ 、西垣 宏 ¹ 、蓮池 紀 幸 ¹ 、播磨 弘 ¹ 、Woo Sik Yoo ² 1. 京工織大、2.WaferMasters Inc.
16:00	E 21p-S223-10	Effects of pulse laser annealing on the crystallinity and electrical properties of B-doped BaSi ₂ epitaxial thin films	○(B)Emha Bayu Miftahullatif ¹ 、H. Urai ¹ 、Daichi Tsukahara ¹ 、Kaoru Toko ¹ 、Tetsuya Makimura ¹ 、Takashi Suemasu ¹ 1.Univ. of Tsukuba
16:15	21p-S223-11	β -FeSi ₂ エピタキシャル膜におけるラマンシフトの成長方位依存性	○山崎 一輝 ¹ 、山口 陽己 ² 、寺井 慶和 ^{1,2} 1. 九工大情報工、2. 鹿児島大理工
16:30	21p-S223-12	ネオンイオンを注入したシリコンのアニールによる構造変化	○羽瀨 仁恵 ¹ 、北川 淳嗣 ¹ 、園原 康介 ¹ 、飯田 民夫 ¹ 、大橋 史隆 ² 、伴 隆幸 ² 、久米 徹二 ² 、野々村 修一 ² 1. 岐阜高専、2. 岐阜大工
16:45	21p-S223-13	β -FeSi ₂ 薄膜の PL 発光特性に及ぼすアニール処理の影響	○秋山 賢輔 ^{1,3} 、松本 佳久 ¹ 、木口 賢紀 ² 、舟窪 浩 ³ 1. 神奈川産技セ、2. 東北大金研、3. 東工大総理工
17:00	21p-S223-14	Mg ₂ Si-Ni 電極界面に現れる相の結晶構造に関するエネルギー論的考察	○今井 庸二 ¹ 、菅原 宏治 ² 、森 嘉久 ³ 、中村 重之 ⁴ 、財部 健一 ³ 1. 産総研、2. 首都大 SD、3. 岡山理科大、4. 津山高専
17:15	21p-S223-15	VGF 法による Mg ₂ Si 結晶成長における原料の形状・純度と封止材のハロゲン処理の影響	○(M1) 和田 大輝 ¹ 、庄野 大貴 ¹ 、勝俣 裕 ¹ 、櫻木 史郎 ² 1. 明大理工、2. ユニオンマテリアル(株)
17:30	21p-S223-16	MgO/Mg ₂ Si/MgB ₂ ナノ複合結晶の微細構造とその電気・磁気特性	○上野 勝也 ¹ 、長嶋 廉仁 ² 、瀬戸 雄介 ¹ 、松本 恵 ¹ 、櫻井 敬博 ¹ 、太田 仁 ¹ 、○内野 隆司 ¹ 1. 神戸大、2. 日本板硝子
17:45	21p-S223-17	Ga 溶媒を用いて成長した単相 MnSi _{1.75-x} 結晶の粒径観察	○堀 俊平 ¹ 、鶴殿 治彦 ¹ 1. 茨城大院
13.3 絶縁膜技術 / Insulator technology			
3/19(Sat.) 13:30 - 15:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P3 会場	
	19p-P3-1	HfO ₂ /GeO ₂ /Ge スタック構造におけるゲルマニウムと酸素の熱拡散に関する研究	○小川 慎吾 ^{1,2} 、浅原 亮平 ² 、箕浦 佑也 ² 、迫 秀樹 ¹ 、1.TRC、2. 阪大院工 川崎 直彦 ¹ 、山田 一子 ¹ 、宮本 隆志 ¹ 、細井 卓治 ² 、志村 考功 ² 、渡部 平司 ²
	19p-P3-2	Radical-enhanced ALD 法による Ge-MIS 構造の欠陥評価(2): 熱処理効果	○成田 英史 ¹ 、山田 大地 ² 、福田 幸夫 ² 、岡本 浩 ¹ 1. 弘前大、2. 諏訪東京理科大
E	19p-P3-3	Characterization of sol-gel derived Nb doped ZrO ₂ thin film	○Joonam Kim ¹ 、Eisuke Tokumitsu ¹ 1.JAIST
	19p-P3-4	GaN パワートランジスタのためのゲート酸化膜堆積技術の開発	○高木 翔太 ¹ 、荒井 哲司 ¹ 、有元 圭介 ¹ 、山中 淳二 ¹ 、中川 清和 ¹ 、高松 利行 ² 、上野 勝典 ³ 1. 山梨大、2.SST、3. 富士電機
	19p-P3-5	GaN MOS デバイスのゲート絶縁膜に向けた Al ₂ O ₃ と SiO ₂ の混合膜の検討	○菊田 大悟 ¹ 、伊藤 健治 ¹ 、成田 哲生 ¹ 、森 朋彦 ¹ 1. 豊田中研
	19p-P3-6	高温・高湿環境下でのシリコン窒化膜表面酸化	○奥 友希 ¹ 、志賀 俊彦 ¹ 、戸塚 正裕 ¹ 、渡辺 斉 ¹ 1. 三菱電機 波光电
E	19p-P3-7	Research on passivation of semiconductor surfaces by heat treatment in liquid water	○takayuki motoki ¹ 、tomohiko nakamura ¹ 、masahiko hasumi ¹ 、toshiyuki sameshima ¹ 、tomohisa mizuno ² 1.TUAT、2.Kanagawa Univ.
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15		口頭講演 (Oral Presentation) S221 会場	
9:00	20a-S221-1	Si ピラーの酸化におけるミッシング Si と Si 放出機構の拡張	○影島 博之 ^{1,4} 、白石 賢二 ^{2,4} 、遠藤 哲郎 ^{3,4} 1. 島根大、2. 名古屋大、3. 東北大、4.JST-ACCEL
9:15	20a-S221-2	V-MOSFET における Si/SiO ₂ (001) 界面における熱酸化過程、水素アニール効果の歪み依存性の第一原理計算による考察	○(M1) 川内 伸梧 ¹ 、白川 裕規 ¹ 、洗平 昌晃 ^{2,1,5} 、影島 博之 ^{3,5} 、遠藤 哲郎 ^{4,5} 、白石 賢二 ^{2,1,5} 1. 名大院工、2. 名大未来研、3. 島根大院総合理工、4. 東北大院工、5.JST-ACCEL
9:30	奨 20a-S221-3	電荷移動型分子動力学法により作成した Si/SiO ₂ 界面構造の評価	○(D) 高本 聡 ¹ 、山崎 隆浩 ^{2,3} 、大野 隆史 ^{2,3,4} 、金田 千穂子 ^{3,5} 、泉 聡志 ¹ 、酒井 信介 ¹ 1. 東大工、2. 物材機構、3.MARCEED、4. 東大生産研、5. 富士通研究所
9:45	20a-S221-4	レーザーテラヘルツ放射顕微鏡によるシリコン MOS 界面の評価	○望月 敏光 ¹ 、伊藤 明 ² 、中西 英俊 ² 、棚橋 克人 ¹ 、川山 巖 ³ 、斗内 政吉 ³ 、白澤 勝彦 ¹ 、高遠 秀尚 ¹ 1. 産総研、2.SCREEN ホールディングス、3. 阪大レーザー研
10:00	E 20a-S221-5	Charge retention characteristics of charge trapping nonvolatile memories with silicon carbonitride (SiCN) dielectrics (II)	○(D)SheikhRashel Al Ahmed ¹ 、Fumiya Uehara ² 、Kyoteru Kobayashi ^{1,2} 1.GRAD SCH S&T、Tokai Univ、2.GRAD SCH Eng、Tokai Univ
10:15	20a-S221-6	アモルファスシリコン TFT 閾値電圧のゲート絶縁膜依存性	○安藤 正彦 ¹ 、若木 政利 ¹ 、鬼沢 賢一 ² 1. 日立研開、2. 古賀総研
10:30	休憩/Break		
10:45	E 20a-S221-7	Thermodynamic Control of GeO ₂ Suppression in SiGe Oxidation by pO ₂ and Temperature Manipulation	○(D)Woojin Song ¹ 、Akira Toriumi ¹ 1.Univ. Tokyo
11:00	20a-S221-8	PLD によるルチル型 TiO ₂ /Ge 作製条件の検討	○(M1) 鈴木 良尚 ^{1,2} 、長田 貴弘 ² 、山下 良之 ² 、生田目 俊秀 ² 、小椋 厚志 ¹ 、知京 豊裕 ² 1. 明治大学大学院、2. 物質・材料研究機構
11:15	20a-S221-9	La _{2-x} A _{2(1-x)}} O ₃ (A=Lu, Y)/La ₂ O ₃ /Ge(111) MIS 構造における C-V 特性の改善	○金島 岳 ¹ 、銭高 真人 ¹ 、山本 圭介 ² 、山城 陸 ¹ 、只野 純平 ³ 、野平 博司 ³ 、中島 寛 ² 、山田 晋也 ¹ 、浜屋 宏平 ¹ 1. 阪大基礎工、2. 九大・産学連携センター、3. 東京都

11:30	20a-S221-10	ゲートスタック中へのAl導入によるGe p-MOSFETの正孔移動度向上	○永富 雄太 ¹ 、田中 慎太郎 ¹ 、建山 知輝 ¹ 、山本 圭介 ² 、王 冬 ¹ 、中島 寛 ²	1. 九大総理工, 2. 九大産連センター
11:45	20a-S221-11	Al ₂ O ₃ キャップ層によるGeO脱離抑制と電気特性の評価	○大竹 博義 ¹	1. 東京農工大・工
12:00	奨 E 20a-S221-12	Influence of Al ₂ O ₃ /GeO ₂ /Ge MOS interface structures on the slow trap density	○(D)Menganan Ke ^{1,2} , Xiao Yu ^{1,2} , Mitsuru Takenaka ^{1,2} , Shinichi Takagi ^{1,2}	1. Tokyo Univ., 2. JST-CREST
3/20(Sun.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) S221 会場				
13:45	20p-S221-1	【注目講演】コンダクタンス法による二硫化モリブデン MOS 界面特性評価	○小澤 悠平 ^{1,2} 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 信一 ^{1,2}	1. 東大院工, 2. JST-CREST
14:00	E 20p-S221-2	Improvement of MOS Interfaces of La ₂ O ₃ /InGaAs by Ultra-thin ALD Al ₂ O ₃ Capping Layers	○(D)ChihYu Chang ^{1,2} , Mitsuru Takenaka ^{1,2} , Shinichi Takagi ^{1,2}	1. The Univ. of Tokyo, 2. JST-CREST
14:15	20p-S221-3	Al ₂ O ₃ 中の水素分布評価 - 熱処理温度依存性 -	○清水 康雄 ¹ 、韓 斌 ¹ 、涂 远 ¹ 、井上 耕治 ¹ 、矢野 史子 ² 、井上 真雄 ³ 、国宗 依信 ⁴ 、島田 康弘 ⁴ 、片山 俊治 ⁴ 、井手 隆 ⁴ 、永井 康介 ¹	1. 東北大金研, 2. 東工大, 3. ルネサス, 4. ルネサスセミコンダクタマニュファクチャリング
14:30	20p-S221-4	原子層堆積 (ALD) 温度を変えて形成した Al ₂ O ₃ 膜の電気特性	○平岩 篤 ¹ 、松村 大輔 ² 、川原田 洋 ^{1,2}	1. 早大ナノライフ, 2. 早大理工
14:45	奨 20p-S221-5	DMAH を用いた原子層堆積による Al ₂ O ₃ 誘電膜の形成	○吉嗣 晃治 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、高橋 清 ² 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端大, 2. 日本アルケルアルミ
15:00	E 20p-S221-6	Anomalous Flatband Voltage Shift of AlF ₃ /Al ₂ O ₃ MOS Capacitors: Dipole Layer Formation at Dielectric Interfaces with Different Anions	○(D)Jiayang Fei ¹ , Koji Kita ¹	1. The Univ. of Tokyo
15:15	奨 20p-S221-7	Al ₂ O ₃ /SiO ₂ 界面のダイポール層の繰返し構造を利用した大きなフラットバンド電圧シフト (>1 V)	○鎌田 啓伸 ¹ 、喜多 浩之 ¹	1. 東大院工
15:30	奨 20p-S221-8	ZrO ₂ /Al ₂ O ₃ /ZrO ₂ スタック構造を用いた DRAM キャパシタにおけるリーク電流特性の改善	○(B) 女屋 崇 ^{1,2} 、生田目 俊秀 ² 、澤田 朋実 ² 、栗島一徳 ^{1,2} 、大井 暁彦 ² 、知京 豊裕 ² 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大学, 2. 物材機構 WPI-MANA
15:45	20p-S221-9	ZrO ₂ /Si 構造における界面層作製手法の検討	○杉野 優介 ¹ 、岩崎 好孝 ¹ 、上野 智雄 ¹	1. 農工大院工
16:00	20p-S221-10	不純物添加による酸化ランタン薄膜の耐湿性向上	○安達 裕 ¹ 、坂口 勲 ¹	1. 物材機構
16:15	休憩 / Break			
16:30	20p-S221-11	液相堆積法による SrTiO ₃ のイオンドリフトの影響	○(MIC) 國光 俊作 ¹ 、稲野 基 ¹ 、羽路 伸夫 ¹	1. 横国大院工
16:45	奨 20p-S221-12	放射光 XRD による強誘電 HF(Y)O 薄膜結晶構造の温度依存性解析	○高石 理一郎 ¹ 、井野 恒洋 ¹ 、藤井 章輔 ¹	1. 東芝
17:00	20p-S221-13	FT-IR 法を用いた強誘電性 HfSiO 膜の構造解析による電気特性のプロセス依存性に対する考察	○上牟田 雄一 ¹ 、藤井 章輔 ¹ 、高石 理一郎 ¹ 、井野 恒洋 ¹ 、中崎 靖 ¹ 、齋藤 真澄 ¹ 、小山 正人 ¹	1. 東芝研開セ
17:15	奨 E 20p-S221-14	New finding of ferroelectricity of N doped HfO ₂ films	○(D)Lun Xu ¹ , Tomonori Nishimura ¹ , Shigehisa Shibayama ¹ , Takeaki Yajima ¹ , Shinji Migita ¹ , Akira Toriumi ¹	1. Univ. Tokyo, 2. AIST
17:30	20p-S221-15	ラマン分光測定及び XRD による強誘電性 Y ドープ HfO ₂ の構造解析	○巖 一孝 ¹ 、柴山 茂久 ^{1,2} 、矢嶋 起彬 ¹ 、西村 知紀 ¹ 、右田 真司 ³ 、島海 明 ¹	1. 東大院工, 2. 学振特別研究員 (PD), 3. 産総研
17:45	20p-S221-16	多相 HfO ₂ 膜における均一強誘電相の発現	○柴山 茂久 ^{1,2} 、徐 倫 ¹ 、右田 真司 ³ 、島海 明 ¹	1. 東大院工, 2. 学振特別研究員, 3. 産総研
18:00	20p-S221-17	強誘電性 HfO ₂ 膜における分極ドメインの減衰	○柴山 茂久 ^{1,2} 、徐 倫 ¹ 、右田 真司 ³ 、島海 明 ¹	1. 東大院工, 2. 学振特別研究員, 3. 産総研
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術 / Si wafer processing / Si based thin film / MEMS/Integration technology				
3/19(Sat.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
9:00	19a-S423-1	ミニマル・メガファブハイブリッドプロセスによる SOI-CMOS 集積回路の作製及び電気特性評価	○柳 永シュン ¹ 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、長尾 昌善 ¹ 、原 史朗 ^{1,2}	1. 産総研, 2. ミニマル
9:15	19a-S423-2	ミニマル液体ドーパントプロセスによる CMOS 試作 (II)	○古賀 和博 ^{1,2} 、居村 史人 ^{1,2} 、北山 佑司 ² 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. 産総研, 2. ミニマルファブ
9:30	19a-S423-3	ミニマルファブで作製したリングオシレータの発振特性	○居村 史人 ^{1,2} 、古賀 和博 ^{1,2} 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. 産総研, 2. ミニマルファブ
9:45	19a-S423-4	チャンパー密閉式ミニマル集光加熱炉を用いた薄い熱酸化膜形成	○三浦 典子 ¹ 、山田 武史 ^{1,2} 、相澤 洸 ^{1,2} 、池田 伸一 ^{1,3} 、石田 夕起 ^{1,3} 、三ヶ原 孝則 ^{1,3} 、西里 洋 ^{1,4} 、梅山 規男 ^{1,3} 、大西 康弘 ^{1,2} 、クンプアン ソマワン ^{1,3} 、原 史朗 ^{1,3}	1. ミニマルファブ, 2. 米倉製作所, 3. 産総研, 4. 堀場エステック
10:00	19a-S423-5	ミニマルレーザ加熱熱酸化膜のウェハ内均一性評価	○佐藤 和重 ¹ 、遠江 栄希 ¹ 、千葉 貴史 ^{1,3} 、寺田 昌男 ^{1,3} 、池田 伸一 ^{1,2} 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. ミニマルファブ技術研究組合, 2. 産総研, 3. 坂口電熱
10:15	19a-S423-6	ウェハ裏面からレーザ照射できるミニマルレーザ加熱装置の加熱特性	○佐藤 和重 ¹ 、遠江 栄希 ¹ 、千葉 貴史 ^{1,3} 、寺田 昌男 ^{1,3} 、池田 伸一 ^{1,2} 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. ミニマルファブ技術研究組合, 2. 産総研, 3. 坂口電熱
10:30	19a-S423-7	高速 MP・CMP 装置を用いたミニマルファブプロセス	○梅山 規男 ^{1,2} 、古賀 和博 ^{1,2} 、居村 史人 ^{1,2} 、澁谷 和孝 ³ 、布施 貴之 ³ 、中村 由夫 ³ 、市川 浩一郎 ³ 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. 産総研, 2. ミニマルファブ技術研究組合, 3. 不二越機械工業
10:45	休憩 / Break			
11:00	19a-S423-8	集光型赤外線加熱炉を用いたハーフインシリコン CVD 装置 (6)	○李 寧 ¹ 、羽深 等 ¹ 、三ヶ原 孝則 ² 、池田 伸一 ^{2,3} 、石田 夕起 ^{2,3} 、原 史朗 ^{2,3}	1. 横国大院工, 2. ミニマルファブ技術研究組合, 3. 産総研
11:15	19a-S423-9	ミニマル Si-CVD 装置における熱対流の影響	○三ヶ原 孝則 ^{1,2} 、三浦 典子 ¹ 、石田 夕起 ² 、伊藤 孝宏 ³ 、池田 伸一 ² 、羽深 等 ⁴ 、クンプアン ソマワン ² 、原 史朗 ²	1. ミニマルファブ, 2. 産総研, 3. オリエンタルモーター, 4. 横浜国立大学
11:30	19a-S423-10	ポイント・アレイ方式を用いた高分解能マスクレス露光の評価	○北山 佑司 ¹ 、竹田 宣生 ³ 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. ミニマルファブ技術研究組合, 2. 産総研, 3. (株) 大日本科研
11:45	19a-S423-11	高速ガススイッチングボッシュプロセスとミニマル多重露光プロセスを用いたエッチングパターンの解像度向上技術	○田中 宏幸 ^{1,2} 、小木曾 久人 ^{1,2} 、中野 禪 ^{1,2} 、速水 利泰 ^{2,3} 、宮崎 俊也 ^{2,3} 、入田 亮一 ^{2,4} 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. 産総研, 2. ミニマル, 3. SPPT, 4. PMT
12:00	19a-S423-12	ミニマル平坦度検査装置を用いたウェハ形状評価	○遠江 栄希 ¹ 、松橋 淑光 ^{1,2} 、上斗米 稔 ^{1,2} 、佐藤 和寛 ^{1,2} 、クンプアン ソマワン ^{1,3} 、原 史朗 ^{1,3}	1. ミニマルファブ, 2. 黒田精工, 3. 産総研
12:15	19a-S423-13	ウェハ表面パーティクル検査装置校正用の粒子数基準ウェハの開発 (III)	○田島 奈穂子 ^{1,2} 、飯田 健次郎 ^{1,2} 、榎原 研正 ¹ 、クンプアン ソマワン ^{1,2} 、原 史朗 ^{1,2}	1. 産総研, 2. ミニマルファブ技術研究組合
3/19(Sat.) 13:45 - 18:15 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
13:45	奨 19p-S423-1	ナノインプリント技術を用いた金属-誘電体-金属サブ波長格子の製作	○溝留 将人 ¹ 、本間 浩章 ¹ 、伊藤 伸太郎 ³ 、石田 誠 ¹ 、澤田 和明 ¹ 、高橋 一浩 ¹	1. 豊橋技科大, 2. 特別研究員 DC2, 3. 名古屋大学
14:00	19p-S423-2	水を原料ガスとするプラズマを用いたミニマルファブ用アッシング装置の開発	○(MI) 北野 卓也 ¹ 、伊藤 卓也 ¹ 、鈴木 宏明 ¹ 、石島 達夫 ¹ 、田中 康規 ¹ 、上杉 喜彦 ¹ 、クンプアン ソマワン ² 、原 史朗 ²	1. 金沢大, 2. 産総研
14:15	奨 19p-S423-3	無電解めっきを用いた電気泳動による TSV 埋め込み用シード膜の成膜	○新田 航平 ¹ 、多喜川 良 ¹ 、池田 晃裕 ¹ 、熊澤 光章 ¹ 、平井 俊明 ² 、小松 通郎 ² 、浅野 種正 ¹	1. 九大シ情, 2. 日揮触媒化成 (株)
14:30	奨 19p-S423-4	CuI を原料とする LPCVD 法による Cu の選択成長	○西川 太二 ¹ 、山内 智 ¹	1. 茨大工

14:45	19p-S423-5	弾道電子の還元効果を利用したCu薄膜のプリンティング堆積	○須田 隆太郎 ¹ 、八木 麻実子 ¹ 、小島 明 ¹ 、白樫 淳一 ¹ 、越田 信義 ¹	1. 農工大・院・工
15:00	19p-S423-6	中性無電解銅めっき液の添加剤効果	○(M1) 宇津野 仁史 ¹ 、杉浦 修 ²	1. 千葉工大, 2. 千葉工大
15:15	19p-S423-7	Ar ⁺ イオン照射によるSiナノワイヤのNi合金化反応の高精度制御	○(B) 大場 俊輔 ¹ 、橋本 修一郎 ¹ 、武井 康平 ¹ 、ソンセイ ¹ 、張 旭 ¹ 、徐 泰宇 ¹ 、麻田 修平 ¹ 、白田 稔宏 ¹ 、遠藤 清 ¹ 、富田 基裕 ^{1,2,3} 、徳武 寛紀 ³ 、今井 亮佑 ³ 、小椋 厚志 ³ 、松川 貴 ⁴ 、昌原 明植 ⁴ 、渡邊 孝信 ¹	1. 早大理工, 2. 学振PD, 3. 明大理工, 4. 産総研
15:30	19p-S423-8	PtHfシリサイドの形成におけるHfN保護層の効果	○(M2) Chen Mengyi ¹ 、政広 泰 ² 、大見 俊一郎 ¹	1. 東工大, 2. 田中貴金属
15:45		休憩 / Break		
16:00	19p-S423-9	メタルS/D型Ge n-MOSFETの寄生抵抗低減	○(M1) 建山 知輝 ¹ 、永富 雄太 ¹ 、田中 慎太郎 ¹ 、山本 圭介 ² 、王 冬 ¹ 、中島 寛 ²	1. 九大総理工, 2. 九大産連センター
16:15	19p-S423-10	界面ダイポール密度の制御による金属/Ge界面のフェルミレベルピンニング緩和の試み	○西村 知紀 ¹ 、矢嶋 超彬 ¹ 、島海 明 ¹	1. 東大院工
16:30	19p-S423-11	金属/Ge界面へのGe _{1-x} Sn _x 層挿入によるフェルミレベルピンニング位置のシフト	○鈴木 陽洋 ¹ 、中塚 理 ¹ 、坂下 満男 ¹ 、財満 鎮明 ^{1,2}	1. 名古屋大院工, 2. 名古屋大未来研
16:45	19p-S423-12	気相合成したW内包Siクラスターを単位構造とするWシリサイド薄膜の膜質評価	○岡田 直也 ^{1,2} 、内田 紀行 ² 、金山 敏彦 ²	1. JST さきがけ, 2. 産総研
17:00	19p-S423-13	SiO ₂ 膜の破壊強度	○石塚 典男 ¹ 、佐久間 憲之 ¹	1. 日立研開
17:15	19p-S423-14	ホットキャリアストレス誘起のRTNと発生した酸化膜トラップの評価	○(M2) 大澤 航 ¹ 、土屋 敏章 ¹	1. 島大工
17:30	19p-S423-15	塩素中性粒子ビームを用いたGe Fin トランジスタ・チャネル加工	○李 恩慈 ¹ 、○野田 周一 ¹ 、水林 亘 ² 、遠藤 和彦 ² 、寒川 誠二 ^{1,2}	1. 東北大流体研, 2. 産総研ナノエレクトロニクス
17:45	19p-S423-16	トランジスタプロセスへの応用へ向けたGe表面の酸素エッチング技術	○森田 行則 ¹ 、前田 辰郎 ¹ 、太田 裕之 ¹ 、水林 亘 ¹ 、大内 真一 ¹ 、昌原 明植 ¹ 、松川 貴 ¹ 、遠藤 和彦 ¹	1. 産業技術総合研究所
18:00	19p-S423-17	人工知能融合超高速量子分子動力学法の開発と半導体プロセスへの応用	○稲葉 賢二 ¹ 、佐藤 絵美 ¹ 、佐藤 愛美 ¹ 、小原 幸子 ¹ 、石澤 由紀江 ¹ 、宮野 正之 ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、ポノーバ トリック ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、畠山 望 ¹ 、張 山 昌論 ¹ 、宮本 明 ¹	1. 東北大学
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
9:00	奨 20a-S423-1	DRAM リテンション測定を用いた3DIC局所曲げ応力の影響評価	○谷川 星野 ¹ 、木野 久志 ² 、福島 啓史 ¹ 、田中 徹 ^{1,3}	1. 東北大院工, 2. 東北大学際研, 3. 東北大院医工
9:15	奨 20a-S423-2	フリップチップ超音波接合時の歪みと温度のその場観測	○(M1) 中堂 賢一 ¹ 、岩崎 圭一郎 ¹ 、千田 洋輔 ¹ 、浅野 種正 ¹	1. 九大シス情
9:30	奨 20a-S423-3	曲げと圧力に高い選択性を持つフレキシブル触覚センサ	○(B) 中田 尚吾 ¹ 、金尾 顕一朗 ¹ 、原田 真吾 ¹ 、有 江 隆之 ¹ 、秋田 成司 ¹ 、竹井 邦晴 ¹	1. 大阪府大工
9:45	20a-S423-4	静電型 MEMS エキゾーメータにおける非線形共振の検討(1)	○小野 一善 ¹ 、ユー アレクサンダー ^{1,2} 、佐藤 昇男 ³ 、田中 雄次郎 ¹ 、阪田 知巳 ³ 、神 好人 ^{1,3} 、小泉 弘 ¹	1. NTT 先端集積デバイス研究所, 2. ジョージア工科大, 3. NTT デバイスイノベーションセンター
10:00	20a-S423-5	高効率静電型エレクトレット MEMS 変圧器の設計	○鈴木 雅人 ¹ 、森山 喬史 ¹ 、橋口 原 ¹	1. 静岡大学
10:15	20a-S423-6	スペース赤外線望遠鏡における波面補正のための極低温用可変形鏡の開発: 実証実験について	○(M2) 高橋 葵 ¹ 、塩谷 圭吾 ² 、樫 香奈恵 ² 、Paul Bieder ³ 、Steven Cornelissen ³ 、Charlie Lam ³ 、Michael Feinberg ³	1. 総研大, 2. JAXA 宇宙研, 3. BMC
10:30		休憩 / Break		
11:30	20a-S423-7	マイクロ流路を用いた微細素子のアレイ化	○(M1) 岡田 義之 ¹ 、川合 健太郎 ¹ 、有馬 健太 ¹ 、森田 瑞穂 ¹	1. 阪大院工
11:45	20a-S423-8	MEMS 可変単結晶シリコン回折格子のLSI回路上への集積	○佐々木 敬 ¹ 、鈴木 智大 ¹ 、松浦 寛 ² 、羽根 一博 ¹	1. 東北大工, 2. 東北学院大工
12:00	E 20a-S423-9	A THz Dynamic Switch with MEMS Metamaterial Method	○Zhengli Han ¹ 、Takuya Takahashi ¹ 、Hiroshi Toshiyoshi ¹	1. The Univ. of Tokyo
3/20(Sun.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
13:45	奨 20p-S423-1	局所溶融液相成長による石英基板上単結晶GeSn層形成とトランジスタ応用	○小山 真広 ¹ 、岡 博史 ¹ 、天本 隆史 ¹ 、富永 幸平 ¹ 、田中 章吾 ¹ 、細井 卓治 ¹ 、志村 孝功 ¹ 、渡部 平司 ¹	1. 阪大院工
14:00	20p-S423-2	大気圧マイクロ熱ブラズマジェットを用いたP ⁺ ドーパGe膜の結晶化及び活性化	○原田 大夢 ¹ 、中谷 太一 ¹ 、新 良太 ¹ 、東 清一郎 ¹	1. 広島大学先端物質科学研究科, 2. 広島大学工学部
14:15	奨 20p-S423-3	薄膜 poly-Ge をチャンネルに利用したガラス基板上の平面型自己整合メタルダブルゲート低温 poly-Ge TFT	○西村 勇哉 ¹ 、中島 拓哉 ¹ 、母里 誠 ¹ 、原 明人 ¹	1. 東北学院大工
14:30	20p-S423-4	ハイパワー大気圧熱ブラズマジェット照射によるシリコン薄膜の高速溶融結晶化と連続結晶成長	○中島 涼介 ¹ 、花房 宏明 ² 、東 清一郎 ²	1. 広大工, 2. 広大院先端研
14:45	20p-S423-5	YSZ 結晶化誘発層と2段階パルスレーザー照射法を用いた固相結晶化 Si 薄膜の TFT 特性	○堀田 将 ¹ 、マイリアン ¹	1. 北陸先端大マテリアル
15:00	20p-S423-6	CW レーザーアニール法による非晶質基板上 Si 薄膜の(100) 面配向結晶化	○(M2) 仁枝 嘉昭 ¹ 、佐々木 伸夫 ² 、菱谷 大輔 ¹ 、堀田 昌宏 ³ 、石河 泰明 ¹ 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端大, 2. 日本女子大, 3. 京大
15:15	奨 20p-S423-7	スパッタ Si 膜へのマルチショット ELA とメタルソース・ドレイン構造 TFT	○原田 大成 ¹ 、我喜屋 風太 ¹ 、安次富 卓哉 ¹ 、岡田 竜弥 ¹ 、野口 隆 ¹ 、野田 勘治 ² 、諏訪 明 ^{2,3} 、池上 浩 ³ 、奥山 哲雄 ⁴	1. 琉球大工, 2. ギガフォトン, 3. 九州大シ, 4. 東洋紡
15:30	20p-S423-8	低コストの CMOS を目指した金属ソース・ドレイン電極による p チャンネル型 poly Si TFT の実現	○原田 大成 ¹ 、安次富 卓哉 ¹ 、岡田 竜弥 ¹ 、野口 隆 ¹ 、西方 靖 ² 、太田 淳 ²	1. 琉球大学工, 2. アルバック (株)
15:45	奨 20p-S423-9	n/p 接合太陽電池に対する水素アニールの最適化	○楊 天熙 ¹ 、魏 煌 ¹ 、鈴木 仁 ¹ 、岡田 竜弥 ¹ 、野口 隆 ¹ 、河本 直哉 ²	1. 琉球大工, 2. 山口大工
16:00	20p-S423-10	青色半導体レーザーアニール中のポリイミド上 Si 膜の温度解析	○岡田 竜弥 ¹ 、志津 勇介 ¹ 、野口 隆 ¹	1. 琉大工
16:15		休憩 / Break		
16:30	20p-S423-11	レーザーアニール技術の高性能パワー素子プロセスへの応用	○陳 訳 ¹ 、岡田 竜弥 ¹ 、野口 隆 ¹ 、マツアムト フルビオ ² 、ヒュエット カリム ²	1. 琉球大工, 2. スクリーンコダクダ (株)
16:45	E 20p-S423-12	Microwave Rapid Heating Used for Diffusing Impurities in Silicon	○Kosuke Ota ¹ 、Shunsuke Kimura ¹ 、Masahiko Hasumi ¹ 、Toshiyuki Sameshima ¹ 、Ayuta Suzuki ² 、Mitsuru Ushijima ²	1. TUAT, 2. TEL
17:00	20p-S423-13	FLA を用いた n+/p 接合 Ge における高活性化と浅い接合形成	○谷村 英昭 ¹ 、河原崎 光 ¹ 、小野 行雄 ¹ 、山田 隆泰 ¹ 、加藤 慎一 ¹ 、青山 敬幸 ¹ 、小林 一平 ¹	1. SCREEN セミコンダクターソリューションズ

17:15	奨 E 20p-S423-14	High On-to-Off Ratio Ge n ⁺ p Junctions by Peripheral Passivation Control	○(P)Chi Liu ¹ , Hiroki Ikegaya ¹ , Tomonori Nishimura ¹ , Akira Toriumi ¹	1.Univ. of Tokyo
17:30	奨 20p-S423-15	ラマン分光法及びイメージング法による低温多結晶シリコン薄膜の結晶性分布評価	○横川 凌 ¹ 、高橋 和也 ² 、小森 克彦 ² 、廣田 良浩 ³ 、1. 明治大理工、2. 東京エレクトロン東北(株)、3. 東京エレクトロン(株)	
17:45	20p-S423-16	中空構造 SOI 層を用いた低温転写技術における PET 基板上高転写率の実現	○水上 隆達 ¹ 、中川 明俊 ² 、平松 和樹 ² 、竹島 真治 ¹ 、1. 広工大、2. 広大先端研	
18:00	20p-S423-17	イオン注入操作によって単結晶ゲルマニウム中に生じる欠陥の DLTS による解析	○池谷 大樹 ¹ 、西村 知紀 ¹ 、矢嶋 起彬 ¹ 、島海 明 ¹	1. 東大院工
18:15	20p-S423-18	スパッタエピタキシーによる p ⁺ エミッタ型 Si 太陽電池の開発	○森山 光 ¹ 、葉 文昌 ¹	1. 島根大学
18:30	E 20p-S423-19	Low Temperature Cat-Doping of Phosphorous Atoms into Crystalline Silicon through Ultrathin SiO ₂ Layer	○(P)ThiCamTu Huynh ¹ , Koichi Koyama ¹ , Shigeki Terashima ¹ , Hideki Matsumura ¹	1.JAIST
3/21(Mon.) 16:00 - 18:00				
ポスター講演 (Poster Presentation) P17 会場				
奨 21p-P17-1		ガラス基板上に形成された自己整合四端子メタルダブルゲート CLC LT poly-Si TFT を用いた pH センサの検討	○大澤 弘樹 ¹ 、中野 道広 ¹ 、鈴木 仁志 ¹ 、桑野 聡子 ¹ 、原 明人 ¹	1. 東北学院大工
21p-P17-2		ガラス基板上の High-k ゲート絶縁膜を有する自己整合メタルダブルゲート Ni-SPC 低温 Poly-Si TFT	○仁部 翔太 ¹ 、原 明人 ¹	1. 東北学院大工
奨 21p-P17-3		Multi-Line-Beam CLC poly-Si TFTs におけるチャンネル不純物導入の効果	○平岩 弘之 ¹ 、平田 達誠 ¹ 、グエンティ トゥイ ¹ 、小谷 光司 ² 、黒木 伸一郎 ¹	1. 広島大学ナノデバイス、2. 東北大工
奨 21p-P17-4		低温 MLB-CLC poly-Si TFTs の電気特性に対する結晶粒界の影響	○平田 達誠 ¹ 、グエン トゥイ ¹ 、平岩 弘之 ¹ 、小谷 光司 ² 、吉川 公磨 ¹ 、黒木 伸一郎 ¹	1. 広島大学ナノデバイス、2. 東北大学院工学研
21p-P17-5		SiGe ストップ層を用いた歪み Ge-On-Insulator 構造の形成技術開発	○(M2) 矢島 佑樹 ¹ 、澤野 憲太郎 ¹	1. 東京都市大学
21p-P17-6		DC マグネトロンスパッタによる Si(001) 基板上への Ge 薄膜の形成	○(PC) 大塚 慎太郎 ¹ 、森 貴洋 ¹ 、森田 行則 ¹ 、内 田 紀行 ¹ 、柳 永助 ¹ 、大内 真一 ¹ 、更田 裕司 ¹ 、右 田 真司 ¹ 、昌原 明植 ¹ 、松川 貴 ¹	1. 産総研
21p-P17-7		フラッシュランプアニール (FLA) による高電子濃度かつ高電子移動度の n ⁺ poly-Ge 形成	○小池 正浩 ^{1,2} 、白田 宏治 ^{1,2} 、鎌田 善己 ^{1,2} 、森 貴洋 ^{2,3} 、前田 辰郎 ^{2,3} 、手塚 勉 ^{1,2}	1. 東芝研開セ、2. 産総研 GNC、3. 産総研
21p-P17-8		Si-ULSI 用の電極形成のための熱処理技術の開発	○上村 和貴 ¹ 、中家 大希 ¹ 、荒井 哲司 ¹ 、山本 千綾 ¹ 、有元 圭介 ¹ 、山中 淳二 ¹ 、中川 清和 ¹ 、高松 利行 ²	1. 山梨大、2. 株式会社 SST
21p-P17-9		表面活性化ボンディング法による Al 箔 / Si 接合の電気特性評価	○古名 克也 ¹ 、梁 剣波 ¹ 、松原 萌子 ² 、西尾 佳高 ² 、重川 直輝 ¹	1. 大阪市大工、2. 東洋アルミニウム
21p-P17-10		CVD 法による MnO _x 拡散バリア層の形成に伴うポーラス SiOCH への Mn 拡散	○小出 紘之 ¹ 、王 昊 ¹ 、安藤 大輔 ¹ 、須藤 祐司 ¹ 、小池 淳一 ¹	1. 東北大工
21p-P17-11		凹凸構造を持つウェハの切削平坦化金パンプを用いた真空封止接合	○平野 栄樹 ¹ 、引地 広介 ² 、田中 秀治 ¹	1. 東北大工、2. テクノファイン
21p-P17-12		Si/Cu 同時研削と無電解 Sn めっきと Si アルカリエッチングを用いた Si 貫通電極露出工程	○渡辺 直也 ¹ 、青柳 昌宏 ¹ 、坂東 翼 ² 、三井 貴彦 ² 、山本 栄一 ²	1. 産業技術総合研究所、2. 岡本工作機械製作所
21p-P17-13		プラズモニク吸収体を用いた波長選択型非冷却赤外線センサ：不要吸収モードの除去	○久保山 貴文 ¹ 、高川 陽輔 ¹ 、小川 新平 ² 、藤澤 大介 ² 、木股 雅章 ¹	1. 立命館大学、2. 三菱電機株式会社
奨 21p-P17-14		プラズモニク吸収体を用いた波長選択型非冷却赤外線センサによる二酸化炭素検知	○久保山 貴文 ¹ 、高川 陽輔 ¹ 、小川 新平 ² 、藤澤 大介 ² 、安井 慎一 ² 、木股 雅章 ¹	1. 立命館大学、2. 三菱電機株式会社
21p-P17-15		波長計測のためのサブ波長ホールアレィを有する光ナノメカニカル振動子の作製	後藤 雅貴 ¹ 、前田 悦男 ¹ 、○米谷 玲皇 ¹	1. 東大院工
21p-P17-16		容量計測型呼吸センサにおける電極配置と信号の安定化	寺澤 慎恵 ¹ 、菊田 桃子 ¹ 、熊谷 慎也 ¹ 、○佐々木 実 ¹	1. 豊田工大
21p-P17-17		積層メタル構造を用いた MEMS 加速度センサのストップバーのロバスト性検討	○小西 敏文 ¹ 、山根 大輔 ^{2,4} 、佐布 晃昭 ¹ 、年吉 洋 ^{3,4} 、曾根 正人 ^{2,4} 、益 一哉 ^{2,4} 、町田 克之 ^{1,2,4}	1.NTT-AT、2. 東工大、3. 東大、4.JST-CREST
21p-P17-18		Sub-1G 検出に向けた CMOS-MEMS 加速度センサの検討	○山根 大輔 ^{1,4} 、小西 敏文 ³ 、伊藤 浩之 ^{1,4} 、年吉 洋 ^{3,4} 、益 一哉 ^{1,4} 、町田 克之 ^{1,2,4}	1. 東工大、2.NTT-AT、3. 東大、4.JST-CREST
奨 21p-P17-19		電解めっきで作製した Ti/Au 微小カンチレバーの構造安定性	○寺西 美波 ^{1,2} 、Chang Tso-Fu Mark ^{1,2} 、Chen Chun-Yi ^{1,2} 、小西 敏文 ³ 、町田 克之 ^{1,2,3} 、年吉 洋 ^{2,4} 、山根 大輔 ^{1,2} 、益 一哉 ^{1,2} 、曾根 正人 ^{1,2}	1. 東工大、2.JST-CREST、3.NTT AT、4. 東大
奨 E 21p-P17-20		Application of Supercritical Carbon Dioxide in Electroplating of Gold Materials Used in MEMS Devices	○(D)Haochun Tang ¹ 、Chun-Yi Chen ^{1,2} 、Tso-Fu Mark Chang ^{1,2} 、Katsuyuki Machida ^{1,2,3} 、Daisuke Yamane ^{1,2} 、Kazuya Masu ^{1,2} 、Masato Sone ^{1,2}	1.P&I Lab. Tokyo Tech、2.CREST JST、3.NTT AT Corp.
奨 21p-P17-21		マイクロ圧縮試験による金 / チタン積層構造の機械的特性評価	○石塚 陽大 ^{1,2} 、柳田 佐理 ^{1,2} 、Chang Tso-Fu Mark ^{1,2} 、Chen Chun-Yi ^{1,2} 、小西 敏文 ³ 、町田 克之 ^{1,2,3} 、年吉 洋 ^{1,4} 、山根 大輔 ^{1,2} 、益 一哉 ^{1,2} 、曾根 正人 ^{1,2}	1. 東工大、2.JST-CREST、3.NTT AT、4. 東大
奨 21p-P17-22		マイクロサイズ圧縮試験を用いた Al 合金の変形挙動における結晶粒界の研究	○鄭 伯倫 ¹ 、名越 貴志 ^{1,2} 、チャン ツォーフ マーク ¹ 、細田 秀樹 ¹ 、里 達雄 ¹ 、曾根 正人 ¹	1. 東工大、2. 産総研
奨 21p-P17-23		マイクロ曲げ試験による電析金薄膜の機械的特性評価	○浅野 啓介 ^{1,2} 、唐 浩峻 ^{1,2} 、Chen Chun-Yi ^{1,2} 、Chang Tso-Fu Mark ^{1,2} 、山根 大輔 ^{1,2} 、町田 克之 ^{1,2,3} 、益 一哉 ^{1,2} 、曾根 正人 ^{1,2}	1.CREST、2. 東工大、3.NTTAT
奨 21p-P17-24		微小圧縮試験及び微小引張試験による MEMS 用 Cu-Ni-Si 合金の機械的特性評価	○(M1) 柳田 佐理 ^{1,2} 、荒木 章好 ¹ 、Chang Tso-Fu Mark ^{1,2} 、Chen Chun-Yi ^{1,2} 、名越 貴志 ³ 、小林 郁夫 ¹ 、細田 秀樹 ¹ 、里 達雄 ¹ 、曾根 正人 ^{1,2}	1. 東工大、2.CREST、3. 産総研
奨 21p-P17-25		マイクロ圧縮試験による MEMS 用金電めっきの機械的特性の評価	○葭葉 将治 ^{1,2} 、Chen Chun-Yi ^{1,2} 、Chang Tso-Fu Mark ^{1,2} 、山根 大輔 ^{1,2} 、町田 克之 ^{1,2,3} 、益 一哉 ^{1,2} 、曾根 正人 ^{1,2}	1.CREST、2. 東工大精研、3.NTTAT
21p-P17-26		エネルギーハーベスト用ショットキーダイオードの検討その 2	○宮地 晃平 ¹ 、松下 誠 ¹ 、岸川 諒子 ^{2,3} 、吉田 賢史 ⁴ 、1. 宇宙航空研究開発機構宇宙研、2. 総研大、3. 産総研、嘉数 誠 ⁵ 、堀部 雅弘 ³ 、西川 健二郎 ⁴ 、岩室 光則 ⁶ 、4. 鹿児島大、5. 佐賀大、6. 日立化成 (株) 川崎 繁男 ^{1,2}	

13.5 デバイス/集積化技術 / Semiconductor devices and related technologies

3/19(Sat.) 13:30 - 15:30				
ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場				
19p-P4-1		SCM/NAND Flash Hybrid SSD の構成とエラー訂正強度を考慮した SSD の性能と信頼性とコストの関係解析	○瀧下 博文 ¹ 、竹内 健 ¹	1. 中大理工
19p-P4-2		プライバシー保護に向けたソリッドステートストレージシステム	○前田 一輝 ¹ 、田中丸 周平 ¹ 、山沢 裕紀 ¹ 、竹内 健 ¹	1. 中大理工

19p-P4-3	アーカイブ/コールドフラッシュ向け長期保存 SSD の高信頼手法	○高橋 知紀 ¹ 、山崎 泉樹 ¹ 、竹内 健 ¹	1. 中大理工	
19p-P4-4	1.0 V で動作する ReRAM 書き込み電圧生成回路の高速化	○鶴見 洗太 ¹ 、田中 誠大 ¹ 、石井 智也 ¹ 、竹内 健 ¹	1. 中大理工	
19p-P4-5	ストア/リストア動作のロバスト性を向上させた MTJ 利用不揮発性フリップフロップ回路	○宇佐美 公良 ¹ 、工藤 優 ¹ 、平賀 啓三 ² 、屋上 公二 ¹	1. 芝浦工大, 2. ソニー 部 ²	
19p-P4-6	UWB-CMOS 集積回路を用いた乳がん位置検出技術	○(B)中村 哲平 ¹ 、宋 航 ¹ 、河野 勇人 ¹ 、瀬尾 裕二 ¹ 、吉川 公磨 ¹ 、アズハリ アフリーン ¹	1. 広島大ナノデバイス研	
奨 19p-P4-7	多層 AI ゲート構造を用いた Si-MOS 量子ドットデバイス作製プロセスの検討	○本田 拓夢 ¹ 、米田 淳 ² 、武田 健太 ² 、川那子 高暢 ¹ 、小寺 哲夫 ^{1,5} 、樽茶 清悟 ^{2,3,5} 、小田 俊理 ¹	1. 東工大量子ナノ研, 2. 理化学研究所, 3. 東大, 4. 東工大, 5. 東大ナノ量子機構	
奨 19p-P4-8	極薄膜 SOI を用いた量子ドットデバイスの作製と評価	○西野 孝夫 ^{1,2} 、平岡 宗一郎 ^{1,2} 、井原 敏 ^{1,2} 、小寺 哲夫 ^{1,2} 、小田 俊理 ^{1,2}	1. 東工大電子物理, 2. 東工大量子ナノ研セ	
19p-P4-9	シリコン単電子ポンプの ppm レベル高精度動作	○山端 元音 ¹ 、Giblin Stephen ² 、片岡 真哉 ² 、唐沢 毅 ¹ 、藤原 聡 ¹	1. NTT 物性基礎研, 2. National Physical Lab.	
奨 19p-P4-10	極低温下連続マイクロ波照射下での単一量子ドットの電子輸送特性	○(M1)前川 未知瑠 ^{1,2} 、テノリオベルル ハイメ ^{1,2} 、ヘルプスレブ エルンスト ^{1,2} 、山岡 裕 ^{1,2} 、小寺 哲夫 ^{1,2} 、小田 俊理 ^{1,2}	1. 東工大 電子物理, 2. 東工大量子ナノ研セ	
奨 19p-P4-11	P 型 Si 二重量子ドット内の少数正孔領域でのパウリスピンブロッケードの観測	○(M2)岩崎 一真 ¹ 、小寺 哲夫 ² 、小田 俊理 ^{1,2}	1. 東工大量子ナノ研セ, 2. 東工大電子物理	
奨 19p-P4-12	高濃度ドーピングしたシリコンを用いた単一量子ドットの正孔輸送特性	○(M1)山岡 裕 ¹ 、小田 俊理 ¹ 、小寺 哲夫 ¹	1. 東工大	
奨 19p-P4-13	Si 単電子トランジスタにおける Excited State への寄生 MOSFET の影響	○内田 貴史 ¹ 、佐藤 光 ¹ 、福地 厚 ¹ 、有田 正志 ¹ 、藤原 聡 ² 、高橋 庸夫 ¹	1. 北大院情報, 2. NTT 物性基礎研	
E 19p-P4-14	Tunneling-transport operation of selectively-doped dopant-atom transistors up to room temperature	Arup Samanta ¹ , Daniel Ioan Moraru ^{1,2} , Yuki Takasu ¹ , Takeshi Mizuno ¹ , Michiharu Tabé ¹	1. RIE, Shizuoka Univ, 2. Fac. Eng., Shizuoka U	
E 19p-P4-15	Effects of phonons and discrete dopants on band-to-band tunneling in two-dimensional Si pn junction diodes	○Daniel Ioan Moraru ^{1,2} , Hoang Nhat Tan ¹ , Ryosuke Unno ¹ , Takeshi Mizuno ¹ , Manoharan Muruganathan ³ , Le The Anh ³ , Ratno Nuryadi ⁴ , Hiroshi Mizuta ^{3,5} , Michiharu Tabé ¹	1. RIE, Shizuoka Univ, 2. Fac. Eng., Shizuoka U, 3. JAIST, 4. AAAT, Indonesia, 5. Univ. Southampton	
19p-P4-16	二次元 Si 系半導体の検証 (III): 半導体膜厚依存性	長嶺 由騎 ¹ 、○小又 祐介 ¹ 、青木 孝 ¹ 、鮫島 俊之 ² 、水野 智久 ¹	1. 神奈川大理, 2. 農工大	
19p-P4-17	パルス光伝導法による酸化膜評価技術の開発	○長野 聖央 ¹ 、清水 公志郎 ¹ 、古田 正昭 ¹ 、久保田 弘 ¹ 、橋新 剛 ¹ 、吉岡 昌雄 ² 、宮下 守也 ³ 、泉妻 宏治 ³ 、前田 貴弘 ³	1. 熊大院自, 2. 熊大工, 3. GWJ	
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S422 会場				
9:00	20a-S422-1	界面トラップ数の真の値とばらつき、および従来のチャージポンピング理論による値との比較	○土屋 敏章 ¹	1. 島根大総理工
9:15	20a-S422-2	電子捕獲放出過程における界面トラップ間の相互作用	○土屋 敏章 ¹	1. 島根大総理工
9:30	20a-S422-3	ランダムテレグラフノイズに起因する SRAM 誤動作のトランジスタレベル解析	○水谷 朋子 ¹ 、更屋 拓哉 ¹ 、竹内 潔 ¹ 、小林 正治 ¹ 、平本 俊郎 ¹	1. 東大生研
9:45	20a-S422-4	結晶シリコンチャンネル FinFET と集積可能な多結晶シリコンチャンネル FinFET を用いた高信頼・コンパクトな PUF 回路とその評価方法	○大内 真一 ¹ 、柳 永助 ¹ 、堀 洋平 ¹ 、入沢 寿史 ¹ 、更田 裕司 ¹ 、森田 行則 ¹ 、右田 真司 ¹ 、森 貴洋 ¹ 、中川 格 ¹ 、塚田 順一 ¹ 、小池 汎平 ¹ 、昌原 明植 ¹ 、松川 貴 ¹	1. 産総研
10:00	20a-S422-5	しきい値電圧制御可能な三角チャンネル FinFET の作製及び電気特性評価	○柳 永助 ¹ 、松川 貴 ¹ 、遠藤 和彦 ¹ 、大内 真一 ¹ 、塚田 順一 ¹ 、石川 由紀 ¹ 、水林 亘 ¹ 、森田 行則 ¹ 、右田 真司 ¹ 、太田 裕之 ¹ 、昌原 明植 ¹	1. 産総研
10:15	20a-S422-6	FinFET エクステンションへの注入イオン種と GIDL の関係	○松川 貴 ¹ 、大塚 慎太郎 ¹ 、森 貴洋 ¹ 、森田 行則 ¹ 、柳 永助 ¹ 、大内 真一 ¹ 、更田 裕司 ¹ 、右田 真司 ¹ 、昌原 明植 ¹	1. 産総研
10:30	休憩 / Break			
10:45	20a-S422-7	ナノワイヤ型不純物偏析ショットキー接合 MOSFET におけるワイヤ幅縮小効果	○遠藤 清 ¹ 、橋本 修一郎 ¹ 、武井 康平 ¹ 、ソーンセイ 1、張 旭 ¹ 、徐 泰宇 ¹ 、麻田 修平 ¹ 、大場 俊輔 ¹ 、松川 貴 ² 、昌原 明植 ² 、渡邊 孝信 ¹	1. 早大理工, 2. 産総研
11:00	奨 20a-S422-8	Si および Ge ナノワイヤにおける高電界正孔輸送の解析	○田中 一 ¹ 、須田 淳 ¹ 、木本 恒暢 ¹	1. 京大院工
11:15	奨 20a-S422-9	Ge における正孔と電子のフォノン周波数に対する影響の違い	○株柳 翔一 ^{1,2} 、西村 知紀 ¹ 、矢嶋 越彬 ¹ 、鳥海 明 ¹	1. 東大院工, 2. 学振特別研究員 DC
11:30	20a-S422-10	短チャンネル MOSFET における、低電界移動度の異常劣化について	○名取 研二 ¹	1. 東工大フロンティア
11:45	20a-S422-11	高信頼性・低オン抵抗デュアル RESURF Nch-LDMOS の提案	松田 順一 ¹ 、○小島 潤也 ¹ 、神山 雅貴 ¹ 、築地 伸和 ¹ 、小林 春夫 ¹	1. 群馬大工
12:00	20a-S422-12	Al ₂ O ₃ 固定電荷層適用における裏面照射型 CMOS イメージセンサ暗電流低減についての検討	○上村 昌己 ¹ 、山華 雅司 ¹ 、内藤 達也 ¹	1. 東芝
3/20(Sun.) 13:45 - 18:30 口頭講演 (Oral Presentation) S422 会場				
13:45	20p-S422-1	スパッタ MoS ₂ 膜のフォーミングガス雰囲気ポストアニールによる電気特性向上	○清水 淳一 ¹ 、大橋 匠 ¹ 、松浦 賢太郎 ¹ 、角嶋 邦之 ¹ 、筒井 一生 ¹ 、若林 整 ¹	1. 東工大
14:00	20p-S422-2	S/Mo 比増加による MoS ₂ 膜の低キャリア濃度化	○大橋 匠 ¹ 、松浦 賢太郎 ¹ 、石原 聖也 ² 、日比野 祐介 ² 、澤本 直美 ² 、角嶋 邦之 ¹ 、筒井 一生 ¹ 、小椋 厚志 ² 、若林 整 ¹	1. 東工大, 2. 明治大
14:15	20p-S422-3	3 次元 IC に向けた多結晶 InSb MOSFET の電気特性評価	○(M1)高橋 正統 ^{1,2} 、藤川 紗千恵 ¹ 、藤代 博記 ¹ 、入沢 寿史 ² 、富永 淳二 ² 、前田 辰郎 ^{1,2}	1. 東理大院, 2. 産総研
14:30	20p-S422-4	デバイスシミュレーションによる積層型 CMOS インバータの構造検討	○服部 淳一 ¹ 、福田 浩一 ¹ 、太田 裕之 ¹ 、入沢 寿史 ¹ 、前田 辰郎 ¹	1. 産総研
14:45	20p-S422-5	VO ₂ モットトランジスタのチャンネルに形成される特異な界面相	○矢嶋 越彬 ¹ 、西村 知紀 ¹ 、鳥海 明 ¹	1. 東大マテ
15:00	20p-S422-6	SOI-FET における強誘電体 HfO ₂ の負性容量を利用した急峻スイッチングの検討: BOX 膜厚設計の重要性	○太田 裕之 ^{1,3} 、右田 真司 ^{1,3} 、福田 浩一 ¹ 、服部 淳一 ¹ 、鳥海 明 ^{2,3}	1. 産総研, 2. 東大工, 3. JST CREST
15:15	20p-S422-7	SS=35 μ V/dec を持つ PN-Body tied SOIMOSFET の解析	○堀井 隆史 ¹ 、吉田 貴大 ¹ 、蔵本 陽介 ¹ 、井田 次郎 ¹	1. 金沢工大

15:30	20p-S422-8	離散不純物分布がもたらす Tunnel FET の特性ばらつきの数値解析	○浅井 栄大 ¹ 、右田 真司 ¹ 、服部 淳一 ¹ 、福田 浩一 ¹ 、佐野 伸行 ²	1.産総研, 2.筑波大物工
15:45	20p-S422-9	平行電界型トンネル FET の TCAD での検討	○福田 浩一 ¹ 、森田 行則 ¹ 、森 貴洋 ¹ 、水林 亘 ¹ 、昌原 明植 ¹ 、右田 真司 ¹ 、太田 裕之 ¹	1.産総研
16:00	20p-S422-10	短チャネル TFET におけるソース・ドレイン間直接トンネリングのオフ電流への寄与	○林 文博 ¹ 、岩田 真次郎 ¹ 、福田 浩一 ^{1,2} 、宮本 恭幸 ¹	1.東工大, 2.産総研
16:15		休憩 / Break		
16:30	20p-S422-11	金属 / Ge 接合及び n ⁺ /Ge 接合を用いた Ge トンネル FET の作製と評価	○山本 圭介 ¹ 、岡本 隼人 ² 、王 冬 ² 、中島 寛 ¹	1.九大産学連携センター, 2.九大総理工
16:45	20p-S422-12	GaAsSb/InGaAs 縦型トンネル FET の動作実証	○(D)後藤 高寛 ^{1,3} 、満原 学 ^{2,3} 、星 拓也 ^{2,3} 、杉山 弘樹 ^{2,3} 、竹中 充 ^{1,3} 、高木 信一 ^{1,3}	1.東大工, 2.NTT, 3.JST CREST
17:00	20p-S422-13	高 In 組成 InGaAs 量子井戸を用いた InGaAs QW TFET の電気特性における性能評価	○安 大煥 ^{1,2} 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 信一 ^{1,2}	1.東大院工, 2.JST CREST
17:15	20p-S422-14	変調ドープ構造 InGaAs ナノワイヤ / Si トンネル FET の作製	○富岡 克広 ^{1,2} 、石坂 文哉 ¹ 、本久 順一 ¹ 、福井 孝志 ¹	1.北大院情報科学および量子集積センター, 2.JST さきがけ
17:30	20p-S422-15	p 型トンネルトランジスタにおける NBTI 劣化の解析	○水林 亘 ¹ 、森 貴洋 ¹ 、福田 浩一 ¹ 、石川 由紀 ¹ 、森田 行則 ¹ 、右田 真司 ¹ 、太田 裕之 ¹ 、柳 永助 ¹ 、大内 真一 ¹ 、塚田 順一 ¹ 、山内 洋美 ¹ 、松川 貴 ¹ 、昌原 明植 ¹ 、遠藤 和彦 ¹	1.産総研
17:45	20p-S422-16	短チャネルトンネルトランジスタにおける結合量子ドットの電子輸送とマイクロ波応答	○森山 悟士 ¹ 、森 貴洋 ² 、大野 圭司 ³	1.物材機構, 2.産総研, 3.理研
18:00	20p-S422-17	TFET におけるチャージボンピングとスピン効果	○大野 圭司 ¹ 、森 貴洋 ² 、森山 悟士 ³	1.理研, 2.産総研, 3.物材機構
18:15	20p-S422-18	Si-TFET 中の価電複合不純物の安定性とトンネル電流特性; 第一原理計算に基づく検討	○飯塚 将太 ¹ 、浅山 佳大 ¹ 、長澤 晶斗 ¹ 、中山 隆史 ¹	1.千葉大理
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S422 会場				
9:00	招 21a-S422-1	【授賞式】(15分) 第7回シリコンテクノロジー分科会論文賞・研究奨励賞	○遠藤 哲郎 ¹	1.東北大学
9:15	招 21a-S422-2	【第7回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演】(30分) シリコンスピン MOSFET 室温動作の実証	○小池 勇人 ¹ 、佐々木 智生 ¹ 、安藤 裕一郎 ^{2,3} 、亀野 誠 ² 、田原 貴之 ³ 、及川 亨 ¹ 、鈴木 淑男 ⁴ 、白石 誠司 ^{2,3}	1.TDK, 2. 阪大院基礎工, 3. 京大院工, 4.AIT
9:45	招 21a-S422-3	【第7回シリコンテクノロジー分科会論文賞受賞記念講演】(30分) スピン量子デバイスに向けた少数電子シリコン量子ドットの研究	○堀部 浩介 ¹ 、○小寺 哲夫 ¹ 、小田 俊理 ¹	1.東工大
10:15	招 21a-S422-4	【第7回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞受賞記念講演】(15分) TEM その場観察を用いた CBRAM 繰り返し抵抗変化時のフィラメント観察	○工藤 昌輝 ¹ 、有田 正志 ² 、大野 裕輝 ³ 、高橋 庸夫 ²	1.北大院情報 (現 九大超顕微セ), 2.北大院情報, 3.北大院情報 (現 三菱自動車)
10:30	招 21a-S422-5	【第7回シリコンテクノロジー分科会研究奨励賞受賞記念講演】(15分) シリコンにおける直接・間接光学遷移の電氣的調整	○登坂 仁一郎 ¹ 、西口 克彦 ¹ 、藤原 聡 ¹	1.NTT 物性研
10:45		休憩 / Break		
11:00	奨 21a-S422-6	SdH 振動を用いたひずみ Si pMOSFET における価電子帯有効質量の評価	○嶋田 絢 ¹ 、中根 了昌 ¹ 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 信一 ^{1,2}	1.東大院・工, 2.JST-CREST
11:15	奨 21a-S422-7	温度サイクルを減らした酸化濃縮法による高圧縮ひずみ極薄膜 Ge-OI 構造の実現	○金 佑強 ^{1,2} 、竹中 充 ^{1,2} 、高木 信一 ^{1,2}	1.東大院工, 2.JST-CREST
11:30	奨 E 21a-S422-8	Realization of Ge n- and p-MOSFETs by using low thermal budget ionimplantation after germanidation technique (< 400 ° C)	○(P)WENHSIN CHANG ¹ , Hiroyuki Ota ¹ , Tatsuro Maeda ¹	1.AIST
11:45	21a-S422-9	石英基板上の InGaAs MOSFET の高周波特性	○久米 英司 ¹ 、石井 裕之 ² 、服部 浩之 ² 、Chang Wen-Hsin ² 、小倉 睦郎 ¹ 、前田 辰郎 ²	1.アイアールズベック, 2.産総研ナノエレ
12:00	奨 21a-S422-10	サブ 10 nm ゲート長 III-V nMOSFET におけるソース・ドレイントンネル電流のチャネル電子有効質量依存性	○(M1)片木 慎也 ¹ 、大森 正規 ¹ 、土屋 英昭 ¹ 、小川 真人 ¹	1.神戸大工
13.6 Semiconductor English Session				
3/19(Sat.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) S224 会場				
9:00	E 19a-S224-1	Distribution of Single-Ion Implanted Dopants in Silicon Investigated by Atom Probe Tomography	○(D)Yuan TU ¹ , Bin Han ¹ , Yasuo Shimizu ¹ , Koji Inoue ¹ , Maasa Yano ² , Yuki Chiba ² , Takashi Tani ² , Takahiro Shinada ³ , Yasuyoshi Nagai ¹	1.IMR Tohoku Univ., 2.Waseda Univ., 3.CIES Tohoku Univ.
9:15	E 19a-S224-2	Poly-Si thin film transistor on (100)-dominantly Si film using MLB-CLC with overlapping	○(D)Thuy Thi Nguyen ¹ , Tatsuki Hirata ¹ , Shin-Ichiro Kuroki ¹	1.The rearch institute for Nanodevice and Bio system, Hiroshima University
9:30	E 19a-S224-3	Simulation Study for Pulse Switching Probability of ReRAM	○Ernest Mlandeli Dlamini ¹ , Masataka Shirasawa ¹ , Yoshinari Kamakura ¹	1.Osaka Univ.
9:45	E 19a-S224-4	First-principles study of the impact of inter-dopants interaction on their wavefunctions in downscaled P-B co-doped Si nanorods	○(PC)Le The Anh ¹ , Daniel Moraru ² , Manoharan Muruganathan ¹ , Michiharu Tabe ² , Hiroshi Mizuta ^{1,3}	1.JAIST, 2.Shizuoka Univ., 3.Univ. of Southampton
10:00	奨 E 19a-S224-5	Investigation of Bilayer HfN Gate Insulator Formed by ECR Plasma Sputtering	○(D)Atthi Nithi ¹ , Shun-ichiro Ohmi ¹	1.Tokyo Tech
10:15		休憩 / Break		
10:30	E 19a-S224-6	Effect of Gate Dielectrics on Trap Density in PbS Nanocrystal Field-Effect Transistors	○(D)Mohamad Insan Nugraha ^{1,2} , Hiroyuki Matsui ¹ , Roger Hausermann ¹ , Satria Zulkarnaen Bisri ³ , Mykhailo Sytnyk ⁴ , Wolfgang Heiss ⁴ , Maria Antonietta Loi ² , Jun Takeya ¹	1.Univ. Tokyo, 2.Univ. Groningen, 3.RIKEN, 4.Univ. Linz
10:45	E 19a-S224-7	InGaN Quantum Nanodisks by Fusion of Bio-nanotemplate and Neutral Beam Etching processes	○Akio Higo ¹ , Cedric Thomas ² , Chang Yong Lee ² , Takayuki Kiba ³ , Shula Chen ⁴ , Tomoyuki Tanikawa ⁵ , Shigeyuki Kuboya ⁵ , Ryuji Katayama ⁵ , Kanako Shojiki ⁵ , Ichiro Yamashita ⁶ , Akihiro Murayama ⁴ , Seiji Samukawa ^{1,2}	1.AIMR, Tohoku Univ., 2.IFS, Tohoku Univ., 3.Kitami Inst. Tech, 4.IST, Hokkaido Univ., 5.IMR, Tohoku Univ., 6.NAIST

11:00	E 19a-S224-8	Temperature Dependent Operation of Different AlGaAs barrier Matrix and GaAs Quantum Nanodisks LED	○(PC) Cedric Thomas ¹ , Akio Higo ² , Takayuki Kiba ³ , Yosuke Tamura ¹ , Junichi Takayama ⁴ , Naofumi Okamoto ⁵ , Ichiro Yamashita ⁵ , Akihiro Murayama ⁴ , Seiji Samukawa ^{1,2}	1.Inst. Fluid Science, Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR, Tohoku Univ., 3.Kitam Inst. Technology, 4.Hokkaido Univ., 5.NAIST
11:15	E 19a-S224-9	Effect of non-halide lead precursors on CH ₃ NH ₂ PbI ₃ perovskite for photovoltaic applications	○ TRILOK SINGH ¹ , Tsutomu Miyasaka ¹	1.Toin Uni. of Yokohama
11:30	E 19a-S224-10	Synthesis and Solar Cell Application of Structure Controlled ZnO Nanocrystals	○ He Sun ¹ , Lina Sun ¹ , Takashi Sugiura ² , Matthew White ^{3,4} , Philipp Stadler ³ , Niyazi Sariciftci ⁴ , Akito Masuhara ¹ , Tsukasa Yoshida ¹	1.Yamagata Univ., 2.Gifu Univ., 3.Univ. of Vermont, 4.Linz Univ.
CS.3.3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session				
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場				
13:45	21p-S621-1	リング状共振器を用いたスピン-光軌道角運動量変換	○岩本 敏 ^{1,2} , 太田 泰友 ² , 荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
14:00	21p-S621-2	超高速波長変換素子に向けた InAs 量子ドットを有する GaAs/AlAs 多層膜三結合共振器	○盧 翔孟 ¹ , 熊谷 直人 ¹ , 北田 貴弘 ¹ , 井須 俊郎 ¹	1. 徳島大フロンティア
14:15	奨 21p-S621-3	量子ドット-ナノ共振器強結合系における時間分解発光測定	○車 一宏 ¹ , 太田 泰友 ² , 角田 雅弘 ² , 岩本 敏 ^{1,2} , 荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
14:30	21p-S621-4	3 連結合光ナノ共振器における光ラビ振動の動的反転操作の実証	○鴻池 遼太郎 ^{1,2} , 仲代 匡宏 ¹ , 田中 良典 ¹ , 浅野 卓 ¹ , 野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員
14:45	奨 21p-S621-5	量子ドット集合体におけるチャープパルスを用いたロバストなフォトンエコー生成	○(M1) 佐藤 嘉高 ¹ , 青沼 直登 ¹ , 赤羽 浩一 ² , 早瀬 潤子 ¹	1. 慶大理工, 2. 情報通信研究機構
15:00	21p-S621-6	結合共振器から生じる二波長レーザー光の時間的コヒーレンスの評価	○北田 貴弘 ¹ , 太田 寛人 ¹ , 原山 千穂 ¹ , 盧 翔孟 ¹ , 熊谷 直人 ¹ , 井須 俊郎 ¹	1. 徳島大院フロンティア
15:15		休憩 / Break		
15:30	奨 E 21p-S621-7	Modulation of Dynamic Nuclear Spin Polarization in Single InAs/GaAs Quantum Dots by Photonic Bandgap Effect	○(D) Chee Fai Fong ¹ , Yasutomo Ota ² , Satoshi Iwamoto ^{1,2} , Yasuhiko Arakawa ^{1,2}	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.Nanoquine
15:45	21p-S621-8	GaAs 中の窒素発光中心から発生した光子の量子干渉	○(D) 張 遼 ¹ , 池沢 道男 ¹ , 佐久間 芳樹 ² , 迫田 和彰 ² , 舩本 泰章 ¹	1. 筑波大物理, 2. 物質・材料研究機構
16:00	21p-S621-9	ピラー型微細形状を有する QDinF を用いた高純度単一光子状態の生成	○村上 大輔 ¹ , 小田島 聡 ² , 中島 秀郎 ³ , 熊野 英和 ¹ , 菅倉 弘理 ⁴	1. 北大理工, 2. 八戸工大, 3. 北大電子研, 4. 北大創成
16:15	21p-S621-10	量子エミッタを含む結合ナノ共振器系のダイナミクスの解析	○上出 健仁 ¹ , 岩本 敏 ^{1,2} , 荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子機構, 2. 東大生研
16:30	21p-S621-11	転写プリント法による数原子層黒リソフォニック結晶ナノ共振器結合系の作製	○太田 泰友 ¹ , 守谷 頼 ² , 矢吹 直人 ² , 荒井 美穂 ² , 角田 雅弘 ¹ , 岩本 敏 ^{1,2} , 町田 友樹 ^{1,2} , 荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子, 2. 東大生研
16:45	21p-S621-12	転写プリント法を用いた量子ドットを有するプラズモニックマイクロリング共振器の作製と光学特性評価	○玉田 晃均 ¹ , 太田 泰友 ² , 車 一宏 ¹ , Jinfa Ho ² , 渡邊 克之 ² , 岩本 敏 ^{1,2} , 荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
17:00		休憩 / Break		
17:15	21p-S621-13	動的熱輻射制御に伴う光源温度及び輻射パワーの過渡応答特性	○井上 卓也 ^{1,2} , 浅野 卓 ¹ , 野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員 DC
17:30	奨 21p-S621-14	2 波長切替型中赤外熱輻射光源の設計	○紀 安き ¹ , 井上 卓也 ^{1,2} , De Zoysa Menaka ^{1,3} , 浅野 卓 ¹ , 野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員 DC, 3. 京大白眉
17:45	21p-S621-15	電気機械フォノン導波路を用いた周波数多重化演算の可能な論理ゲート素子	○畑中 大樹 ¹ , ダラス トム ¹ , マーブ イムラン ¹ , 小野満 恒二 ¹ , 山口 浩司 ¹	1.NTT 物性研
18:00	奨 21p-S621-16	GaN/AlGaIn 多重量子井戸とフォトニック結晶に基づく中波長赤外熱輻射光源の開発	○(D) Kang Daniel Dongyeon ¹ , 井上 卓也 ^{1,2} , 浅野 卓 ¹ , 野田 進 ¹	1. 京都大学, 2. 学振特別研究員 DC
18:15	21p-S621-17	MgO 基板上的の狭帯域近赤外 Si フォトニック結晶熱輻射光源の開発	○末光 真大 ¹ , 堤 達紀 ² , 浅野 卓 ² , De Zoysa Menaka ^{2,3} , 野田 進 ²	1. 大阪ガス, 2. 京大院工, 3. 京大白眉
18:30	21p-S621-18	埋込ヘテロ構造共振器を用いたフォトニック結晶 PT 対称結合共振器導波路の解析	○高田 健太 ^{1,2} , 納富 雅也 ^{1,2}	1.NTT 物性研, 2.NTT NPC
18:45	21p-S621-19	コヒーレント状態と個数状態を用いたハイブリッド解析手法の微小共振器ラマン効果への応用	○乾 善貴 ¹ , 浅野 卓 ¹ , 高橋 和 ² , 野田 進 ¹	1. 京大院工, 2. 阪府大院
13.7 ナノ構造・量子現象 / Nano structures and quantum phenomena				
3/20(Sun.) 9:00 - 10:45 口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場				
9:00	20a-S223-1	Zn カルコゲナイドナノシート超格子の作製と光物性	○(M1) 草加 健太 ¹ , 松石 清人 ¹	1. 筑波大数物
9:15	20a-S223-2	X 線回折を用いた PbS 量子ドット超格子の配列評価技術	○藤本 智士 ¹ , 中塚 裕斗 ² , 加納 朋弥 ² , 向井 剛輝 ^{1,2}	1. 横浜国大理工, 2. 横浜国大院工
9:30	20a-S223-3	【注目講演】表面 In(Ga)As 量子ドット仕事関数の歪依存性	○(M1) 小林 知弘 ¹ , 高林 統 ¹ , Zhang Yuwei ¹ , 山田 郁彦 ¹ , 神谷 格 ¹	1. 豊田工大
9:45	20a-S223-4	単一 InAs 量子リング正孔 g 因子の面内異方性と歪・形状異方性	○(M1) 富永 隆宏 ¹ , 鍛冶 怜奈 ¹ , 吳 祐年 ² , 巫 明帆 ² , 鄭 舜仁 ² , 足立 智 ¹	1. 北大理工, 2. 台湾国立交通大
10:00	20a-S223-5	零磁場下における核磁場形成と検出	○松崎 亮典 ¹ , 山本 壮太 ¹ , 足立 智 ¹ , 鍛冶 怜奈 ¹	1. 北大理工
10:15	20a-S223-6	Hanle 効果による単一量子ドットの面内核磁場検出	○(B) 山本 壮太 ¹ , 松崎 亮典 ¹ , 鍛冶 怜奈 ¹ , 足立 智 ¹	1. 北大工
10:30	20a-S223-7	CaF ₂ /Si/CaF ₂ 共鳴トンネル構造の室温微分性抵抗特性	○田辺 直之 ¹ , 望月 雅人 ¹ , 須田 慶太 ¹ , 島中 智史 ¹ , 渡辺 正裕 ¹	1. 東工大総理工
3/20(Sun.) 13:45 - 15:45 口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場				
13:45	20p-S223-1	配位子交換による PbS 量子ドット超格子の電子結合状態の制御	○末統 文正 ¹ , 加納 朋弥 ² , 丹羽 慶輔 ² , 向井 剛輝 ^{1,2}	1. 横浜国大理工, 2. 横浜国大院工
14:00	20p-S223-2	PbS 量子ドット位置制御のための Si ナノ・テンプレートの改良	○山下 洲造 ¹ , 広田 章展 ² , 向井 剛輝 ^{1,2}	1. 横浜国大理工, 2. 横浜国大院工
14:15	20p-S223-3	チャープパルスを用いた量子ドット集合体のロバストな量子制御	○(B) 青沼 直登 ¹ , 佐藤 嘉高 ¹ , 赤羽 浩一 ² , 早瀬 潤子 ¹	1. 慶大, 2. 情報通信研究機構
14:30	20p-S223-4	Er イオンにおける誘導ラマン断熱通過	○濱田 裕紀 ¹ , 〇俵 毅彦 ^{1,2} , 足立 智 ³ , アレシユ イエナス ¹ , 尾身 博雄 ^{1,2} , 後藤 秀樹 ¹	1.NTT 物性研, 2.NTT ナノフォニクスセンタ, 3. 北大工
14:45	20p-S223-5	時間分解発光強度相関測定による単一ナノ粒子中の励起子分子オーজে再結合過程の研究	○広重 直 ¹ , 井原 章之 ¹ , 金光 義彦 ¹	1. 京大化研
15:00	20p-S223-6	pnpn 構造 GaAs における電子スピン緩和の時間分解測定	○両角 篤志 ^{1,2} , 伊藤 哲 ^{1,2} , 市田 正夫 ³ , 安藤 弘明 ³	1. 静岡大電子研, 2. 静岡大院総合科学, 3. 甲南大理工
15:15	奨 20p-S223-7	GaAs/AlGaAs/AlAs タイプ II トンネル双量子井戸のスピン緩和の温度依存性	○中山 航 ¹ , 有竹 貴紀 ¹ , Wu Hao ¹ , ショウ サンウ ¹ , 中村 芳樹 ¹ , 武藤 俊一 ² , 竹内 淳 ¹	1. 早大先進理工, 2. 北大理工

15:30	奨 20p-S223-8	In _{0.6} Ga _{0.2} As/Al _{0.5} Ga _{0.3} As/AlAs _{0.5} Sb _{0.41} 結合量子井戸におけるスピン緩和の観測	○石川 友樹 ¹ 、牛頭 一郎 ² 、物集 照夫 ² 、浅川 将 ¹ 、早大先進理工、2. 産業技術総合研究所 輝 ¹ 、大木 俊介 ¹ 、竹内 淳 ¹
13.8 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術 / Compound and power electron devices and process technology			
3/20(Sun.)	13:30 - 15:30	ポスター講演 (Poster Presentation) P9 会場	
	20p-P9-1	表面リセス型電極構造を用いた AlGaIn 系 PIN 型 UV フォトダイオードの作製および特性評価	○岡田 真由子 ¹ 、宮地 祐太 ¹ 、三好 実人 ¹ 、江川 孝 ¹ 、名工大 志 ¹
	20p-P9-2	GaN 自立基板を用いた InAlN/AlN/GaN HEMT のデバイス特性	○山下 良美 ¹ 、渡邊 一世 ¹ 、遠藤 聡 ^{1,2} 、笠松 章史 ¹ 、1. 情報通信研究機構、2. 富士通研 三村 高志 ^{1,2}
	20p-P9-3	SiO ₂ を用いた GaN 基板上 MOSFET の Mg 濃度依存性	○上野 勝典 ¹ 、高島 信也 ¹ 、稲本 拓朗 ¹ 、松山 秀昭 ¹ 、1. 富士電機 (株)、2. 山梨大 1、江戸 雅晴 ¹ 、中川 清和 ²
	20p-P9-4	プラズマ CVD SiO ₂ /InAlN 界面への Al ₂ O ₃ 超薄膜層挿入の効果	○(M1) 清野 惇 ¹ 、長谷崎 泰斗 ¹ 、横田 直茂 ¹ 、赤 澤 正道 ¹ 、1. 北大 量集センター
E	20p-P9-5	Catalyst free direct deposition of multilayer graphene on GaN by solid phase precipitation.	○(D)Md Sahab Uddin ¹ 、Kazuyoshi Ueno ^{1,2} 、1. Shibaura Inst. Tech., 2. SITI RCGI
	20p-P9-6	InAlN/GaN ヘテロ構造の InAlN バリア層における成長速度依存性	○浦山 雄也 ¹ 、渡邊 新 ¹ 、江川 孝志 ¹ 、1. 名古屋工業大学大学院
	20p-P9-7	大口径対向縦型 MOCVD 炉による GaN/AlGaIn/GaN ヘテロエピ成長	○中村 文彦 ¹ 、平田 祥子 ¹ 、杉浦 浩 ¹ 、河合 弘治 ¹ 、1. パウデック
	20p-P9-8	n-GaN に水素イオン注入で誘起されたトラップの評価	○(M1) 上田 聖悟 ¹ 、後藤 雅浩 ¹ 、高林 洗太 ¹ 、徳田 豊 ¹ 、塩島 謙次 ² 、伊藤 成志 ³ 、八木 孝秀 ³ 古賀 祐介 ¹ 、井上 凌兵 ¹ 、○中村 成志 ¹ 、奥村 次徳 ¹ 、1. 首都大理工
	20p-P9-9	n 型および p 型 GaN 中のプラズマ照射誘起欠陥挙動	○中野 由崇 ¹ 、坂井 佑輔 ¹ 、新部 正人 ² 、川上 烈生 ¹ 、1. 中部大、2. 兵庫県立大、3. 徳島大
	20p-P9-10	CF ₄ プラズマ処理した n-GaN 膜の電気的評価	○中野 由崇 ¹ 、坂井 佑輔 ¹ 、新部 正人 ² 、川上 烈生 ¹ 、1. 中部大、2. 兵庫県立大、3. 徳島大
E	20p-P9-11	Fabrication of GaN Porous Structures Using Photo-Electrochemical Etching and Electrode Response	○Xiaoyi Zhang ¹ 、Keisuke Ito ¹ 、Hirofumi Kida ¹ 、Yusuke Kumazaki ¹ 、Taketo Sato ¹ 、1. RCIQE, Hokkaido Univ.
	20p-P9-12	光電気化学反応を利用した GaN 表面の陽極酸化	○枝元 将彰 ¹ 、熊崎 祐介 ¹ 、佐藤 威友 ¹ 、1. 北海道大量集
	20p-P9-13	プライマー層を用いた Cu/AlN 接合界面の密着強度改善	○佐藤 宏太郎 ¹ 、安藤 大輔 ¹ 、須藤 祐司 ¹ 、小池 淳一 ¹ 、1. 東北大工
	20p-P9-14	InAs 系 PHEMT における Auger 再結合	○佐藤 宇人 ¹ 、西尾 結 ¹ 、平山 尚美 ¹ 、飯田 努 ¹ 、高梨 良文 ¹ 、1. 東理大基礎工
	20p-P9-15	SLS 回数と成長温度の最適化による InSb-HEMT 構造の電気的特性向上	○(M2) 加藤 三四郎 ¹ 、宮下 愛理、藤川 紗千恵、藤代 博記、1. 東京理科大学大学院
奨	20p-P9-16	Ar プラズマエッチングを用いた二段階ゲートリセス構造を持つ InGaAs 系 HEMT の試作とその特性	○細谷 友崇 ¹ 、尾辻 泰一 ¹ 、末光 哲也 ¹ 、1. 東北大通研
奨	20p-P9-17	InGaAsSb/InP DHBT におけるベースコンタクト抵抗低減手法	○星 拓也 ¹ 、柏尾 典秀 ² 、白鳥 悠太 ¹ 、杉山 弘樹 ¹ 、栗島 賢二 ¹ 、井田 実 ¹ 、松崎 秀昭 ¹ 、1. NTT 先端集積デバイス研、2. NTT デバイスイノベーションセンタ
	20p-P9-18	高濃度 Sn ドープ beta-Ga ₂ O ₃ (-2 0 1) 単結晶の温度特性の検討	○大石 敏之 ¹ 、嘉数 誠 ¹ 、1. 佐賀大院工
	20p-P9-19	高効率無線電力伝送を目指したダイヤモンド・レクテナデバイスの提案	○大石 敏之 ¹ 、河野 直士 ¹ 、嘉数 誠 ¹ 、1. 佐賀大院工
奨	20p-P9-20	ダイヤモンド素子を用いたレクテナ回路の作製	○(B) 河野 直士 ¹ 、大石 敏之 ¹ 、嘉数 誠 ¹ 、1. 佐賀大院工
	20p-P9-21	GaN 表面 CARE 加工の反応メカニズムの第一原理計算による解析 II - 表面キックサイト周辺の H ₂ O 終端構造 -	○稲垣 耕司 ¹ 、Pho Van Bui ¹ 、磯橋 藍 ¹ 、藤 大雪 ¹ 、森川 良忠 ¹ 、山内 和人 ¹ 、1. 阪大院工
	20p-P9-22	人工知能融合超高速化量子分子動力学法の開発と化合物半導体プロセスへの応用	○石澤 由紀江 ¹ 、稲葉 賢二 ¹ 、小原 幸子 ¹ 、佐藤 絵美 ¹ 、佐藤 愛美 ¹ 、宮野 正之 ¹ 、ポノーバトリック ¹ 、三浦 隆治 ¹ 、鈴木 愛 ¹ 、宮本 直人 ¹ 、畠山 望 ¹ 、宮本 明 ¹ 、1. 東北大学
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場			
9:00	21a-W541-1	自立 GaN 基板上 p-n 接合ダイオードにおける順方向電流集中領域の検討	○林 賢太郎 ¹ 、太田 博 ¹ 、金田 直樹 ² 、堀切 文正 ³ 、成田 好伸 ³ 、吉田 丈洋 ³ 、三島 友義 ¹ 、中村 徹 ¹ 、1. 法政大、2. クオラムスプレッド、3. サイオクス
9:15	21a-W541-2	自立基板の劈開面に形成した n-GaN ショットキー接触の評価 (2) - 表面処理の影響 -	○永縄 萌 ¹ 、青木 俊親 ¹ 、三島 友義 ² 、塩島 謙次 ¹ 、1. 福大院工、2. 法政大
9:30	21a-W541-3	Au/p 形ダイヤモンドショットキー接触の変位電流 - p 形 GaN ショットキー接触との比較 -	○塩島 謙次 ¹ 、青木 俊周 ¹ 、寺地 徳之 ² 、小出 康夫 ¹ 、1. 福井大院工、2. 物質・材料研究機構
9:45	21a-W541-4	Ag ナノインクの印刷により形成した Ag/n-GaN ショットキー接触の 2 次元評価 (2)	○新郷 正人 ¹ 、伊藤 尊史 ¹ 、柏木 行康 ² 、重宗 翼 ³ 、小泉 淳 ³ 、児島 貴徳 ³ 、齊藤 大志 ² 、松川 公洋 ² 、藤原 康文 ³ 、塩島 謙次 ¹ 、1. 福井大院工、2. 大阪市工研、3. 阪大院工
10:00	21a-W541-5	ICP エッチングにより GaN 表面に導入された損傷の界面顕微光応答法による 2 次元評価	○今立 宏美 ¹ 、寺野 昭久 ¹ 、塩島 謙次 ¹ 、1. 福井大院工
10:15	21a-W541-6	フォトキャパシタンス測定による GaN 中のプラズマ照射誘起欠陥の評価	折茂 力都 ¹ 、大西 健太 ¹ 、○中村 成志 ¹ 、奥村 次徳 ¹ 、1. 首都大理工
10:30	休憩 / Break		
10:45	21a-W541-7	ホモエピタキシャル成長低ドーブ n 型 GaN の深さ方向ドナー密度分布解析における深い準位の影響	○須田 淳 ¹ 、堀田 昌宏 ¹ 、前田 拓也 ² 、澤田 直暉 ¹ 、木本 恒暢 ¹ 、1. 京大院工、2. 京大工
11:00	21a-W541-8	過渡容量測定によるホモエピタキシャル成長 n 型 GaN の深い準位密度のウェハ内マッピング評価	○堀田 昌宏 ¹ 、成田 哲生 ² 、加地 徹 ² 、須田 淳 ¹ 、1. 京大院工、2. 豊田中研
11:15	21a-W541-9	GaN 基板上低キャリア厚膜 n-GaN ショットキー接触の DLTS 評価	○塩島 謙次 ¹ 、田中 丈士 ^{1,2} 、三島 友義 ³ 、徳田 豊 ⁴ 、1. 福井大院工、2. サイオクス (株)、3. 法政大学、4. 愛知工大
11:30	21a-W541-10	高 N ₂ /N ₂ 比の MOCVD n-GaN の一定容量 DLTS 測定	○(M1) 上田 聖悟 ¹ 、宮本 一輝 ¹ 、徳田 豊 ¹ 、1. 愛知工大
11:45	奨 21a-W541-11	GaN 基板上 GaN ショットキーダイオードにおける転位と深い準位の関連性評価	○間瀬 駿 ¹ 、浦山 雄也 ¹ 、江川 孝志 ¹ 、1. 名工大
12:00	奨 21a-W541-12	逆バイアス電圧印加 n 型 GaN ショットキーバリアダイオードにおける Franz-Keldysh 効果に起因したサブバンドギャップ光吸収による光電流	○(B) 前田 拓也 ¹ 、岡田 政也 ² 、上野 昌紀 ² 、山本 喜之 ² 、堀田 昌宏 ³ 、須田 淳 ³ 、1. 京大工、2. 住友電工、3. 京大院工

3/21(Mon.) 13:45 - 17:00 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場			
13:45	奨 21p-W541-1	AlGaIn/GaN HEMT オフ耐圧と EL 発光との相関	○(M1) 吉田 知司 ¹ 、大井 慎太郎 ¹ 、山崎 泰誠 ¹ 、1. 福井大院工 Asubar Joel ¹ 、徳田 博邦 ¹ 、葛原 正明 ¹
14:00	21p-W541-2	スパッタ成膜したアルミナ系絶縁膜 / AlGaIn 界面の TEM 観察	○野崎 幹人 ¹ 、浅原 亮平 ¹ 、伊藤 丈予 ¹ 、渡邊 健太 ¹ 、1. 阪大院工、2. パナソニック 山田 高寛 ¹ 、中澤 敏志 ² 、按田 義治 ² 、石田 昌宏 ² 、 上田 哲三 ² 、細井 卓治 ¹ 、志村 考功 ¹ 、渡部 平司 ¹
14:15	奨 21p-W541-3	AlGaIn/GaN MOS-HEMT における SiO ₂ /AlON 積層ゲート絶縁膜の検討	○(B) 渡邊 健太 ¹ 、浅原 亮平 ¹ 、伊藤 丈予 ¹ 、野崎 幹人 ¹ 、山田 高寛 ¹ 、中澤 敏志 ² 、按田 義治 ² 、石田 昌宏 ² 、上田 哲三 ² 、細井 卓治 ¹ 、志村 考功 ¹ 、渡部 平司 ¹
14:30	奨 21p-W541-4	AlGaIn/GaN 系ノーマリーオフ P チャネル MOS-HFET における基板バイアス効果	○久保田 俊介 ¹ 、中島 昭 ² 、西澤 伸一 ² 、大橋 弘通 ¹ 、1. 東工大総理工、2. 産総研 ¹ 、角嶋 邦之 ¹ 、若林 整 ¹ 、筒井 一生 ¹
14:45	奨 21p-W541-5	トレンチ構造をもつ GaN 縦型 MOSFET の特性評価	○(M1) 篠倉 暁希 ¹ 、徳田 博邦 ¹ 、江戸 雅晴 ² 、上 野 勝典 ² 、葛原 正明 ¹
15:00	21p-W541-6	Si 基板上 AlGaIn/GaN HEMT 構造縦方向リーク電流の AlGaIn 緩衝層 Al 組成依存性	○山岡 優哉 ^{1,2} 、伊藤 和宏 ² 、生方 映徳 ¹ 、矢野 良樹 ¹ 、1. 太陽日酸、2. 名工大 田淵 俊也 ¹ 、松本 功 ¹ 、江川 孝志 ²
15:15	休憩 / Break		
15:30	21p-W541-7	ノーマリーオフ GaN HEMT のダイオード動作における耐圧および容量特性	○加藤 直樹 ¹ 、永井 昂哉 ¹ 、成田 智隆 ¹ 、長田 大和 ² 、1. 名工大、2. ULVAC、3. 金沢工大 上村 隆一郎 ² 、伊東 健治 ³ 、分島 彰男 ¹ 、江川 孝 ¹
15:45	21p-W541-8	自立 GaN 基板上イオン注入 MISFET のノーマリーオフ動作	○菅又 滉大 ¹ 、金田 直樹 ² 、三島 友義 ¹ 、中村 徹 ¹ 1. 法政大、2. クオラムスプレッド
16:00	21p-W541-9	銅板平坦化による AlGaIn/GaN 転写 HEMT の放熱性の改善	○廣木 正伸 ¹ 、熊倉 一英 ¹ 、山本 秀樹 ¹ 1. NTT 物性研
16:15	21p-W541-10	カスコード接続したサファイア基板上 GaN PSJ (分極超接合) トランジスタの 1,000 V スイッチング特性	○八木 修一 ¹ 、平田 祥子 ¹ 、神山 祐輔 ¹ 、中村 文彦 ¹ 、1. パウデック 齋藤 武尊 ¹ 、河合 弘治 ¹
16:30	21p-W541-11	高誘電率絶縁膜を用いた FP 電極を有する縦型 GaN ダイオード	○吉野 理貴 ¹ 、堀切 文正 ² 、太田 博 ¹ 、山本 康博 ¹ 、1. 法政大、2. サイオクス 三島 友義 ¹ 、中村 徹 ¹
16:45	21p-W541-12	Si 基板上 GaAs/GaN ヘテロ接合の縦方向電気特性評価	○(M1) 山條 翔二 ¹ 、尹 翔至 ¹ 、梁 剣波 ¹ 、渡邊 則之 ² 、1. 大阪市大工、2. NTT 先端集積デバイス研 重川 直輝 ¹
3/22(Tue.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場			
9:00	22a-W541-1	放射光を用いた X 線光電子分光による成膜後アニールを施した ALD-HfO ₂ /AlGaIn 界面の評価	○久保 俊晴 ¹ 、西野 剛介 ¹ 、江川 孝志 ¹ 1. 名工大
9:15	奨 22a-W541-2	AlGaIn/GaN HEMT への凹凸 AlGaIn 層導入によるコンタクト抵抗低減効果のメカニズム解明	○武井 優典 ¹ 、下田 智裕 ¹ 、高橋 昌靖 ¹ 、筒井 一生 ¹ 、1. 東工大、2. 東芝セミコンダクター&ストレージ社 齋藤 渉 ² 、角嶋 邦之 ¹ 、若林 整 ¹ 、岩井 洋 ¹
9:30	22a-W541-3	Fe 層を挿入した TiN 電極と pGaN の電流電圧特性	○池内 勇太 ¹ 、若林 整 ¹ 、筒井 一生 ¹ 、岩井 洋 ¹ 、1. 東工大総理工 角嶋 邦之 ¹
9:45	22a-W541-4	低欠陥密度 GaN 基板の熱酸化過程の評価	○山田 高寛 ¹ 、伊藤 丈予 ¹ 、浅原 亮平 ¹ 、渡邊 健太 ¹ 、1. 阪大院工、2. パナソニック、3. 原子力機構 野崎 幹人 ¹ 、中澤 敏志 ² 、按田 義治 ² 、石田 昌宏 ² 、 上田 哲三 ² 、吉越 章隆 ³ 、細井 卓治 ¹ 、志村 考功 ¹ 、 渡部 平司 ¹
10:00	22a-W541-5	GaN 表面熱酸化処理による MOS 界面特性の向上	○山田 高寛 ¹ 、伊藤 丈予 ¹ 、浅原 亮平 ¹ 、渡邊 健太 ¹ 、1. 阪大院工 野崎 幹人 ¹ 、細井 卓治 ¹ 、志村 考功 ¹ 、渡部 平司 ¹
10:15	休憩 / Break		
10:30	奨 22a-W541-6	高温アニールプロセスが GaN MOSFET 特性に与える影響	○西口 賢弥 ¹ 、橋詰 保 ¹ 1. 北海道大学量子集積エレクトロニクス研究センター
10:45	22a-W541-7	Al ₂ O ₃ あるいは AlTiO ₂ ゲート絶縁膜を用いた InAlIn-GaN 金属 / 絶縁体 / 半導体構造における絶縁体 / 半導体界面固定電荷	○山口 横也 ¹ 、宇井 利昌 ¹ 、長谷川 貴大 ¹ 1. 北陸先端大
11:00	奨 22a-W541-8	高圧水蒸気処理を施した SiO ₂ /GaN 縦型 MOS キャパシタの電気的特性評価	○富永 雄太 ¹ 、上野 勝典 ² 、吉嗣 晃治 ¹ 、多田 雄貴 ¹ 、1. 奈良先端大、2. 富士電機 石河 泰明 ¹ 、浦岡 行治 ¹
11:15	奨 22a-W541-9	中性粒子ビームエッチングによる AlGaIn/GaN HEMT の素子間リーク電流抑制効果	○遠見 ふゆみ ¹ 、Thomas Cedric ² 、Lai Yi-Chun ³ 、1. 東北大通研、2. 東北大流体研、3. 東北大 AIMR、4. MTL 肥後 昭男 ³ 、Guo Alex ⁴ 、Warnock Shireen ⁴ 、del MIT Alamo Jesus A. ⁴ 、寒川 誠二 ^{2,3} 、尾辻 泰一 ¹ 、末光 哲也 ¹
11:30	22a-W541-10	酸化・還元反応場を同一基板上に形成した金属 / GaN 光触媒薄膜	○渦巻 裕也 ¹ 、小野 陽子 ¹ 、小川 重男 ¹ 、谷保 芳孝 ¹ 、1. NTT 先デ研、2. NTT 物性研 熊倉 一英 ² 、小松 武志 ¹
3/22(Tue.) 13:00 - 15:00 口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場			
13:00	奨 22p-W541-1	原子拡散接合で作製された PIN-ダイオードの電気特性	○山田 友輝 ¹ 、魚本 幸 ² 、島津 武仁 ² 、名田 允洋 ¹ 、1. NTT 先端集積デバイス研、2. 東北大学 松崎 秀昭 ¹
13:15	奨 22p-W541-2	蒸着 SiO ₂ 膜を用いた f _T = 300GHz 超 InSb-HEMT の作製	○(M2) 辻 大介 ¹ 、磯野 恭佑 ¹ 、竹鶴 達哉 ¹ 、藤川 紗千恵 ¹ 、渡邊 一世 ² 、山下 良美 ² 、遠藤 聡 ² 、原 紳介 ² 、笠松 章史 ² 、藤代 博記 ¹
13:30	22p-W541-3	50 GHz 帯における InGaAs/InAlAs HEMT の雑音特性	○渡邊 一世 ¹ 、遠藤 聡 ^{1,2} 、三村 高志 ^{1,2} 、笠松 章史 ¹ 1. 情報通信研究機構、2. 富士通研究所 ¹
13:45	22p-W541-4	f _T > 500 GHz を有するメタルサブコレクタ InP/InGaAsSb DHBT	○白鳥 悠太 ¹ 、星 拓也 ¹ 、柏尾 典秀 ² 、栗島 賢二 ¹ 、1. NTT 先端集積デバイス研、2. NTT デバイスイノベーションセンタ、3. 東京大学 日暮 栄治 ³ 、松崎 秀昭 ¹
14:00	22p-W541-5	再成長 S/D を有する InGaAs マルチゲート MOSFET の Lch=16nm 動作	○木下 治紀 ¹ 、木瀬 信和 ¹ 、柗津 誠晃 ¹ 、金澤 徹 ¹ 、1. 東工大理工 宮本 恭幸 ¹
14:15	22p-W541-6	ダブル NO ₂ ホールドーピングを用いたダイヤモンド電界効果トランジスタの作製	○嘉数 誠 ¹ 、原田 和也 ¹ 、古賀 優太 ¹ 、花田 賢志 ¹ 、1. 佐賀大院工 大石 敏之 ¹
14:30	22p-W541-7	Ga ₂ O ₃ (010) 上に堆積した SiO ₂ 膜におけるポストアニールの影響	○小西 敬太 ¹ 、上村 崇史 ¹ 、ワン マンホイ ¹ 、佐々木 公平 ^{2,1} 、倉又 朗人 ² 、山腰 茂伸 ² 、東脇 正高 ¹
14:45	E 22p-W541-8	Field-Plated Ga ₂ O ₃ MOSFETs With a Breakdown Voltage of Over 750 V	○ManHoi Wong ¹ 、Kohei Sasaki ^{2,1} 、Akito Kuramata ² 、1. NICT、2. Tamura Corp. Shigenobu Yamakoshi ² 、Masataka Higashiwaki ¹
13.9 光物性・発光デバイス / Optical properties and light-emitting devices			
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P10 会場			
	20p-P10-1	Yb ³⁺ と Tm ³⁺ を添加した Zn ₂ TiO ₄ アップコンバージョン蛍光体の焼成温度依存性	○野中 俊宏 ¹ 、大山 湊人 ¹ 、菖蒲 勇 ¹ 、杉村 健太郎 ¹ 、1. 龍谷大理工 山本 伸一 ¹
	20p-P10-2	ナノストライプ電極を用いた無機 EL パネルの光学特性	○野中 俊宏 ¹ 、森 啓補 ¹ 、山本 伸一 ¹ 1. 龍谷大理工

20p-P10-3	粉末希土類を添加したアップコンバージョン蛍光体の発光特性評価	○木村 大海 ¹ 、野中 俊宏 ¹ 、大山 溪人 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大学
20p-P10-4	イットリウムチオシリケート蛍光体の温度特性に関する研究	○溝澤 隆太郎 ¹ 、鈴木 洋介 ¹ 、奥野 剛史 ¹ 、七井 靖 ¹	1. 電通大先進理工, 2. 日大文理
20p-P10-5	高圧相 SrO:Ce 紫外蛍光体のカソードルミネッセンス	○小松 啓志 ¹ 、中村 淳 ^{2,1} 、齋藤 秀俊 ¹	1. 長岡技科大, 2. 中部キレスト
20p-P10-6	Ce:Lu ₃ Al ₅ O ₁₂ 結晶における電子スピン共鳴スペクトルのアルカリ土類イオン共添加効果	○(M2) 李 守鎬 ¹ 、北浦 守 ² 、鎌田 圭 ³ 、黒澤 俊介 ³ 、大西 彰正 ² 、原 和彦 ⁴	1. 山形大院理工, 2. 山形理, 3. 東北大 NiChe, 4. 静岡大電研
20p-P10-7	添加物による Y ₄ (Si ₃) ₃ 蛍光体の発光特性の研究	○鈴木 智大 ¹ 、奥野 剛史 ¹ 、七井 靖 ²	1. 電通大先進理工, 2. 日大文理
20p-P10-8	Y ₄ (Si ₃) ₃ :Ce ³⁺ 蛍光体の粒径および均一性の評価	○片柳 賢祐 ¹ 、奥野 剛史 ¹ 、七井 靖 ² 、御園生 敏行 ³ 、佐藤 義孝 ³	1. 電気通信大学, 2. 日本大学, 3. 双葉電子工業
20p-P10-9	Sr ₂ SiO ₄ :Eu シリケート蛍光体の還元雰囲気における相制御	矢倉 浩太 ¹ 、○加藤 有行 ¹	1. 長岡技科大理工
20p-P10-10	液中酸化還元反応プローブ用 K ₂ PO ₄ :Eu 蛍光体のポリオール法を用いた微細化による感度の向上	常盤 庸平 ¹ 、濱谷 憲太 ¹ 、高橋 一匡 ¹ 、佐々木 徹 ¹ 、菊池 崇志 ¹ 、原田 信弘 ¹ 、○加藤 有行 ¹	1. 長岡技科大理工
20p-P10-11	CaY ₂ Si ₂ S ₈ :Eu ²⁺ チオシリケート蛍光体の発光特性	○田邊 冬夢 ¹ 、加藤 有行 ¹	1. 長岡技科大理工
20p-P10-12	Sr-Al-O 系蛍光体における Sr 比の構造および発光特性に及ぼす影響	○赤堀 太一 ¹ 、羽田 京右 ² 、小南 裕子 ¹ 、原 和彦 ³ 、中西 洋一郎 ³	1. 静岡大院, 2. 静岡大工, 3. 静岡大電子研
20p-P10-13	SrAl ₂ O ₄ :Eu 結晶における電子トラップの熱安定性	○北浦 守 ¹ 、鶴見 祐太 ¹ 、大西 彰正 ¹ 、石橋 知也 ² 、古川 翔子 ² 、小田 久哉 ² 、山中 明生 ²	1. 山形大理工, 2. 千歳科技大
20p-P10-14	過冷却融液の固化およびガラスの結晶化により合成した高温相 β-SrAl ₂ O ₄ の長残光特性と B ₂ O ₃ 添加の効果	○篠崎 健二 ¹ 、小高 幹也 ¹ 、本間 剛 ¹ 、Affatigato Mario ² 、小松 高行 ¹	1. 長岡技科大, 2. コー大学
20p-P10-15	YVO ₄ :Bi ³⁺ , Eu ³⁺ 蛍光ナノ粒子の新規液相合成法の探究 (II)	○(M1) 大野 貴之 ¹ 、磯 由樹 ¹ 、磯部 徹彦 ¹	1. 慶大理工
20p-P10-16	再沈法を用いた Eu 錯体コロイド含有シリカガラスの耐光性改善	八巻 建樹 ¹ 、○福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、本多 善太郎 ¹	1. 埼玉大
20p-P10-17	スピコート法を用いた Eu 添加 SnO ₂ 薄膜の作製と評価	○澤島 淳二 ¹ 、秋元 伊織 ¹	1. 茨城高専
20p-P10-18	ユーロビウム添加ジベンジルメタントリアンモニウム	ラナシンゲマノジ ¹ 、ラジャバクセ ガーミニ ² 、奥 谷 昌之 ³ 、下村 勝 ³ 、○村上 健司 ³	1. 静岡大院創造, 2. ベラデニア大化学, 3. 静岡大院総合
20p-P10-19	黄色から赤色の残光蛍光体 Ca ₂ Si ₂ :Eu における Nd ³⁺ 、Gd ³⁺ 添加の影響	○清水 裕介 ¹ 、奥野 剛史 ¹ 、七井 靖 ²	1. 電通大先進理工, 2. 日大文理
奨 20p-P10-20	層状応力発光化合物 Sr ₃ Sn ₂ O ₇ :Sm ³⁺ の応力発光特性の向上機構	○(M1) 浜辺 竜太 ^{1,2} 、塗 東 ² 、吉田 晃人 ² 、徐 超男 ^{1,2}	1. 九州大総理工, 2. 産総研
20p-P10-21	TiO ₂ 薄膜に添加した Sm ³⁺ イオンの局所構造と発光特性	○村山 真理子 ¹ 、森本 えつこ ¹ 、柳田 祐嗣 ¹ 、小室 修二 ² 、趙 新為 ¹	1. 東理大理工, 2. 東洋大理工
20p-P10-22	n-TiO ₂ :Sm ³⁺ /p-NiO/Ni 発光素子の発光特性	○柳田 祐嗣 ¹ 、村山 真理子 ¹ 、小室 修二 ² 、趙 新為 ¹	1. 東理大理工, 2. 東洋大理工
20p-P10-23	有機無機励起共鳴アミノアクリジン-ZnSe/CdSe ナノ粒子複合体の光学特性評価	○(M1) 矢幅 拓真 ¹ 、越水 正典 ¹ 、藤本 裕 ¹ 、浅井 圭介 ¹	1. 東北大院工
20p-P10-24	TMAS 誘導シリカに包埋された CuInS ₂ /ZnS/ZnS 量子ドットの発光特性	○(M1) 和田 知歌子 ¹ 、磯 由樹 ¹ 、磯部 徹彦 ¹ 、佐々木 洋和 ²	1. 慶大理工, 2. 昭栄化学工業
20p-P10-25	量子ドット Cu-In-S/ZnS のコアシェル構造比の発光特性	○伊藤 里早 ¹ 、山本 伸一 ¹ 、長久保 準基 ²	1. 龍谷大学, 2. アルバック
20p-P10-26	ガス輸送相成長法による ZnSe ナノワイヤーの作製と評価	○松本 和也 ¹ 、尾崎 俊二 ¹	1. 群馬大理工
20p-P10-27	亜酸化銅を用いた直流駆動無機 EL の電気伝導性の検討	○橋向 一樹 ¹ 、鈴木 幹太郎 ¹ 、三浦 登 ¹	1. 明大理工
20p-P10-28	フレキシブル基板を用いた張り合わせ両面発光分散型無機 EL の特性	○森 啓輔 ¹ 、山本 伸一 ¹	1. 龍谷大学
20p-P10-29	片側絶縁直流駆動無機 EL における発光位置の検討	○佐々木 翔 ¹ 、大西 雄地 ¹ 、三浦 登 ¹	1. 明大理工
3/20(Sun.) 16:15 - 18:30	口頭講演 (Oral Presentation) S223 会場		
16:15	奨 20p-S223-9	フォトニック結晶ナノ共振器の導入による GaAs 中の Er 発光中心の発光制御	○児島 貴徳 ¹ 、櫻木 寛至 ¹ 、小川 雅之 ¹ 、藤岡 夏輝 ¹ 、小泉 淳 ¹ 、野田 進 ¹ 、藤原 康文 ¹
16:30	E 20p-S223-10	Relationship between electrical and luminescence properties of GaN/Eu-doped GaN multiple-nanolayer structures investigated with impedance spectroscopy	○Wanxin ZHU ¹ , Masashi Ishii ² , Atsushi Koizumi ¹ , Yasufumi Fujiwara ¹
16:45	20p-S223-11	GaN:Eu 赤色 LED 発光中心の三次元マッピングによる解析	○石井 真史 ¹ 、小泉 淳 ² 、藤原 康文 ²
17:00	奨 20p-S223-12	Eu 添加 GaN における 2 価 Eu イオンの出現とその制御	○布川 拓未 ¹ 、小泉 淳 ¹ 、松田 将明 ¹ 、朱 婉新 ¹ 、藤原 康文 ¹
17:15	奨 20p-S223-13	微小光共振器による Eu 添加 GaN の発光特性制御	○(D) 稲葉 智宏 ¹ 、児島 貴徳 ¹ 、小泉 淳 ¹ 、藤原 康文 ¹
17:30	20p-S223-14	RF-MBE 法により作製した Eu 添加立方晶及び六方晶 GaN 薄膜の結晶構造の蛍光 X 線ホログラフィーによる評価	○弓達 新治 ¹ 、北村 優天 ¹ 、小山 裕生 ¹ 、宮田 晃 ¹ 、白方 祥 ¹ 、八方 直久 ² 、細川 伸也 ³ 、林 好一 ⁴
17:45	20p-S223-15	スパッタリング併用 MOCVD 法による Tm, Yb 共添加 ZnO 薄膜の作製と発光特性	○亀井 勇人 ¹ 、高野 翔太 ¹ 、吉居 玄哉 ¹ 、児島 貴徳 ¹ 、小泉 淳 ¹ 、藤原 康文 ¹
18:00	20p-S223-16	ZnGa ₂ O ₄ ホスト結晶膜にドーパされた Eu ³⁺ の発光特性	○赤沢 方省 ¹ 、篠島 弘幸 ²
18:15	20p-S223-17	PLD 法による p 型 Si(111) 基板への Er ドープ Ga ₂ O ₃ 薄膜の成長と評価	○野田 真司 ¹ 、陳 政委 ¹ 、齊藤 勝彦 ¹ 、田中 徹 ¹ 、西尾 光弘 ¹ 、郭 其新 ¹
3/21(Mon.) 9:30 - 12:00	口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場		
9:30	21a-S423-1	La _{0.5} F _{0.5} S ₃ :Eu ³⁺ 赤色蛍光体における電荷移動状態 (CTS) 励起帯	○岡田 将大 ¹ 、加藤 聖也 ¹ 、石垣 雅 ² 、吉松 良 ^{1,3} 、大観 光徳 ^{1,4}
9:45	21a-S423-2	(La,Ce,Y) ₃ Si ₅ 蛍光体の発光帯と Ce ³⁺ 置換サイトとの関係	○七井 靖 ^{1,2} 、花輪 有紀 ¹ 、上岡 隼人 ¹ 、奥野 剛史 ²
10:00	21a-S423-3	Eu ²⁺ /Ce ³⁺ 付着蛍光体の第一原理バンド計算: 結晶サイトエンジニアリング	ボンズ サミュエル ² 、ジア ヨンチャオ ² 、○三上 昌義 ¹ 、ミグリオ アンナ ² 、ゴンゼ ザビエル ²
10:15	21a-S423-4	熱ルミネッセンス励起スペクトルを利用した Y ₃ Al ₅ O ₁₂ :Ce ³⁺ 蛍光体の消光原因の解明	○上田 純平 ¹ 、Dorenbos Pieter ² 、J. J. Bos Adrie ² 、Meijerink Andries ³ 、田部 勢津久 ¹
10:30	21a-S423-5	YAG:Ce ³⁺ 蛍光体の温度特性における欠陥単位の影響の解析	○長尾 宣明 ¹ 、新田 充 ¹ 、稲田 安寿 ¹
10:45	21a-S423-6	Lu ₃ Al ₅ O ₁₂ :Ce ³⁺ 蛍光体のパッシベーション効果における発光特性	○小泉 洋 ¹ 、村山 幸大 ¹ 、イスラム モニル ¹ 、櫻井 岳暁 ¹ 、秋本 克洋 ¹ 、チャー ユージン ² 、関口 隆史 ² 、渡部 純也 ³ 、杉山 伸 ³

11:00	奨 21a-S423-7	Mg ²⁺ イオン共添加による Ce:GAGG 結晶中電子捕獲中心の抑制	○(M1) 稲葉 涼太 ¹ 、北浦 守 ² 、鎌田 圭 ³ 、黒澤 俊介 ³ 、大西 彰正 ² 、原 和彦 ⁴	1. 山形大院理工, 2. 山形大理, 3. 東北大 NICHe, 4. 静岡大電研
11:15	21a-S423-8	高効率指向性発光を実現するナノグレーティング蛍光体薄膜	○新田 充 ¹ 、稲田 安寿 ¹ 、橋谷 享 ¹ 、富田 昇吾 ¹ 、平澤 拓 ¹	1. パナソニック
11:30	21a-S423-9	Y ₃ Al ₅ Ga ₃ O ₁₂ :Cr ³⁺ における光刺激誘起残光	○片山 裕美子 ¹ 、Bruno Viana ² 、Didier Gourier ² 、許 健 ¹ 、田部 勢津久 ¹	1. 京都大学, 2. パリ国立化学研究所
11:45	21a-S423-10	ZnS:Cu 蛍光体への高エネルギー電子線照射による長残光性の出現	○稲垣 徹 ^{1,2} 、石垣 雅 ³ 、大観 光徳 ^{2,4} 、堀 史説 ⁵ 、岩瀬 彰宏 ⁵	1. 宇部興産株式会社, 2. 鳥大院工, 3. 鳥大 TiFREC, 4. 鳥大 TEDREC, 5. 大阪府立大
3/21(Mon.) 13:45 - 18:45 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
13:45	21p-S423-1	Rb ₂ TiF ₆ :Mn ⁴⁺ 蛍光体の作製と評価	○(M1) 櫻井 翔之 ¹ 、中村 俊博 ¹ 、安達 定雄 ¹	1. 群馬大院理工
14:00	奨 21p-S423-2	K ₂ TiF ₆ :Mn ⁴⁺ 蛍光体の二波長励起 PL 測定	○高塚 洋右 ¹ 、福田 武司 ¹ 、本多 善太郎 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、金吉 正実 ²	1. 埼玉大工, 2. 信越化学
14:15	E 21p-S423-3	Wider Color Gamut LED Backlight using β -sialon:Eu ²⁺ and K ₂ SiF ₆ :Mn ⁴⁺ Phosphors	○Rong-Jun Xie ¹ , Le Wang ² , Wang Xiaojun ¹ , Kohsei Takahashi ¹ , Takashi Takeda ¹ , Naoto Hirotsaki ¹ , Makoto Izumi ³ , Ken-ichi Yoshimura ³	1.NIMS, 2.China Jiliang Univ., 3.Sharp
14:30	21p-S423-4	広色域ディスプレイ用バックライト LED - Mn ²⁺ , Mg ²⁺ 共賦活 γ -AlON 蛍光体と Mn ⁴⁺ 賦活 K ₂ SiF ₆ 蛍光体 -	○吉村 健一 ¹ 、福永 浩史 ¹ 、和泉 真 ¹ 、高橋 向星 ² 、解 栄軍 ² 、広崎 尚登 ²	1. シャープ, 2. 物材機構
14:45	21p-S423-5	(Sr, Ba)Al ₂ Si ₂ O ₇ :Eu ²⁺ 蛍光体の励起・発光特性	○吉松 良 ^{1,2} 、山田 鈴弥 ² 、大観 光徳 ¹ 、広崎 尚登 ³	1. 鳥大院工, 2. デンカ, 3. 物材機構
15:00	21p-S423-6	蛍光寿命ゆらぎ: 蛍光体発光機構解明の新しいアプローチ	○石井 真史 ¹ 、吉松 良 ² 、広崎 尚登 ¹ 、大観 光徳 ³	1. 物材機構, 2. デンカ株式会社, 3. 鳥取大
15:15	21p-S423-7	BaSi ₂ N ₁₀ :Eu 派生窒化物蛍光体の白色発光 (I)	○舟橋 司朗 ¹ 、武田 隆史 ¹ 、広崎 尚登 ¹ 、解 栄軍 ¹	1. 物材機構
15:30	21p-S423-8	BaSi ₂ N ₁₀ :Eu 派生窒化物蛍光体の白色発光 (II)	○武田 隆史 ¹ 、舟橋 司朗 ¹ 、広崎 尚登 ¹ 、解 栄軍 ¹	1. 物材機構
15:45	奨 E 21p-S423-9	Comparison of GPS and HIP methods for Si-doped AlN powders synthesis	○(D)Yujin Cho ^{1,2} , Kohsei Takahashi ² , Benjamin Dierre ² , Takashi Takeda ² , Naoki Fukata ² , Naoto Hirotsaki ² , Takashi Sekiguchi ^{2,1}	1.Tsukuba Univ., 2.NIMS
16:00	21p-S423-10	Eu ²⁺ 付活ハロリン酸蛍光体の赤色発光特性	○榎本 公典 ¹ 、四ノ宮 裕 ¹ 、大長 久芳 ¹ 、中埜 彰俊 ² 、澤 博 ² 、松石 聡 ³ 、細野 秀雄 ³	1. 榎小糸製作所, 2. 名古屋大学, 3. 東京工業大学
16:15	21p-S423-11	Eu ²⁺ 付活ハロリン酸赤色蛍光体の放射光粉末 X線構造解析	○(M2) 中埜 彰俊 ¹ 、澤 博 ¹ 、榎本 公典 ² 、四ノ宮 裕 ² 、大長 久芳 ² 、松石 聡 ³ 、細野 秀雄 ³	1. 名古屋大学, 2.(株) 小糸製作所, 3. 東京工業大学
16:30	休憩 / Break			
16:45	21p-S423-12	近赤外無機蛍光体を分散させた農業用波長変換フィルム	○宮崎 裕介 ¹ 、永山 凌 ¹ 、上原 航 ¹ 、石垣 雅 ² 、大倉 央 ³ 、西原 英治 ¹ 、大観 光徳 ¹	1. 鳥取大学, 2.TiFREC, 3. メルク (株)
17:00	21p-S423-13	結晶シリコン太陽電池のための広帯域応答アップコンバーター	○竹田 康彦 ¹ 、水野 真太郎 ¹ 、ルイテル ホーム ナト ¹ 、谷 俊彦 ¹	1. 豊田中研
17:15	21p-S423-14	RE ₂ Ba ₂ Zn ₆ Al ₆ O ₁₃ :Yb ³⁺ , Er ³⁺ (RE = Y, Gd) のアップコンバージョン特性	○古川 雄亮 ¹ 、佐俣 博章 ¹ 、小澤 忠司 ² 、松下 能孝 ²	1. 神戸大海事, 2. 物材機構
17:30	21p-S423-15	固相反応法による YPO ₄ :Bi 蛍光体の合成および評価	○矢島 英樹 ¹ 、野口 圭佑 ¹ 、芹澤 和泉 ¹ 、呉 準席 ^{2,3} 、古田 寛 ^{2,3} 、八田 章光 ^{2,3}	1. 株式会社オーク製作所, 2. 高知工科大, 3. 高知工科大 ナノセンター
17:45	21p-S423-16	RF スパッタリング法による Gd ³⁺ 添加 YAIO ₃ 薄膜紫外 EL デバイスの作製	○(PC) 清水 雄平 ¹ 、植田 和茂 ¹	1. 九工大
18:00	21p-S423-17	中性粒子ビームとバイオオナノテンプレートを用いて作製した GaAs 量子ナノディスクのキャリア再結合とその埋め込み効果	○(M2) 近藤 清文 ¹ 、大堀 大介 ¹ 、境 健太郎 ² 、トーマス セドリック ³ 、肥後 昭男 ⁴ 、寒川 誠二 ³ 、前田 幸治 ¹ 、碓 哲雄 ¹ 、福山 敦彦 ¹	1. 宮崎大工, 2. 宮崎大産地連, 3. 東北大流休研, 4. 東北大 WPI-AIMR
18:15	21p-S423-18	一軸性応力下におけるダイヤモンドのフォトルミネッセンススペクトル	○石井 良太 ¹ 、鹿田 真一 ² 、船戸 充 ¹ 、川上 養一 ¹	1. 京大院工, 2. 関西学院大理工
18:30	21p-S423-19	急速熱酸化による Zn ₃ (VO ₄) ₂ 蛍光体薄膜の形成	○川島 知之 ¹ 、鷲尾 勝由 ¹	1. 東北大院工
3/22(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
9:00	E 22a-S423-1	Luminescence of Silicon nanocrystals treated by High-pressure Water Vapor Annealing	○Bernard Gelloz ¹ , Firman Bagja Juangsa ² , Tomohiro Nozaki ² , Lianhua Jin ³ , Nobuyoshi Koshida ⁴	1.Nagoya Univ., 2.Tokyo Inst. Tech., 3.Yamanashi Univ., 4.Tokyo Univ. Agr.&Tech.
9:15	E 22a-S423-2	Porous Silicon Optical Constants from Photoconduction in HF	○Bernard Gelloz ¹ , Hiroki Fuwa ² , Lianhua Jin ²	1.Nagoya Univ., 2.Yamanashi Univ.
9:30	22a-S423-3	光伝導効果を利用したフッ化水素酸によるポーラスシリコンの化学溶解観測	○(M2) 市村 一貴 ¹ 、金 蓮花 ¹ 、近藤 英一 ¹ 、ジェロズ ベルナル ²	1. 山梨大工, 2. 名大工
9:45	22a-S423-4	シリコンナノ粒子上への吸着による巨大フォトルミネッセンス増強のメカニズムの解明	○松本 健俊 ¹ 、前田 譲章 ¹ 、小林 光 ¹	1. 阪大産研
10:00	22a-S423-5	有機分子修飾した水分散性シリコンナノ結晶の光学特性	○菅野 天 ¹ 、多田 康洋 ¹ 、加納 伸也 ¹ 、杉本 泰 ¹ 、今北 健二 ¹ 、藤井 稔 ¹	1. 神戸大院工
10:15	休憩 / Break			
10:30	22a-S423-6	マイクロリアクターを用いた生体イメージング用近赤外ナノ蛍光体の合成	○稲垣 徹 ^{1,2} 、石垣 雅 ³ 、坂田 陵輔 ² 、上原 航 ² 、大観 光徳 ^{2,4}	1. 宇部興産株式会社, 2. 鳥大院工, 3. 鳥大 TiFREC, 4. 鳥大 TEDREC
10:45	奨 22a-S423-7	生体イメージング用 Mn ⁵⁺ 付活 Ca ₁₀ (PO ₄) ₆ (OH) ₂ 近赤外ナノ蛍光体の液相合成	○上原 航 ¹ 、石垣 雅 ² 、岡本 優樹 ¹ 、稲垣 徹 ^{1,4} 、大観 光徳 ^{1,3}	1. 鳥大院工, 2.TiFREC, 3.TEDREC, 4. 宇部興産
11:00	22a-S423-8	電気泳動堆積法による Y ₂ O ₃ :Bi ³⁺ , Eu ³⁺ 蛍光ナノシートの積層膜の作製	○(B) 小菅 裕太 ¹ 、磯 由樹 ¹ 、磯部 徹彦 ¹	1. 慶大理工
11:15	22a-S423-9	X線照射による Ag ゼオライト蛍光ナノ粒子の蛍光の増強	会場 理晶 ¹ 、○磯 由樹 ¹ 、磯部 徹彦 ¹	1. 慶大理工
11:30	奨 22a-S423-10	マイクロ波オートクレーブ処理によるカーボンドット蛍光体の水熱合成	○(B) 慶長 泰周 ¹ 、磯 由樹 ¹ 、磯部 徹彦 ¹	1. 慶大理工
11:45	奨 22a-S423-11	CuInS ₂ 量子ドットへの Zn 添加による発光波長の短波長化	○牧 純也 ¹ 、菱沼 賢智 ¹ 、福田 武司 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、本多 善太郎 ¹	1. 埼玉大工
12:00	22a-S423-12	ZnO ナノロッドを用いた分散型無機 EL の発光強度の向上	○張 栖岩 ¹ 、市川 洋 ¹ 、本田 光裕 ¹ 、佐藤 利文 ²	1. 名工大, 2. 東芸大
3/22(Tue.) 13:15 - 14:30 口頭講演 (Oral Presentation) S423 会場				
13:15	22p-S423-1	蛍光ガラスの発光特性と微細構造との相関	○武藤 亮太 ¹ 、赤井 智子 ² 、高羽 洋充 ¹	1. 工学院大工, 2. 産総研
13:30	22p-S423-2	Sol-gel 法で作製した Fe 添加 SrTiO ₃ :Pr 蛍光体の発光特性	○赤尾 賢人 ¹ 、田代 竜之 ² 、小南 裕子 ¹ 、原 和彦 ³ 、中西 洋一郎 ³ 、Oleg Marchylo ⁴	1. 静岡大大学院, 2. 静岡大工, 3. 静岡大電子研, 4. ラスカリョフ半導体物理研究所
13:45	22p-S423-3	Eu ³⁺ 賦活 Al ₂ O ₃ 蛍光体の作製と評価	○(B) 大西 勇也 ¹ 、中村 俊博 ¹ 、安達 定雄 ¹	1. 群馬大院理工
14:00	22p-S423-4	CaZrO ₃ :Eu ³⁺ , Bi ³⁺ 蛍光体の発光特性	○(M1) 折橋 拓也 ¹ 、中村 俊博 ¹ 、安達 定雄 ¹	1. 群馬大院理工
14:15	22p-S423-5	β -Ga ₂ O ₃ :Tb ³⁺ , Eu ³⁺ 蛍光体に於ける共鳴エネルギー移動	○(MIC) 澤田 健士 ¹ 、中村 俊博 ¹ 、安達 定雄 ¹	1. 群馬大院理工

13.10 化合物太陽電池 / Compound solar cells				
3/20(Sun.) 10:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) S011 会場				
10:00	招 20a-S011-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) フーリエ変換赤外光電流分光による量子ドット太陽電池における室温2段階光吸収の最適化設計	○玉置 亮 ¹ 、庄司 靖 ¹ 、菅谷 武芳 ² 、岡田 至崇 ¹	1. 東大先端研, 2. 産総研
10:15	20a-S011-2	InAs/GaAs 量子ドット超格子太陽電池におけるミニバンド形成が2段階光吸収に与える影響	○(M1) 渡辺 翔 ¹ 、朝日 重雄 ¹ 、加田 智之 ¹ 、海津 利行 ¹ 、原田 幸弘 ¹ 、喜多 隆 ¹	1. 神戸大院工
10:30	20a-S011-3	Dot-in-Well 中間バンド型太陽電池における中間準位内の長い電子寿命	○(D) 朝日 重雄 ¹ 、寺西 陽之 ¹ 、渡辺 翔 ¹ 、渡部 大 ¹ 、海津 利行 ¹ 、喜多 隆 ¹	1. 神戸大工
10:45	E 20a-S011-4	Up-converted photoluminescence in InAs QD-based structures with confined state	○(P) Yuwei Zhang ¹ , Itaru Kamiya ¹	1. Toyota Tech. Inst.
11:00	20a-S011-5	面内超高密度 InAs 量子ドット層を導入した太陽電池の熱処理効果	○(M1) 秋元 直己 ¹ 、仁井 皓大 ¹ 、南 裕太 ¹ 、遠藤 航介 ¹ 、山口 浩一 ¹	1. 電気通信大学
11:15	20a-S011-6	量子井戸太陽電池における電子と正孔の走行時間および実効移動度の評価	○トープラサートボン カシディット ¹ 、谷淵 泰三 ² 、加田 智之 ² 、朝日 重雄 ² 、渡辺 健太郎 ¹ 、杉山 正和 ¹ 、喜多 隆 ² 、中野 義昭 ¹	1. 東大工, 2. 神戸大
11:30	奨 20a-S011-7	低温での量子井戸および波状量子井戸太陽電池におけるキャリア回収効率の評価	○趙 博文 ¹ 、トープラサートボン カシディット ¹ 、ソダーバンル ハッサネット ² 、渡辺 健太郎 ² 、杉山 正和 ¹ 、中野 義昭 ¹	1. 東大工, 2. 東大先端研
11:45	20a-S011-8	可視光励起光電子分光法を用いた GaP におけるキャリア散乱の温度依存性評価	○(D) 市橋 史朗 ¹ 、川口 昂彦 ² 、董 鑫宇 ¹ 、井上 明人 ¹ 、桑原 真人 ¹ 、伊藤 孝寛 ¹ 、原田 俊太 ¹ 、田川 美穂 ¹ 、宇治原 徹 ¹	1. 名大院工, 2. 名大 VBL
3/20(Sun.) 13:30 - 15:30 口頭講演 (Oral Presentation) S011 会場				
13:30	20p-S011-1	テラヘルツ分光による GaAs 太陽電池内部の光励起キャリア評価	○(D) 山下 元気 ¹ 、松原 英一 ^{1,2} 、永井 正也 ¹ 、金 昌秀 ³ 、秋山 英文 ³ 、金光 義彦 ⁴ 、芦田 昌明 ¹	1. 阪大基礎工, 2. 大阪歯科大, 3. 東大物性研, 4. 京大化研
13:45	20p-S011-2	波長可変レーザーテラヘルツ放射顕微鏡による3接合太陽電池の観察	○濱内 翔太 ¹ 、酒井 裕司 ¹ 、梅垣 俊仁 ¹ 、川山 巖 ¹ 、伊藤 明 ² 、中西 英俊 ² 、村上 博成 ¹ 、斗内 政吉 ¹	1. 阪大レーザー研, 2. SCREEN ホールディングス
14:00	20p-S011-3	多接合太陽電池エレクトロルミネッセンス定量計測の測定精度評価	○吉田 正裕 ¹ 、朱 琳 ¹ 、金 昌秀 ¹ 、久保田 英博 ² 、中村 徹哉 ³ 、今泉 充 ³ 、金光 義彦 ⁴ 、秋山 英文 ¹	1. 東大物性研, 2. アトー (株), 3. JAXA, 4. 京大化研
14:15	20p-S011-4	逆積み 1.0 eV 帯 GaInAsP 薄膜太陽電池における暗電流の低減	○大島 隆治 ¹ 、牧田 紀久夫 ¹ 、大野垣 健 ¹ 、菅谷 武芳 ¹	1. 産総研
14:30	E 20p-S011-5	Low Optical Reflection at Intermediate Adhesive Layer for Mechanically Stacked Multi-Junction Solar Cells	○(B) Takashi Sugawara ¹ , Shunsuke Kimura ¹ , Shinya Yoshidomi ¹ , Shosuke Saito ¹ , Masahiko Hasumi ¹ , Toshiyuki Sameshima ¹	1. TUAT
14:45	奨 20p-S011-6	超高効率多接合太陽電池作製に向けた表面活性化接合界面の評価	○山下 大之 ¹ 、渡辺 健太郎 ¹ 、藤野 真久 ¹ 、星井 拓也 ^{1,2} 、杉山 正和 ¹ 、岡田 至崇 ^{1,2} 、須賀 唯知 ¹ 、中野 義昭 ¹	1. 東大院工, 2. 東大先端研
15:00	奨 20p-S011-7	エピタキシャルリフトオフにより作製した GaInNAsSb 薄膜太陽電池評価	○宮下 直也 ^{1,2} 、Benoît Behaghel ^{1,2} 、Jean-François Guillemoles ^{1,2} 、岡田 至崇 ^{1,2}	1. 東大先端研, 2. LIA-NextPV
15:15	E 20p-S011-8	Analysis of subcell damage in proton irradiated triple-junction solar cells with time-resolved photoluminescence	○(P) David Michael Tex ¹ , Toshiyuki Ihara ¹ , Tetsuya Nakamura ² , Mitsuru Imaizumi ² , Takeshi Ohshima ³ , Yoshihiko Kanemitsu ¹	1. ICR Kyoto Univ., 2. JAXA, 3. JAEA
3/20(Sun.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P14 会場				
	20p-P14-1	GaN 基板上 InGaN/GaN MQW 太陽電池における井戸層厚と太陽電池特性	○渡邊 則之 ¹ 、満原 学 ¹ 、重川 直輝 ²	1. NTT 先デ研, 2. 大阪市大
	20p-P14-2	GaAs/Si 太陽電池における変換効率・発電コストの GaAs 層厚依存性	○長岡 恵里奈 ¹ 、井上 智之 ¹ 、トープラサートボン カシディット ¹ 、山下 大之 ¹ 、渡辺 健太郎 ² 、杉山 正和 ¹ 、中野 義昭 ¹	1. 東大工, 2. 東大先端研
	奨 20p-P14-3	低エネルギー電子線フラックスが GaAs 太陽電池へ及ぼす影響	○(DC) 奥野 泰希 ¹ 、奥田 修一 ¹ 、岡 喬 ¹ 、川北 史郎 ^{1,2} 、今泉 充 ² 、舛分 宏昌 ²	1. 大阪府立大学, 2. 宇宙航空研究開発機構
	奨 20p-P14-4	電気化学堆積法による Cu ₂ O/InP ヘテロ界面の形成	○(M1) 近江 沙也夏 ¹ 、熊崎 祐介 ¹ 、佐藤 威友 ¹	1. 北大量集セ
	20p-P14-5	薄膜太陽電池応用に向けた電気化学インピーダンス法による堆積時のスパッタダメージの定量化	○(M1) 中井 洋志 ¹ 、坂倉 秀徳 ¹ 、川出 大祐 ¹ 、Hüseyin San ² 、板垣 昌幸 ¹ 、杉山 睦 ¹	1. 東京理科大学 理工/総研, 2. アンカラ大学
	20p-P14-6	固相反応法を用いた CZTS 多結晶における組成分布の均一性向上	○(M1) 小谷 昌大 ¹ 、沈 用球 ² 、脇田 和樹 ¹	1. 千葉工大, 2. 大府大院工
	20p-P14-7	化学量論比組成に近い組成を持つ Cu ₂ ZnSnS ₄ 薄膜発光の組成比依存	○田中 久仁彦 ¹ 、進也 三浦 ¹ 、高松 良春 ¹	1. 長岡技大
	20p-P14-8	種々の温度で合成した Cu ₂ ZnSnSe ₄ ナノ粒子の光学特性	○鈴木 俊正 ¹ 、鈴木 吏 ² 、堀 茂雄 ² 、野々村 修一 ²	1. JFCC, 2. 岐阜大工
	20p-P14-9	化合物を用いた連続蒸着法による Cu ₂ ZnSnSe ₄ 薄膜への NaF 添加	○中嶋 崇喜 ¹ 、山田 竜也 ¹ 、山口 利幸 ¹	1. 和高専
	20p-P14-10	スプレー熱分解法による Cu ₂ ZnGeS ₄ 薄膜太陽電池の作製	○(M1) 藤川 祥太郎 ¹ 、ヒェブ グエン ティ ¹ 、原 田 隆史 ¹ 、中西 周次 ¹ 、池田 茂 ¹	1. 阪大太エネ化研センター
	20p-P14-11	セレン化法による Cu ₂ SnSe ₃ 薄膜の作製と太陽電池への応用	○中嶋 崇喜 ¹ 、上北 崇弘 ¹ 、山口 利幸 ¹	1. 和高専
	20p-P14-12	Sn/Cu/Ag ブリカーサにおけるアニール温度の影響	○田之上 幸輝 ¹ 、荒木 秀明 ² 、中村 重之 ³ 、瀬戸 悟 ⁴ 、山口 利幸 ⁵ 、赤木 洋二 ¹	1. 都城高専, 2. 長岡高専, 3. 津山高専, 4. 石川高専, 5. 和歌山高専
	20p-P14-13	Ag-Sn 膜の硫化による Ag-Sn-S 薄膜の評価	○秋田 駿斗 ¹ 、荒木 秀明 ² 、中村 重之 ³ 、瀬戸 悟 ⁴ 、山口 利幸 ⁵ 、赤木 洋二 ¹	1. 都城高専, 2. 長岡高専, 3. 津山高専, 4. 石川高専, 5. 和歌山高専
	20p-P14-14	異なる基板温度で蒸着した SnS 薄膜の熱処理の影響	○岩崎 和也 ¹ 、中村 重之 ² 、荒木 秀明 ³ 、赤木 洋二 ¹	1. 都城高専, 2. 津山高専, 3. 長岡高専
	20p-P14-15	硫化法を用いた SnS 薄膜における S 分圧制御および Na 添加の効果	○(M1) 三上 俊太郎 ¹ 、横井 翼 ¹ 、鷲見 浩貴 ¹ 、相原 理 ¹ 、浅野 貴士 ¹ 、逸見 章彦 ¹ 、KIHATRI ISHWOR ¹ 、杉山 睦 ¹	1. 東京理科大学 理工/総研
	20p-P14-16	近接昇華法を用いた SnS 薄膜の作製	○阿部 聖人 ¹ 、家後 和美 ¹ 、赤木 洋二 ² 、片桐 裕則 ¹ 、荒木 秀明 ¹	1. 長岡高専, 2. 都城高専
	20p-P14-17	液相法による SnS ナノ粒子の合成	○水野 裕貴 ¹ 、濱中 泰 ¹	1. 名工大
	20p-P14-18	液液界面を介した電気泳動法による高分散 Iron pyrite(FeS ₂) 量子ドット溶液の作製	○田村 伸一 ¹ 、生野 孝 ¹	1. 豊田中研
	20p-P14-19	PLD 法による CuInS ₂ 薄膜成長と組成制御	○喜屋武 一成 ¹ 、吉田 亮 ¹ 、沈 用球 ² 、脇田 和樹 ¹	1. 千葉工大, 2. 大阪大院工

20p-P14-20	FTPS法を用いた化合物薄膜太陽電池の光吸収評価	○(M1)Nur Syazwana Binti Abd Rahman ¹ 、祖父江 弘志 ¹ 、伊藤 貴司 ¹ 、野々村 修一 ¹ 、山田 明 ²	1. 岐阜大工, 2. 東工大院理工
20p-P14-21	Mo エピタキシャル膜に及ぼす低温バッファ層の効果	○(B)山上 武 ¹ 、寺本 真浩 ¹ 、Ishwor Khatri ² 、杉山 1. 東京理科大学理工, 2. 東京理科大学総研	睦 ^{1,2} 、中田 時夫 ²
20p-P14-22	分子線エピタキシー法による n-ZnS/p-CuGaS ₂ 接合作製と評価	○山田 秀明 ¹ 、倉掛 真弥 ¹ 、松下 将也 ¹ 、高村 健 ¹ 、1. 鳥取大院工	
20p-P14-23	分子線エピタキシー法による Te 添加 CuGaS ₂ 薄膜の作製	○松下 将也 ¹ 、倉掛 真弥 ¹ 、山田 秀明 ¹ 、高村 健 ¹ 、1. 鳥取大院工	
		馬場崎 巧 ¹ 、阿部 友紀 ¹ 、市野 邦男 ¹	
3/21(Mon.) 9:30 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S221 会場			
9:30	奨 21a-S221-1 ACuSeF(A = Ba, Sr)/ITO 複合膜を裏面電極に用いた CdTe 太陽電池	○北林 秀弥 ¹ 、和田 隆博 ¹ 、小川 洋平 ² 、細野 藍馨 ² 、岡本 保 ²	1. 龍谷大理工, 2. 木更津高専
9:45	21a-S221-2 FeOOH 薄膜の硫黄アニールによる FeSO の作製	○牧 采佳 ¹ 、市村 正也 ¹	1. 名工大
10:00	奨 21a-S221-3 金属 Zn 薄膜のリン化による高配向 Zn ₃ P ₂ 薄膜の作製	○(D)勝部 涼司 ¹ 、野瀬 嘉太郎 ¹ 、白井 泰治 ¹	1. 京大院工
10:15	奨 21a-S221-4 ラマン分光法を用いた ZnSnP ₂ における規則 - 不規則変態挙動の調査	○(D)中塚 滋 ¹ 、岩田 晃樹 ¹ 、野瀬 嘉太郎 ¹ 、原田 隆史 ² 、池田 茂 ² 、白井 泰治 ¹	1. 京大院工, 2. 阪大太陽エネ研セ
10:30	21a-S221-5 ZnSnP ₂ 薄膜太陽電池の光電特性の面内分布解析	○(M2)湯澤 典之 ¹ 、中塚 滋 ² 、野瀬 嘉太郎 ² 、峯 元 高志 ¹	1. 立命館大, 2. 京都大
10:45	奨 21a-S221-6 Effect of NaF addition to Cu ₂ SnS ₃ absorbers	○(M1)Koichi Suzuki ¹ 、Hikaru Uegaki ¹ 、Kazuki Hamamura ¹ 、Takanori Kondo ¹ 、Takashi Minemoto ¹	1. Ritsumeikan Univ.
11:00	21a-S221-7 Cu ₂ SnS ₃ バルク結晶の励起子発光スペクトル	○粟飯原 直也 ¹ 、松本 祐典 ¹ 、田中 久仁彦 ¹	1. 長岡技大
11:15	E 21a-S221-8 Comparative study of self-constituent buffer layers for synthesis Cu ₂ ZnSnS ₄ thin films	○(D)Shengwen Fu ¹ 、Huiju Chen ¹ 、ChuanFeng Shih ¹	1. Cheng Kung Univ.
11:30	21a-S221-9 過酸化水素水による CZTS 薄膜の表面エッチング	○宮崎 尚 ¹ 、岸村 浩明 ¹ 、青野 祐美 ¹ 、片桐 裕則 ²	1. 防衛大材料, 2. 長岡高専
11:45	21a-S221-10 塗布型 Cu ₂ ZnSn(S,Se) ₄ 薄膜太陽電池におけるチオ尿素処理	○桑名 潤 ¹ 、江尾 卓也 ¹ 、杉本 寛太 ¹ 、陶山 直樹 ¹ 、1. 東工大院理工, 2. 凸版印刷, 3. 東工大 PVREC	
12:00	21a-S221-11 塗布型 Cu ₂ ZnSn(S,Se) ₄ 薄膜に対する VI 族粉末を用いた焼結過程の解析	○(M2)杉本 寛太 ¹ 、桑名 潤 ¹ 、陶山 直樹 ¹ 、佐竹 哲夫 ² 、張 毅聞 ² 、山田 明 ^{1,3}	1. 東工大院理工, 2. 凸版印刷, 3. 東工大 PVREC
3/21(Mon.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) S221 会場			
13:45	招 21p-S221-1 【第 6 回女性研究者研究業績・人材育成賞 (小館香椎子賞) 受賞記念講演】(30 分) CIGS 薄膜太陽電池の変換効率抑制要因の解明と高効率化技術の開発	○上川 由紀子 ¹	1. 産総研
14:15	21p-S221-2 低温製膜における単傾斜構造を有する Cu(In,Ga)Se ₂ 薄膜太陽電池の界面電子制御による高効率化	○荻原 知寛 ¹ 、サドノ アディユダ ¹ 、山田 明 ^{1,2}	1. 東工大院理工, 2. 東工大 PVREC
14:30	21p-S221-3 Cu(In,Ga)Se ₂ 薄膜太陽電池の光吸収層へのチオ尿素溶液処理	○(M2)古田 健人 ¹ 、渡辺 基 ¹ 、土岐 爽真 ¹ 、山田 明 ^{1,2}	1. 東工大院理工, 2. 東工大 PVREC
14:45	21p-S221-4 大気下における CIGS 太陽電池の効率劣化の解析	○西永 慈郎 ¹ 、上川 由紀子 ¹ 、柴田 肇 ¹ 、仁木 栄 ¹	1. 産総研
15:00	21p-S221-5 光熱モード AFM を用いた CIGS 単膜および CdS/CIGS 膜における非発光再結合特性の評価	○小松 里紗 ¹ 、峯元 高志 ³ 、高橋 琢二 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構, 3. 立命館大理工
15:15	奨 21p-S221-6 CuInSe ₂ /CuGaSe ₂ 単一量子井戸の時間分解フォトルミネッセンス測定	○ショウ サンウ ¹ 、Sathibama Thiru ² 、中村 芳樹 ¹ 、堀越 佳治 ¹ 、竹内 淳 ¹	1. 早大先進, 2. UTM Razak School
15:30	21p-S221-7 CuGaSe ₂ 太陽電池のデバイス化工程の影響評価	○石塚 尚吾 ¹ 、上川 由紀子 ¹ 、西永 慈郎 ¹ 、柴田 肇 ¹	1. 産総研
15:45	休憩 / Break		
16:00	21p-S221-8 Cu(In,Ga)Se ₂ /CdS 界面への Cu(In,Ga)Se ₂ 挿入による Cu(In,Ga)Se ₂ 太陽電池の高効率化	○(M1)土岐 爽真 ¹ 、西村 昂人 ¹ 、山田 明 ^{1,2}	1. 東工大院理工, 2. 東工大 PVREC
16:15	21p-S221-9 CuIn ₂ Se ₅ および CuGa ₃ Se ₅ の電子構造	○(PC)前田 毅 ¹ 、宮 イゲン ¹ 、西谷 幹彦 ¹ 、和田 隆博 ¹	1. 龍谷大 理工
16:30	奨 21p-S221-10 CuIn ₂ Se ₅ および CuGa ₃ Se ₅ への硫黄の固溶効果	○(B)上田 健太 ¹ 、前田 毅 ¹ 、和田 隆博 ¹	1. 龍谷大 理工
16:45	21p-S221-11 Cu(In,Ga)S ₂ 系固溶体の光学評価とバンドラインナップ	○細木 恵 ¹ 、前田 毅 ¹ 、西谷 幹彦 ¹ 、和田 隆博 ¹	1. 龍谷大理工
17:00	奨 21p-S221-12 PLD 法を用いた CuInS ₂ 膜の作製と太陽電池への応用	○川邊 利幸 ¹ 、和田 隆博 ¹	1. 龍谷大理工
17:15	21p-S221-13 対向ターゲット式反応性スパッタ法による CuInS ₂ 薄膜及び太陽電池セルの作製と評価	○鳴海 航太 ¹ 、上田 朝陽 ¹ 、山田 一樹 ¹ 、野本 隆宏 ¹ 、石川 亮佑 ¹ 、坪井 望 ¹	1. 新潟大
17:30	奨 21p-S221-14 高開放電圧、高曲線因子を目指した Ag(In,Ga)Se ₂ 薄膜太陽電池の開発	○(DC)梅原 猛 ¹ 、飯沼 祥平 ¹ 、ビン モハマドズ ルキフリ ファリス アキラ ¹ 、山田 明 ^{1,2}	1. 東工大院理工, 2. 東工大 PVREC

15 結晶工学 / Crystal Engineering

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

15.1 バルク結晶成長 / Bulk crystal growth

3/19(Sat) 9:45 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場			
9:45	奨 19a-H112-1 ESYPE 法により作製した AlN 膜結晶性の膜厚依存性	○(M1)岸元 克浩 ¹ 、Wu PeiTsien ¹ 、船戸 充 ¹ 、川 上 養一 ¹	1. 京大院工
10:00	19a-H112-2 EFG 法による β -Ga ₂ O ₃ 単結晶のドーパント偏析	○渡辺 信也 ¹ 、奥 公祥 ¹ 、山岡 優 ¹ 、増井 建和 ¹ 、倉又 朗人 ¹ 、山腰 茂伸 ¹	1. タムラ製作所
10:15	19a-H112-3 一方向凝固 β -Ga ₂ O ₃ 単結晶 (I)	○小林 拓実 ¹ 、大葉 悦子 ¹ 、中村 由夫 ¹ 、宮川 千宏 ¹ 、1. 不二越機械工業, 2. 信大工	
10:30	19a-H112-4 一方向凝固 β -Ga ₂ O ₃ 単結晶 (II)	○大葉 悦子 ¹ 、小林 拓実 ¹ 、中村 由夫 ¹ 、宮川 千宏 ¹ 、1. 不二越機械工業, 2. 信大工	
10:45	E 19a-H112-5 Effect of packing structure of Si chunks on melting process and carbon contamination in Czochralski silicon crystal growth	○(P)Xin Liu ¹ 、Bing Gao ¹ 、Satoshi Nakano ¹ 、Hirofumi Harada ¹ 、Yoshiji Miyamura ¹ 、Koichi Kakimoto ¹	1. RIAM, Kyushu Univ.
11:00	19a-H112-6 IR-FZ 法によるシリコンの結晶育成における回転槽円鏡の傾斜効果	○綿打 敏司 ¹ 、ホサイン エムディー ムクター ¹ 、1. 山梨大院クリスタル研	
11:15	19a-H112-7 VB 法 Ge 結晶育成における坩堝内壁状態と B ₂ O ₃ が品質に与える影響	○(M2)荒浜 智貴 ¹ 、平賀 祐希 ¹ 、太子 敏則 ¹	1. 信州大工
11:30	19a-H112-8 国際宇宙ステーション内 InGaSb 結晶成長に関する数値解析	○岡野 泰則 ^{1,2,3} 、Xin Jin ¹ 、山本 卓也 ¹ 、高木 洋平 ¹ 、早川 泰弘 ² 、稲富 裕光 ³	1. 阪大基礎工, 2. 静大電研, 3. JAXA
3/19(Sat) 13:15 - 17:15 口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場			
13:15	19p-H112-1 重力沈降によるシリカコロイド結晶の積層欠陥観察	○大木 芳正 ¹ 、中野 勇二 ¹ 、川中 智司 ¹ 、今井 宏起 ¹ 、 ¹ 、内田 文生 ¹	1. 富士化学機
13:30	19p-H112-2 コロイド結晶表面における 2 次元核形成メカニズム	○野澤 純 ¹ 、胡 素夢 ¹ 、郭 素麗 ¹ 、小泉 晴比古 ¹ 、藤原 航三 ¹ 、宇田 聡 ¹	1. 東北大学

13:45	19p-H112-3	コロイド結晶成長における固液界面形態が与える粒界偏析の変化	胡素夢 ¹ 、○野澤 純 ¹ 、郭 素霞 ¹ 、小泉 晴比古 ¹ 、藤原 航三 ¹ 、宇田 聡 ¹	1. 東北大
14:00	19p-H112-4	種結晶を用いたタンパク質結晶内に存在する多量の局所的な歪みの解消	○小泉 晴比古 ¹ 、宇田 聡 ¹ 、橋 勝 ² 、塚本 勝男 ³ 、小島 謙一 ⁴ 、野澤 純 ¹	1. 東北大・金研, 2. 横浜市大・院生命ナノ, 3. 阪大・院工, 4. 創英大・教育
14:15	19p-H112-5	タンタル酸ニオブ酸カリウム (KTN) 結晶成長における初晶の検討	○太子 敏則 ¹ 、伊藤 幸介 ¹ 、細川 和也 ¹ 、于川 圭吾 ¹ 、小島 孝広 ² 、小松 貴幸 ³	1. 信大工, 2. オキサイド, 3. NTT-AT
14:30	19p-H112-6	タンタル酸リチウム結晶中の転位の観察	○梶ヶ谷 富男 ¹ 、杉山 正史 ¹ 、石川 治男 ¹ 、米永 一 郎 ² 、大野 裕 ²	1. 住友金属鉱山(株) 技術, 2. 東北大金研
14:45	19p-H112-7	金属元素ドーパ LiTaO ₃ 基板の表面弾性波特性評価	○杉山 正史 ¹ 、寺島 彰 ¹ 、梶ヶ谷 富男 ¹ 、飯田 潤二 ¹ 、宇田 聡 ² 、橋本 研也 ³	1. 住友金属鉱山, 2. 東北大金研, 3. 千葉大院工
15:00	19p-H112-8	コングメント・ニオブ酸リチウム単結晶成長における酸素挙動 (3) 休憩 / Break	○宇田 聡 ¹ 、小山 千尋 ¹	1. 東北大金研
15:30	E 19p-H112-9	Electrical resistivity, dielectric and piezoelectric properties of Ca ₃ TaGa _{3-x} Al _x Si ₂ O ₁₄ (CTGAS) single crystals as a function of Al content	○(D)Xiuwei Fu ^{1,2} , Encarnacion G. Villora ¹ , Yuuki Kitanaka ³ , Yuji Noguchi ³ , Masaru Miyayama ³ , Kiyoshi Shimamura ^{1,2} , Naoki Ohashi ^{1,4}	1. NIMS, 2. Waseda Uni., 3. Uni. Tokyo, 4. Tokyo Inst. Tech.
15:45	19p-H112-10	Ca ₃ Ta(Ga _{3-x} Al _x) ₂ Si ₂ O ₁₄ (x=0,0.25,0.5,0.75) 圧電単結晶における音響特性の Al 置換量依存性	○工藤 哲男 ¹ 、横田 有為 ² 、大橋 雄二 ¹ 、庄子 育宏 ^{1,3} 、鎌田 圭 ^{2,3} 、黒澤 俊介 ² 、吉川 彰 ^{1,2,3}	1. 東北大金研, 2. 東北大 NICHe, 3. C&A
16:00	19p-H112-11	GdAlO ₃ /Al ₂ O ₃ 共結晶の表面積化	○鎌田 圭 ¹ 、山口 大聡 ² 、安居 伸浩 ³ 、大橋 良太 ³ 、田透 ³ 、黒澤 俊介 ^{2,1} 、庄子 育宏 ² 、横田 有為 ¹ 、大橋 雄二 ² 、吉川 彰 ^{1,2}	1. 東北大 NICHe, 2. 東北大金研, 3. キヤノン
16:15	19p-H112-12	ガーネット型酸化物シンチレータ結晶の作製と近赤外発光特性評価	○山路 晃広 ¹ 、黒澤 俊介 ² 、村上 力輝斗 ¹ 、大橋 雄二 ¹ 、鎌田 圭 ² 、横田 有為 ² 、吉川 彰 ^{1,2}	1. 東北大金研, 2. 東北大 NICHe
16:30	19p-H112-13	マイクロ引き下げ法で作製した Ce:Y ₃ Al ₅ O ₁₂ 単結晶における面内 Ce 偏析の改善	○横田 有為 ¹ 、Zeng Zhong ² 、大橋 雄二 ³ 、黒澤 俊介 ¹ 、鎌田 圭 ^{1,4} 、川添 良幸 ¹ 、吉川 彰 ^{1,3,4}	1. 東北大 NICHe, 2. 重慶大, 3. 東北大金研, 4. C&A
16:45	19p-H112-14	Na 共添加 Eu:LiCaAlF ₆ 中性子シンチレータ単結晶における蛍光およびシンチレーション特性の Na 濃度依存性	○(MIC) 田中 智恵子 ¹ 、横田 有為 ² 、黒澤 俊介 ² 、山路 晃広 ¹ 、大橋 雄二 ¹ 、鎌田 圭 ^{2,3} 、吉川 彰 ^{1,2,3}	1. 東北大金研, 2. 東北大 NICHe, 3. C&A
17:00	19p-H112-15	フッ化物光学結晶の育成と評価	○中畑 秀利 ¹ 、中嶋 力夫 ¹	1. ナカジマ技研
3/20(Sun.) 16:00 - 18:00	ポスター講演 (Poster Presentation) P15 会場			
	20p-P15-1	Ag ₃ GaS ₂ -AgGaS ₂ 共晶反応領域でのマイクロ波合成による AgGaS ₂ 多結晶のフォトルミネセンス	○須崎 昌己 ¹	1. 大阪府立大学高専
15.2 II-VI 族結晶および多元系結晶 / II-VI and related compounds				
3/21(Mon.) 9:00 - 10:15	口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場			
9:00	21a-H113-1	有機-無機ハイブリッド型 ZnSe 系紫外 APD アレイのクロストーク特性	○内田 繁人 ¹ 、田中 健太 ¹ 、井上 亮一 ¹ 、藤本 健 ¹ 、田末 章男 ¹ 、平野 弘樹 ¹ 、加納 卓弥 ¹ 、阿部 友紀 ¹ 、笠田 洋文 ¹ 、安東 孝止 ¹ 、市野 邦男 ¹	1. 鳥取大工
9:15	21a-H113-2	分子線エピタキシャル成長 ZnMgS/GaP の構造的評価	○門田 匡弘 ¹ 、櫻山 翔太 ¹ 、佐藤 響真 ¹ 、阿部 友紀 ¹ 、市野 邦男 ¹	1. 鳥大院工
9:30	21a-H113-3	分子線エピタキシャル成長 ZnTe/GaP の構造的評価	○難波 直 ¹ 、櫻山 翔太 ¹ 、長谷川 浩康 ¹ 、佐藤 響真 ¹ 、阿部 友紀 ¹ 、市野 邦男 ¹	1. 鳥取大院工
9:45	21a-H113-4	MBE 法による Cl ドープ ZnTeO の光学特性の評価	○堤 修治 ¹ 、岡野 友紀 ¹ 、寺沢 俊貴 ¹ 、田中 徹 ¹ 、齊藤 勝彦 ¹ 、郭 其新 ¹ 、西尾 光弘 ¹	1. 佐賀大理工
10:00	21a-H113-5	分子線エピタキシャル法による ZnCdO 薄膜の成長と評価	○潮 昇平 ¹ 、寺沢 俊貴 ¹ 、岡野 友紀 ¹ 、田中 徹 ¹ 、齊藤 勝彦 ¹ 、郭 其新 ¹ 、西尾 光弘 ¹	1. 佐賀大院工
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30	ポスター講演 (Poster Presentation) P8 会場			
	21p-P8-1	ミスド CVD 法を用いて作製した ZnS 薄膜の光学特性評価	○(M1) 浅野 康幸 ¹ 、宇野 和行 ¹ 、山崎 佑一郎 ¹ 、田中 一郎 ¹	1. 和歌山大学
	21p-P8-2	量子井戸幅の揺らぎによる CdTe 無歪ドットの作製および PL スペクトル	○(M1) 内海 駿人 ¹ 、坂本 圭祐 ¹ 、金澤 研 ¹ 、黒田 真司 ¹ 、Lafuente-Sampietro Alban ^{1,2} 、Besombes Lucien ² 、Boukari Herve ²	1. 筑波大院理物質, 2. CNRS ネール研
	E 21p-P8-3	Synthesis of ZnO hierarchical nanostructures using NaOH as self-capping agent and optical properties	○Sankar Ganesh Ramaraj ¹ 、Navaneethan Mani ¹ 、Ponnusamy Suruttaiyudaiyar ² 、Muthamizhchelvan Chellamuthu ² 、Yasuhiro Hayakawa ¹	1. RIE Shizuoka Univ, 2. SRM Univ.
	21p-P8-4	IQB 理論による II-VI 族化合物混晶半導体の電子状態の計算	○藤本 徳明 ¹	1. 和歌山大シス工
	21p-P8-5	水素イオン注入 KNbO ₃ バルク単結晶中の水素の挙動：弾性反跳分析評価	○鶴岡 遼太郎 ¹ 、新川 輝 ¹ 、西村 智朗 ¹ 、田沼 千秋 ¹ 、栗山 一男 ¹ 、串田 一雅 ²	1. 法政大理工, 2. 大阪教育大学
3/22(Tue.) 9:00 - 10:30	口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場			
9:00	22a-H116-1	サファイア基板の化学処理が ZnTe 薄膜のドメイン構造形成に与える効果	○中須 大蔵 ¹ 、木津 健 ¹ 、服部 翔太 ¹ 、橋本 勇輝 ¹ 、孫 惟哲 ¹ 、風見 露乃 ¹ 、王 競 ¹ 、小高 圭佑 ¹ 、玉川 陽菜 ¹ 、山本 洋輔 ¹ 、小林 正和 ^{1,2} 、朝日 聡明 ³	1. 早大先進理工, 2. 早大材研, 3. JX 金属
9:15	奨 22a-H116-2	ナノファセットを持つサファイア m 面基板上 ZnTe 薄膜の成長過程解析	○中須 大蔵 ¹ 、服部 翔太 ¹ 、木津 健 ¹ 、橋本 勇輝 ¹ 、孫 惟哲 ¹ 、風見 露乃 ¹ 、王 競 ¹ 、山本 洋輔 ¹ 、玉川 陽菜 ¹ 、小高 圭佑 ¹ 、小林 正和 ^{1,2} 、朝日 聡明 ³	1. 早大先進理工, 2. 早大材研, 3. JX 金属
9:30	22a-H116-3	フッ酸系エッチャントによる ZnTe のメサエッチングと ZnMgTe/ZnTe 光導波路のリッジ化	○風見 露乃 ¹ 、孫 惟哲 ¹ 、王 競 ¹ 、中須 大蔵 ¹ 、服部 翔太 ¹ 、木津 健 ¹ 、橋本 勇輝 ¹ 、玉川 陽菜 ¹ 、小高 圭佑 ¹ 、山本 洋輔 ¹ 、小林 正和 ^{1,2} 、朝日 聡明 ³	1. 早大先進理工, 2. 早大材研, 3. JX 金属
9:45	E 22a-H116-4	Enhanced photocatalytic performance under visible light irradiation due to controlled morphology evolution of ZnO nanostructure	○Harish Santhanakrishnan ¹ 、Archana Jayaram ¹ 、Navaneethan mani ¹ 、Ponnusamy Suruttaiyudaiyar ² 、Muthamizhchelvan Chellamuthu ² 、Yasuhiro Hayakawa ¹	1. RIE Shizuoka Univ, 2. SRM Univ.
10:00	22a-H116-5	III 族元素をドーパした高抵抗 ZnTe 結晶の深い準位からの発光	○瀬戸 悟 ¹ 、鈴木 和彦 ²	1. 石川高専, 2. 北海道科学大
10:15	奨 22a-H116-6	大気中レーザーアブレーションで作製した Sb ドープ ZnO マイクロスフィアの特異性評価	○永壽 史明 ¹ 、下垣 哲也 ¹ 、池淵 達也 ¹ 、植山 健史 ¹ 、田中 稔伸 ¹ 、藤原 優輝 ¹ 、東島 三洋 ¹ 、中村 大輔 ¹ 、岡田 龍雄 ¹	1. 九大シス情

3/22(Tue.) 13:00 - 14:30		口頭講演 (Oral Presentation) H116 会場	
13:00	22p-H116-1	MOVPE 法による (211) および (100)Si 基板上の CdTe 成長層のフォトルミネッセンス特性	○北川 翔三 ¹ 、神野 悟 ¹ 、伊藤 祐葵 ¹ 、杉本 宗一郎 ¹ 、1. 名工大理工 山崎 大輔 ¹ 、小島 将弘 ¹ 、坪田 眞太郎 ¹ 、安形 保則 ¹ 、ニラウラ マダン ¹ 、安田 和人 ¹
13:15	22p-H116-2	MOVPE 法による (211)Si 基板上の As ドープ CdTe 層のフォトルミネッセンス特性	○小島 将弘 ¹ 、伊藤 祐葵 ¹ 、神野 悟史 ¹ 、杉本 宗一郎 ¹ 、1. 名工大理工 山崎 大輔 ¹ 、北川 翔三 ¹ 、坪田 眞太郎 ¹ 、安田 和人 ¹ 、ニラウラ マダン ¹ 、安形 保則 ¹
13:30	22p-H116-3	MOVPE 法による (211)CdTe/Si 成長層のエッチピット評価	○坪田 眞太郎 ¹ 、杉本 宗一郎 ¹ 、伊藤 祐葵 ¹ 、山崎 大輔 ¹ 、神野 悟史 ¹ 、小島 将弘 ¹ 、北川 翔三 ¹ 、安田 和人 ¹ 、ニラウラ マダン ¹ 、安形 保則 ¹
13:45	22p-H116-4	Cu ₂ ZnSnS ₄ バルク多結晶の作製と評価	○竹内 麻希子 ¹ 、大石 耕一郎 ¹ 、青柳 成俊 ¹ 、西田 元記 ¹ 、清水 渉 ¹ 、中村 謙太 ¹ 、片桐 裕則 ¹ 、山崎 誠 ¹
14:00	22p-H116-5	Se 蒸気圧制御アニールによる Cu ₂ ZnSn(S,Se) ₄ の作製と太陽電池応用	○梅嶋 悠人 ¹ 、瀧 駿也 ¹ 、上村 一生 ¹ 、宇留野 彩 ¹ 、1. 早大先進理工, 2. 早大 ICSEP, 3. 早大材研 張 陰峰 ² 、小林 正和 ^{1,3}
14:15	奨 22p-H116-6	Ag ₂ Te 中間層を導入した Si 基板上の AgGaTe ₂ 作製と太陽電池応用	○(D) 宇留野 彩 ¹ 、小林 正和 ^{1,2}
15.3 III-V 族エピタキシャル結晶 / III-V-group epitaxial crystals			
3/20(Sun.) 16:00 - 18:00		ポスター講演 (Poster Presentation) P16 会場	
	20p-P16-1	原子層エピタキシー法により成長温度及び原料供給時間を変化させて作製した GaAsN 薄膜の X 線回折及びラマン分光法による結晶性の評価	○橋本 英明 ¹ 、前田 幸治 ¹ 、横山 祐貴 ¹ 、堀切 将 ¹ 、1. 宮崎大工 鈴木 秀俊 ¹
	20p-P16-2	窒素 δ ドープ GaAs 上 InAs 量子ドットにおける In-Ga イオンミキシング制御	○海津 利行 ^{1,2} 、喜多 隆 ²
	20p-P16-3	In _{1-x} Ga _x Sb 量子井戸構造の電気的特性の評価	○(M1) 原田 義彬 ¹ 、岡 直希 ¹ 、藤川 紗千恵 ¹ 、藤代 博記 ¹
奨	20p-P16-4	高密度 GaSb ドットを用いた Si(100) 基板上の GaSb 薄膜成長	○(DC) 町田 龍人 ¹ 、戸田 隆介 ¹ 、藤川 紗千恵 ¹ 、原 伸介 ² 、渡邊 一世 ² 、赤羽 浩一 ² 、笠松 章史 ² 、藤代 博記 ¹
	20p-P16-5	微傾斜 GaAs(111)B 基板上に作製した GaSb タイプ II ナノロッドの光学異方性	○川津 琢也 ¹ 、野田 武司 ¹ 、佐久間 芳樹 ¹ 、榊 裕之 ^{1,2}
	20p-P16-6	As ₂ 分子線を用いて成長した InAs-QD による電流注入型広帯域光源	○林 佑真 ¹ 、尾崎 信彦 ¹ 、大河内 俊介 ² 、大里 啓孝 ³ 、渡辺 英一郎 ³ 、池田 直樹 ³ 、杉本 喜正 ³
	20p-P16-7	中間バンド型太陽電池に向けた InAs/InAlAsSb 量子構造の作製と評価	○庄司 靖 ¹ 、玉置 亮 ¹ 、アーサン ナズムル ¹ 、岡田 至崇 ¹
	20p-P16-8	面内超高密度 InAs 量子ドット層における熱処理効果	○(B) 南 裕太 ¹ 、秋元 直己 ¹ 、鮫島 一樹 ¹ 、山口 浩一 ¹
	20p-P16-9	分子線エピタキシーによる Si(111) 基板上 GaAs/GaAsBi コア-シェルナノワイヤ成長	○石川 史太郎 ¹ 、赤松 良彦 ¹ 、渡辺 健太郎 ² 、上杉 文彦 ³ 、朝比奈 俊輔 ⁴ 、Jahn Uwe ⁵ 、下村 哲 ¹
奨 E	20p-P16-10	MBE growth for high quality GaAsBi/GaAs MQWs for longer wavelength emission	○(D) Pallavi Patil ¹ , Fumitaroh Ishikawa ¹ , Satoshi Shimomura ¹
	20p-P16-11	In _{0.71} Ga _{0.29} As/AlAs/In _{0.35} Al _{0.65} As 結合量子井戸の光吸収特性の成長温度依存性	○牛頭 信一郎 ¹
	20p-P16-12	ディンプル研磨した (411)A GaAs 基板上の GaAs/InGaAs 量子井戸の MBE 成長	○橋本 飛鳥 ¹ 、下村 哲 ¹
3/21(Mon.) 9:30 - 12:00		口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場	
9:30	21a-H112-3	GaAs(775)B 基板上における InAs の成長モード	○(M1) 佐藤 勇樹 ¹ 、下村 哲 ¹
9:45	21a-H112-4	GaAs(111)A 基板上の InGaAs 成長に対する InAs 界面層の効果	○(M2) 出来 亮太 ¹ 、佐々木 拓生 ² 、高橋 正光 ^{1,2}
10:00	21a-H112-5	InAsSb/GaAs(001) 上の InAs 成長における 3 次元核形成機構	○(B) 及川 信吾 ¹ 、鮫島 一樹 ¹ 、山口 浩一 ¹
10:15	21a-H112-6	結晶欠陥を導入したモンテカルロシミュレーションによる自己集合量子ドットのモフォロジー変化	○村松 修 ¹ 、笹倉 弘理 ² 、武藤 俊一 ¹
10:30	休憩 / Break		
10:45	21a-H112-7	近赤外広帯域光源を目指した InAs 量子ドットの室温 PL 特性	○沢渡 義規 ¹ 、吉沢 勝美 ¹ 、赤羽 浩一 ² 、山本 直克 ²
11:00	21a-H112-8	長波長発光近接積層 InAs/GaAs 量子ドットの偏光フォトルミネッセンス特性	○田尻 祐介 ¹ 、海津 利行 ^{1,2} 、喜多 隆 ¹
11:15	21a-H112-9	DWell 構造による InP 基板上 InAs 量子ドット発光の長波長化	○赤羽 浩一 ¹ 、松本 敦 ¹ 、梅沢 俊匡 ¹ 、山本 直克 ¹ 、橋本 圭太 ² 、高井 裕司 ²
11:30	21a-H112-10	部分キャップ制御による低密度 InAs/GaAs 量子ドットの光学特性向上	○角田 雅弘 ¹ 、権 晋寛 ¹ 、車 一宏 ² 、太田 泰友 ¹ 、渡邊 克之 ^{1,2} 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
11:45	21a-H112-11	ドット密度の高密度化効果により障壁層を薄膜化した多層積層量子ドット構造の分子線成長とレーザ評価	○影山 健生 ¹ 、ゾクオック フイ ² 、渡邊 克之 ² 、武政 敬三 ³ 、菅原 充 ³ 、岩本 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}
3/21(Mon.) 13:15 - 16:45		口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場	
13:15	21p-H112-1	III-V 化合物半導体表面の微量金属汚染の定量分析	○大野 力一 ¹ 、嵯峨 幸一郎 ¹
13:30	21p-H112-2	GaSb 基板上表面酸化膜の純水水洗処理時間依存性	○苦米地 秀一 ¹ 、奥村 滋一 ¹ 、鈴木 僚一 ¹ 、松倉 祐輔 ¹ 、今 純一 ¹ 、西野 弘師 ¹
13:45	21p-H112-3	太陽電池応用 InGaAs/GaAsP 多重量子井戸への緩層導入効果	○渡辺 健太郎 ¹ 、井上 智之 ² 、トープラサートボン カシディット ² 、アメリ デラマール ² 、ソダーバン ル ハッサネット ¹ 、杉山 正和 ² 、中野 義昭 ^{1,2}
14:00	21p-H112-4	GaAsN 薄膜の ALE 法による Si 供給順序が Si 吸着サイトに与える影響	○横山 祐貴 ¹ 、堀切 将 ¹ 、原口 智宏 ¹ 、山内 俊浩 ¹ 、鈴木 秀俊 ¹ 、碓 哲雄 ¹ 、福山 敦彦 ¹
14:15	21p-H112-5	InGaAsN/GaAsSb タイプ II 量子井戸ダイオードのアニール効果 (II)	○河村 裕一 ^{1,2} 、穴戸 郁哉 ¹ 、田中 章 ¹ 、川又 修一 ^{1,2}
14:30	21p-H112-6	急速熱アニールした GaAs 中のエピタキシャル窒素膜の輻射再結合寿命	○小川 泰弘 ¹ 、原田 幸弘 ¹ 、海津 利行 ¹ 、喜多 隆 ¹
14:45	休憩 / Break		
15:00	奨 21p-H112-7	MOVPE 成長 GaAs/Ge/Si 構造のアニールによる結晶品質の向上	○中尾 亮 ^{1,2} 、荒井 昌和 ^{1,2} 、山本 剛 ¹ 、松尾 慎治 ^{1,2}

15:15	奨 21p-H112-8	Si 基板上格子整合系 GaAsPN 混晶の導電性制御	○(MIC) 佐藤 健人 ¹ 、山根 啓輔 ¹ 、西尾 卓也 ¹ 、 麦倉 俊 ¹ 、関口 寛人 ¹ 、岡田 浩 ^{1,2} 、若原 昭浩 ¹	1. 豊橋技科大院・工, 2. 豊橋技科大 EIIRIS
15:30	21p-H112-9	Si 基板に直接接合した InP 薄膜上への InGaAsP 系 MQW 成長	○藤井 拓郎 ^{1,2} 、武田 浩司 ^{1,2} 、菅野 絵理奈 ¹ 、長谷部 浩一 ^{1,2} 、山本 剛 ¹ 、碓塚 孝明 ^{1,2} 、松尾 慎治 ^{1,2} 、 タ	1.NTT 先端集積デバイス研, 2. ナノフォトニクスセン
15:45	21p-H112-10	【注目講演】 GaN(10-10) 上へのウルツ鉱構造 AllnP の成長と緑色発光	○福井 孝志 ¹ 、平谷 佳大 ¹ 、石坂 文哉 ¹ 、富岡 克広 ^{1,2}	1. 北大情報、量集センタ, 2.JST さきがけ
16:00	21p-H112-11	波長 3-5 μm 帯 GaAs 基板上 InAsSb の MOVPE 成長	○(B) 今村 優雅 ¹ 、吉元 圭太 ¹ 、荒井 昌和 ¹	1. 宮崎大工
16:15	奨 21p-H112-12	低温成長 C ドーピングによる高品質 InSb 膜の成長方法	○(D) 吉川 陽 ¹ 、森下 朋浩 ¹ 、永瀬 和宏 ¹	1. 旭化成
16:30	奨 21p-H112-13	Electrical characteristics of rapid heat-treated InSb film	○(D)Charith Jayanada Koswaththage ¹ , Takashi Noguchi ¹ , Shinichi Taniguchi ² , Shokichi Yoshitome ²	1.Univ. of the Ryukyus, 2.e-tec INC.
15.4 III-V 族窒化物結晶 / III-V-group nitride crystals				
3/19(Sat.) 8:45 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場				
8:45	19a-H121-1	GaN 単結晶における基板と冷却速度の転位密度に与える影響	○中野 智 ¹ 、高 冰 ¹ 、柿本 浩一 ¹	1. 九大応力研
9:00	19a-H121-2	RF 加熱式 HVPE 法を用いたサファイア基板上への AlN 成長	○山下 泰弘 ¹ 、三宅 秀人 ^{1,2} 、平松 和政 ¹	1. 三重大・院工, 2. 三重大・地域イノベ
9:15	19a-H121-3	ハイドライド気相成長法におけるサファイア加工基板を用いた自立 GaN 基板の自発分離技術	○石橋 直人 ¹ 、板垣 憲広 ¹ 、岡田 成仁 ¹ 、只友 一行 ¹	1. 山口大工
9:30	19a-H121-4	ハイドライド気相成長における GaN 選択成長のファセット形状のストライプマスク周期依存性	○河原 慎 ¹ 、行實 孝太 ¹ 、松原 徹 ¹ 、板垣 憲広 ¹ 、 岡田 成仁 ¹ 、山根 啓輔 ² 、只友 一行 ¹	1. 山口大学院理工, 2. 豊橋技術科学大
9:45	19a-H121-5	ハイドライド気相成長法を用いた Fe ドープ GaN の成長	○傳寶 裕品 ¹ 、西平 貴則 ¹ 、山根 啓輔 ² 、岡田 成仁 ¹ 、 葛原 正明 ³ 、只友 一行 ¹	1. 山口大学院理工, 2. 豊橋技術科学大学, 3. 福井大学
10:00	休憩/Break			
10:15	招 19a-H121-6	【第 6 回女性研究者研究業績・人材育成賞 (小館香椎子賞) 受賞記念講演】 (30 分) 実験と計算化学の協調による III 族窒化物半導体気相成長の研究	○富樫 理恵 ¹	1. 農工大
10:45	招 19a-H121-7	【講演奨励賞受賞記念講演】 (15 分) X 線マイクロ回折を用いた 3 次元逆格子マップ解析による窒化物半導体結晶構造評価	○鎌田 祥平 ¹ 、竹内 正太郎 ¹ 、ディンタン カン ¹ 、 三宅 秀人 ² 、平松 和政 ² 、今井 康彦 ³ 、木村 滋 ³ 、 酒井 朗 ¹	1. 阪大基礎工, 2. 三重大院工, 3.JASRI/SPring-8
11:00	19a-H121-8	3 次元逆格子空間マップ解析による周期溝 SiC 基板上 AlN 厚膜の微視的結晶構造評価	○鎌田 祥平 ¹ 、竹内 正太郎 ¹ 、ディンタン カン ¹ 、 三宅 秀人 ² 、平松 和政 ² 、今井 康彦 ³ 、木村 滋 ³ 、 酒井 朗 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 三重大院工, 3.JASRI/SPring-8
11:15	19a-H121-9	OVPE 法による GaN 成長における GaN(0001) 表面構造の検討	○河村 貴宏 ^{1,2} 、北本 啓 ² 、今出 完 ² 、吉村 政志 ² 、 森 勇介 ² 、森川 良忠 ²	1. 三重大院工, 2. 阪大院工
11:30	19a-H121-10	ナノインデンテーションを用いたウルツ鉱構造窒化ホウ素 (w-BN) の機械的特性評価	○出浦 桃子 ¹ 、沓掛 健太郎 ¹ 、大野 裕 ¹ 、米永 一郎 ¹ 、 谷口 尚 ²	1. 東北大金研, 2. 物材機構
3/19(Sat.) 13:15 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場				
13:15	招 19p-H121-1	【第 6 回化合物半導体エレクトロニクス業績賞 (赤崎勇賞) 受賞記念講演】 (30 分) 青色及び紫外光デバイスの開発	○天野 浩 ¹	1. 名古屋大学
13:45	19p-H121-2	AlGaIn 母材自立化に伴う単一 GaN 界面ゆらぎ量子ドット光学特性の変化	○有田 宗貴 ^{1,2} 、加古 敏 ^{1,2} 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子機構, 2. 東大生産研
14:00	E 19p-H121-3	Single Photon Emission from a GaN Interface Fluctuation Quantum Dot	○(M2) Florian LeRoux ¹ , Mark Holmes ^{1,2} , Munetaka Arita ^{1,2} , Gao Kang ¹ , Satoshi Kako ^{1,2} , Yasuhiko Arakawa ^{1,2}	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.NanoQuine, Univ. of Tokyo
14:15	19p-H121-4	フーリエ変換分光法を用いた GaN ナノワイヤ量子ドットにおけるフォノン相互作用の評価	○HOLMES Mark ¹ 、加古 敏 ² 、崔 琦鉉 ¹ 、有田 宗貴 ¹ 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子, 2. 東大生研
14:30	19p-H121-5	摂氏 77 度で動作する単一光子源	○HOLMES Mark ¹ 、加古 敏 ² 、崔 琦鉉 ¹ 、有田 宗貴 ¹ 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子, 2. 東大生研
14:45	休憩/Break			
15:00	19p-H121-6	InGaIn ナノコラムにおける成長機構と臨界コラム径	○(PC) 大音 隆男 ¹ 、水野 祐太郎 ¹ 、柳原 藍 ¹ 、宮川 倫 ¹ 、加納 達也 ¹ 、吉田 純 ¹ 、榊原 直樹 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智大ナノテク
15:15	奨 19p-H121-7	多色発光 InGaIn 系規則配列ナノコラムの微小領域集積化	○榊原 直樹 ¹ 、加納 達也 ¹ 、吉田 純 ¹ 、宮川 倫 ¹ 、 水野 祐太郎 ¹ 、大音 隆男 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智大ナノテク
15:30	19p-H121-8	短周期配列ナノコラムの黄色領域光励起レーザ発振	○松井 祐三 ¹ 、石沢 峻介 ¹ 、本山 界 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテク
15:45	19p-H121-9	規則配列 AlGaIn ナノコラムを用いた発光デバイスの作製	○吉田 純 ¹ 、加納 達也 ¹ 、松井 祐三 ¹ 、宮川 倫 ¹ 、 榊原 直樹 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテク
16:00	19p-H121-10	分子線エピタキシー法により成長した GaN ナノリング微小光共振器による糖センサ	○武島 歩志 ¹ 、光野 徹也 ¹ 、酒井 優 ² 、岸野 克巳 ³ 、 原 和彦 ¹	1. 静岡大工, 2. 山梨大医工, 3. 上智大理工
16:15	休憩/Break			
16:30	19p-H121-11	水素雰囲気熱処理 InGaIn/GaN 多重量子井戸層の発光特性評価及び水素雰囲気異方性熱エッチング (HEATE) 法によるナノ構造の作製	○(B) 石嶋 駿 ¹ 、小川 航平 ¹ 、水谷 友哉 ¹ 、蜂屋 諒 ¹ 、 菊池 昭彦 ^{1,2}	1. 上智大学, 2. 上智大ナノテク研究センター
16:45	19p-H121-12	水素雰囲気異方性熱エッチング (HEATE) 法による InGaIn/GaN 単一量子ディスクナノ LED の作製	○小川 航平 ¹ 、蜂屋 諒 ¹ 、水谷 友哉 ¹ 、石嶋 駿 ¹ 、 菊池 昭彦 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智大学ナノテクセンター
17:00	奨 19p-H121-13	III 族窒化物ナノワイヤを用いた端面発光レーザの理論的検討	○栗崎 湧気 ¹ 、上山 智 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、 赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工, 2. 名古屋大・赤崎記念研究センター
17:15	奨 19p-H121-14	異方性ウェットエッチングによる GaN 多孔質構造の作製と光学特性評価	○熊崎 祐介 ¹ 、松本 悟 ¹ 、佐藤 威友 ¹	1. 北大量集セ
17:30	19p-H121-15	カーボンナノチューブ/GaN 界面の電気特性とバンド構造の評価	○横川 俊哉 ¹ 、三宅 祥太 ¹ 、山下 輝 ¹ 、毛利 裕治 ¹ 、 中山 雅晴 ¹	1. 山口大工
17:45	19p-H121-16	バルク GaN 表面のナノインデンテーションにおける r 面すべりの HRTEM 観察と歪解析	○横川 俊哉 ¹ 、二木 佐知 ² 、前川 順子 ² 、青木 正彦 ¹	1. 山口大工, 2. イオンテクノセンター
3/20(Sun.) 8:45 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場				
8:45	20a-H121-1	高キャリア濃度 n 型 m 面 GaN 単結晶におけるホットキャリアの輻射再結合ダイナミクス	○小島 一信 ¹ 、池田 宏隆 ² 、藤戸 健史 ² 、秩父 重英 ¹	1. 東北大多元研, 2. 三菱化学 (株)
9:00	20a-H121-2	高品質 GaN 単結晶の絶対放射量子効率測定	○小島 一信 ¹ 、大友 友美 ¹ 、齊藤 真 ^{1,2} 、池田 宏隆 ² 、 藤戸 健史 ² 、秩父 重英 ¹	1. 東北大多元研, 2. 三菱化学 (株)

9:15	20a-H121-3	自立 GaN 基板上 m 面 $Al_{1-x}In_xN$ エピタキシャル薄膜の発光特性 (IV)	○秩父 重英 ¹ 、小島 一信 ¹ 、山崎 芳樹 ¹ 、佐藤 義孝 ² 、上殿 明良 ³	1. 東北大多元研, 2. 双葉電子工業, 3. 筑波大学
9:30	20a-H121-4	InGaN/GaN 超格子が InGaN 系発光ダイオードの発光特性に及ぼす効果の分離検討	○杉本 浩平 ¹ 、岡田 成人 ¹ 、只友 一行 ¹	1. 山口大学院理工
9:45	20a-H121-5	レーザ散乱を用いた InGaN 結晶成長表面粗さ回復の観察	○(M1) 山本 哲也 ¹ 、田村 彰 ¹ 、永松 謙太郎 ¹ 、新田 州吾 ^{1,3} 、本田 善央 ^{1,3} 、天野 浩 ^{1,2,3}	1. 名大院工, 2. 赤崎記念研究センター, 3. 未来材料システム研究所
10:00	20a-H121-6	InGaN 量子井戸の選択領域 In 拡散によるバンドギャップ制御と光導波路作製	○横川 俊哉 ¹ 、梶 拓也 ¹ 、今井 康彦 ² 、木村 滋 ²	1. 山口大工, 2. JASRI
10:15		休憩/Break		
10:30	奨 20a-H121-7	Core-Shell 型 MQW における発光波長の成長条件依存性	○岩瀬 航平 ¹ 、Lim Stanley ¹ 、澁谷 弘樹 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、上山 智 ¹ 、赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工, 2. 名古屋大・赤崎記念センター
10:45	20a-H121-8	GaN ナノコラムにおける LO フォノンレプリカおよび励起子多体効果	○猪瀬 裕太 ¹ 、金城 一哉 ¹ 、江馬 一弘 ^{1,2} 、吉田 純 ¹ 、山野 晃司 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテク
11:00	20a-H121-9	InGaN/GaN 規則配列ナノコラムにおける局在深さの解析	○金城 一哉 ¹ 、猪瀬 裕太 ¹ 、佐藤 光 ¹ 、江馬 一弘 ^{1,2} 、中岡 俊裕 ^{1,2} 、大音 隆男 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテク
11:15	20a-H121-10	光音響・発光同時計測法を用いた GaN の内部量子効率の測定	○中納 隆 ¹ 、河上 航平 ¹ 、山口 敦史 ¹	1. 金沢工大
11:30	20a-H121-11	光音響・発光同時計測法及び時間分解発光計測による GaN の輻射・非輻射再結合寿命の測定	○河上 航平 ¹ 、中納 隆 ¹ 、山口 敦史 ¹	1. 金沢工大
3/20(Sun.) 13:15 - 19:45		口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場		
13:15	奨 20p-H121-1	THz エリプソメトリーによる GaN 膜評価と断面観察による検証	○達 紘平 ¹ 、浅上 史歩 ¹ 、藤井 高志 ^{1,3} 、荒木 努 ¹ 、名西 徳之 ¹ 、長島 健 ² 、岩本 敏志 ³ 、佐藤 幸徳 ³ 、森田 直威 ⁴ 、杉江 隆一 ⁴ 、上山 智 ⁵	1. 立命館大学, 2. 摂南大学, 3. 日邦プレジジョン, 4. 東レリサーチセンター, 5. 名城大学
13:30	20p-H121-2	THz エリプソメトリーとホール効果測定によるサファイア基板上 n 型 GaN の電気特性の比較検討	○(B) 浅上 史歩 ¹ 、達 紘平 ¹ 、藤井 高志 ^{1,3} 、荒木 努 ¹ 、名西 徳之 ¹ 、長島 健 ² 、岩本 敏志 ³ 、佐藤 幸徳 ³ 、森田 直威 ⁴ 、杉江 隆一 ⁴ 、上山 智 ⁵	1. 立命館大理工, 2. 摂南大理工, 3. 日邦プレジジョン, 4. 東レリサーチセンター, 5. 名城大理工
13:45	20p-H121-3	SiC/GaN の界面構造とバンドオフセットとの関係の理論的検討	○小嶋 英嗣 ¹ 、遠藤 賢太郎 ¹ 、白川 裕規 ¹ 、洗平 昌晃 ¹ 、海老原 康裕 ² 、金村 高司 ² 、恩田 正一 ² 、白石 賢二 ¹	1. 名大, 2. デンソー
14:00	20p-H121-4	貫通転位の絶縁膜/GaN 界面への影響評価	○横川 俊哉 ¹ 、山本 雄大 ¹ 、梶 拓也 ¹ 、西平 貴則 ¹ 、岡田 成仁 ¹ 、只友 一行 ¹	1. 山口大工
14:15	20p-H121-5	PXD 法によるハフニウム上への GaN 薄膜成長	○金 惠蓮 ¹ 、○太田 実雄 ^{1,2} 、井上 茂 ¹ 、小林 篤 ¹ 、野 耕平 ¹ 、藤岡 洋 ^{1,3}	1. 東大 生研, 2. JST さきがけ, 3. JST-ACCEL
14:30	20p-H121-6	擬似 III-V 族窒化物半導体 ZnSnN ₂ 結晶合成	○川村 史朗 ¹ 、今井 基晴 ¹ 、谷口 尚 ¹ 、山田 直臣 ²	1. 物質・材料研究機構, 2. 中部大工
14:45	奨 E 20p-H121-7	Growth and Characterizations of a pseudo-III-nitride ZnSnN ₂	○(DC)Xiang Cao ¹ 、Koji Umezome ¹ 、Fumio Kawamura ² 、Yoshihiro Ninomiya ¹ 、Takashi Taniguchi ² 、Naomii Yamada ¹	1. Chubu Univ., 2. NIMS
15:00	20p-H121-8	窒化物半導体への低濃度ドーピング技術の開発	○荒川 靖章 ¹ 、上野 耕平 ¹ 、太田 実雄 ^{1,2} 、藤岡 洋 ^{1,3}	1. 東大生研, 2. JST- さきがけ, 3. JST-ACCEL
15:15		休憩/Break		
15:30	20p-H121-9	その場放射光 X 線回折による MBE 成長窒化物半導体のひずみ緩和観測	○佐々木 拓生 ¹ 、出来 亮太 ² 、石川 史太郎 ² 、山口 智広 ⁴ 、高橋 正光 ^{1,2}	1. 原子力機構, 2. 兵庫県立大, 3. 愛媛大, 4. 工学院大
15:45	20p-H121-10	ステップ高さ制御 SiC 基板上 AlN 層の高分解能 X 線回折評価における界面局在ミスフィット転位に起因する横方向サテライトピーク	○金子 光顕 ¹ 、木本 恒暢 ¹ 、須田 淳 ¹	1. 京大院工
16:00	20p-H121-11	SiC 基板上の GaN および AlN 薄膜のエネルギー論：第一原理計算による検討	○秋山 亨 ¹ 、中根 晴信 ¹ 、中村 浩次 ¹ 、伊藤 智徳 ¹	1. 三重大院工
16:15	20p-H121-12	C-AFM によるスパイラル成長した GaN の極微領域評価	○小村 一樹 ¹ 、荒浪 誠生 ¹ 、荒木 努 ¹ 、名西 徳之 ¹ 、赤坂 哲也 ²	1. 立命館大, 2. NTT 物性科学基礎研
16:30	20p-H121-13	c-BN 薄膜のイオンビームアシスト MBE 成長における基板へのバイアス電圧印加の効果	○平間 一行 ¹ 、谷保 芳孝 ¹ 、山本 秀樹 ¹ 、熊倉 一英 ¹	1. NTT 物性研
16:45	20p-H121-14	グラフェン上 GaN ナノコラムの選択成長	○今野 裕太 ¹ 、林 宏暁 ¹ 、岸野 克巳 ^{1,2}	1. 上智大理工, 2. 上智ナノテク研究センタ
17:00	20p-H121-15	RF-MBE 法を用いた Eu 添加 GaN ナノコラムの Eu 濃度依存性	○(M1) 今西 智彦 ¹ 、関口 寛人 ¹ 、西川 聡志 ¹ 、尾崎 耕平 ¹ 、山根 啓輔 ¹ 、岡田 浩 ^{2,3} 、岸野 克巳 ³ 、若原 昭浩 ¹	1. 豊橋技科大, 2. EIIRIS, 3. 上智大理工
17:15	20p-H121-16	RF-MBE 法を用いた InGaN 成長時における表面拡散長の評価	○伊達 浩平 ¹ 、関口 寛人 ¹ 、柳原 藍 ² 、山根 啓輔 ¹ 、岡田 浩 ¹ 、若原 昭浩 ¹ 、岸野 克巳 ²	1. 豊技大工, 2. 上智大理工
17:30		休憩/Break		
17:45	奨 20p-H121-17	N 極性 InGaN/GaN LED に形成された InGaN 微小島からの局所発光	○谷川 智之 ¹ 、正直 花奈子 ¹ 、片山 竜二 ¹ 、窪谷 茂 ¹ 、幸 ¹ 、松岡 隆志 ¹	1. 東北大金研
18:00	奨 20p-H121-18	Si/SiO ₂ /GaN-LED 構造を用いた Si-MOSFET および LED のモノリシック集積	○(DC) 土山 和晃 ¹ 、宇都宮 脩 ¹ 、中川 翔太 ¹ 、山根 啓輔 ¹ 、関口 寛人 ¹ 、岡田 浩 ^{2,1} 、若原 昭浩 ^{1,2}	1. 豊技大工, 2. EIIRIS
18:15	奨 20p-H121-19	Si 基板上 GaN 系 LED の素子構造作製に伴う応力の変化	○岡田 葵 ¹ 、上杉 謙次郎 ¹ 、木村 重哉 ¹ 、坂野 竜則 ¹ 、吉田 学史 ¹ 、布上 真也 ¹	1. 東芝研究開発センター
18:30	20p-H121-20	光電流測定による LED 内部量子効率評価	○(M2) 宇佐美 茂佳 ¹ 、本田 善央 ^{1,3} 、天野 浩 ^{1,2,3}	1. 名大院工, 2. 赤崎記念研究センター, 3. 未来材料・システム研究所
18:45	奨 20p-H121-21	Si ₃ N ₄ による高 AlN モル分率 n-AlGaIn 用 V 系電極の低接触比抵抗	○永田 訓章 ¹ 、森 一喜 ¹ 、武田 邦宏 ¹ 、草深 敏匡 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、上山 智 ¹ 、赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工, 2. 名古屋大, 赤崎記念研究センター
19:00	20p-H121-22	表面保護膜形成による InGaN/GaN 多重量子井戸構造太陽電池の高性能化に関する研究	○加畑 智基 ¹ 、堤 達哉 ¹ 、森 拓磨 ¹ 、加藤 正史 ¹ 、三好 実人 ¹ 、江川 孝志 ¹	1. 名工大
19:15	奨 E 20p-H121-23	P-Channel InGaN/GaN heterostructure metal-oxide-semiconductor field effect transistor based on polarization-induced two-dimensional hole gas	○Li-wen SANG ¹ 、kexiong Zhang ¹ 、Masatomo Sumiya ¹ 、Meiyong Liao ¹ 、Yasuo Koide ¹	1. NIMS
19:30	20p-H121-24	誘導結合型プラズマ反応性イオンエッチングを用いた GaN の逆メサ加工	○(M1) 板垣 憲広 ¹ 、永利 圭 ¹ 、岡田 成仁 ¹ 、井本 良 ¹ 、西宮 智晴 ² 、松尾 文晴 ² 、只友 一行 ¹	1. 山口大学院理工, 2. サムコ (株)
3/21(Mon.) 8:45 - 11:45		口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場		
8:45	奨 21a-H121-1	Na フラックスポイントシード法による半極性 GaN 単結晶の結晶性向上	○(B) 金 度勲 ¹ 、今西 正幸 ¹ 、山田 拓海 ¹ 、本城 正智 ¹ 、村上 航介 ¹ 、松尾 大輔 ¹ 、今林 弘毅 ¹ 、丸山 美帆子 ¹ 、今出 完 ¹ 、吉村 政志 ¹ 、森 勇介 ¹	1. 阪大工
9:00	21a-H121-2	種結晶 GaN 表面および成長モードを制御した Na フラックス GaN の欠陥構造解析	○(M1) 水田 祐貴 ¹ 、竹内 正太郎 ¹ 、今西 正幸 ² 、今出 完 ² 、森 勇介 ² 、酒井 朗 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. 阪大院工

9:15	奨	21a-H121-3	Na フラックス法におけるサファイア溶解を用いたクラックフリー自立 GaN 基板の作製	○(M1) 山田 拓海 ¹ 、今西 正幸 ¹ 、中村 幸介 ¹ 、村上 航介 ¹ 、今林 弘毅 ¹ 、松尾 大輔 ¹ 、本城 正智 ¹ 、丸山 美帆子 ¹ 、今出 完 ¹ 、吉村 政志 ¹ 、森 勇介 ¹	1. 阪大院工
9:30		21a-H121-4	炭素炭素添加による GaN 多結晶抑制効果の向上	○(M2) 小川 翔悟 ¹ 、今西 正幸 ¹ 、村上 航介 ¹ 、今林 弘毅 ¹ 、松尾 大輔 ¹ 、丸山 美帆子 ¹ 、今出 完 ¹ 、吉村 政志 ¹ 、森 勇介 ¹	1. 阪大工
9:45	奨	21a-H121-5	Na フラックス結合成長法における c 面 GaN 結晶の低転位化	○今西 正幸 ¹ 、山田 拓海 ¹ 、村上 航介 ¹ 、本城 正智 ¹ 、今林 弘毅 ¹ 、松尾 大輔 ¹ 、丸山 美帆子 ¹ 、今出 完 ¹ 、吉村 政志 ¹ 、津坂 佳幸 ² 、松井 純爾 ³ 、森 勇介 ¹	1. 阪大院工、2. 兵庫県大理工、3. 放射光ナノテク研
10:00		21a-H121-6	高品質ポイントシード結合 Na-flux 成長 GaN 基板への HVPE ホモエピ成長	○吉田 丈洋 ¹ 、今西 正幸 ² 、北村 寿朗 ¹ 、大高 健治 ¹ 、今出 完 ² 、森 勇介 ²	1. サイオクス、2. 阪大院工
10:15			休憩 / Break		
10:30		21a-H121-7	Cr-Ni 溶媒を用いた AlN の溶液成長におけるサファイア種結晶の結晶面の影響	○黒坂 真一郎 ¹ 、鳴海 大翔 ¹ 、川西 咲子 ^{2,3} 、佐々木 秀顕 ² 、吉川 健 ² 、前田 正史 ²	1. 東大工、2. 東大生研、3. 東北大多元研
10:45		21a-H121-8	アモルファス基板上に作製した InGaN 薄膜トランジスタの特性	○小林 篤 ¹ 、伊藤 剛輝 ¹ 、ライ ケーシン ¹ 、上野 耕平 ¹ 、太田 実雄 ^{1,2} 、藤岡 洋 ^{1,3}	1. 東大生研、2. JST さきがけ、3. JST-ACCEL
11:00		21a-H121-9	ScAlMgO ₃ 基板上的 GaN 薄膜の構造安定性に関する理論的検討	○中根 晴信 ¹ 、秋山 亨 ¹ 、中村 浩次 ¹ 、伊藤 智徳 ¹	1. 三重大院工
11:15	奨	21a-H121-10	ScAlMgO ₃ 基板上への GaN 薄膜成長における不純物混入の抑制	○矢原 弘崇 ¹ 、岩淵 拓也 ¹ 、窪谷 茂幸 ¹ 、谷川 智之 ¹ 、花田 貴 ¹ 、片山 竜二 ¹ 、福田 承生 ² 、松岡 隆志 ¹	1. 東北大金研、2. 福田結晶
11:30		21a-H121-11	310nm 帯紫外 LED 用 Ga ₂ O ₃ (-201) 基板上 AlGaIn (0001) エピタキシャル膜の成長	○森島 嘉克 ¹ 、平山 秀樹 ² 、飯塚 和幸 ¹ 、山崎 進一 ¹ 、西村 良男 ¹ 、山腰 茂伸 ¹	1. タムラ製作所、2. 理研
3/21(Mon.) 13:15 - 18:00			口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場		
13:15		21p-H121-1	赤外反射分光による GaN 薄膜の電子特性深さ分解評価手法	○上條 隆明 ¹ 、坂本 裕則 ¹ 、馬 蓓 ¹ 、森田 健 ¹ 、石 谷 善博 ¹	1. 千葉大院工
13:30		21p-H121-2	GaN における非熱平衡系励起子遷移過程のフォノン・衝突・輻射モデルに基づく解析	○岩堀 友洋 ¹ 、野町 健太郎 ¹ 、大木 健輔 ¹ 、馬 蓓 ¹ 、森田 健 ¹ 、石 谷 善博 ¹	1. 千葉大院工
13:45		21p-H121-3	高次励起子準位を用いた GaN における励起子の励起・脱励起ダイナミクス解析	○竹内 和真 ¹ 、大泉 尚之 ¹ 、馬 蓓 ¹ 、森田 健 ¹ 、石 谷 善博 ¹ 、三宅 秀人 ² 、平松 和政 ²	1. 千葉大院工、2. 三重大院工
14:00		21p-H121-4	AlGaIn 量子井戸構造における励起子分子の結合エネルギー - 混晶障壁層の組成比依存性 -	○和泉 平 ¹ 、福地 駿平 ¹ 、中村 豪仁 ¹ 、倉井 聡 ¹ 、三宅 秀人 ² 、平松 和政 ² 、○山田 陽一 ¹	1. 山口大院・理工、2. 三重大院・工宅
14:15		21p-H121-5	90% を超える電子・正孔波動関数の重なり積分を達成可能な AlGaIn 量子井戸の設計指針	○小島 一信 ¹ 、山崎 芳樹 ¹ 、古澤 健太郎 ¹ 、三宅 秀人 ² 、平松 和政 ² 、秩父 重英 ¹	1. 東北大多元研、2. 三重大院
14:30		21p-H121-6	深紫外 AlGaIn MQW 発光層の放射再結合効率の大幅向上	○大橋 隆宏 ¹ 、白岩 佳子 ¹ 、○鳥羽 隆一 ¹	1. 東北大学大学院
14:45		21p-H121-7	深紫外 AlGaIn MQW 発光層の CL 強度マップ温度依存性	○大橋 隆宏 ¹ 、白岩 佳子 ¹ 、○鳥羽 隆一 ¹	1. 東北大学大学院 環境科学研究科
15:00			休憩 / Break		
15:15		21p-H121-8	組成揺らぎを考慮した AlGaIn および InGaIn 量子井戸における光学利得の理論的比較	○(M1) 南 琢人 ¹ 、小島 一信 ² 、繁太 坂井 ¹ 、秩父 重英 ² 、山口 敦史 ¹	1. 金沢工大、2. 東北大多元研
15:30	奨	21p-H121-9	微傾斜 (0001) サファイア基板上に作製した AlGaIn 量子細線構造における輻射再結合過程の増強	○早川 峰洋 ¹ 、林 佑樹 ¹ 、市川 修平 ¹ 、船戸 充 ¹ 、川上 養一 ¹	1. 京大院工
15:45		21p-H121-10	AlGaIn 多重量子井戸成長における AlN バッファ層の効果	○藤田 直宏 ¹ 、三宅 秀人 ^{1,2} 、平松 和政 ¹	1. 三重大院工、2. 三重大・地域イノベ
16:00		21p-H121-11	m 面サファイア基板上半極性 AlGaIn/AlN 層の結晶成長とドーピング及び量子井戸発光特性	○(M1) 大島 一晟 ^{1,2} 、定 昌史 ¹ 、前田 哲利 ¹ 、鎌田 憲彦 ² 、平山 秀樹 ¹	1. 理研、2. 埼玉大
16:15		21p-H121-12	無極性 m 面 AlGaIn/GaN 量子井戸サブバンド間吸収の温度特性	○小谷 晃央 ^{1,2,3} 、有田 宗貴 ¹ 、荒川 泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子、2. 東大生研、3. シャープ
16:30			休憩 / Break		
16:45	奨	21p-H121-13	AlGaIn 成長用表面窒化 α-(AlGa) ₂ O ₃ 基板の極微構造評価と熱的安定性評価	○武馬 輝 ¹ 、増田 直 ¹ 、荒木 努 ¹ 、名西 徳之 ¹ 、織田 真也 ² 、人羅 俊実 ²	1. 立命館大、2. FLOSFIA
17:00	奨	21p-H121-14	アニール処理 AlN 下地層上 AlGaIn/AlN-MQW の光学特性	○袴田 淳哉 ¹ 、草澤 敏匡 ¹ 、千賀 崇史 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、上山 智 ¹ 、三宅 秀人 ² 、赤崎 勇 ^{1,3}	1. 名城大・理工、2. 三重大・工、3. 名古屋大・赤崎記念研究センター
17:15	奨	21p-H121-15	AlGaIn 多重量子井戸構造のレーザ発振特性の Si 濃度依存性	○千賀 崇史 ¹ 、永田 訓章 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、上山 智 ¹ 、赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工、2. 名古屋大・赤崎記念研究センター
17:30		21p-H121-16	AlGaIn Deep UV LED の光取り出し効率向上の検討	○丹羽 紀隆 ¹ 、稲津 哲彦 ² 、一ノ倉 啓慈 ² 、ベルノ シリル ² 、友澤 秀征 ¹ 、石黒 永孝 ² 、縄田 晃史 ³ 、須崎 泰正 ³ 、本田 善史 ⁴ 、天野 浩 ⁴	1. 日機装、2. 日機装技研、3. SCIVAX、4. 名大未来研
17:45	奨	21p-H121-17	窒化物半導体 HFET 型光センサの温度特性	○牛田 彩希 ¹ 、吉川 陽 ^{1,3} 、山本 雄磨 ¹ 、奥村 俊紀 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、上山 智 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工、2. 名古屋大・赤崎記念研究センター、3. 旭化成
3/22(Tue.) 8:45 - 11:45			口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場		
8:45		22a-H121-1	(0001) 面 AlGaIn/AlN ヘテロ構造におけるすべり系と格子緩和モデル	○(DC) 市川 修平 ¹ 、船戸 充 ¹ 、川上 養一 ¹	1. 京大院工
9:00		22a-H121-2	AlGaIn 系ヘテロ構造における格子不整合位の導入箇所制御	○(DC) 市川 修平 ¹ 、熊本 恭介 ¹ 、船戸 充 ¹ 、川上 養一 ¹	1. 京大院工
9:15	奨	22a-H121-3	その場観察技術を用いた MOVPE 法で作製する AlGaIn/GaN ヘテロ構造の観察	○大角 純也 ¹ 、金山 亮介 ¹ 、高西 徹 ¹ 、岩谷 素顕 ¹ 、竹内 哲也 ¹ 、上山 智 ¹ 、赤崎 勇 ^{1,2}	1. 名城大・理工、2. 名古屋大・赤崎記念研究センター
9:30		22a-H121-4	AlN 成長のための空気中アニールによる c 面サファイアの原子ステップ形成	○玉置 真哉 ¹ 、鈴木 周平 ¹ 、三宅 秀人 ^{1,2} 、平松 和政 ¹	1. 三重大院工、2. 三重大・地域イノベ
9:45	E	22a-H121-5	Structural quality of AlN epilayer grown on atomic layer deposition (ALD)-Al ₂ O ₃ /sapphire substrate	○(PC)RYAN BANAL ¹ 、Masataka Imura ¹ 、Koide Yasuo ¹	1. NIMS
10:00			休憩 / Break		
10:15	招	22a-H121-6	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 歪補償 AlN/AlGaIn 障壁層による橙色 InGaIn 系 LED の発光特性	○飯田 大輔 ¹ 、声 深 ¹ 、平原 蠅太 ¹ 、丹羽 一将 ² 、上山 智 ² 、大川 和宏 ¹	1. 東京理大・理、2. 名城大・理工
10:30		22a-H121-7	無極性 m 面 AlN 基板上への AlN の流量変調エピタキシャル	○西中 淳一 ¹ 、谷保 芳孝 ¹ 、赤坂 哲也 ¹ 、熊倉 一英 ¹	1. NTT 物性研
10:45		22a-H121-8	r 面サファイア上への a 面 AlN 成長におけるバッファ層成長温度依存性	○林家 弘 ¹ 、三宅 秀人 ^{1,2} 、平松 和政 ¹	1. 三重大院工、2. 三重大・地域イノベ

11:00	E 22a-H121-9	Growth and characterization of inversion domain reduced semipolar (10 $\bar{1}$ 3) GaN grown on Si (001) substrate	○Hojun Lee ¹ , Siyoung Bae ¹ , Kaddour Lekhal ¹ , Akira Tamura ¹ , Manato Deki ² , Yoshio Honda ² , Hiroshi Amano ^{2,3}	1.Nagoya Univ., 2.CIRFE, 3.ARC
11:15	22a-H121-10	MOVPE 法による窒素極性 (000-1) 面 InN/GaN ダブルヘテロ構造の作製	○赤坂 哲也 ¹ , 林家 弘 ¹ , 山本 秀樹 ¹ , 熊倉 一英 ¹	1.NTT 物性基礎研
11:30	奨 22a-H121-11	r 面サファイア基板上 a 面 GaInN 量子井戸構造に関する検討	○新實 輝行 ¹ , 神野 大樹 ¹ , 岩谷 素顕 ¹ , 竹内 哲也 ¹ , 上山 智 ¹ , 赤崎 勇 ^{1,2}	1.名城大理工, 2.名大赤崎研究記念センター
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P6 会場				
	22a-P6-1	硬 X 線光電子分光法による SiN/AlGaIn 界面評価	○田中 政幸 ¹ , 清井 明 ¹ , 本谷 司 ¹ , 倉橋 健一郎 ¹	1.三菱電機 先端総研
	22a-P6-2	強制振動子法による窒化物混晶の格子振動解析 (II)	○(M2) 南部 卓也 ¹ , 大八木 晋 ¹ , Md.Sherajul Islam ¹ , 橋本 明弘 ¹	1.福井大学院工
	22a-P6-3	4H-SiC(0001) 上エピタキシャルグラフェン基板を用いた MOVPE 法 InN エピタキシャル成長	○戸松 佑輝 ¹ , 道幸 雄真 ¹ , 石丸 大樹 ¹ , 橋本 明弘 ¹	1.福井大院工
	22a-P6-4	WS ₂ /h-AlN ヘテロ構造の電子状態	○太田 優一 ¹	1.都産技研
	22a-P6-5	pin-GaN ダイオードを用いた α 線検出特性評価	○有川 卓弥 ¹ , 杉浦 睦仁 ¹ , 宇佐美 茂佳 ² , 久志本 真希 ² , 本田 善丈 ² , 天野 浩 ^{2,3} , 三村 秀典 ⁴ , 井上 大電研 翼 ¹ , 青木 徹 ⁴ , 中野 貴之 ¹	1.静大院工, 2.名大院工, 3.赤崎リサーチセンター, 4.静大電研
	22a-P6-6	MOVPE 法を用いた BGaN 成長における成長雰囲気の影響の検討	○中村 匠 ¹ , 矢野 雄大 ¹ , 上山 浩平 ¹ , 青木 徹 ² , 井上 翼 ¹ , 小島 一信 ³ , 秩父 重英 ³ , 中野 貴之 ¹	1.静岡大院, 2.静岡大電研, 3.東北大多元研
	22a-P6-7	GaN-MOVPE 両極性同時成長における原料拡散に関する検討	○大隅 紀之 ¹ , 八木 裕隆 ¹ , 久瀬 健太 ¹ , 井上 翼 ¹ , 中野 貴之 ¹	1.静岡大院
	22a-P6-8	立体チャネルトランジスタ応用に向けた GaN 選択成長の検討	○黒岩 宏紀 ¹ , 武井 優典 ¹ , 高橋 言緒 ² , 井手 利英 ² , 清水 三聡 ² , 筒井 一生 ¹ , 角嶋 邦之 ¹ , 若林 整 ¹ , センター 岩井 洋 ¹	1.東工大, 2.産総研 先進パワーエレクトロニクス研究
	22a-P6-9	NH ₃ 分解触媒援用 MOVPE 成長 In _{0.95} Ga _{0.05} N(x=0.35) の Mg ドーピング挙動	○山本 高勇 ^{1,2} , 児玉 和樹 ^{1,2} , 重川 直輝 ³ , 松岡 隆志 ⁴ , 葛原 正明 ¹	1.福井大, 2.JST-CREST, 3.大阪市大, 4.東北大
	22a-P6-10	MgO 微傾斜基板上に作製した立方晶 InN ドット配列構造の堆積量依存性	○石井 健一 ¹ , 八木 修平 ¹ , 矢口 裕之 ¹	1.埼玉大院理工
	22a-P6-11	MOCVD 成長した InGaIn/GaN MQW 太陽電池における外部量子効率の well 厚依存性	○堤 達哉 ¹ , 加畑 智基 ¹ , 森 拓磨 ¹ , 三好 実人 ¹ , 江川 孝志 ¹	1.名工大
	22a-P6-12	MOS トランジスタ及び発光素子の一貫形成に向けた Si / SiO ₂ / GaN / Sapphire 構造の熱耐性に関する調査	○(MIC) 宇都宮 脩 ¹ , 立原 佳樹 ¹ , 土山 和晃 ¹ , 山根 啓輔 ¹ , 関口 寛人 ¹ , 岡田 浩 ^{2,1} , 若原 昭浩 ¹	1.豊技大工, 2.EIIRIS
	22a-P6-13	イオン注入技術を用いたプレーナ型 GaN-LED の作製	○(MIC) 上月 誠也 ¹ , 土山 和晃 ¹ , 山根 啓輔 ¹ , 関口 寛人 ¹ , 岡田 浩 ^{2,1} , 若原 昭浩 ^{1,2}	1.豊技大工, 2.EIIRIS
	22a-P6-14	Highly Efficient AlGaIn-Based DUV LED by Introducing of Two Stages n-AlGaIn Buffer Layer	○(D)Noritoshi Maeda ¹ , Tran Tinh ¹ , Masafumi Jo ¹ , Hideki Hirayama ¹	1.RIKEN
	E 22a-P6-15	Pico-second Laser epitaxy for GaN regrowth	○(P)Romualdo Alejandro Ferreyra ¹ , Tomohiro Kazumoto ¹ , Hideki Matsumura ¹ , Asamira Suzuki ² , Daisuke Ueda ¹	1.Kyoto Inst. of Tech., 2.R&D, Panasonic Corp.
	22a-P6-16	GaN 結晶成長メカニズムの熱力学解析	○(B) 関口 一樹 ¹ , 白川 裕規 ¹ , 山本 芳裕 ¹ , 洗平 昌晃 ^{1,2} , 白石 賢二 ^{1,2}	1.名大院工, 2.名大未来研
	22a-P6-17	反応性プラズマ支援成膜法により形成した BN 膜の構造変化と密着性	○野間 正男 ¹ , 山下 満 ² , 江利口 浩二 ³ , 長谷川 繁彦 ⁴	1.神港精機株式会社, 2.兵庫県立工業技術センター, 3.京大院工, 4.阪大産研
	22a-P6-18	縦型パッチがけでの LP HVPE GaN エピタキシャル成長	○梅澤 好太 ¹	1.東京エレクトロン
	22a-P6-19	RF-MBE を用いた Si 基板上への窒化物半導体の成長	○小柴 俊 ¹ , 竹口 諒 ¹ , 平城 大輝 ¹ , 石原 健也 ¹ , 久保 文寿 ¹ , 藤田 寛子 ¹ , 森下 和博 ¹ , 田中 康弘 ¹ , 高橋 尚志 ¹ , 鶴町 徳昭 ¹ , 金 昌秀 ² , 吉田 正裕 ² , 秋山 英文 ²	1.香川大, 2.東大物性研
3/22(Tue.) 13:15 - 15:00 口頭講演 (Oral Presentation) H121 会場				
13:15	招 22p-H121-1	【講演奨励賞受賞記念講演】 (15 分) n 型 AlInN/GaN DBR を有する微小共振器 LED	○池山 和希 ¹ , 小塚 祐吾 ¹ , 吉田 翔太郎 ¹ , 松井 健城 ¹ , 赤木 孝信 ¹ , 岩山 章 ¹ , 竹内 哲也 ¹ , 上山 智 ¹ , 岩谷 素顕 ¹ , 赤崎 勇 ^{1,2}	1.名城大理工, 2.名大赤崎記念研究センター, 3.京大院工, 4.阪大産研
13:30	奨 22p-H121-2	半極性 (10-11) 面自立 GaN 基板上 GaInN の成長機構の解析	○高西 徹 ¹ , 大角 純也 ¹ , 岩谷 素顕 ¹ , 上山 智 ¹ , 竹内 哲也 ¹ , 赤崎 勇 ^{1,2}	1.名城大理工, 2.名古屋大赤崎記念研究センター
13:45	22p-H121-3	温度ステップがある InGaIn/GaN MQW 成長の反射率変化の解析	○家近 泰 ¹	1.ニューフレテクノロジー
14:00	22p-H121-4	500 Torr での、枚葉式高速回転 MOCVD 装置による 200 mm Si 基板上 InGaIn/GaN MQW の成膜特性	○家近 泰 ¹ , 石川 幸孝 ¹ , 佐藤 裕輔 ¹ , 高橋 英志 ¹	1.ニューフレテクノロジー
14:15	22p-H121-5	InGaIn/GaN 超格子による広帯域発光 LED のスペクトル制御	○荒川 達哉 ¹ , 宮島 顕祐 ² , 杉山 正和 ¹ , 中野 義昭 ¹	1.東工大, 2.東京理大理
14:30	奨 22p-H121-6	組成傾斜 GaInN を用いた窒化物半導体トンネル接合	○高須賀 大貴 ¹ , 井野 正貴 ¹ , 竹内 哲也 ¹ , 岩谷 素顕 ¹ , 上山 智 ¹ , 赤崎 勇 ^{1,2}	1.名城大, 2.名古屋大赤崎記念研究センター
14:45	奨 22p-H121-7	GaInN トンネル接合と n 型 GaNSb による低温 p 側構造の作製	○(M1) 鈴木 健太 ¹ , 財部 寛 ¹ , 小森 大資 ¹ , 高須賀 大貴 ¹ , 小出 典克 ¹ , 竹内 哲也 ¹ , 岩谷 素顕 ¹ , 上山 智 ¹ , 赤崎 勇 ^{1,2}	1.名城大理工, 2.名古屋大赤崎記念研究センター
15.5 IV 族結晶, IV-IV 族混晶 / Group IV crystals and alloys				
3/20(Sun.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場				
9:00	20a-H112-1	非晶質 Si ₃ Ge _{1-x} /SiO ₂ の Au 誘起成長に及ぼす圧縮応力の影響	○草野 欽太 ¹ , 工藤 和樹 ¹ , 坂井 拓也 ¹ , 本山 慎一 ² , 楠田 豊 ² , 古田 真浩 ² , 中庸行 ³ , 沼田 朋子 ³ , 高倉 健一郎 ¹ , 角田 功 ¹	1.熊本高専, 2.サムコ, 3.堀場製作所
9:15	20a-H112-2	ガラス上 Ge 薄膜の Ag 誘起層交換成長	○吉峯 達太 ¹ , 都甲 薫 ¹ , 末益 崇 ¹	1.筑波大院
9:30	20a-H112-3	低温固相成長法による a-GeSn/ 絶縁膜構造の高移動度化 -GeSn の膜厚効果 -	○甲斐 友樹 ¹ , 松村 亮 ^{1,2} , 佐道 泰造 ¹ , 宮尾 正信 ¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
9:45	20a-H112-4	絶縁基板上における a-GeSn の金属誘起低温成長 - 横方向成長による Ge への Sn ドーピング -	○酒井 崇嗣 ¹ , 松村 亮 ^{1,2} , 佐道 泰造 ¹ , 宮尾 正信 ¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
10:00	奨 20a-H112-5	繰り返しレーザーアニール法による非晶質 GeSn/ 絶縁膜の非熱平衡成長 - 過飽和 Sn 濃度の冷却速度依存性 -	○茂藤 健太 ¹ , 松村 亮 ^{1,2} , 佐道 泰造 ¹ , 池上 浩 ¹ , 宮尾 正信 ¹	1.九大院システム情報, 2.学振特別研究員
10:15	奨 20a-H112-6	固相成長による C 媒介 Ge 量子ドット形成への Ge 堆積温度の効果	○(B) 武島 開斗 ¹ , 伊藤 友樹 ² , 川島 知之 ² , 鷲尾 勝由 ²	1.東北大工, 2.東北大院工

10:30	奨	20a-H112-7	Si(100) 基板上 C 媒介 Ge 量子ドットの低温固相成長	○(D) 伊藤 友樹 ¹ 、武島 開斗 ² 、川島 知之 ^{1,2} 、鷲尾 勝由 ^{1,2}	1. 東北大学院工, 2. 東北大工
10:45	奨	20a-H112-8	C-Si 反応を利用した Ge 量子ドット形成における C 堆積量の最適化	○安田 康佑 ¹ 、佐藤 佑紀 ² 、伊藤 友樹 ² 、川島 知之 ¹ 、鷲尾 勝由 ²	1. 東北大工, 2. 東北大院工
11:00		20a-H112-9	液浸ラマン分光法による Si 基板上 SiC 薄膜に印加された応力評価	○山本 章太郎 ¹ 、武内 一真 ¹ 、石原 聖也 ¹ 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大学
11:15		20a-H112-10	イオン注入を利用した圧縮歪み Si/ 緩和 Si _{1-x} C _x ヘテロ構造の作製におけるイオン注入条件の検討	○有澤 洋 ¹ 、澤野 憲太郎 ² 、宇佐美 徳隆 ¹	1. 名古屋大, 2. 東京都市大
3/20(Sun.) 13:15 - 16:30 口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場					
13:15		20p-H112-1	GeSiSn/GeSn/GeSiSn 二重ヘテロ構造の結晶性に対する GeSiSn 層の歪の影響	○福田 雅大 ¹ 、山羽 隆 ^{1,2} 、浅野 孝典 ^{1,2} 、藤浪 俊介 ¹ 、志村 洋介 ¹ 、黒澤 昌志 ^{1,3} 、中塚 理 ¹ 、財満 鎮明 ^{1,3}	1. 名古屋大院工, 2. 学振特別研究員, 3. 名古屋大未来研
13:30	奨	20p-H112-2	歪制御による GeSn 系混晶薄膜中 Sn 原子の熱的安定化	○志村 洋介 ¹ 、浅野 孝典 ^{1,2} 、山羽 隆 ^{1,2} 、中塚 理 ¹ 、財満 鎮明 ^{1,3}	1. 名古屋大院工, 2. 学振特別研究員, 3. 名古屋大未来研
13:45	奨	20p-H112-3	液浸ラマン分光法による歪 Ge _{1-x} Sn _x のフォノン変形ポテンシャル導出	○武内 一真 ¹ 、須田 耕平 ¹ 、山本 章太郎 ¹ 、横川 凌 ¹ 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大理工
14:00	奨	20p-H112-4	分子動力学法および分子軌道法を用いた SiGe 混晶内のフォノン再現に関する考察	○富田 基裕 ^{1,2,3} 、小椋 厚志 ² 、渡邊 孝信 ¹	1. 早大理工, 2. 明大理工, 3. 学振特別研究員 PD
14:15	奨	20p-H112-5	選択的イオン注入法で作製した一軸性歪 Ge の異方性応力評価	○山本 章太郎 ¹ 、武内 一真 ¹ 、小瀬村 大亮 ¹ 、此島 詩織 ² 、澤野 憲太郎 ² 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大理工, 2. 都市大総研
14:30			休憩 / Break		
14:45	奨	20p-H112-6	マイクロ回折法による MOCVD-Ge _{1-x} Sn _x /Ge 細線構造内部の局所歪量評価	○犬塚 雄貴 ¹ 、池 進一 ^{1,2} 、鷲津 智也 ¹ 、竹内 和歌奈 ¹ 、志村 洋介 ¹ 、今井 康彦 ³ 、木村 滋 ³ 、中塚 理 ¹ 、財満 鎮明 ^{1,4}	1. 名古屋大院工, 2. 学振特別研究員, 3. JASRI, 4. 名古屋大未来研
15:00		20p-H112-7	X線マイクロ回折による高 Ge 組成 SiGe / 組成傾斜層の結晶性層マッピング解析	○志田 和己 ¹ 、竹内 正太郎 ¹ 、今井 康彦 ² 、木村 滋 ² 、酒井 朗 ¹	1. 阪大院基礎工, 2. JASRI/Spring-8
15:15	奨	20p-H112-8	MOCVD 法を用いた in situ P ドープ Ge 薄膜のエピタキシャル成長	○池 進一 ^{1,2} 、志村 洋介 ¹ 、竹内 和歌奈 ¹ 、中塚 理 ¹ 、財満 鎮明 ^{1,3}	1. 名古屋大院工, 2. 学振特別研究員, 3. 名古屋大未来研
15:30		20p-H112-9	固相成長により単結晶 Si 基板上に結晶 SiGe 薄膜のエピタキシャル成長に関する検討	○(M1) ハムド アラー ¹ 、黒岩 杏太 ¹ 、金子 哲也 ¹ 、磯村 雅夫 ¹	1. 東海大院工
15:45		20p-H112-10	原子ステップ c 面サファイア基板上 Ge(111) 薄膜成長の検討	○河口 大和 ¹ 、伊藤 友樹 ¹ 、川島 知之 ¹ 、鷲尾 勝由 ¹	1. 東北大院工
16:00		20p-H112-11	TLZ 法を利用した均一組成バルク SiGe 結晶 (1) 大口径化と高品質化	○木下 恭一 ¹ 、荒井 康智 ¹	1. 宇宙航空研究開発機構
16:15		20p-H112-12	TLZ 法を利用した均一組成バルク SiGe 結晶 (2) 移動度評価	○前田 辰郎 ¹ 、服部 浩之 ¹ 、Chang Wen Hsin ¹ 、木下 恭一 ² 、荒井 康智 ²	1. 産業技術総合研究所, 2. 宇宙航空研究開発機構
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P9 会場					
		21p-P9-1	太陽電池用 C, Sn 添加 Si 結晶における原子配置の第一原理計算	○豊崎 兼人 ¹ 、末岡 浩治 ¹	1. 岡山県大院情報系工
		21p-P9-2	エクス線吸収微細構造 (XAFS) 法による MOCVD 成長 Ge _{1-x} Sn _x (GeSn) 薄膜の局所構造評価	○白田 宏治 ¹ 、吉木 昌彦 ¹ 、須田 耕平 ² 、小椋 厚志 ² 、富田 充裕 ¹	1. 東芝, 2. 明治大学
		21p-P9-3	スパッタエピタキシー法を用いた Ge 基板上への GeSiSn 薄膜の形成	○羽田 一暁 ¹ 、塚本 貴広 ¹ 、広瀬 信光 ² 、笠松 章史 ² 、三村 高志 ² 、松井 敏明 ² 、須田 良幸 ¹	1. 東京農工大理工, 2. 情報通信研究機構
		21p-P9-4	フレキシブル基板上のめっき法 Ge 膜の Cu 誘起低温多結晶化	○内田 恭敬 ¹ 、船山 朋子 ¹ 、木暮 嘉明 ¹ 、葉 文昌 ²	1. 帝京科学大, 2. 島根大総理工
		21p-P9-5	貼り合わせ法による一軸性歪み SiGe-on-Insulator(SGOI) の作製	○(M2) 松尾 拓哉 ¹ 、澤野 憲太郎 ¹	1. 都市大総研
	E	21p-P9-6	Investigation of Σ 3 Generation on Random Grain Boundary in Multicrystalline Silicon	○(P)Xianjia Luo ¹ 、Jun Chen ¹ 、Takashi Sekiguchi ¹	1. National Institute for Materials Science (NIMS)
		21p-P9-7	微傾斜基板を用いた伸張歪み Si/ 緩和 SiGe/Si(110) ヘテロ構造のモフォロジー及び素子特性	○宇津山 直人 ¹ 、佐藤 圭 ¹ 、山田 崇峰 ¹ 、有元 圭介 ¹ 、山中 淳二 ¹ 、中川 清和 ¹ 、原 康介 ¹ 、宇佐美 徳隆 ² 、澤野 憲太郎 ³	1. 山梨大クリスタル研, 2. 名古屋大, 3. 東京都市大総研
		21p-P9-8	伸張歪み Si/SiGe/Si(110) ヘテロ構造中の microtwin が表面モフォロジーに及ぼす影響	○佐藤 圭 ¹	1. 山梨大学
	E	21p-P9-9	Formation of Large-grain polycrystalline Si Layer on Quartz by Al-induced Crystallization for Thin-Film Solar Cells	Joko Suwardy ^{1,2} 、Thiyagu Subramani ² 、Wipakorn Jevasuwan ² 、Kaoru Toko ¹ 、Takashi Suemasu ¹ 、Naoki Fukata ^{1,2}	1. Univ. of Tsukuba, 2. NIMS
15.6 IV 族系化合物 (SiC) / Group IV Compound Semiconductors (SiC)					
3/20(Sun.) 9:00 - 11:45 口頭講演 (Oral Presentation) H101 会場					
9:00		20a-H101-1	Cr 溶媒を用いた SiC 溶液成長における SiC 過飽和度と成長速度の関係	○宮坂 遼 ¹ 、鳴海 大翔 ¹ 、川西 咲子 ^{2,3} 、佐々木 秀顕 ² 、吉川 健 ² 、前田 正史 ²	1. 東大工, 2. 東大生研, 3. 東北大多元研
9:15	奨	20a-H101-2	SiC 溶液法における溶媒への金属添加による炭素溶解度変化の熱力学計算	○(B) 畑佐 豪記 ¹ 、原田 俊太 ¹ 、田川 美穂 ¹ 、村山 健太 ¹ 、加藤 智久 ² 、宇治原 徹 ¹	1. 名大, 2. 産総研
9:30		20a-H101-3	SiC 溶液成長時のスパイラル成長とステップの競合過程のその場観察	○川西 咲子 ^{1,2} 、吉川 健 ¹	1. 東大生研, 2. 東北大多元研
9:45		20a-H101-4	SiC 溶液成長における基底面転位と表面モフォロジーの関係	○堀 司紗 ¹ 、村山 健太 ¹ 、原田 俊太 ¹ 、肖 世玉 ¹ 、田川 美穂 ¹ 、宇治原 徹 ¹	1. 名大院工
10:00		20a-H101-5	4H-SiC 溶液成長におけるステップ形状による TED 変換率向上	○関 和明 ¹ 、楠 一彦 ¹ 、海藤 宏志 ¹ 、森口 晃治 ¹ 、亀井 一人 ²	1. 新日鐵住金, 2. 早稲田大学
10:15		20a-H101-6	溶液法による 4H-SiC バルク結晶成長と結晶品質評価	○楠 一彦 ¹ 、関 和明 ¹ 、岸田 豊 ¹ 、海藤 宏志 ¹ 、森口 晃治 ¹ 、岡田 信宏 ¹ 、大黒 寛典 ² 、加渡 幹尚 ² 、土井 雅喜 ² 、且野 克典 ² 、関 章憲 ² 、佐藤 和明 ² 、別所 毅 ² 、原田 俊太 ³ 、宇治原 徹 ³	1. 新日鐵住金, 2. トヨタ自動車, 3. 名大
10:30			休憩 / Break		
10:45		20a-H101-7	複屈折観察による単結晶 4H-SiC 基板の結晶転位の評価	○竹中 研介 ¹ 、加藤 智久 ¹ 、松永 達也 ¹ 、武井 学 ² 、米澤 喜幸 ¹ 、奥村 元 ¹	1. 産総研, 2. 富士電機
11:00		20a-H101-8	EBSD-Wilkinson 法による SiC ウェハ加工変質層の局所歪み解析	○着本 享 ^{1,2} 、伊勢 立彦 ^{1,3} 、橋本 哲 ² 、櫻田 委大 ² 、先崎 純寿 ¹ 、加藤 智久 ¹ 、児島 一聡 ¹	1. 産総研, 2. JFE テクノリサーチ, 3. 旭ダイヤモンド工業
11:15	奨	20a-H101-9	4H-SiC 基板の二波長励起 PL 測定 - BGE 強度依存性 -	○近藤 圭太郎 ¹ 、福田 武司 ¹ 、本多 善太郎 ¹ 、鎌田 憲彦 ¹ 、八木 修平 ¹ 、矢口 裕之 ¹	1. 埼玉大工

11:30	20a-H101-10	プロトンマイクロビーム照射による SiC 中の発光中心の形成	○本多 智也 ^{1,2} , Kraus Hannes ^{2,3} , 加田 涉 ⁴ , 小野 一 ¹ . 埼玉大学, 2. 原子力機構, 3. Würzburg 大学, 4. 群馬大田 忍 ² , 春山 盛善 ^{2,4} , 佐藤 隆博 ² , 江夏 昌志 ² , 神 谷 富裕 ² , 川端 駿介 ^{2,4} , 三浦 健太 ⁴ , 花泉 修 ⁴ , 土方 泰斗 ¹ , 大島 武 ²
3/20(Sun.) 13:15 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) H101 会場			
13:15	20p-H101-1	Si(001) 上の 3C-SiC エピ膜形成および積層欠陥生成過程の断面 TEM 解析	○山崎 順 ¹ , 石田 篤志 ² , 秋山 賢輔 ³ , 平林 康男 ³ . 1. 阪大電顕セ, 2. 名大工, 3. 神奈川県産技セ
13:30	20p-H101-2	超高耐圧パワーデバイス用 4H-SiC C 面エピタキシャル成長の検討	○西尾 諒司 ^{1,2} , 櫛部 光弘 ^{1,2} , 浅水 啓斗 ^{2,3} , 北井 秀憲 ² , 児島 一聡 ² . 1. 東芝 研開センター, 2. 産総研, 3. ローム
13:45	奨 20p-H101-3	4H-SiC C 面 on-axis 基板上的スパイラル成長	○升本 恵子 ¹ , 齊藤 新吾 ¹ , 児島 一聡 ¹ , 加藤 智久 ¹ . 1. 産総研 ¹ , 奥村 元 ¹
14:00	20p-H101-4	電位コントラスト法による 4H-SiC エピタキシャル層の拡張欠陥観察	○木村 嘉伸 ¹ , 津野 夏規 ¹ , 沖野 泰之 ¹ , 毛利 友紀 ¹ . 1. 日立研究開発グループ ¹ , 大野 俊之 ¹ , 山田 廉一 ¹
14:15	20p-H101-5	4H-SiC における表面再結合速度の解析制度向上	○小濱 公洋 ¹ , 加藤 正史 ¹ , 市村 正也 ¹ . 1. 名工大
14:30	20p-H101-6	水溶液と接触した 4H-SiC における表面再結合	○市川 義人 ¹ , 加藤 正史 ¹ , 市村 正也 ¹ . 1. 名工大
14:45	奨 20p-H101-7	p 型 SiC の電気化学エッチングにおける酸化物除去過程についての考察	○榎岡 太郎 ¹ , 木本 恒暢 ¹ , 須田 淳 ¹ . 1. 京大工
15:00	休憩 / Break		
15:15	20p-H101-8	エピタキシャル基板を使用した 4H-SiC MOS 窒化界面の ESR 評価	○梅田 享英 ¹ , 鹿見山 陽平 ¹ , 奥田 貴史 ² , 須田 淳 ² . 1. 筑波大数物, 2. 京大, 3. 産総研 木本 恒暢 ² , 小杉 亮治 ³ , 岡本 光央 ³ , 原田 信介 ³
15:30	奨 20p-H101-9	超高次非線形誘電率顕微鏡法を用いた局所 DLTS 法の提案と SiO ₂ /SiC 界面評価への応用	○茅根 慎通 ¹ , 小杉 亮治 ² , 田中 保宣 ³ , 原田 信介 ³ . 1. 東北大, 2. 産総研, 3. 内閣府 ² , 奥村 元 ² , 長 康雄 ¹
15:45	20p-H101-10	超高温酸化と急速冷却による SiC-MOS 界面特性改善	○染谷 満 ^{1,2} , 永井 大介 ¹ , 細井 卓治 ¹ , 志村 孝功 ¹ . 1. 阪大院工, 2. 富士電機 渡部 平司 ¹
16:00	奨 20p-H101-11	広温度範囲にわたる 4H-SiC 熱酸化反応の面方位依存性の検証	○(M2) 永井 大介 ¹ , 染谷 満 ^{1,2} , 細井 卓治 ¹ , 志村 孝功 ¹ , 渡部 平司 ¹ . 1. 阪大院工, 2. 富士電機
16:15	奨 E 20p-H101-12	Thermal oxidation enhancement using barium on 4H-SiC(0001) substrates	○(PC)Atthawut Chanthaphan ¹ , Yoshihito Katsu ¹ , Takuji Hosoi ¹ , Takayoshi Shimura ¹ , Heiji Watanabe ¹ . 1. Osaka Univ.
16:30	奨 20p-H101-13	SiC MOS デバイスにおけるゲートリーク伝導機構と正孔捕獲挙動の相関	○勝 義仁 ¹ , チャンタバン アタウト ¹ , 細井 卓治 ¹ , 志村 孝功 ¹ , 渡部 平司 ¹ . 1. 阪大院工
16:45	20p-H101-14	4H-SiC MOS キャパシタ界面近傍における電子と正孔の膜中トラップ密度分布の比較	○藤野 雄貴 ¹ , 喜多 浩之 ¹ . 1. 東大院工
17:00	休憩 / Break		
17:15	20p-H101-15	4H-SiC C 面における高温・低 O ₂ 分圧下ドライ酸化による MOS 界面特性の制御	○梶房 裕之 ¹ , 喜多 浩之 ¹ . 1. 東大院工
17:30	奨 20p-H101-16	4H-SiC MOSFET 移動度に対する熱酸化による基板特性劣化とダメージ層除去効果の競合	○平井 悠久 ¹ , 作田 良太 ¹ , 喜多 浩之 ¹ . 1. 東大院工
17:45	奨 20p-H101-17	SiC MOS 反転層におけるホール移動度の p 型アクセプタ濃度依存性	○野口 宗隆 ¹ , 岩松 俊明 ¹ , 網城 啓之 ¹ , 渡邊 寛 ¹ . 1. 三菱電機, 2. 東大工 中田 修平 ¹ , 黒岩 丈晴 ¹ , 喜多 浩之 ² , 山川 聡 ¹
18:00	奨 20p-H101-18	界面単位密度を考慮した SiC-MOSFET 伝達特性モデルの構築	○国崎 愛子 ¹ , 長谷川 淳一 ¹ , 岩崎 孝之 ¹ , 野口 宗隆 ² , 古橋 壮之 ² , 渡邊 寛 ² , 中田 修平 ² , 小寺 哲夫 ¹ , 波多野 睦子 ¹
18:15	20p-H101-19	SiC-MOSFET の SPICE 用ドレイン電流モデル	○鶴留 亮太 ¹ , 山崎 武 ¹ , 前川 凌雅 ¹ , 濱 雄介 ¹ , 村上 英一 ¹ . 1. 九産大工
18:30	20p-H101-20	実動作に則した閾値電圧変動の動的評価	○岡本 光央 ¹ , 染谷 満 ^{1,2} , 原田 信介 ¹ , 矢野 裕司 ³ . 1. 産総研, 2. 富士電機, 3. 筑波大学 奥村 元 ¹
18:45	20p-H101-21	SiC-MOSFET のスイッチング動作による劣化 (AC-PBTI)	○古市 貴大 ¹ , 交易場 良輔 ¹ , 鶴 爽稀 ¹ , 村上 英一 ¹ . 1. 九州産業大学
3/21(Mon.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) H101 会場			
9:00	21a-H101-1	AR-XPS による 4H-SiC (0001) on-Axis, 4° Off-Axis 基板の初期酸化過程の解明	○荒井 仁 ¹ , 豊田 涼馬 ¹ , 磯橋 藍 ² , 佐野 泰久 ² . 1. 東京都市大工, 2. 阪大院工 野平 博司 ¹
9:15	21a-H101-2	ウェット酸化により形成した SiO ₂ /4H-SiC の電子状態評価 (II)	○渡辺 浩成 ¹ , 大田 晃生 ¹ , 藤村 信幸 ¹ , 牧原 克典 ¹ . 1. 名古屋大学 宮崎 誠一 ¹
9:30	21a-H101-3	光電子回折による SiC(000-1)/SiO ₂ 界面の窒素の局所構造解析	○森 大輔 ¹ , 八瀬 隆之 ¹ , 大山 悦輝 ² , 松井 文彦 ² . 1. 富士電機株式会社, 2. 奈良先端大
9:45	21a-H101-4	4H-SiC m 面上に形成された熱酸化膜の界面近傍における微視的構造の特徴の赤外分光法による解析	○黒山 滉平 ¹ , 平井 悠久 ¹ , 山本 建築 ² , 金村 高司 ² . 1. 東京大工, 2. デンソー 喜多 浩之 ¹
10:00	21a-H101-5	SiC 熱酸化膜における界面近傍の膜質評価	○永井 龍 ¹ , 飯塚 望 ¹ , 蓮沼 隆 ¹ , 山部 紀久夫 ¹ . 1. 筑波大
10:15	21a-H101-6	SiC 熱酸化膜のステップエッチングによる表面ラフネス増加	永井 龍 ¹ , 飯塚 望 ¹ , 蓮沼 隆 ¹ , 山部 紀久夫 ¹ . 1. 筑波大
10:30	21a-H101-7	SiC の Wet 酸化に伴う酸化膜表面および界面のラフネス増加	○川村 浩晃 ¹ , 永井 龍 ¹ , 蓮沼 隆 ¹ , 山部 紀久夫 ¹ . 1. 筑波大
10:45	休憩 / Break		
11:00	奨 21a-H101-8	堆積薄膜へのレーザ照射による 4H-SiC への Al のドーピング特性	○角名 陸歩 ¹ , 池田 晃裕 ¹ , 池上 浩 ¹ , 浅野 種正 ¹ . 1. 九大シ情
11:15	奨 21a-H101-9	レーザアニールによる 4H-SiC C 面上の Ti-Si-C オーミックコンタクトの形成	○ミランタ デシルワ ¹ , 川崎 輝尚 ² , 吉川 公磨 ¹ . 1. 広島大学ナノデバイス, 2. 住友重工 黒木 伸一郎 ¹
11:30	21a-H101-10	WC 電極と W ₂ C 電極による SiC ショットキーダイオードの電気特性評価	○(M1) 鈴木 智之 ¹ , 若林 整 ¹ , 筒井 一生 ¹ , 岩井 洋 ¹ . 1. 東工大総理工 角嶋 邦之 ¹
11:45	奨 21a-H101-11	界面顕微光応答法による Ni/p-3C-SiC ショットキー接触の 2 次元評価	○新郷 正人 ¹ , 市川 尚澄 ² , 加藤 正史 ² , 塩島 謙次 ¹ . 1. 福井大院工, 2. 名大院工
3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P10 会場			
	21p-P10-1	リアクタ部品表面保護膜物質の三フッ化塩素によるエッチング速度	塩田 耕平 ¹ , ○羽深 等 ¹ , 深江 功也 ² . 1. 横浜国大院工, 2. 関東電化
	21p-P10-2	Si 雰囲気アニール法による SiC トレンチ構造形状制御	○矢吹 紀人 ¹ , 鳥見 聡 ¹ , 野上 暁 ¹ , 金子 忠昭 ² . 1. 東洋炭素, 2. 関学大理工 北島 真 ¹
	21p-P10-3	4H-SiC 光電極を用いた CO ₂ 還元への助触媒効果	○赤羽 俊之輔 ¹ , 佐原 豪 ¹ , 市川 尚澄 ² , 加藤 正史 ² . 1. 東京工業大学, 2. 名古屋工業大学 前田 和彦 ¹ , 岩崎 孝之 ¹ , 小寺 哲夫 ¹ , 波多野 睦子 ¹
	奨 21p-P10-4	表面 n 型層の形成による p 型 3C-SiC 光電極の性能向上	○市川 尚澄 ¹ , 加藤 正史 ¹ , 市村 正也 ¹ . 1. 名工大

21p-P10-5	界面顕微光応答法を用いたイオン注入 n-SiC ショットキー接触の2次元評価	○村瀬 真悟 ¹ 、三島 友義 ² 、中村 徹 ² 、塩島 謙次 ¹	1. 福井大院工, 2. 法政大
21p-P10-6	4H-SiC 上金属多層膜界面の高温安定性	○関 伸弥 ¹ 、村松 哲郎 ¹ 、菅原 徹 ¹ 、長尾 至成 ¹ 、菅沼 克昭 ¹	1. 阪大産研
21p-P10-7	SiC 基板上のニッケルおよびチタン界面反応層の構造評価	○小金澤 智之 ¹ 、安野 聡 ¹ 、石丸 哲 ^{1,2}	1. 高輝度光科学研究セ, 2.SPring-8 サービス
21p-P10-8	Al、N イオン注入した SiC のシート抵抗と結晶欠陥との相関	○吉田 謙一 ¹ 、前川 順子 ¹ 、川野 輪仁 ¹	1. イオンテクノセンター
21p-P10-9	Si ₃ N ₄ 膜レーザーアブレーションによる 4H-SiC への窒素ドーピングと窒素拡散機構に関する研究	○小島 遼太 ¹ 、池上 浩 ¹ 、諏訪 輝 ¹ 、池田 晃裕 ¹ 、中村 大輔 ¹ 、浅野 正正 ¹ 、岡田 龍雄 ¹	1. 九州大シス情
21p-P10-10	フェムト秒レーザー照射による SiC 表面周期構造形成メカニズム	○広瀬 雄治 ¹ 、江龍 修 ¹	1. 名工大
21p-P10-11	Si/6H-SiC 貼り合わせ界面における漏れ電流伝導機構	○袖岡 大輝 ¹ 、木下 博之 ¹ 、石田 秀俊 ¹ 、吉本 昌広 ¹	1. 京都工繊大
21p-P10-12	熱処理による 4H-SiC/Si HBT の電気特性の改善	○(M1) 清水 彩絵 ¹ 、梁 剣波 ¹ 、新井 学 ² 、重川 直輝 ¹	1. 大阪市大工, 2. 新日本無線 (株)
21p-P10-13	4H-SiC(0001)/SiO ₂ 界面での欠陥準位の分布の第一原理解析	○金子 智昭 ^{1,2} 、山崎 隆浩 ^{1,2} 、田島 暢夫 ^{1,2,3} 、奈良 純 ^{1,2} 、清水 達雄 ⁴ 、加藤 弘一 ³ 、大野 隆央 ^{1,2,3}	1. 物質・材料研究機構, 2. 高効率電デバコンソ, 3. 東大生産研, 4. 東芝研究開発センター
21p-P10-14	4H-SiC/SiO ₂ 界面酸化の第一原理シミュレーション ~ O ₂ 酸化による炭素凝集と CO 脱離 ~	○山崎 隆浩 ^{1,2} 、田島 暢夫 ^{1,2} 、金子 智昭 ^{1,2} 、清水 達雄 ³ 、加藤 弘一 ⁴ 、大野 隆央 ^{1,2,4}	1. 物材機構, 2. MARCEED, 3. 東芝研究開発センター, 4. 東大生産研
21p-P10-15	アルカリ土類金属による Si 及び 4H-SiC の増殖酸化	○村岡 幸輔 ¹ 、瀬崎 洋 ^{1,2} 、石川 誠治 ^{1,2} 、前田 智徳 ^{1,2} 、吉川 公磨 ¹ 、黒木 伸一郎 ¹	1. 広島大学ナノデバイス, 2. フェニテックセミコンダクター
奨 21p-P10-16	4H-SiC nMOSFETs による論理インバータ回路の研究	○(B) 黒瀬 達也 ¹ 、黒木 伸一郎 ¹ 、長妻 宏都 ¹ 、石川 誠治 ² 、前田 知徳 ² 、瀬崎 洋 ² 、吉川 公磨 ¹ 、牧野 高紘 ³ 、大島 武 ³ 、Mikael Ostling ⁴ 、Carl-Mikael Zetterling ⁴	1. 広島大学ナノデバイス, 2. フェニテック社, 3. 原子力研究開発機構, 4. KTH
奨 21p-P10-17	4H-SiC nMOSFET による Pseudo-CMOS 論理インバータの研究	○長妻 宏都 ¹ 、黒木 伸一郎 ¹ 、黒瀬 達也 ¹ 、石川 誠治 ^{1,2} 、前田 知徳 ^{1,2} 、瀬崎 洋 ^{1,2} 、吉川 公磨 ¹ 、牧野 高紘 ³ 、大島 武 ³ 、Mikael Ostling ⁴ 、Carl-Mikael Zetterling ⁴	1. 広島大学ナノデバイス, 2. フェニテックセミコンダクター (株), 3. 日本原子力研究開発機構, 4. KTH Royal Institute of Technology
21p-P10-18	高温・高湿度雰囲気中γ線照射により SiC MOSFETs に生成される電荷の線量依存	○武山 昭憲 ¹ 、松田 拓磨 ^{1,2} 、横関 貴史 ^{1,2} 、三友 啓 ^{1,2} 、村田 航一 ^{1,2} 、牧野 高紘 ¹ 、小野田 忍 ¹ 、大久保 秀一 ³ 、田中 雄季 ³ 、神取 幹郎 ³ 、吉江 徹 ³ 、大島 武 ¹ 、土方 泰斗 ²	1. 原子力機構, 2. 埼玉大院理工研, 3. サンケン電気
21p-P10-19	ガンマ線照射耐性における SiC-MOSFET の構造最適化	○(M1) 三友 啓 ^{1,2} 、松田 拓磨 ^{1,2} 、村田 航一 ^{1,2} 、横関 貴史 ^{1,2} 、牧野 高紘 ² 、武山 昭憲 ² 、小野田 忍 ² 、大島 武 ² 、大久保 秀一 ³ 、田中 雄季 ³ 、神取 幹郎 ³ 、吉江 徹 ³ 、土方 泰斗 ¹	1. 埼玉大学, 2. 日本原子力機構, 3. サンケン電気
21p-P10-20	SiC MOSFET のガンマ線照射効果に及ぼすゲートバイアスの影響	○(M1) 村田 航一 ^{1,2} 、三友 啓 ^{1,2} 、松田 拓磨 ^{1,2} 、横関 貴史 ^{1,2} 、牧野 高紘 ² 、武山 昭憲 ² 、小野田 忍 ² 、大久保 秀一 ³ 、田中 雄季 ³ 、神取 幹郎 ³ 、吉江 徹 ³ 、大島 武 ² 、土方 泰斗 ¹	1. 埼玉大学, 2. 原子力機構, 3. サンケン電気
21p-P10-21	フルバンドモンテカルロ法による 4H-SiC の高電界電子輸送シミュレーション	○藤田 流星 ¹ 、小長 晃輔 ¹ 、小谷 岳生 ² 、鎌倉 良成 ¹ 、森 伸也 ¹	1. 阪大工, 2. 鳥取大工
21p-P10-22	SiC デバイスの高速スイッチング時における不完全イオン化による影響のシミュレーション検討	○海老原 洪平 ¹ 、川原 洗太郎 ¹ 、渡邊 寛 ¹ 、中田 修平 ¹ 、山川 聡 ¹	1. 三菱電機
21p-P10-23	ディスクリート SiC-MOSFET のオンゴーイング高温放置試験	○荒木 祥和 ¹ 、鈴木 達広 ¹ 、山下 真理 ¹ 、大野 俊明 ² 、薬丸 尚志 ³ 、澤田 浩紀 ⁴ 、谷本 智 ¹	1. 日産アーク, 2. ノトツツ・アドバンス・テクノロジー, 3. 日立パワーソリューションズ, 4. 岩通計測
21p-P10-24	低インダクタンス SiC パワー半導体モジュールの製作と解析	○鈴木 達広 ¹ 、山下 真理 ¹ 、森 哲也 ¹ 、谷本 智 ¹ 、飯塚 祥太 ² 、新妻 裕太 ² 、赤津 観 ²	1. 日産アーク, 2. 芝浦工業大学

15.7 エピタキシーの基礎 / Fundamentals of epitaxy

3/21(Mon.) 9:00 - 9:30 口頭講演 (Oral Presentation) H112 会場			
9:00	21a-H112-1	SiC における欠陥誘起ポリティプの簡単な理解	○伊藤 智徳 ¹ 、秋山 亨 ¹ 、中村 浩次 ¹
9:15	21a-H112-2	InAs/GaAs(001) 系界面転位形成に関する理論的検討	○海田 諒 ¹ 、秋山 亨 ¹ 、中村 浩次 ¹ 、伊藤 智徳 ¹
15.8 結晶評価、不純物・結晶欠陥 / Crystal evaluation, impurities and crystal defects			
3/20(Sun.) 9:30 - 12:45 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場			
9:30	20a-H113-1	シリコン結晶中の熱平衡点欠陥：フレネル対称ショットキー欠陥	○末澤 正志 ¹ 、飯島 嘉明 ¹ 、米永 一郎 ¹
9:45	20a-H113-2	ヴォロンコフモデルへのコメント (1) ステージ 1 & 2	○末澤 正志 ¹ 、飯島 嘉明 ¹ 、米永 一郎 ¹
10:00	20a-H113-3	ヴォロンコフモデルへのコメント (2) : 不純物効果	○末澤 正志 ¹ 、飯島 嘉明 ¹ 、米永 一郎 ¹
10:15	20a-H113-4	CZ シリコン結晶の長時間成長停止中に発生する格子間シリコンの観察	○阿部 孝夫 ¹ 、高橋 徹 ¹ 、白井 光雲 ²
10:30	20a-H113-5	格子間酸素が育成中 Si 単結晶の点欠陥濃度に与える影響 (2)	○末岡 浩治 ¹ 、中村 浩三 ¹ 、ファンヘレモン t イアン ²
10:45	20a-H113-6	n 型ドーパント近傍における Si 空孔クラスターの安定性に関する第一原理計算	○河合 宏樹 ¹ 、中崎 靖 ¹ 、金村 貴永 ²
11:00	休憩 / Break		
11:15	20a-H113-7	箱庭法による半導体諸物性値の算出 - 第一原理計算と熱統計力学をベースに -	○神山 栄治 ^{1,2} 、○末岡 浩治 ¹
11:30	20a-H113-8	Si 結晶中の低濃度炭素の赤外吸収測定 (VIII) 第二世代技術による 10 ¹⁴ cm ⁻³ 台の測定と SIMS、放射化	○渡邊 香 ¹ 、井上 直久 ^{2,9} 、後藤 安則 ³ 、杉山 隆英 ⁴ 、関 洋文 ⁵ 、大淵 真澄 ⁶ 、鶴野 浩行 ⁷ 、藤山 紀之 ⁵ 、嶋田 茂 ⁸ 、河村 裕 ⁹
11:45	20a-H113-9	シリコン結晶の高感度赤外吸収と赤外欠陥動力学 (11) 照射誘起複合体の挙動の結晶成長法依存性	○井上 直久 ^{1,6} 、後藤 安則 ² 、杉山 隆英 ³ 、関 洋文 ⁴ 、渡邊 香 ⁵ 、河村 裕 ⁶
12:00	奨 20a-H113-10	フォトルミネッセンス法による高濃度 Si 結晶の不純物効果の解析	○中川 啓 ¹ 、田島 道夫 ¹ 、小椋 厚志 ¹
12:15	20a-H113-11	平行デュアルレーザービーム法による自由キャリアのバルク寿命評価：赤外レーザービーム屈折の理論	○金田 寛 ¹ 、大村 一郎 ¹
12:30	20a-H113-12	平行デュアルレーザービーム法による自由キャリアのバルク寿命評価：装置構成と平行デュアルビームの実現	○金田 寛 ¹ 、大村 一郎 ¹

3/20(Sun.) 14:15 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) H113 会場				
14:15	20p-H113-1	炭素クラスターイオン注入 Si エピウェーハの特徴 (1) - デバイス作製工程の重金属汚染に対するゲッターリング能力 -	○栗田 一成 ¹ , 奥山 亮輔 ¹ , 梶田 亜由美 ¹ , 門野 武 ¹ . 1. 株式会社 SUMCO 1, 廣瀬 諒 ¹ , 古賀 祥泰 ¹ , 奥田 秀彦 ¹	
14:30	奨 20p-H113-2	炭素クラスターイオン注入 Si エピウェーハの特徴 (2) - 水素に対する注入領域の捕獲能力 -	○奥山 亮輔 ¹ , 廣瀬 諒 ¹ , 梶田 亜由美 ¹ , 門野 武 ¹ , 1. SUMCO 古賀 祥泰 ¹ , 奥田 秀彦 ¹ , 栗田 一成 ¹	
14:45	20p-H113-3	炭素クラスターイオン注入 Si エピウェーハの特徴 (3) - 酸素に対する捕獲効果 -	○奥田 秀彦 ¹ , 廣瀬 諒 ¹ , 梶田 亜由美 ¹ , 門野 武 ¹ , 1. SUMCO 奥山 亮輔 ¹ , 古賀 祥泰 ¹ , 栗田 一成 ¹	
15:00	20p-H113-4	炭素クラスターイオン注入 Si エピウェーハの特徴 (4) - 常温接合界面における酸素の捕獲能力 -	○古賀 祥泰 ¹ , 栗田 一成 ¹	1. (株) SUMCO
15:15	奨 20p-H113-5	炭素クラスターイオン注入 Si エピウェーハの特徴 (5) - マイクロ波加熱処理がクラスター注入レンジに与える効果 -	○門野 武 ¹ , 奥山 亮輔 ¹ , 梶田 亜由美 ¹ , 廣瀬 諒 ¹ , 1. 株式会社 SUMCO 古賀 祥泰 ¹ , 奥田 秀彦 ¹ , 栗田 一成 ¹	
15:30	奨 20p-H113-6	炭素クラスターイオン注入 Si エピウェーハの特徴 (6) - 多元素・分子イオン注入技術の開発検討 -	○廣瀬 諒 ¹ , 奥山 亮輔 ¹ , 門野 武 ¹ , 古賀 祥泰 ¹ , 1. 株式会社 SUMCO, 2. 日新イオン機器株式会社 奥田 秀彦 ¹ , 栗田 一成 ¹ , 宮本 直樹 ²	
15:45	休憩 / Break			
16:00	20p-H113-7	Si ウェーハにおける傷を起点とした Slip 転位発生の臨界応力	○藤瀬 淳 ¹ , 小野 敏昭 ¹	1. 株式会社 SUMCO
16:15	奨 20p-H113-8	シリコン単結晶の転位増殖に及ぼす酸素の影響	○福島 航 ¹ , 高 冰 ² , 原田 博文 ² , 宮村 佳児 ² , 中野 智 ² , 柿本 浩一 ^{1,2}	1. 九大理工, 2. 九大応力研
16:30	20p-H113-9	TEM による GaN 層中の転位芯における原子位置解析	○松原 徹 ^{1,2} , 杉本 浩平 ¹ , 河原 慎 ¹ , 岡田 成仁 ¹ , 只友 一行 ¹	1. 山口大, 2. UBE 科学分析センター
16:45	20p-H113-10	レーザーアニール SiC の結晶性評価 (3)	○山本 秀和 ¹ , 内盛 瑞記 ¹ , マツタムト フルビオ ² , 金 鍾得 ³ , 小野 修一 ⁴ , 新井 学 ⁴	1. 千葉工大, 2. SCREEN/LASSE, 3. パークシステムズ, 4. 新日本無線
17:00	20p-H113-11	スキャントポグラフィ法を用いた SiC ウェーハの定量的な結晶歪みの検出	○米山 明男 ¹ , 横山 夏樹 ¹ , 山田 廉一 ¹	1. 日立製作所
17:15	20p-H113-12	非弾性 X 線散乱法による ScN エピタキシャル膜のフォノン分散と寿命	○内山 裕士 ¹ , 大島 祐一 ² , Villora Garcia ² , 島村 清史 ²	1. JASRI/SPRING8, 2. 物材機構
17:30	E 20p-H113-13	X-Ray Determination of the Structure of Ice Confined in Carbon Nanotubes	○(PC)Gregory A Pilgrim ^{1,2} , Todd D Krauss ¹	1. Univ. of Rochester, 2. JSPS International Research Fellow

3/21(Mon.) 13:30 - 15:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P11 会場			
21p-P11-1	プロトン照射と水素プラズマ処理による単結晶 Si のドーナー形成	○清井 明 ¹ , 川上 剛史 ¹ , 湊 忠玄 ¹ , 多留谷 政良 ¹	1. 三菱電機
21p-P11-2	Ge 単結晶中のドーパントが点欠陥の形成エネルギーに与える影響	○山岡 俊太 ¹ , 小林 弘治 ¹ , 末岡 浩治 ¹ , ファンヘ レメント イアン ²	1. 岡山県大院情報系工, 2. ゲント大学
21p-P11-3	Si 単結晶中の点欠陥形成に与えるドーパントの影響	○小林 弘治 ¹ , 山岡 俊太 ¹ , 末岡 浩治 ¹ , ファンヘ レメント イアン ²	1. 岡山県大, 2. ゲント大
21p-P11-4	Si 単結晶中のドーパント近傍の金属拡散に関する第一原理計算	○山田 惇弘 ¹ , 白澤 渉 ¹ , 末岡 浩治 ¹	1. 岡山県立大学
21p-P11-5	C ₂ H ₂ クラスターイオン注入により形成されるゲッターリングサイトとその安定性	白澤 渉 ¹ , ○末岡 浩治 ¹	1. 岡山県大院情報系工
21p-P11-6	4H-SiC 中のショックレー型積層欠陥の起点構造解析	○中村 勇 ¹ , 古庄 智明 ¹ , 山本 茂久 ¹	1. 三菱電機 (株)
21p-P11-7	角度分解トポグラフィと局所ロッピングカーブ法による Al イオン注入 SiC 基板の歪状態の観察	○高橋 由美子 ¹ , 平野 馨一 ¹ , 志村 考功 ² , 吉村 順一 ¹ , 長町 信治 ³	1. KEK-PF, 2. 大阪大院工, 3. (株) 長町サイエンスラボ
奨 21p-P11-8	レーザーアニール SiC の結晶性評価 (2)	○内盛 瑞記 ¹ , マツタムト フルビオ ² , 永井 哲也 ³ , 中居 克彦 ³ , 小野 修一 ⁴ , 新井 学 ⁴ , 山本 秀和 ¹	1. 千葉工大, 2. SCREEN セミコンダクターソリューションズ/LASSE, 3. 日鉄住金テクノロジーズ株式会社 富津事業所 解析ソリューション部, 4. 新日本無線 (株)
奨 21p-P11-9	パワーデバイス用 GaN ウェーハのラマン散乱分光法による評価 (5)	○(M1) 池田 直樹 ¹ , 山本 秀和 ¹	1. 千葉工業大学
21p-P11-10	パワーデバイス用 GaN ウェーハのラマン散乱分光法による評価 (6)	○安喰 和也 ¹ , 山本 秀和 ¹	1. 千葉工大
21p-P11-11	X 線を照射されたアルカリハライドの光電子放出挙動の観察	○山下 大輔 ¹	1. 理研計器

16 非晶質・微結晶 / Amorphous and Microcrystalline Materials

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

3/21(Mon.) 9:30 - 11:30 ポスター講演 (Poster Presentation) P8 会場			
21a-P8-1	希土類 -- リン共ドーピングシリカガラスの紫外吸収端の希土類依存性	○梶原 浩一 ¹ , 山口 葉 ¹ , 金村 聖志 ¹	1. 首都大
21a-P8-2	Na ₂ O-TiO ₂ -SiO ₂ 系ガラスの電気化学特性	○本間 剛 ¹ , 横山 亮太 ¹ , 篠崎 健二 ¹ , 小松 高行 ¹	1. 長岡技科大
21a-P8-3	FLA での a-Si の結晶化における反射防止膜利用によるパルス光エネルギー低減	○園田 裕生 ¹ , 大平 圭介 ¹	1. 北陸先端大
21a-P8-4	Ion Beam Assist 法を用いた a-Si:H 膜への過剰水素添加に関する研究	○(M2) 美山 和樹 ¹ , 大津 宗一郎 ² , 小野 貴寛 ² , 久保田 弘 ¹ , 橋新 剛 ² , 吉岡 昌雄 ²	1. 熊大院自然科学, 2. 熊工大
21a-P8-5	金属薄膜の相対反射率変化による太陽電池モジュール内の酢酸検出	○板山 知広 ¹ , 浅香 孝 ¹ , 若生 峻太郎 ¹ , 長崎 秀昭 ¹ , 岩見 健太郎 ¹ , 山本 千津子 ² , 原 由希子 ² , 増田 淳 ² , 梅田 倫弘 ¹	1. 農工大, 2. 産総研
21a-P8-6	太陽電池モジュール内酢酸検出のための金ナノコンポジット LSPR センサの開発	○(B) 若生 峻太郎 ¹ , 浅香 孝 ¹ , 板山 知広 ¹ , 長崎 秀昭 ¹ , 岩見 健太郎 ¹ , 梅田 倫弘 ¹ , 山本 千津子 ² , 原 由希子 ² , 増田 淳 ²	1. 農工大, 2. 産総研
21a-P8-7	pH 感受性蛍光色素を用いた太陽電池モジュール内酢酸検出センサの信頼性向上	○長崎 秀昭 ¹ , 浅香 孝 ¹ , 板山 知宏 ¹ , 若生 峻太郎 ¹ , 農工大, 2. 産総研 岩見 健太郎 ¹ , 梅田 倫弘 ¹ , 山本 千津子 ² , 原 由希子 ² , 増田 淳 ²	1. 農工大, 2. 産総研
21a-P8-8	非対称導波路結合フォトン・フォトキャリア直交型マルチストライプ半導体太陽電池	○石橋 晃 ¹ , 河西 剛 ¹ , 近藤 憲治 ¹ , 澤村 信雄 ¹	1. 北大電子研
E 21a-P8-9	Fabrication of back-contact c-Si/PEDOT:PSS heterojunction solar cells	○Jaker Hossain ¹ , Koji Kasahara ¹ , Qiming Liu ¹ , Ryo Ishikawa ¹ , Keiji Ueno ¹ , Tetsuya Kaneko ² , Hajime Shirai ¹	1. Saitama Univ., 2. Tokai Univ.
21a-P8-10	霧化塗布法による c-Si 上の PEDOT:PSS 製膜過程の評価	○市川 浩気 ¹ , 大木 達也 ¹ , ホサイン ジャケル ¹ , 石川 良 ¹ , 上野 啓司 ¹ , 白井 肇 ¹	1. 埼玉大学院理工

21a-P8-11	プラズマ CVD による c-Si/PEDOT:PSS 太陽電池反射防止膜用 a-SiOH 膜の作製	○笠原 浩司 ¹ 、ホサイン ジャケル ² 、劉 奇明 ² 、石 川良 ² 、上野 啓司 ² 、白井 肇 ²	1. 埼玉大工, 2. 埼玉大理工研
21a-P8-12	多結晶 Si 太陽電池評価のための顕微メスバウア分光装置の開発	○伊野 裕司 ¹ 、副島 啓義 ¹ 、早川 一生 ¹ 、行平 憲一 ¹ 、1. 静岡理工科大, 2. アプロ 藤田 浩享 ¹ 、渡辺 富夫 ¹ 、森口 幸一 ² 、小粥 啓子 ² 、 原田 芳仁 ² 、吉田 豊 ¹	
21a-P8-13	Cu/酸化物層/Siの密着強度と拡散バリア性	○(D)齋藤 友大 ¹	1. 東北大院工
21a-P8-14	光熱輻射分光法によるシリコン系薄膜の欠陥密度評価(III)	○加藤 大貴 ¹ 、近藤 宏紀 ² 、石本 雅人 ¹ 、吉田 憲充 ^{2,3} 、野々村 修一 ^{2,3}	1. 岐阜大工, 2. 岐阜大院工, 3. 岐大次世代エネセンタ
21a-P8-15	Al誘起成長 Ge 薄膜をシードとした低不純物密度 Ge 層の厚膜形成	○中田 充紀 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、原 康祐 ² 、宇佐美 徳隆 ³ 、末益 崇 ¹	1. 筑波大 数理物質, 2. 山梨大 クリスタル研, 3. 名大工
21a-P8-16	La ₂ O ₃ 薄膜界面層を用いたショットキー太陽電池の作製	○和泉 慶彦 ¹ 、若林 整 ¹ 、筒井 一生 ¹ 、岩井 洋 ¹ 、角嶋 邦之 ¹	1. 東工大総理工
E 21a-P8-17	Novel optically-rough and physically-flat Zn _{1-x} Mg _x O:Al substrate for superstrate-type thin-film solar cells	○(D)Lei Meng ¹ , Shinsuke Miyajima ¹	1. Tokyo Inst. of Tech.
21a-P8-18	Si アルカリエッチングによる規則配列ピラミッドテクスチャーの作成II	○上原 直己 ¹ 、福田 卓也 ¹ 、伊藤 和男 ¹ 、野口 克也 ¹	1. 群馬大院理工
21a-P8-19	N-フルオロピリジニウム塩を用いた光エッチングによる Si 表面ランダムダブルテクスチャー形成	○熊田 竜也 ¹ 、川合 健太郎 ¹ 、永井 隆文 ² 、足達 健 ² 、有馬 健太 ¹ 、森田 瑞穂 ¹	1. 阪大院工, 2. ダイキン工業
21a-P8-20	水添加液体ガラスを用いた反射防止ガラス薄膜の低屈折率化	○村上 功一 ¹ 、三和 寛之 ¹ 、野田 真一 ¹ 、児玉 篤紀 ¹ 、川口 雄大 ¹ 、野々村 修一 ¹	1. 岐大院工
21a-P8-21	球状シリカ粒子および液体ガラスを用いた高光散乱性透明導電基板	○井上 将成 ¹ 、三和 寛之 ¹ 、野田 真一 ¹ 、村上 功一 ¹ 、川口 雄大 ¹ 、児玉 篤紀 ¹ 、野々村 修一 ¹	1. 岐大院工
21a-P8-22	高効率 GaInP//Si 低倍率集光型・波長スプリットング太陽電池	○久保田 智也 ¹ 、佐藤 綾祐 ¹ 、澤野 憲太郎 ¹ 、Sichanugrist Porponth ² 、小長井 誠 ^{1,2}	1. 東京都市大学, 2. 科学技術振興機構
21a-P8-23	ヘテロ接合における a-Si:H パッシベーション膜の高品質化の検討	○(M1)坂本 潤平 ¹ 、山本 翔太 ¹ 、三和 寛之 ¹ 、西 田 哲 ¹ 、栗林 志頭真 ¹	1. 岐阜大学
21a-P8-24	Cat-CVD a-Si パッシベーション膜への ITO スパッタダメージ	○小西 武雄 ¹ 、大平 圭介 ¹	1. 北陸先端大
21a-P8-25	Cat-CVD で形成した窒化 Si 膜の高温アニール後のパッシベーション能力	○西川 斉志 ¹ 、大平 圭介 ¹	1. 北陸先端大
21a-P8-26	フラッシュランプアニールによる SiN _x /c-Si 界面特性の改善	○宮浦 純一郎 ¹ 、大平 圭介 ¹	1. 北陸先端大
21a-P8-27	n 型 Si 表面における PECVD-SiN _x :H パッシベーション性に対する光照射・熱処理の効果	○(PC)神岡 武文 ¹ 、岩橋 泰正 ¹ 、Lee Hyunju ¹ 、佐藤 友理 ¹ 、中村 京太郎 ² 、大下 祥雄 ¹	1. 豊田工大, 2. 明治大

16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス / Fundamental properties, evaluation, process and devices in disordered materials

3/22(Tue.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場			
9:00	招 22a-W331-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) フツホウ酸ガラス表面への単結晶パターニングと屈曲・交差したライン状単結晶の成長挙動	○篠崎 健二 ¹ 、阿部 翔太 ¹ 、本間 剛 ¹ 、小松 高行 ¹
9:15	奨 22a-W331-2	テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換素子の研究 —紫外光ポーリングの時間依存性—	○(B)張 存宇 ¹ 、鈴木 美明 ¹ 、三田地 成幸 ¹
9:30	奨 22a-W331-3	テルライト系ガラスを用いた超高速一括波長変換素子の研究 —ガラスサンプル厚さ依存性—	○(B)鈴木 美明 ¹ 、張 存宇 ¹ 、三田地 成幸 ¹
9:45	22a-W331-4	Ag ₂ O-TeO ₂ ガラスのガラス構造と線形/非線形光学特性	○早川 知克 ¹ 、加藤 圭一 ¹ 、Colas Maggy ² 、Duclere Jean Rene ² 、Thomas Philippe ² 相馬 遥香 ¹ 、上中 友紀 ¹ 、浅原 彰文 ² 、末元 徹 ² 、○内野 隆司 ¹
10:00	22a-W331-5	MgO 立方体結晶からの室温紫外レーザー発振	1. 神戸大, 2. 東大物性研
10:15	22a-W331-6	リチウムホウケイ酸塩ガラスにおける Ce ³⁺ の発光特性	○正井 博和 ¹ 、白井 貴昭 ¹ 、岡田 豪 ² 、柳田 健之 ²
10:30	22a-W331-7	高分解能誘導ブリルアン分光によるシリカガラスにおける音速および超音波減衰の評価	三澤 七菜美 ¹ 、藤井 康裕 ¹ 、是枝 聡肇 ¹ 、○正井 博和 ² 、梶原 浩一 ³
10:45		休憩 / Break	
11:00	22a-W331-8	Ge-Sb-Te 薄膜におけるファラデー電流と抵抗スイッチ現象の共存	○今西 佑典 ¹ 、中岡 俊裕 ¹
11:15	22a-W331-9	Cr-Ge-Te 化合物薄膜の相変化挙動	○畑山 祥吾 ¹ 、進藤 怜史 ¹ 、安藤 大輔 ¹ 、須藤 祐司 ¹ 、小池 淳一 ¹
11:30	22a-W331-10	SnS 薄膜のキャリア濃度の制御	○後藤 民浩 ¹
11:45	22a-W331-11	変調アドミタンス法によるヘテロ接合の評価	○岩崎 真宝 ¹ 、大江 和顕 ¹ 、酒井 作周 ¹ 、清水 耕作 ¹
12:00	22a-W331-12	前駆体 a-Si の膜質制御による FLA-poly-Si 膜の欠陥密度低減	○野澤 尚樹 ¹ 、大平 圭介 ¹

16.3 シリコン系太陽電池 / Bulk, thin-film and other silicon-based solar cells

3/19(Sat.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W321 会場			
9:00	19a-W321-1	レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡による太陽電池の PID 評価II	○北村 藤和 ¹ 、松尾 清隆 ¹ 、水端 稔 ¹ 、中西 英俊 ¹ 、川山 巖 ² 、斗内 政吉 ² 、白澤 勝彦 ³ 、望月 敏光 ³ 、高遠 秀尚 ³
9:15	19a-W321-2	酢酸蒸気曝露環境における c-Si PV セル劣化機構の解析	○棚橋 紀悟 ¹ 、坂本 憲彦 ¹ 、柴田 肇 ¹ 、増田 淳 ¹
9:30	19a-W321-3	p 型結晶シリコン太陽電池モジュールにおける PID 現象と Na 拡散の関係	○城内 紗千子 ¹ 、増田 淳 ¹
9:45	19a-W321-4	電圧誘起劣化加速試験により拡散した太陽電池モジュール用部材内の Na の評価	○大橋 史隆 ¹ 、宮腰 悠平 ¹ 、水野 佳貴 ¹ 、イン マン グ マング ¹ 、吉田 弘樹 ¹ 、原 由希子 ² 、増田 淳 ² 、野々村 修一 ¹
10:00	奨 19a-W321-5	多結晶 Si 太陽電池モジュールの K イオンによる PID 劣化メカニズム解明に向けた光過渡吸収法の検討	○野口 一輝 ¹ 、Islam Mohammad ¹ 、石河 泰明 ¹ 、仲 濱 秀齊 ² 、浦岡 行治 ¹
10:15	奨 19a-W321-6	裏面側にエミッターを有する n 型 c-Si 太陽電池モジュールの PID 挙動	○山口 世力 ¹ 、増田 淳 ² 、大平 圭介 ¹
10:30	19a-W321-7	電圧誘起劣化した太陽電池モジュールのレーザー加熱による回復	○吉田 弘樹 ¹ 、志知 拓弥 ¹ 、イン マン グ マング ¹ 、大橋 史隆 ¹ 、増田 淳 ² 、野々村 修一 ¹
10:45		休憩 / Break	

11:00	19a-W321-8	太陽光励起レーザーと組み合わせるためのシリコン光電変換素子 (III)	○山田 登 ¹ 、伊藤 忠 ¹ 、竹田 康彦 ¹	1. 豊田中研
11:15	19a-W321-9	シリコンナノワイヤ太陽電池のキャリア収集特性の改善	○加藤 慎也 ¹ 、阿部 祐介 ² 、白柳 裕介 ² 、黒川 康良 ³ 、宮島 晋介 ⁴ 、小長井 誠 ^{2,5}	1. 名工大理工, 2. 科学技術振興機構, 3. 名大院工, 4. 東工大理工院工, 5. 東京都市大学総研
11:30	19a-W321-10	MACES 法で作製したシリコンナノワイヤの細線化	○(M2) 矢野 貢 ¹ 、黒川 康良 ^{2,3} 、宮島 晋介 ¹ 、山田 明 ¹	1. 東工大理工院工, 2. 名大院工, 3. JST- さきがけ
11:45	19a-W321-11	Si/SiO ₂ 超格子ワイヤー太陽電池の作製と光起電力効果の確認	○山田 繁 ¹ 、小長井 誠 ^{1,2} 、宮島 晋介 ³	1. 科学技術振興機構, 2. 東京都市大学総合研究所, 3. 東工大理工
12:00	19a-W321-12	異方性ウェットエッチングによる太陽電池用 Si ナノウォールの形成	○吉葉 修平 ¹ 、平井 政和 ¹ 、市川 幸美 ^{1,2} 、小長井 誠 ^{1,2}	1. 科学技術振興機構, 2. 都市大
3/20(Sun.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) W611 会場				
9:00	奨 20a-W611-1	化学的転写法により形成した極低反射 Si 表面の光学特性と、高効率太陽電池への応用	○今村 健太郎 ^{1,2} 、入鹿 大地 ^{1,2} 、鬼塚 裕也 ^{1,2} 、小林 光 ^{1,2}	1. 阪大産研, 2. CREST-JST
9:15	奨 20a-W611-2	化学的転写法による極低反射表面と裏面ナノ構造を用いた結晶 Si 太陽電池の変換効率向上	○鬼塚 裕也 ^{1,2} 、入鹿 大地 ^{1,2} 、今村 健太郎 ^{1,2} 、小林 光 ^{1,2}	1. 阪大産研, 2. CREST-JST
9:30	20a-W611-3	PERC 型太陽電池用 LTC コンタクトの電気的特性	○ト部 駿介 ¹ 、宮島 晋介 ¹	1. 東工大理工
9:45	E 20a-W611-4	A method for removal of single-side doped layers of PERT solar cells	○SIMAYI SHALAMUJIANG ¹ , Yasuhiro Kida ¹ , Katsuhiko Shirasawa ¹ , Hidetaka Takato ¹	1. AIST
10:00	20a-W611-5	n 型結晶 Si 太陽電池のエミッタ形成方法検討	○西村 邦彦 ¹ 、小林 裕美子 ¹ 、綿引 達郎 ¹ 、時岡 秀忠 ¹	1. 三菱電機
10:15	20a-W611-6	高変換効率 (21% 以上) n-PERC 型単結晶シリコン太陽電池の開発	○西村 慎也 ¹ 、綿引 達郎 ¹ 、新延 大介 ¹ 、林田 哲郎 ¹ 、湯田 洋平 ¹ 、森岡 孝之 ¹ 、過能 慎太郎 ² 、西村 邦彦 ¹ 、時岡 秀忠 ¹ 、山向 幹雄 ¹	1. 三菱電機先端技術総合研究所, 2. 三菱電機生産技術センター
10:30	休憩 / Break			
10:45	20a-W611-7	結晶シリコン太陽電池セルにおけるイオン注入によるリンエミッタの形成	○棚橋 克人 ¹ 、森谷 正昭 ¹ 、木田 康博 ¹ 、福田 哲生 ¹ 、白澤 勝彦 ¹ 、高遠 秀尚 ¹	1. 産総研
11:00	20a-W611-8	超高次走査型非線形誘電率顕微鏡法を用いた単結晶シリコン太陽電池のリンイオン注入エミッタ層におけるキャリア分布の可視化	○廣瀬 光太郎 ¹ 、棚橋 克人 ² 、高遠 秀尚 ² 、茅根 慎通 ¹ 、長 康雄 ¹	1. 東北大通研, 2. 産総研
11:15	20a-W611-9	太陽電池構造断面試料作製時のダメージが仕事関数測定に与える影響	○(PC) 山田 郁彦 ¹ 、神岡 武文 ¹ 、大下 祥雄 ¹ 、神谷 格 ¹	1. 豊田工大
11:30	20a-W611-10	太陽光発電セル用単結晶シリコンウェハの穴明け加工	○小野 裕道 ¹ 、三瓶 義之 ¹ 、小林 翼 ¹ 、大野 仁嗣 ² 、高島 康文 ³ 、渋川 達弘 ⁴ 、池田 正則 ⁵ 、木田 康博 ⁶ 、白澤 勝彦 ⁶ 、高遠 秀尚 ⁶	1. 福島県ハイテクプラザ, 2. 横浜石英, 3. 東成 EB 東北, 4. 東北電子, 5. 日大工, 6. 産総研福島再エネ研
11:45	20a-W611-11	Al 誘起成長法を用いた p 型薄膜多結晶 Si の太陽電池セルへの応用	○高橋 勲 ¹ 、筋原 康博 ¹ 、Wibowo Jefferson ¹ 、宇佐 美徳隆 ¹	1. 名大院工
12:00	奨 20a-W611-12	電界効果が太陽電池の変換効率に及ぼす影響	○(MIC) 日下部 昂志 ¹ 、大木 康平 ¹ 、松尾 直人 ¹ 、部家 彰 ¹	1. 兵庫県立大院工
3/20(Sun.) 13:30 - 18:00 口頭講演 (Oral Presentation) S611 会場				
13:30	20p-S611-1	50 cm 径ルツボを用いた 45 cm 径インゴット単結晶の 2 ゾーン加熱 Noncontact Crucible (NOC) 炉による成長	○中嶋 一雄 ¹ 、小野 聖 ¹ 、金子 弦 ¹ 、村井 良多 ¹ 、白澤 勝彦 ² 、福田 哲生 ² 、高遠 秀尚 ²	1. JST FUTURE-PV, 2. FREA
13:45	20p-S611-2	Noncontact crucible method により成長した Si インゴット単結晶の転位分布評価	○村井 良多 ¹ 、中嶋 一雄 ¹ 、小野 聖 ¹ 、金子 弦 ¹	1. 科学技術振興機構
14:00	20p-S611-3	撥液のつばを用いて成長した PV 用 CZ シリコン単結晶のバルク評価	○福田 哲生 ¹ 、堀岡 佑吉 ² 、棚橋 克彦 ¹ 、沙拉木江 司馬依 ¹ 、白澤 勝彦 ¹ 、高遠 秀尚 ¹	1. (国) 産総研, 2. FTB 研究所株式会社
14:15	20p-S611-4	n 型 CZ シリコンのキャリア寿命に対する熱処理による酸素析出の影響	○小島 拓人 ¹ 、鈴木 涼太 ¹ 、小椋 厚志 ¹ 、立花 福久 ² 、大下 祥雄 ³ 、西島 英一 ⁴ 、正田 勲 ⁴ 、飯田 伸仁 ⁴ 、ヤマ橋 昇二 ⁴	1. 明大理工, 2. 産総研福島, 3. 豊田工大, 4. 株式会社ト
14:30	20p-S611-5	機能性欠陥層を用いた太陽電池用結晶シリコンの不純物制御	○(B) 羽山 優介 ¹ 、高橋 勲 ¹ 、宇佐 美徳隆 ¹	1. 名大院工
14:45	20p-S611-6	欠陥マニピュレーションに向けた結晶 Si の粒界構造と転位発生の関係	○(M1) 岩田 大将 ¹ 、高橋 勲 ¹ 、宇佐 美徳隆 ¹	1. 名大院工
15:00	20p-S611-7	Si ビーズ核形成層によるハイパフォーマンス多結晶 Si の育成	○(B) 村松 哲郎 ¹ 、高橋 勲 ¹ 、G. Anandha babu ¹ 、宇佐 美徳隆 ¹	1. 名大院工
15:15	奨 20p-S611-8	太陽電池用多結晶 Si の粒界での応力集中	○杉岡 翔太 ¹ 、香掛 健太郎 ¹ 、出浦 桃子 ¹ 、大野 裕一 ¹ 、米永 一郎 ¹	1. 東北大金研
15:30	20p-S611-9	大型多結晶 Si の残留歪みイメージング	○下村 祥生 ¹ 、山田 基晴 ¹ 、福澤 理行 ¹	1. 京都市織大
15:45	奨 20p-S611-10	太陽電池用多結晶 Si における酸素析出初期状態のフォトルミネッセンス	○(M1) 樋口 史仁 ¹ 、宇野 匠 ¹ 、田島 道夫 ¹ 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大理工
16:00	休憩 / Break			
16:15	奨 E 20p-S611-11	Effect and Optimization of Chemical Cleaning before Deposition of Cat-CVD Passivation Films to Realize Extremely Low Surface Recombination Velocity on Flat and Textured Structures	○(PC) Cong Thanh Nguyen ¹ , Koichi Koyama ¹ , Shigeki Terashima ¹ , Chikao Okamoto ² , Shuichiro Sugiyama ² , Keisuke Ohdaira ¹ , Hideki Matsumura ¹	1. JAIST (Japan Adv. Inst. Sci. & Tech.), 2. SHARP Corporation
16:30	奨 20p-S611-12	結晶 Si 太陽電池におけるポストプラズマ処理を用いた SiN パッシベーション特性	○山下 祥弘 ¹ 、池野 成裕 ¹ 、小島 拓人 ¹ 、肥山 卓矢 ¹ 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大理工
16:45	20p-S611-13	a-Si _{1-x} O _x :H ヘテロ接合太陽電池構造に対する少数キャリアライフタイム温度依存測定	○稲葉 真宏 ¹ 、宮島 晋介 ¹	1. 東工大理工
17:00	20p-S611-14	Al ₂ O ₃ パッシベーション膜を堆積した結晶シリコンの実効少数キャリアライフタイムの温度依存性	○(M1) 増田 貴永 ¹ 、稲葉 真宏 ¹ 、宮島 晋介 ¹	1. 東工大理工
17:15	20p-S611-15	電界効果パッシベーションにおける実効少数キャリアライフタイムの温度依存性	○宮島 晋介 ¹ 、稲葉 真宏 ¹ 、増田 貴永 ¹ 、小林 裕美 ¹ 、綿引 達郎 ² 、時岡 秀忠 ²	1. 東工大理工, 2. 三菱電機株式会社
17:30	20p-S611-16	新規アルミニウム材料を用いたスプレー塗布法による酸化アルミニウム薄膜の作製とそのパッシベーション特性	○稲葉 孝一郎 ¹ 、豊田 浩司 ¹ 、中 俊雄 ¹ 、宮島 晋介 ¹	1. 東ソー・ファインケム, 2. 東工大理工
17:45	20p-S611-17	レーザーテラヘルツエミッション顕微鏡と C-V 測定によるパッシベーション膜特性の比較評価	○伊藤 明 ¹ 、望月 敏光 ³ 、中西 英俊 ¹ 、棚橋 克人 ³ 、川山 巖 ² 、斗内 政吉 ² 、白澤 勝彦 ³ 、高遠 秀尚 ³	1. SCREEN, 2. 阪大レーザー研, 3. 産総研

3/22(Tue.) 9:00 - 13:15		口頭講演 (Oral Presentation) W321 会場	
9:00	22a-W321-1	a-Si/c-Si ヘテロ接合太陽電池の a-Si 層へのプラズマドーピング	○小山 晃 ¹ 、山口 昇 ² 、田中 美和 ² 、鈴木 英夫 ² 、1. 北陸先端大、2. 株式会社 アルバック 大平 圭介 ¹ 、松村 英樹 ¹
9:15	22a-W321-2	a-Si パッシベーション膜への Cat-doping による結晶 Si の少数キャリア寿命の変化	○瀬戸 純一 ¹ 、大平 圭介 ¹ 、松村 英樹 ¹
9:30	22a-W321-3	液体 Si を用いた Si ヘテロ接合太陽電池の作製	○過程 ¹ 、大平 圭介 ¹ 、高岸 秀行 ² 、増田 高史 ¹ 、1.JAIST、2.Fukushima Univ. 下田 達也 ¹
9:45	22a-W321-4	Cu ₂ O:N/c-Si ヘテロ接合太陽電池のデバイスシミュレーション	○(M1) 竹井 雄太郎 ¹ 、滝口 雄貴 ¹ 、宮島 晋介 ¹
10:00	22a-W321-5	Cu ₂ O:N/c-Si ヘテロ接合の作製と評価	○滝口 雄貴 ¹ 、竹井 雄太郎 ¹ 、宮島 晋介 ¹
10:15	22a-W321-6	デバイスシミュレーションによるペロブスカイト / ヘテロ接合結晶 Si タンデム太陽電池のトンネル接合層の解析	○(M1) 中西 諒 ¹ 、滝口 雄貴 ¹ 、宮島 晋介 ¹
10:30	22a-W321-7	低倍率集光型 Si ヘテロ接合太陽電池の動作解析	○佐藤 綾祐 ¹ 、櫻井 健太 ¹ 、澤野 憲太郎 ¹ 、1. 東京都市大学、2. 科学技術振興機構 Sichanugrist Porponth ² 、中田 和吉 ² 、小長井 誠 ^{1,2}
10:45		休憩 / Break	
11:00	22a-W321-8	ガス加熱トライオードプラズマ CVD 法による低温成長 a-Si:H の高品質化	○新倉 ちさと ¹ 、Sichanugrist Porponth ² 、宮島 晋介 ³ 、1. 物質・材料研究機構、2. 科学技術振興機構、3. 東工大 市川 幸美 ² 、小長井 誠 ^{2,4}
11:15	22a-W321-9	最適な 3D ミクロ構造アモルファス Si 太陽電池の探索	○藪野 恭平 ¹ 、新倉 ちさと ² 、宮島 晋介 ¹ 、小長井 誠 ^{3,4}
11:30	22a-W321-10	高温製膜アモルファスシリコンにおける欠陥密度分布と太陽電池応用	○傍島 靖 ^{1,2} 、西尾 佑典 ¹ 、籠島 瑛二 ¹ 、久保田 晴香 ¹ 、1. 阪大院基礎工、2.JST-CREST 松田 彰久 ¹ 、岡本 博明 ^{1,2}
11:45	22a-W321-11	表面にフォトニック結晶構造を有する μ c-Si 太陽電池 - 厚膜 μ c-Si 表面へのフォトニック結晶形成による効率向上の検討 -	○元平 暉人 ¹ 、石崎 賢司 ¹ 、田中 良典 ¹ 、De Zoysa Menaka ^{1,2} 、長谷川 創 ¹ 、野田 進 ¹
12:00	22a-W321-12	フォトニックナノ構造と Metal Assisted Chemical Etching 法を用いた新規光閉じ込め構造の作製	○(B) 清 美樹 ¹ 、黒川 康良 ¹ 、宇佐美 徳隆 ¹
12:15	22a-W321-13	Ge ドット積層条件の変調によるフォトニックナノ構造の形状制御	○(B) 古田 大知 ¹ 、青沼 理 ¹ 、黒川 康良 ¹ 、宇佐美 徳隆 ¹
12:30	22a-W321-14	表面形状のランダムネスを有するフォトニックナノ構造の光学特性解析	○(M2) 青沼 理 ¹ 、黒川 康良 ¹ 、太野 健 ² 、宇佐美 徳隆 ¹
12:45	22a-W321-15	単層 Ge ドットマスクを用いたアルカリエッチングによる結晶 Si 太陽電池用新規光閉じ込め構造	○(B) 本部 惇史 ¹ 、黒川 康良 ¹ 、宇佐美 徳隆 ¹
13:00	E 22a-W321-16	Mask less neutral beam texturing to make nano holes on micro pyramids; broadband optical light trapping in thin wafer based Si (<100 μ m) solar cells	○(PC)Halubai Sekhar ¹ 、Tomohiro Kubota ² 、Yasuhiro Kida ¹ 、Tetsuo Fukuda ¹ 、Katsuto Tanahashi ¹ 、Hidetaka Takato ¹ 、Michio Kondo ¹ 、Seiji Samukawa ^{2,3}

17 ナノカーボン / Nanocarbon Technology

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

3/20(Sun.) 9:30 - 11:30		ポスター講演 (Poster Presentation) P4 会場	
	20a-P4-1	酸化グラフェン上への単層カーボンナノチューブ成長 : Pt, Fe, Co 触媒の比較	○小川 征悟 ¹ 、小澤 颯成 ¹ 、桐林 星光 ¹ 、才田 隆広 ¹ 、成塚 重弥 ¹ 、丸山 隆浩 ¹
	20a-P4-2	新しい LSI 配線のための超臨界エタノールを用いたカーボンナノ材料の作製	○(M1) 西川 慶 ¹ 、本間 匠 ¹ 、橋原 健太 ¹ 、宇原 祥夫 ¹ 、伊藤 勝利 ¹ 、大竹 勝人 ¹ 、齊藤 茂 ¹
奨	20a-P4-3	ミスト触媒 CVD 法を用いた CNT 成長における塩素ガス効果	○木下 聖也 ¹ 、苅田 基志 ¹ 、中野 貴之 ¹ 、井上 翼 ¹ 、長岡 宏一 ² 、三輪 鉄春 ² 、宮林 孝行 ²
	20a-P4-4	ラマンイメージングによるガスフロー成長単層カーボンナノチューブの評価	○木原 勝也 ¹ 、石谷 暁広 ¹ 、小山 智央 ¹ 、稲葉 工 ¹ 、本間 芳和 ¹
	20a-P4-5	多価イオン照射孤立多層カーボンナノチューブの構造評価	○出野 文哉 ¹ 、山下 拳太郎 ¹ 、関岡 嗣久 ¹ 、本多 信一 ¹ 、西田 尚史 ² 、徳井 太央貴 ² 、佐々木 康二 ² 、宮本 貴裕 ² 、櫻井 誠 ² 、新部 正人 ¹ 、寺澤 倫孝 ¹ 、平瀬 龍二 ³ 、泉 宏和 ³ 、吉岡 秀樹 ³ 、庭瀬 敬右 ⁴ 、田口 英次 ⁵
E	20a-P4-6	Synthesis of Two Dimensional Carbon Nanosheets through C-H Activation Reaction in Solution Plasma	○(D)Hyemin Kim ^{1,2,3,4} 、Nagahiro Saito ^{1,2,3,4}
	20a-P4-7	イオン照射法による金属含有 CNF 探針の透過型電子顕微鏡観察	○谷山 皓紀 ¹ 、中村 恭一朗 ¹ 、小山田 賢斗 ¹ 、種村 真幸 ¹ 、北澤 正志 ²
	20a-P4-8	カーボンナノチューブ薄膜電極の絶縁破壊に伴う薄膜表面モルフォロジーの変化	○水島 悠貴 ¹ 、古松 佑介 ¹ 、佐藤 英樹 ¹
	20a-P4-9	単層カーボンナノチューブの蛍光強度の濃度依存性	○(P) 魏 小均 ¹ 、平川 琢也 ¹ 、蓬田 陽平 ¹ 、平野 篤 ¹ 、藤井 俊治郎 ¹ 、田中 丈士 ¹ 、片浦 弘道 ¹
	20a-P4-10	低電流・低電圧水中アーク放電法による金属内包ナノファイバーの合成	○水野 恵輔 ¹ 、金 勇一 ¹ 、西川 英一 ¹
	20a-P4-11	4-ニトロベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボラートによるカーボンナノチューブ・ファイバの電気的特性改善	○(M1) 楠 拓真 ¹
奨	20a-P4-12	電解液による MnO ₂ -C ₆₀ ハイブリッドキャパシタの特性評価	○松久保 佑馬 ¹
	20a-P4-13	クラウンエーテルを用いた半導体型カーボンナノチューブ複合紙の n 型ドーピング	○(M1) 松井 洗樹 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹
	20a-P4-14	水平配向 SWNT を用いた圧電ポリマー被膜 SWNT タッチセンサーの圧力応答の改善	○吉澤 武志 ¹ 、田代 征久 ¹ 、鶴鷹 健 ¹ 、田畑 博史 ¹ 、久保 理 ¹ 、片山 光浩 ¹
	20a-P4-15	塗工型色素増感太陽電池向けカーボンナノチューブ塗料の改良	○(M1) 松永 悠樹 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹
	20a-P4-16	カーボンナノチューブ複合紙による電磁波シールドの遠方界性能向上	○(M1) 稲垣 忠光 ¹ 、大矢 剛嗣 ¹
	20a-P4-17	絶縁基板上多層グラフェン合成に向けた金属誘起層交換成長の検討	○村田 博雅 ¹ 、都甲 薫 ¹ 、末益 崇 ¹
	20a-P4-18	液体金属触媒とパターン基板により制御されたグラフェンドメインの観察	○今泉 雄太 ¹ 、荻野 俊郎 ¹
	20a-P4-19	サファイア基板上へのグラフェンの無触媒 CVD における成長時間依存性	○(M1) 上田 悠貴 ¹ 、山田 純平 ¹ 、内堀 樹 ¹ 、堀部 真史 ¹ 、松田 晋一 ¹ 、丸山 隆浩 ¹ 、成塚 重弥 ¹

20a-P4-20	大気圧 CVD 法における簡易酸化プロセス導入によるグラフェン核生成の制御	○(PC) 鈴木 誠也 ¹ 、寺田 佳史 ¹ 、吉村 雅満 ¹	1. 豊田工大院工
20a-P4-21	二軸電界印加状態での酸化グラフェン還元によるグラフェン作製	○煙山 史人 ¹ 、山内 繁 ² 、高山 正和 ¹ 、小宮山 崇夫 ¹ 、長南 安紀 ¹ 、山口 博之 ¹ 、青山 隆 ¹	1. 秋田県立大、2. 秋田県立大木工研
20a-P4-22	Al ₂ O ₃ /Fe 系複合触媒によるグラフェンの生成	○中村 基訓 ¹ 、平田 拓巳 ¹ 、壘 耕司 ¹	1. 旭川高専
20a-P4-23	Cu foil 触媒を用いた大気圧化学相成長法によるグラフェン成長の系統的な評価	○シリニ ソライヤ ¹ 、アグス スバギヨ ^{1,2} 、末岡 和久 ¹	1. 北大院情報科学、2. 北大創成研
奨 20a-P4-24	エッチングフリーな単結晶グラフェンデバイスアレイの作製	○(M1) 森 祐樹 ¹ 、生田 昂 ¹ 、金井 康 ¹ 、小野 亮生 ¹ 、大野 恭秀 ^{1,2} 、前橋 兼三 ^{1,3} 、井上 恒一 ¹ 、松本 和彦 ¹	1. 阪大産研、2. 徳島大、3. 東京農工大
20a-P4-25	RF 誘導加熱による微傾斜 Si 面 SiC(0001) 上単一ドメインエピタキシャルグラフェンの欠陥密度制御	○道幸 雄真 ¹ 、和田 拓也 ² 、今井 宏友 ¹ 、橋本 明弘 ¹	1. 福井大院工、2. 福井大工
20a-P4-26	Ni 上グラフェンの二次電子コントラストにおけるエネルギー依存性	○(B) 四本松 康太 ¹ 、高橋 惇郎 ¹ 、加藤 大輝 ¹ 、本 間 芳和 ¹	1. 東理大理
20a-P4-27	Ni パターン凝集を用いて作製したサファイヤ基板上グラフェン膜の評価	○(M1) 有馬 幸記 ¹ 、三好 実人 ¹ 、久保 俊晴 ¹ 、江川 孝志 ¹	1. 名工大
20a-P4-28	グラファイト / グラフェンのエッジ領域における電気化学活性の可視化	○熊谷 明哉 ¹ 、高橋 康史 ² 、三浦 千穂 ³ 、珠玖 仁 ³ 、末永 智一 ^{1,3}	1. 東北大 AIMR、2. 金沢大、3. 東北大
20a-P4-29	2 層レジストを用いたグラフェンナノディスクの作製と光学特性評価	○石田 周太郎 ¹ 、新宅 貴志 ¹ 、笹木 敬司 ¹	1. 北大電子研
奨 20a-P4-30	水を用いた異方性エッチングによるグラフェンナノリボンの作製と評価	○小川 峻 ¹ 、井上 凌介 ¹ 、渡邊 賢司 ² 、谷口 尚 ² 、真庭 豊 ¹ 、宮田 耕充 ^{1,3}	1. 首都大理工、2. 物材機構、3. JST さきがけ
奨 20a-P4-31	熱伝導率測定に向けたグラフェンの歪み制御	○今北 悠貴 ¹ 、安野 裕貴 ¹ 、竹井 邦晴 ¹ 、秋田 成司 ¹ 、有江 隆之 ¹	1. 大阪府立大工
20a-P4-32	歪み印加されたグラフェンナノリボンの過渡電気伝導現象の数値解析	○(M1) 加藤 大喜 ¹ 、笹岡 健二 ¹ 、小川 真人 ¹ 、相馬 聡文 ¹	1. 神大院工
20a-P4-33	グラフェンの歪み / 無歪み遷移領域におけるガウス波束の伝播に関する量子ダイナミクスシミュレーション	○(M1) 迫田 翔太郎 ¹ 、笹岡 健二 ¹ 、小川 真人 ¹ 、相馬 聡文 ¹	1. 神大院工
20a-P4-34	歪みグラフェン p-n 接合ダイオードの整流特性に関する量子輸送シミュレーション	○(M1) 市原 圭祐 ¹ 、笹岡 健二 ¹ 、小川 真人 ¹ 、相馬 聡文 ¹	1. 神戸大院工
E 20a-P4-35	Nitrogen Doping of Graphene	Hare Ram Aryal ¹ 、○(PC) Sudip Adhikari ¹ 、Hideo Uchida ¹ 、Koichi Wakita ¹ 、Masayoshi Umeno ¹	1. Chubu Univ.
奨 20a-P4-36	走査プローブ顕微鏡による多層グラフェンの表面電位計測	○清住 香奈 ¹ 、鈴木 誠也 ¹ 、吉村 雅満 ¹	1. 豊田工大院工
奨 20a-P4-37	光定在波による両持ち梁グラフェン機械共振の非線形制御	○(B) 井上 太一 ¹ 、安野 裕貴 ¹ 、竹井 邦晴 ¹ 、有江 隆之 ¹ 、秋田 成司 ¹	1. 大阪府立大工
奨 20a-P4-38	グラフェンナノメッシュ構造による熱輸送制御	○関口 卓弥 ¹ 、安井 悠馬 ¹ 、安野 裕貴 ¹ 、竹井 邦晴 ¹ 、秋田 成司 ¹ 、有江 隆之 ¹	1. 大阪府立大工
20a-P4-39	多層グラフェンに対する低エネルギー窒素イオンの照射効果	○大島 大命 ¹ 、前川 透 ¹ 、吉田 善一 ¹ 、中島 義賢 ¹ 、内田 貴司 ¹	1. 東洋大
20a-P4-40	有限温度でのグラフェン内電子間相互作用によるエネルギー分散補正の計算モデル構築	○小松 竜大 ¹ 、尾辻 泰一 ¹ 、Ryzhii Victor ¹ 、Svintsov Dmitry ² 、Vyurkov Vladimir ² 、佐藤 昭 ¹	1. 東北大、2. ロシア物理工科大学
20a-P4-41	CVD 成長した二層グラフェンへの FeCl ₃ のインターカレーション	○木下 博貴 ¹ 、河原 憲治 ² 、吾郷 浩樹 ^{1,2,3}	1. 九大院総理工、2. 九大先導研、3. JST さきがけ
20a-P4-42	強制振動子法を用いたサブ 2 次元ナノカーボンの格子振動解析 (II)	○大八木 晋 ¹ 、Md. Sherajul Islam ¹ 、南部 卓也 ¹ 、橋本 明弘 ¹	1. 福井大学院工
20a-P4-43	DWNT アンジップ単層グラフェンナノリボンのクロス構造の作製電気特性の角度依存性評価	○(M2) 劉 柏麟 ¹ 、葛西 誠也 ³ 、殷 翔 ³ 、山田 豊和 ² 、小川 琢治 ⁴ 、福森 稔 ⁴ 、田中 啓文 ¹	1. 九州工業大学、2. 千葉大学、3. 北海道大学、4. 大阪大学
E 20a-P4-44	Solution-based formation of high quality Al ₂ O ₃ gate dielectrics on graphene using microwave-assisted annealing	○(DC) KwanSoo Kim ¹ 、Goon-Ho Park ¹ 、Hirokazu Fukidome ¹ 、Tetsuya Suemitsu ¹ 、Taiichi Otsuji ¹ 、Maki Suemitsu ¹	1. Tohoku Univ.
20a-P4-45	光照射を用いて還元した窒素ドーピンググラフェンの開発とスーパーキャパシタ電極への応用	○中井 湧基 ¹ 、仁科 勇太 ^{2,3} 、林 靖彦 ¹ 、羽田 真毅 ¹	1. 岡山大自然、2. 岡山大 RCIS、3. JST さきがけ
E 20a-P4-46	Hydrogen Annealing Effect on Graphene Nanoribbon FET Covered by Silicon Dioxide Passivation Layer	○(DC) Wenzhen WANG ¹ 、Takuya Iwasaki ^{1,2} 、Jian Sun ¹ 、Manaharan Muruganathan ¹ 、Hiroshi Mizuta ^{1,2}	1. JAIST、2. Univ. of Southampton
20a-P4-47	グラフェンチューブの形成とフレキシブルデバイス応用	○(M1) 濱西 敏貴 ¹ 、中村 篤志 ¹	1. 静大工
20a-P4-48	酵素 / グラフェン電極の電気化学特性の評価	○(M1) 中川 典駿 ¹ 、黄 晋二 ¹	1. 青学大理工
20a-P4-49	グラフェン / Si ショットキー太陽電池の特性改善	○(PC) アディカリ スディーブ ¹ 、アリヤル ハレラ ム ¹ 、内田 秀雄 ¹ 、梅野 正義 ¹	1. 中部大
E 20a-P4-50	Fabrication and electrical characterization of a graphene-to-graphene crossbar device.	○Jothiramalingam Kulothungan ¹ 、Manoharan Muruganathan ¹ 、Marek Edward Schmidt ¹ 、Hiroshi Mizuta ^{1,2}	1. JAIST、2. Univ. of Southampton
20a-P4-51	グラフェン上に作製したコプレーナ導波路のマイクロ波帯における伝送特性の測定	○(B) 小菅 祥平 ¹ 、須賀 良介 ¹ 、黄 晋二 ¹ 、橋本 修一 ¹	1. 青学大理工
20a-P4-52	グラフェン / 電解質溶液の界面における電気化学相互作用	○鈴木 大輔 ¹ 、高井 和之 ^{1,2}	1. 法政大院理工、2. 法政大 生命科学
20a-P4-53	グラフェンのフレキシブル歪みセンサーへの応用	○仲村 渠 翔 ¹ 、ソリス・フェルデス バプロ ² 、スクマ・アジ アザ ¹ 、吾郷 浩樹 ^{1,2,3}	1. 九大院総理工、2. 九大先導研、3. JST さきがけ
20a-P4-54	酸化グラフェンをホール輸送層として用いたペロブスカイト太陽電池	○藤井 俊治郎 ¹ 、田中 丈士 ¹ 、片浦 弘道 ¹	1. 産総研ナノ材料
E 20a-P4-55	Damage mitigation of roll-transferred graphene onto arbitrary substrate	○Bongkyun Jang ¹ 、Sejeong Won ¹ 、Kwang-Seop Kim ¹ 、Hak-Joo Lee ¹ 、Jae-Hyun Kim ¹	1. KIMM
20a-P4-56	SiO ₂ /Si 上酸化グラフェンのアミド化 / エステル化反応における基板依存性	○沖本 治哉 ¹ 、吉井 靖剛 ¹ 、佐野 正人 ¹	1. 山大院理工
20a-P4-57	単層 Mo _{1-x} Re _x S ₂ における 1H-1T 相転移とヘテロ接合形成	○森 勝平 ¹ 、佐々木 将悟 ¹ 、小林 裕 ¹ 、劉 暉 ^{2,3} 、吉田 昭二 ⁴ 、竹内 高広 ⁴ 、重川 秀実 ⁴ 、末永 和知 ³ 、真庭 豊 ¹ 、宮田 耕充 ^{1,5}	1. 首都大理工、2. 産総研無機機能材料、3. 産総研ナノ材料、4. 筑波大学、5. JST さきがけ
20a-P4-58	単層 Nb ドープ WS ₂ のハライドアシスト CVD と評価	○(M1) 佐々木 将悟 ¹ 、小林 佑 ¹ 、劉 暉 ^{2,3} 、末永 和知 ³ 、真庭 豊 ¹ 、宮田 耕充 ^{1,4}	1. 首都大理工、2. 産総研無機機能材料、3. 産総研ナノ材料、4. JST さきがけ
20a-P4-59	Two-flow CVD による MoSe ₂ 薄膜成長	○田崎 直也 ¹ 、上野 啓司 ¹	1. 埼玉大院理工

20a-P4-60	単層 MoS ₂ における多原子空孔の研究	○浦崎 柊 ¹ , 影島 博之 ¹	1. 島根大総理工
20a-P4-61	SiC 表面上のエピタキシャルグラフェン上への BN 成長の検討	○夏目 拓弥 ¹ , 村部 雅央 ¹ , 才田 隆広 ¹ , 成塚 重弥 ¹ , 丸山 隆浩 ¹	1. 名城大理工
20a-P4-62	第一原理計算を用いた MoS ₂ の結晶成長理論検討	○岡田 克也 ¹ , 影島 博之 ¹	1. 島根大総理工
20a-P4-63	PTCDA プロモータを用いた CVD 法による MoS ₂ 薄膜の成長と評価	○大井 皓平 ¹ , 田畑 博史 ¹ , 久保 理 ¹ , 片山 光浩 ¹	1. 阪大院工
20a-P4-64	SiC(2/3x2 13)-Si 上への Sn 吸着	○林 真吾 ¹ , 原 剣斗 ¹ , 安藤 寛 ¹ , 梶原 隆司 ¹ , Visikovskiy Anton ¹ , 田中 悟 ¹	1. 九大院工
20a-P4-65	SiC(0001) 上におけるゲルマニウム吸着構造	○(M1C) 前田 裕介 ¹ , 林 真吾 ¹ , 梶原 隆司 ¹ , Visikovskiy Anton ¹ , 田中 悟 ¹	1. 九大院工
20a-P4-66	スライド可能な原子層の作製と操作	○(M2) 小林 佑 ¹ , 渡邊 賢司 ² , 谷口 尚 ² , 真庭 豊 ¹ , 宮田 耕充 ^{1,3}	1. 首都大理工, 2. 物材機構, 3. JST さきがけ
20a-P4-67	二次元原子層材料の電子ビーム加工解析	○多田 和広 ¹ , 中川 力哉 ¹ , 鎌仲 章 ¹ , 安田 雅昭 ²	1. 富山高専, 2. 大阪府大院工
奨 20a-P4-68	高品質 MoS ₂ /WS ₂ 積層型ヘテロ構造における層間励起子	○齊藤 哲輝 ¹ , 小林 佑 ¹ , 渡邊 賢司 ² , 谷口 尚 ² , 真庭 豊 ¹ , 宮田 耕充 ^{1,3}	1. 首都大理工, 2. 物材機構, 3. JST さきがけ
20a-P4-69	原子層薄膜 MoS ₂ の低温フォトルミネセンス評価	○南野 達哉 ¹ , 村上 俊也 ² , 木曾田 賢治 ¹ , 伊東 千尋 ²	1. 和歌山大教, 2. 和歌山大シス工
20a-P4-70	アルミナ薄膜封止による黒リン電界効果トランジスタの安定動作	○(M2) 中西 将毅 ¹ , 上野 啓司 ¹	1. 埼玉大理工
20a-P4-71	自己組織化単分子膜をゲート絶縁膜に用いた低電圧駆動 MoS ₂ FET の作製	○川那子 高暢 ¹ , 小田 俊理 ¹	1. 東工大 量子ナノ研
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料 / Carbon nanotubes & other nanocarbon materials			
3/21(Mon.) 9:15 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S421 会場			
9:15	21a-S421-1	Rh 触媒を用いたアルコールガスソース法による 400 °C 以下の単層カーボンナノチューブ成長	○小澤 顕成 ¹ , 桐林 星光 ¹ , 小川 征悟 ¹ , 才田 隆広 ¹ , 成塚 重弥 ¹ , 丸山 隆浩 ¹
9:30	21a-S421-2	Rh 触媒を用いた単層カーボンナノチューブ成長における Al ₂ O ₃ バッファ層作製法の検討	○桐林 星光 ¹ , 小川 征悟 ¹ , 小澤 顕成 ¹ , 才田 隆広 ¹ , 成塚 重弥 ¹ , 丸山 隆浩 ¹
9:45	21a-S421-3	CVD 法によって合成されたダイヤモンド結晶を用いた単層カーボンナノチューブ成長の試み	長谷川 光斗 ¹ , 清水 大平 ¹ , ○石川 豊 ¹
10:00	21a-S421-4	ナノダイヤモンドから成長したカーボンナノチューブの密度・長さおよび成長駆動力の効果	○(M2) 林 明生 ¹ , 有福 達治 ² , 清柳 典子 ² , 小林 慶裕 ¹
10:15	E 21a-S421-5	Direct observation of structural change in Au-incorporated carbon nanofibers by current-induced annealing	○(D) Mohamad Saufi Rosmi ^{1,2} , Yazid Yaakob ^{1,3} , Subash Sharma ¹ , Mohd Zamri Mohd Yusop ⁴ , Golap Kalita ¹ , Masaki Tanemura ¹
10:30	休憩 / Break		
10:45	21a-S421-6	繊維状カーボンナノホーン集合体の構造と電気的特性	○弓削 亮太 ¹ , 二瓶 史行 ¹ , 當山 清彦 ¹ , 湯田坂 雅子 ²
11:00	21a-S421-7	液中プラズマ法を用いた燃料電池用触媒の作製および評価	○(M1) アルサイディ アブドラハマン ¹ , 庄 善之 ²
11:15	21a-S421-8	中空コア・シェル型 Si/C ナノ複合体の作製に向けた新手法の確立	○若林 慶 ¹ , 山浦 大地 ¹ , 伊藤 和希 ¹ , 荻野 俊郎 ¹
11:30	21a-S421-9	貴金属表面に形成される炭素ナノ構造の解明	○(M1) 平重 憲治 ¹ , 黒川 修 ¹ , 酒井 明 ¹
11:45	21a-S421-10	長尺 CNT の分散剤レス分散処理	○權田 秀雄 ¹ , 徳富 純一郎 ¹ , 伊藤 彩 ²
12:00	奨 21a-S421-11	ダイヤモンドへの高温アニールにより作製した垂直配向グラファイト	○(DC) 稲葉 優文 ¹ , 費 文茜 ¹ , 平野 優 ¹ , 鈴木 和真 ¹ , 川原田 洋 ¹
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S421 会場			
13:45	21p-S421-1	透明で伸縮可能な全カーボン薄膜トランジスタの作製と評価	大西 健夫 ¹ , ○廣谷 潤 ¹ , 岸本 茂 ¹ , 大野 雄高 ^{1,2}
14:00	21p-S421-2	水蒸気およびポリマー援用燃焼による金属単層カーボンナノチューブの長尺除去	○井ノ上 泰輝 ¹ , 大塚 慶吾 ¹ , 千足 昇平 ¹ , 丸山 茂夫 ^{1,2}
14:15	奨 21p-S421-3	カーボンナノチューブを用いた高速度熱応答性を有する半透明フレキシブルヒーターの作製	○小林 大起 ¹ , 竹井 邦晴 ¹ , 有江 隆之 ¹ , 秋田 成司 ¹
14:30	奨 E 21p-S421-4	Cost-effective fabrication of high-performance flexible all-solid-state carbon micro-supercapacitors by blue-violet laser direct writing and further surface treatment	○(P) Jinguang Cai ¹ , Akira Watanabe ¹
14:45	21p-S421-5	カーボンナノチューブ薄膜を用いた IgE 検出における吸着サイト密度の効果	○加瀬 寛人 ¹ , 松井 祐司 ¹ , 根岸 良太 ¹ , 有福 達治 ¹ , 清柳 典子 ² , 小林 慶裕 ¹
15:00	E 21p-S421-6	Carbon Nanotube Membranes for Simultaneous Transport of Protons and Electrons	○(PC) Gregory A Pilgrim ^{1,2} , Amanda Amori ¹ , Zhenhao Hou ¹ , Fen Qiu ¹ , Todd Krauss ¹
15:15	21p-S421-7	カーボンナノチューブ複合紙による"熱発電紙"の開発	○(B) 川田 一貴 ¹ , 稲垣 忠光 ¹ , 大矢 剛嗣 ¹
15:30	21p-S421-8	CNT/Si/Al 構造における光電変換特性の評価	○柚木 健翔 ¹ , 藤森 翔太郎 ¹ , ミヨウ タンテイ ¹ , 百瀬 成空 ² , 橋本 佳男 ¹
15:45	21p-S421-9	カーボンナノチューブ複合紙による色素増感太陽電池紙の効率向上検討	○藤原 孝史 ¹ , 大矢 剛嗣 ¹
16:00	21p-S421-10	ラジオ波酸素プラズマ処理により表面修飾されたナノカーボン材料上の担持 Pt ナノ粒子のメタノール酸化活性評価	吉竹 晴彦 ¹ , 稲見 栄一 ² , 王志朋 ³ , ○緒方 啓典 ^{1,2}
16:15	休憩 / Break		
16:30	奨 21p-S421-11	単分子吸着によって発現するカーボンナノチューブ素子におけるランダムテレグラフシグナルノイズ	○藤井 逸人 ¹ , Setiadi Agung ¹ , 赤井 恵 ¹ , 葛西 誠也 ² , 金井 康 ³ , 松本 和彦 ³ , 桑原 裕司 ¹
16:45	奨 21p-S421-12	カーボンナノチューブへのポリスチレンビーズの溶着	○安田 正明 ¹ , 竹井 邦晴 ¹ , 有江 隆之 ¹ , 秋田 成司 ¹
17:00	21p-S421-13	集束イオンビームを用いたトップゲート型多層カーボンナノチューブ量子ドットの作製	○(B) 鈴木 克弥 ^{1,2} , 富沢 啓 ¹ , 山口 智弘 ¹ , 秋田 成司 ³ , 青木 伸之 ² , 石橋 幸治 ^{1,4}
17:15	21p-S421-14	直径・結晶品質に依存したカーボンナノチューブの電気伝導特性 (2)	○西浦 憲 ¹ , 徳富 淳一郎 ¹ , 田中 将嗣 ² , 松本 凌 ² , 高野 義彦 ²
17:30	奨 21p-S421-15	SiC 基板上高密度 CNT 配向膜における電気伝導機構の解明	○(DC) 松田 敬太 ^{1,2} , 乗松 航 ¹ , 楠 美智子 ²

17:45	21p-S421-16	単一カーボンナノコイルのコイル径と電子伝導特性の関係	○中村 康史 ¹ 、須田 善行 ¹ 、針谷 達 ¹ 、飯田 民夫 ² 、1.豊技大工、2.岐阜高専、3.東海カーボン、4.山梨大医 滝川 浩史 ¹ 、植仁志 ³ 、島弘幸 ⁴ 工
18:00	奨 21p-S421-17	単層カーボンナノチューブからの電界電子放出電流挙動の解明	○(D)入田 賢 ¹ 、本間 芳和 ¹ 1.Tokyo Univ. of Science
18:15	奨 21p-S421-18	霜柱状 CNT フォレストの赤外吸収	○宮地 弘樹 ¹ 、Pander Adam ¹ 、八田 章光 ^{1,2} 、古田 寛 ^{1,2} 1.高知工科大学、2.高知工科大学総研ナノテク C.
18:30	21p-S421-19	金属・半導体混合型 SWCNT フィルムの熱電物性	○(M2)林 大介 ¹ 、上田 智大 ¹ 、中井 祐介 ¹ 、客野 通 ¹ 、1.首都大理工、2.JST さきがけ、3.東京理科大 宮田 耕充 ^{1,2} 、真庭 豊 ¹ 、山本 貴博 ³
18:45	21p-S421-20	単層カーボンナノチューブに内包されたヨウ化セシウムの局所構造および物性評価	○横倉 瑛太 ¹ 、片岡 洋石 ¹ 、緒方 啓典 ^{1,2} 1.法政大学大学院 理工学研究科 応用化学専攻、2.法政大学 マイクロナノテクノロジー研究センター

17.2 グラフェン / Graphene

3/20(Sun.) 16:00 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S011 会場			
16:00	20p-S011-9	SiC 劈開面の熱分解による異方性グラフェン成長	○高崎 友也 ¹ 、塩路 淳 ¹ 、○梶原 隆司 ¹ 、Visikovskiy Anton ¹ 、田中 悟 ¹ 1.九大院工
16:15	20p-S011-10	SiC 表面上の Si 熱脱離グラフェン成長機構に関する第一原理分子動力学シミュレーション - 炭素鎖から二次元的構造の形成過程	○小野 裕己 ^{1,4} 、山崎 隆浩 ^{2,4} 、奈良 純 ^{2,4} 、大野 隆史 ^{2,3,4} 1.高度情報、2.物材機構、3.東大生研、4.高効率エデバ
16:30	20p-S011-11	Ir(111)/ α -Al ₂ O ₃ (0001) 基板上グラフェンのエピタキシャル成長および電気化学的転写	○齋藤 祐太 ¹ 、榎山 佳貴 ¹ 、児玉 英之 ¹ 、澤邊 厚仁 ¹ 、青学大理工 1、黄晋二 ¹
16:45	20p-S011-12	固相反応を用いた絶縁基板上への窒素ドーピンググラフェンの直接合成	○杉浦 孝俊 ¹ 、若松 裕司 ¹ 、Kalita Golap ¹ 、種村 眞幸 ¹ 1.名工大院工
17:00	奨 20p-S011-13	h-BN 上へのグラフェン直接合成	○(B)岡崎 凌 ¹ 、生田 昂 ¹ 、金井 康 ¹ 、小野 堯生 ¹ 、1.阪大産研、2.物材機構 井上 恒一 ¹ 、渡邊 賢司 ² 、谷口 尚 ² 、松本 和彦 ¹
17:15	20p-S011-14	高エネルギーイオン照射によるグラフェンへのヘテロ原子ドーピング	○園谷 志郎 ¹ 、水口 将輝 ² 、渡邊 英雄 ³ 、橋本 洋 ¹ 、1.原子力機構先端基礎、2.東北大金研、3.九州大応力研 境 誠司 ¹
17:30	20p-S011-15	グラフェン CVD 成長における核発生と基板形状の in-situ 観察	○平良 隆信 ¹ 、寺澤 知潮 ² 、小幡 誠司 ³ 、齊木 幸一朗 ^{1,3} 1.東大理、2.筑波大数理、3.東大新領域
17:45	20p-S011-16	金属上の多層グラフェンのその場光学観察	○加藤 幹大 ¹ 、高橋 惇郎 ¹ 、本間 芳和 ¹ 、趙 新為 ¹ 1.東理大理
18:00	20p-S011-17	銅触媒と CH ₄ プラズマを用いた酸化グラフェンからのグラフェン生成	○小幡 誠司 ¹ 、赤田 圭史 ¹ 、齊木 幸一朗 ¹ 1.東大新領域
18:15	奨 20p-S011-18	W キャップ層を用いた析出法により直接成長した多層グラフェンの結晶性向上に関する検討	○山田 純平 ¹ 、上田 悠貴 ¹ 、丸山 隆浩 ¹ 、成塚 重弥 ¹ 1.名城大理工
18:30	E 20p-S011-19	Optimization of CVD parameters for graphene synthesis through designs of experiments	○(D)Remi PAPON ¹ 、Christel PIERLOT ² 、Subash SHARMA ¹ 、Sachin M. SHINDE ¹ 、Golap KALITA ¹ 、Masaki TANEMURA ¹ 1.Nagoya Instit. of Technol., 2.ENSCL
18:45	奨 20p-S011-20	プラズマ CVD のグラフェン合成におけるガス残渣の影響	○沖川 侑揮 ^{1,2} 、加藤 隆一 ² 、山田 貴壽 ^{1,2} 、石原 正統 ^{1,2} 、長谷川 雅考 ^{1,2} 1.産総研、2.TASC
3/21(Mon.) 9:00 - 12:15 口頭講演 (Oral Presentation) S011 会場			
9:00	招 21a-S011-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) 高移動度グラフェンを用いたバリスティックかつコヒーレントな量子輸送現象の観測とその制御	○森川 生 ¹ 、増淵 覚 ¹ 、守谷 頼 ¹ 、渡邊 賢司 ² 、谷口 尚 ² 、Dou Ziwei ³ 、Wang Shu-Wei ³ 、Smith Charles ³ 、Connolly Malcolm ³ 、町田 友樹 ^{1,4,5} 1.東大生研、2.物材機構、3.Cambridge Cavendish 研、4.東大ナノ量子、5.CREST-JST
9:15	21a-S011-2	六方晶窒化ホウ素 (hBN)/グラフェン/hBN 構造におけるゼロ磁場中非局所抵抗	○(PC)小松 克伊 ^{1,2} 、渡辺 英一郎 ¹ 、津谷 大樹 ¹ 、渡邊 賢司 ¹ 、谷口 尚 ¹ 、森山 悟士 ¹
9:30	21a-S011-3	解離性イオン散乱を用いたグラフェンの弾性プローブ	○持地 広造 ¹ 、乾 徳夫 ¹ 、盛谷 浩石 ¹ 1.兵庫県立大院工
9:45	21a-S011-4	グラフェン・分割リング共振器	○鈴木 哲 ¹ 、山本 秀樹 ¹ 1.NTT 物性基礎研
10:00	21a-S011-5	ゼーベック係数の欠陥状態・キャリア散乱依存性	○安野 裕貴 ¹ 、竹井 邦晴 ¹ 、秋田 成司 ¹ 、有江 隆之 ¹ 1.大阪府大院工
10:15	21a-S011-6	トポロジカル欠陥のある hBN 基板のグラフェンの伝導	○金子 智昭 ^{1,2} 、大野 隆史 ^{1,2,3} 1.物質・材料研究機構、2.高効率エデバコンソ、3.東大生産研
10:30	休憩 /Break		
10:45	21a-S011-7	電気化学的手法による単層グラフェン/Au(111)の物性評価	○保田 諭 ¹ 、熊谷 諒太 ¹ 、中島 浩司 ¹ 、村越 敬 ¹ 1.北大理院
11:00	21a-S011-8	グラフェン触媒を援用した水中での Ge 表面エッチングの基礎検討	○(M2)森 大地 ¹ 、中出 和希 ¹ 、佐藤 慎祐 ¹ 、川合 健太郎 ¹ 、森田 瑞穂 ¹ 、有馬 健太 ¹ 1.阪大院工
11:15	E 21a-S011-9	Facile preparation and thermoelectric properties of reduced graphene oxide	○(DC)Pandiyarasan Veluswamy ¹ 、Wanami Masaya ¹ 、1.Shizuoka Univ、2.Univ. of Malaya Shanthi Selvaraj ¹ 、Salleh Faiz ² 、Archana Jayaram ¹ 、Navaneethan Mani ¹ 、Hayakawa Yasuhiro ¹ 、Hiroya Ikeda ¹
11:30	21a-S011-10	酸化グラフェンからの高結晶性グラフェン薄膜におけるバンド伝導の起源	○根岸 良太 ¹ 、伊藤 孝寛 ² 、仲武 昌史 ³ 、赤堀 誠志 ⁴ 、渡辺 義夫 ³ 、小林 慶裕 ¹ 1.阪大院工、2.名大院工、3.あいち SR センター、4.北陸先端大
11:45	21a-S011-11	水素終端処理したグラフェン/SiC(0001)におけるグラフェンの劣化 - 電流通電が誘起した非常に遅い界面酸化 -	○前田 文彦 ^{1,2} 、高村 真琴 ² 、日比野 浩樹 ^{3,2} 1.福岡工大、2.NTT 物性基礎研、3.関西学院大学理工
12:00	21a-S011-12	グラフェン上金属微粒子の熱的挙動のその場観察	○高橋 惇郎 ¹ 、加藤 大樹 ¹ 、榎内 雄太 ¹ 、本間 芳和 ¹ 1.東理大理
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S011 会場			
13:45	21p-S011-1	歪み誘起擬似磁場を利用したグラフェン FET の制御における電子-フォノン散乱の影響	○相馬 聡文 ¹ 、笹岡 健二 ¹ 、小川 真人 ¹ 1.神戸大院工
14:00	21p-S011-2	グラフェン共鳴トンネル電界効果トランジスタの素子性能解析	○(M2)鈴木 俊英 ¹ 、ムルガナタン マノハラン ¹ 、水田 博 ^{1,2} 1.北陸先端大、2.サザンブトン大学
14:15	E 21p-S011-3	Triple Gate Graphene Nanoribbon Field Effect Transistor (TG-GNRFET)	○(D)Ahmed Mohammed Hammam ^{1,2} 、Marek E. Schmidt ¹ 、Manoharan Muruganathan ¹ 、Hiroshi Mizuta ^{1,2} 1.JAIST、2.Southampton Univ、3.Menia Univ
14:30	奨 21p-S011-4	h-BN/2層グラフェン/h-BN ゲートスタック構造での I _{on} /I _{off} 向上	○ウワンノー ティーラユット ¹ 、谷口 尚 ² 、渡邊 賢司 ² 、長汐 晃輔 ^{1,3} 1.東大、2.NIMS、3.JST- さきがけ
14:45	奨 21p-S011-5	グラフェン FET における真性トランジスタパラメータ抽出モデルの評価	○(M1)満塩 純希 ¹ 、玉虫 元 ¹ 、菅原 健太 ¹ 、佐藤 昭 ¹ 、1.東北大通研 吹留 博一 ¹ 、末光 真希 ¹ 、尾辻 泰一 ¹
15:00	奨 21p-S011-6	グラフェン光検出器の高感度化検討	○嶋谷 政彰 ¹ 、小川 新平 ¹ 、藤澤 大介 ¹ 、奥田 聡志 ^{1,2} 、金井 康 ² 、小野 堯生 ² 、松本 和彦 ² 1.三菱電機、2.阪大産研
15:15	21p-S011-7	Pd ナノドット修飾グラフェンに水素が及ぼす影響	○後藤 瑛人 ¹ 、竹内 豪 ¹ 、山知 亮介 ¹ 、田中 貴久 ¹ 、1.慶應大理工、2.JST CREST 高橋 綱己 ^{1,2} 、内田 建 ^{1,2}

15:30	21p-S011-8	自己加熱を利用したPdナノドット修飾グラフェン・ガスセンサ	○竹内 豪 ¹ 、後藤 瑛人 ¹ 、山口 公平 ¹ 、山知 亮介 ¹ 、1.慶應大理工 電子工, 2.JST CREST 田中 貴久 ¹ 、高橋 綱己 ^{1,2} 、内田 建 ^{1,2}
15:45	21p-S011-9	CVDグラフェンを用いた高感度ストレスセンサの開発	○(B)植村 孝平 ¹ 、生田 昂 ² 、小野 亮生 ² 、金井 康 ¹ 1.農工大, 2.阪大産研 ² 、井上 恒一 ² 、松本 和彦 ² 、前橋 兼三 ¹
16:00	奨 21p-S011-10	糖鎖機能化グラフェンFETを用いたノイラミナーゼ反応計測	○(M1)鎌田 果歩 ¹ 、小野 亮生 ¹ 、金井 康 ¹ 、大野 恭秀 ^{1,2} 1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大, 4.京都府立医大, 恭秀 ^{1,2} 、前橋 兼三 ^{1,3} 、井上 恒一 ¹ 、渡邊 洋平 ⁴ 、河 5.中部大, 6.香川大 原 敏男 ⁵ 、鈴木 康夫 ⁵ 、中北 慎一 ⁶ 、松本 和彦 ¹
16:15		休憩/Break	
16:30	21p-S011-11	太陽電池応用を目指したグラフェン透明導電膜のp形導電性制御	○大矢 智也 ¹ 、青山 悠生 ¹ 、野本 隆宏 ¹ 、石川 亮佑 ¹ 1.新潟大 ¹ 、坪井 望 ¹
16:45	奨 21p-S011-12	酸化グラフェン電極の仕事関数制御と有機FETへの応用	○(D)赤田 圭史 ¹ 、小幡 誠司 ¹ 、齊木 幸一朗 ¹ 1.東大新領域
17:00	21p-S011-13	グラフェンの界面挿入による金属/p型SiCのオーミックコンタクト形成	○藤井 健志 ¹ 、佐藤 まり子 ¹ 、稲本 拓朗 ¹ 1.富士電機
17:15	21p-S011-14	サスペンデッドグラフェンNEMS共振器の作製と評価	○武市 旺大 ¹ 、スン ジアン ¹ 、シュミット マレク ¹ 、1.北陸先端大, 2.サザンブトン大 ムルガナタン マノハラン ¹ 、水田 博 ^{1,2}
17:30	21p-S011-15	HIMを用いたサブ10nm幅サスペンデッドグラフェンナノリボンの作製	○シュミット マレク ¹ 、○武市 旺大 ¹ 、神崎 晃悠 ¹ 、1.北陸先端大, 2.産総研, 3.サザンブトン大 小川 真一 ² 、水田 博 ^{1,3}
17:45	奨 21p-S011-16	グラフェン量子ドットにおける近藤効果の観測	○金井 康 ¹ 、生田 昂 ¹ 、小野 亮生 ¹ 、大野 恭秀 ^{2,1} 、1.阪大産研, 2.徳島大, 3.東京農工大 前橋 兼三 ^{3,1} 、井上 恒一 ¹ 、松本 和彦 ¹
18:00	21p-S011-17	グラフェン-超伝導体接触界面形成に対する金属薄膜微細構造の影響	○津村 公平 ¹ 、平林 元樹 ¹ 、大杉 正樹 ¹ 、渡辺 英一 ¹ 1.東理大理, 2.NIMS微細加工プラットフォーム, 3.東 理大総研
18:15	21p-S011-18	グラフェンナノリボン移動度のエッジ揺らぎおよびリボン幅依存性のモンテカルロシミュレーション	○伊藤 直人 ¹ 、三澤 太一 ¹ 、粟野 祐二 ¹ 1.慶大理工
18:30	奨 21p-S011-19	弱く結合したジグザグ端ナノリボン列の電子状態解析	○(B)橋本 風渡 ¹ 、森 伸也 ¹ 、久保 理 ¹ 、片山 光浩 ¹ 1.阪大工
18:45	奨 21p-S011-20	高配向ボトムアップ・グラフェンナノリボンアレイの電荷輸送特性	○(PC)大伴 真名歩 ¹ 、関根 佳明 ¹ 、日比野 浩樹 ^{1,2} 、1.NTT物性研, 2.関西学院大 山本 秀樹 ¹
3/22(Tue.) 9:00 - 13:15 口頭講演(Oral Presentation) S011 会場			
9:00	22a-S011-1	酸化グラフェンのエタノール中超高温加熱処理で生成したグラフェンの積層構造解析	○(B)疋田 裕也 ¹ 、石田 俊 ¹ 、篠田 佳彦 ² 、小林 慶 ¹ 1.阪大院工, 2.若狭湾エネ研 裕 ¹
9:15	奨 22a-S011-2	VUV光による酸化グラフェンへの窒素ドーピング	○(M1)曾我 正寛 ¹ 、屠 宇迪 ¹ 、宇都宮 徹 ¹ 、一井 崇 ¹ 、1.京大院工 杉村 博之 ¹
9:30	22a-S011-3	多層酸化グラフェン還元体の電気特性評価	○屠 宇迪 ¹ 、中元 宏 ¹ 、宇都宮 徹 ¹ 、一井 崇 ¹ 、杉村 博之 ¹ 1.京大院工
9:45	E 22a-S011-4	Stabilization of alloy nanoparticles on reduced graphene oxide for catalytic application: Utilization of graphene oxide as a capping agent	○Muttaqin Muttaqin ¹ , Takahiro Nakamura ¹ , Shunichi Sato ¹ 1.Tohoku Univ.
10:00	22a-S011-5	Pt表面上における酸化グラフェンの界面選択還元	○(B)本間 弘樹 ¹ 、小幡 誠司 ² 、齊木 幸一朗 ² 、藤川 安仁 ¹ 1.弘前理工, 2.東大新領域
10:15	E 22a-S011-6	Influence of Cu crystallographic orientations on graphene anisotropic etching	○(D)Kamal Prasad Sharma, Golap Kalita ¹ , Masaki Tanemura ¹ 1.Nagoya Inst. Technol.
10:30	奨 22a-S011-7	脱炭酸アリアル化によるグラフェン量子ドットの可溶化と発光色の制御	○小田 一磨 ¹ 、廣戸 聡 ¹ 、忍久保 洋 ¹ 1.名大院工
10:45	22a-S011-8	【注目講演】グラフェンサンドイッチ構造を利用した液体の透過型電子顕微鏡観察手法の開発と応用	○(DC)佐々木 祐生 ¹ 、北浦 良 ¹ 、Yuk Jong Min ² 、Zettl Alex ² 、篠原 久典 ¹ 1.名大院理, 2.UCBA
11:00		休憩/Break	
11:15	22a-S011-9	TMDCによる多結晶グラフェンのグレイン構造の可視化	○深町 悟 ¹ 、遠藤 寛子 ¹ 、Rozan Mohamad Yunus ² 、1.九大先導研, 2.九大総理工, 3.九大炭素センター, 辻 正治 ³ 、吾郷 浩樹 ^{1,2,4} 4.JST さきがけ
11:30	22a-S011-10	ロジウム-二硫化モリブデン-グラフェンヘテロ接合の電気特性に関する研究	○楊 順涵 ¹ 、有月 琢哉 ¹ 、高嶋 和也 ¹ 、大野 恭秀 ¹ 、1.徳島大学 永瀬 雅夫 ¹
11:45	22a-S011-11	ゲート制御型端選択的光酸化によるグラフェンナノリボン形成	○松本 守広 ¹ 、○野内 亮 ¹ 1.阪府大 21 機構
12:00	22a-S011-12	in-situ 水素アニールによるグラフェンのダメージ修復評価	○岩下 晋也 ¹ 、ムルガナタン マノハラン ¹ 、シュミット マレク ¹ 、水田 博 ^{1,2} 1.北陸先端大, 2.サザンブトン大
12:15	22a-S011-13	エピタキシャルグラフェン上の吸着水層	○中村 晃大 ¹ 、有月 琢哉 ¹ 、高嶋 和也 ¹ 、永濱 拓也 ¹ 1.徳島大工 ¹ 、北岡 誠 ¹ 、大野 恭秀 ¹ 、永瀬 雅夫 ¹
12:30	22a-S011-14	CVD法により形成したSiC(3x3)界面層上グラフェンの電子状態	○梶原 隆司 ¹ 、林 真吾 ¹ 、Visikovskiy Anton ¹ 、飯盛 拓嗣 ² 、小森 文夫 ² 、田中 悟 ¹ 1.九大院工, 2.東大物性研
12:45	22a-S011-15	SiCファセット上サブ2次元グラフェンの構造制御	○福岡 洗平 ¹ 、林 真吾 ¹ 、梶原 隆司 ¹ 、Visikovskiy Anton ¹ 、飯盛 拓嗣 ² 、家永 紘一郎 ² 、矢治 光一郎 ² 、中辻 寛 ² 、小森 文夫 ² 、田中 宏和 ³ 、神田 晶申 ³ 、田中 悟 ¹ 1.九大院工, 2.東大物性研, 3.筑波大
13:00	22a-S011-16	グラフェン上の大気由来吸着物	○日比野 浩樹 ^{1,2} 、小川 友以 ² 、高村 真琴 ² 、Wang Shengnan ² 、関根 佳明 ² 、赤石 暁 ³ 、中村 淳 ³ 1.関学大理工, 2.NTT物性基礎研, 3.電通大院先進理工
17.3 層状物質 / Layered materials			
3/20(Sun.) 13:45 - 16:45 口頭講演(Oral Presentation) S421 会場			
13:45	20p-S421-1	シリセン-アミンヘテロ界面の電子物性に対する電界効果	○飯田 健二 ¹ 、野田 真史 ¹ 、信定 克幸 ¹ 1.分子研
14:00	奨 20p-S421-2	単結晶六方晶ボロンナイトライドの絶縁破壊強度の異方性	○服部 吉晃 ¹ 、谷口 尚 ² 、渡邊 賢司 ² 、長汐 晃輔 ^{1,3} 1.東大マテリアル, 2.NIMS, 3.JST- さきがけ
14:15	奨 20p-S421-3	MoS ₂ /WS ₂ 半導体ヘテロ接合界面におけるバンドギャップ変調	○(M2)小林 佑 ¹ 、吉田 昭二 ² 、櫻田 龍司 ² 、齊藤 哲輝 ¹ 、渡邊 賢司 ³ 、谷口 尚 ³ 、真庭 豊 ¹ 、重川 秀実 ² 、きかげ 宮田 耕充 ^{1,4} 1.首都大院理工, 2.筑波大数理, 3.物材機構, 4.JST さきがけ
14:30	20p-S421-4	電界効果ドーピングによる遷移金属ダイカルコゲナイド原子層ヘテロ構造の発光変調	○毛利 真一郎 ¹ 、張 文金 ¹ 、宮内 雄平 ¹ 、松田 一成 ¹ 1.京都大学エネ研
14:45	20p-S421-5	単層・2層GeSeおよびGeSe/MoS ₂ ヘテロ構造の第一原理計算	○大淵 真理 ¹ 1.富士通研
15:00	奨 20p-S421-6	マイルド酸素プラズマ機能化数層WSe ₂ を用いた高性能光電子デバイスの開発	○永井 黎人 ¹ 、加藤 俊顕 ¹ 、金子 俊郎 ¹ 1.東北大院工

15:15	奨 20p-S421-7	CVD-MoS ₂ /SiO ₂ 相互作用評価と完全被覆 TG によるデュアルゲート変調	○(M1) 倉林 空 ¹ 、長沙 晃輔 ^{1,2}	1. 東大工, 2.JST- さきがけ
15:30	20p-S421-8	MoS ₂ FET の電気特性を向上させるための熱処理プロセスの検討	○佐野 宏亮 ¹ 、足立 薫彦 ¹ 、下川 慶久 ¹ 、高橋 綱己 ^{1,2} 、内田 建 ^{1,2}	1. 慶應大理工, 2.JST CREST
15:45	20p-S421-9	シリケイン及びゲルマニウムをチャネルとする CMOS トランジスタのパラメトリック性能解析	○兼古 志郎 ¹ 、岡 直左 ¹ 、土屋 英昭 ¹ 、小川 真人 ¹	1. 神戸大工
16:00	奨 20p-S421-10	数層 WSe ₂ ショットキー型太陽電池における光発電特性の高性能化	○(M2) 赤間 俊紀 ¹ 、加藤 俊顕 ¹ 、金子 俊郎 ¹	1. 東北大院工
16:15	20p-S421-11	MoS ₂ 単層グラフェンヘテロ構造の局所ガス応答特性評価	○佐藤 雄太 ¹ 、大井 皓平 ¹ 、麻下 卓嗣 ¹ 、田畑 博史 ¹ 、久保 理 ¹ 、片山 光浩 ¹	1. 阪大院工
16:30	奨 20p-S421-12	Ti _{0.87} O ₂ ナノシートとの固相変態による極薄 TiO ₂ アナターゼ FET	○関崎 舜也 ¹ 、長田 実 ² 、佐々木 高義 ² 、長沙 晃輔 ^{1,3}	1. 東大マテリアル, 2.NIMS, 3.JST- さきがけ
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) S421 会場				
9:00	招 22a-S421-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) WSe ₂ 表面酸化層の p 型コンタクト・ドープメント応用	○山本 真人 ¹ 、中払 周 ¹ 、上野 啓司 ² 、塚越 一仁 ¹	1. 物材機構, 2. 埼玉大院理工
9:15	22a-S421-2	単層から二層シリセンへの相変態	○八百川 律子 ¹ 、大砂 哲 ¹ 、中野 秀之 ^{1,2}	1. 豊田中研, 2.JST さきがけ
9:30	22a-S421-3	拡散・析出法による h-BN 薄膜の形成過程	○鈴木 哲 ¹ 、小川 友以 ¹ 、Wang Shengnan ¹ 、山本 秀樹 ¹	1.NTT 物性基礎研
9:45	E 22a-S421-4	Synthesis of large-area hexagonal boron nitride films using chemical vapor deposition	VICTORIA HAMILTON ¹ 、○ SHENGNAN WANG ¹ 、SATORU SUZUKI ¹ 、HIROKI HIBINO ^{1,2} 、HIDEKI YAMAMOTO ¹	1.NTT Basic Research Labs., 2.Kwansei Gakuin Univ.
10:00	22a-S421-5	CVD 法により合成した h-BN 多層膜の触媒依存性	○近藤 大雄 ^{1,2} 、林 賢二郎 ^{1,2} 、片岡 真紗子 ^{1,2} 、岩井 大介 ^{1,2} 、佐藤 信太郎 ^{1,2}	1. 富士通研, 2. 富士通
10:15	奨 E 22a-S421-6	Synthesis of BCN layers and anisotropic etching for nanoribbon fabrication	○(DC)Riteshkumar Ratneshkumar Vishwakarma ¹ 、Golap Kalita ¹ 、Masaki Tanemura ¹	1.Nagoya Inst.Technol.
10:30		休憩 / Break		
10:45	奨 22a-S421-7	単層単結晶 WS ₂ の広域集積化合成	○高橋 智之 ¹ 、加藤 俊顕 ¹ 、金子 俊郎 ¹	1. 東北大院工
11:00	22a-S421-8	GaAs 基板上への MoSe ₂ /WSe ₂ ヘテロ構造の MBE 成長	○小野満 恒二 ¹ 、熊倉 一英 ¹ 、山本 秀樹 ¹	1.NTT 物性科学基礎研究所
11:15	22a-S421-9	ミスト CVD による二硫化モリブデン (MoS ₂) 層状薄膜作製への挑戦	○(M1) 佐藤 翔太 ¹ 、川原村 敏幸 ^{1,2}	1. 高知工大院知能機械システム工学コース, 2. 高知工大総研
11:30	奨 22a-S421-10	スパッタ堆積 MoS ₂ 薄膜の XPS と光学コントラスト法による層数識別	○石原 聖也 ¹ 、日比野 祐介 ¹ 、澤本 直美 ¹ 、須田 耕平 ¹ 、大橋 匠 ² 、松浦 賢太郎 ² 、町田 英明 ³ 、石川 真人 ³ 、須藤 弘 ³ 、若林 整 ² 、小椋 厚志 ¹	1. 明治大, 2. 東工大, 3. 気相成長 (株)
11:45	奨 E 22a-S421-11	Passivation of Phosphorene in Ambient Conditions by Encapsulation with Monolayer Hexagonal Boron Nitride Grown by Chemical Vapor Deposition Technique	○(B)Sapna Sinha ¹ 、Yuya Takabayashi ¹ 、Haruka Omachi ¹ 、Hisanori Shinohara ¹ 、Ryo Kitaura ¹	1.Nagoya Univ.

合同セッション K / Joint Session K

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

21.1 合同セッションK ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス / Joint Session K

3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P12 会場				
	19p-P12-1	触媒反応生成高エネルギー H ₂ O ビームの運動エネルギー評価	○安井 寛治 ¹ 、寺口 祐介 ¹ 、田島 諒一 ¹ 、玉山 泰宏 ¹	1. 長岡技科大
	19p-P12-2	電気化学堆積した低温バッファ層が ZnO ナノロッド形状に与える効果	○木田 正紀 ¹ 、鈴木 聡 ¹	1. 木更津高専
	19p-P12-3	触媒反応支援 CVD 法による非極性 ZnO 結晶膜の成長	○田島 諒一 ¹ 、叶内 慎吾 ¹ 、玉山 泰宏 ¹ 、安井 寛治 ¹	1. 長岡技術科学大学
	19p-P12-4	UHV スパッタ法により成長した ZnO 単結晶層のアニール処理 (I)	○羽鳥 翼 ¹ 、佐久間 大樹 ¹ 、松久 健司 ¹ 、渡邊 和樹 ¹ 、水野 愛 ¹ 、安藤 毅 ¹ 、篠田 宏之 ¹ 、六倉 信喜 ¹	1. 東京電機大工
	19p-P12-5	UHV スパッタ法により成長した ZnO 単結晶層のアニール処理 (II)	○水野 愛 ¹ 、安藤 毅 ¹ 、篠田 宏之 ¹ 、六倉 信喜 ¹	1. 東京電機大工
奨	19p-P12-6	MOCVD 法による ZnMgO:N/ZnO シングルヘテロ接合を採用した UV-LED	○柳瀬 将吾 ¹ 、錦織 大和 ¹ 、藤田 恭久 ¹	1. 島根大院総理
	19p-P12-7	(0001)α-Al ₂ O ₃ 基板上および (0001)GaN テンプレート上への In ₂ O ₃ 膜のミスト CVD 成長	○小林 拓也 ¹ 、田沼 圭亮 ¹ 、山口 智広 ¹ 、尾沼 猛儀 ¹ 、本田 徹 ¹	1. 工学院大
	19p-P12-8	オゾンを用いた β -Ga ₂ O ₃ の MBE 成長	○中田 義昭 ¹ 、佐々木 公平 ² 、倉又 朗人 ² 、山腰 茂 ¹ 、東脇 正高 ¹	1. 情通機構, 2. タムラ製作所
	19p-P12-9	β -Ga ₂ O ₃ (010) 基板上への Ga 照射	○中田 義昭 ¹ 、佐々木 公平 ² 、倉又 朗人 ² 、山腰 茂 ¹ 、東脇 正高 ¹	1. 情通機構, 2. タムラ製作所
	19p-P12-10	塗布熱分解法で成膜した Ca ₃ Co ₂ O ₆ 膜の結晶成長におよぼす焼成条件の影響	○田橋 正浩 ¹ 、高橋 誠 ¹ 、後藤 英雄 ¹	1. 中部大学
	19p-P12-11	Fe 支援 CBD 法による Cu ₂ O 薄膜の成長	○寺迫 智昭 ¹ 、大森 裕也 ² 、佐伯 拓哉 ² 、門田 直己 ¹ 、宮田 晃 ²	1. 愛媛大院理工, 2. 愛媛大工
	19p-P12-12	分子プレカーサー法を用いた In-Ga-Mg-O 薄膜製作検討	○高橋 勇貴 ¹ 、後藤 良介 ¹ 、安野 泰平 ¹ 、尾沼 猛儀 ¹ 、永井 裕己 ¹ 、山口 智広 ¹ 、佐藤 光史 ¹ 、本田 徹 ¹	1. 工学院大工
	19p-P12-13	RF-MS 法で作製した ZnO 系透明導電膜における結晶性の基板位置依存性	○正力 幹也 ¹ 、杉浦 恰 ¹ 、船木 修平 ¹ 、山田 容士 ¹	1. 島大総理工
	19p-P12-14	短時間アニールによる ZnO 系導電膜の低抵抗化	○(M1) 杉浦 恰 ¹ 、宮尾 信行 ¹ 、正力 幹也 ¹ 、船木 修平 ¹ 、山田 容士 ¹	1. 島大総理工
	19p-P12-15	ミストデポジション法 ITO 透明導電膜を用いたタッチセンサの試作	中積 誠 ¹ 、○西 康孝 ¹ 、堀 正和 ¹ 、林田 洋祐 ¹ 、鬼頭 義昭 ¹ 、奈良 圭 ¹ 、加藤 正紀 ¹	1. (株) ニコン
	19p-P12-16	二層 InSiO 薄膜トランジスタの水素還元とオゾン酸化効果	○木津 たきお ¹ 、相川 慎也 ² 、生田目 俊秀 ¹ 、塚越 一仁 ¹	1. 物材機構, 2. 工学院大
	19p-P12-17	溶液法により作製した Al 添加 ZnO 薄膜トランジスタの焼結雰囲気によるトランジスタ特性への影響	○佐々木 祥太 ¹ 、木村 史哉 ¹ 、孫 屹 ¹ 、小山 政俊 ¹ 、前元 利彦 ¹	1. 阪大院ナノ材研
	19p-P12-18	ゲート絶縁膜厚が ZnO-SnO ₂ 薄膜を用いた TFT 特性に与える影響	○佐藤 和郎 ¹ 、田中 剛 ¹ 、山田 義春 ¹ 、村上 修一 ¹ 、寛 芳治 ¹ 、櫻井 芳昭 ¹	1. 大阪府立産技研
奨	19p-P12-19	High-K ゲート絶縁膜による TFT の高性能化と低消費 ReRAM の搭載	○(D) 鍋坂 恭平 ¹ 、山内 祥光 ¹ 、門 圭佑 ¹ 、藤井 茉美 ¹ 、石河 泰明 ¹ 、浦岡 行治 ¹	1. 奈良先端物質創成科
	19p-P12-20	1 mm チャネル長酸化物 IGZO 自己整合縦形トランジスタ	○栗原 史昂 ¹ 、中 茂樹 ¹ 、岡田 裕之 ¹	1. 富山大学

19p-P12-21	ゾルゲル法を用いた ZnO 系 TFT の作製と評価	○大東 隆文 ¹ 、大溝 悠樹 ¹ 、小山 政俊 ¹ 、前元 利彦 ¹ 、大工 大ナノ材研 1、佐々 誠彦 ¹
19p-P12-22	ZnO 単結晶の紫外線応答特性に及ぼす過酸化水素処理効果	○柏葉 宏安 ¹ 、安藤 昌広 ¹ 、佐久間 実緒 ¹ 、川崎 浩 ¹ 、仙台高専、2. 岩手大工 司 ¹ 、今井 裕司 ¹ 、阿部 貴美 ² 、中川 玲 ² 、新倉 郁 生 ² 、柏葉 安兵衛 ² 、長田 洋 ²
奨 19p-P12-23	スパッタ堆積 ZnO 薄膜のキャリア生成と O1s スペクトルとの関係	○(D)張 捷生 ¹ 、佐藤 伸吾 ¹ 、大村 泰久 ¹ 、齊藤 正 ¹ 、関西大 1
19p-P12-24	β -Ga ₂ O ₃ ナノワイヤーの形状制御性とフォトルミネッセンス特性	○寺道 智昭 ¹ 、河崎 雄樹 ² 、矢木 正和 ³ 1. 愛媛大理工, 2. 愛媛大工, 3. 香川高専
奨 19p-P12-25	分子ブレイカーサー法で作製した銀分散 ZnO 薄膜の光学的特性	○高 大地 ¹ 、尾沼 猛儀 ¹ 、澁川 貴史 ¹ 、永井 裕己 ¹ 、1. 工学院大, 2. 嶺南大 山口 智弘 ¹ 、Ja-Soon Jang ² 、佐藤 光史 ¹ 、本田 徹 ¹
19p-P12-26	水素プラズマを照射した酸化亜鉛の特性	○安部 功二 ¹ 、秦 弘樹 ¹ 1. 名古屋工業大
19p-P12-27	硬 X 線光電子分光法を用いた a-IGZO/SiO ₂ 保護膜界面の電子状態評価	○森田 晋也 ¹ 、越智 元隆 ¹ 、林 和志 ¹ 、釘宮 敏洋 ¹ 1. 神戸製鋼所
3/20(Sun.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場		
9:00 奨 20a-S222-1	飛来粒子定量分析による反応性プラズマ蒸着 Ga 添加 ZnO 薄膜の成膜因子の解明	○北見 尚久 ¹ 、酒見 俊之 ¹ 、野本 淳一 ² 、牧野 久雄 ¹ 、住友重機械, 2. 高知工科大総研, 3. 高知工科大システム工 23、青木 康 ¹ 、加藤 隆典 ¹ 、山本 哲也 ²
9:15 20a-S222-2	ガリウム添加酸化亜鉛導電膜を感材とする水素センサーにおける応答速度向上のための水素ガス輸送制御	○山本 哲也 ¹ 、野本 淳一 ¹ 、牧野 久雄 ¹ 、岸本 誠一 ¹ 、高知工科大総研, 2. 高知高専 2
9:30 20a-S222-3	V 添加による ZnO 中のキャリア生成メカニズムに関する検討	○川島 知之 ¹ 、安倍 大 ¹ 、鷲尾 勝由 ¹ 1. 東北大院工
9:45 20a-S222-4	DC スパッタ法で成膜した Ti 添加 ZnO 透明導電膜の熱安定性	北尾 寿貴 ¹ 、○牧野 久雄 ^{1,2} 、野本 淳一 ² 、山本 哲也 ² 、1. 高知工科大システム工, 2. 高知工科大総研, 3. 住友化学 中田 邦彦 ³
10:00 20a-S222-5	多結晶 AZO 透明導電膜のキャリア輸送に対する結晶粒界の影響 (III)	○宇崎 涼介 ¹ 、渡辺 恭輔 ¹ 、池永 訓昭 ¹ 、宮田 俊 ¹ 、金沢工大 OEDS R&D センター 弘 ¹ 、南 内嗣 ¹
10:15 20a-S222-6	直流マグネトロンスパッタ多結晶 Al 添加 ZnO 透明導電膜の配向秩序特性及びキャリア輸送特性に与える Al 添加量の影響	○野本 淳一 ¹ 、牧野 久雄 ^{1,2} 、山本 哲也 ¹ 1. 高知工科大総研, 2. 高知工科大システム工
10:30	休憩 / Break	
10:45 奨 20a-S222-7	プラズマ発光制御を用いた反応性スパッタ法による ITO および IZO 透明導電膜の成膜	○宮崎 裕介 ¹ 、丸山 恵莉 ¹ 、買 軍軍 ¹ 、待永 広宣 ² 、1. 青学大理工, 2. 日東電工 宮崎 司 ² 、重里 有三 ¹
11:00 20a-S222-8	ミストデポジション法を用いた ITO ナノ微粒子透明導電膜の開発	○中積 誠 ¹ 、西 康孝 ¹ 、奈良 圭 ¹ 、岩堀 恒一郎 ¹ 1. ニコン
11:15 20a-S222-9	Dy を添加した酸化バナノ粒子の作製と磁気特性	○(M1)西岡 正治 ¹ 、柏木 行康 ² 、齊藤 大志 ² 、中 許 昌美 ² 、周逸凱 ³ 、劉 宝 ³ 、崔 行恒 ³ 、太田 椋也 ¹ 、藤元 章 ¹ 、原田 義之 ¹ 、神村 共住 ¹ ○五十嵐 佳苗 ¹ 、杉本 悠紀子 ¹ 、菊池 昭彦 ^{1,2}
11:30 20a-S222-10	AMZO/Ag(AI)/AMZO-DMD における薄膜 Ag 層の Al ドープ効果	○西中 浩之 ¹ 、吉本 昌広 ¹ 1. 京工織大
11:45 20a-S222-11	ミスト CVD 法による菱面体晶 ITO のヘテロエピタキシャル成長	○西中 浩之 ¹ 、吉本 昌広 ¹ 1. 京工織大
3/20(Sun.) 13:00 - 17:30 口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場		
13:00 招 20p-S222-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) グラフォエピタキシャル ZnO 薄膜におけるホール移動度の向上	○工藤 徹也 ¹ 、大島 孝仁 ¹ 、吉松 公平 ¹ 、大友 明 ^{1,2} 1. 東工大理工, 2. 元素戦略
13:15 奨 20p-S222-2	RF マグネトロンスパッタリング法で作製した (ZnO) _x (InN) _{1-x} 膜の表面モフォロジー制御	○松島 宏一 ¹ 、井手 智章 ¹ 、山下 大輔 ¹ 、徐 鉉雄 ¹ 、1. 九大 古閑 一憲 ¹ 、白谷 正治 ¹ 、板垣 奈穂 ¹
13:30 20p-S222-3	ミスト CVD 法により形成したバッファ層上の ZnO 薄膜の結晶性	○田之上 博信 ¹ 、和田 祥平 ¹ 、山下 達也 ¹ 、永岡 昭二 ^{3,4} 、谷田部 然治 ^{1,2} 、中村 有水 ^{1,4} 1. 熊本大学院, 2. 熊本先端機構, 3. 熊本産技, 4. 熊本有機 機
13:45 20p-S222-4	c 面サファイア基板上 V 添加 ZnO 薄膜の初期成長初期過程	○兼松 知弘 ¹ 、千葉 博 ² 、川島 知之 ² 、鷲尾 勝由 ² 1. 東北工大, 2. 東北大院工
14:00 20p-S222-5	熱処理による固相成長を用いた単結晶化に向けた ZnO 積層膜の構成に関する考察	○碓井 将也 ¹ 、渡部 晃弘 ² 、千葉 博 ² 、川島 知之 ² 、1. 東北工大, 2. 東北大院工 鷲尾 勝由 ²
14:15 20p-S222-6	c 面サファイア上アモルファス ZnO/V 添加 ZnO 積層膜の熱処理による固相成長	○渡部 晃弘 ¹ 、碓井 将也 ² 、川島 知之 ¹ 、鷲尾 勝由 ¹ 1. 東北大院工, 2. 東北大工 1
14:30 20p-S222-7	バナジウムと窒素を共添加した ZnO 薄膜成長に関する検討	○鈴木 智也 ¹ 、川島 知之 ¹ 、鷲尾 勝由 ¹ 1. 東北大院工
14:45 奨 20p-S222-8	常圧非平衡プラズマを用いて作製した高抵抗 ZnO 薄膜の電子状態	○野瀬 幸則 ¹ 、木口 拓也 ¹ 、岩崎 裕徳 ¹ 、吉村 武 ¹ 、1. 阪府大院工, 2. 積水化学 芦田 淳 ¹ 、上原 剛 ² 、藤村 紀文 ¹
15:00 20p-S222-9	水素を添加した ZnO 単結晶の欠陥と電気特性	○大澤 健男 ¹ 、坂口 勲 ¹ 、上田 茂典 ¹ 、大橋 直樹 ¹ 1. 物材機構
15:15	休憩 / Break	
15:30 20p-S222-10	低貫通転位密度 Zn 極性 ZnO ホモエピタキシャル薄膜への 3d 遷移金属添加によるキャリア寿命制御	○秩父 重英 ¹ 、小島 一信 ¹ 、山崎 芳樹 ¹ 、古澤 健太 ¹ 1. 東北大多元研, 2. 筑波大理工 郎 ¹ 、上殿 明良 ²
15:45 20p-S222-11	Ga ドープ酸化亜鉛ランダムレーザーの発振特性	○(B)高橋 龍平 ¹ 、中村 俊博 ¹ 、山本 泰生 ² 、安達 定雄 ¹ 1. 群馬大理工, 2. ハクスイテック
16:00 奨 20p-S222-12	燐ドープ ZnO マイクロ結晶球の構造および発光特性評価	○藤原 優輝 ¹ 、池淵 達也 ¹ 、植山 健史 ¹ 、田中 稔伸 ¹ 、1. 九大シス情 永嵩 史明 ¹ 、東島 三洋 ¹ 、中村 大輔 ¹ 、岡田 龍雄 ¹
16:15 20p-S222-13	Pt/Mg _{1-x} Zn _x O/n ⁺ -ZnO ショットキーフォトダイオードにおける電流感度の改善	○遠藤 治之 ¹ 、高橋 強 ¹ 、柏葉 安兵衛 ² 1. 岩手県工技センタ, 2. 岩手大
16:30 20p-S222-14	常圧 MOCVD 法による CuO 薄膜の作製 (2)	○藤原 一樹 ¹ 、寺村 瑞樹 ¹ 、田口 健太郎 ¹ 、谷口 凱 ¹ 、1. 芝浦工大, 2. SIT GI 研究センター 1、酒井 駿吾 ¹ 、石川 博康 ^{1,2}
16:45 20p-S222-15	耐熱性 TNO 透明導電膜の導入による色素増感太陽電池の高効率化	遠藤 剛志 ¹ 、小野 理恵子 ¹ 、岩城 諒 ¹ 、竹村 秀一郎 ¹ 、1. 静岡大院工, 2. 静岡大グリーン研, 3. 神奈川技術アカ 1、○奥谷 昌之 ^{1,2} 、中尾 祥一郎 ³ 、岡崎 壮平 ³ 、坂 デミー、4. 東北大 WPI-AIMR, 5. 東大院理 井 延寿 ³ 、山田 直臣 ³ 、一杉 太郎 ⁴ 、長谷川 哲也 ⁵
17:00 20p-S222-16	ZrO ₂ 微粒子光散乱層を導入による色素増感太陽電池の高効率化	小野 理恵子 ¹ 、遠藤 剛志 ¹ 、大塚 玲奈 ¹ 、○奥谷 昌之 ^{1,2} 1. 静岡大院工, 2. 静岡大グリーン研
17:15 20p-S222-17	マイクロ波加熱法による多孔質 TiO ₂ 層の作製と色素増感太陽電池への応用	青山 貴裕 ¹ 、大橋 拓也 ¹ 、○奥谷 昌之 ^{1,2} 1. 静岡大院工, 2. 静岡大グリーン研

3/21(Mon.) 9:00 - 12:15			口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場
9:00	21a-S222-1	β -Ga ₂ O ₃ 基板の加工変質層の評価	○渡辺 信也 ¹ 、奥 公祥 ¹ 、山岡 優 ¹ 、増井 建和 ¹ 、 倉又 朗人 ¹ 、山腰 茂伸 ¹ 1. タムラ製作所
9:15	21a-S222-2	β -Ga ₂ O ₃ 成長結晶の (010) における溝型欠陥の観察	○(PC) 花田 賢志 ¹ 、森林 朋也 ¹ 、奥 公祥 ² 、佐々木 公平 ² 、倉又 朗人 ² 、上田 修 ³ 、嘉数 誠 ¹ 1. 佐賀大、2. タムラ製作所、3. 金沢工大
9:30	21a-S222-3	β -Ga ₂ O ₃ (010) 単結晶のエッチピットの観察	○(PC) 花田 賢志 ¹ 、森林 朋也 ¹ 、奥 公祥 ² 、佐々木 公平 ² 、倉又 朗人 ² 、上田 修 ³ 、嘉数 誠 ¹ 1. 佐賀大、2. タムラ製作所、3. 金沢工大
9:45	奨 21a-S222-4	高品質 α -Ga ₂ O ₃ に向けた α -(Al,Ga _{1-x}) ₂ O ₃ 超格子バッファ層の作製と結晶構造評価	○神野 莉衣奈 ¹ 、内田 貴之 ¹ 、金子 健太郎 ¹ 、藤田 静雄 ¹ 1. 京大院工
10:00	奨 21a-S222-5	α -(Al _{1-x} Ga _x) ₂ O ₃ 薄膜の電子状態解析および α -(Al _{1-x} Ga _x) ₂ O ₃ / α -Ga ₂ O ₃ のバンドアライメント解析	○内田 貴之 ¹ 、神野 莉衣奈 ¹ 、竹本 柁 ² 、金子 健太郎 ¹ 、藤田 静雄 ¹ 1. 京大院工、2. 京大工
10:15	21a-S222-6	β -Ga ₂ O ₃ 結晶における励起子-LO フォノン相互作用	○尾沼 猛儀 ^{1,2} 、齋藤 伸吾 ² 、佐々木 公平 ^{3,2} 、後藤 健 ³ 、増井 建和 ³ 、山口 智広 ¹ 、本田 徹 ¹ 、倉又 朗人 ³ 、東脇 正高 ² 1. 工学院大、2. 情通機構、3. タムラ製作所
10:30	休憩 / Break		
10:45	21a-S222-7	NiO 上に形成した β -Ga ₂ O ₃ 薄膜の結晶配向とそのヘテロ接合	○中込 真二 ¹ 、久保 匠平 ¹ 、國分 義弘 ¹ 1. 石巻専修大理工
11:00	21a-S222-8	beta-Ga ₂ O ₃ ショットキーバリアダイオード素子特性の分布	○嘉数 誠 ¹ 、原田 和也 ¹ 、花田 賢志 ¹ 、大石 敏之 ¹ 1. 佐賀大院工
11:15	21a-S222-9	HVPE 法による In ₂ O ₃ 成長の検討	○沼田 至優 ¹ 、富樫 理恵 ¹ 、後藤 健 ² 、村上 尚 ¹ 、倉又 朗人 ² 、山腰 茂伸 ² 、熊谷 義直 ¹ 1. 東京農工大大院工、2. タムラ製作所
11:30	21a-S222-10	MBE 成長した単結晶 WO ₃ 薄膜のエレクトロクロミック特性	○(MI) 村山 喬之 ¹ 、栗形 航行 ¹ 、原田 義之 ¹ 、小池 一歩 ¹ 、佐々 誠彦 ¹ 、矢野 満明 ¹ 、稲葉 克彦 ² 、小林 信太郎 ² 1. 大阪工大ナノ材研センタ、2. リガク X 線研
11:45	奨 21a-S222-11	薄膜トランジスタ構造を有するアモルファス酸化物エレクトロクロミック素子	○小野里 高記 ¹ 、片瀬 貴義 ² 、太田 裕道 ² 1. 北大院情報科学、2. 北大電子研
12:00	21a-S222-12	β -Ga ₂ O ₃ 基板上への NiO 薄膜の成長とヘテロ接合ダイオードへの応用	○國分 義弘 ¹ 、久保 匠平 ¹ 、中込 真二 ¹ 1. 石巻専修大理工
3/22(Tue.) 9:30 - 11:30			口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場
9:30	22a-S222-1	非晶質酸化物半導体 ITZO 薄膜の NBITS 不安定性評価	○田中 聡 ¹ 、清水 耕作 ¹ 1. 日大生産工
9:45	奨 22a-S222-2	酸化物薄膜トランジスタへ向けた C ドープした In-W-O チャンネル材料の特性	○(M2) 栗島 一徳 ^{1,2} 、生田目 俊秀 ² 、三苦 伸彦 ² 、木津 たきお ² 、塚越 一仁 ² 、澤田 朋実 ² 、大井 暁彦 ² 、山本 逸平 ^{3,2} 、大石 知司 ³ 、知京 豊裕 ³ 、小椋 厚志 ¹ 1. 明治大、2. 物材機構 WPI-MANA、3. 芝浦工大
10:00	奨 22a-S222-3	a-IGZO 薄膜の後焼成に伴う構造緩和と結晶化	○須古 彩香 ¹ 、賈 軍軍 ¹ 、中村 新一 ¹ 、岡島 敏浩 ² 、重里 有三 ¹ 1. 青山学院大、2. 九州シンクロトン光研究センター
10:15	22a-S222-4	IGZO 結晶における原子配置と酸素欠損の関係	○高橋 正弘 ¹ 、中山 智則 ¹ 、菊地 彫 ¹ 、中島 基 ¹ 、山崎 舜平 ¹ 1. 半エネ研
10:30	22a-S222-5	IGZO の結晶構造及び CAAC-IGZO 物性の組成比依存性	○山内 諒 ¹ 、太田 将志 ¹ 、山田 良則 ¹ 、石黒 佳美 ¹ 、山崎 舜平 ¹ 1. 半エネ研
10:45	22a-S222-6	CAAC-IGZO 薄膜の偏光 XANES 測定	○石黒 佳美 ¹ 、黒澤 陽一 ¹ 、菊地 彫 ¹ 、高橋 正弘 ¹ 、中山 智則 ¹ 、津吹 将志 ¹ 、山崎 舜平 ¹ 1. 半エネ研
11:00	奨 22a-S222-7	超ワイドギャップアモルファス半導体 a-Ga ₂ O _x の実現と Ga-Zn-O 系のバンドアライメント	○金正煥 ¹ 、関谷 拓実 ¹ 、井手 啓介 ¹ 、平松 秀典 ¹ 、細野 秀雄 ¹ 、神谷 利夫 ¹ 1. 東工大応セラ研
11:15	22a-S222-8	【注目講演】アモルファス酸化物半導体をホストとする蛍光体薄膜の室温作製	○神谷 利夫 ^{1,2} 、Kim Junghwan ¹ 、三代川 範彦 ¹ 、井手 啓介 ¹ 、戸田 喜丈 ² 、平松 秀典 ^{1,2} 、細野 秀雄 ^{1,2} 1. 東工大応セラ研、2. 東工大元素センター
3/22(Tue.) 12:30 - 14:45			口頭講演 (Oral Presentation) S222 会場
12:30	22p-S222-1	IGZO TFT 特性における不純物の影響	○坂本 純一 ¹ 、武井 応樹 ¹ 、小林 大士 ¹ 、清田 淳也 ¹ 、齋藤 一也 ¹ 1. 株式会社アルバック
12:45	奨 22p-S222-2	低電流動作非晶質 InGaZnO 抵抗変化メモリに関する研究	○門 圭佑 ¹ 、山内 祥光 ¹ 、鍋坂 恭平 ¹ 、藤井 美美 ¹ 、Juan Paolo Bermundo ¹ 、石河 泰明 ¹ 、浦岡 行治 ¹ 1. 奈良先端大
13:00	22p-S222-3	閾値駆動による a-InGaZnO TFT pH センサのドリフト制御	○岩松 新之輔 ¹ 、竹知 和重 ² 、阿部 泰 ¹ 、今野 俊介 ¹ 、矢作 徹 ¹ 、村上 稷 ¹ 、田邊 浩 ² 、加藤 睦人 ¹ 1. 山形県工技セ、2. NLT テクノロジー
13:15	22p-S222-4	高感度 a-InGaZnO TFT pH センサの Vgs 応答特性	○竹知 和重 ¹ 、田邊 浩 ¹ 、岩松 新之輔 ² 、今野 俊介 ¹ 、矢作 徹 ² 、阿部 泰 ² 、加藤 睦人 ² 1. NLT テクノロジー、2. 山形県工技セ
13:30	22p-S222-5	a-InGaZnO TFT の光誘起トランプゲート効果	○竹知 和重 ¹ 、田邊 浩 ¹ 1. NLT テクノロジー
13:45	奨 22p-S222-6	塗布型酸化物 TFT における水素プラズマの効果	○宮川 幹司 ¹ 、中田 充 ¹ 、辻 博史 ¹ 、藤崎 好英 ¹ 、山本 敏裕 ¹ 1. NHK 技研
14:00	奨 22p-S222-7	溶液法で作製した IGZO 薄膜の UV 照射による不活性化と熱による回復	○(B) 落合 祐輔 ¹ 、陳 東京 ¹ 、森本 貴明 ¹ 、福田 伸子 ³ 、大木 義路 ^{1,2} 1. 早大先進理工、2. 早大材研、3. 産総研 FLEC
14:15	奨 22p-S222-8	溶液法で作製したアモルファス IGZO 薄膜の伝達特性に与えるイオン注入とアニールの効果	○(M2) 陳 東京 ¹ 、森本 貴明 ¹ 、福田 伸子 ² 、大木 義路 ^{1,3} 1. 早大先進理工、2. 産総研 FLEC、3. 早大材研
14:30	22p-S222-9	水系塗布型 IGZO-TFT における塗布型有機ゲート絶縁膜の適用	○中田 充 ¹ 、福田 伸子 ² 、辻 博史 ¹ 、宮川 幹司 ¹ 、藤崎 好英 ¹ 、山本 敏裕 ¹ 1. NHK 技研、2. 産総研

チュートリアル / Tutorial

シンポジウムのプログラムは p.33 ~ p.40 にございます

チュートリアル 1 / Tutorial1

3/19(Sat.) 9:00 - 12:10			口頭講演 (Oral Presentation) W541 会場
9:00	招	はじめての光学 一光の基礎からプラズモニクスまで	○川田 善正 ¹ 1. 静岡大学電子工学研究所

チュートリアル 2 / Tutorial2

3/19(Sat.) 9:00 - 12:10			口頭講演 (Oral Presentation) W621 会場
9:00	招	大気圧プラズマの基礎と農業への応用 ～超格安電源づくりから農作物生産や鮮度保持への活用まで～	○高木 浩一 ¹ 1. 岩手大学工学部

チュートリアル 3 / Tutorial3

3/19(Sat.) 9:00 - 12:10			口頭講演 (Oral Presentation) W641 会場
9:00	招	スピントロニクス入門	○高梨 弘毅 ¹ 1. 東北大

チュートリアル 4 / Tutorial4

3/19(Sat.) 9:00 - 12:10			口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場
9:00	招	半導体光デバイスの基礎と今後 LED、LD、QCL へー	○平山 秀樹 ¹ 1. 理化学研究所平山量子光素子研究室

チュートリアル5/ Tutorial5						
3/22(Tue.) 9:00 - 12:10 口頭講演 (Oral Presentation) W9 会場						
9:00	招		「半導体デバイス：物理の基礎からデバイスの動作原理・回路への展開まで」――もう一度、学部の基礎から復習してみよう――	○柴田 直 ¹		1. 東京大学
チュートリアル6 / Tutorial6						
3/22(Tue.) 9:00 - 12:10 口頭講演 (Oral Presentation) W641 会場						
9:00	招		結晶成長を理解する	○西永 頌 ¹		1. 東京大学
CS コードシェアセッション / Code-sharing session						
シンポジウムプログラムは p.33 ~ p.40 にございます						
CS.1 3.5 レーザー装置・材料と 3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション / 3.5/3.14 Code-sharing session						
3/21(Mon.) 9:00 - 11:30 口頭講演 (Oral Presentation) S611 会場						
9:00		21a-S611-1	常温接合 Nd:YAG/ダイヤモンド複合構造レーザーの熱屈折評価	○(B) 山口 頌木 ¹ 、奥山 洋平 ¹ 、市川 裕允 ¹ 、庄司 一郎 ¹		1. 中央大理工
9:15		21a-S611-2	レーザーセラミックス接合技術の開発 ― 真空熱処理による Yb:YAG セラミックスの光学特性の劣化 ―	○持田 哲郎 ¹ 、藤岡 加奈 ¹ 、時田 茂樹 ¹ 、藤本 靖 ¹ 、宮永 憲明 ¹ 、河仲 準二 ¹		1. 阪大レーザー研
9:30		21a-S611-3	常温接合を用いたレーザー結晶と銅との直接接合	○安達 亮次 ¹ 、松井 鵬樹 ¹ 、庄司 一郎 ¹		1. 中央大理工
9:45		21a-S611-4	水晶を用いた高強度光励起波長変換の検討	○石月 秀貴 ¹ 、平等 拓範 ¹		1. 分子研
10:00		21a-S611-5	波長変換材料 LaBGeO ₅ の 2 次非線形光学定数精密測定	○本多 勇介 ¹ 、河崎 進太 ¹ 、庄司 一郎 ¹		1. 中央大理工
10:15		21a-S611-6	電圧印加による LaBGeO ₅ 周期分極反転構造作製の基礎検討	○沖野 行佑 ¹ 、梶原 敏明 ¹		1. 阪大院工
10:30		21a-S611-7	MgO(8mol%) 添加 c-LiTaO ₃ 周期分極反転構造による 355nm 紫外光と周波発生	○岡 寿治 ¹ 、梶原 敏明 ¹		1. 阪大院工
10:45	奨	21a-S611-8	周期空間反転 GaAs ホモ接合ダイオードの作製	○鈴木 涼介 ¹ 、松下 智紀 ^{1,2} 、近藤 高志 ^{1,2}		1. 東大工, 2. 東大先端研
11:00		21a-S611-9	定比組成 LiNbO ₃ の電気光学定数精密測定	○中野 翔太 ¹ 、秋山 和己 ¹ 、庄司 一郎 ¹		1. 中央大理工
11:15		21a-S611-10	圧力印加による高 Q 値結晶 WGM 共振器の周波数制御及び 2 次高調波発生	○(DC) 吉岐 航 ^{1,2} 、Werner Christoph ² 、Breunig Ingo ² 、Buse Karsten ²		1. 慶應理工, 2. フライブルグ大
CS.2 3.7, 12.6, 12.7 のコードシェアセッション「レーザー・ナノ・バイオ プロセッシングとセンシングの融合に向けて」/ 3.7/12.6/12.7 Code-sharing session						
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) W331 会場						
13:45	招	21p-W331-1	【講演奨励賞受賞記念講演】(15分) フェムト秒レーザーアブレーションを用いた成長機構転換によるタンパク質結晶の高品質化	○富永 勇佑 ¹ 、丸山 美帆子 ¹ 、吉村 政志 ¹ 、杉山 成 ² 、安達 宏昭 ^{1,3} 、塚本 勝男 ¹ 、松村 浩由 ^{3,4} 、高野 和文 ^{3,5} 、村上 聡 ^{3,6} 、井上 豪 ^{1,3} 、吉川 洋史 ^{1,7} 、森 勇介 ^{1,3}		1. 阪大院工, 2. 阪大院理, 3. 創晶, 4. 立命大生科, 5. 京府大院生環, 6. 東工大院生理工, 7. 埼玉大
14:00	奨	21p-W331-2	フォトニック結晶ナノレーザーでの電気化学センシング	○渡部 工 ¹ 、古田 祐樹 ¹ 、高橋 大智 ¹ 、長谷川 湧 ¹ 、馬場 俊彦 ¹		1. 横国大・院工
14:15	奨	21p-W331-3	マイクロ流路内における生分解性粒子支援フェムト秒レーザー外来分子導入	○石井 敦浩 ¹ 、有安 和優 ¹ 、三橋 龍樹 ¹ 、Dag Heinemann ² 、Alexander Heisterkamp ^{2,3} 、寺川 光洋 ¹		1. 慶大院理工, 2. レーザーセンターハノーバー, 3. ライプニッツ大学ハノーバー
14:30	奨	21p-W331-4	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での微小物体の高速ソーティング	○山川 健 ^{1,4} 、萩原 宏規 ^{1,4} 、飯野 敏矩 ^{1,4} 、田中 直樹 ^{2,4} 、芝田 悠大 ^{2,4} 、野沢 泰祐 ^{2,4} 、磯崎 瑛宏 ^{2,4} 、Dino Di Carlo ^{3,4} 、合田 圭介 ^{2,3,4} 、細川 陽一郎 ^{1,4}		1. 奈良先端大物質, 2. 東大院理, 3. UCLA, 4. JST
14:45		21p-W331-5	レーザー走査光触媒リソグラフィを活用した液中細胞パターンニング	○(M1) 藤城 翔偉 ¹ 、関根 浩平 ¹ 、河野 翔 ¹ 、池田 丈 ² 、黒田 章夫 ² 、山本 英明 ³ 、谷井 孝至 ¹		1. 早大理工, 2. 広大先端研, 3. 東北大学際研
15:00		21p-W331-6	マイクロ流路作製のための LPP EUV 光による PDMS の加	○浦井 ひかり ¹ 、小川 瑞生 ¹ 、深見 慎太郎 ¹ 、島居 周一 ¹ 、牧村 哲也 ¹ 、中村 大輔 ² 、高橋 昭彦 ² 、岡田 龍雄 ² 、新納 弘之 ³		1. 筑波大院数理, 2. 九大院シス情, 3. 産総研
15:15			休憩 / Break			
15:30		21p-W331-7	金属ナノ粒子を用いたレーザー直接描画法による 3 次元マイクロ構造体の形成	○渡辺 明 ¹ 、蔡 金光 ¹		1. 東北多元研
15:45		21p-W331-8	Bull's eye 構造のプラズモニクチップを用いた蛍光標識ナノ粒子の蛍光顕微鏡観察	○泉 章太 ¹ 、細川 千絵 ² 、當麻 真奈 ¹ 、田和 圭子 ¹		1. 関西学院大理工, 2. 産総研
16:00		21p-W331-9	遺伝子変換フェリチンによる離散金ナノ粒子アレイ作製技術の構築	○信澤 和行 ¹ 、岡本 尚文 ² 、Chong Karen Siew Ling ³ 、山下一郎 ^{1,2}		1. 阪大院工, 2. 奈良先端大物質, 3. IMRE A*STAR
16:15		21p-W331-10	汎用グリーンレーザーによるフッ素ポリマーの微細加工技術開発および水棲微生物観察用バイオチップ作製	○根本 佳祐 ¹ 、小川 達也 ¹ 、花田 修賢 ^{1,2}		1. 弘前大理工, 2. 理研
16:30		21p-W331-11	集光フェムト秒レーザーを用いた単一細胞刺激による神経細胞ネットワークの活動特性	○中川 裕太 ^{1,2} 、工藤 卓 ² 、田口 隆久 ³ 、細川 千絵 ¹		1. 産総研, 2. 関西学院大理工, 3. 情通機構
16:45		21p-W331-12	物理ストレスを受けたミトコンドリアの力印加共焦点顕微鏡による活性酸素応答測定	○本田 諭志 ¹ 、李 永波 ¹ 、上田 雅 ¹ 、長崎 秀昭 ¹ 、岩見 健太郎 ¹ 、太田 善浩 ¹ 、梅田 倫弘 ¹		1. 農工大
17:00			休憩 / Break			
17:15		21p-W331-13	Measurement of Reactive Species for the Development of Plasma-on-Chip	○呉 準席 ^{1,2} 、小島 信也 ³ 、八田 章光 ^{1,2} 、佐々木 実 ³ 、熊谷 慎也 ³		1. Kochi Univ. Technol., 2. Center Nanotechnol., 3. Toyota Technol. Inst.
17:30		21p-W331-14	可視光照射によるバイオセンシング用銀ナノ構造基板の作製	○吉川 裕之 ¹ 、沈 正君 ¹ 、廣納 麻美 ¹ 、民谷 栄一 ¹		1. 阪大院工
17:45		21p-W331-15	神経細胞表面のグルタミン酸受容体分子の初期集合状態に依存した光捕捉過程	○前澤 安代 ¹ 、岸本 龍典 ^{1,2} 、工藤 卓 ² 、田口 隆久 ³ 、細川 千絵 ^{1,2}		1. 産総研 バイオメディカル, 2. 関西学院大理工, 3. 情通機構 脳情報
18:00		21p-W331-16	界面レーザー捕捉による局所的タンパク濃度上昇・結晶化促進の顕微分光	○三浦 篤志 ^{1,2} 、吉松 泉 ² 、喜多村 昇 ^{1,2}		1. 北大院理, 2. 北大院総化
18:15		21p-W331-17	光熱熱集効果を用いた高速細菌数測定法の原理構築	○山本 靖之 ^{1,2} 、清水 恵美 ² 、西村 勇姿 ¹ 、床波 志保 ² 、飯田 琢也 ¹		1. 阪大院理, 2. 阪大院工
18:30		21p-W331-18	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたマイクロチップ中での単一細胞の高速操作：操作性の流速およびレーザー強度依存性	○萩原 宏規 ^{1,4} 、山川 健 ^{1,4} 、飯野 敏矩 ^{1,4} 、田中 直樹 ^{2,4} 、芝田 悠大 ^{2,4} 、野沢 泰祐 ^{2,4} 、磯崎 瑛宏 ^{2,4} 、Dino Di Carlo ^{3,4} 、合田 圭介 ^{2,3,4} 、細川 陽一郎 ^{1,4}		1. 奈良先端大物質, 2. 東大院理, 3. UCLA, 4. JST
18:45		21p-W331-19	フェムト秒レーザー誘起衝撃力を用いたオープンチップ中の高速流体からの細胞分取	○飯野 敏矩 ^{1,3} 、山川 健 ^{1,3} 、萩原 宏規 ^{1,3} 、佐久間 臣耶 ^{2,3} 、早川 健 ^{2,3} 、益田 泰輔 ^{2,3} 、新井 史人 ^{2,3} 、細川 陽一郎 ^{1,3}		1. 奈良先端大物質創成, 2. 名大院工, 3. JST
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象, 13.7 ナノ構造・量子現象のコードシェアセッション / 3.11/13.7 Code-sharing session						
3/21(Mon.) 13:45 - 19:00 口頭講演 (Oral Presentation) S621 会場						
13:45		21p-S621-1	リング状共振器を用いたスピン・光軌道角運動量変換	○岩本 敏 ^{1,2} 、太田 泰友 ² 、荒川 泰彦 ^{1,2}		1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
14:00		21p-S621-2	超高速波長変換素子に向けた InAs 量子ドットを有する GaAs/AlAs 多層膜三結合共振器	○盧 翔益 ¹ 、熊谷 直人 ¹ 、北田 貴弘 ¹ 、井須 俊郎 ¹		1. 徳島大フロンティア

14:15	奨 21p-S621-3	量子ドット・ナノ共振器強結合系における時間分解光測定	○車一宏 ¹ 、太田泰友 ² 、角田雅弘 ² 、岩本敏 ^{1,2} 、荒川泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
14:30	21p-S621-4	3 連結合光ナノ共振器における光ラビ振動の動的反転操作の実証	○鴻池遼太郎 ^{1,2} 、仲代匡宏 ¹ 、田中良典 ¹ 、浅野卓 ¹ 、野田進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員
14:45	奨 21p-S621-5	量子ドット集合体におけるチャープパルスを用いたロバストなフォトンエコー生成	○(M1)佐藤嘉高 ¹ 、青沼直登 ¹ 、赤羽浩一 ² 、早瀬潤子 ¹	1. 慶大理工, 2. 情報通信研究機構
15:00	21p-S621-6	結合共振器から生じる二波長レーザー光の時間的コヒーレンスの評価	○北田貴弘 ¹ 、太田寛人 ¹ 、原山千穂 ¹ 、盧翔孟 ¹ 、熊谷直人 ¹ 、井須俊郎 ¹	1. 徳島大院フロンティア
15:15		休憩/Break		
15:30	奨 E 21p-S621-7	Modulation of Dynamic Nuclear Spin Polarization in Single InAs/GaAs Quantum Dots by Photonic Bandgap Effect	○(D)CheeFai Fong ¹ , Yasutomo Ota ² , Satoshi Iwamoto ^{1,2} , Yasuhiko Arakawa ^{1,2}	1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.Nanoquine
15:45	21p-S621-8	GaAs 中の窒素発光中心から発生した光子の量子干渉	○(D)張遼 ¹ 、池沢道男 ¹ 、佐久間芳樹 ² 、迫田和彰 ² 、舛本泰章 ¹	1. 筑波大物理, 2. 物質・材料研究機構
16:00	21p-S621-9	ピラー型微細形状を有する QDinF を用いた高純度単一光子状態の生成	○村上大輔 ¹ 、小田島聡 ² 、中島秀郎 ³ 、熊野英和 ⁴ 、笹倉弘理 ⁴	1. 北大院工, 2. 八戸工大, 3. 北大電子研, 4. 北大創成
16:15	21p-S621-10	量子エミッタを含む結合ナノ共振器系のダイナミクスの解析	○上出健仁 ¹ 、岩本敏 ^{1,2} 、荒川泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子機構, 2. 東大生研
16:30	21p-S621-11	転写プリント法による数原子層黒リンフォトニック結晶ナノ共振器結合系の作製	○太田泰友 ¹ 、守谷頼 ² 、矢吹直人 ² 、荒井美穂 ² 、角田雅弘 ¹ 、岩本敏 ^{1,2} 、町田友樹 ^{1,2} 、荒川泰彦 ^{1,2}	1. 東大ナノ量子, 2. 東大生研
16:45	21p-S621-12	転写プリント法を用いた量子ドットを有するプラズモニックマイクロリング共振器の作製と光学特性評価	○玉田晃均 ¹ 、太田泰友 ² 、車一宏 ¹ 、Jinfa Ho ² 、渡邊克之 ² 、岩本敏 ^{1,2} 、荒川泰彦 ^{1,2}	1. 東大生研, 2. 東大ナノ量子機構
17:00		休憩/Break		
17:15	21p-S621-13	動的熱輻射制御に伴う光源温度及び輻射パワーの過渡応答特性	○井上卓也 ^{1,2} 、浅野卓 ¹ 、野田進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員 DC
17:30	奨 21p-S621-14	2 波長切替型中赤外熱輻射光源の設計	○紀安き ¹ 、井上卓也 ^{1,2} 、De Zoysa Menaka ^{1,3} 、野田進 ¹	1. 京大院工, 2. 学振特別研究員 DC, 3. 京大白眉
17:45	21p-S621-15	電気機械フォノン導波路を用いた周波数多重化演算の可能な論理ゲート素子	○畑中大樹 ¹ 、ダラス トム ¹ 、マブーブ イムラン ¹ 、小野満恒二 ¹ 、山口浩司 ¹	1. NTT 物性研
18:00	奨 21p-S621-16	GaN/AlGaIn 多重量子井戸とフォトニック結晶に基づく中波長赤外熱輻射光源の開発	○(D)Kang Daniel Dongyeon ¹ 、井上卓也 ^{1,2} 、浅野卓 ¹ 、野田進 ¹	1. 京都大学, 2. 学振特別研究員 DC
18:15	21p-S621-17	MgO 基板上の狭帯域近赤外 Si フォトニック結晶熱輻射光源の開発	○末光真大 ¹ 、堤達紀 ² 、浅野卓 ² 、De Zoysa Menaka ^{2,3} 、野田進 ²	1. 大阪ガス, 2. 京大院工, 3. 京大白眉
18:30	21p-S621-18	埋込ヘテロ構造共振器を用いたフォトニック結晶 PT 対称結合共振器導波路の解析	○高田健太 ^{1,2} 、納富雅也 ^{1,2}	1. NTT 物性研, 2. NTT NPC
18:45	21p-S621-19	コヒーレント状態と個数状態を用いたハイブリッド解析手法の微小共振器ラマン効果への応用	○乾善貴 ¹ 、浅野卓 ¹ 、高橋和 ² 、野田進 ¹	1. 京大院工, 2. 阪府大院

CS.4 6.6 プローブ顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション / 6.6/12.2 Code-sharing session

3/20(Sun.) 9:00 - 12:30 口頭講演 (Oral Presentation) W631 会場				
9:00	20a-W631-1	ベント型ナノピペットを有する走査型イオン伝導顕微鏡の開発と生体組織の観察	○白澤樹 ¹ 、平田惇 ¹ 、水谷祐輔 ² 、牛木辰男 ² 、岩田太 ¹	1. 静岡大工, 2. 新潟大医
9:15	奨 20a-W631-2	AFM による有機分子の高分解能室温観察	○(DC)岩田孝太 ¹ 、山崎詩郎 ² 、Mutombo Pingo ³ 、Hapala Prokop ³ 、Ondracek Martin ³ 、Jelinek Pavel ³ 、杉本宜昭 ^{1,4}	1. 阪大院工, 2. 東工大総理工, 3. チェコ科学アカデミー, 4. 東大新領域
9:30	20a-W631-3	金平坦面上に固定した量子ドット固定密度の評価	○伊藤裕貴 ¹ 、坂上弘之 ¹ 、鈴木仁 ¹	1. 広島大先端研
9:45	奨 20a-W631-4	PCBM と CuPc が形成する 2D 混合構造に対するアニールの影響	○榊井茜 ¹ 、坂上弘之 ¹ 、高萩隆行 ¹ 、鈴木仁 ¹	1. 広島大先端研
10:00	20a-W631-5	KFM を用いた ITO/Ru 錯体/AuNPs 構造の局所電荷分布の計測	○丹下直之 ¹ 、大塚洋一 ¹ 、高木大敬 ¹ 、西嶋知史 ¹ 、松本卓也 ¹	1. 阪大院理
10:15	20a-W631-6	周波数シフト法静電気力顕微鏡による有機薄膜太陽電池における光誘起電荷マッピング	○荒木健人 ¹ 、家裕隆 ² 、安蘇義雄 ² 、大山浩 ¹ 、松本卓也 ¹	1. 阪大理, 2. 阪大産研
10:30		休憩/Break		
10:45	奨 20a-W631-7	時間分解静電気力顕微鏡による有機薄膜トランジスタのキャリアダイナミクスの可視化	○山岸裕史 ¹ 、木村知玄 ¹ 、小林圭 ^{1,2} 、野田啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ, 3. 慶應大理工
11:00	20a-W631-8	時間分解静電気力顕微鏡による電極-有機半導体グレイン界面の局所電気特性評価	○木村知玄 ¹ 、小林圭 ^{1,2} 、山田啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
11:15	20a-W631-9	走査型プローブエレクトロスタティックイオン化質量イメージング法の高分解能化の検討	○大塚洋一 ¹ 、小東剛 ² 、嶋津亮 ² 、岩田太 ³ 、荒川隆一 ² 、松本卓也 ¹	1. 阪大院理, 2. 関大化生工, 3. 静大院工
11:30	20a-W631-10	各濃度溶液中における Streptavidin 2 次元結晶の液中 FM-AFM 高分解能構造観察	○(D)崔子鵬 ¹ 、小林圭 ^{1,2} 、平田芳樹 ³ 、山田啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ, 3. 産総研
11:45	20a-W631-11	biotin 結合による streptavidin 2 次元結晶の構造変化のその場評価	○(B)濱田貴裕 ¹ 、宮本真之 ¹ 、木南裕陽 ¹ 、小林圭 ^{1,2} 、山田啓文 ¹	1. 京大工, 2. 京大白眉セ
12:00	20a-W631-12	3D-SFM を用いた磁気ディスク上における潤滑剤分子の 3 次元吸着構造計測	○中嶋脩貴 ¹ 、宮澤佳甫 ¹ 、豊田真理子 ¹ 、相方良介 ² 、清水豪 ² 、曾田孝雄 ² 、福岡剛士 ^{1,3}	1. 金大理工, 2. MORESCO, 3. ACT-C
12:15	20a-W631-13	SAM 膜修飾電極を用いた c 型シクロクロム単一分子の電気伝導計測	○角田早 ¹ 、大山浩 ¹ 、松本卓也 ¹	1. 阪大理

CS.5 9.4 熱電変換, 16.2 エナジーハーベスティングのコードシェアセッション / 9.4/16.2 Code-sharing session

3/19(Sat.) 16:00 - 18:00 ポスター講演 (Poster Presentation) P13 会場				
19p-P13-1		高温薄膜熱電特性評価装置の開発 II	○(M1)佐々木一真 ¹ 、内藤智之 ¹ 、藤代博之 ¹	1. 岩手大工
19p-P13-2		Ba ₂ NaNb ₂ O ₁₅ の輸送及び熱電特性	○掛本博文 ¹ 、常盤祐汰 ² 、渡邊拓哉 ³ 、小澤健介 ³ 、入江寛 ^{1,2,3}	1. 山梨大学 クリーンエネルギー研究センター, 2. 工学部, 3. 大学院 医学工学総合教育部
19p-P13-3		Ca ₉ Bi ₁₀ MnO ₃ の粒径微細化が熱電特性に及ぼす影響	○中村雄一 ¹ 、白井小雪 ¹ 、井上光輝 ¹	1. 豊橋技科大
19p-P13-4		(LaO)CuSe, (BiO)CuSe の熱電特性の違い	○菅野聖人 ¹ 、東谷篤志 ² 、生天目博文 ³ 、谷口雅樹 ³ 、佐藤仁 ³ 、アワベクリスル ⁴ 、渡辺忠孝 ¹ 、高野良紀 ¹ 、高瀬浩一 ¹	1. 日大理工, 2. 摂南大理工, 3. 広大放射光, 4. 広大院理
19p-P13-5		AlMgB ₁₄ 基熱電変換材料の熱電特性制御と金属サイト占有率	○(M2)有松英輝 ¹ 、藤間卓也 ¹ 、高木研一 ¹	1. 東京都市大工
E 19p-P13-6		Synthesis of clathrate K ₈ Ga _x Al _{1-x} Si _{146-y} with enhanced thermoelectric property	○(PC)Shiva Kumar Singh ¹ , Motoharu Imai ¹	1. National Institute for Materials Science, 1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki, 305-0047, Japan

19p-P13-7	高キャリア濃度を有する Sb-doped Mg ₂ Si の作製と熱的安定性評価	○加藤 大輔 ^{1,2} , 岩崎 航太 ² , 吉野 正人 ¹ , 山田 智明 ¹ , 1.名古屋大, 2.トヨタ紡織 長崎 正雅 ¹
19p-P13-8	Si/Mg ₂ Si コンポジットの微細組織と熱電特性	○(DC) 窪内 将隆 ¹ , 林 慶 ¹ , 宮崎 謙 ¹ 1.東北大院工
19p-P13-9	単結晶 SnSe への Sb 置換効果	○秋山 拓海 ¹ , 宮田 全展 ¹ , 西野 俊佑 ¹ , 伊藤 暢晃 1.北陸先端大 ¹ , 大島 義文 ¹ , 小矢野 幹夫 ¹
19p-P13-10	Si 系クラスレートにおける Ag 置換と熱電特性	○前島 理佐 ¹ , 上田 貴大 ¹ , 岡本 和也 ¹ , 阿武 宏明 1.山口東理大工 ¹
19p-P13-11	PLD 法を用いた SnSe 薄膜の作製と熱電性能	○原 貴充 ¹ , 内藤 智之 ¹ , 藤代 博之 ¹ , 伊藤 暁彦 ² , 1.岩手大工, 2.東北大金研 後藤 孝 ²
19p-P13-12	基板表面に担持した Bi-Te 熱電微粒子の AFM 観察	○林 祐司 ¹ , 水谷 慎吾 ¹ , 西野 俊佑 ¹ , 宮田 全展 ¹ , 1.JAIST, 2.株式会社 KELK 小矢野 幹夫 ¹ , 田中 哲史 ² , 福田 克史 ²
19p-P13-13	熱電インクを用いた Bi ₂ Te ₃ 配向ナノバルクの低温作製	○水谷 慎吾 ¹ , 林 祐司 ¹ , 西野 俊佑 ¹ , 宮田 全展 ¹ , 1.JAIST, 2.株式会社 KELK 小矢野 幹夫 ¹ , 田中 哲史 ² , 福田 克史 ²
19p-P13-14	ビスマスナノ構造における表面状態の数値解析	青野 友祐 ¹ , ○小峰 啓史 ¹ , 村田 正行 ² , 長谷川 靖 1.茨城大, 2.産総研, 3.埼玉大 洋 ³
19p-P13-15	擬一次元伝導体マイクロリボンの熱電特性評価	○佐久間 佑 ¹ , 西野 俊佑 ¹ , 宮田 全展 ¹ , 小矢野 幹 夫 ¹ 1.JAIST
3/20(Sun.) 13:45 - 17:45 口頭講演 (Oral Presentation) W323 会場		
13:45	20p-W323-1	TiO ₂ 結晶化ガラスによる可視光照射水分解 高橋 寛 ¹ , ○吉田 和貴 ¹ , 寺門 信明 ¹ , 高橋 儀宏 ¹ , 1.東北大院工, 2.東北大多元研 藤原 巧 ¹ , 加藤 英樹 ² , 垣花 真人 ²
14:00	20p-W323-2	VO ₂ 結晶化ガラス創製のための還元剤添加による析出相制御 ○村本 圭 ¹ , 寺門 信明 ¹ , 高橋 儀宏 ¹ , 藤原 巧 ¹ 1.東北大院工
14:15	20p-W323-3	(001) 配向した SrCu ₂ O ナノ結晶膜における面内熱拡散率と構造の関係 ○寺門 信明 ¹ , 高橋 良輔 ¹ , 高橋 儀宏 ¹ , 藤原 巧 ¹ 1.東北大院工
14:30	奨 E 20p-W323-4	偏光 CW レーザー光を用いたスピン熱伝導性 SrCu ₂ O ₂ の異方的結晶化ラインの作製 ○高橋 良輔 ¹ , 寺門 信明 ¹ , 高橋 儀宏 ¹ , 藤原 巧 ¹ 1.東北大工
14:45	休憩 / Break	
15:00	20p-W323-5	アモルファス SiGe フォノンニック結晶ナノ構造の熱伝導 ○中川 純貴 ¹ , Jeremie Maire ² , 澤野 憲太郎 ³ , 野 村 政宏 ^{1,4,5} 1.東大生研, 2.LIMMS, 3.東京都市大総研, 4.ナノ量子機構, 5.JST さきがけ
15:15	20p-W323-6	フォノンニック結晶におけるネック効果による熱伝導率の低減 ○柳澤 亮人 ¹ , アスフリエフ ロマン ¹ , メール ジェレミ ¹ , 野村 政宏 ^{1,2,3} 1.東大生研, 2.ナノ量子機構, 3.JST さきがけ
15:30	奨 E 20p-W323-7	Thermal conduction control by thermal phononics and its mechanisms ○(PC)Jeremie Kevin Maire ^{1,2} , Roman Anufriev ¹ , Ryoto Yanagisawa ¹ , Sebastian Volz ⁴ , Masahiro Nomura ^{1,3,5} 1.IIS, Univ. of Tokyo, 2.LIMMS-CNRS/IIS, 3.Nanoquine, 4.EM2C CNRS, 5.JST PRESTO
15:45	20p-W323-8	Bi ナノワイヤーの磁場中における電気物性の解析 ○村田 正行 ¹ , 山本 淳 ¹ , 長谷川 靖洋 ² , 小峰 啓史 1.産総研, 2.埼玉大, 3.茨城大 ³
16:00	E 20p-W323-9	Thermoelectric Properties of Colloidal Quantum Dot Solids ○Satria Zulkarnaen Bisri ¹ , Maria Ibanez ^{2,3} , Maksym Kovalenko ^{2,3} , Yoshihiro Iwasa ^{1,4} 1.RIKEN-CEMS, 2.ETH Zurich, 3.EMPA, 4.Univ. Tokyo
16:15	休憩 / Break	
16:30	20p-W323-10	プラズモニクスと Ge-Sn 材料を融合した光熱発電システムの構築 ○小松 諒祐 ¹ , 西島 喜明 ¹ , Gediminas Seniutinas ² , Saulius Juodkazis ² 1.横国大院工, 2.スインバーン工科大
16:45	20p-W323-11	ZnO ナノ構造を用いたフレキシブル熱電材料の熱拡散率 ○和波 雅也 ¹ , セルバラジ シャンティ ¹ , 鈴木 悠平 ¹ , 1.静大院工, 2.マラヤ大 ベルスワミィ バンディヤラサン ¹ , ファイズ サレ ² , 下村 勝 ¹ , 村上 健司 ¹ , 池田 浩也 ¹
17:00	奨 E 20p-W323-12	エピタキシャル Ge ナノドット含有 Si 構造を用いた Si 系熱電材料の性能向上 ○(D) 山阪 司祐人 ¹ , 渡辺 健太郎 ^{1,2} , 澤野 憲太郎 ³ , 1.阪大院基礎工, 2.JST-CREST, 3.東京都市大総研 竹内 正太郎 ¹ , 酒井 朗 ¹ , 中村 芳明 ^{1,2}
17:15	奨 E 20p-W323-13	汎用性を向上した 2 ω 法による熱電薄膜の熱伝導率測定 ○奥畑 亮 ¹ , 渡辺 健太郎 ^{1,2} , 池内 賢朗 ³ , 石田 明広 ⁴ , 1.阪大基礎工, 2.JST-CREST, 3.アドバンス理工, 4.静岡大院工 中村 芳明 ^{1,2}
17:30	奨 E 20p-W323-14	Fabrication of ultrathin Ge-on-insulator by direct wafer-bonding ○(D)Manimuthu Veerappan ¹ , Arivanandhan Mukannan ¹ , Yasuhiro Hayakawa ¹ , Hiroya Ikeda ¹ 1.Shizuoka Univ.
CS.6 10.1, 10.2, 10.3 のコードシェアセッション「新規スピン操作方法および関連現象」		
/ 10.1/10.2/10.3 Code sharing session "Emerging control-methods of magnetization and related phenomena"		
3/22(Tue.) 9:00 - 12:00 口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場		
9:00	奨 E 22a-W241-1	Electric-field effect on domain structure in MgO/CoFeB/Ta ○Takaaki Dohi ¹ , Shun Kanai ^{1,2} , Atsushi Okada ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{4,1,2} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4} 1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
9:15	E 22a-W241-2	Large voltage-induced magnetic anisotropy change in Cr/ultrathin Fe/MgO/Fe magnetic tunnel junctions II ○Takayuki Nozaki ¹ , Anna Koziol-Rachwal ^{1,2} , Witold Skowronski ^{1,2} , Vadym Zayets ¹ , Yoichi Shiota ¹ , Shingo Tamaru ¹ , Hitoshi Kubota ¹ , Akio Fukushima ¹ , Shinji Yuasa ¹ , Yoshishige Suzuki ^{1,3} 1.AIST, 2.AGH Univ., 3.Osaka Univ.
9:30	E 22a-W241-3	Different effects between Al- and Zr-insertion on voltage control of PMA at CoFeB/oxide interface ○Ryusuke Oishi ¹ , Weidong Li ¹ , Koji Kita ¹ 1.the Univ. of Tokyo
9:45	22a-W241-4	希土類金属超薄膜における結晶磁気異方性の第一原理計算 ○(D) 名和 憲嗣 ¹ , 池浦 雄志 ¹ , 中村 浩次 ¹ , 秋山 亨 ¹ , 伊藤 智徳 ¹ , 小口 多美夫 ² 1.三重大院工, 2.阪大産研
10:00	奨 E 22a-W241-5	Laser-induced spin precessional dynamics in CoFeB/MgO/CoFeB magnetic tunnel junction under the electric field ○yuta sasaki ¹ , Kazuya Suzuki ² , Satoshi Iihama ¹ , Atsushi Sugihara ² , Yasuo Ando ¹ , Shigemi Mizukami ² 1.Tohoku Univ., 2.WPI-AIMR
10:15	奨 E 22a-W241-6	Fe MgO における界面ジャロシンスキー守谷相互作用の電圧変調 ○(DC) 縄岡 孝平 ¹ , 三輪 真嗣 ¹ , 塩田 陽一 ^{1,2} , 野崎 隆行 ² , 湯浅 新治 ² , 水落 憲和 ¹ , 鈴木 義茂 ¹ 1.阪大院基礎工, 2.産総研ナノスピン
10:30	休憩 / Break	
10:45	奨 E 22a-W241-7	Voltage modulation of interfacial spin direction at MnIr MgO with triple-Q spin state ○Minori Goto ¹ , Kohei Nawaoka ¹ , Shinji Miwa ¹ , Shohei Hatanaka ¹ , Norikazu Mizuochi ² , Yoshishige Suzuki ¹ 1.Osaka Univ., 2.Kyoto Univ.
11:00	E 22a-W241-8	Electric-Field-Induced X-ray Magnetic Circular Dichroism for Studying Perpendicularly Magnetized Ni/Cu Multilayers ○Jun Okabayashi ¹ , Tomoyasu Taniyama ² 1.Univ. of Tokyo, 2.Tokyo Tech.
11:15	22a-W241-9	SrTiO ₃ バックゲートを用いた Co 極薄膜の電界効果: 面方位依存性 ○中澤 新悟 ¹ , 大日方 絢 ² , 千葉 大地 ² , 上野 和紀 1.東大院総合, 2.東大院工 ¹

11:30	奨 E 22a-W241-10	Electrical control of magnetism in electric double layer capacitors with a Co electrode	○ Takamasa Hirai ¹ , Aya Obinata ¹ , Yuki Hibino ¹ , Tomohiro Koyama ¹ , Kazumoto Miwa ² , Shimpei Ono ² , Makoto Kohda ³ , Daichi Chiba ¹	1.The Univ. of Tokyo, 2.CRIEPI, 3.Tohoku Univ.
11:45	奨 E 22a-W241-11	Mechanical modulation of magnetic anisotropy in Pt/Co films deposited on a flexible substrate	○ Shinya Ota ¹ , Ryo Asai ¹ , Takahiro Kozeki ² , Hirokazu Akamine ² , Tatsuya Fujii ² , Takahiro Namazu ² , Taishi Takenobu ³ , Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.Univ. of Tokyo, 2.Univ. of Hyogo, 3.Waseda Univ.
3/22(Tue.) 13:15 - 14:15	口頭講演 (Oral Presentation) W241 会場			
13:15	奨 E 22p-W241-1	Spin-orbit torque induced magnetization switching in W/CoFeB/MgO	○ (D)Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGuptta ¹ , Hideo Sato ^{2,3} , Fumihiko Matsukura ^{1,2,4} , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
13:30	奨 E 22p-W241-2	Crystal Structure Dependence of Spin-Orbit Fields in Pt/Co/AIO Trilayer Structures	○ (M1)Minsik KONG ¹ , Hiromu Gamou ¹ , Makoto Kohda ¹ , Junsaku Nitta ¹	1.Tohoku Univ.
13:45	奨 E 22p-W241-3	Dot size dependence of magnetization switching by spin-orbit torque in antiferromagnet/ferromagnet structures	○ Aleksandr Kurenkov ¹ , Chaoliang Zhang ¹ , Shunsuke Fukami ^{2,3} , Samik DuttaGuptta ¹ , Hideo Ohno ^{1,2,3,4}	1.Laboratory for Nanoelectronics and Spintronics, RIEC, Tohoku Univ., 2.CSIS, Tohoku Univ., 3.CIES, Tohoku Univ., 4.WPI-AIMR, Tohoku Univ.
14:00	E 22p-W241-4	Determination of spin-orbit torque effective field from magnetic domain wall creep velocity	○ Tomohiro Koyama ¹ , Daichi Chiba ¹	1.The Univ. of Tokyo